



فصل ۱

مقدمه‌ای بر فیزیک الکترونیک

- ۱- مقاومت یک سیم مسی به قطر $\frac{\Omega}{\text{cm}} = \frac{1}{14} \times 10^{-3}$ برابر است. در صورتی که بدانیم چگالی الکترون‌های آزاد در مس $m^{-2} = 8 \times 10^{28}$ است و با فرض اینکه چگالی جریان برابر $10^6 \times 2$ باشد، مطلوبست محاسبه:
- الف) مقدار جریان
- ب) رسانایی ویژه سیم
- ج) سرعت حرکت الکترون‌های آزاد
- اده هل:

(الف) می‌دانیم که رابطه چگالی جریان (J) و جریان (I) الکتریکی به صورت زیر می‌باشد:

$$J = \frac{I}{A}, \quad A = \pi R^2, \quad 2R = 1/0^3 \Rightarrow R = \frac{1/0^3}{2} \text{ m.m}$$

$$\Rightarrow I = JA = 2 \times 10^6 \times \pi \times \left(\frac{1/0^3 \times 10^{-3}}{2} \right)^2 = 1/86 (\text{A})$$

(ب) با توجه به داده مسئله مقاومت این رشته سیم به طول یک سانتیمتر $10^{-4} \times 14 \times 2$ اهم خواهد بود و از طرفی برای مقاومت داریم:

$$R = \frac{\rho L}{A} \text{ یا } \sigma A \Rightarrow \sigma = \frac{L}{AR} = \frac{1(\text{cm})}{2/14 \times 10^{-4} \times \pi \times \left(\frac{1/0^3 \times 10^{-3}}{2} \right)^2} = 0.056 \times 10^6 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

$$J = (nq) \cdot v \Rightarrow v = \frac{J}{nq}$$

ج) طبق رابطه (۱ - ۲ کتاب) داریم:

$$\Rightarrow v = \frac{2 \times 10^6}{8/4 \times 10^{28} \times 1/6 \times 10^{-19}} = 1/488 \times 10^{-4} \left(\frac{m}{s} \right)$$

$$\sigma = nq\mu_e$$

د) طبق رابطه (۱ - ۳) خواهیم داشت:

$$n = 8/4 \times 10^{28} (m^{-3}) = 8/4 \times 10^{22} (cm^{-3})$$

$$\rightarrow \mu_e = \frac{\sigma}{nq} = \frac{0/56 \times 10^6}{8/4 \times 10^{22} \times 1/6 \times 10^{-19}} = 41/66 \left(\frac{cm^2}{v \cdot sec} \right)$$

۲ - ثابت کنید که تعداد الکترون‌های آزاد در یک متر مکعب یک فلز برابر است با:

$$n = \frac{dv}{AM} = \frac{A_0 \times 10^3 dv}{A}$$

که در آن d جرم حجمی ($\frac{kg}{m^3}$)، v ظرفیت (تعداد الکترون‌های آزاد در هر اتم)، A وزن اتمی (g)، M وزن یک اتم با وزن اتمی واحد (kg) و A_0 عدد آووگادرو است.

راه حل:

$$\text{تعداد مول} \times \text{ظرفیت} = n$$

اگر A عدد آووگادرو باشد خواهیم داشت:

$$\text{تعداد مول} \times A_0 \times \text{ظرفیت} =$$

$$\frac{\text{حجم} \times \text{چگالی}}{\text{وزن اتمی}} = \frac{\text{حجم}}{\text{وزن اتمی}} = \text{تعداد مول}$$

چون در صورت مسئله فرض شده است که حجم یک متر مکعب را در نظر بگیرید به جای حجم در رابطه فوق یک قرار می‌دهیم. بنابراین خواهیم داشت:

$$\text{تعداد مول} = \frac{d \times 1}{A}$$

$$\Rightarrow n = v \cdot A_0 \cdot \frac{d \times 1}{A \times 10^{-3} (gr)} = \frac{A_0 \times v d \times 10^3}{A (gr)}$$

همچنین می‌توان نوشت:

$$n = \frac{d \times \text{حجم کل}}{\text{حجم یک اتم فلز}} \times \text{ظرفیت} = \frac{d \times \text{حجم}}{\text{حجم یک اتم}} \times v$$

$$M \cdot A = (\text{وزن اتمی}) A \times (\text{وزن اتمی با وزن واحد}) M = \text{حجم یک اتم} \cdot \text{فلز}$$

$$\Rightarrow n = \frac{d \times 1 \times v}{MA} = \frac{dv}{MA}$$

۳- مقاومت یک میله از جنس سیلیکن به طول ۵ cm و سطح مقطع ۸ mm² را به دست آورید.
 (۱۵ حل)

برای سیلیکن $\mu_n = 1300$ و $\mu_p = 500$ باشد. بنابراین σ قابل محاسبه می‌باشد:

$$\sigma = q \times n_i (\mu_n + \mu_p)$$

$$\sigma = 1/6 \times 10^{-19} \times 1/5 \times 10^{10} (1300 + 500) = 4/32 \times 10^{-6} = \frac{1}{\rho}$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{1}{4/32 \times 10^{-6}} = 231/48 \times 10^3 \text{ } (\Omega\text{-cm})$$

با توجه به رابطه مقاومت $R = \frac{\rho L}{A}$ خواهیم داشت:

$$R = \frac{231/48 \times 5 \times 10^3}{8 \times 10^{-2} (\text{cm}^2)} = 14/46 \times 10^6 \Omega \text{ یا } 14/46 \text{ M}\Omega$$

۴- به یک قطعه نیمه هادی، هم ناخالصی نوع N و هم ناخالصی نوع P تزریق شده است. اگر چگالی ناخالصی‌ها به ترتیب برابر $2 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ و $N_D = 5 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ باشند، چگالی حفره‌ها (P) و چگالی الکترون‌های افزاد (n) را محاسبه نمایید. برای نیمه هادی مورد نظر چگالی خالص $3 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ باشد.

(۱۶ حل)

با توجه به رابطه (۱-۹) داریم:

$$P + N_D = n + N_A \quad (1)$$

$$\Rightarrow P + 2 \times 10^{12} = n + 5 \times 10^{11} \quad (1)$$

$$np = n_i^2 \Rightarrow np = (3 \times 10^{11})^2 = 9 \times 10^{22} \quad (2)$$

از حل معادله (۱) و (۲) خواهیم داشت:

$$p = n - 1/5 \times 10^{12} \Rightarrow n(n - 1/5 \times 10^{12}) = 9 \times 10^{22}$$

$$n^2 - 1/5 \times 10^{12} n - 9 \times 10^{22} = 0 \Rightarrow n = 15/57 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$$

$$p = (15/57 - 15) \times 10^{11} = 0/57 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$$

۵- چگالی حفره‌ها والکترون‌های افزاد را در دمای ۳۰۰°K برای بلورهای زیر محاسبه کنید:

الف) ژرمانیوم نوع P با مقاومت ویژه $0.2 \Omega\text{-cm}$

ب) سیلیکن نوع N با مقاومت ویژه $20 \Omega\text{-cm}$

راه حل:

$$\text{الف) می دانیم که } n = \frac{n_i^{\gamma}}{p} \text{ اگر } p \text{ را محاسبه کنیم مقدار } n \text{ به دست خواهد آمد. داریم:}$$

$$nq\mu_n + pq\mu_p = \sigma$$

چون در نیمه هادی نوع p ، p از n خیلی بزرگتر است بنابراین:

$$pq\mu_p \approx \sigma \Rightarrow p = \frac{\sigma}{q\mu_p} = \frac{\frac{1}{0.02}}{1/6 \times 10^{-19} \times 1800} = 1/74 \times 10^{17} (\text{cm}^{-3})$$

$$n = \frac{n_i^{\gamma}}{p} = \frac{(2/5 \times 10^{13})^{\gamma}}{1/74 \times 10^{17}} = 3/59 \times 10^9 (\text{cm}^{-3})$$

ب) در نیمه هادی نوع N ، n از p بزرگتر است بنابراین:

$$nq\mu_n \approx \sigma \Rightarrow n = \frac{\sigma}{q\mu_n} = \frac{\frac{1}{20}}{1/6 \times 10^{-19} \times 1300} = 2/4 \times 10^{14} (\text{cm}^{-3})$$

$$p = \frac{n_i^{\gamma}}{n} = \frac{(1/5 \times 10^{10})^{\gamma}}{2/4 \times 10^{14}} = 9/37 \times 10^5 (\text{cm}^{-3})$$

۶- چگالی حفره ها و الکترون های آزاد را برای یک نمونه سیلیکن با $\text{cm}^{-3} 10^{17}$ و $N_D = 1/874 \times 10^{13}$ به دست آورید.

راه حل:

در سیلیکن $n_i = 1/5 \times 10^{10}$ می باشد.

$$\text{در نیمه هادی نوع } N: P_n \cong \frac{n_i^{\gamma}}{N_D} = \frac{(1/5 \times 10^{10})^{\gamma}}{1/874 \times 10^{13}} = 1/2 \times 10^7 \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{در نیمه هادی نوع } P: n_p \cong \frac{n_i^{\gamma}}{N_A} = \frac{(1/5 \times 10^{10})^{\gamma}}{3/748 \times 10^{13}} = 6 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$$

۷- مقاومت ویژه ($\rho = \delta^{-1}$) سیلیکن خالص را در دمای $300^\circ K$ به دست آورید. در صورتی که با افزایش ناخالصی نوع N مقاومت ویژه تا حد $9/6 \Omega \cdot \text{cm}$ کاهش یابد، نسبت چگالی اتم های ناخالصی به اتم های سیلیکن را در واحد حجم محاسبه نمایید.

راه حل:

در یک بلور سیلیکن خالص هم حفره ها و هم الکترون ها در هدایت الکتریکی دخالت دارند بنابراین:

$$\sigma = q n_i (\mu_n + \mu_p) = 1/9 \times 10^{-19} \times 1/5 \times 10^{10} (1300 + 500) = 4/32 \times 10^{-16} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = 231/4 (\text{k}\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

اگر ناخالصی نوع N اضافه شود خواهیم داشت:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{9/6} = 0.14 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

از طرفی داریم:

$$P_n = \frac{n_i^r}{N_D} , \quad n_p \cong N_D , \quad \sigma = q \mu_n n_p + q \mu_p p_n$$

$$\sigma = q (1300 N_D + 500 \frac{n_i^r}{N_D}) = 0.14 \Rightarrow N_D = 5 \times 10^{14}$$

$$\frac{N_D}{n_i} = \frac{5 \times 10^{14}}{1/5 \times 10^{10}} = 3/34 \times 10^4 \approx 33400$$

۸- در یک بلور حاوی ناخالصی‌های نوع N و P، چگالی حفره‌ها 10^{10} برابر چگالی الکترون‌های آزاد است. در صورتی که برای این بلور $n_i = 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ باشد، چه مقدار ناخالصی نوع N در واحد حجم باید به آن اضافه نمود تا به بلور خالص تبدیل شود؟

(۱۵ حل:

$$p = 100 n , \quad np = n_i^r$$

$$100 n^2 = (10^{11})^2 \Rightarrow n = 10^{10} (\text{cm}^{-3})$$

با توجه به دو رابطه فوق داریم:

$$P = 10^{12} (\text{cm}^{-3})$$

برای اینکه بلور خالص شود باید اندازه p و n با هم برابر شوند بنابراین به مقدار $10^{10} - 10^{12}$ الکtron آزاد

باید به بلور اضافه شود $N_D = 99 \times 10^{10} (\text{cm}^{-3})$

تقریباً تعداد الکترون‌های آزاد باید همان 10^{12} باشد.

۹- به یک بلور نوع P آنقدر ناخالصی نوع N اضافه کردایم که به بلور خالص تبدیل شده است. اکنون اگر بخواهیم چگالی الکترون‌های آزاد را به 10^{10} برابر چگالی حفره‌ها برسانیم، چه مقدار ناخالصی نوع N در واحد حجم باید به آن اضافه کنیم. ($n_i = 10^{12} \text{ cm}^{-3}$)

(۱۶ حل:

$$n = 100 p \quad (1)$$

مشابه مسئله قبل داریم:

$$np = n_i^{\gamma} = 10^{24} \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow p = 10^{11} \text{ cm}^{-3} \Rightarrow n = 100p = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D \approx 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

در نتیجه مقدار الکترون‌های آزاد N_D باید برابر با n باشد یعنی:

۱۰- در یک قطعه بلور چگالی حفره‌ها ۵ برابر چگالی الکترون‌های آزاد است. اگر با تزریق ناخالصی مناسب به این بلور، چگالی الکترون‌های آزاد را تا ۳ برابر چگالی حفره‌ها افزایش دهیم، مقاومت ویژه بلور با چه نسبتی تغییر می‌کند؟ (فرض کنید $(\mu_n = 3\mu_p)$)

(ا) هل:

در حالت اول $P = 5n$ می‌باشد پس خواهیم داشت:

$$\sigma_1 = nq\mu_n + pq\mu_p = q(3\mu_p n + p\mu_p) = q\mu_p(3n + p) = \lambda q\mu_p n$$

در حالت دوم $n = 3p$

$$\sigma_2 = q\mu_p(3n + \frac{n}{3}) = q\mu_p n \cdot \frac{10}{3}$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{q\mu_p n \times \lambda}{q\mu_p \cdot n \times \frac{10}{3}} = 2/4$$

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12} = 0.416$$

۱۱- در یک نمونه ژرمانیوم چگالی ناخالصی نوع N برابر 10^{12} cm^{-3} و چگالی ناخالصی P برابر 10^{13} cm^{-3} است. در دمای معمولی، مقاومت ویژه ژرمانیوم خالص برابر $60 \Omega \cdot \text{cm}$ است. در صورتی که چگالی جریان هدایت کل برابر $\frac{52}{3} \frac{\text{mA}}{\text{cm}^2}$ باشد، شدت میدان الکتریکی اعمال شده چقدر است؟

(ا) هل:

برای ژرمانیوم خالص می‌توان نوشت:

$$\delta = q \cdot n_i (\mu_n + \mu_p) \Rightarrow \delta = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{6} = n_i \times 1/6 \times 10^{-19} \times (3800 + 1800)$$

$$\Rightarrow n_i = 1/85 \times 10^{13}$$

در نیمه هادی فوق 10^{13} cm^{-3} و $N_A = 7 \times 10^{14}$ می‌باشد. پس داریم:

$$n \cdot p = n_i^{\gamma}, \quad n + N_A = P + N_D$$

$$\begin{cases} n \cdot p = (1/85 \times 10^{13})^2 \\ n + V \times 10^{13} = p + 10^{14} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 3/88 \times 10^{13} \\ p = 0/88 \times 10^{13} \end{cases}$$

حال برای ژرمانیوم ناخالص با توجه به مقادیر به دست آمده داریم:

$$\sigma = n q \mu_n + p q \mu_p = q(n \mu_n + p \mu_p) = 1/6 \times 10^{-19} (3/88 \times 10^{13} \times 3800 + 0/88 \times 10^{13} \times 1800) \Rightarrow \sigma = 261/5 \times 10^{-4}$$

$$J = \sigma E \Rightarrow E = \frac{J}{\sigma} = \frac{52/3 \times 10^4}{261/5} = 2(\frac{V}{cm})$$

- ۱۲- یک قطعه بلور نوع P با $6 \times 10^{12} cm^{-3}$ در اختیار داریم. به این بلور به طور یکنواخت مقداری فسفر اضافه می‌کنیم. چگالی اتم‌های فسفر را برای هر یک از حالت‌های زیر تعیین کنید:
 الف) چگالی الکترون‌های افزوده در بلور حاصل 10^6 برابر چگالی حفره‌ها شود

$$(n_i = 2/5 \times 10^{11} cm^{-3})$$

- ب) مقاومت ویژه بلور حاصل k برابر بلور اولیه شود. (فرض کنید $\frac{\mu_n}{\mu_p} = b$ ، جواب را به صورت پارامتری بیان کنید و در صورت امکان در مورد مقادیر مناسب k بحث کنید).

راه حل:

الف) فرض مسئله $n = 10^6 p$

$$10^3 n_i + N_A = 10^3 p \rightarrow (10^6 p) \times p = n_i^2 \rightarrow 10^3 p = n_i \rightarrow p = \frac{n_i}{10^3} \quad (I)$$

$$n = 10^6 p = 10^6 \times \frac{n_i}{10^3} = 10^3 n_i \quad (II)$$

$$10^3 n_i + N_A = p + N_D \quad (III)$$

روابط (I) و (II) را در رابطه (III) قرار می‌دهیم:

$$10^3 n_i + N_A = \frac{n_i}{10^3} + N_D$$

$$10^3 n_i : \text{داریم} \quad n_i = 2/5 \times 10^{11} cm^{-3} \quad N_A = 6 \times 10^{12} cm^{-3} \quad N_D = ?$$

$$\rightarrow 10^3 \times 2/5 \times 10^{11} + 6 \times 10^{12} = \frac{2/5 \times 10^{11}}{10^3} + N_D \rightarrow 8/5 \times 10^{14} = 2/5 \times 10^8 + N_D$$

$$\rightarrow N_D = 8/5 \times 10^{14} - 2/5 \times 10^8 \simeq 8/5 \times 10^{14} cm^{-3}$$

ب) قبل از اضافه کردن فسفر مقاومت ویژه بلور به صورت زیر می‌باشد:

$$\rho_1 = \frac{1}{\delta_1} = \frac{1}{n_1 q \mu_n + p_1 q \mu_p} \quad (I')$$

$n_1 + N_{A_1} = P_1 + N_{D_1}$: از طرفی

قبل از اضافه کردن فسفر $N_{D_1} = n_1 \ll N_{A_1}$ می‌باشد و همچنین n_1 می‌باشد پس داریم:

$$P_1 = N_{A_1} = 6 \times 10^{12}$$

$$(I') \Rightarrow n_1 = \frac{(2/5 \times 10^{11})^2}{(6 \times 10^{12})} = 1/0.4 \times 10^8$$

$$(I') \Rightarrow \rho_1 = \frac{1}{\delta_1} = \frac{1}{q(1/0.4 \times 10^8 \mu_n + 6 \times 10^{12} \mu_p)} \approx \frac{1}{q \times 6 \mu_p \times 10^{12}}$$

در حالت دوم با اضافه کردن فسفر مقاومت ویژه به صورت زیر می‌باشد:

$$\rho_\gamma = \frac{1}{\delta_\gamma} = \frac{1}{q(n_\gamma \mu_n + p_\gamma \mu_p)} = k \rho_1 \rightarrow \frac{1}{q(n_\gamma \mu_n + p_\gamma \mu_p)} = k \times \frac{1}{6q \mu_p \times 10^{12}} \quad (II')$$

$$n_\gamma p_\gamma = n_i^\gamma \rightarrow p_\gamma = \frac{n_i^\gamma}{n_\gamma} \quad \mu_n = b \mu_p \quad \text{فرض مسئله}$$

$$(II') \Rightarrow \frac{1}{n_\gamma \mu_n + \frac{n_i^\gamma}{n_\gamma} \mu_p} = k \times \frac{1}{6 \mu_p \times 10^{12}} \rightarrow \frac{n_\gamma}{n_\gamma \times b + (2/5 \times 10^{11})^\gamma} = k \times \frac{1}{6 \times 10^{12}}$$

$$\rightarrow ab n_i^\gamma - n_\gamma + 6/25 \times 10^{22} a = 0 \rightarrow n_\gamma = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 25 \times 10^{22} a^2 b}}{2ab}$$

$$p_\gamma = \frac{n_i^\gamma}{n_\gamma} = \frac{6/25 \times 10^{22}}{\frac{1 \pm \sqrt{1 - 25 \times 10^{22} a^2 b}}{2ab}} = \frac{6/25 \times 10^{22} \times 2ab}{1 \pm \sqrt{1 - 25 \times 10^{22} a^2 b}}$$

$$n_\gamma + N_{A_\gamma} = P_\gamma + N_{D_\gamma} \quad \text{داریم}$$

$$\rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{1 - 25 \times 10^{22} a^2 b}}{2ab} + N_{A_\gamma} = \frac{6/25 \times 10^{22} \times 2ab}{1 \pm \sqrt{1 - 25 \times 10^{22} a^2 b}} + N_{D_\gamma}$$

$$\rightarrow N_{D_\gamma} = \frac{1 + 1 - 25 \times 10^{22} a^2 b \pm 2\sqrt{1 - 25 \times 10^{22} a^2 b} - (6/25 \times 10^{22} \times 2ab) \times 2ab}{2ab(1 \pm \sqrt{1 - 25 \times 10^{22} a^2 b})} + N_{A_\gamma}$$

$$N_{A_1} = N_{A_\gamma} = 6 \times 10^{12}$$

$$\rightarrow N_{D_r} = \frac{2 - 25 \times 10^{12} a^2 b (1+b) \pm 2 \sqrt{1 - 25 \times 10^{12} a^2 b}}{2ab (1 \pm \sqrt{1 - 25 \times 10^{12} a^2 b})} + 6 \times 10^{14}$$

$$\rightarrow N_{D_r} = \frac{2(1 \pm \sqrt{1 - 25 \times 10^{12} a^2 b}) - 2/5 \times 10^{12} a^2 b (1+b)}{2ab (1 \pm \sqrt{1 - 25 \times 10^{12} a^2 b})} + 6 \times 10^{14}$$

$$\rightarrow N_{D_r} = \frac{1}{ab} - \frac{12/5 \times 10^{12} a \times (1+b)}{(1 \pm \sqrt{1 - 25 \times 10^{12} a^2 b})} + 6 \times 10^{14}$$

از طرفی $a = \frac{k}{6 \times 10^{14}}$

$$\Rightarrow N_{D_r} = \frac{6 \times 10^{14}}{kb} - \frac{20/83 \times 10^7 k \times (1+b)}{1 \pm \sqrt{1 - 0/694 \times 10^{-6} k^2 b}} + 6 \times 10^{14}$$

از آنجایی که N_{D_r} باید عدد مثبتی باشد پس باید داشته باشیم:

$$\frac{6 \times 10^{14}}{kb} + 6 \times 10^{14} > \frac{20/83 \times 10^7 k (1+b)}{1 \pm \sqrt{1 - 0/694 \times 10^{-6} k^2 b}}$$

$$\rightarrow (1 \pm \sqrt{1 - 0/694 \times 10^{-6} k^2 b}) (1+kb) > \frac{20/83 \times 10^7 k^2 b (1+b)}{6 \times 10^{14}}$$

$$\rightarrow (1 \pm \sqrt{1 - 0/694 \times 10^{-6} k^2 b}) (1+kb) > 3/47 \times 10^{-7} \times k^2 b (1+b)$$

$$1 - 0/694 \times 10^{-6} k^2 b > 0 \rightarrow k^2 b < \frac{10^6}{0/694} = 1/44 \times 10^6$$

۱۳- به یک قطعه نیمه هادی از جنس ژرمانیم در دمای معمولی، اتم‌های ناخالصی پذیرنده اضافه شده است. اگر مقاومت کل که دارای طول یک سانتیمتر و سطح مقطع 20 میلیمتر مربع است برابر 40 آمپر باشد.

الف) میزان چگالی ناخالصی (N_A) اضافه شده به قطعه را به دست آورید.

ب) اگر به همین قطعه علاوه بر ناخالصی پذیرنده بند (الف) ناخالصی بخششده نیز با چگالی اضافه شود، مقدار مقاومت جدید قطعه را به دست آورید.

$$N_D = 3 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

(راه حل:

$$\text{الف) با توجه به رابطه } R = \frac{L}{\sigma A} \text{ خواهیم داشت:}$$

$$\sigma = \frac{L}{R \cdot A} = \frac{1}{4.0 \times 2.0 \times 10^{-2}} = 0.125 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

$$N_A = \frac{\sigma}{q \mu_p} = \frac{0.125}{1.6 \times 10^{-19} \times 1800} = 4.34 \times 10^{14}$$

ب) مانند مسائل قبل:

$$\begin{cases} np = (n_i)^2 \Rightarrow np = 2/5 \times 10^{13} \\ n + N_A = p + N_D \quad n + 4.34 \times 10^{14} = p + 3 \times 10^{13} \end{cases}$$

از حل دو معادله فوق مقادیر n و p به صورت زیر به دست می‌آیند و با داشتن این دو مقدار می‌توان هدایت ویژه جدید را محاسبه نمود.

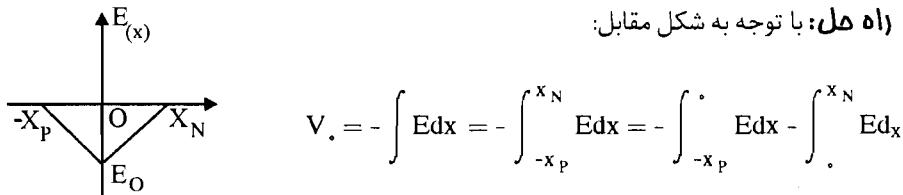
$$n = 0.18 \times 10^{13}, \quad p = 13/8 \times 10^{13}$$

$$\begin{aligned} \sigma &= n q \mu_n + p q \mu_p = q(n \mu_n + p \mu_p) = 1.6 \times 10^{-19} (0.18 \times 3800 + 13/8 \times 1800) \times 10^{+13} \\ &\Rightarrow \sigma = 39.8 / 53 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

$$R = \frac{L}{\sigma \cdot A} = \frac{1}{39.8 / 53 \times 10^{-4} \times 2.0 \times 10^{-2}} = 125 / 5 \Omega$$

۱۴- روابط ۲۷ و ۲۸- متن کتاب را اثبات کنید.

(راه حل: با توجه به شکل مقابل:



$$V_{\bullet} = - \int E dx = - \int_{-x_p}^{x_N} E dx = - \int_{-x_p}^0 E dx - \int_0^{x_N} E dx$$

با توجه به رابطه (۱- ۲۳) و (۱- ۲۴) کتاب و شکل بالا می‌توان معادله خط را به صورت دو ضابطه‌ای نوشت:

$$E(x) = \begin{cases} \frac{E_{\bullet}}{x_p} x + E_{\bullet} & ; \quad -x_p < x < 0 \\ -\frac{E_{\bullet}}{x_N} x + E_{\bullet} & ; \quad 0 < x < x_N \end{cases} = \begin{cases} \frac{-qN_A}{\epsilon} x - \frac{qN_A x_p}{\epsilon} & ; \quad -x_p < x < 0 \\ +\frac{qN_D}{\epsilon} x - \frac{qN_D x_N}{\epsilon} & ; \quad 0 < x < x_N \end{cases}$$

از طرفی داریم:

$$(a) \quad x_N = \frac{N_A}{N_D} x_P \quad \leftarrow \quad N_A x_P = N_D x_N$$

$$V_s = - \int_{-x_P}^0 \left(-\frac{qN_A}{\epsilon} x - \frac{qN_A x_P}{\epsilon} \right) dx - \int_0^{x_N} \left(+\frac{qN_D}{\epsilon} x - \frac{qN_D x_N}{\epsilon} \right) dx$$

$$V_s = -\frac{qN_A}{\gamma \epsilon} x_P^\gamma + \frac{qN_A}{\epsilon} x_P^\gamma - \frac{qN_D}{\epsilon} + \frac{qN_D}{\epsilon} x_N^\gamma = \frac{1}{\gamma} \frac{qN_A}{\epsilon} x_P^\gamma + \frac{qN_D}{\gamma \epsilon} \left(\frac{N_A}{N_D} x_P \right)^\gamma \quad (b)$$

$$V_s = x_P^\gamma \cdot \frac{qN_A}{\gamma \epsilon} \left(1 + \frac{N_A}{N_D} \right) \Rightarrow x_P = \left[\frac{\gamma \epsilon V_s}{qN_A \left(1 + \frac{N_A}{N_D} \right)} \right]^{\frac{1}{\gamma}} \quad \text{رابطه (۲۷-۱)}$$

اگر در رابطه (b) به جای x_P معادل آن را از رابطه (a) قرار دهیم خواهیم داشت:

$$V_s = \frac{1}{\gamma \epsilon} qN_D \left(1 + \frac{N_D}{N_A} \right) \cdot x_N^\gamma \Rightarrow x_N = \left[\frac{\gamma \epsilon V_s}{qN_D \left(1 + \frac{N_D}{N_A} \right)} \right]^{\frac{1}{\gamma}} \quad \text{رابطه (۲۸-۱)}$$

۱۵- دو قطعه بلور سیلیکن در دمای معمولی، یکی از نوع $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ با و دیگری از نوع P با $N_A = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ موجودند.

الف) چگالی حامل‌های اقلیت و اکتریت را در هر یک از این قطعه‌ها محاسبه نمایید.

ب) در صورتی که این قطعه دارای سطح مقطع یکسان باشند، اختلاف پتانسیل تماس ناشی از پیوند آنها چه مقدار خواهد بود؟

ج) عرض ناحیه تهی و پیشرفتگی آن در هر ناحیه محاسبه نمایید.

۱۵ هل:

الف) در دمای معمولی برای سیلیکن $10^{\circ} \times 1/5 \times n_i = 10^{\circ}$ می‌باشد.

$$P_N \approx \frac{n_i^\gamma}{N_D} = \frac{(1/5 \times 10^{\circ})^\gamma}{10^{16}} = 2/25 \times 10^4 (\text{cm}^{-3}) \quad \text{برای نیمه هادی نوع N : } N$$

$$n_P \approx \frac{n_i^\gamma}{N_A} = \frac{(1/5 \times 10^{\circ})^\gamma}{10^{14}} = 2/25 \times 10^6 (\text{cm}^{-3}) \quad \text{برای نیمه هادی نوع P : } P$$

ب) می دانیم $V_0 = V_T L_n \frac{N_A \cdot N_D}{(n_i)^2}$ و $V_T = 26 \text{ mV}$ در نتیجه داریم:

$$V_0 = 26 \times 10^{-3} \times L_n \frac{10^{14} \times 10^{16}}{(1/5 \times 10^{19})^2} = 0.38 \text{ V} (V_0 \text{H})$$

$$W = x_p + x_n = \left[\frac{\gamma \epsilon V_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \text{ و } \epsilon_r = 12 \quad (ج)$$

$$= \left[\frac{2 \times 8 / 804 \times 10^{-12} \times 12 \times 0.38}{1/6 \times 10^{-19}} \times \left(\frac{1}{10^{14}} + \frac{1}{10^{16}} \right) \right]^{\frac{1}{2}} =$$

$$= 2/27 \text{ mm}$$

$$x_p = \left[\frac{\gamma \epsilon V_0}{q N_A (1 + \frac{N_A}{N_D})} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{2 \times 8 / 804 \times 10^{-12} \times 12 \times 0.38}{1/6 \times 10^{-19} \times 10^{14} \left(1 + \frac{1/14}{10^{16}} \right)} \right]^{\frac{1}{2}} = 2/25 \text{ mm}$$

$$x_n = W - x_p = 2/27 - 2/25 = 0.02 \text{ mm}$$

۱۶- در یک پویند P-N، $P = N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ و $N_D = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ است. این پیوند را در دمای معمولی به یک ولتاژ خارجی ۵ ولتی به صورت بایاس معکوس وصل می کنیم

$$(n_i = 1/5 \times 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}})$$

(الف) پیشرفتگی ناحیه تهی را در هر قسمت به دست آورید.

(ب) عرض ناحیه تهی (W) چقدر می شود.

راه حل:

(الف)

$$x_p = \left[\frac{\gamma \epsilon V_j}{q N_A (1 + \frac{N_A}{N_D})} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_j = V_0 + V_d = V_0 + V_T L_n \frac{N_A N_D}{n_i^2} = 0 + 26 \times 10^{-3} L_n \frac{10^{17} \times 10^{13}}{(1/5 \times 10^{-12})^2} = 0 + 0.218 = 0.218$$

بر حسب $\frac{F}{m}$ داده شده آن را بر حسب $\frac{F}{cm}$ می‌نویسیم:

$$\varepsilon = 1/1 \times 10^{-14} \frac{F}{cm}$$

$$x_p = \left[\frac{2 \times 1/1 \times 10^{-14} \times 5/218}{1/6 \times 10^{-19} \times 10^{17} \left[1 + \frac{10^{17}}{10^{12}} \right]} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{11/5 \times 10^{-14}}{1600/6 \times 10^{-2}} \right]^{\frac{1}{2}} = 2/68 \times 10^{-8} cm$$

$$x_N = \left[\frac{2 \times 1/1 \times 10^{-14} \times 5/218}{1/6 \times 10^{-19} \times 10^{13} \left[1 + \frac{10^{13}}{10^{17}} \right]} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{11/5 \times 10^{-14}}{1/600 \times 16 \times 10^{-6}} \right]^{\frac{1}{2}} = 2/68 \times 10^{-4} cm$$

$$W = x_N + x_p = 2/68 \times 10^{-8} + 2/68 \times 10^{-4} = 2/68 \times 10^{-4} cm \quad (b)$$

۱۷- در یک پیوند P-N از جنس سیلیکن، $cm^{-3} N_D = 3 \times 10^{16}$ است.

الف) N_A را طوری تعیین کنید که اختلاف پتانسیل تماس ϕ در دمای معمولی برابر $7^\circ C$ ولت شود

$$(n_i = 2/5 \times 10^{10} cm^{-3})$$

ب) عرض ناحیه تهی (W) و پیشرفتگی آن در هر قسمت را به دست آورید.

(ا) هل:

$$(f) N_D = 3 \times 10^{16} (cm^{-3}), N_A = ?$$

$$V_0 = V_T L_n \frac{N_A N_D}{n_i^2} \Rightarrow \phi/V = 26 \times 10^{-3} L_n \frac{3 \times 10^{16} \times N_A}{(2/5 \times 10^{10})^2}$$

$$\Rightarrow e^{\phi/V} = \frac{3 \times 10^{16} \times N_A}{(2/5 \times 10^{10})^2} \Rightarrow N_A = 1/26 \times 10^{16} (cm^{-3})$$

$$\epsilon_r \cong 12 \quad (b)$$

$$W = \left[\frac{\gamma \epsilon V_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{2 \times 12 \times \epsilon_0 \times \phi/V}{1/6 \times 10^{-19}} \left(\frac{10^{-16}}{1/26} + \frac{10^{-16}}{3} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$W = 0.348 \mu m$$

$$x_p = \left[\frac{\gamma \epsilon + \epsilon_0 V_0}{q N_D \left(1 + \frac{N_D}{N_A} \right)} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{2 \times 12 \times 8/804 \times 10^{-12} \times \phi/V}{1/6 \times 10^{-19} \times 3 \times 10^{16} \left(1 + \frac{3}{1/26} \right)} \right]^{\frac{1}{2}} = 0.09 \mu m$$

$$x_N = W - x_p = 0.348 - 0.09 = 0.258 \mu m$$

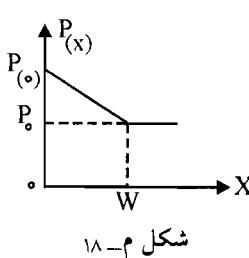
۱۸- تغییرات چگالی حفره‌ها در یک نمونه هادی مطابق شکل م - ۱۸ است.

(الف) در صورتی که هیچ گونه میدان الکتریکی خارجی اعمال نشود، عبارت چگالی جریان (J_p) را به دست آورده و آن را رسم نمایید.

(ب) شدت میدان الکتریکی داخلی (E) که باید وجود داشته باشد تا توزیع حفره نشان داده شده در شکل منجر به هیچ گونه جریان انتشاری حفره نشود را به دست آورید.

(ج) با فرض $10^3 = \frac{p}{p_0}$ ، اختلاف پتانسیل بین نقاط $x = 0$ و $x = W$ را محاسبه کنید.

راه حل:

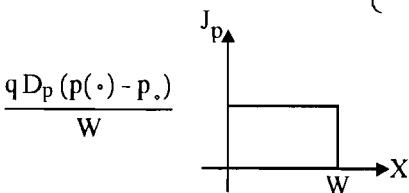


$$P(x) = \begin{cases} -\frac{(p(0) - p_0)}{W}x + p(0) & ; \quad 0 < x < W \\ p_0 & ; \quad x > W \end{cases} \quad (\text{الف})$$

$$J_p = -q D_p \frac{dp(x)}{dx} = -q D_p \frac{(p_0 - p(0))}{W}$$

$$J_p = \begin{cases} 0 & ; \quad x > W \\ \frac{q \cdot D_p (p_0 - p(0))}{W} & ; \quad x < W \end{cases}$$

$$\text{ب) با فرض } \frac{p(0) - p_0}{W} \triangleq M$$



$$\text{و با استفاده از رابطه } E(x) = \frac{V_T}{p(x)} \cdot \frac{dp(x)}{dx} \text{ خواهیم داشت:}$$

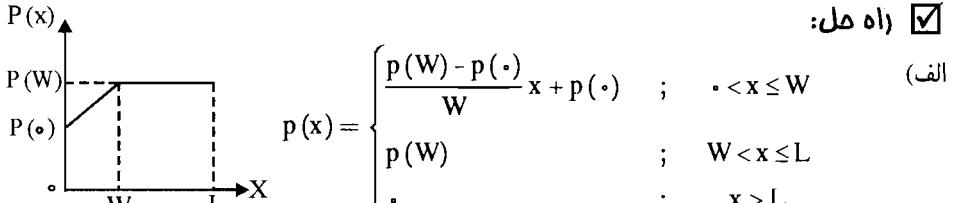
$$E(x) = \frac{V_T \cdot (-M)}{-Mx + p(0)} = \begin{cases} \frac{MV_T}{Mx - p(0)} & ; \quad x < W \\ 0 & ; \quad x > W \end{cases}$$

$$V_0 = V_T L_N \frac{p(0)}{p_0} = 26 \times 10^{-3} \times L_N \times 10^3 = 179/6 \text{ mv} \quad (\text{ج})$$

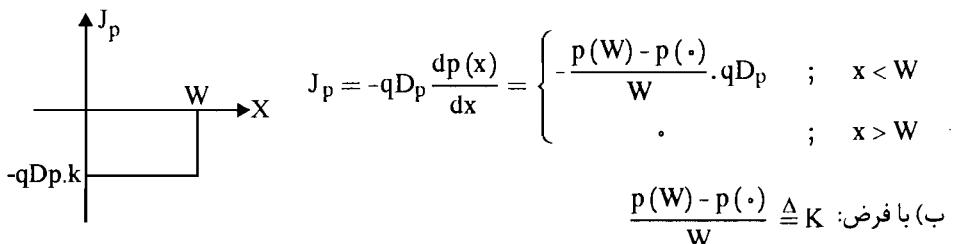
۱۹- در یک قطعه بلور نیمه هادی توزیع چگالی حفره‌ها مطابق شکل م - ۱۹ است.

(الف) در صورتی که هیچ میدان خارجی اعمال نشود چگالی جریان انتشاری حفره‌ها را به دست آورده (به صورت پارامتری) و ترسیم نمایید.

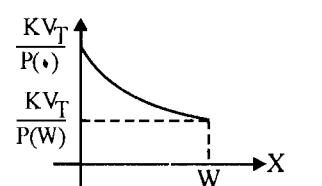
- ب) چه میدان الکتریکی داخلی به وجود می‌آید. عبارت آن را به دست اورده و ترسیم نمایید.
 ج) اگر $p(W)/p(0) = 10^{14}$ باشد، اختلاف پتانسیل بین نقاط $x=0$ و $x=L$ چقدر است؟



شکل ۱۹

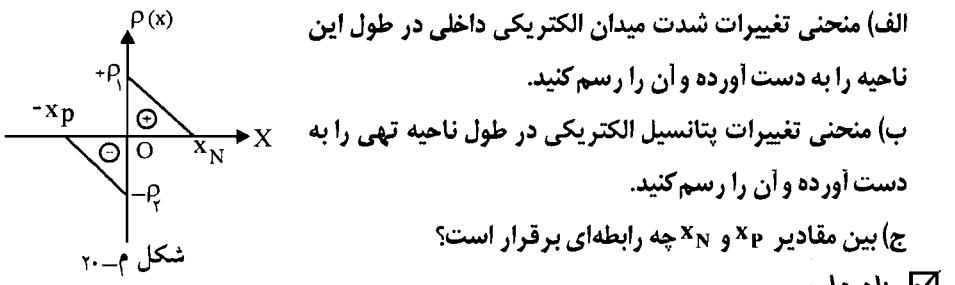


$$E(x) = \frac{V_T}{p(x)} \cdot \frac{dp(x)}{dx} = \begin{cases} \frac{KV_T}{Kx + p(0)} & ; \quad x < W \\ 0 & ; \quad x > W \end{cases}$$



$$V_0 = V_T L_n \frac{p(W)}{p(0)} = 26 \times 10^{-3} L_n 10^4 = 239/46 (\text{mv})$$

۲۰- منحنی تغییرات چگالی بار الکتریکی در ناحیه تهی یک پیوند P-N در شکل م-۲۰ آمده است.



$$\frac{dv}{dx} = -\frac{\rho}{\epsilon} \rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dv}{dx} \right) = -\frac{\rho}{\epsilon} \rightarrow \frac{d}{dx} (-E) = -\frac{\rho}{\epsilon} \rightarrow$$

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon} \rightarrow dE = \frac{\rho}{\epsilon} dx \rightarrow \int dE = \int \frac{\rho}{\epsilon} dx \quad (I)$$

اما تغییرات چگالی بار طبق شکل م - ۲۰ به صورت زیر می باشد:

$$-x_p < x < 0 \Rightarrow \frac{\rho - (-\rho_2)}{x - 0} = -\frac{\rho_2}{x_p} \rightarrow \rho = -\left(\frac{\rho_2}{x_p}\right)x - \rho_2$$

$$\rightarrow \rho = -\rho_2 \left(1 + \frac{x}{x_p}\right)$$

$$0 < x < x_N \Rightarrow \frac{\rho - \rho_1}{x - 0} = -\frac{\rho_1}{x_N} \rightarrow \rho = \left(\frac{\rho_1}{x_N}\right)x + \rho_1 \left(1 - \frac{x}{x_N}\right)$$

حال تغییرات ρ در فاصله $0 < x < -x_p$ را در رابطه با I قرار می دهیم:

$$E(x) - E(-x_p) = \int_{-x_p}^{x} \frac{-\rho_2}{\varepsilon} \left(\frac{x}{x_p} + 1\right) dx \Rightarrow E(x) = \left[\frac{-\rho_2}{\varepsilon} \left(x + \frac{x^2}{2x_p}\right) \right]_{-x_p}^x$$

$$= -\frac{\rho_2}{\varepsilon} \left(x + \frac{x^2}{2x_p}\right) - \frac{\rho_2}{2\varepsilon} x_p$$

$$x = 0 \rightarrow E(x = 0) = -\frac{\rho_2}{2\varepsilon} x_p$$

$$0 < x < x_N \Rightarrow E(x) - E(x = 0) = \int_0^x \frac{\rho_1}{\varepsilon} \left(1 - \frac{x}{x_N}\right) dx \rightarrow E(x) + \frac{\rho_1}{2\varepsilon} x_p = \frac{\rho_1}{\varepsilon} \left(x - \frac{x^2}{2x_N}\right)$$

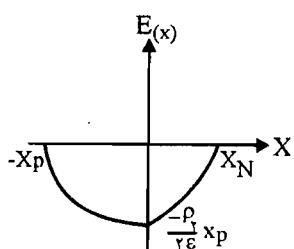
$$\rightarrow E(x) = \frac{\rho_1}{2\varepsilon} \left(x - \frac{x^2}{2x_N}\right) - \frac{\rho_1}{2\varepsilon} x_p$$

$$x = x_N \Rightarrow E(x_N) = \frac{\rho_1}{\varepsilon} \left(x_N - \frac{x_N^2}{2x_N}\right) - \frac{\rho_1}{2\varepsilon} x_p$$

$$\Rightarrow E(x_N) = \frac{\rho_1}{2\varepsilon} x_N - \frac{\rho_1}{2\varepsilon} x_p$$

شکل را با فرض $x = x_p = \rho_1 x_N = \rho_2 x_N$ رسم می کنیم یعنی در $x = x_N$ داریم $E(x = 0)$ و همچنین داریم

$$E(x = 0) = -\frac{\rho_2}{2\varepsilon} x_p$$



ب) داریم: $E = -\frac{dv}{dx}$: برای $-x_p < x < 0$ در E تغییرات نداشتیم پس ثابت می باشد که این مقدار برابر صفر

می باشد چون در این قسمت هیچ باری نداریم و همچنین هیچ تغییرات باری نداریم.

$$x < -x_p \Rightarrow v = 0$$

$$-x_p < x < 0 \Rightarrow \frac{dv}{dx} = -E(x)$$

مقدار $E(x)$ را از قسمت الف داریم و آن را در رابطه بالا جایگزین می کنیم:

$$E(x) = -\frac{\rho_1}{\epsilon} \left(x + \frac{x^r}{\gamma x_p} \right) - \frac{\rho_1}{\gamma \epsilon} x_p$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} = \frac{\rho_1}{\epsilon} \left(x + \frac{x^r}{\gamma x_p} \right) + \frac{\rho_1}{\gamma \epsilon} x_p \Rightarrow$$

$$\int_{v(-x_p)}^{v(x)} \frac{dv}{dx} = \int_{-x_p}^x \left(\frac{\rho_1}{\epsilon} \left(x + \frac{x^r}{\gamma x_p} \right) + \frac{\rho_1}{\gamma \epsilon} x_p \right) dx$$

$$\Rightarrow v(x) - v(-x_p) = \left(\frac{\rho_1}{\epsilon} \left(\frac{x^r}{\gamma} + \frac{x^r}{\gamma x_p} \right) + \frac{\rho_1}{\gamma \epsilon} x_p \times x \right) \Big|_{-x_p}^x$$

$$\Rightarrow v(x) - v(-x_p) = \left(\frac{\rho_1}{\epsilon} \left(\frac{x^r}{\gamma} + \frac{x^r}{\gamma x_p} \right) \right) = \frac{\rho_1}{\gamma \epsilon} x_p x \Big|_{-x_p}^x$$

$$v(x) = \frac{\rho_1 x^r}{\gamma \epsilon} \left(1 + \frac{x}{\gamma x_p} \right) + \frac{\rho_1 x_p x}{\gamma \epsilon} + \frac{1}{\epsilon} \frac{\rho_1 x_p^r}{\gamma}$$

$$x = 0 \Rightarrow v(0) = \frac{1}{\epsilon} \frac{\rho_1 x_p^r}{\gamma}$$

$$E(x) = \frac{\rho_1}{\epsilon} \left(x - \frac{x^r}{\gamma x_N} \right) - \frac{\rho_1}{\gamma \epsilon} x_p$$

: $0 < x < x_N$ در

$$0 < x < x_N \Rightarrow \int_{v(x=0)}^{v(x)} \frac{dv}{dx} = \int_{0}^x -\frac{\rho_1}{\epsilon} \left(x - \frac{x^r}{\gamma x_N} \right) + \frac{\rho_1}{\gamma \epsilon} x_p dx$$

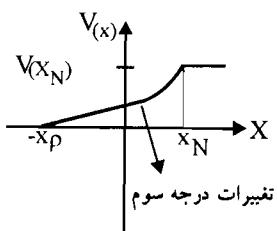
$$\Rightarrow v(x) - v(x=0) = \left(-\frac{\rho_1}{\epsilon} \left(\frac{x^r}{\gamma} - \frac{x^r}{\gamma x_N} \right) + \frac{\rho_1}{\gamma \epsilon} x_p \right) \Big|_0^x$$

$$\Rightarrow v(x=0) = \frac{1}{\epsilon} \frac{\rho_1 x_p^r}{\gamma}$$

به دست آوردهیم:

$$\Rightarrow v(x) = \frac{-\rho_1}{\epsilon} \left(\frac{x^r}{\gamma} - \frac{x^r}{\gamma x_N} \right) + \frac{\rho_1}{\gamma \epsilon} x_p x + \frac{1}{\epsilon} \frac{\rho_1 x_p^r}{\gamma}$$

$$\Rightarrow v(x=x_N) = -\frac{1}{\epsilon} \frac{\rho_1}{\gamma} x_N^r + \frac{\rho_1}{\gamma \epsilon} x_N x_p + \frac{1}{\epsilon} \frac{\rho_1 x_p^r}{\gamma}$$



در $x_N > x_p$ فرض می‌کنیم $\rho_1 x_N = \rho_2 x_p$ و لذا $v(x) = E(x) = 0$ باشد. \leftarrow

ج) در $x = x_N$ باید $E(x) = 0$ گردد برای برآورده شدن این شرط:

$$E(x_N) = 0 \Rightarrow \frac{\rho_1 x_N}{\gamma_e} - \frac{\rho_2 x_p}{\gamma_e} = 0$$

$$\rightarrow \rho_1 x_N = \rho_2 x_p \rightarrow \frac{x_p}{x_N} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

۲ خصی

دیود پیوندی

۱- (الف) مطلوب است محاسبه مقادیر I_s و η برای یک دیود پیوندی که در ولتاژ مستقیم 7 V ولت، جریان 1 mA و در ولتاژ 8 V ولت، جریان 10 mA از آن عبور می‌کند.

(ب) مقاومت دینامیکی این دیود در ولتاژهای مستقیم 7 V و 8 V ولت چقدر است؟

۱۵ هل: در بایاس مستقیم می‌توان رابطه جریان - ولتاژ دیود پیوندی را تقریباً به صورت زیر نوشت. (یعنی از یک می‌توان صرفنظر کرد)

$$I_D = I_s e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} \quad (a)$$

$$I_{D_1} = I_s e^{\frac{V_{D_1}}{\eta V_T}}, \quad I_{D_\gamma} = I_s e^{\frac{V_{D_\gamma}}{\eta V_T}} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{I_{D_1}}{I_{D_\gamma}} = e^{\frac{V_{D_1} - V_{D_\gamma}}{\eta \times V_T}} \Rightarrow \frac{1}{10} = e^{\frac{0.7 - 0.8}{1.67 \times 26 \times 10^{-3}}} \Rightarrow \boxed{\eta = 1/67}$$

با جایگذاری $\eta = 1/67$ در یکی از روابط (a) می‌توان I_s را محاسبه نمود. مثلاً:

$$I_s = \frac{I_{D_1}}{e^{\frac{V_{D_1}}{\eta V_T}}} = \frac{1 \times 10^{-3}}{e^{\frac{0.7}{1/67 \times 26 \times 10^{-3}}}} = 0.1 \text{ (nA)}$$

ب) مقاومت دینامیکی از رابطه (۲ - ۶) محاسبه می‌شود. بنابراین:

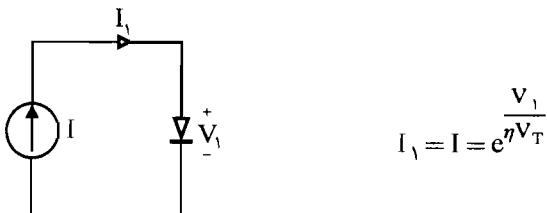
$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_D + I_s} = \frac{\eta V_T}{\left(\frac{V_D}{\eta V_T} \right) e^{-\frac{V_D}{\eta V_T}}}$$

$$r_{d_1} = \frac{1/6V \times 26 \times 10^{-3}}{10^{-3} + 0/1 \times 10^{-9}} = 43/42 \Omega \quad \Leftarrow I_{D_1} = 1 \text{ mA}$$

$$r_{d_2} = \frac{1/6V \times 26 \times 10^{-3}}{10^{-2} + 10^{-10}} = 4/34 \Omega \quad \Leftarrow I_{D_2} = 10 \text{ mA}$$

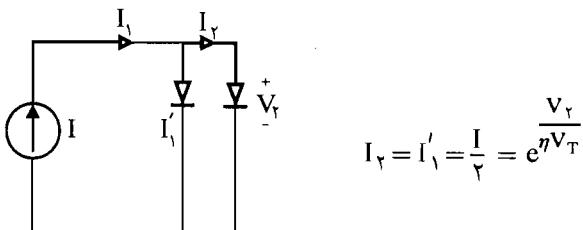
۲ - یک دیود پیوندی در یک مدار، توسط یک منبع جریان I تغذیه می‌شود. اگر این دیود با یک دیود مشابه خود موازی شود ولتاژ مستقیم دوسر آن چه تغییری می‌کند؟

(ا) هل: برای یک دیود تنها می‌توان مدار را مطابق شکل (a) فرض کرد بنابراین داریم:



شکل (a)

اگر دیود مشابهی با دیود اول موازی شود مطابق شکل (b) می‌توان نوشت:



شکل (b)

با توجه به دو رابطه بالا خواهیم داشت:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{2} = e^{\frac{V_2 - V_1}{\eta V_T}} \Rightarrow \boxed{V_2 - V_1 = -\eta V_T \ln(2)}$$

۳- جریان اشباع معکوس دیودی به ازای هر 10°C افزایش دما دو برابر می شود.

(الف) چه افزایش دمایی این جریان را تا 30°C برابر مقدار اولیه اش در دمای معمولی بالا می برد؟

(ب) چه تغییری در دما (نسبت به 25°C) باعث کاهش جریان اشباع معکوس تا سطح 10°C مقدار اولیه اش در دمای معمولی می شود؟

(ا) هل: می دانیم I_s تابعی از دما (θ) می باشد اگر به ازای هر 10°C افزایش دما I_s دو برابر شود پس

می توان رابطه I_s را در دو دمای متفاوت به صورت زیر نوشت:

$$I_s(\theta_2) = I_s(\theta_1) \times 2^{\frac{\theta_2 - \theta_1}{10}}$$

$$I_s(\theta_2) = 30 \cdot I_s(\theta_1) \rightarrow \frac{I_s(\theta_2)}{I_s(\theta_1)} = 30 = 2^{\frac{\theta_2 - \theta_1}{10}} \quad (\text{الف})$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta_2 - \theta_1 = 49.06^\circ\text{C}}$$

$$I_s(\theta_2) = 0.1 I_s(25^\circ)$$



$$\frac{I_s(\theta_2)}{I_s(25^\circ)} = \frac{1}{10} = 2^{\frac{\theta_2 - 25}{10}} \Rightarrow \theta_2 - 25 = -31/21^\circ\text{C} \quad (\text{ب})$$

$$\boxed{\theta_2 = -8/21^\circ\text{C}}$$

۴- (الف) در دمای معمولی در چه ولتاژی جریان اشباع معکوس یک دیود سیلیکنی به 95 درصد مقدار اشباع آن می رسد؟

(ب) نسبت جریان دیود با ولتاژ مستقیم 10°V ولت را به جریان دیود تا همان مقدار ولتاژ معکوس به دست آورید.

(ج) با فرض $I_s = 10^{-10}\text{nA}$ جریان دیود را برای ولتاژهای 5°V ، 6°V و 7°V ولت محاسبه نمایید.

$$I_D = \frac{95}{100} I_s$$

(ا) هل:

(الف)

$$I_D = I_s (e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1) \Rightarrow 0.95 = e^{\frac{V_D \times 10.3}{2 \times 26}} - 1$$

برای سیلیکن می توان $\eta \approx 2$

$$\Rightarrow e^{\frac{10.00 V_D}{2 \times 26}} = 1/95 \Rightarrow \boxed{V_D = 34/72 \text{ mV}}$$

$$I_1 = I_s \left(e^{\frac{-V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

$$I_2 = I_s \left(e^{\frac{-V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

$$\Leftrightarrow V_D = -\frac{V_T}{e^{\frac{I_1}{I_s}} - 1}$$

$$\Leftrightarrow V_D = -\frac{V_T}{e^{\frac{I_2}{I_s}} - 1}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\left| e^{\frac{100}{52}} - 1 \right|}{\left| e^{\frac{-144/72}{52}} - 1 \right|} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = 11/99$$

$$I_D(V_D = 0/0) = 10 \times 10^{-9} \left(e^{\frac{0/0 \times 10^3}{52}} - 1 \right) = 0/149 \text{ (mA)}$$

$$I_D(V_D = 0/6) = 10^{-8} \left(e^{\frac{600}{52}} - 1 \right) = 1/0.25 \text{ (mA)}$$

$$I_D(V_D = 0/7) = 10^{-8} \left(e^{\frac{700}{52}} - 1 \right) = 7/0.2 \text{ (mA)}$$

۵- (الف) در صورتی که جریان اشباع معکوس یک دیود برابر 1 nA باشد به ازای چه ولتاژ مستقیمی جریان دیود برابر $5 \mu\text{A}$ خواهد شد؟

(ب) چنانچه ولتاژ محاسبه شده در بند (الف) را به یک دیود ژرمانیم در جهت مستقیم اعمال کنیم چه جریانی از آن عبور خواهد کرد؟ (فرض کنید $A = 20 \mu\text{m}^2$ است).

(ا) هل:

$$V_D = ? \Leftrightarrow I_D = 0/5 \mu\text{A} \quad , \quad I_s = 1 \text{ nA} \quad , \quad \eta = 2 \quad (\text{الف})$$

$$I_D = I_s \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right) \Rightarrow 0/5 \times 10^{-6} = 10^{-9} \left(e^{\frac{1000 V_D}{52}} - 1 \right)$$

$$\Rightarrow V_D = 0/323 \text{ (Volt)}$$

$$I_D = ? \Leftrightarrow V_D = 0/323 \text{ , } I_s = 20 \mu\text{A} , \eta = 2 \quad (\text{ب})$$

$$I_D = I_s \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right) = 20 \times 10^{-6} \left(e^{\frac{0/323 \times 1000}{52}} - 1 \right) = 9/949 \text{ (mA)}$$

۶- از یک دیود سیلیکنی در دمای 300°K و در ولتاژ 7V ولت جریان 5mA عبور می‌کند. چنانچه ولتاژ را تا حد 8V ولت افزایش دهیم جریان دیود چقدر خواهد شد؟ برای این دیود I_s چقدر است؟

(۱۵ حل)

برای محاسبه جریان I_s مورد نیاز است. مقدار I_s را می‌توان با توجه به داده‌های ابتدای مسئله محاسبه نمود به صورت زیر:

$$I_s = ? \leftarrow I_D = 5\text{mA}, V_D = 7\text{V}$$

$$I_D = 5 \times 10^{-3} = I_s (e^{\frac{-7 \times 1000}{52}} - 1) \Rightarrow I_s = 7/12 (\text{nA})$$

حال با توجه به I_s محاسبه شده، برای $V_D = 8\text{V}$ داریم:

$$I_D = I_s (e^{\frac{-8 \times 1000}{52}} - 1) = 7/12 \times 10^{-9} \times e^{48/52} = 34/2 (\text{mA})$$

۷- یک دیود سیلیکنی در ولتاژ مستقیم 7V ولت در حال کار است. چنانچه دما از 25°C به 55°C - کاهش یابد جریان دیود به چه میزان تغییر خواهد کرد؟ ($\eta = 1$)

(۱۵ حل)

واضح است که با تغییر دما V_T و هم I_s تغییر می‌نمایند.

$$V_T \cong \frac{T^{(ok)}}{11500} \quad \text{برای } V_T \text{ جدید داریم:}$$

$$T_2 = -55 + 273 = 218^{\circ}\text{K} \Rightarrow V_{T_2} \cong \frac{218}{11500} = 18/95 (\text{mv})$$

$$I_{S_2}(T_2) = I_S(T_1) \times 2^{\frac{T_2 - T_1}{10}} \Rightarrow \frac{I_{S_2}}{I_{S_1}} = 2^{\frac{-55 - 25}{10}} = 2^{-1}$$

$$I_{D_1} = I_{S_1} (e^{\frac{-7 \times 26}{\eta \times 26}}) \Rightarrow \frac{I_{D_2}}{I_{D_1}} = \frac{I_{S_2}}{I_{S_1}} \times e^{1000(\frac{1}{18/95} - \frac{1}{26})}$$

$$I_{D_2} = I_{S_2} (e^{\frac{-7 \times 18/95}{\eta \times 18/95}})$$

$$\Rightarrow \frac{I_{D_2}}{I_{D_1}} = 2^{-1} \times e^{1000(\frac{1}{18/95} - \frac{1}{26})} = 79/42$$

-۸- ثابت کنید که در یک پیوند N-P آلیازی رابا ($N_A \ll N_D$) عرض ناحیه تهی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$W = \left[\frac{\gamma \epsilon \mu V_j}{\delta_p} \right]^{\frac{1}{2}}$$

که در آن V_d اختلاف پتانسیل پیوند با وجود ولتاژ خارجی V_d است.

(ا) حل:

از فصل اول داریم:

$$W = \left[\frac{\gamma \epsilon V_j}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

چون $N_D \ll N_A$ پس می‌توان از $\frac{1}{N_A}$ در مقابل $\frac{1}{N_D}$ صرفنظر کرد. بنابراین داریم:

$$W = \left[\frac{\gamma \epsilon V_j}{q N_A} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (a)$$

$$\sigma_p = q N_A \mu_p \Rightarrow q N_A = \frac{\sigma_p}{\mu_p} \quad (b)$$

از طرفی دیگر داریم:

$$(a), (b) \Rightarrow W = \left[\frac{\gamma \epsilon \mu_p V_j}{\sigma_p} \right]^{\frac{1}{2}}$$

-۹- برای یک دیود در دمای 125°C ، جریان اشباع معکوس برابر $1 \mu\text{A}$ است.

الف) در دمای 105°C مقاومت دینامیکی را در ولتاژ مستقیم $/8$ ولت به دست آورید.

ب) در همان دما مقاومت دینامیکی را در ولتاژ معکوس $/8$ ولت محاسبه نمایید.

(ا) حل:

$$r_d = \frac{\eta V_T}{\left(\frac{V_D}{I_s e^{\frac{V_D}{\eta V_T}}} \right)}$$

الف) واضح است که در دمای 105°C مقدار I_s عوض می‌شود. یعنی

$$I_s(105^{\circ}\text{C}) = I_s(125^{\circ}\text{C}) \cdot 2^{\frac{105 - 125}{10}} = 0.1 \times 10^{-6} \times 2^{-1} = 25 \mu\text{A}$$

$$r_d (V_D = 0/\lambda) = \frac{\eta V_T}{I_D + I_s} = \frac{2 \times 26 \times 10^{-3}}{I_s (e^{\frac{V_D}{\eta V_T}})} = 0.433 \Omega$$

ب) در بایاس معکوس $V_D = -V_0/\lambda$

$$r_d(V_D = -V_0/\lambda) = \frac{\eta V_T}{\frac{V_D}{I_s(e^{\eta V_T})}} = \frac{2 \times 26 \times 10^{-3}}{25 \times 10^{-9} (e^{-\frac{26}{10}})} \cong 10^{13} \Omega$$

۱۰- رابطه ۲-۱۱ را به دست آورید.

(اهنگی): برای این کار می‌توانید از تعریف ظرفیت خازنی $C_T = \frac{dQ}{dV_r}$ این گونه استفاده

نمایید که ابتدا آن را به شکل $\frac{dQ}{dx_p} = \frac{dQ}{dV_r} \cdot \frac{dx_p}{dV_r}$ مقدار معادلش ($Aq N_A$) را

قرار دهید و سپس $\frac{dx_p}{dV_r}$ را با استفاده از رابطه ۱-۲۷ که در آن $V_r + V_0$ را V جایگزین نموده‌اید،

محاسبه کنید.

$$C_T = \frac{dQ}{dV_r} = \frac{dQ}{dx_p} \cdot \frac{dx_p}{dV_r} \quad (a)$$

۱۱ هل:

$$\frac{dQ}{dx_p} = qN_A \quad (b)$$

$$x_p = \left[\frac{\gamma \epsilon (V_0 + V_r)}{qN_A (1 + \frac{N_A}{N_D})} \right]^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{dx_p}{dV_r} = \frac{1}{\gamma \sqrt{V_0 + V_r}} \cdot \sqrt{\frac{\gamma \epsilon}{qN_A (1 + \frac{N_A}{N_D})}} \quad (c)$$

اگر (b) و (c) را در (a) قرار دهیم خواهیم داشت:

$$C_T = qN_A \cdot \frac{1}{\gamma \sqrt{V_0 (1 + \frac{V_r}{V_0})}} \times \sqrt{\frac{\gamma \epsilon N_D}{qN_A (N_A + N_D)}} = \sqrt{\frac{q^2 N_A^2 \gamma \epsilon N_D}{\gamma V_0 (1 + \frac{V_r}{V_0}) \cdot qN_A (N_A + N_D)}}$$

$$C_T = \sqrt{\frac{q \epsilon N_A N_D}{\gamma V_0 (N_A + N_D)}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{V_r}{V_0}}} \quad , \quad \sqrt{\frac{q \epsilon N_A N_D}{\gamma V_0 (N_A + N_D)}} = C_{T_0}$$

$$C_T = C_{T_0} \left(1 + \frac{V_r}{V_0} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

۱۱- برای یک دیود سیلیکنی، $N_D \gg N_A$ و $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ است. در صورتی که به این دیود یک ولتاژ معکوس $V_0 = 5V$ و لقی اعمال شود، مطلوب است:

(الف) عرض ناحیه تهی (W)

(ب) مقدار شدت میدان الکتریکی در محل پیوند

(ج) مقدار ظرفیت خازنی در سانتیمتر مربع

: (اه) هل:

$$W \cong x_N \leftarrow x_N \gg x_p \quad \text{چون } N_A \gg N_D$$

$$\epsilon_s = 8/854 \times 10^{-12}, \quad V_r = 10, \quad V_0 = 5 \quad \text{الف) همچنین دائم:}$$

$$W = \left[\frac{\epsilon_s (V_0 + V_r)}{q} \times \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2 \times 10 \times 8/854 \times 10^{-12} \times 10/5}{1/6 \times 10^{-19}} \times \frac{1}{10^{15}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$W = 3/73 \times 10^{-3} \text{ mm} \quad \text{یا} \quad 3/73 \mu\text{m}$$

$$|E_0| = \frac{q N_D x_N}{\epsilon} \quad \text{و} \quad N_D = 10^{21} (\text{m}^{-3}) \quad \text{(ب)}$$

$$E_0 = \frac{q N_D W}{\epsilon} = \frac{1/6 \times 10^{-19} \times 10^{21} \times 3/73 \times 10^{-6}}{12 \times 8/854 \times 10^{-12}} = 56/17 \times 10^5 \text{ V/m} \quad \text{یا}$$

$$56/17 \times 10^5 \left(\frac{\text{V}}{\text{cm}} \right)$$

ج) چون N_A از N_D بسیار بزرگتر است پس از $\frac{1}{N_A}$ صرفنظر می‌کنیم.

$$\epsilon_s = 8/854 \times 10^{-12} \left(\frac{\text{F}}{\text{cm}} \right)$$

$$C_T = \left(\frac{q \epsilon N_A N_D}{2 V_0 (N_A + N_D)} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1/6 \times 10^{-19} \times 12 \times 8/854 \times 10^{-12}}{2 \times 5/10} \right)^{\frac{1}{2}} = 1/3 \times 10^{-8} \left(\frac{\text{F}}{\text{cm}^2} \right)$$

$$C_T = C_T \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{V_r}{V_0}}} = 1/3 \times 10^{-8} \times \frac{1}{\sqrt{1 + 20}} = 2/83 \frac{\text{nF}}{\text{cm}^2}$$

۱۲- (الف) ثابت کنید که برای یک پیوند آلیاژی P-N از جنس سیلیکن ($N_A \ll N_D$)، ظرفیت خازنی

ناحیه تهی (C_T) بر حسب پیکوفاراد بر سانتیمتر مربع از رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$C_T = 2/913 \times 10^{-4} \left[\frac{N_A}{V_j} \right]^{\frac{1}{2}}$$

ب) در صورتی که مقاومت ویژه (ρ) بلور برابر $4\Omega \cdot \text{cm}$ ، اختلاف پتانسیل تماس V برابر $3V$ ولت، ولتاژ خارجی اعمال شده 4 ولت و سطح مقطع دایره‌ای به قطر $1/25 \text{ mm}$ باشد، مقدار C_T را محاسبه نمایید.

۱۵ حل:

(الف)

$$C = C_{T_0} \cdot \frac{1}{1 + \frac{V_r}{V_0}} = \sqrt{\frac{q\epsilon}{2V_0 \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \cdot \frac{V_0}{V_0 + V_r}}$$

$$V_r + V_0 = V_j$$

$$\epsilon_r = 12, \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \left(\frac{F}{cm} \right)$$

$$C = \sqrt{\frac{1/8 \times 10^{-19} \times 12 \times 8.854 \times 10^{-12}}{2 \times \frac{1}{N_A} \cdot V_j}} = 2/91 \times 10^{-14} \sqrt{\frac{N_A}{V_j}} \left(\frac{F}{cm^2} \right)$$

$$2/91 \times 10^{-4} \sqrt{\frac{N_A}{V_j}} \left(\frac{PF}{cm^2} \right)$$

$$\mu = 500, \delta = N_A q \mu \Rightarrow N_A = \frac{\sigma}{q \mu} = \frac{1}{\rho q \mu} = \frac{1}{4 \times 1/8 \times 10^{-19} \times 500} \quad (b)$$

$$\Rightarrow N_A = 3/120 \times 10^{15}$$

$$V_j = V_0 + V_r = 4 + 0/3 = 4/3 V$$

$$C_T = 2/91 \times 10^{-4} \sqrt{\frac{3/120 \times 10^{15}}{4/3}} \frac{PF}{cm^2} = 7844/83 \times 10^{-9} \left(\frac{F}{cm^2} \right)$$

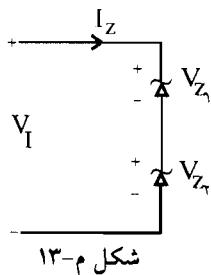
$$\text{سطح مقطع} = \pi R^2 = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 = \pi \times \left(\frac{1/20 \times 10^{-1}}{2} \right)^2 = 0.122 \text{ cm}^2$$

$$C_T = 7844/83 \times 10^{-9} \times 0.122 = 95/86 (\rho F)$$

۱۳ - در شکل م - ۱۳ جریان اشباع معکوس دو دیود ۱ و ۲ میکروآمپر است. ولتاژ شکست دو دیود مساوی برابر 10^0 ولت است.

- (الف) جریان و ولتاژ هر دیود را برای ولتاژهای ورودی 80 و 120 ولت به دست آورید.
 (ب) برای حالتی که هر دیود با یک مقاومت $8M\Omega$ موازی شود، بند (الف) را حل نمایید.

۱۴ حل:



چون دو دیود با هم سری هستند پس جریان هر دو با هم مساوی است.

$$2 \times 10^{-6} \left(e^{\frac{V_2 + 10^0}{52}} - 1 \right) = 10^{-6} \left(e^{\frac{V_1 + 1000}{52}} - 1 \right)$$

$$2e^{\frac{V_2 + 1000}{52}} - e^{\frac{V_1 + 100}{52}} = -1 \quad (a)$$

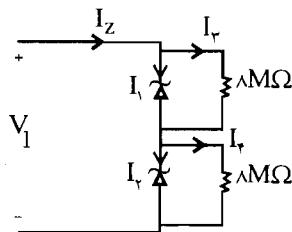
$$V_1 + V_2 = 80 \quad (b)$$

باید معادله (a) و (b) را حل کنیم. سپس از حل: $V_2 = 36 \text{ mV}$ و $V_1 = 79/96 \text{ V}$

$$I_2 = I_1 = 10^{-6} \left(e^{\frac{79/96 \times 10^0}{52}} - 1 \right) \approx 1 \mu\text{A}$$

اگر $V_1 = 120$ همانند روش بالا خواهیم داشت:

$V_1 = 100 \text{ V}$ و $V_2 = 20 \text{ mV}$ در این حالت چون $V_1 = 100 \text{ V}$ شده است، می‌شکند و جریان مدار $2 \mu\text{A}$ خواهد شد.



ب) در این حالت مدار مشابه شکل مقابل خواهد شد.

با اعمال KVL در حلقه مربوط به مقاومت‌ها داریم:

$$V_I = I_3 + I_4 = 80 \quad \leftarrow V_I = 80$$

$$I_3 + I_4 = 10 \mu\text{A} \quad (a)$$

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 \quad (b) \quad \text{از طرفی داریم:}$$

چون هر دو دیود به صورت معکوس تغذیه شده‌اند داریم:

بنابراین:

$$I_4 = 4/5 \mu A , I_3 = 5/5 \mu A$$

$$V_1 = 8 \times 10^6 \times 5/5 \times 10^{-6} = 44 V , V_2 = 8 \times 10^6 \times 4/5 \times 10^{-6} = 36 V$$

در حالتی که $V_I = 120$ خواهیم داشت:

$$\begin{cases} I_3 + I_4 = 15 \mu A \\ I_1 + I_3 = I_2 + I_4 \end{cases}$$

مشابه حالت قبل:

$$I_1 = 1 \mu A , I_2 = 2 \mu A$$

$$I_3 = 8 \mu A , I_4 = 6 \mu A$$

$$V_1 = 8 \times 8 = 64 V , V_2 = 8 \times 7 = 56 V$$

مشاهده می شود که در این حالت به علت موازی شدن مقاومت ها هیچکدام از دیودها نمی شکنند.

۱۴- ظرفیت خازنی ناحیه تهی یک پیوند P-N ژرمانیم با سطح مقطع 25 mm^2 و عرض ناحیه

تهی $10^{-7} \text{ cm} \times 3$ را بدست آورید.

(۱۴ حل):

برای دیود ژرمانیم داریم: $\epsilon_r = 16$

$$A = 0/25 \text{ mm}^2 = 0/25 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$W = 3 \times 10^{-4} \text{ cm} = 3 \times 10^{-6} \text{ (m)}$$

$$C = \frac{\epsilon A}{W} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{W} = \frac{16 \times 8/84 \times 10^{-12} \times 0/25 \times 10^{-6}}{3 \times 10^{-6}} = 11/8 \times 10^{-12} \text{ F} \quad \text{یا } 11/8 \text{ (PF)}$$

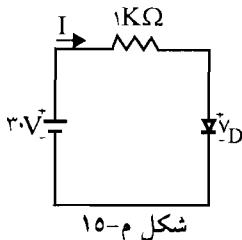
۱۵- در مدار شکل م-۱۵ دیود ژرمانیم در دمای معمولی دارای جریان اشباع معکوس $10 \mu A$ ، ولتاژ

شکست $100V$ و مقاومت اهمی ناچیز است. جریان مدار را در حالت های زیر به دست آورید.

(الف) دیود به صورت مستقیم بایاس شده باشد.

(ب) دیود به صورت معکوس بایاس شده باشد.

(۱۵ حل):



الف) در حالت بایاس مستقیم با اعمال KVL در حلقه مدار خواهیم داشت:

$$30 = I \times 10^3 + V_D \quad (\text{a})$$

از طرفی برای خود دیود نیز داریم:

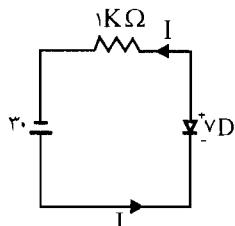
$$I = 10 \times 10^{-6} \left(e^{\frac{V_D \times 10^3}{52}} - 1 \right) \quad (\text{b})$$

با جایگذاری (b) در (a) یک معادله غیرخطی بر حسب V_D به دست می‌آید با حل این معادله V_D را به دست می‌آوریم:

$$30 = 0.1 \times \left(e^{\frac{1000 V_D}{52}} - 1 \right) + V_D$$

$$V_D = 0.18 \text{ V} \Rightarrow I = \frac{30 - V_D}{10^3} = \frac{30 - 0.18}{10^3} = 29/82 \text{ (mA)}$$

ب) در این حالت مدار مطابق شکل روبرو خواهد بود:



$$I \times 10^3 - V_D = 30$$

$$I = 10 \times 10^{-3} \left(e^{\frac{1000 V_D}{52}} - 1 \right)$$

باز هم اگر معادله روبرو حل شود خواهیم داشت:

$$V_D \approx -29/99 \Rightarrow I = \frac{30 + V_D}{10^3} = \frac{0.1}{10^3} = 10 \mu\text{A}$$

۱۶- یک دیود سیلیکنی با یک مقاومت $10 \text{ M}\Omega$ سری شده و توسط یک منبع ولتاژ ۱ ولتی به صورت معکوس بایاس شده است.

الف) ولتاژ دو سر دیود را به دست آورید.

ب) در صورتی که جای قطب‌های منبع ولتاژ را عوض کنیم، ولتاژ دو سر دیود چقدر خواهد شد؟

(۱۵ هل:

الف) چون مقدار جریان اشباع معکوس را نداریم آن را $I_s = 1 \text{nA}$ در نظر می‌گیریم و با توجه به قسمت

(ب) مسئله قبل داریم

$$I_D = I_s \rightarrow I_D = 1 \text{nA}$$

$$V_R = R I_D = 10 \text{ M}\Omega \times 1 \text{nA} = 0.1 \text{ V}$$

$$\text{ولتاژ دو سر مقاومت} \rightarrow V_D = 1 - 0.1 = 0.99 \text{ V}$$

ب) ابتدا مقدار I_D را از حل دو معادله زیر به دست می‌آوریم:

$$(1) \quad 1 \text{ V} = 10 I_D + V_D \rightarrow V_D = 1 - 10 I_D$$

$$(2) \quad I_D = 10^{-9} \left(e^{\frac{V_D}{52}} - 1 \right)$$

با جایگذاری رابطه (۱) در رابطه (۲) مقدار I_D به دست می‌آید.

$$(1), (2) \rightarrow I_D = 0.077 \mu A$$

$$V_R = 10 M\Omega \times 0.077 \mu A = 0.77 V \rightarrow V_D = 1 - V_R = 1 - 0.77 = 0.23 V$$

۱۷- یک دیود سیلیکنی در دمای $30^{\circ}C$ و در ولتاژ 7.0 ولت، دارای جریان $5 mA$ است.

الف) جریان اشباع معکوس را محاسبه نمایید.

ب) اگر ولتاژ به 8.0 ولت برسد جریان چقدر خواهد شد؟

ج) چه تنفس ولتاژی در ناحیه هدایت باعث ده برابر شدن جریان می‌شود؟ (در دمای $30^{\circ}C$)

(۱۵)

الف) با توجه به رابطه مقابل داریم:

$$I_D = I_s (e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1) \rightarrow 5 mA = I_s (e^{\frac{V_0}{n \times 25}} - 1) \rightarrow I_s = 7 / 12 nA$$

$$I_D = 7 / 12 nA (e^{\frac{V_0}{n \times 25}} - 1) = 34 / 19 mA \quad (b)$$

$$\frac{I_2}{I_1} = 10 \rightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10 = \frac{e^{\frac{V_2}{n \times 25}} - 1}{e^{\frac{V_1}{n \times 25}} - 1} = \frac{e^{\frac{V_2}{n \times 25}}}{e^{\frac{V_1}{n \times 25}}} = e^{\frac{V_2 - V_1}{n \times 25}} \quad (c)$$

$$\rightarrow (\ln 10) \times 52 = V_2 - V_1 \rightarrow V_2 - V_1 = 119 mV$$

۱۸- در مدار شکل م-۱۸ دیودها مشابه، از نوع سیلیکن و دارای $I_s = 10 nA$ می‌باشند.

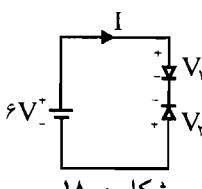
الف) در صورتی که ولتاژ شکست دیودها برابر 1.0 ولت باشد، جریان 1 مدار و ولتاژ دوسر هر دیود را به دست آورید.

ب) با فرض اینکه ولتاژ شکست دیودها برابر 5 ولت باشد جریان I مدار و ولتاژ دوسر هر دیود چقدر خواهد بود؟

(۱۶)

الف) چون دو دیود سری هستند پس جریان آنها برابر و ولتاژ آنها متفاوت است.

$$I = I_s = 10 nA$$



شکل م-۱۸

$$I_D = I_s (e^{\frac{V_1}{n \times 25}} - 1) \rightarrow 10 = 10 (e^{\frac{V_1}{n \times 25}} - 1) \rightarrow 1 = e^{\frac{V_1}{n \times 25}} - 1 \rightarrow$$

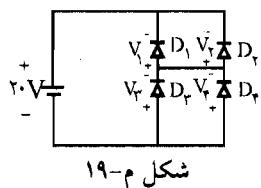
$$V_1 = e^{\frac{V_1}{0.02}} \rightarrow \frac{V_1}{0.02} = \ln 2 \rightarrow V_1 = 0.2 \ln 2 = 26 \text{ mV}$$

$$V_2 = 6V - 0.026V = 5.974 \text{ V}$$

$$V_2 = 5V \rightarrow V_1 = 6 - 5 = 1 \text{ V}$$
(ب)

۱۹- مدار شکل م-۱۹ را در نظر بگیرید. با فرض $I_{s_1} = I_{s_2} = 15 \text{ nA}$ و $I_{s_3} = I_{s_4} = 10 \text{ nA}$ ولتاژها و جریان‌های دیودها را به دست آورید.

۱۹- حل:



با توجه به فرض مسئله $I_{s_1} = I_{s_2} = 15 \text{ nA}$ با برابر بودن ولتاژها داریم:

$$I_1 = I_2 = 15 \text{ nA} \leftarrow I_{s_1} = I_{s_2}$$

$$I_3 = 2I_2$$

$$\text{KCL: } \begin{cases} I_1 + I_2 = I_3 + I_4 = 15 + 15 = 30 \text{ nA} \\ 2I_2 = I_4 \end{cases} \Rightarrow I_3 + 2I_2 = 30 \text{ nA} \rightarrow I_3 = 10 \text{ nA}$$

$$\rightarrow I_4 = 2I_3 = 2 \times 10 \text{ nA} = 20 \text{ nA}$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_1 = I_2 = 15 \text{ nA} \\ I_3 = 10 \text{ nA} \\ I_4 = 20 \text{ nA} \end{cases}$$

برای به دست آوردن ولتاژها:

دیودهای D_1 و D_2 موازی هستند پس ولتاژها برابر دارند و همچنین دیودهای D_3 و D_4 موازی هستند پس آنها نیز ولتاژ برابر دارند.

$$I_{D_4} = I_{s_4} (e^{\frac{V_4'}{0.02}} - 1) \rightarrow I_{D_4} = -20 = 40 (e^{\frac{V_4'}{0.02}} - 1) \rightarrow$$

$$V_4' = 26 \text{ mV} \rightarrow V_4 = V_4' = -26 \text{ mV}$$

$$V_1 = V_2 = 2.0 \text{ V} + 0.026 \text{ V} = 2.026 \text{ V}$$

۲۰- در دیود ژرمانیم پدیده شکست زنر در $E_z = 2 \times 10^7$ ولت بر متر اتفاق می‌افتد. نشان دهید $V_z = 50/\rho_p$ است، که در آن مقاومت ویژه بلور ژرمانیم نوع P می‌باشد. فرض کنید $N_A \ll N_D$ است.

۱۰ حل:

با توجه به صورت مسئله ۲۲ داریم:

$$V_z = \frac{\epsilon E_z}{2q N_D}$$

$$\delta_p = q \mu_p N_D$$

$$\rightarrow q N_D = \frac{\delta p}{\mu_p} \quad \delta_p = \frac{1}{\rho_p}$$

و همچنین رابطه مقابله داریم:

پس با توجه به روابط فوق داریم:

$$\mu_p = 1800$$

$$16 \text{ برای دیود ژرمانیم}$$

$$V_z = \frac{\epsilon \cdot \epsilon_r E_z}{2q N_D} \rightarrow V_z = \frac{16 \times 8.85 \times 10^{-12} \times (2 \times 10^7 \times 10^{-2})^2 \times 1800 \rho_p}{2}$$

$$\rightarrow V_z = 50/976 \rho_p$$

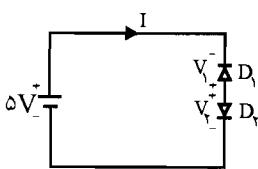
چون با توجه به جدول صفحه (۱۶) ρ_p بر حسب ($\Omega \cdot \text{cm}$) است ϵ_z را برابر حسب ولت بر سانتیمتر می‌نویسیم.

۲۱- در مدار شکل م-۲۱ دیودها مشابه و از جنس ژرمانیم با ولتاژ شکست بیشتر از ۵ ولت هستند.

الف) ولتاژ دوسر هر دیوار را در دمای معمولی به دست اورید.

ب) چنانچه ولتاژ شکست دیودها برابر $4/9$ ولت و جریان اشباع معکوس $5 \mu A$ باشد، جریان مدار را به دست اورید.

ج) با فرض ولتاژ شکست ۲ ولتاژ، جریان اشباع معکوس $5 \mu A$ و اضافه کردن مقاومت 100Ω هم به صورت سری در مدار، جریان مدار را به دست اورید.



شکل م-۲۱

۱۰ حل:

الف)

$$I_V = I_S \rightarrow I_S = I_S (e^{\frac{V_V}{\Delta V}} - 1) \rightarrow e^{\frac{V_V}{\Delta V}} = 2 \rightarrow V_V = 0.2 \times \ln 2 = 36 \text{ mV}$$

$$V_1 = V_V - 0.5V = 36 \times 10^{-3} - 0.5 = -4/964 \text{ V}$$

$$I = I_S (e^{\frac{V_V}{\Delta V}} - 1) = 0.5 \mu A (e^{\frac{(0.5V - 4/964) \times 10^{-3}}{0.2}} - 1) = 29/2 \mu A \quad (b)$$

$$V_1 = 2^V$$

$$(1) 2^V = V_D + 0.1 I_D, \quad I_D = 0.5 \times 10^{-3} (e^{\frac{V_D}{0.2}} - 1) \quad (2) \quad (ج)$$

$$(1) \quad V_D = (2^V - 0.1 I_D) \times 10^{-3} \text{ mV} \quad (a)$$

حال رابطه (a) را در رابطه (2) قرار می دهیم پس داریم:

۲۲- ثابت کنید که در یک دیود زنر که در آن $N_A \gg N_D$ است، ولتاژ زنر (V_V) از رابطه زیر به دست

می آید:

$$V_V = \frac{\epsilon E_z}{q N_D} \quad \text{که در آن } E_z \text{ میدان لازم برای شکست زنر است.}$$

(اهمیاتی): از رابطه V_V بر حسب W و نیز روابط E_z استفاده کنید.

(اهمیت): در فصل اول روابط زیر را داشتیم:

$$E_z = \frac{-q N_D x_N}{\epsilon} \rightarrow x_N = \frac{\epsilon^2 E_z^2}{q^2 N_D^2} \quad (1) \quad \text{رابطه (۱-۲۳) صفحه ۲۲}$$

$$x_N = \left[\frac{\epsilon^2 V_z}{q N_D \left(1 + \frac{N_D}{N_A} \right)} \right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{رابطه (۱-۲۸) صفحه ۲۲}$$

$$\text{فرض مسئله: } N_A \gg N_D \rightarrow \frac{N_D}{N_A} = 0$$

$$\rightarrow x_N = \left(\frac{\epsilon^2 V_z}{q N_D} \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow x_N = \frac{\epsilon^2 V_z}{q N_D} \quad (2)$$

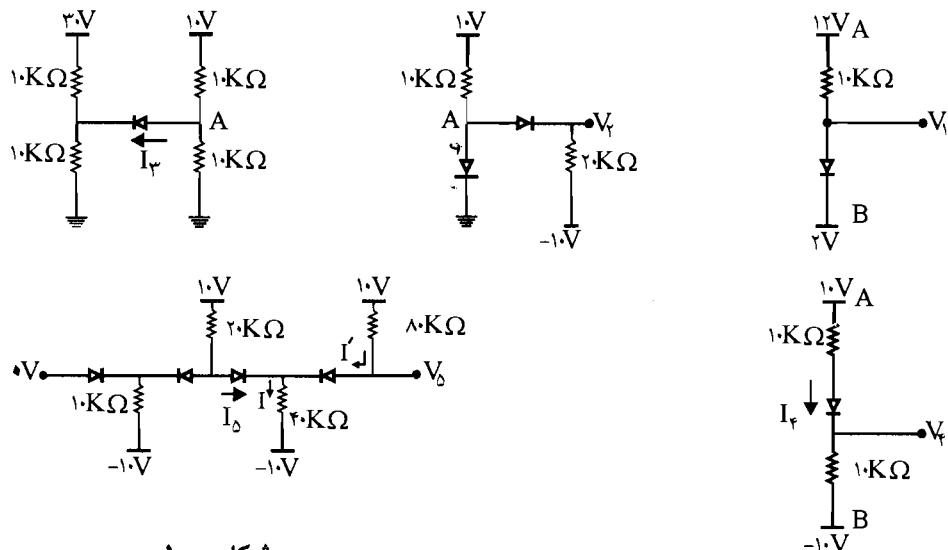
$$\rightarrow \begin{cases} x_N = \frac{\epsilon^2 E_z^2}{q^2 N_D^2} & (1) \\ x_N = \frac{\epsilon^2 V_z}{q N_D} & (2) \end{cases} \rightarrow \frac{\epsilon^2 E_z^2}{q^2 N_D^2} = \frac{\epsilon^2 V_z}{q N_D}$$

$$\frac{\epsilon E_z^2}{q N_D} = V_z \rightarrow V_z = \frac{\epsilon E_z^2}{q N_D}$$

۳ فصل

مدارهای دیودی

۱- در مدارهای دیودی شکل م - ۱ ولتاژها و جریانهای نشان داده شده را محاسبه کنید. دیودها را ایدهآل در نظر بگیرید.



شکل م - ۱

(۱) مل:

در شکل (۱) چون $V_A > V_B$ است پس دیود روشن بوده و هدایت می‌کند پس داریم:

در شکل (۲) چون $V_A = 0$ است پس دیود روشن بوده و $V_A = 10V$ می‌باشد. و چون $V_A > 0$ است

$$V_A = V_2 = 0V$$

در شکل (۳): چون $V_A < V_B$ می‌باشد پس دیود قطع است و هیچ جریانی از آن نمی‌گذرد پس $I_3 = 0$ می‌باشد.

در شکل (۴): چون $V_A > V_B$ می‌باشد پس دیود روشن بوده و هدایت می‌کند پس جریان آن از KVL به دست می‌آید.

$$-10V + 10I_4 + 10I_4 - 10 = 0 \rightarrow 20K\Omega I_4 = 20V \rightarrow I_4 = 1mA$$

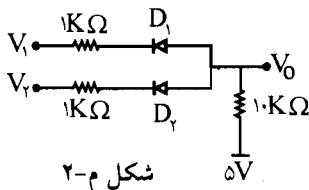
$$V_4 = 10I_4 - 10 = 10(1) - 10 = 0V$$

در شکل (۵): هر چهار دیود هدایت می‌کنند پس داریم:

$$V_5 = 0V$$

$$I_5 = I - I' \quad \begin{cases} I = \frac{1}{4}mA \\ I' = \frac{1}{8}mA \end{cases} \rightarrow I_5 = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8} = 0.125mA$$

۲- در مدار شکل م-۲ دیودها ایده‌آل هستند. مطلوب است ولتاژ خروجی V_0 برای حالت‌های زیر:



شکل م-۲

$$\text{الف) } V_1 = V_2 = 5V$$

$$\text{ب) } V_1 = 5V \text{ و } V_2 = 0V$$

$$\text{ج) } V_1 = V_2 = 0V$$

: اه هل

الف) با فرض اینکه هر دو دیود در حالت وصل قرار دارند داریم:

$$\text{KCL: } \frac{V_o - 5}{10K\Omega} = \frac{V_o - V_1}{1K\Omega} + \frac{V_o - V_2}{1K\Omega} \rightarrow$$

$$\frac{V_o - 5}{10K\Omega} = \frac{V_o - 5V}{1K\Omega} + \frac{V_o - 5}{1K\Omega} = 2V_o - 10V \rightarrow V_o - 5V = 20V_o - 100V$$

$$\rightarrow 19V_o = 95V \rightarrow V_o = \frac{95}{19} = 5V$$

ب) با فرض اینکه D_1 خاموش و D_2 روشن باشد داریم:

$$V_o = 0 \times \frac{1}{10+1} = \frac{0}{11} = 0 / 45 V$$

که با این ولتاژ قطع بودن D_1 محقق است. چون ولتاژ آند از کاتد کوچکتر می‌باشد و وصل بودن نیز

$$I_{D_2} = \frac{0 - 0}{11} = \frac{0}{11} > 0$$

محقق است چون

ج) با فرض وصل بودن هر دو داریم:

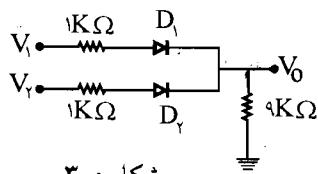
$$\frac{V_o - 0}{10} + \frac{V_o - 0}{1} + \frac{V_o - 0}{1} = 0 \Rightarrow V_o = \frac{0}{19}$$

با این ولتاژ به دست آمده وصل بودن هر دو دیود ثابت می‌شود.

۳- در مدار شکل م-۳، برای دیودها $V_D(ON) = 0 / 7 V$ است. ولتاژ خروجی را به ازای ولتاژهای ورودی داده شده به دست اورید و وضعیت قطع یا وصل هر یک از دیودها را مشخص کنید.

$$V_1 = 10 V \quad , \quad V_2 = 5 V \quad \text{(ج)} \quad V_1 = 10 V \quad , \quad V_2 = 0 V \quad \text{(الف)}$$

$$V_1 = 5 V \quad , \quad V_2 = 5 V \quad \text{(د)} \quad V_1 = 5 V \quad , \quad V_2 = 0 V \quad \text{(ب)}$$



شکل م-۳

راه حل:

الف) در این حالت D_1 به صورت مستقیم بایاس شده و دیود D_2 به صورت معکوس بایاس شده پس داریم: دیود D_1 روشن و دیود D_2 قطع خواهد بود:

$$\frac{V_o}{9K\Omega} = \frac{10 - V_o - 0 / V}{1K\Omega} \rightarrow V_o = 90 - 9V_o - 6 / 3$$

$$10V_D = 83 / 7 V \rightarrow V_o = 83 / 87 V$$

ب) در این حالت نیز D_1 روشن و D_2 خاموش می‌باشد پس داریم:

$$\frac{V_o}{9K\Omega} = \frac{0 - V_o - 0 / V}{1K\Omega} \rightarrow V_o = 45 - 9V_o - 6 / 3$$

$$\rightarrow 10V_o = 38 / 7 V \rightarrow V_o = 38 / 87 V$$

ج) در این حالت هر دیود روشن می‌باشد:

$$\frac{V_1 - 0/V}{1K\Omega} + \frac{V_2 - 0/V}{1K\Omega} = V_0 \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right)$$

$$\rightarrow V_0 (1 + 9 + 9) = 9(V_1 - 0/V) + 9(V_2 - 0/V) \rightarrow V_0 = \frac{9(10 - 0/V) + 9(5 - 0/V)}{19}$$

$$\rightarrow V_0 = 6/44$$

با این V_0 به دست آمده مشخص می‌شود که D_2 خاموش می‌باشد و D_1 روشن می‌باشد پس داریم

$$V_0 = (V_1 - 0/V) \times \frac{9}{9+1} = 8/33V$$

$$\text{KCL: } \frac{V_1 - V_0 - 0/V}{1} + \frac{V_2 - V_0 - 0/V}{1} = \frac{V_0}{9} \quad \text{د) با فرض وصل بودن هر دو دیود داریم:}$$

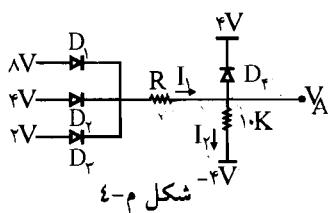
$$5 - V_0 - 0/V + 5 - V_0 = \frac{V_0}{9} \rightarrow 8/6 - 2V_0 = \frac{V_0}{9} \rightarrow V_0 = 4/07V$$

با این ولتاژ به دست آمده مشخص می‌شود که هر دو دیود روشن می‌باشد پس فرض ما درست است.

۴- در مدار شکل م-۴ دیودها را ایده‌آل فرض کنید.

الف) مقاومت R را طوری تعیین کنید که V_A برابر $2V$ شود. در این صورت I_1 و I_2 چقدر خواهد بود؟

ب) به ازای $\Omega R = 2K\Omega$ مقادیر I_1 ، I_2 و V_A را تعیین کنید.



راه حل:

الف) D_4 قطع می‌باشد و دیودهای دیگر هدایت می‌کنند.

$$\text{KCL: } \frac{8 - V_A}{R} + \frac{4 - V_A}{R} + \frac{2 - V_A}{R} = \frac{V_A + 4}{10} \quad \text{از طرفی} \quad V_A = 2V$$

$$\frac{6}{R} + \frac{2}{R} + 0 = \frac{6}{10} = 0/6 \rightarrow \frac{8}{R} = 0/6 \rightarrow R = \frac{80}{6} = \frac{40}{3} = 13/33 \Omega$$

و چون داریم دیود D_2 قطع می‌باشد پس $I_1 = I_2$ برابرند پس داریم:

$$I_1 = I_2 = \frac{V_A + 4}{10} = \frac{4 + 4}{10} = 1/125 \text{ mA}$$

ب) چون نمی‌دانیم مقدار V_A چند است پس ابتدا فرض می‌کنیم D_2 قطع است پس داریم:

$$\text{KCL: } \frac{8 - V_A}{2} + \frac{4 - V_A}{2} + \frac{2 - V_A}{2} = \frac{V_A + 4}{10} \rightarrow \frac{14 - 3V_A}{2} = \frac{V_A + 4}{10}$$

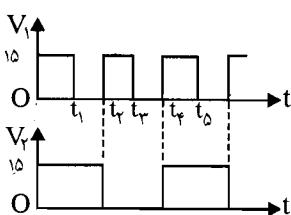
$$140 - 30V_A = 2V_A + 8 \rightarrow 32V_A = 132 \rightarrow V_A = 4/125 \text{ V}$$

پس فرض قطع بودن D_2 اشتباه است پس مسئله را با فرض روشن بودن D_2 حل می‌کنیم در این حالت $V_A = 4 \text{ V}$ برابر می‌باشد.

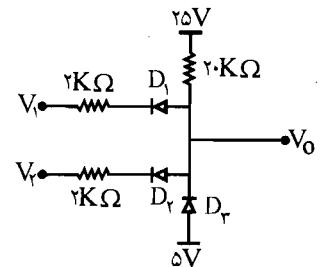
$$I_2 = \frac{4 + 4}{10} = 0.8 \text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{8 - V_A}{R} + \frac{4 - V_A}{R} + \frac{2 - V_R}{R} = \frac{8 - 4}{2} + \frac{4 - 4}{2} + \frac{2 - 4}{2} = 2 + 0 - 1 = 1 \text{ mA}$$

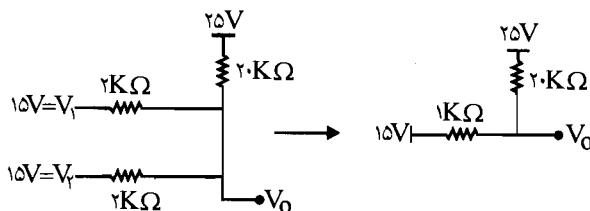
۵- در مدار شکل ۵-۵ دیودها ایده‌آل هستند. با توجه به شکل موج ولتاژهای V_1 و V_2 ، شکل موج ولتاژ خروجی رارسم کنید.



شکل ۵-۵



در زمان $t_1 < t < t_2$ داریم دیود D_1 قطع و دیودهای D_2 و D_3 روشن هستند پس مدار معادل به صورت زیر خواهد بود: (دیودها ایده‌آل)



$$V_0 = 15 + \frac{(25 - 15)}{20 + 1} = 15/4.8 \text{ V}$$

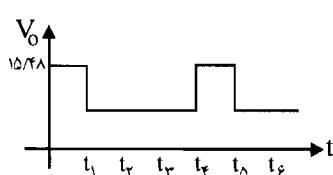
در زمان $t_1 < t < t_2$: هر سه دیود هدایت می‌کنند پس داریم $V_o = 0V$

در زمان $t_2 < t < t_3$: هر سه دیود هدایت می‌کنند پس داریم $V_o = 0V$

در زمان $t_3 < t < t_4$: هر سه دیود هدایت می‌کنند پس داریم $V_o = 0V$

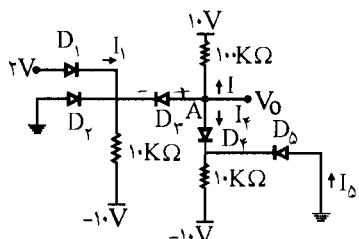
در زمان $t_4 < t < t_5$: باز دیود D_4 قطع و دیود D_1 و D_2 روشن هستند و همانند حالت اول می‌باشد پس

$$V_o = 15/48 \text{ V}$$



پس مدار معادل V_o به صورت زیر خواهد بود:

۶- در مدار شکل م-۶، با فرض ایدهآل بودن همه دیودها، ولتاژ V_o و جریان‌های I_1 و I_5 را تعیین کنید.



شکل م-۶

راه حل:

با توجه به مدار داریم: $D_1: ON \quad D_2: OFF \quad D_3: OFF \quad D_4: ON \quad D_5: ON$

$$I_1 = \frac{2V - (-10V)}{10\text{ k}\Omega} = 1/2 \text{ mA}$$

و چون D_4 و D_5 روشن می‌باشند پس $V_o = 0V$ می‌باشد.

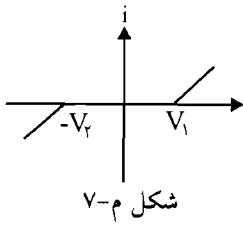
$$\text{KCL: } \frac{V_o - 10V}{10\text{ k}\Omega} - I_5 + \frac{V_o - (-10V)}{10\text{ k}\Omega} = 0$$

$$V_o = 0V \rightarrow \frac{-10}{10} - I_5 + \frac{10}{10} = 0 \rightarrow I_5 = 1 - 0/1 = 0/9 \text{ mA}$$

۷- منحنی مشخصه ولتاژ - جریان در شکل م - ۷ را در نظر بگیرید:

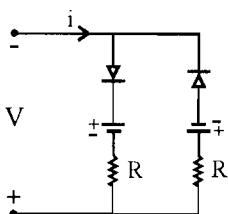
الف) با استفاده از دیودهای ایدهآل، منابع و مقاومت مداری طراحی کنید که دارای مشخصه مذبور باشد.

ب) طرح خود را به نحوی اصلاح کنید که دو شیب موجود در مشخص متفاوت باشند.



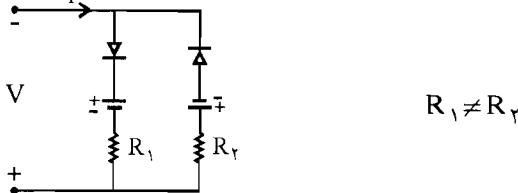
۱۴ حل:

الف) با فرض اینکه دو شیب برابر باشند.



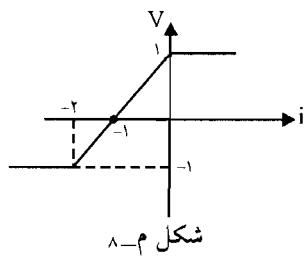
ب) با فرض اینکه دو شیب برابر نباشند مدار همان مقدار قبلی می‌باشد ولی باید R ها متفاوت باشند

$$R_1 \neq R_2 \quad \text{يعني}$$



$$R_1 \neq R_2$$

۸- با استفاده از کمترین تعداد مقاومت، منبع ولتاژ و دیود ایدهآل مداری با مشخصه جریان - ولتاژ مطابق شکل م - ۸ طراحی کنید.



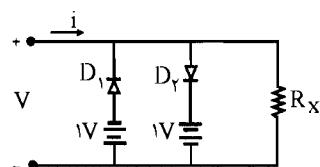
۱۰۵ مل:

با توجه به شکل م - ۸ داریم:

V مقدار ثابت می‌باشد:

V مقدار ثابت می‌باشد:

بنابراین مدار باید دارای چنین فرمی باشد:



در این مدار داریم:

اگر D_1 و D_2 هر دو خاموش باشند: $i = R_x \times V$ و شرط خاموش بودن D_1 به صورت زیر می‌باشد:

$$D_1 \text{ خاموش} \Rightarrow V_{A_1} < V_{K_1} \text{ و } V_{A_1} = -1V \quad \text{شرط خاموش بودن } D_1$$

$$V_{A_1} < V_{K_1} \Rightarrow -1V < R_x i \rightarrow i > \frac{-1}{R_x}$$

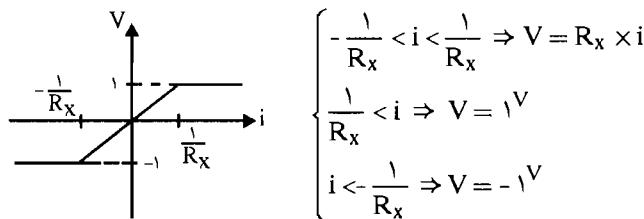
شرط خاموش بودن D_2 :

$$D_2 \text{ خاموش} \Rightarrow V_{A_2} < V_{K_2} \text{ و } V_{A_2} = R_x i \quad , \quad V_{K_2} = 1V$$

$$V_{A_2} < V_{K_2} \Rightarrow R_x i < 1V \rightarrow i < \frac{1}{R_x}$$

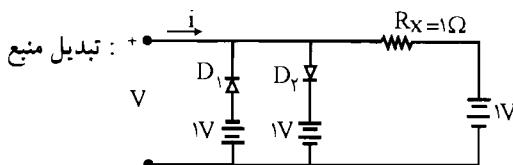
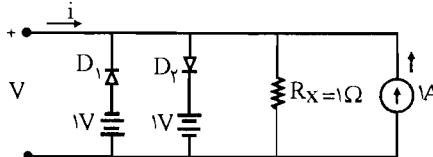
يعنى در $i < \frac{1}{R_x}$ هر دو دیود خاموش می‌باشند و به ازای $i < -\frac{1}{R_x}$ دیود D_1 روشن می‌شود و دیود D_2 همچنان خاموش می‌ماند و در این حالت $V = 1V$ می‌باشد.

به ازای $i > \frac{1}{R_x}$ دیود D_2 روشن می‌شود و دیود D_1 همچنان خاموش می‌ماند و در این حالت $V = 1V$ می‌باشد.

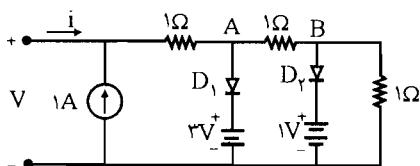


اگر این مشخصه رسم شده را با مشخصه داده شده مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که باید در مشخصه داده

شده تغییر محور دهیم یعنی i را به $-i$ -تبدیل کنیم یعنی کافی است که $\frac{1}{R_X} = 1$ انتخاب شود یعنی $R_X = 1\Omega$ خواهد شد و یک تغییر A به $-A$ -انیزاجام گیرد یعنی یک منبع جریان یک آمپر در گره ورودی اضافه شود سپس مدار به صورت فرم زیر می‌باشد:



۹- در مدار شکل م- دیودها ایده‌آل هستند. مشخصه نسبت حسب V را در این مدار به دست آورده و رسم کنید.



شکل م-

۱۵ حل:

فرض می‌کنیم هر دو دیود روشن باشند پس داریم: $V_A = 3V$ $V_B = 1V$

$$ID_2 = \frac{V_A - V_B}{1\Omega} - \frac{V_B}{1\Omega} = \frac{3 - 1}{1} - \frac{1}{1} = 1A$$

$$ID_1 = \frac{V - V_A}{1\Omega} - \frac{V_A - V_B}{1\Omega} = \frac{V - 3}{1} - \frac{3 - 1}{1} = V - 5 > 0 \rightarrow V > 5$$

با شرط $V > 5$ هر دو دیود روشن می‌باشند و داریم:

$$KVL: V = (i + 1) \times 1\Omega + 3V = i + 4$$

$$V > 5 \Rightarrow \begin{cases} D_1: ON \\ D_2: ON \end{cases}, \quad V = i + 4$$

(ا) برای اینکه دیود D_2 خاموش شود باید رابطه زیر را داشته باشیم:

$$V_B < 1V \Rightarrow V \times \frac{1}{3} < 1V \rightarrow V < 3V$$

(II) برای اینکه دیود D_1 خاموش باشد باید رابطه زیر را داشته باشیم:

$$V_A < 3V \Rightarrow V \times \frac{2}{3} < 3V \Rightarrow V < 4.5V$$

که قسمت مشترک دو شرط (I) و (II)، $3 < V$ می‌باشد پس داریم:

$$V < 3V \Rightarrow \begin{cases} D_1: \text{Off} \\ D_2: \text{Off} \end{cases}, \quad V = 3i + 3$$

اگر D_1 خاموش و D_2 روشن باشد داریم:

$$V_A = (V - 1) \times \frac{1}{2} + 1, \quad V_B = 1V$$

$$ID_2 = \frac{V - 1}{2} - 1 = \frac{V - 3}{2} > 0 \rightarrow V > 3$$

$$V_A < 3 \Rightarrow V \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} < 3 \rightarrow V < 5V$$

شرط روشن بودن D_2

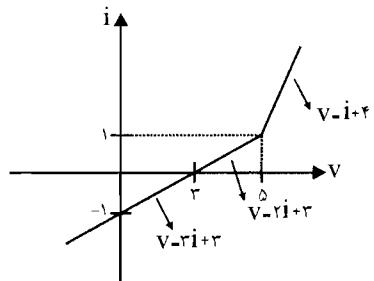
شرط خاموش بودن D_1

که قسمت مشترک $3 < V < 5$ می‌باشد برای اینکه D_1 خاموش و D_2 روشن باشد.

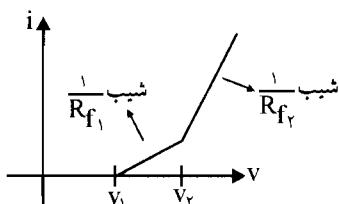
$$V = (i + 1) \times 2 + 1$$

$$= 2i + 3$$

$$3 < V < 5 \Rightarrow \begin{cases} D_1: \text{OFF} \\ D_2: \text{ON} \end{cases}, \quad V = 2i + 3$$



۱۰- منحنی مشخصه یک دیود را مطابق شکل م - ۱۰ مدل سازی کنید. مدار معادل این مدل را با استفاده از دیودهای ایده‌آل، مقاومت‌های و منابع طرح کنید. مقادیر قطعه‌های به کار رفته در مدار را بحسب پارامترهای مدل به دست آورید.



شکل م

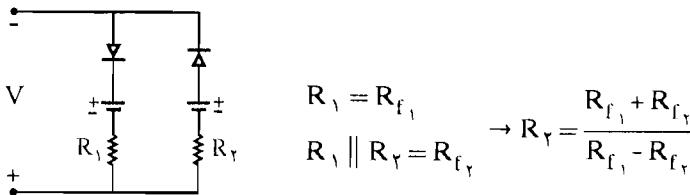
۱۰ مدل:

$V \leq V_1 \rightarrow$ هر دو دیود قطع

با توجه به شکل م - ۱۰ داریم:

$V_1 \leq V \leq V_2 \rightarrow D_2$ وصل و D_1 قطع

$V \geq V_2 \rightarrow$ هر دو دیود روشن

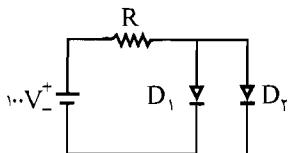


11- در مدار شکل م- 11 دیودها دارای مدل خطی پاره‌ای به صورت زیر هستند:

$$D_1 = V_{D_1} = 0/2, \quad R_f = 20\Omega$$

$$D_2 = V_{D_2} = 0/6, \quad R_f = 15\Omega$$

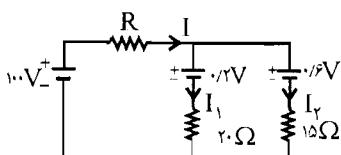
به ازای $R = 10K\Omega$ و $R = 1K\Omega$ جریان دیودها را به دست آورید.



شکل م- 11

راه حل:

هر دو دیود به صورت مستقیم بایاس شده‌اند پس مدار معادل به صورت شکل زیر می‌باشد.



$$\begin{cases} VD_1 = 0/2 + 0/0.2I_1 \\ VD_2 = 0/6 + 0/0.15I_2 \end{cases}$$

$$\text{از طرفی: } VD_1 = VD_2 \rightarrow 0/2 + 0/0.2I_1 = 0/6 + 0/0.15I_2$$

$$\rightarrow 0/0.2I_1 = 0/4 + 0/0.15I_2 \rightarrow I_1 = 20 + 0/V5I_2$$

$$\text{KCL: } I = I_1 + I_2 = I_2 + 20 + 0/V5I_2 = 20 + 1/V5I_2$$

$$\text{KVL: } 100 = RI + 0/6 + 0/0.15I_2 = R(20 + 1/V5I_2) + 0/6 + 0/0.15I_2$$

$$R = 1K\Omega \rightarrow 100 = 1K\Omega(20 + 1/V5I_2) + 0/6 + 0/0.15I_2$$

$$\rightarrow 100 = 20 + 1/V5I_2 + 0/6 + 0/0.15I_2 \rightarrow 79/4 = 1/V50I_2$$

$$\rightarrow I_2 = \frac{79/4}{1/V50} = 45 \text{ mA} \rightarrow I_1 = 20 + 0/V5I_2 = 53/V5 \text{ mA}$$

$$R = 1K\Omega \rightarrow 100 = 10(20 + 1/V5I_2) + 0/6 + 0/0.15I_2 \rightarrow$$

$$100 = 200/5 + 1V/52I_2 \rightarrow I_2 = -5 \text{ mA}$$

یعنی در این حالت دیود D_2 هدایت نمی‌کند و اگر فرض کنیم دیود D_1 هدایت می‌کند داریم:

$$I = I_1 = \frac{100 - 0}{10 + 0} = 9/96 \text{ mA}$$

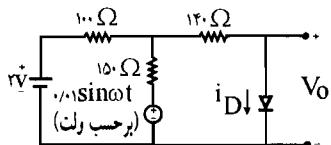
۱۲- در مدار شکل م- ۱۲ معادله ولتاژ - جریان دیود آن به صورت زیر است:

$$i_D = 10^{-9} \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

(آبر حسب آمپر و V_D بر حسب ولت) مطلوبست محاسبه مقادیر زیر:

الف) مدار معادل تونن دو سر دیود
ب) جریان ثابت گذرنده از دیود

ج) مقاومت دینامیکی دیود (r_d)
د) ولتاژ خروجی V_o

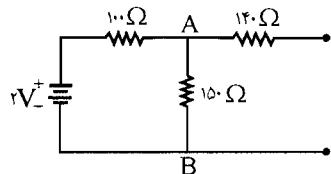


شکل م- ۱۲

راه حل:

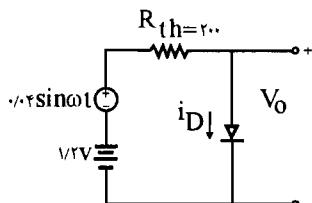
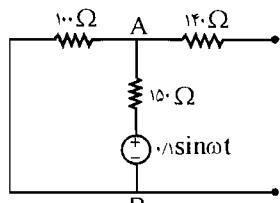
الف) برای به دست آوردن مدار معادل تونن دو سر دیود در شکل dc باید منبع ac را از بین ببریم:

$$\begin{cases} R_{th} = 15\Omega \parallel 10\Omega + 14\Omega = 20\Omega \\ V_{th} = 2 \times \frac{15}{15+10} = 1/2V = V_{AB} \end{cases}$$



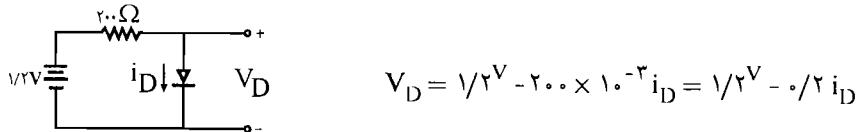
و تونن دو سر دیود در شکل ac با بی اثر کردن منبع dc به دست می‌آید.

$$\begin{cases} R_{th} = 15\Omega \parallel 10\Omega + 14\Omega = 20\Omega \\ V_{th} = 0/1 \sin \omega t \times \frac{10}{10+15} = 0.4 \sin \omega t \end{cases}$$



پس مدار معادل تون به صورت زیر می‌باشد:

ب) برای به دست آوردن جریان DC دیود منبع سینوسی در مدار معادل تونن اتصال کوتاه می‌شود:



فرض مسئله: $i_D = 10^{-6} \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right)$

$$\Rightarrow i_D = 10^{-6} \left(e^{\frac{1/2 - 0.2 i_D}{26} \times 1000} - 1 \right) \times 10^3$$

$$\Rightarrow 10^3 i_D = \left[e^{\left(\frac{1/2 - 0.2 i_D}{26} \times 1000 \right)} - 1 \right]$$

از روش سعی و خطأ استفاده می‌کنیم:

فرض $V_D = 0.2V \Rightarrow I_D = \frac{1/2 - V_D}{0.2} = \frac{1/2 - 0.2}{0.2} = 5mA$

$$\rightarrow 10^3 \times 5 = e^{\left(\frac{1/2 - 0.2 \times 5}{26} \times 1000 \right)} - 1 \Rightarrow 5000 = e^{2191/4} - 1$$

پس طرف دوم باید بزرگتر شوند لذا i_D را باید کوچکتر انتخاب کنیم:

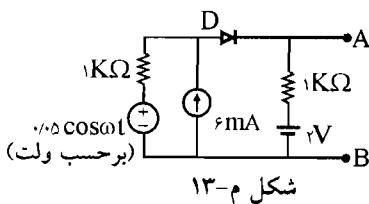
$$i_D = 4/9 mA \Rightarrow 2/9 \times 10^3 = e^{\left(\frac{1/2 - 4/9 \times 0.2}{26} \times 1000 \right)} - 1 = 4728$$

پس $i_D = 4/9 mA$ را می‌پذیریم.

$$r_d = \frac{V_T}{i_D} = \frac{26 mV}{4/9 mA} = 5.25 \Omega$$

$$V_o = V_D = 1/2 - 0.2 i_D = 1/2 - 0.2 \times 4/9 = 0.22 V \quad (d)$$

۱۳- در مدار شکل م- ۱۳ دیودها دارای $I_s = 1mA$ مطلوب است محاسبه مقادیر زیر:



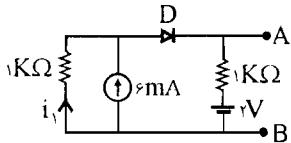
الف) نقطه کار DC دیود *

ب) مقاومت دینامیکی دیود

ج) $V_{AB}(t)$

راه حل:

الف) برای تعیین نقطه کار DC دیود مدار را تحلیل DC می‌کنیم:



$$\text{KVL: } 1\text{k}\Omega \times i_1 + V_D + i_D \times 1\text{k}\Omega + V = 0 \rightarrow i_1 + V_D + i_D + V = 0$$

$$\text{KCL: } i_1 = i_D - 8\text{ mA}$$

$$\rightarrow \begin{cases} V_D + 2i_D = 0 \\ \frac{V_D}{1\text{k}\Omega} = i_1 \\ i_D = i_s e^{\frac{V_D}{2T}} \end{cases} \rightarrow V_D + 2i_s e^{\frac{V_D}{2T}} = 0 \rightarrow V_D + 2 \times 8\text{ mA} e^{\frac{V_D}{2T}} = 0$$

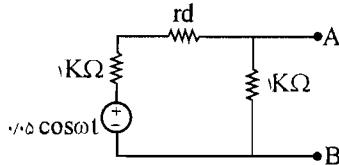
$$\frac{V_D}{2T} = x \rightarrow V_D = 2Tx \rightarrow 2Tx + 2 \times 8 \times 10^{-6} e^x = 0$$

از حل این معادله مقادیر زیر به دست می‌آید $V_D = 0.74\text{ V}$ و $I_{DQ} = 1/8\text{ mA}$

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_D} = \frac{2 \times 26}{1/8} = 32\Omega \quad (\text{ب})$$

ج) تحلیل ac:

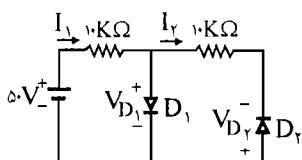
$$V_{AB}(t) = \frac{1000 \times 0.74}{1000 + 32 + 1000} \cos \omega t = 0.24 \cos \omega t \quad \text{با استفاده از تقسیم ولتاژ داریم:}$$



۱۴- در مدار شکل م-۱۴، دیودها دارای $R_f = r_z = 50\Omega$ و $V_g = 0.7\text{ V}$ و ولتاژ شکست 25 V هستند. مطلوب است:

. V_{D2}, V_{D1}, I_1 (الف)

ب) با تغییر جهت هر دو دیود، بند (الف) را تکرار کنید.



شکل م-۱۴

۱۵ حل:

$$I_2 = 0, \quad I_1 = \frac{50 - 0/V}{10000 + 50} = 4/9 \text{ mA}$$

با فرض قطع بودن دیود D_2 داریم:

$$VD_1 = 50 I_1 + 0/V = 50 \times 4/9 \text{ mA} + 0/V = 0.945 \text{ V}$$

پس فرض قطع بودن دیود D_2 درست می‌باشد و D_2 به شکست نمی‌رود.

$$\rightarrow V_{D_1} = -V_{D_2} = -0.945 \text{ V}$$

ب) وقتی جهت دیودها عوض می‌شود فرض می‌کنیم دیود D_1 قطع می‌باشد و با این فرض مسئله را حل

$$I_1 = \frac{50 - 0/V}{20000 + 50} = 2/46 \text{ mA} \quad \text{می‌کنیم.}$$

$$V_{D_1} = 50 - 10 \times 2/46 = 25/4$$

پس فرض قطع بودن D_1 اشتباه می‌باشد و دیود D_1 به شکست نمی‌رود.

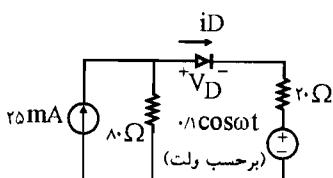
$$I_2 = \frac{25/4 - 0/V}{10000 + 50} = 2/45 \text{ mA}, \quad VD_2 = 2/45 \times 0.05 + 0/V = 0.822 \text{ V}$$

۱۵- در مدار شکل م-۱۵ معادله مشخصه دیود را به صورت زیر در نظر بگیرید.

$$i_D = \begin{cases} 200(V_D - 0.5)^2 & V_D \geq 0.5 \\ 0 & V_D \leq 0.5 \end{cases}$$

بر حسب V_D و mA بر حسب (V) مطلوب است محاسبه مقادیر زیر:

الف) نقطه کار DC دیود.

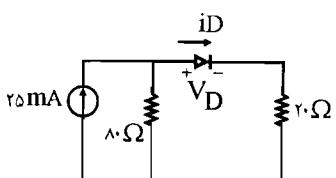


ب) مقاومت دینامیکی دیود

$$i_D(t)$$

۱۵ حل:

الف) برای به دست آوردن نقطه کار DC دیود مدار را تحلیل می‌کنیم:



$$\text{KVL: } 10(I_D - 25 \times 10^{-3}) + V_D + 20I_D = 0$$

$$\rightarrow 100I_D + V_D - 2 = 0 \quad (I)$$

طبق فرض مسئله داریم: (II) $I_D = 200(V_D - 0.5)^2$ mA می‌باشد.
با قرار دادن رابطه (II) در رابطه (I) داریم:

$$100 \times \left[0.2(V_D - 0.5)^2 \right] + V_D - 2 = 0$$

$$\rightarrow 20(V_D - 0.5)^2 + V_D - 2 = 0$$

$$20V_D^2 - 20V_D + 5 + V_D - 2 = 0 \rightarrow$$

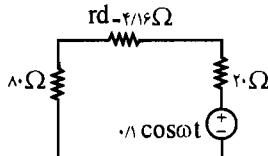
$$20V_D^2 - 19V_D + 3 = 0$$



از حل این معادله $V_D = 7.5$ V به دست می‌آید. با قرار دادن این مقدار در رابطه (II) مقدار $I_D = 12/5$ mA به دست می‌آید.

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_D} = \frac{0.5}{12/5} = 4/16 \Omega \quad (b)$$

ج) تحلیل ac :



$$i_D = \frac{-0.1 \cos \omega t}{4 + 20 + 4/16} = -0.96 \cos \omega t \text{ (A)}$$

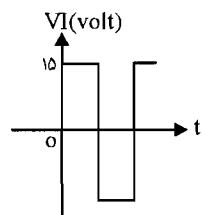
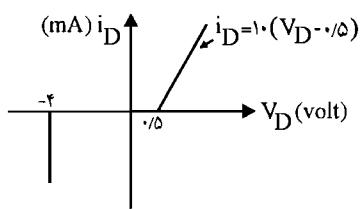
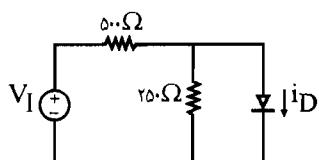
$$i(t) = i_D + I_D = -0.96 \cos \omega t + 12/5 \times 10^{-3} \text{ (A)}$$

۱۶- شکل موج ورودی، مشخصه ولتاژ - جریان دیود و مدار شکل م- ۱۶ را در نظر بگیرید.

الف) مدار معادل تونن دو سر دیود را به دست آورید.

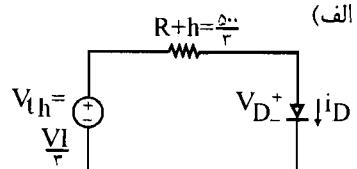
ب) (t) i_D را رسم کنید.

ج) جریان متوسط دیود را به دست آورید.



ا) مل:

$$\begin{cases} R_{th} = 25\Omega \parallel 50\Omega = \frac{500\Omega}{3} \\ V_{th} = V_I \times \frac{25}{25+50} = V_I \times \frac{1}{3} = \frac{V_I}{3} \end{cases}$$



ب) تغییرات V_I شامل دو قسمت می باشد

$$\begin{cases} V_I = 15V \\ V_I = -15V \end{cases}$$

$$V_I = 15V \Rightarrow \text{KVL: } V_D = V_{th} - R_{th} \times i_D = \frac{15}{3} - \frac{500}{3} i_D \Rightarrow i_D = \frac{15 - 3V_D}{500} A$$

$$\Rightarrow i_D = 2(15 - 3V_D) mA$$

این رابطه را در رابطه دیود (نمودار i_D بر حسب V_D) قرار می دهیم. طبق نمودار فرض می کنیم دیود در در ناحیه خطی کار می کند پس داریم:

$$i_D = 10(V_D - 0/5) = 2(15 - 3V_D) \Rightarrow V_D = 2/19 V$$

مقدار به دست آمده در $V_D > 0/5$ صدق می کند پس دیود در این ناحیه در ناحیه خطی کار می کند.

$$\Rightarrow V_I = 15V , V_D = 2/19 V$$

$$i_D = 10(V_D - 0/5) = 10(2/19 - 0/5) = 16/9 mA$$

$$V = -15V \Rightarrow$$

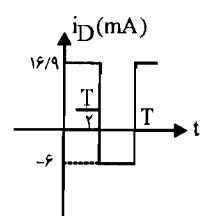
با $V_I = -15V$ دیود در ناحیه شکست قرار دارد ($V_D = -4V$) در این حالت i_D باید منفی باشد پس

را حساب می کنیم:

$$i_D = \frac{V_{th} - V_D}{R_{th}} = \frac{-\frac{15}{3} - (-4)}{\frac{500}{3}} = \frac{-1}{\frac{500}{3}} = \frac{-3}{500} A \Rightarrow i_D = -6 mA$$

اکمتر از صفر یعنی منفی به دست آمد لذا دیود در ناحیه شکست قرار دارد پس داریم:

$$\Rightarrow V_I = -15V , V_D = -4V , i_D = -6 mA$$

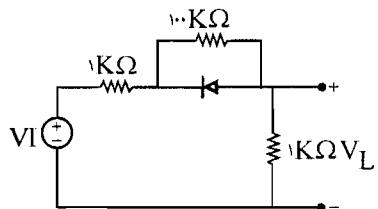
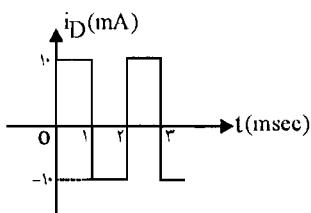


$$i_D = \frac{16/9 \times \frac{T}{2} - 6 \times \frac{T}{2}}{T} = \frac{16/9 - 6}{2} = \frac{10/9}{2} = 5/45 \text{ mA} \quad (ج)$$

۱۷- مدار شکل م-۱۷ را در نظر بگیرید.

(الف) با فرض ایدهآل بودن دیود ولتاژ V_L را به دست آورده و رسم کنید.

(ب) بند (الف) را با فرض ورودی مثلثی تکرار کنید (دامنه موج ورودی را 10 V ولت در نظر بگیرید).



شکل م-۱۷

۱۸ حل:

(الف) طبق نمودار V_I را بر حسب i داریم:

اگر $V_I = 10 \text{ V}$ باشد فرض می‌کنیم D خاموش باشد در این صورت داریم:

$$V_L = V_I \times \frac{1}{1 + 100 + 1} = V_I \times \frac{1}{102} = \frac{10}{102} = 0.1 \text{ V}$$

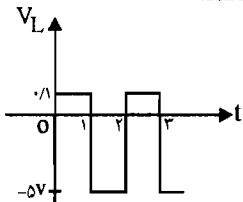
$$V_D = -V_I \times \frac{100}{100 + 1 + 1} = -0.1 \times \frac{100}{102} = -9.8 \text{ V}$$

چون V_D منفی می‌باشد و مقدارش برابر -9.8 V - شد پس فرض قطع بودن دیود درست می‌باشد.

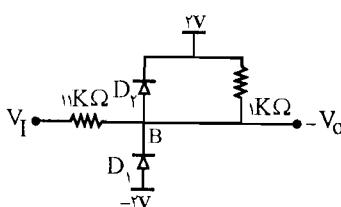
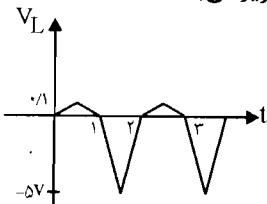
اگر $V_I = -10 \text{ V}$ باشد فرض می‌کنیم دیود روشن می‌باشد پس داریم:

$$V_L = -10 \times \frac{1}{1 + 1} = -5 \text{ V} \quad , \quad i_D = \frac{0 - (-10)}{2} = 5 \text{ mA}$$

پس روشن بودن دیود درست می‌باشد پس شکل موج V_L به صورت زیر می‌باشد.



ب) اگر ورودی موج مثلثی با دامنه ۱۰ ولت باشد خروجی به صورت شکل زیر می‌باشد:



۱۸- در مدار شکل م-۱۸ دیودها را ایدهآل در نظر بگیرید.

(الف) مشخصه انتقالی را رسم کنید. ($-8V < V_I < 8V$)

(ب) پس از حذف مقاومت موازی D_2 مشخصه را مجدداً رسم نمایید.

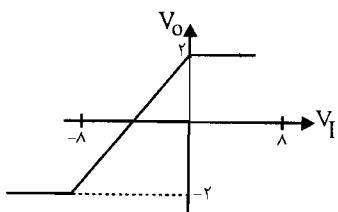
شکل م-۱۸

۱۹ حل:

$$V_B = 2 + \frac{1K\Omega \times V_I}{1k\Omega \times 1k\Omega} = 2 + 0.5 V_I \quad (\text{الف})$$

$$\begin{cases} D_1: \text{ON} \\ D_2: \text{Off} \end{cases} : V_B < -2V \rightarrow 2 + 0.5 V_I < -2V \rightarrow V_I < -8V, V_o = -2V$$

$$\begin{cases} D_1: \text{ON} \\ D_2: \text{Off} \end{cases} : V_B > 2V \rightarrow 2 + 0.5 V_I > 2 \rightarrow V_I > 0V, V_o = 2V$$

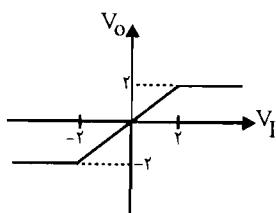


$$\begin{cases} D_1: \text{Off} \\ D_2: \text{On} \end{cases} : -2 < V_B < 2 \rightarrow V_o = V_B = 2 + 0.5 V_I$$

$$\begin{cases} D_1: \text{Off} \\ D_2: \text{On} \end{cases} : V_I > 2V \rightarrow V_o = 2V$$

$$\begin{cases} D_1: \text{On} \\ D_2: \text{Off} \end{cases} : V_I < -2V \rightarrow V_o = -2V$$

$$\begin{cases} D_1: \text{off} \\ D_2: \text{Off} \end{cases} : -2V < V_I < 2V \rightarrow V_o = V_I$$

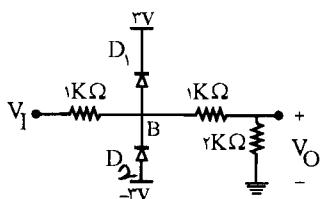


ب)

۱۹- در مدار شکل م - ۱۹ دیودها را ایدهآل فرض کنید.

(الف) مشخصه انتقالی را رسم کنید ($-V \leq V_I \leq V$)

(ب) اگر جهت D_1 عوض شود مشخصه جدید را رسم نمایید.



شکل م - ۱۹

۱۹- حل:

(الف) ابتدا ولتاژ نقطه B را بر حسب V_I می‌نویسیم:

$$V_B = \frac{(1+2)k\Omega \times V_I}{(1+2)k\Omega + 1k\Omega} = \frac{3}{4} V_I$$

از تقسیم ولتاژ استفاده می‌کنیم:

$$V_o = \frac{2k\Omega \times V_B}{2k\Omega + 1k\Omega} = \frac{2}{3} V_B$$

برای اینکه دیود D_2 روشن باشد باید ولتاژ نقطه B از $-3V$ کمتر باشد:

$$D_2: ON ; \quad V_B < -3 \rightarrow \frac{3}{4} V_I < -3 \Rightarrow V_I < -4V$$

$$\rightarrow V_B = -3V \rightarrow V_o = \frac{2}{3} \times -3V = -2V$$

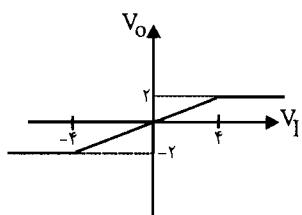
برای اینکه دیود D_1 روشن باشد باید ولتاژ نقطه B از $3V$ بیشتر باشد:

$$D_1: ON ; \quad V_B > 3V \rightarrow \frac{3}{4} V_I > 3 \rightarrow V_I > 4V \rightarrow V_B = 3V \rightarrow$$

$$V_o = \frac{2}{3} \times 3 = 2V$$

و در حالتی که $-3V < V_B < 3V$ باشد هر دو دیود خاموش می‌باشند:

$$D_1, D_2: Off ; \quad -3V < V_B < 3V \rightarrow V_o = \frac{2K\Omega \times V_I}{(2K\Omega + 1K\Omega + 1K\Omega)} = \frac{1}{2} V_I$$

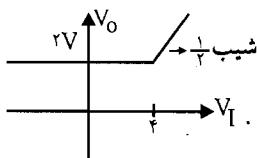


ب) وقتی جهت دیود D_1 عوض می‌شود برای اینکه دیود D_1 باشد باید $V_B < 3V$ باشد.

$$D_1: ON ; V_B < 3V \rightarrow V_I < 4V \rightarrow V_B = 3V \rightarrow V_o = 2V$$

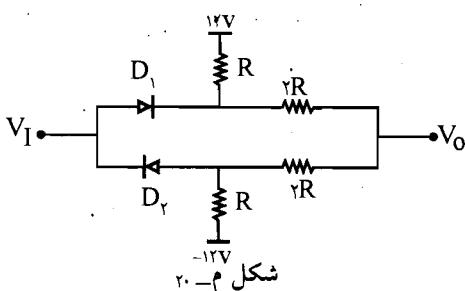
و وقتی $V_B > 3V$ شود هر دو دیود خاموش می‌شوند پس داریم:

$$D_1, D_2: off ; V_B > 3V \rightarrow V_I > 4V \rightarrow V_o = \frac{1}{2} V_I$$



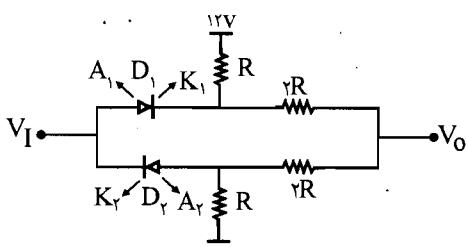
۲۰- در مدار شکل م - ۲۰ برای هر یک از دیودها داریم: $R_f = \infty$ و $R_r = 0/V$

مشخصه انتقالی مدار را به دست آورده و رسم کنید.



راه حل:

ابتدا فرض می‌کنیم هر دو دیود خاموش باشند در این صورت با استفاده از جمع آثار خواهیم داشت:



$$V_o = 12 \times \frac{(R + 2R)}{(R + 2R + R + 2R)} + (-12) \times \frac{(R + 2R)}{(R + 2R + R + 2R)}$$

$$\rightarrow V_o = 0V$$

شرط خاموش بودن دیود D_1 به صورت مقابل می‌باشد:

$$V_{A_1} - V_{K_1} < 0/V$$

$$\begin{cases} V_{K_1} = 12 \times \frac{(2R + R + 2R)}{(R + 2R + R + 2R)} - 12 \times \frac{R}{(R + 2R + R + 2R)} \Rightarrow V_{K_1} = 12 \times \frac{5}{6} - 12 \times \frac{1}{6} \\ V_{A_1} = V_I \end{cases} .$$

$$\Rightarrow V_{K_1} = 10 - 2 = 8V$$

$$\Rightarrow V_{A_1} - V_{K_1} < 0/V \Rightarrow V_I - 8 < 0/V \Rightarrow V_I < 8/V$$

$$V_{A_2} - V_{K_2} < 0/V$$

شرط خاموش بودن دیود D_2 به صورت مقابل می‌باشد:

$$\begin{cases} V_{A_2} = -12 \times \frac{(R + 2R + 2R)}{(R + 2R + R + 2R)} + 12 \times \frac{R}{(R + 2R + R + 2R)} = -12 \times \frac{5}{6} + 12 \times \frac{1}{6} = -8V \\ V_{K_2} = V_I \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_{A_2} - V_{K_2} < 0/V \Rightarrow -8 - V_I < 0/V \rightarrow V_I > -8/V$$

پس در صورتی که $-8/V < V_I < 8/V$ باشد هر دو دیود خاموش می‌باشند. و در این صورت V_o نیز

صفر می‌باشد:

$$-8V < V_I < 8V \Rightarrow \begin{cases} D_1: \text{off} \\ D_2: \text{off} \end{cases}, \quad V_o = 0V$$

و اگر $V_I > 8/V$ شود در این صورت دیود D_1 روشن می‌شود و دیود D_2 همچنان خاموش می‌باشد در این صورت V_o را با استفاده از جمع آثار به دست می‌آوریم: (وقتی D_1 روشن می‌شود به جای آن در مدار یک منبع ولتاژ به اندازه $V_I - 8/V$ در نظر می‌گیریم).

$$V_o = (V_I - 8/V) \times \frac{(R + 2R)}{(R + 2R + \eta R)} + (-12) \times \frac{2R}{(R + 2R + 2R)} = 0/6 V_I - 5/22$$

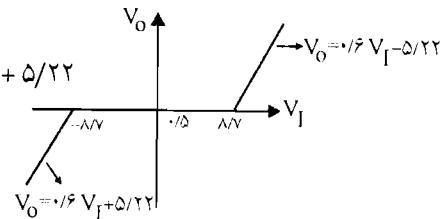
$$\Rightarrow V_I > 8/V \Rightarrow \begin{cases} D_1: \text{ON} \\ D_2: \text{Off} \end{cases}, \quad V_o = 0/6 V_I - 5/22$$

و اگر $V_I < -8/V$ باشد در این صورت دیود D_2 روشن می‌شود و دیود D_1 خاموش می‌باشد پس داریم: (در این حالت به جای D_2 یک منبع ولتاژ به اندازه $-V_I - 8/V$ در مدار در نظر می‌گیریم).

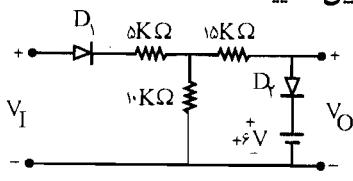
$$V_o = 12 \times \frac{2R}{2R + 2R + R} + (V_I + 8/V) \times \frac{(R + 2R)}{(R + 2R + 2R)}$$

$$\Rightarrow V_o = 0/6 V_I + 5/22$$

$$\Rightarrow V_I < -V \Rightarrow \begin{cases} D_1: \text{Off} \\ D_2: \text{ON} \end{cases} \Rightarrow V_o = 0/6 V_I + 5/22$$



۲۱- در شکل م- ۲۱ دیودها ایدهآل هستند. مشخصه انتقالی مدار را برای V_I $\leq -20\text{V}$ و $V_I \geq 20\text{V}$ - رسم نموده، در هر ناحیه از مشخصه، وضعیت هو یک از دیودها را تعیین نمایید.



شکل م- ۲۱

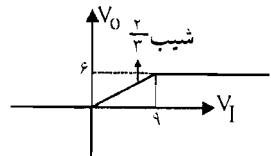
راه حل:

$$V_I < -V \rightarrow \begin{cases} D_1: \text{Off} \\ D_2: \text{Off} \end{cases} \rightarrow V_o = -V$$

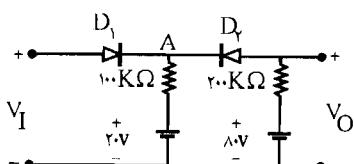
$$-V < V_I < ? \rightarrow \begin{cases} D_1: \text{ON} \\ D_2: \text{Off} \end{cases} \rightarrow \frac{V_I - V_o}{5} = \frac{V_o}{10} \rightarrow 2V_I - 2V_o = V_o \\ \rightarrow V_o = \frac{2}{3} V_I \rightarrow V_o = 6V \rightarrow V_I = 9$$

$$\rightarrow -V < V_I < 9V \quad \begin{cases} D_1: \text{ON} \\ D_2: \text{Off} \end{cases}$$

$$V_I > 9V \rightarrow \begin{cases} D_1: \text{ON} \\ D_2: \text{ON} \end{cases} \rightarrow V_o = 6V$$



۲۲- ولتاژ ورودی V_I مدار شکل م- ۲۲ از 0 تا 100 ولت به صورت خطی تغییر می کند. ولتاژ خروجی V_o را با همان مقیاس زمانی T رسم نمایید. (دیودها را ایدهآل فرض کنید)



شکل م- ۲۲

(اہ حل:

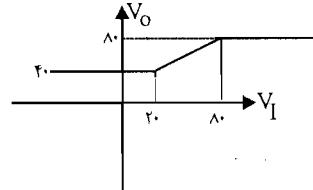
وقتی $V_I < 2.0 \text{ V}$ باشد D_1 خاموش و D_2 روشن می‌باشد با استفاده از تقسیم ولتاژ مقدار V_O را به دست می‌آوریم.

$$V_I < 2.0 \text{ V} \rightarrow \begin{cases} D_1: \text{Off} \\ D_2: \text{ON} \end{cases} \rightarrow \frac{V_O - 2.0}{100} + \frac{V_O - 8.0}{200} = 0 \rightarrow V_O = 4.0 \text{ V}$$

وقتی $2.0 \text{ V} \leq V_I \leq 8.0 \text{ V}$ باشد هر دو دیود روشن می‌باشند پس داریم

$$V_O = V_I$$

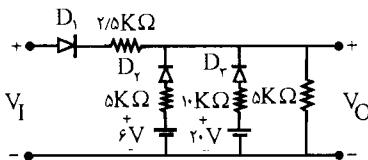
$$2.0 \text{ V} < V_I < 8.0 \text{ V} \rightarrow \begin{cases} D_1: \text{ON} \\ D_2: \text{ON} \end{cases} \rightarrow V_O = V_I$$



وقتی V_I بزرگتر از 8.0 V ولت می‌شود دیود D_1 روشن می‌باشد و D_2 خاموش (چون در این صورت در D_2 ولتاژ آند از کاتد کوچکتر می‌باشد) پس در مدار معادل داریم $V_O = 8.0 \text{ V}$

$$V_I > 8.0 \text{ V} \rightarrow \begin{cases} D_1: \text{ON} \\ D_2: \text{Off} \end{cases} \rightarrow V_O = 8.0 \text{ V}$$

۲۳- در مدار شکل م-۲۳، با فرض ایده‌آل بودن دیودها: مشخصه انتقالی را به دست آورد و رسم نمایید. ورودی V_I از 0 تا 5.0 V ولت تغییر می‌کند.



شکل م-۲۳

(اہ حل:

حالت اول حالتی است که D_1 خاموش و D_2 روشن و D_3 خاموش است:

$$\begin{cases} D_1: \text{Off} \\ D_2: \text{ON} \\ D_3: \text{Off} \end{cases} \rightarrow V_O = \frac{6 \times 5\text{K}\Omega}{5+5} = 3\text{V}$$

و چون $V_O = 3\text{V}$ و D_1 هم خاموش می‌باشد پس

$$3\text{V} < V_I < ?\text{V} \rightarrow \begin{cases} D_1: \text{ON} \\ D_2: \text{ON} \\ D_3: \text{Off} \end{cases} \rightarrow \frac{V_O - V_I}{2.5} + \frac{V_O - 6}{5} + \frac{V_O}{5} = 0$$

$$\rightarrow V_O = \frac{V_I}{2} + \frac{3}{2}$$

و برای اینکه D_2 روشن باشد و D_3 خاموش $V_o = 6V$ باید از $6V$ کوچکتر باشد یعنی داریم:

$$V_o = \frac{V_I}{2} + \frac{3}{2} < 6V \Rightarrow V_I < 9V$$

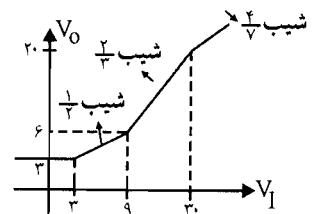
$$9V < V_I < ? \rightarrow \begin{cases} D_1: ON \\ D_2: Off \rightarrow V_o = V_i \times \frac{5}{5+2.5} = \frac{2}{3} V_I \\ D_3: Off \end{cases}$$

برای اینکه D_2 همچنان خاموش باشد باید $V_o = 20V$ کوچکتر از $20V$ باشد:

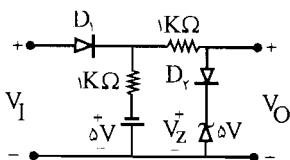
$$V_o = \frac{V}{2} V_I < 20 \rightarrow V_I < 20V$$

$$V_I > 20V \rightarrow \begin{cases} D_1: ON \\ D_2: Off \rightarrow \frac{V_o - V_I}{2/5} + \frac{V_o - 20}{10} + \frac{V_o}{5} = 0 \\ D_3: ON \end{cases}$$

$$\rightarrow V_o = \frac{4}{5} V_I + \frac{20}{5}$$



۲۴- در مدار برش شکل م-۲۴، مشخصه انتقالی را محاسبه و رسم نمایید (دیودها را ایده‌آل فرض کنید).

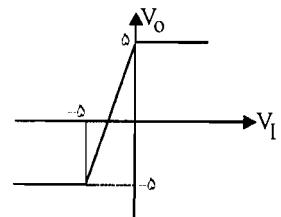


شکل م-۲۴

$$V_I < -5V \rightarrow \begin{cases} D_1: Off \\ D_2: Off \end{cases} \rightarrow V_o = -5V$$

$$V_I > -5V \rightarrow \begin{cases} D_1: ON \\ D_2: Off \end{cases} \Rightarrow \frac{V_I + 5V}{1} + \frac{V_I - V_o}{1} = 0$$

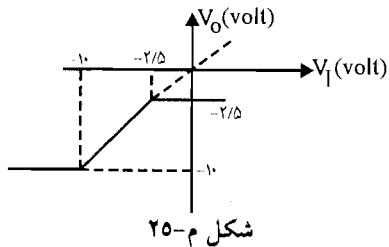
$$\rightarrow V_o = 2V_I + 5$$



برای اینکه D_2 روشن شود باید $V_o = 5V$ بزرگتر از $5V$ شود.

$D_2: ON \rightarrow V_o > 5V \rightarrow 2V_I + 5V > 5 \rightarrow V_I > 0 \rightarrow V_o = 5V$

۲۵- مشخصه انتقالی شکل م-۲۵ را در نظر بگیرید. یک مدار برای مشخصه مذکور طراحی نموده و مقادیر قطعه‌های به کار رفته را مشخص نمایید. (از دیودهای ایده‌آل، مقاومت و منابع استفاده کنید).



(۱) هل:

با توجه به شکل م-۲۵ داریم:

وقتی V_I کوچکتر از -10^7 است V_O مقدار ثابت می‌باشد

$$V_I < -10^7 \rightarrow V_O = -10^7$$

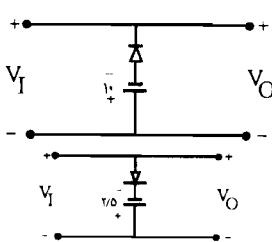
تا به اینجا شکل مدار به صورت مقابل می‌باشد. ←

وقتی V_I بزرگتر از $-2/5^7$ است V_O مقدار ثابت می‌باشد.

$$V_I > -2/5^7 \rightarrow V_O = -2/5^7$$

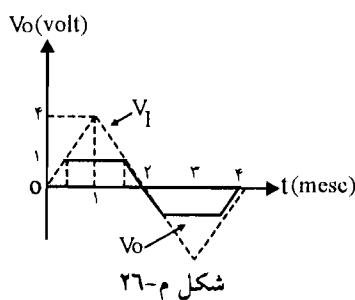
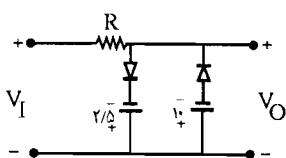
در این حالت مدار به صورت مقابل می‌باشد. ←

وقتی V_I بین این دو مقدار می‌باشد رابطه خطی $V_O = V_I$ برقرار می‌باشد.



$$-10^7 < V_I < -2/5^7 \rightarrow V_O = V_I \rightarrow$$

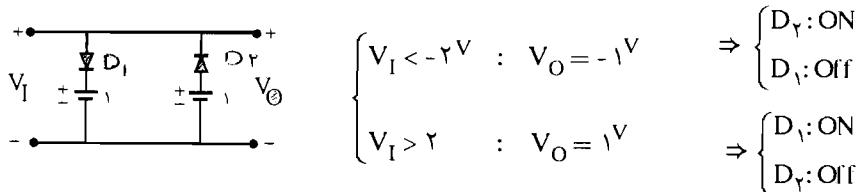
در حالت سوم هر دو دیود قطع هستند و همچنین یک مقاومت برای کنترل جریان و حفاظت دیودها نیاز داریم، پس مداری کلی به صورت زیر می‌باشد.



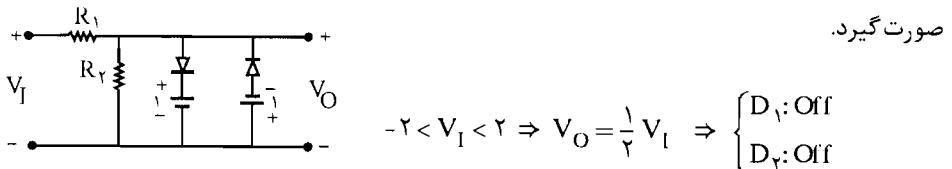
۲۶- مداری طراحی کنید که از شکل موج مثلثی ورودی نشان داده شده در شکل م-۲۶، شکل موج ذوزنقه‌ای نشان داده شده را ایجاد نماید (از دیودهای ایده‌آل، مقاومت و منابع استفاده نمایید).

۱۴ حل:

به ازای V_I های بزرگتر و کوچکتر از یک مقدار خاصی مقدار V_O برابر ۱ می‌شود پس قسمت زیر حتماً باید در مدار باشد:



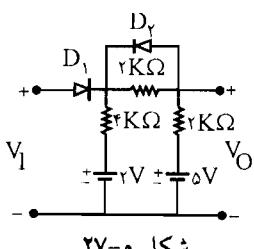
و در بقیه V_I ها، V_O کسری از V_I می‌باشد پس باید مقاومت‌های زیر را در مدار قرار دهیم تا تقسیم ولتاژ



مقادیر R_1 و R_2 با توجه به نسبت I_1 و I_2 مشخص می‌شوند.

۲۷- در مدار شکل م-۲۷، دیودها ایده‌آل هستند. مشخصه انتقالی را محاسبه و رسم نمایید.

۱۵ حل:



شرط ON بودن دیود D_2 به صورت زیر می‌باشد:
 $I_{D_2} > 0 \Rightarrow V_I + 5 > 0 \Rightarrow V_I < 5$

و شرط ON بدن دیود D_1 نیز چنین می‌باشد:
 $I_{D_1} > 0 \Rightarrow I_{D_1} = I_1 - I_{D_2}$

$$\Rightarrow I_{D_1} = \frac{V_I - 2}{4} + \frac{V_I - 5}{2} \Rightarrow I_{D_1} = \frac{3V_I - 12}{4} > 0 \Rightarrow V_I > 4V$$

پس برای اینکه دیود D_1 خاموش باشد باید $V_I < 4V$ باشد. با توجه به مطالب بالا وقتی $V_I < 4V$ است، دیود D_2 روش می‌باشد.

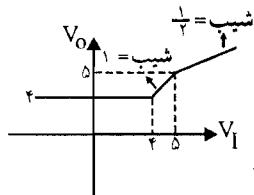
$$V_I < ?^4V \rightarrow \begin{cases} D_1: Off \\ D_2: On \end{cases} \rightarrow V_O = 5 - \frac{(5-2) \times 2K\Omega}{2+4} = 5 - 1 = 4V$$

وقتی V_I از $5V$ بزرگتر می‌شود، D_1 نیز روشن می‌گردد \Leftarrow

$$4V < V_I < 5V \rightarrow \begin{cases} D_1: ON \\ D_2: ON \end{cases} \rightarrow V_O = V_I = 5V$$

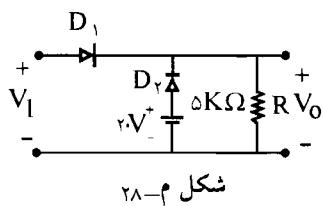
و وقتی روشن می‌باشد که V_I از $5V$ کوچکتر باشد و وقتی V_I از $2V$ بزرگتر می‌شود، D_2 خاموش می‌شود. \Leftarrow

$$V_I > 5V \rightarrow \begin{cases} D_1: ON \\ D_2: Off \end{cases} \rightarrow V_O = 5 + \frac{V_I - 5}{2+2} \times 2 = 2/5 + \frac{1}{2} V_I$$



۲۸- در مدار برش شکل م-۲۸، برای دیودهای مدار $R_f = 20\Omega$ ، $R_r = \infty$ و $V_T = 0$ است.

(الف) مشخصه انتقالی را رسم نمایید. نشان دهید که مدار دارای یک نقطه شکست گسترش یافته (دو نقطه شکست نزدیک به هم) است.

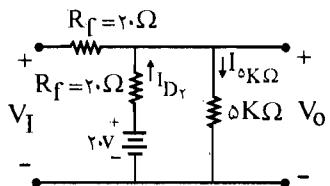


(ب) با فرض تعویض دیود D_2 با یک مقاومت $5K\Omega$ ، مشخصه انتقالی را به دست آورید.

(ج) نشان دهید در صورتی که R دیود خیلی کوچکتر از R باشد، دو نقطه شکست بند (الف) به یک نقطه شکست بند (ب) تبدیل می‌شود.

راه حل:

(الف) فرض می‌کنیم D_1 و D_2 روشن باشند در این صورت داریم:



$$V_O \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_f} \right) = \frac{V_I}{R_f} + \frac{2}{R_f} \Rightarrow V_O (2R + R_f) = R_{V_I} + 2R \Rightarrow V_O = \frac{R}{2R + R_f} V_I + \frac{2R}{2R + R_f}$$

$$\Rightarrow V_O = \frac{0.000}{1.002} V_I + \frac{2.0 \times 0.000}{1.002} \Rightarrow V_O = 0.499 V_I + 0.98 \quad (I)$$

شرط روشن بودن D_2 به صورت مقابل می باشد:

$$I_{D_1} = \frac{2.0 - V_O}{2.0} > 0 \Rightarrow 2.0 - \frac{R}{2R + R_f} V_I - \frac{2.0 R}{2R + R_f} > 0 \Rightarrow 2.0 \times 2R + 2.0 \times R_f - R_{V_I} - 2.0 R > 0$$

$$\Rightarrow V_I < 2.0 + \frac{2.0 R_f}{R} \Rightarrow V_I < 2.0 / 0.8$$

شرط روشن بودن D_1 به صورت زیر می باشد:

$$I_{D_1} = -I_{D_2} + I_{\Delta K\Omega} = -\frac{2.0 - V_O}{R_f} + \frac{V_O}{R} > 0 \Rightarrow V_O (R + R_f) - 2.0 R > 0 \Rightarrow V_O > \frac{2.0 R}{R + R_f}$$

با جایگزینی V داریم

$$\frac{R}{2R + R_f} V_I + \frac{2.0 R}{2R + R_f} > \frac{2.0 R}{R + R_f} \Rightarrow V_I (R + R_f) + 2.0 (R + R_f) > 2.0 (2R + R_f)$$

$$\Rightarrow V_I > \frac{2.0 R}{R + R_f} \Rightarrow V_I > \frac{2.0 \times 0.000}{0.000 + 2.0} = 19/92$$

بخش مشترک دو شرط بالا به صورت مقابل می باشد:

$$19/92 < V_I < 2.0 / 0.8$$

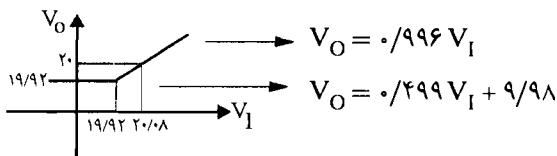
$$\Rightarrow 19/92 < V_I < 2.0 / 0.8 , \quad V_O = 0.499 V_I + 0.98 \quad \begin{cases} D_1: ON \\ D_2: ON \end{cases}$$

وقتی $V_I < 2.0 / 0.8$ باشد D_1 OFF می شود و D_2 ON می ماند.

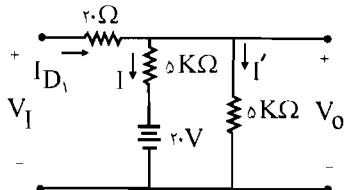
$$V_I > 2.0 / 0.8 \Rightarrow V_O = V_I \times \frac{0}{0/0.2} = 0.996 V_I \quad \begin{cases} D_1: ON \\ D_2: Off \end{cases}$$

وقتی $V_I < 19/92$ باشد D_1 ON می شود و D_2 OFF می ماند.

$$V_I < 19/92 \Rightarrow V_O = V_I \times \frac{0}{0/0.2} = 19/92 \quad \begin{cases} D_1: Off \\ D_2: ON \end{cases}$$



ب) حال اگر در مدار به جای دیود D_2 مقاومت $5\text{K}\Omega$ قرار دهیم مدار به صورت زیر درمی‌آید:



برای اینکه D_2 روشن باشد باید داشته باشیم:

$$V_{A_1} > V_{K_1} \Rightarrow \begin{cases} V_{K_1} = 2 \times \frac{5}{5+5} = 1.0 \text{ V} \\ V_{A_1} = V_I \end{cases} \Rightarrow V_I > 1.0 \text{ V}$$

(ولتاژ کاند > ولتاژ آند)

$$V_O = \left(\frac{1}{5000} + \frac{1}{5000} + \frac{1}{2} \right) V_I = \frac{V_I}{2} + \frac{2}{5000} \Rightarrow V_O = \frac{250}{252} V_I + \frac{2}{252}$$

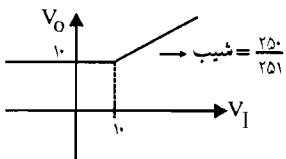
$$\Rightarrow D_2: \text{ON} \Rightarrow \begin{cases} V_I > 1.0 \text{ V} \\ V_O = \frac{250}{252} V_I + \frac{2}{252} \end{cases}$$

و وقتی $V_I < 1.0 \text{ V}$ شود D_1 خاموش می‌شود و V_O به صورت مقابل به دست می‌آید:

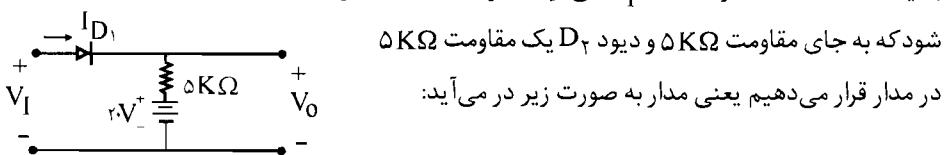
$$V_O = 2 \times \frac{5}{5+5} = 1.0 \text{ V}$$

$$\Rightarrow D_1: \text{Off} \Rightarrow \begin{cases} V_I < 1.0 \text{ V} \\ V_O = 1.0 \text{ V} \end{cases}$$

مشخصه انتقالی به صورت زیر می‌باشد:



ج) با کوچک بودن مقاومت R دو نقطه شکست نزدیک به هم، بسیار نزدیک‌تر به هم می‌شوند و تبدیل به یک نقطه شکست در $V_I = 2.0 \text{ V}$ می‌گردند در قسمت ب صورت مسئله باید به این صورت تصحیح



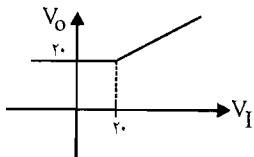
$$D_1 \text{ ON شرط } I_{D_1} = \frac{V_I - 2}{\omega} > 0 \Rightarrow V_I > 2V$$

$$\Rightarrow D_1: ON \Rightarrow \begin{cases} V_I > 2V \\ V_O = V_I \end{cases}$$

و اگر $V_I < 2V$ شود D_1 خاموش می‌شود و $V_O = 2V$ می‌شود.

$$D_1: Off \Rightarrow \begin{cases} V_I < 2V \\ V_O = 2V \end{cases}$$

و مشخصه انتقالی به صورت زیر می‌باشد:

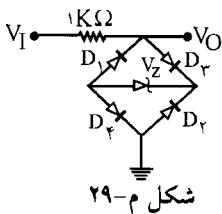


حال بند (ج) می‌تواند چنین بیان شود که با توجه به بند (الف) شکست چنین پیدا شده بودند.

$$V_I < 2 + \frac{2R_f}{R} = 2/0.8 \quad \text{و} \quad V_I > \frac{2R}{R + R_f} = 19/92$$

و با کوچک بودن R_f این دو نقطه به سوی $V_I = 2V$ میل می‌نمایند و دو نقطه شکست به یک نقطه شکست در $V_I = 2V$ تبدیل می‌گردند.

- در مدار شکل م-۲۹ با فرض $V_z = 9/2V$ و $R_f = \infty$ و $R_r = 0$ ، $V_\gamma = 0/7V$ ، مشخصه انتقالی را برابر $2V \leq V_I \leq 20V$ -رسم کنید.



شکل م-۲۹

(اه هل):

اگر D_3 و D_4 روشن و D_1 و D_2 خاموش باشند D_2 در حالت شکست باشد داریم:

$$V_O = V_z + V_\gamma + V_\gamma = 9/2 + 0/7 + 0/7 = 9/6$$

$$D_2: \text{شرط روشن بودن } D_2 \text{ و } D_4 \Rightarrow I_{D_2} = I_{D_4} = I_{D_z} = \frac{V_I - V_\gamma - V_\gamma - V_z}{1} > 0 = \frac{V_I - 9/6}{1} > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_I > 9/6 \\ V_+ = 9/6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_1, D_2: Off \\ D_3, D_4: ON \end{cases}$$

اگر D_1 و D_2 خاموش و D_3 و D_4 روشن باشند و D_Z در حالت شکست باشد.

$$V_O = -V_\gamma - V_\gamma - V_Z = -9/6$$

$$D_1 = D_2 = I_{D_1} = I_{D_2} = \frac{-V_I - V_\gamma - V_\gamma - V_Z}{1} > 0 \Rightarrow V_I < -9/6$$

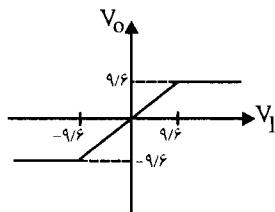
$$\Rightarrow \begin{cases} V_I < -9/6 \\ V_O = -9/6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_1, D_2 : ON \\ D_3, D_4 : Off \end{cases}$$

و در حالت $-9/6 < V_I < 9/6$ همه دیودها قطع و D_Z نیز در حالت بایاس معکوس می‌باشد لذا در این

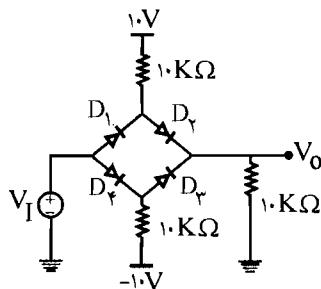
$$V_O = V_I$$

$$V_O = V_I \Rightarrow D_1, D_2, D_3, D_4 : Off$$

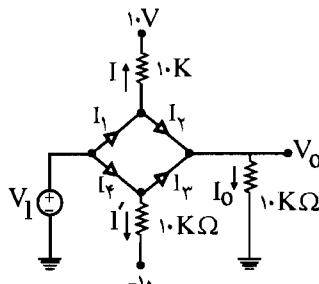
مشخصه به صورت زیر می‌شود:



۳۰- در مدار شکل م- ۳۰ با فرض ایده‌آل بودن دیودها، مشخصه انتقالی مدار را به دست آورید.



شکل م-۳۰



۱۵ حل:

ابتدا فرض می‌کنیم همه دیودها روشن باشند.

با این فرض مدار مطابق شکل زیر خواهد شد.

در این حالت واضح است که $V_O = V_i$ حالا جهت بررسی شرایط روشن بودن دیودهای D_1 الی D_4 باید I_1, I_2, I_3 و I_4 مشخص شده برحسب V حساب شوند و باید

همگی مثبت باشند. برای این منظور داریم:

$$I = I_1 - I_2 = \frac{V_i - 10}{10K} \quad (1)$$

$$I' = I_4 - I_3 = \frac{V_i + 10}{10K} \quad (2)$$

$$I_2 + I_3 = I_o = \frac{V_i}{10K} \quad (3)$$

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 \quad (4)$$

با حل چهار معادله فوق خواهیم داشت:

$$I_1 = \frac{3V_i - 10}{20} > 0 \Rightarrow V_i > \frac{10}{3}$$

$$I_2 = \frac{V_i + 10}{20} > 0 \Rightarrow V_i > -10$$

$$I_3 = \frac{V_i - 10}{20} > 0 \Rightarrow V_i > 10$$

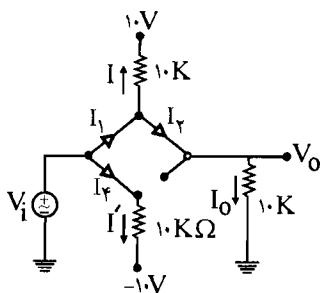
$$I_4 = \frac{3V_i + 10}{20} > 0 \Rightarrow V_i > -\frac{10}{3}$$

اشتراک چهار شرط فوق $V_i > 10$ است.

$$V_i > 10 \text{ V} \Rightarrow V_o = V_i \quad , \quad D_1, D_2, D_3, D_4: \text{ON}$$

بنابراین داریم:

اگر $V_i < 10$ باشد واضح است که D_3 off است و مدار به صورت شکل زیر خواهد شد:



با خواهیم داشت $V_o = V_i$ و داریم:

$$I_4 = \frac{V_i - (-10)}{10K} = \frac{V_i + 10}{10} > 0 \Rightarrow V_i > -10 \quad (5)$$

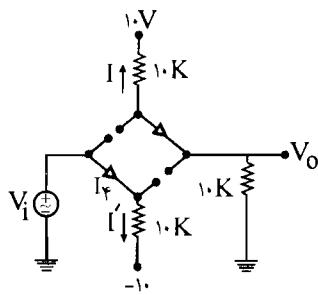
$$I_2 = \frac{V_i}{10} > 0 \Rightarrow V_i > 0 \quad (6)$$

$$I_1 = I + I_2 = \frac{V_i - 10}{10} + \frac{V_i}{10} > 0 \Rightarrow V_i > 5 \quad (7)$$

بنابراین اشتراک شروط (5)، (6) و (7) به صورت $V_i > 5$ خواهد شد. خواهیم داشت:

$$5 < V_i < 10 \Rightarrow V_o = V_i \quad , \quad D_1, D_2, D_4: \text{ON} , \quad D_3: \text{Off}$$

برای $V_i < 5$ باشد با توجه به شرط (۷)، D_1 می‌شود و مدار به شکل زیر خواهد شد.



$$V_O = 10 \times \frac{10}{10 + 10} = 5V$$

$$I_2 = \frac{10}{20K} > 0 \quad \text{شرط } D_2 \text{ بودن}$$

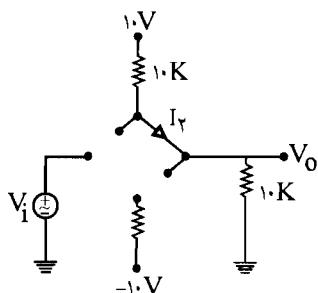
برای D_4 بودن خواهیم داشت:

$$I_4 = \frac{V_i - (-10)}{10K} > 0 \Rightarrow V_i > -10 \quad (8)$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$-10 < V_i < 5 \Rightarrow V_O = 5, D_1, D_2: \text{off}, D_3, D_4: \text{on}$$

اگر $10 < V_i < -5$ باشد. با توجه به رابطه (۸)، D_4 خواهد بود و مدار چنین می‌شود.



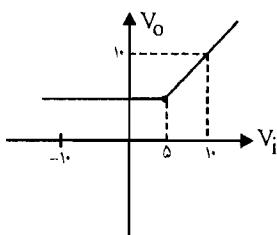
$$V_O = \frac{10}{20K} \times 10K = 5V$$

$$I_2 = \frac{10 - 0}{20K} > 0 \quad \text{شرط } D_2 \text{ بودن}$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$V_i < -10 \Rightarrow V_O = 5 \Rightarrow D_1, D_3, D_4: \text{off}, D_2: \text{on}$$

بنابراین مشخصه انتقال مدار مورد بحث به صورت شکل زیر خواهد شد:



۳۱- یک مدار یکسوکننده تمام موج دارای دامنه ولتاژ حداکثر برابر 100 ولت است. به این مدار یک صافی خازنی اضافه می‌کنیم. در صورتی که $R_L = 1K\Omega$ و فرکانس برق شهر 50 HZ باشد؛ در هر یک از حالت‌های زیر ضریب ریپل (r.f) که به صورت زیر تعریف می‌شود و جریان حداکثر دیود را محاسبه کنید.

$$C = 100.0 \mu F \quad (\text{ب})$$

$$C = 10 \mu F \quad (\text{الف})$$

راه حل:

ضریب ریپل به صورت نسبت درصد ولتاژ DC خروجی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\% \text{ r.f.} = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{dc}} \times 100$$

برای $V_r(\text{rms})$ از نتایج مسئله ۳-۳۵ استفاده کنید.

$$V_{dc} = \frac{\sqrt{2} V_m}{\pi} = \frac{\sqrt{2} \times 100}{\pi} = 63.66 \text{ V}$$

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R_L} = \frac{63.66 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 63.66 \text{ mA}$$

$$V_r(\text{dc}) = \frac{I_{dc}}{\sqrt{fC}}$$

الف: $C = 10 \mu\text{F} \rightarrow V_r(\text{dc}) = \frac{63.66 \text{ mA}}{\sqrt{2 \times 50 \times 10 \mu\text{F}}} = 63.66 \text{ V}$

ب: $C = 1000 \mu\text{F} \rightarrow V_r(\text{dc}) = 63.66 \times 10^{-2} \text{ V}$

$$V_r(\text{rms}) = \frac{V_r(\text{dc})}{\sqrt{2}}$$

الف: $C = 10 \mu\text{F} \rightarrow V_r(\text{rms}) = 18.37 \text{ V}$

ب: $C = 1000 \mu\text{F} \rightarrow V_r(\text{rms}) = 0.1837 \text{ V}$

$$\% \text{ r.f.} = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{dc}} \times 100$$

الف: $C = 10 \mu\text{F} \rightarrow \% \text{ r.f.} = \frac{18.37}{63.66} \times 100 = 28.86\%$

ب: $C = 1000 \mu\text{F} \rightarrow \% \text{ r.f.} = \frac{0.1837}{63.66} \times 100 = 0.2886\%$

$$I_m = V_m \sqrt{\omega^2 C^2 + \frac{1}{R_L^2}}$$

رابطه (۳-۳۲) صفحه ۸۳

$$I_m =$$

الف: $C = 10 \mu\text{F} \rightarrow I_m = 100 \sqrt{(2\pi \times 50)^2 \times 10 \mu\text{F}^2 + \frac{1}{1^2}} = 32.9 \text{ mA}$

ب: $C = 1000 \mu\text{F} \rightarrow I_m = 100 \sqrt{(2 \times \pi \times 50)^2 \times 1000 \mu\text{F}^2 + \frac{1}{1^2}} = 31.4 \text{ mA}$

۳۲- با استفاده از تعریف بازده (η) در یکسوکنندها نشان دهید که

الف) برای مدار یکسوکننده نیم موج رابطه زیر برقرار است:

$$\eta = \frac{40/5}{1 + \frac{R_f}{R_L}}$$

ب) برای مدار یکسوکننده تمام موج مقدار av دو برابر مقدار فوق است.

۱۵ هل:

$$76 \quad \eta = \frac{(P_{out})dc}{(P_{in})av} \quad \text{الف)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{in}(av) = \frac{V_m^r}{\pi^r(R_f + R_L)} \Rightarrow \eta = \frac{\frac{V_m^r R_L}{\pi^r(R_f + R_L)^r}}{\frac{V_m^r}{\pi^r(R_f + R_L)}} = \frac{V_m^r R_L}{\pi^r(R_f + R_L)^r} \times \frac{\pi^r(R_f + R_L)}{V_m^r} \\ P_{out}(dc) = \frac{V_m^r R_L}{\pi^r(R_f + R_L)^r} \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \% \eta = \frac{\pi^r R_L}{\pi^r(R_f + R_L)} \times 100 = \frac{\frac{40/5}{R_f + R_L}}{\frac{R_f}{R_L}} = \frac{40/5}{1 + \frac{R_f}{R_L}} \%$$

ب) در یکسوکننده تمام موج مقدار $(P_{out})dc$ و $(P_{in})av$ به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} (P_{in})av &= \frac{V_m^r}{\pi^r(R_f + R_L)} & \rightarrow \% \eta = \frac{\frac{\pi^r V_m^r R_L}{\pi^r(R_f + R_L)^r}}{\frac{V_m^r}{\pi^r(R_f + R_L)}} \times 100 \\ (P_{out})dc &= \frac{\pi^r V_m^r R_L}{\pi^r(R_f + R_L)^r} \end{aligned}$$

$$\eta \% = \frac{\pi^r V_m^r R_L}{\pi^r(R_f + R_L)^r} \times \frac{\pi^r(R_f + R_L)}{V_m^r} = \frac{\pi^r R_L}{\pi^r(R_f + R_L)} = \frac{1}{1 + \frac{R_f}{R_L}} \times 100$$

می‌بینیم که مقدار بازده در حالت دوم دو برابر حالت اول می‌باشد.

۳۳- یک مدار یکسوکننده تمام موج غیر پل با صافی خازن و $C = 40 \mu F$ و $R_L = 5 K\Omega$ را در نظر بگیرید. در صورتی که ولتاژ بین هر یک از سرهای نانویه و زمین به صورت $V_I = V_m \sin 2\pi 50t$ با

$V_m = 100 \text{ V}$ باشد.

الف) $V_{L,dc}$ و ولتاژ ریپل V_r خروجی را محاسبه کنید.

ب) با فرض $V_r = 0$ ، آیا مقادیر فوق به نحو قابل ملاحظه‌ای تغییر خواهد کرد؟

ج) دیودهای به کار رفته در این مدار چه جریان حداکثر و چه ولتاژ معکوس حداکثری را باید بتوانند تحمل کنند؟

(ا) هم

الف) با توجه به رابطه (۳-۴۱) کتاب داریم:

$$V_{dc} = V_m - \frac{I_{dc}}{4fC} = V_m - \frac{V_{dc}}{R_L \times 4fC} = 100 - \frac{V_{dc}}{5000 \times 4 \times 50 \times 40 \times 10^{-6}}$$

$$\rightarrow V_{dc} = 100 - \frac{V_{dc}}{4} \rightarrow 4 \cdot V_{dc} = 4 \cdot 100 - V_{dc} \rightarrow V_{dc} = 97/56 \text{ V}$$

$$V_r = \frac{V_{dc}}{4fCR} = \frac{97/56 \text{ V}}{2 \times 5 \text{ K}\Omega \times 50 \times 40 \times 10^{-6}} = 4.87 \text{ V}$$

ب) در این صورت $V_m = 100 - 0/56 \text{ V}$ خواهد شد.

$$V_{dc} = (100 - 0/56) - \frac{V_{dc}}{4} \rightarrow V_{dc} = 96/97 \text{ V}$$

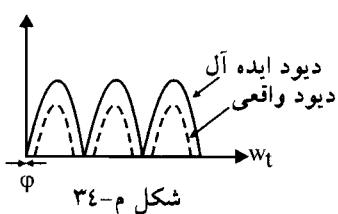
$$V_r = \frac{V_{dc}}{4fCR_L} = \frac{96.97 \text{ V}}{2 \times 50 \times 40 \times 10^{-6} \times 5 \text{ K}\Omega} = 4.84 \text{ V}$$

$$\text{حداکثر ولتاژ معکوس} = 2V_m = 200 \text{ V}$$

ج)

$$I_m = V_m \sqrt{\omega^2 C + \frac{1}{R_L^2}} = 1/26 \text{ A}$$

در شکل م-۳۴، خروجی یکسوکننده تمام موج برای دو حالت دیود ایده‌آل و واقعی رسم شده است. مقدار تأخیر φ را بر حسب دامنه ورودی سینوس (V_m) و ولتاژ آستانه هدایت (V_r) دیود بیان نمایید. آیا φ برای یکسوکننده پل متفاوت خواهد بود؟ چرا؟



۱۰ هل:

$V(t) = V_m \sin \omega t$ تأخیر فاز φ به دلیل ایدهآل نبودن دیود می‌باشد.

$$V_O(t) = \begin{cases} |V_i(t)| - V_\gamma & , \quad |V_i(t)| \geq V_\gamma \\ 0 & , \quad |V_i(t)| < V_\gamma \end{cases}$$

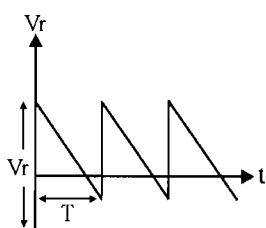
$$V_m \sin \omega t = V_m \sin \varphi = V_\gamma \Rightarrow \varphi = \sin^{-1}\left(\frac{V_\gamma}{V_m}\right)$$

مقدار φ برای یکسوکننده پل متفاوت خواهد بود زیرا V_γ در یکسوکننده تمام موج برابر $V_\gamma = 0$ و برای یکسوکننده تمام موج پل $V_\gamma = 1/4 V$ می‌باشد.

$$V_m \sin \omega t = 2V_\gamma \Rightarrow \varphi = \sin^{-1}\left(\frac{2V_\gamma}{V_m}\right)$$

۳۵- ریپل خروجی یک یکسوکننده با صافی خازنی را می‌توان با منحنی شکل م-۳۵ تقریب زد.

مقدار مؤثر ولتاژ ریپل (V_r rms) را بحسب V_r به دست آورید.



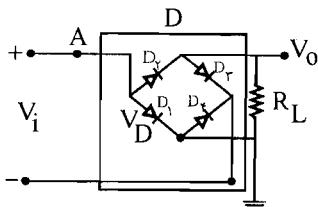
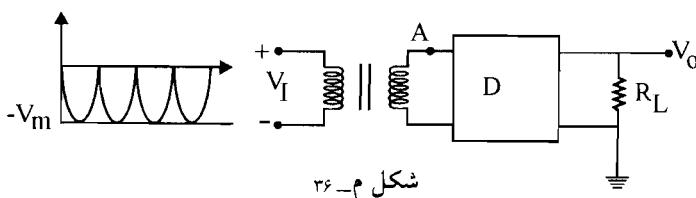
شکل م-۳۵

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T (V_r(t))^2 dt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V_\gamma : \text{معادله تغییرات} \quad V_r(t) = \frac{-V_r(P-P)}{T} t + \frac{V_r(P-P)}{\gamma} \quad 0 \leq t \leq T$$

$$\begin{aligned} V_O(rms) &= \frac{1}{T} \int_0^T \left[\frac{-V_r(P-P)}{T} t + \frac{V_r(P-P)}{\gamma} \right]^2 dt \\ &= \frac{V_r(P-P)}{T} \int_0^T \left(\frac{1}{4} + \frac{t^2}{T^2} - \frac{t}{T} \right) dt = \frac{V_r(P-P)}{T} \left(\frac{T}{4} + \frac{T^2}{2\gamma} - \frac{T}{2} \right) \\ &= \frac{V_r(P-P)}{12} \rightarrow V_{rms} = \frac{V_r(P-P)}{\sqrt{12}} = \frac{V_r(P-P)}{2\sqrt{3}} \end{aligned}$$

۳۶- در مدار شکل م-۳۶، در محل جعبه D یک مدار پل دیودی مناسب طوری جایگزین کنید که به ازای یک شکل موج سینوسی ورودی با دامنه V_m ، ولتاژ خروجی V_o دارای شکل موج نشان داده شده باشد شکل موج ولتاژ نقطه A نسبت به زمین چگونه خواهد بود؟ (از دیودهای ایده‌آل استفاده کنید).



۱۵ هل:

پل دیودی مناسب به صورت مقابل می‌باشد که همان پل دیود یکسو سازی است که در بخش درسی کتاب آمده است با این تفاوت که چون ولتاژ V_o خواسته شده منفی می‌باشد بنابراین دو سر دیودی که کاتد آنها به هم وصل می‌شود و مثبت ولتاژ خروجی بوده حال به زمین وصل می‌شود و سر دیگر مدار خروجی می‌باشد.

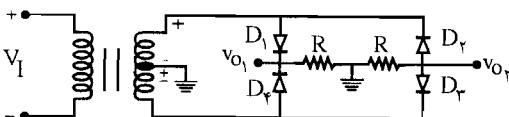
ولتاژ نقطه A نسبت به زمین $V_A = V_D$ خواهد شد که همان ولتاژ دو سر دیود D_1 می‌باشد که وقتی دیود D_1 روشن باشد برابر V_{D_1} و وقتی D_1 خاموش باشد برابر $V_L + V_{D_1}$ یا $V_m \sin \omega t + V_{D_1}$ خواهد شد.

۳۷- در مدار شکل م-۳۷، ولتاژ آستانه هدایت دیودها را صفر و مقاومت مستقیم آنها را R_f در نظر بگیرید. اگر V_I یک ولتاژ سینوسی باشد.

الف) شکل موج ولتاژهای خروجی V_{O_1} و V_{O_2} را رسم کنید.

ب) مقادیر متوسط و مؤثر ولتاژهای V_{O_1} و V_{O_2} را محاسبه کنید.

ج) حداقل ولتاژ معکوس که روی هر یک از دیودها قرار می‌گیرد، دقیقاً چقدر است؟

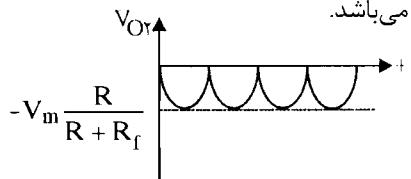
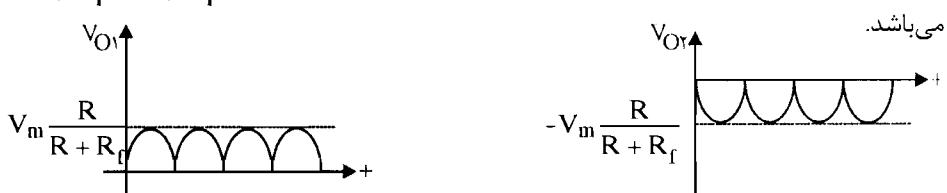


شکل م-۳۷

راه حل:

در نیم سیکل مثبت D_1 و D_2 ON و D_4 و D_2 Off می‌باشند و در نیم سیکل منفی D_2 و D_4 ON و D_1 و D_2 Off می‌باشند.

الف) پیک ولتاژی که روی هر مقاومت افت می‌کند با تقسیم ولتاژ به ترتیب



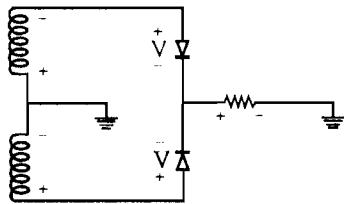
ب) مقدار متوسط ولتاژ برابر خواهد بود با: $\frac{V_{O1m}}{\sqrt{2}}$ و $\frac{-2V_{O1m}}{\pi}$ و $\frac{2V_{O1m}}{\pi}$ و مقدار مؤثر برابر است با:

$$\frac{-V_{O1m}}{\sqrt{\gamma}}$$

$$\begin{cases} Vdc_1 = \frac{\gamma V_m R}{\pi(R + R_f)} \\ Vrms_1 = \frac{V_m R}{\sqrt{\gamma}(R + R_f)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} Vdc_2 = \frac{-2V_m R}{\pi(R + R_f)} \\ Vrms_2 = \frac{-V_m R}{\sqrt{\gamma}(R + R_f)} \end{cases}$$

ج) اگر در مسیر مشخص شده KVL بزنیم:



$$\frac{-V_m R}{R + R_f} + P_{IV} - V_m = 0$$

$$\rightarrow P_{IV} = \frac{\gamma R + R_f}{R + R_f} V_m$$

وقتی که V_1 مثبت است دیودهای D_1 و D_2 هدایت کرده و در این صورت $V_{O1} = V_m + V_r$ برابر $V_{O2} = V_m - V_r$ می‌شود. وقتی که V_1 منفی است دیودهای D_2 و D_4 هدایت کرده و در این صورت نیز $V_{O1} = V_m + V_r$ برابر $V_{O2} = V_m - V_r$ می‌شود. مقدار ولتاژ حداکثر روی هر دیود خاموش دیود می‌شود که عبارت است از:

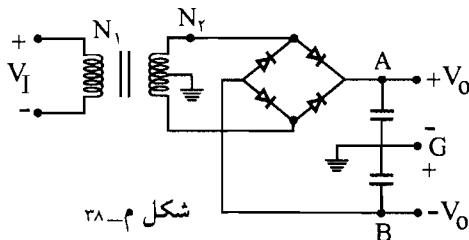
$$V_{D4} = V_R + V_{D1} = \gamma V_R + R_f I_R \quad \text{داریم: } I_R = \frac{V_m}{R + R_f}$$

$$\Rightarrow V_{D4} = \frac{\gamma R V_m}{R + R_f} + \frac{R_f V_m}{R + R_f} = \left(\frac{\gamma R + R_f}{R + R_f} \right) V_m$$

که ولتاژ حداکثر معکوس روی یک دیود را نشان می‌دهد.

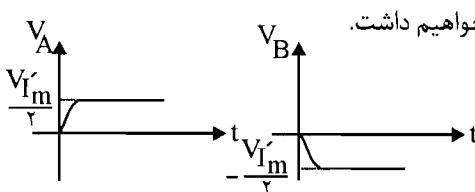
۳۸ - مدار شکل م - یک مدار پل با سر وسط است. طرز کار آن را توضیح دهید. در صورتی که

$$V_I = 100 \sin \omega t \text{ باشد، ولتاژ خروجی را تعیین نمایید.}$$



راه حل:

وقتی V_I مثبت می‌باشد و دیودهای D_1 و D_2 هدایت می‌کنند و بین نقطه A و زمین ولتاژ $\frac{V'_I}{2}$ را خواهیم داشت البته با فرض ایده‌آل بودن دیود و اگر دیود ایده‌آل نباشد برابر $(V_y - \frac{V'_I}{2})$ خواهد شد و بین نقطه B و زمین ولتاژ $\frac{V'_I}{2} - V_y$ را خواهیم داشت. (V'_I را با استفاده از تبدیل ولتاژ در ثانویه ترانسفورماتور به دست می‌آوریم) و وقتی V_I منفی می‌باشد دیودهای D_1 و D_2 هدایت می‌کنند و بین نقطه A و زمین ولتاژ $\frac{V'_I}{2} - V_y$ و بین نقطه B و زمین ولتاژ $-\frac{V'_I}{2} - V_y$ را خواهیم داشت.



$$\begin{cases} \frac{N_2}{N_1} = 0.1 \\ V_I = 100 \sin \omega t \end{cases} \Rightarrow \frac{V'_I}{V_I} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow \frac{V'_I}{100 \sin \omega t} = 0.1 \Rightarrow V'_I = 10 \sin \omega t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_A' = \frac{V'_I}{2} = 5 \sin \omega t \\ V_B' = -\frac{V'_I}{2} = -5 \sin \omega t \end{cases}$$

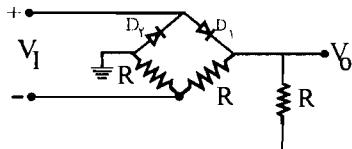
شکل موج خروجی به صورتی که نشان داده شده خواهد بود که ماکزیمم $V_A = 5$ ولت که روی این مقدار ثابت باقی می‌ماند و مینیمم $V_B = -5$ ولت که با این مقدار ثابت می‌ماند.

- در مدار شکل م-۳۹ دیودها ایدهآل و $V_I = V_m \sin \omega t$ است.

الف) شکل موج ولتاژ خروجی V_O را به دست آورده و رسم کنید.

ب) مقدار DC ولتاژ خروجی را محاسبه کنید.

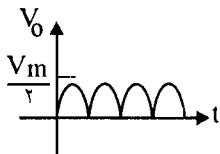
ج) مشخصه انتقالی مدار را رسم کنید.



شکل م-۳۹

(اه هل:

الف) ورودی شکل موج سینوسی با دامنه V_m باشد، خروجی نیز موج سینوسی یکسو شده تمام موج با دامنه $\frac{V_m}{\pi}$ باشد.



$$V_O(\text{dc}) = \frac{1}{\pi} V_O(\text{max}) , \quad V_O(\text{max}) = \frac{V_m}{\pi} \quad (\text{ب})$$

$$\Rightarrow V_O(\text{dc}) = \frac{1}{\pi} \times \frac{V_m}{\pi} = \frac{V_m}{\pi^2}$$

ج) فرض می‌کنیم D_1 روشن و D_2 خاموش باشد در این صورت داریم:

$$V_O = V_i \times \frac{R}{R+R} = \frac{1}{2} V_i$$

$$I_{D_1} = \frac{V_i}{2R} + \frac{V_i}{R} = \frac{3V_i}{2R}$$

شرط روشن بودن دیود D_1 به صورت زیر است:

$$I_{D_1} > 0 \Rightarrow V_i > 0$$

شرط خاموش بودن دیود D_2 به صورت زیر است:

$$V_{A_2} < V_{K_2} \Rightarrow \frac{V_i}{2} < V_i \Rightarrow V_i > 0$$

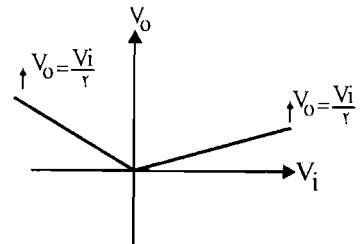
در این صورت به ازای $V_i > 0$ دیود D_1 روشن و دیود D_2 خاموش می‌باشد

$$V_i > 0 \Rightarrow \begin{cases} D_1: \text{ON} \\ D_2: \text{Off} \end{cases} \Rightarrow V_O = \frac{V_i}{2}$$

و اگر $V_i < 0$ شود در این صورت D_2 خاموش و D_1 روشن می‌شود:

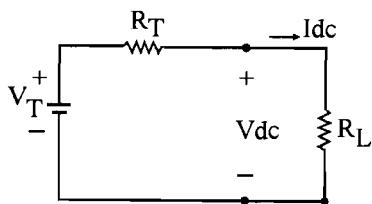
$$V_o = -V_i \times \frac{R}{R+R} = -\frac{V_i}{2}$$

$$\Rightarrow V_i < 0 \Rightarrow \begin{cases} D_1: \text{Off} \\ D_2: \text{ON} \end{cases} \Rightarrow V_o = \frac{-V_i}{2}$$



- ۴۰- با استفاده از رابطه ۳-۴۱ و مدار شکل ۳-۳۰ معادل تونن یکسوکننده تمام موج با فیلتر خازنی

را به دست آورید.



(۱۵ هل:

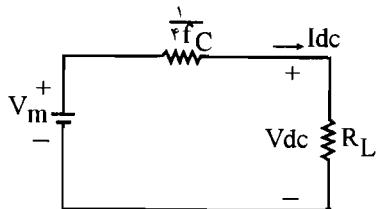
$$V_{dc} = V_m - \frac{I_{dc}}{fC} \quad (I)$$

$$V_{dc} = V_T - R_T I_{dc} \quad (II)$$

با مقایسه این دو رابطه داریم:

$$\begin{cases} V_T = V_m \\ R_T = \frac{1}{fC} \end{cases}$$

پس مدار معادل تونن چنین می‌شود:



- ۴۱- ضریب تنظیم بار را برای هر یک از مدارهای یکسوکننده زیر به دست آورید.

ب) یکسوکننده نیم موج

د) یکسوکننده تمام موج با صافی خازنی

الف) یکسوکننده نیم موج

ج) یکسوکننده نیم موج با صافی خازنی

راه حل:

$$V.R = \frac{V_{dcnL} - V_{dcfl}}{V_{dcfl}} = \frac{\frac{V_m}{\pi} - \frac{V_m}{\pi} \times \left(\frac{R_L}{R_f + R_L} \right)}{\frac{V_m}{\pi} \times \left(\frac{R_L}{R_f + R_L} \right)}$$

الف)

$$= \frac{\frac{V_m}{\pi} \left(1 - \frac{R_L}{R_f + R_L} \right)}{\frac{V_m}{\pi} \times \left(\frac{R_L}{R_f + R_L} \right)} = \frac{\left(\frac{R_f}{R_f + R_L} \right)}{\left(\frac{R_L}{R_f + R_L} \right)} = \frac{R_f}{R_L} \times 100$$

$$V.R = \frac{\frac{V_m}{\pi} - \frac{V_m}{\pi} \left(\frac{R_L}{R_f + R_L} \right)}{\frac{V_m}{\pi} \left(\frac{R_L}{R_f + R_L} \right)} = \frac{\frac{V_m}{\pi} \left(1 - \frac{R_L}{R_f + R_L} \right)}{\frac{V_m}{\pi} \left(\frac{R_L}{R_f + R_L} \right)} = \frac{R_f}{R_L} \times 100$$

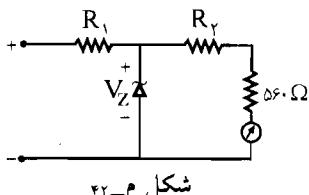
ب)

$$V.R = \frac{V_m - V_m \times \left(\frac{R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}} \right)}{V_m \times \left(\frac{R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}} \right)} = \frac{\frac{V_m}{\pi} \left(1 - \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}} \right)}{\frac{V_m}{\pi} \left(\frac{R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}} \right)} = \frac{\frac{R_L + \frac{1}{f_c} - R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}}}{\frac{R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}}} = \frac{1}{f_c R_L} \times 100$$

ج)

$$V.R = \frac{V_m - V_m \times \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}}}{V_m \times \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}}} = \frac{\frac{V_m}{\pi} \left(1 - \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}} \right)}{\frac{V_m}{\pi} \left(\frac{R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}} \right)} = \frac{\frac{R_L + \frac{1}{f_c} - R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}}}{\frac{R_L}{R_L + \frac{1}{f_c}}} = \frac{1}{f_c R_L} \times 100$$

د)



۴۲- برای حفاظت دستگاههای اندازه‌گیری می‌توان از دیود زنر استفاده نمود بدون اینکه به خطی بودن دستگاه خدشهای وارد شود. مدار شکل م-۴۲ نمایش یک ولت‌متر DC است که حداقل ولتاژ قابل خواندن آن ۲۵V است. مقاومت داخلی آن ۵۶Ω و حداقل جریان گذرنده از آن ۰/۲mA است. در صورتی که ولتاژ شکست دیود زنر برابر ۲۰V باشد، مقاومت‌های R₁ و R₂ را طوری به دست آورید که برای دیود زنر هدایت

نموده و اضافه جریان دستگاه اندازه‌گیری را از خود عبور دهد.

(۱۵) هل:

$$KVL: ۲۵ - R_1 \times ۰ / ۲ \leq ۲۰ \Rightarrow R_1 \geq ۲۵ K\Omega$$

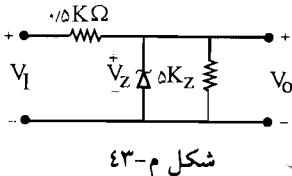
$$KVL: (R_2 + R_m) \times ۰ / ۲ \leq ۲۰ \Rightarrow R_2 + R_m \leq ۱۰۰ K\Omega$$

$$R_m = ۵۰ \cdot \Omega = ۰ / ۵۰ K\Omega \Rightarrow R_2 + ۰ / ۵۰ K\Omega \leq ۱۰۰ K\Omega \Rightarrow R_2 \leq ۹۹ / ۴۹ K\Omega$$

۴۳- در مدار تنظیم کننده ولتاژ شکل م-۴۳، $V_Z = ۵V$ و $I_K = ۰ / ۲ mA$ و $I_{Z, max} = ۱۰ mA$ است.

(الف) با فرض $r_z = ۰$ حداقل و حداکثر مجاز V_I را تعیین نمایید.

(ب) در صورتی که $r_z = ۵ \Omega$ باشد $\Delta V_O = ۲V$ را به ازای $\Delta V_I = ۲V$ محاسبه کنید.



(۱۵) هل:

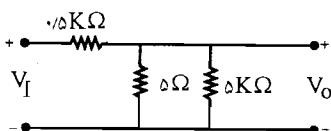
$$i_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5V}{5K\Omega} = 1 mA$$

$$KCL: \frac{V_I - V_Z}{R} = I_Z + I_L \rightarrow \frac{V_I - 5}{0/5} = I_Z + 1 mA$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_K = 0/2 mA \rightarrow \frac{V_I - 5}{0/5} = 1/2 \rightarrow V_I = 5 + 0/5 = 5/6 V = V_{I_{min}} \\ I_{Z_{max}} = 10 mA \rightarrow \frac{V_I - 5}{0/5} = 11 \rightarrow V_I = 5/5 + 5 = 10/5 = V_{I_{max}} \end{cases}$$

$$\rightarrow 5.6 \leq V_I \leq 10.5$$

(ب) مدار معادل به صورت زیر می‌باشد:

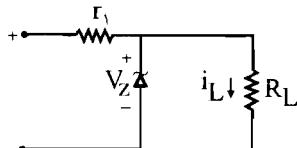


$$\Delta V_o = \Delta V_I \times R_{کل} = \Delta V_I \times \frac{5000 \parallel 5}{(5000 \parallel 5) + 500} = 19/V \Delta mV$$

۴۴ - در مدار تنظیم کننده ولتاژ V_L - ۴۴ دیود زنر i_Z ولتی و جریان حداقل آن 15 mA است. ولتاژ ورودی V_I بین 13 V تا 16 V و جریان i_L بین 10 mA تا 15 mA تغییر می‌کند.

(الف) حداکثر مقدار i_L را به دست آورد.

(ب) با استفاده از روش فوق حداکثر توان تلف شده توسط دیود زنر را به دست آورید.



شکل ۴۴-م

راه حل:

(الف) طبق فرض مسئله $10 \text{ mA} \leq i_L \leq 15 \text{ mA}$ و $13 \text{ V} \leq V_I \leq 16 \text{ V}$ و $i_K = 10 \text{ mA}$ و $V_Z = 10 \text{ V}$

$$I_{L_{\max}} = \frac{V_{i_{\min}} - V_Z}{r_i} - i_K \rightarrow 15 \text{ mA} = \frac{13 - 10}{r_i} - 10 \text{ mA}$$

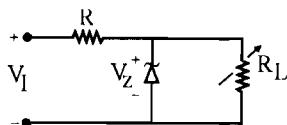
$$\rightarrow 10 \text{ mA} = \frac{3}{r_i} \rightarrow r_i = \frac{3}{100} = 30 \Omega$$

$$I_{Z_{(\max)}} = \frac{V_{i_{\max}} - V_Z}{r_i} - i_{L_{(\min)}} \quad (ب)$$

$$\Rightarrow I_{Z_{(\max)}} = \frac{16 - 10}{0.03 \text{ K}\Omega} - 10 = 190 \text{ mA}$$

$$P_{Z_{(\max)}} = I_{Z_{(\max)}} \times V_Z = 190 \text{ mA} \times 10 \text{ V} = 19 \text{ W}$$

۴۵ - در مدار شکل م-۴۵، با فرض مقادیر $I_{z, \max} = 10 \text{ mA}$ و $R_{L, \min} = 1 \text{ K}\Omega$ و $11 \text{ V} \leq V_I \leq 13 \text{ V}$ و $V_Z = 6.8 \text{ V}$ و $i_K = 0.2 \text{ mA}$ مقدار مقاومت R و نیز $R_{L, \max}$ را محاسبه کنید.



شکل ۴۵-م

راه حل: این مدار یک مدار تنظیم کننده ولتاژ است و در این مدار رابطه زیر برقرار است:

$$i_{L_{\max}} = \frac{V_Z}{R_{L_{\min}}} = \frac{6.8 \text{ V}}{1 \text{ K}\Omega} = 6.8 \text{ mA}$$

$$i_{L\max} = i - I_K = \frac{V_{i\min} - V_Z}{R} - I_K = \frac{11 - 6/1}{R} - 0/2 = 6/1$$

$$\rightarrow \frac{11 - 6/1}{R} = v \rightarrow \frac{4/2}{v} = R = 0.6 \text{ K}\Omega$$

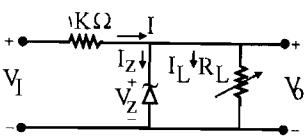
$$I_{L\min} = \frac{V_{i\max} - V_Z}{R} - I_{Z\max} = \frac{13 - 6/1}{0.6} - 10 = 0.33 \text{ mA}$$

$$R_{L\max} = \frac{V_Z}{i_{L\min}} = \frac{6/1}{0.33} = 20/6 \text{ K}\Omega$$

۴۶- مدار شکل م-۴۶ را با فرض $I_K = 0/2 \text{ mA}$ و $I_{Z\max} = 3/6 \text{ mA}$ در نظر بگیرید.

الف) مقادیر حداقل و حداکثر مقاومت R_L را به گونه‌ای تعیین کنید که تنظیم ولتاژ به خوبی صورت پذیرد. ولتاژ ورودی بین 8 V تا 10 V ولت تغییر می‌کند و $V_Z = 6/2 \text{ V}$ است.

ب) اگر $R_L = 20 \text{ K}\Omega$ بوده و دیود زنر دارای مقاومت داخلی 5Ω باشد درصد تغییرات ولتاژ خروجی را به ازای تغییرات ولتاژ ورودی به دست آورید.



شکل م-۴۶

راه حل:

الف) این مدار یک مدار تنظیم کننده ولتاژ می‌باشد و در این مدار روابط زیر را داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{\max} = I_{L\min} + I_{Z\max} \quad (1) \\ I_{\min} = I_{L\max} + I_{Z\min} \quad (2) \end{array} \right.$$

$$(1) \rightarrow I_{\max} = I_{L\min} + I_{Z\min}$$

$$(2) \rightarrow \frac{V_{i\max} - V_Z}{1 \text{ K}\Omega} = \frac{V_Z}{R_{L\max}} + 3/6 \text{ mA}$$

$$\rightarrow \frac{10 - 6/2}{1 \text{ K}\Omega} = \frac{6/2}{R_{L\max}} + 3/6 \rightarrow 3/8 - 3/6 = \frac{6/2}{R_{L\max}} \rightarrow R_{L\max} = \frac{6/2}{0/2} = 30 \text{ K}\Omega$$

$$(2) \rightarrow I_{\min} = I_{\max} + I_{Z\min}$$

از طرفی

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{\max} = \frac{V_{i\max} - V_Z}{R_i} \\ I_{L\min} = \frac{V_Z}{R_{L\max}} \end{array} \right.$$

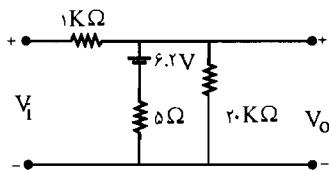
از طرفی

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{\min} = \frac{V_{i\min} - V_Z}{R_i} \\ I_{L\max} = \frac{V_Z}{R_{L\min}} \end{array} \right.$$

$$(2) I_{\min} = \frac{V_{i\min} - V_Z}{R_i} = \frac{V_Z}{R_{L\min}} + I_{Z\min}$$

$$\rightarrow \frac{1 - 6/2}{1 K\Omega} = \frac{6/2}{R_{L\min}} + 0/2 \rightarrow 1/8 - 0/2 = \frac{6/2}{R_{L\min}} \rightarrow R_{L\min} = \frac{6/2}{1/6} = 36 K\Omega$$

ب) مدار معادل به صورت شکل زیر می‌باشد:

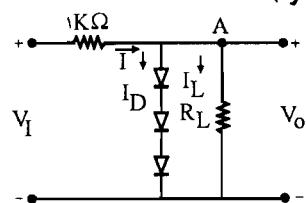


$$V_o = \frac{V_i}{1000 + 5 \parallel 2000} (5 \parallel 2000) + \frac{6.2}{5 + 1000 \parallel 2000} (1000 \parallel 2000)$$

$$= V_i \times 4/95 \times 10^{-3} + 6/15 \rightarrow \begin{cases} V_{o\max} = 6/1996 V \\ V_{o\min} = 6/1896 V \end{cases}$$

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} \times 100 = \frac{0.1}{2} \times 100 = 0.5\%$$

- در مدار تنظیم کننده ولتاژ شکل ۴۷-۱ از دیودهای معمولی مشابه با $V_g = 0.7V$ استفاده شده است. در صورتی که ولتاژ V_g به اندازه $0.5V \pm \Delta V$ تغییرات داشته باشد، تغییرات ولتاژ خروجی چه مقدار خواهد بود؟ ($R_L \gg rd$ محاسبه شود).



شکل ۴۷-۱

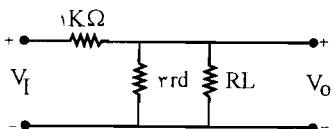
راه حل:

$$V_A = 3 \times V_d = 3 \times 0.7 = 2.1 V$$

$$\text{KCL: } I = I_D + I_L \rightarrow \frac{4 - 2/1}{1} = I_D + \frac{2/1}{R_L} \rightarrow I_D \cong 1/9 mA$$

$$\rightarrow rd = \frac{\eta V_T}{I_D} = \frac{2 \times 26}{1/9} = 2V\Omega$$

مدار معادل به صورت زیر می‌باشد:



$$R_L \gg r_{rd} \rightarrow R_{R_L \parallel r_{rd}} = r_{rd}$$

$$V_O = \frac{V_i \times r_{rd}^{\Omega}}{R_i + r_{rd}} = \frac{V_i \times 2V \times 3}{1000 + 2V \times 3} = V_i \times (0.075^{\Omega}) \times 1000 = V_i \times 75 \text{ mV}$$

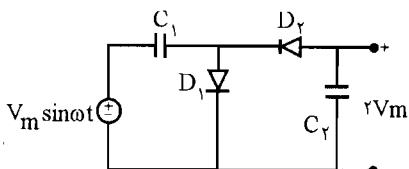
$$\Delta V_I = \pm 0.5 \text{ V}$$

$$\rightarrow \Delta V_O = (\pm 0.5) \times 75 \cong 38 \text{ mV}$$

۴۸- مدار شکل م-۴۸ را در نظر بگیرید.

الف) توضیح دهید که چگونه این مدار به صورت یک مدار دو برابر کننده ولتاژ عمل می‌کند؟

ب) چگونه می‌توان با تکمیل این مدار یک مدار چهار برابر کننده ولتاژ به دست آورد؟

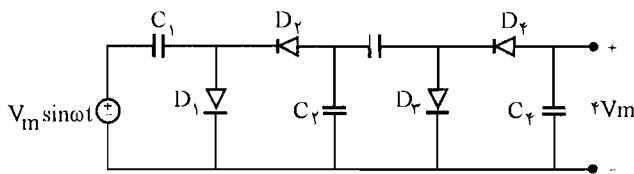


شکل م-۴۹

راه حل:

الف) در سیکل اول وقتی V_i مثبت است دیود D_1 هدایت می‌کند و دیود D_2 قطع می‌باشد و خازن C_1 از طریق دیود D_1 شارژ شده به اندازه حداکثر مقدار ولتاژ ورودی V_m + شارژ می‌شود، به محض اینکه ولتاژ ورودی از حد اکثر مقدار رد شد و به حداقل مقدار خود یعنی $-V_m$ رسید دیود D_1 قطع شده ولی خازن C_1 همچنان در حالت شارژ می‌ماند و دیود D_2 وصل می‌شود در این حالت خازن C_2 نیز به اندازه V_m شارژ می‌شود. با عبور V_i از مقدار حداقل به مقدار حداکثر دوباره دیود D_2 قطع و دیود D_1 شارژ می‌شود ولی مقدار ولتاژ خازن C_2 تغییر نمی‌کند. از این لحظه به بعد ولتاژ خروجی V_o برابر مجموع ولتاژهای دو خازن C_1 و C_2 و مساوی $2V_m$ می‌باشد.

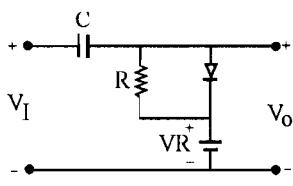
ب) مدار چهار برابر کننده:



۴۹- در مدار کلمپ شکل م- ۴۹ دامنه شکل موج مثلثی ورودی برابر 4 V است.

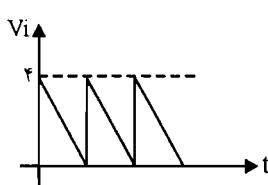
الف) شکل موج خروجی را به ازای مقادیر $V_R = 2\text{ V}$ و $V_R = -2\text{ V}$ رسم نمایید.

ب) در صورتی که $V_R = \pm 5\text{ V}$ باشد آیا مدار، ورودی را کلمپ خواهد کرد؟ چرا؟

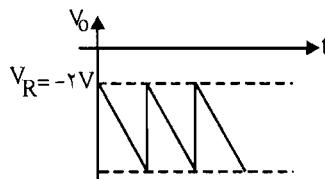
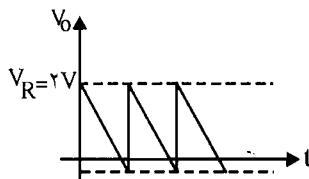


شکل م- ۴۹

راه حل:

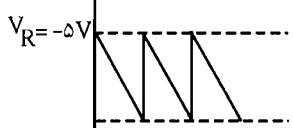


الف) با توجه به شکل م- ۴۹ ولتاژ خروجی برابر $V_D + V_R$ است و چون $V_D = V_s - V_m$ در سطح صفر کلمپ شده است و در نتیجه خروج (V_O) کلمپ شده در سطح V_R خواهد بود.



ب) در مدار کار نمی کند ولی در سطح $V_R = 5\text{ V}$ خروجی کلمپ می کند.

با $V_R > V_{I(\max)}$ لذا کلمپ انجام نمی شود و دیود ON نمی شود.



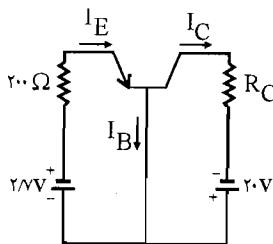
۴۵

ترانزیستور پیوندی دوقطبی

- ۱- در مدار شکل م-۱، ترانزیستور دارای $\alpha = 0.9$ و $V_{BE(ON)} = 0.7V$ است.
- الف) جریان های I_E و I_C و I_B را محاسبه کنید.

ب) اگر بخواهیم قدر مطلق ولتاژ V_{CE} از $2V$ ولت تجاوز نکند (حداقل

مقدار R_C چقدر باشد؟



شکل م-۱

راه حل:

الف) در حلقه KVL، $V_{EB} = 2V$ و $V_{EC} = 0.7V$ می‌زنیم.

$$\text{KVL: } -2V + 0.7V + 0.7V = 0 \rightarrow I_E = 10 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha I_E = 0.9 \times 10 = 9 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_B \rightarrow 9 \text{ mA} = \frac{0.9}{1-0.9} I_B \rightarrow I_B = 1 \text{ mA}$$

ب) در حلقه R_C و V_{CE} می‌زنیم.

$$KVL: -20 - 2V + 0.2I_E + R_C I_C + V_{EC} = 0 \rightarrow$$

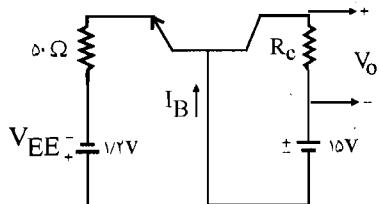
$$|V_{CE}| = 20/V - 9R_C = 20V \rightarrow R_{C\min} = 77/77 \Omega$$

۲- در مدار شکل م-۲ ترانزیستور دارای $\alpha = 0/9$ و $V_{BE}(\text{ON}) = 0.77V$ است.

(الف) به ازای چه مقدار R_C ، قدر مطلق ولتاژ خروجی برابر $4/5$ ولت می‌شود؟ در این صورت

چقدر خواهد بود؟

ب) اگر بخواهیم با مقاومت R_C محاسبه شده در بند (الف) ولتاژ V_{CB} برابر $7/5$ ولت شود، را چقدر باید تغییر داد؟



شکل ۲-م

راه حل:

(الف) با نوشتن KVL در حلقه R_C و V_{EB} و V_{EE} داریم:

$$KVL: -12V + 0.5I_E + 0.7V = 0 \rightarrow I_E = 10mA$$

$$I_C = \alpha I_E = 9mA$$

$$V_{CE} = R_C I_C = 9R_C = 4/5 \rightarrow R_C = 0.5k\Omega$$

ب) در حلقه V_{CE} و R_C و V_{EE} می‌زنیم:

$$V_{CE} = 15V + 12V - 0.5 \times 9 - 10 \times 0.5 = 11.2V$$

$$\text{در حلقه } V_{CB}: V_{CB} = 15V - 0.5I_C \rightarrow I_C = 15mA$$

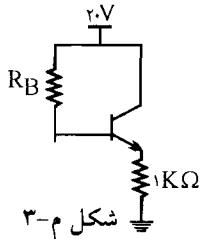
$$I_E = \frac{1}{\alpha} I_C = \frac{15}{0.9} = 16.67mA$$

$$V_{EE} = 0.7V + 0.5 \times 16.67mA = 1.53V \Rightarrow \Delta V_{EE} = 1.53 - 1.2 = 0.33V$$

۳- برای ترانزیستور مدار شکل م-۳، فرض کنید $\beta = 100$ و $V_{BE}(\text{ON}) = 0.7V$ باشد.

(الف) مقدار R_B را به گونه‌ای تعیین کنید که $V_{CE} = 10V$ شود.

ب) در صورتی که β ترانزیستور برابر 150 باشد، با R_B محاسبه شده در بند (الف) ولتاژ چقدر خواهد بود؟



ا) حل:

$$R_E \text{ و } V_{CE} \text{ و } 20V \text{ در حلقه KVL: } V_{CE} = 10V = 20V - 1I_E \rightarrow I_E = 10mA \quad (\text{الف})$$

$$I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = 0.099mA$$

$$R_E \text{ و } V_{BE} \text{ و } R_B \text{ در حلقه KVL: } -20 + R_B I_B + 0.7V + 1 \times I_E = 0 \rightarrow$$

$$-20 + 0.099R_B + 0.7 + 10 = 0 \rightarrow R_B = 93.94K\Omega$$

$$\text{KVL: } -20 + 93.94I_B + 0.7V + 1 \times I_E = 0 \rightarrow I_E = 19/3 - 93.94I_B \quad (\text{I}) \quad (\text{ب})$$

$$\text{از طرفی: } I_E = (1+\beta)I_B = 151 \times I_B \quad (\text{II})$$

$$(I) \rightarrow 151I_B = 19/3 - 93.94I_B \rightarrow 244/94I_B = 19/3 \rightarrow$$

$$I_B = 0.079$$

$$\rightarrow I_E = 151 \times I_B = 11.9mA$$

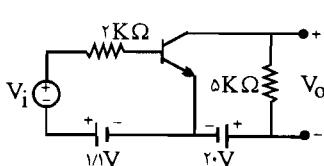
$$V_{CE} = 20 - R_E I_E = 20 - 11.9 = 8.1V$$

۴- در تقویت کننده امپیتر مشترک شکل م- $\beta=0.9$ و $V_{BE}(\text{ON})=0.7V$ و ولتاژ ورودی بر حسب ولت برابر $1 \sin \omega t$ است.

(الف) ولتاژ خروجی V_o چقدر است؟

(ب) مقدار حداقل ولتاژ V_{CE} را محاسبه کنید.

(ج) در صورتی که بخواهیم V_{CE} از $10V$ ولت کمتر نشود، حد اکثر دامنه ولتاژ ورودی سینوسی چقدر می‌تواند باشد؟



راه حل:

$$R_B \text{ و } V_{BE} \text{ و } 1V \text{ در حلقه KVL: } -1V + 0V + 2I_B \rightarrow I_B = 0.2mA \quad : DC$$

$$\rightarrow I_C = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_B = \frac{0.9}{1-0.9} I_B = 0.9mA$$

$$V_O = -R_C I_C = -9V$$

$$-V_i + 2I_B = 0 \rightarrow i_B = \frac{V_i}{2} mA \quad : ac$$

$$V_O = -5i_C = -5 \times 0.9i_B = \frac{V_i}{2} mA$$

$$V_O = -9 - 2/25 \sin \omega t \quad \Leftarrow V_O = V_{O(dc)} + V_{O(ac)}$$

$$V_{CE} = 20 + V_O \Rightarrow V_{CE\ min} = 20 + V_{O\ min} \quad (b)$$

$$V_{O\ min} = -9 - 2/25 = -11/25V$$

$$\rightarrow V_{CE\ min} = 20 - 11/25 = 17.8V \quad (c)$$

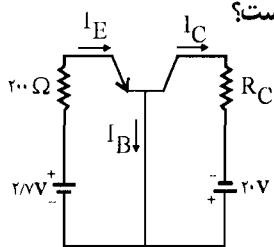
$$V_{CE\ min} = 0/3V \Rightarrow V_{CE} = 20 + V_O = 20 + (-9 - 22/5 V_i) = 0/3V \Rightarrow V_{i\ max} = 0/475V$$

۵- در مدار شکل م-۵ ترانزیستور دارای $\alpha = 0.9$ و $V_{BE\ (ON)} = 0.7V$ باشد.

الف) مقدار مقاومت R_E چقدر باشد تا جریان کلکتور در ناحیه $1.8mA$ شود؟

ب) مقدار R_C که ترانزیستور را به مرز اشباع میبرد چقدر است؟ ($0.2V$)

ج) برای ثابت ماندن جریان I_C چه مقادیری برای R_C قابل قبول است؟



شکل م-۱

راه حل:

$$I_E = \frac{I_C}{\alpha} = \frac{0.9}{0.9} = 1mA \quad (f)$$

$$R_E \text{ و } V_{BE} \text{ و } 3V \text{ در حلقه KVL: } -3V + 0V + R_E I_E = 0 \rightarrow R_E = 15K\Omega$$

$$(R_C \geq 11/39)$$

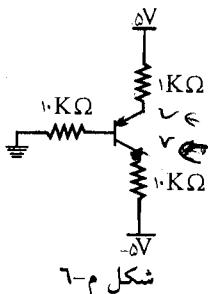
در حلقه KVL V_{CE} و R_E و R_C و V_{BE} داریم.

$$|V_{CE}| = 20 - R_C I_C - R_E I_E + 3/V = 0/2V \rightarrow R_C = 11/39 \text{ k}\Omega$$

ج) در صورتی که $R_C < 11/39 \text{ k}\Omega$ باشد جریان $I_C < 11/39$ ثابت خواهد ماند. چون به ازای

ترانزیستور در ناحیه فعال کار می‌کند.

۶- در مدار شکل م- ع، مقادیر ولتاژهای V_B و V_E و V_C را با فرض $\beta = 30$ محاسبه نمایید.



شکل م

(ا) هل:

$$\text{KVL: } -5 + 0/V + 10 I_B - 1 \times I_E = 0 \quad \text{و} \quad I_E = (1 + \beta) I_B = 31 I_B$$

$$\rightarrow I_B = 10.4/9 \mu\text{A}$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B = 3/25 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 30 \times 10.4/9 \mu\text{A} = 3/15 \text{ mA}$$

$$V_B = R_B I_B = 10 \times 10.4/9 \text{ mA} = 10.49 \text{ V}$$

$$V_C = -5 + R_C I_C = -5 + 10 \times 3/15 = 26/5 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 26/5 - 1/75 = 24/75 \text{ V}$$

پس نتیجه می‌گیریم تمام محاسبات اشتباه بوده و ترانزیستور در حالت اشباع قرار دارد:

$$I_{C\text{sat}} = \frac{5 - (-5) - 0/2}{1 + 10} = 0/89 \text{ mA}$$

$$V_{CE(\text{sat})} = 4/2 \text{ V}$$

$$I_E = I_C = 0/89 \text{ mA}$$

$$V_E = 5 - I_E(\text{sat}) R_E = 5 - 0/89 \times 1 = 4/11 \text{ V}$$

$$V_{BE(\text{sat})} = 0/8 \text{ V} \rightarrow V_B = 4/11 - 0/8 = 3/31 \text{ V}$$

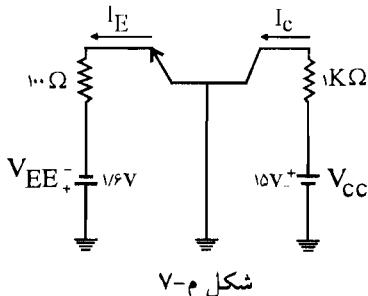
$$I_B = \frac{3/31}{1 \cdot 10^3 \text{ k}\Omega} = 0/331 \text{ mA}$$

$$\beta_{sat} = \frac{I_{Csat}}{I_{Bsat}} = 3 \ll 30$$

$$V_C = -\Delta + R_C I_C = 3/4 V$$

در مدار شکل م-۷ ترانزیستور دارای $\beta = 9$ و $V_{BE(on)} = 0.7 V$ است.

(الف) مقادیر I_E و I_C و V_{CE} را محاسبه نمایید.



شکل م-۷

(ب) به ازای $V_{CC} = 5 V$ اندازه کمیت‌های مذکور را به دست آورید.

$$(| V_{CE(sat)} = 0.2 V |)$$

(ج) به ازای $V_{CC} = 5 V$ ، اگر بخواهیم ترانزیستور را به مرز اشباع ببریم، چه مقدار جدیدی برای V_{EE} باید اختیار کنیم؟

: (اه هل: ✓)

$$KVL: V_{EE} = R_E I_E + V_{BE} \rightarrow 1.6 = 1/I_E + 0.7 \rightarrow I_E = 9 mA \quad (\text{الف})$$

$$I_C = \frac{\beta}{1+\beta} I_E = \frac{9}{10} \times 9 mA = 8.1 mA$$

$$KVL: -V_{CC} + R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E - V_{EE} = 0$$

$$-10 + 1 \times 8.1 + V_{CE} + 1/I_E - 1.6 = 0 \rightarrow V_{CE} = 10 - 8.1 - 0.9 + 1.6 = 2.4 V$$

$$KVL: V_{CE} = 5 - 8.1 - 0.9 + 1.6 = -2.4 V \quad (\text{ب})$$

در نتیجه ترانزیستور فعال نمی‌باشد بلکه در حالت اشباع قرار دارد.
 I_E هیچ تغییری نمی‌کند ولی مقدار I_C تغییر می‌کند.

$$KVL: -\Delta + R_C I_C + R_E I_E + 0.7 - V_{EE} = 0 \rightarrow I_C = 6/6 - 1/1 = 5/5 mA$$

$$\begin{cases} I_E = \frac{V_{EE} - 0.7}{1/1} \\ (V_{CE} = 0.7, \quad I_C = \frac{\beta}{1+\beta} I_E) \end{cases} \quad (\text{ج})$$

$$KVL: -\Delta + R_C I_C + R_E I_E + 0.7 - V_{EE} = 0 \quad (\text{II})$$

مقادیر روابط (I) را در رابطه (II) قرار می‌دهیم:

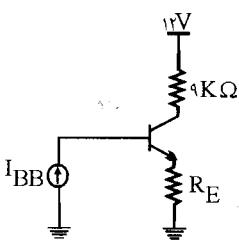
$$-5 + 1 \times 0/9 \left(\frac{V_{EE} - 0/\Delta}{0/1} \right) + 0/1 \left(\frac{V_{EE} - 0/\Delta}{0/1} \right) + 0/2 - V_{EE} = 0$$

$$-5 + 1 \times (V_{EE} - 0/\Delta) + 0/2 - V_{EE} = 0 \rightarrow -4/\Delta + 9V_{EE} - \Delta = 0$$

$$9V_{EE} = 12\Delta \rightarrow V_{EE} = \frac{12/\Delta}{9} = 1/4V$$

۸- در مدار شکل م-۸ منبع جریان I_{BB} برابر $1mA$ است. با فرض $\beta < 200$ ،

الف) به ازای $R_E = 1K\Omega$ ترانزیستور در چه وضعیتی قرار دارد؟



ب) به ازای چه مقادیری از R_E ، ترانزیستور همواره در اشباع خواهد بود؟

شکل م-۸

(۱۰ هل:

الف) اگر با β متوسط مقادیر I_E را محاسبه کنیم داریم:

$$I_E = \beta_{av} I_B = \left(\frac{100 + 200}{2} \right) \times 0/01 = 1/5mA$$

$$V_{CE} = 12 - (9 + 1) \times 1/5 = -3V$$

در نتیجه ترانزیستور در حالت اشباع قرار دارد.

ب) به ازای $V_{CE} \leq 0/0$ ترانزیستور همواره در حالت اشباع قرار دارد پس:

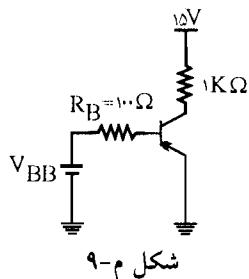
$$\begin{aligned} \text{KVL: } -9I_C + 12 - R_E(I_B + I_C) &\leq 0/0 \Rightarrow -(9 + R_E)I_C - R_E I_B \leq -11/\Delta \Rightarrow \\ -(9 + R_E) \times \beta I_B - R_E I_B &\leq -11/\Delta \Rightarrow [(9 + R_E)\beta + R_E] \times I_B \geq 11/\Delta \Rightarrow \\ [(9 + R_E)\beta + R_E] \times 0/01 &\geq 11/\Delta \end{aligned}$$

چون می‌خواهیم طرف اول رابطه مقابل به ازای جمیع مقادیر β بزرگتر از $11/\Delta$ باشد بنابراین کمترین مقدار آن یعنی به ازاء $\beta_{min} = 100$ نیز باید طرف اول بزرگ‌تر از $11/\Delta$ باشد لذا داریم:

$$(9 + R_E) \times 100 + R_E \geq \frac{11/\Delta}{0/01} \Rightarrow 900 + 101R_E \geq 1180 \Rightarrow R_E \geq \frac{280}{101}$$

به ازای این مقادیر R_E ترانزیستور همواره در حالت اشباع قرار دارد.

۹- در مدار شکل م - ۹ ترانزیستور از نوع ژرمانیم و دارای $I_{CBO} = 1\mu A$ در دمای $25^\circ C$ است.
 الف) V_{BB} را طوری تعیین کنید که ترانزیستور در دمای $25^\circ C$ در حالت قطع باشد.



شکل م - ۹

ب) آیا با V_{BB} محاسبه شده در بند (الف) ترانزیستور در دمای $85^\circ C$ نیز در حالت قطع خواهد ماند؟ مقدار لازم برای V_{BB} جهت قطع ترانزیستور در این دما چقدر است؟

ج) در صورتی که $R_B = 30 K\Omega$ و $V_{BB} = 3V$ باشد، تاچه دمایی ترانزیستور در وضعیت قطع خواهد ماند؟

راه حل:

$$V_{BE(cut)} = +0.1V \quad I_B = I_{CBO} = 1\mu A \quad (\text{الف})$$

$$V_{BB} = 100 \times 10^{-3} + 0.1 = 0.2V \quad \text{پس باید } V_{BB} \geq 0.2V \text{ باشد.}$$

$$I_{CBO}(85^\circ) = I_{FCBO}(25^\circ) \times 2^{\frac{85-25}{10}} = 1 \times 2^6 = 64\mu A \quad (\text{ب})$$

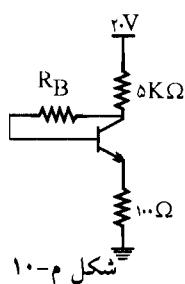
$$V_B = V_{BB} - R_B I_{CBO} = 0.2 - 100 \times 0.064 = -6.2V \quad \text{ترانزیستور در دمای فوق در حالت فعال قرار دارد.}$$

$$V_{BB} = 100 \times 0.064 + 0.1 = 6.5V \rightarrow V_{BB} > 6.5V \quad \text{در این حالت ترانزیستور در حالت قطع قرار می‌گیرد.}$$

$$V_{BB} = 30 I_{CBO} + 0.1 = 3V \rightarrow I_{CBO} = 96.67\mu A \quad (\text{ج})$$

$$\frac{T-25}{96.67} = 1 \times 2^{\frac{10}{10}} \Rightarrow \ln \frac{96.67}{96} = \frac{T-25}{10} \ln 2 \rightarrow T = 91^\circ C$$

۱۰- در مدار شکل م - ۱۰ در صورتی که از یک ترانزیستور با $\beta = 100$ استفاده کرده باشیم، به ازی چه مقدار R_B ، ولتاژ V_{CE} برابر ۴V خواهد شد؟



شکل م - ۱۰

۱۰ هم:

$$KVL: -20 + 5k\Omega (I_C + I_B) + V_{CE} + 0/1I_E = 0$$

$$\text{از طرفی: } I_C + I_B = I_E$$

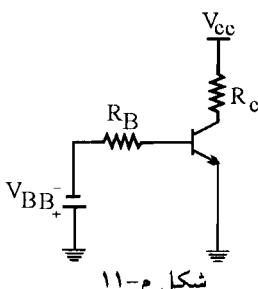
$$\rightarrow -20 + 5/1I_E + 4 = 0 \rightarrow I_E = 3/14mA$$

$$KVL: -20 + 5I_E + R_B \frac{I_E}{1+\beta} + 0/V + 0/1I_E = 0$$

$$\rightarrow -20 + 5 \times 3/14 + R_B \times \frac{3/14}{1+1} + 0/V + 0/1 \times 3/14$$

$$3/289 = R_B \times \frac{3/14}{1+1} \rightarrow R_B = 10.5/V k\Omega$$

۱۱- در مدار شکل م-۱۱، از یک ترانزیستور سیلیکنی با $I_{CBO} = 10nA$ در دمای $25^\circ C$ استفاده شده، که به ازای هر 10° درجه افزایش دما این جریان دو برابر می شود.



شکل م-۱۱

(الف) با فرض $V_{BB} = 8V$ ، به ازای چه مقدار R_B

ترانزیستور در دمای $185^\circ C$ در حالت قطع باقی می ماند؟

(ب) اگر $R_B = 20k\Omega$ و $V_{BB} = 2V$ باشد، تا چه

دمایی ترانزیستور در حالت قطع باقی خواهد ماند؟

۱۰ هم:

(الف) در حالت قطع $V_{BE} = 0V$

$$I_{CBO}(185^\circ) = 10nA \times 2^{\frac{185-25}{10}} = 0.65mA$$

از طرفی $I_B \leq -I_{CBO}$

$$R_B I_B = -V_{BB} - V_{BE} = -V_{BB} \Rightarrow I_B = \frac{-V_{BB}}{R_B} \leq -0.65$$

$$\Rightarrow \frac{V_{BB}}{R_B} \geq 0.65 \Rightarrow \frac{1}{R_B} \geq 0.65 \Rightarrow R_B \geq 1.57k\Omega$$

$$V_{BB} - R_B I_{CBO} = 0 \rightarrow 2 - 2 \cdot I_{CBO} = 0 \rightarrow I_{CBO} = 0.1mA$$

(ب)

$$0.1 = 10 \times 10^{-9} \times 2^{\frac{T-25}{10}} \rightarrow \ln 10 = \frac{T-25}{10} \ln 2 \rightarrow T = 158^\circ$$

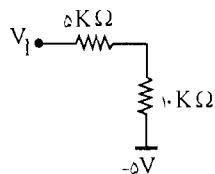
۱۲ - در مدار کلید ترانزیستوری شکل م - ۱۲ برای ترانزیستور $\beta = 50$ و در دمای 25°C ،

$$I_{CBO} = 20 \text{ nA}$$

الف) حداکثر V_I برای اینکه ترانزیستور در دمای 75°C در حالت قطع بماند چه مقدار خواهد بود؟

ب) R_C را طوری تعیین کنید که به ازای $V_I = 5\text{V}$ و با فرض $|V_{CE(sat)}| = 0/2\text{V}$ ترانزیستور اشباع شود. این مقدار R_C حداقل است یا حداکثر؟

راه حل:



معادل تونن مدار مقابل را تعیین می‌کنیم.

$$V_{th} = -5 \times \frac{5}{5+10} + V_I \times \frac{10}{10+5} = \frac{10V_I - 50}{15} = \frac{2V_I - 10}{3}$$

$$R_{th} = 10\text{k}\Omega \parallel 5\text{k}\Omega = \frac{10 \times 5}{10+5} = 3/3\text{k}\Omega$$

$$I_{CBO}(75^\circ) = 2\text{nA} \times 2^{-10} = 64\text{nA}$$

الف) در حالت قطع $V_{th} = 3/3 \times 64 \times 10^{-9} = 0 \rightarrow V_{th} = 2/1 \times 10^{-7}\text{V} \Rightarrow V_{BE} = 0\text{V}$

$$V_{th} = 2/1 \times 10^{-7}\text{V} = \frac{2V_I - 10}{3} \rightarrow 6/3 \times 10^{-7} = 2V_I - 10$$

$$2V_I = 6/3 \times 10^{-7} + 10 \rightarrow V_I = 2/5 \times 10^{-7}\text{V}$$

$$V_I = 5\text{V} \rightarrow V_{th} = \frac{2 \times 5 - 10}{3} = \frac{10 - 10}{3} = 0\text{V} \quad (\text{ب})$$

$$\text{KVL: } -\frac{10}{3}\text{V} + 3/3I_B + 0/V = 0 \rightarrow I_B = 0/29\text{mA}$$

$$V_{CB} = 0/2$$

$$V_E = 0 \rightarrow V_C = 0/2\text{V}$$

$$V_C = 0 - R_C I_C = 0/2 \Rightarrow 0 - 0/2 = R_C I_C \Rightarrow I_C = \frac{0/2}{R_C} \quad (\text{I})$$

$$I_{C(sat)} = \beta_{min} I_B = 20 \times 0/29 = 0/1\text{mA}$$

شرط اینکه ترانزیستور در اشباع باشد این است که $I_B \geq I_{B(sat)}$ و $I_C = \beta_{min} I_B$ و $V_{CE} \leq 0/2$ پس

$$(I) \quad I_B \geq \frac{I_C}{\beta_{min}}$$

$$(II) \quad R_C \geq \frac{V_A}{R_C \times 2.0} \Rightarrow R_C \geq \frac{16/55}{2.0} = 8.2 K\Omega$$

۱۳ - ترانزیستور سیلیکنی مدار شکل م - ۱۳ دارای $\beta < 50$ و $30 < V_{CBO} = 10 \text{ mA}$ در دمای $25^\circ C$

است. $(|V_{CE(sat)}|)$

الف) به ازای $V_I = 12V$ ، ولتاژ V را محاسبه نمایید. ترانزیستور در چه ناحیه‌ای است؟

ب) حداقل مقادیر R را که به ازای آن ترانزیستور در ناحیه فعال خواهد بود به دست آورید.

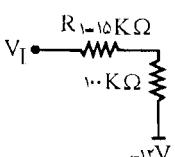
ج) به ازای مقادیر $V_I = 1V$ و $R_I = 15 k\Omega$ ترانزیستور در چه ناحیه‌ای کار می‌کند؟ در این صورت

V را محاسبه نمایید.

د) با مقادیر مفروض در بند (ج) ترانزیستور تا حد اکثر چه دمایی در حالت قطع باقی می‌ماند؟

راه حل:

الف) ابتدا مدار معادل تونن ورودی را به دست می‌آوریم.



$$V_{th} = V_I \times \frac{100}{115} + (-12) \times \frac{15}{115} = \frac{100V_I - 180}{115} = \frac{20V_I - 36}{23}$$

$$R_{th} = 15 \parallel 100 = \frac{100 \times 15}{115} = \frac{300}{23}$$

$$V_I = 12V \rightarrow V_{th} = \frac{20 \times 12 - 36}{23} = \frac{204}{23}$$

$$\text{KVL: } \frac{-20.4}{23} + \frac{300}{23} I_B + 0/V = 0 \rightarrow I_B = 0.63 \text{ mA}$$

$$I_E = (1 + \beta_{av}) I_B = (1 + \frac{30 + 50}{2}) \times 0.63 = 25.8 \text{ mA}$$

$$V_C = 12 - 2/2 \times 25/8 = -44/V_0 < 0$$

پس ترانزیستور در ناحیه اشباع قرار دارد و محاسبات بالا غلط می‌باشد.

$$V_{CE} = 0/V \rightarrow V_{CE} = V_C - V_E = 0/V \rightarrow V_C - 0 = 0/V \rightarrow V_0 = 0/V$$

$$I_C = \frac{12 - 0.7}{2/2} = 5.36 \text{ mA} \quad (b)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{min}} = 0.118 \text{ mA}$$

$$\text{KVL: } V_{th} = R_{th} I_B + 0/V \rightarrow$$

$$\frac{12 \times 100}{100 + R_1} - \frac{12 R_1}{100 + R_1} = \frac{100 R_1}{R_1 + 100} \times 0.118 + 0/V$$

$$1200 - 12R_1 = 100R_1 \times 0.118 + 0/V (100 + R_1) \rightarrow 1200 - 120 = 12R_1 + 1 \\ = 118R_1 + 0/V R_1$$

$$1130 = 30/5R_1 \rightarrow R_1 = 37/0.5 \text{ k}\Omega$$

$$V_{th} = \frac{12 \times 1 - 36}{23} = \frac{-16}{23} \quad R_{th} = \frac{300}{23} \quad (c)$$

$$\text{KVL: } -\frac{16}{23} = \frac{300}{23} \times I_B + 0/V \rightarrow I_B = -0.107 < 0$$

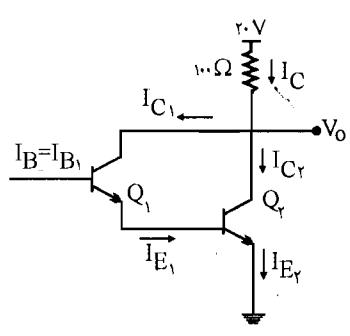
چون I_B کمتر از صفر می‌باشد پس ترانزیستور در ناحیه قطع می‌باشد پس:

$$I_C = 0, \quad V_o = V_{CC} = 12V$$

$$-V_{th} = R_{th} I_{CBO} \rightarrow I_{CBO} = \frac{\frac{16}{23}}{\frac{300}{23}} = 0.053 \text{ mA} \quad (d)$$

$$53/3 \mu A = 10 \times 10^{-3} \times 2^{-10} \rightarrow \ln 53/3 \times 100 = \left(\frac{T_2 - 25}{10} \right) \ln 2$$

$$\rightarrow T_2 = 149^\circ C$$



در مدار شکل م-۱۳ و $\alpha_2 = 0.98$, $I_{E_2} = 120 \text{ mA}$

$\alpha_1 = 0.99$ است. با فرض اینکه ترانزیستورها در ناحیه

فعال باشند (مدار بایاس رسم نشده است)، جریان‌های I_{C_1} و I_{E_1} را محاسبه نمایید. ولتاژ V چقدر

است؟ نسبت جریان‌های I_C و I_{E_2} را محاسبه نمایید.

$$\frac{I_C}{I_{E_2}} = \frac{I_C}{I_B}$$

(ا) مل:

$$I_{E_1} = 12 \text{ mA} \rightarrow I_{C_1} = \alpha_1 I_{E_1} = 0.98 \times 12 \text{ mA} = 11.76 \text{ mA}$$

$$I_{B_1} = I_{E_1} \quad I_{B_1} = I_{C_1} \times \frac{1 - \alpha_1}{\alpha_1} = 11.76 \times \frac{1 - 0.98}{0.98} = 0.2 \text{ mA}$$

$$I_{E_2} = I_{B_1} = 0.2 \text{ mA}$$

$$\rightarrow I_{C_2} = \alpha_2 I_{E_2} = 0.99 \times 0.2 = 0.199 \text{ mA} \rightarrow I_{B_2} = I_{C_2} \times \frac{1 - \alpha_2}{\alpha_2} = 0.199 \times \frac{1 - 0.99}{0.99} = 0.02 \mu\text{A}$$

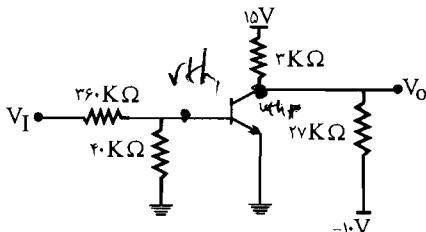
$$I_C = I_{C_1} + I_{C_2} = 0.199 + 0.199 = 0.398 \text{ mA}$$

$$V_o = 20 - 0.1 I_C = 20 - 0.1 \times 0.398 = 19.602 \text{ V}$$

$$\frac{I_C}{I_B} = \frac{0.398}{0.02} = \frac{0.398 \text{ mA}}{0.02 \mu\text{A}} = 19.9 \text{ A/V}$$

$$\frac{I_C}{I_{E_1}} = \frac{0.398}{12} = 0.033 \text{ A}$$

۱۵- در مدار شکل م-۱۵، $\beta = 40$ ، $\alpha = 0.99$ است. مطلوب است محاسبه V_o باشد.

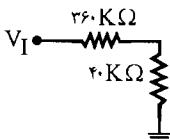


الف) اگر $V_I = 15 \text{ V}$ باشد.

ب) اگر $V_I = 30 \text{ V}$ باشد.

(ا) مل:

مدار معادل تونن ورودی را می‌نویسیم:



$$V_{th} = V_I \times \frac{40}{40 + 0.99} = \frac{V_I}{1.01}$$

$$R_{th} = \frac{40 \times 0.99}{40 + 0.99} = 36 \text{ k}\Omega$$

و مدار معادل کلکتور هم به صورت زیر می‌باشد:

$$V'_{CC} = 5 \times \frac{2V}{2V + 3} + \frac{(-10) \times 3}{3 + 2V} = \frac{2V}{6} - 1 = \frac{21}{6} = 3.5 \text{ V}$$

$$R'_C = 3 \text{ k}\Omega \parallel 2V \text{ k}\Omega = \frac{3 \times 2V}{3 + 2V} = 2/V \text{ k}\Omega$$

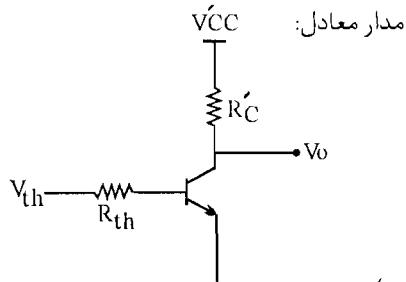
(الف)

$$V_I = 15V \rightarrow \begin{cases} V_{th} = 1/5V \\ R_{th} = 36K\Omega \end{cases} \quad \begin{cases} V'_{CC} = 2/5V \\ R'_C = 2/VK\Omega \end{cases}$$

$$\text{KVL: } V_{th} = 36I_B + 0/V = 1/5V \rightarrow I_B = 22\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 40 \times 22\mu A = 0.88mA$$

$$V_o = 2/5 - 2/V \times 0.88 = 1/124V$$



(ب)

$$V_I = 3.0V \rightarrow \begin{cases} V_{th} = 3V \\ R_{th} = 36K\Omega \end{cases} \quad \begin{cases} V'_{CC} = 2/5V \\ R'_C = 2/VK\Omega \end{cases}$$

$$\text{KVL: } 3 = 36I_B + 0/V \rightarrow I_B = 63/8\mu A$$

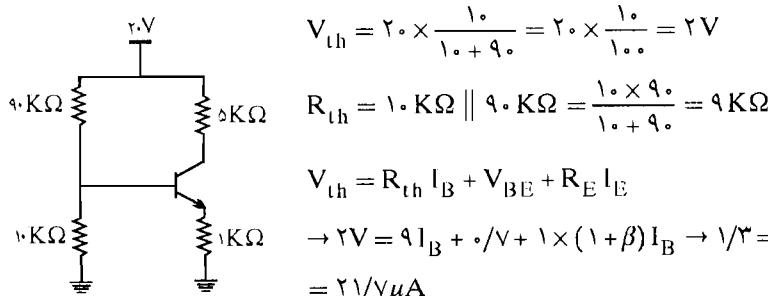
$$I_C = 40 \times 63/8\mu A = 2/55mA$$

$$V_o = 2/5 - 2/V \times 2/55 = -3/36$$

پس ترانزیستور در حالت اشباع قرار دارد پس محاسبات انجام شده غلط می باشد.

$$V_{CE} = 0/2V \rightarrow V_{CE} = V_C - V_E = V_C - 0 = 0/2 \rightarrow V_o = 0/2V$$

۱۶- در مدار شکل م- ۱۶، $\beta = 50$ است. جریان های کلکتور و بیس را محاسبه نمایید.



$$V_{th} = 2.0 \times \frac{10}{10+90} = 2.0 \times \frac{10}{100} = 2V$$

$$R_{th} = 10K\Omega \parallel 90K\Omega = \frac{10 \times 90}{10+90} = 9K\Omega$$

$$V_{th} = R_{th} I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

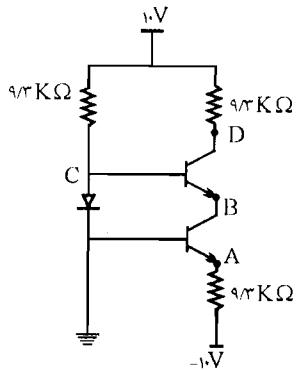
$$\rightarrow 2V = 9I_B + 0/V + 1 \times (1+\beta) I_B \rightarrow 1/3 = 6 \cdot I_B \rightarrow I_B = 21/V\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 50 \times 21/V\mu A = 1.080mA$$

$$V_{CE} = 2.0 - (50+1) \times 1.080 = 13/49V$$

پس ترانزیستور در ناحیه فعال قرار دارد.

۱۷ - در مدار شکل م - ۱۷ برای ترانزیستورها کاملاً مشابه و دارای $V_{BE} = 0.7V$ و برای دیود $V_D = 0.7V$ است. مطلوب است محاسبه ولتاژ نقاط A و B و C و D با فرض



(الف) $\beta = \infty$

(ب) $\beta = 10$

۱۸ حل:

(الف) $\beta = \infty$

$$I_B = 0$$

$$V_C = 0 + 0.7V = 0.7V$$

$$V_A = 0 - 0.7V = -0.7V$$

$$V_B = V_C - 0.7V = 0V$$

$$V_D = 10 - 9/3 \times I_C$$

$$I_{C_1} = I_{E_1} = \frac{10 - 0.7V}{9/3} = 1mA \rightarrow V_D = 10 - 9/3 = 0.7V$$

(ب) $\beta = 10$

$$V_C = 0 + 0.7V = 0.7V$$

$$V_A = 0 - 0.7V = -0.7V$$

$$V_B = V_C - 0.7V = 0V$$

$$I_{E_1} = \frac{10 - 0.7V}{9/3} = 1mA \quad I_{C_1} = I_{E_1} \times \frac{\beta}{1+\beta} = \frac{10}{11} mA$$

$$I_{C_1} = I_{E_1} = I_{C_1} \times \frac{\beta}{1+\beta} = \frac{100}{121} mA$$

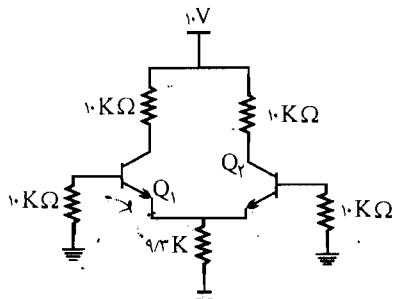
$$V_D = 10 - 9/3 \times \frac{100}{121} = 2.314V$$

۱۸ - در مدار شکل م - ۱۸ ترانزیستورها کاملاً مشابه و دارای $V_{BE} = 0.7V$ هستند. ولتاژ کلکتور

ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 را برای حالت های زیر محاسبه نمایید:

(الف) $\beta_1 = \beta_2 = \infty$

$$\beta_1 = \beta_2 = 100$$



$$I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{10}{10} = 1 \text{ mA}$$

راه حل:

$$\beta_1 = \beta_2 = \infty$$

به علت تقارن دو ترانزیستور Q_1 و Q_2 داریم:

$$\text{KVL: } 10 - I_{B1} + V_{BE1} + 9/3 K\Omega (I_{E1} + I_{E2}) - 10 = 0$$

$$\rightarrow 10 \times \frac{I_{E1}}{\infty} + 0/V + 9/3 \times 2I_{E1} - 10 = 0 \rightarrow 9/3 = 2I_{E1} \times 9/3 \rightarrow I_{E1} = I_{E2} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_C1 = I_{C2} = I_E \rightarrow V_{C1} = V_{C2} = 10 - 10 \times 0.5 = 5 \text{ V}$$

$$\beta_1 = \beta_2 = 100$$

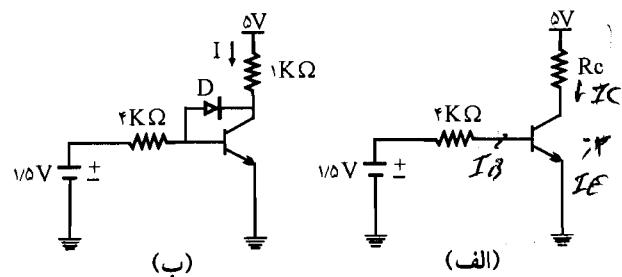
$$\text{KVL: } 10 \times \frac{I_{E1}}{100} + 0/V + 9/3 \times 2I_{E1} - 10 = 0 \rightarrow 9/3 = 18/V I_{E1} \rightarrow$$

$$I_{E1} = I_{E2} = 0.49 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_E \times \frac{\beta}{1+\beta} = 0.49 \times \frac{100}{101} = 0.48 \text{ mA}$$

$$V_{C1} = V_{C2} = 10 - 10 \times 0.48 = 5.2 \text{ V}$$

۱۹- در مدار شکل م-۱۹ برای ترانزیستور، $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ و $\beta = 48$ است.



الف) در مدار شکل

۱۹-م را طوری

تعیین کنید که ترانزیستور

در مرز اشباع قرار گیرد.

ب) در شکل م-۱۹- ب،

شکل م-۱۹

دیود D را به مدار اضافه و $R_C = 1K\Omega$ انتخاب شود. $V_{CE} = 0V$ باشد و I و V_{CE} چقدر خواهد بود؟ ترانزیستور چه وضعیتی دارد؟ نقش دیود D چیست؟

۱۵ حل:

(الف) برای اینکه ترانزیستور در مرز اشباع قرار گیرد باید $V_{CE} = 0V$ در نظر گرفته شود.

$$KVL: -1/5 + 4I_B + 0/V = 0 \rightarrow I_B = \frac{0/5}{4} = 0/2 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 4 \times 0/2 = 9/6 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 0/2V \rightarrow -5 + R_C I_C + 0/2 = 0 \rightarrow R_C = \frac{4/5}{9/6} = 0/5 K\Omega$$

$$V_C = 5 - R_C I_C = 5 - 1 \times 9/6 = -4/6 < 0 \quad (ب)$$

پس ترانزیستور در حالت اشباع قرار خواهد گرفت اما به علت وجود دیود ولتاژ کلکتور بیشتر از $3V$ ولت از ولتاژ بیس کمتر نمی شود.

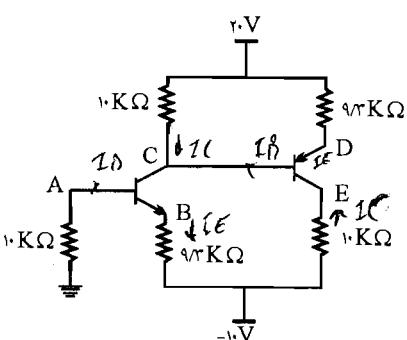
$$V_E = 0 \quad V_B = 0 + 0/V - 0/V \quad V_C = 0/V - 0/3 = 0/4$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 0/4V \rightarrow I = \frac{5 - 0/4}{1K\Omega} = 4/6 \text{ mA}$$

در این حالت ترانزیستور در ناحیه فعال قرار دارد و نقش دیود جلوگیری از به اشباع رفتن ترانزیستور می باشد.

۲۰- در مدار شکل م-۲۰، برای هر یک از ترانزیستورها $V_{BE} = 0.7V$ است. با فرض $\beta = \infty$

مقادیر ولتاژ نقاط A، D، C، B، E را پیدا کنید.



شکل م-۲۰

۱۵ حل:

وقتی $\beta = \infty$ باشد $I_B = 0$ صفر می شود.

$$I_B = 0 \rightarrow V_A = 0V$$

$$V_B = 0 - 0/V = -0/V$$

$$I_{C_1} = I_{E_1} = \frac{10 - 0}{9/3} = 1 \text{ mA} \rightarrow V_C = 20 - 1 \cdot I_{C_1} = 20 - 10 = 10 \text{ V}$$

$$V_D = 0 + 0/V = 0/V$$

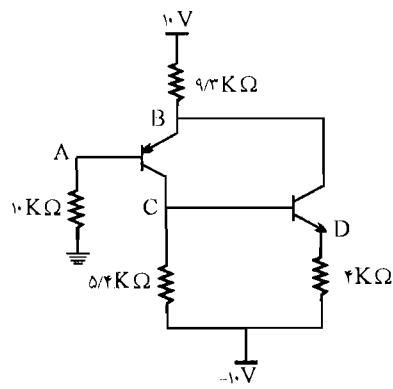
$$I_{C_2} = I_{E_2} = \frac{20 - 10 - 0}{19/3} = 0.4 \text{ mA}$$

$$V_E = -10 - 10 \times 0/48 = -14/48 \text{ V}$$

۲۱- در مدار شکل م - ۲۱ ترانزیستورها مشابه بوده و برای هر یک از آنها به $\beta = \infty$ را به دست آورید. اگر:

$$\beta = \infty$$

$$\beta = 100$$



شکل م

(ا) حل:

$$\beta = \infty$$

$$I_B = 0 \rightarrow V_A = 0 \quad V_B = 0 + 0/V = 0/V$$

$$I = \frac{10 - 0}{9/3} = 1 \text{ mA} = I_{C_1} + I_{C_2} \rightarrow I_{C_1} = 1 - I_{C_2} \quad (\text{I})$$

$$\text{KVL: } 5/4 I_{C_1} = 0/V + 4 I_{C_2} \quad (\text{II})$$

$$(II) \rightarrow 5/4(1 - I_{C_2}) = 0/V + 4 I_{C_2} \rightarrow 5/4 - 4/5 I_{C_2} = 0/V + 4 I_{C_2}$$

$$\rightarrow I_{C_2} = 0.5 \text{ mA} \rightarrow I_{C_1} = 1 - I_{C_2} = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_C = -10 + 5/4 \times 0/5 = -5/2 \text{ V}$$

$$V_D = -5/2 - 0/V = -5/2 \text{ V}$$

$$\beta = 100 \quad (\text{ب})$$

$$\text{KVL: } -10 + 9/3(I_{C_1} + I_{C_2}) + 0/V + 10 \cdot \frac{I_{C_1}}{100} = 0$$

$$\begin{cases} I_{C_2} = I_{E_2} \\ I_{C_1} = I_{E_1} \end{cases} \quad \text{با تقریب}$$

$$KVL: 0.4(I_{C_1} - I_{B_1}) = 0.7V + 4I_{C_1}, \quad I_{B_1} = \frac{I_{C_1}}{\beta} = \frac{I_{C_1}}{100}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -10 + 9/3 I_{C_1} + 9/3 I_{C_1} + 0.7V + 0.1 I_{C_1} = 0 \\ 0.4 I_{C_1} - 0.054 I_{C_1} = 0.7V + 4I_{C_1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 9/4 I_{C_1} + 9/3 I_{C_1} = 9/3 \\ 0.4 I_{C_1} - 4/0.054 I_{C_1} = 0.7V \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_{C_1} = 0.5mA \\ I_{C_1} = 0.49mA \end{cases}$$

$$I_{B_1} = \frac{I_{C_1}}{\beta} = 0.5 \times 10^{-3} mA$$

$$V_A = 10 I_{B_1} = 0.05V \quad V_B = V_A + 0.7V = 0.75V$$

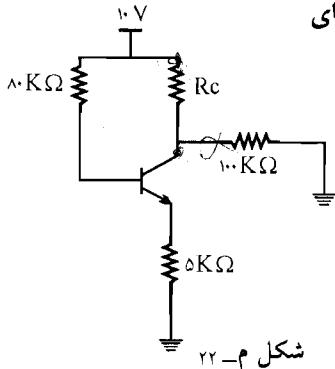
$$V_D = -10 + 4I_{C_1} = -10 + 0.4 \quad V_C = V_D + 0.7V = -10.34V$$

۲۲- لدر مدار شکل ۲۲ با فرض $V_{CE(sat)} = 0.2V$ و $V_{BE(ON)} = 0.7V$ ، $\beta = 100$

(الف) به ازای $R_C = 5k\Omega$ ولتاژها و جریان‌های پایه‌های

ترانزیستور را محاسبه کنید.

(ب) مقدار R_C را طوری تعیین کنید که $V_{CE} = 1V$ شود.



شکل ۲۲

(راه حل:

$$KVL: -10 + 10 I_B + 0.7V + 5 I_E = 0 \quad I_E = (1 + \beta) I_B \quad (\text{الف})$$

$$\rightarrow -10 + 10 I_B + 0.7 + 50 \times 10^{-4} I_B = 0 \rightarrow 50.7 I_B = 9.3$$

$$\rightarrow I_B = 1.86 \mu A$$

$$I_E = 1.1 I_B = 1.1 \times 1.86 \mu A = 1.9 \mu A$$

$$V_E = 5 \times 1.9 \mu A = 5V \quad V_B = 5 + 0.7V = 5.7V$$

مدار معادل کلکتور به صورت زیر می‌باشد:

$$V'_{CC} = 10 \times \frac{100}{100 + R_C} = 10 \times \frac{100}{100} = 9/02 \text{ V}$$

$$R_{th} = R_C \parallel 100 \text{ K}\Omega = \frac{0 \times 100}{0 + 100} = 4/76 \text{ K}\Omega$$

$$V_C = V_{th} - R_{th} I_C = 9/02 - 4/76 \times 1/089 = 1/96 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 1 \text{ V} \quad (\text{b})$$

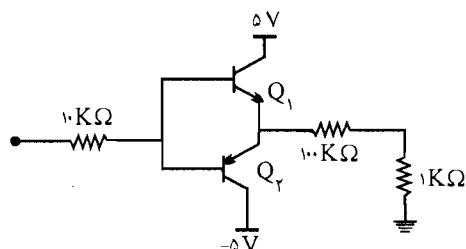
$$\text{KVL: } -V'_{CC} + R_{th} I_C + V_{CE} + 0 I_E = 0$$

$$\rightarrow -10 \times \frac{100}{100 + R_C} + \frac{100 R_C}{100 + R_C} \times 1/089 + 1 \text{ V} + 0 \times 1/6 = 0$$

$$-1000 + 100 R_C \times 1/089 + 9(100 + R_C) = 0 \rightarrow$$

$$100 = 9 R_C + 108/9 R_C \rightarrow R_C = 0/09 \text{ K}\Omega$$

۲۳ در مدار شکل م-۲۳ برای $V_I = \pm 5 \text{ V}$ و $\beta = 100$ و $V_T = \pm 5 \text{ V}$ ، نقطه کار ترانزیستورها را به دست آورید.



شکل م-۲۳

(ا) حل:

$$V_I = 0 \text{ V} \rightarrow \begin{cases} Q_1 = \text{ON} \\ Q_2 = \text{Off} \end{cases}$$

$$I_{E1} = \frac{0 - 0/V}{1 + \frac{1}{10}} = 3/9 \text{ mA} \simeq I_{C1}$$

در اینجا ابتدا مقاومت R_B را به امیتر انتقال می‌دهیم یعنی مقدار R_B در امیتر برابر می‌شود با

$$\frac{1}{1+1} = \frac{1}{1+\beta}$$

$$V_{CE} = 5 - 1 \times I_{E_1} = 5 - 3/9 = 1/1 V$$

$$Q_1 \Rightarrow \begin{cases} I_{C_1} = 3/9 mA \\ V_{CE_1} = 1/1 V \end{cases}$$

$$V_I = -5 V \rightarrow \begin{cases} Q_1: \text{Off} \\ Q_2: \text{ON} \end{cases}$$

$$I_{E_2} = \frac{5 - 0/V}{1 + \frac{1}{10}} = 3/9 mA \approx I_{C_2}$$

$$V_{CE} = -5 + 1 \times I_{E_2} = -5 + 3/9 = -1/1 V$$

$$Q_2 \Rightarrow \begin{cases} I_{C_2} = 3/9 mA \\ V_{CE_2} = -1/1 V \end{cases}$$

۲۴- مسئله ۲۳ را به ازای ولتاژ ورودی ۷ ولت حل کنید.

(راه حل:

$$V_I \text{ و } 10 K\Omega \text{ و } V_{BE_1} \text{ در حلقه KVL: } 10 I_{10K\Omega} + 1 \times I_{1K\Omega} = V_I - V_{BE_1}$$

ترانزیستورها در ناحیه active در نظر گرفته می‌شوند:

$$10(I_{B_1} - I_{B_2}) + 1(I_{E_1} - I_{E_2}) = 7 - 0/V = 7 \Rightarrow 10I_{B_1} + (1+\beta)I_{B_2} - 10I_{B_2} - (1+\beta)I_{B_1} = 7/3$$

$$\Rightarrow 111I_{B_1} - 111I_{B_2} = 7/3 \quad : \beta = 100$$

$$V_I \text{ و } 10 K\Omega \text{ و } V_{BE_2} \text{ در حلقه KVL}$$

$$10I_{10K\Omega} + 1I_{1K\Omega} = V_I + V_{EB_2} = 7 + 0/V = 7/V \Rightarrow$$

$$111I_{B_1} - 111I_{B_2} = 7/V$$

در این دو معادله به دست آمده دیده می‌شود که طرف اول برابر ولی طرف دوم متفاوت می‌باشند پس دو

ترانزیستور با هم نمی‌توانند روشن باشند و Q_2 را در حالت قطع در نظر می‌گیریم خواهیم داشت:

$$111I_{B_1} = 7/3 \Rightarrow I_{B_1} = \frac{7/3}{111} \quad \text{و معادله اول چنین می‌شود: } I_{B_2} = I_{E_2} = 0.$$

$$I_{E_1} = (1+\beta)I_{B_1} = 10 \times \frac{7/3}{111} = 5/111 mA$$

$$V_{CE_1} = V_{C_1} - V_{E_1} = 5 - 1 \times I_{E_1} = -7/111 V$$

پس Q_1 نمی‌تواند فعال باشد چون $V_{CE_1} < 0$ به دست آمد پس Q_1 در حالت اشباع می‌باشد و داریم
 $V_{CE_1} = 0$

$$1K\Omega \text{ و } V_{CE_1} \text{ و } 5K\Omega \text{ در حلقه KVL } 1 \times I_{E_1} = 0 - V_{CE_1} = 0 - 0/2 \Rightarrow I_{E_1} = 4/\Delta mA$$

$$1K\Omega \text{ و } V_{BE_1} \text{ و } V_I \text{ و } 10K\Omega \text{ در حلقه } 10: 10I_{B_1} + 1I_{E_1} = V_I - V_{BE_1} \Rightarrow 10I_{B_1} + 1 \times 4/\Delta$$

$$= V_I - 0/2I_{B_1} = 0/10mA \Rightarrow V_{E_1} = V_{BE_1} = 1 \times I_{B_1} = 1 \times 4/\Delta = 4/\Delta V$$

$$V_{BE_1} = V_{B_1} - V_{E_1} = 0/V \Rightarrow V_{B_1} = 0/V + V_{E_1} = 4/5V$$

$$V_{B_1} = V_B = 5/5V$$

و با این V_{EB} مشخص می‌شود که Q_2 در حالت قطع قرار دارد پس نقطه کار ترانزیستور به صورت زیر می‌باشد:

$$I_{B_1} = 0/10mA$$

$$I_{E_1} = 4/\Delta mA$$

$$I_{B_2} = 0$$

$$I_{C_1} = 4/\Delta - 0/10 = 4/60mA$$

$$I_{E_2} = 0$$

$$V_{CE_1} = 0/2V$$

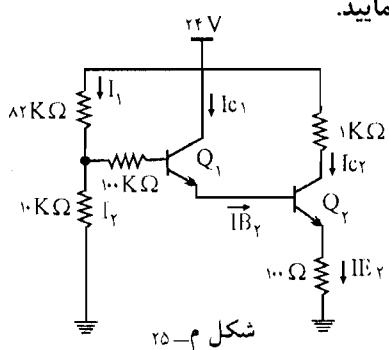
$$I_{C_2} = 0$$

۲۵-۲۵ در مدار شکل م-۲۵ ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 در ناحیه فعال کار می‌کنند.

$$\beta_1 = 100, \beta_2 = 50, V_{BE_1} = V_{BE_2} = 0.7V \text{ و از جریان اشباع معکوس صرفنظر می‌شود.}$$

(الف) جریان‌های $I_{E_1}, I_{C_1}, I_1, I_{B_2}$ و I_{E_2} را محاسبه نمایید.

(ب) ولتاژ V_{E_2} و V_{C_2} را پیدا کنید.



۱۵ حل:

(الف) ابتدا مدار معادل تونن ورودی را می‌یابیم:

$$V_{th} = 24 \times \frac{10}{10 + 82} = 2.6V$$

$$R_{th} = 82K\Omega \parallel 10K\Omega + 100K\Omega = 10.9/9K\Omega$$

وقتی به بیس ترانزیستور منتقل شود در $(1 + \beta_1) \times (1 + \beta_2)$ ضرب می‌شود.

$$KVL: -V_{th} + R_{th} I_{B_1} + \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} \times (1 + \beta_1) \times (1 + \beta_2) I_{B_1} + \frac{V}{R_2} = 0$$

$$\rightarrow -24 + 10 \times 9 I_{B_1} + 10 + \frac{V}{10} \times 10 \times 51 \times I_{B_1} = 0$$

$$\frac{V}{10} = 624 I_{B_1} \rightarrow I_{B_1} = 1/92 \mu A$$

$$I_{E_1} = I_{B_1} = (1 + \beta_1) I_{B_1} = 51 I_{B_1} = 1 \times 1/92 \mu A = 97/92 \mu A$$

$$I_{C_1} = \beta_1 I_{B_1} = 50 \times 1/92 \mu A = 96 \mu A$$

$$I_{C_2} = \beta_2 I_{B_2} = 100 \times 97/92 \mu A = 9792 \mu A$$

$$I_{E_2} = (1 + \beta_2) I_{B_2} = 101 \times 97/92 \mu A = 989 \mu A$$

$$KVL: \begin{cases} I_1 = ? \\ I_2 = ? \end{cases} \quad \rightarrow -24 + 10(I_2 + 1/92 \times 10^{-3}) + 10 I_2 = 0 \rightarrow I_2 = 0/26 \mu A$$

$$I_1 = 0/26 \mu A + 1/92 \times 10^{-3} = 0/261 \mu A$$

$$V_{C_2} = 24 - 1 K\Omega \times I_{C_2} = 24 - 9/92 = 24/91 \mu V$$

$$V_{E_2} = 0/1 I_{E_2} = 0/1 \times 989 = 989 \mu V$$

۲۶- در مدار شکل م-۲۶ با فرض فعال بودن ترانزیستور، رابطه V

بر حسب زاربه دست آورده و نشان دهید رفتار مدار مشابه رفتار

دیود در ناحیه مستقیم است. مقادیر γ و R_2 را بر حسب V_{BE} و β و R_1 و R_2 به دست آورید.

ا) حل:

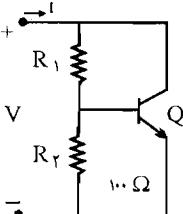
$$V_B = V_{th} = \frac{V \times R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2$$

$$I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_{th}} \quad , \quad I_C = \beta I_B = \beta \times \frac{V_B - V_{BE}}{R_{th}}$$

$$i = I_C + I_{R_2} + I_B$$

$$I_{R_2} = \frac{V_{BE}}{R_2}$$

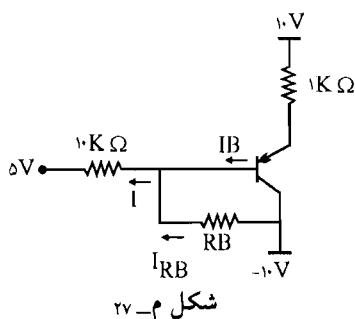


$$\begin{aligned}
\rightarrow i &= (\beta + 1) I_B + I_{R_Y} \\
\rightarrow i &= (\beta + 1) \times \frac{V_B - V_{BE}}{R_{th}} + \frac{V_{BE}}{R_Y} = (\beta + 1) \times \frac{\frac{VR_Y}{R_1 + R_Y} - V_{BE}}{\frac{R_1 R_Y}{R_1 + R_Y}} + \frac{V_{BE}}{R_Y} \\
&= (\beta + 1) \times V \times \frac{R_Y}{R_1 + R_Y} \times \frac{R_1 + R_Y}{R_1 R_Y} - (\beta + 1) \times \frac{V_{BE}}{R_1 R_Y} (R_1 + R_Y) + \frac{V_{BE}}{R_Y} \\
&= \frac{(\beta + 1)V}{R_1} - V_{BE} \times \left[\frac{1 + \beta}{R_1 \parallel R_Y} - \frac{1}{R_Y} \right]
\end{aligned}$$

و رفتار دیود در ناحیه مستقیم به شکل زیر می‌باشد:

$$\begin{aligned}
i &= (V - V_\gamma) \times \frac{1}{R_f} \\
R_f &= \frac{R_1}{R_1 + R_Y} \quad V = \frac{R_1}{1 + \beta} \left[\frac{1 + \beta}{R_1 \parallel R_Y} - \frac{1}{R_Y} \right] V_{BE}
\end{aligned}$$

۲۷ - در مدار شکل م - ۲۷ برای ترانزیستور و $V_{EB}(\text{sat}) = 0/\Delta V$ و $V_{EC}(\text{sat}) = 0/2V$ و $V_{BE}(\text{ON}) = 0/7V$ و $\beta = 100$ است.



الف) به ازای $R_B = 5K\Omega$ ولتاژ و جریان امیتر را به دست آورید.

ب) آیا می‌توان R_B را طوری تعیین نمود که ترانزیستور اشباع شود.

ج) آیا می‌توان R_B را طوری تعیین نمود که ترانزیستور قطع شود.

راه حل:

$$\text{KVL: } 1K\Omega \times I_E + 10I = 10 - 5 - 0/V \Rightarrow I_E + 10I = 4/3 \quad (I)$$

$$\text{KVL: } 10I + R_B \times I_{RB} = -10 - 5 \Rightarrow 10I + 5 \times (I - I_B) = -15 \Rightarrow$$

$$10I + 5(I - \frac{I_E}{100 + 1}) = -15 \Rightarrow \frac{-5}{101} I_E + 15I = -15 \quad (II)$$

$$(I), (II) \Rightarrow \begin{cases} I_E + 10I = 4/3 \rightarrow I = \frac{4/3 - I_E}{10} & (III) \\ \frac{-\beta}{1+\beta} I_E + 15I = -15 \Rightarrow & \text{قرار می‌دهیم} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{-\beta}{1+\beta} I_E + 15 \times \frac{4/3 - I_E}{10} = -15 \Rightarrow I_E = 13/84 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow V_E = 10 - 1K\Omega \times I_E = 10 - 13/84 = -3/84 \text{ V}$$

ب) برای اینکه ترانزیستور ناحیه اشباع قرار گیرد باید $V_{CE} = -0.2 \text{ V}$ باشد و $V_{EB} (\text{sat}) = 0.8 \text{ V}$

$$KVL: 1 \times I_E = 10 - (-10) - 0.2 \Rightarrow I_E = 19/8 \text{ mA}$$

$$I_B (\text{sat}) = \frac{I_E}{1+\beta} = \frac{19/8}{1+1} = 0.196 \text{ mA}$$

$$KVL: 10I + 1 \times I_E = 10 - 0 - 0.2 \Rightarrow I = -1/56 \text{ mA}$$

$$I_{RB} = \frac{V_{EB} - V_{EC}}{R_B} = \frac{0.8 - 0.2}{R_B} = \frac{0.6}{R_B}$$

$$\text{از طرفی: } I_{RB} = I - I_B \Rightarrow \frac{0.6}{R_B} = -1/56 - I_B$$

$$\rightarrow I_B = -1/56 - \frac{0.6}{R_B}$$

مالحظه می‌کنیم که I_B مقدار منفی دارد و نمی‌تواند از $(sat)_B$ بیشتر باشد پس ترانزیستور هیچ وقت به اشباع نمی‌رود.

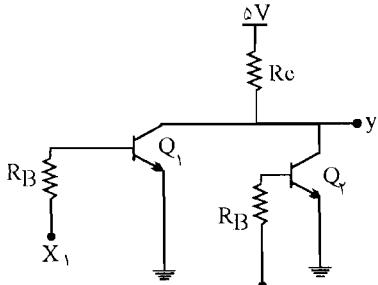
ج) برای اینک ترانزیستور قطع شود:

$$\begin{cases} I_E = 0 \\ V_{EB} = 0 \end{cases} \Rightarrow KVL: 10I = 10 - 0 \rightarrow I = 1 \text{ mA} , \quad I_{RB} = \frac{-10 - 10}{R_B} = \frac{-20}{R_B}$$

$$I_B = I - I_{RB} = 1/56 + \frac{20}{R_B}$$

برای اینکه ترانزیستور قطع شود باید $I_C < I_B$ شود می‌بینیم که I_B مقداری ثابت است و نمی‌تواند از I_{CO} -کوچکتر شود پس ترانزیستور هیچ وقت به حالت قطع نمی‌رود.

۲۸- در مدار شکل م- ۲۸ با فرض اینکه $V_{CE(sat)} = 0.2V$ و با صرفنظر از جریان I_{CB} جدول داده شده را تکمیل نمایید.



شکل - ۲۸

x_1	x_2	y
۰ V	۰ V	
۰ V	۵ V	
۵ V	۵ V	

راه حل:

در حالت اول $x_1 = 0V$ پس در ترانزیستور Q_1 $I_B = 0V$ و $x_2 = 0V$ در ترانزیستور Q_2 نیز $I_B = 0V$ باشد پس $y = V_0 = 5V$ یعنی $V_0 = V_{CC}$

x_1	x_2	y
۰ V	۰ V	۵ V
۰ V	۵ V	۰.۲ V
۵ V	۵ V	۰.۲ V

در حالت دوم $x_1 = 5V$ و $x_2 = 0V$ در ترانزیستور اول I_B صفر می‌شود ولی در ترانزیستور دوم جریان

$$R_B I_{B_2} = 5 - V_{BE_2} \Rightarrow I_{B_2} = \frac{4/3}{R_B} \quad I_B \text{ داریم.}$$

اگر ترانزیستور Q_2 در حالت اشباع باشد $y = 0.2V$ می‌شود پس باید تحقیق کنید که در حالت اشباع قرار دارد یا نه.

$$R_C (I_{C_1} + I_{C_2}) = 5 - V_{CE_2} \Rightarrow R_C I_{C_2} = 4/8 \Rightarrow I_{C_2} = \frac{4/8}{R_C}$$

$$\frac{4/3}{R_B} \geq \frac{4/8}{R_C \times \beta_{min}}$$

$$\Leftrightarrow I_{B_2} > I_B(\text{sat}) = \frac{I_{C_2}}{\beta_{min}}$$

و بین مقاومت‌های R_B و R_C باید رابطه فوق برقرار باشد تا ترانزیستور Q_2 در اشباع باشد.

$$\frac{R_B}{R_C} \leq \frac{4/3 \times \beta_{min}}{4/8} \Rightarrow \frac{R_B}{R_C} \leq 0.896 \beta_{min}$$

پس با $x_1 = 0$ و $x_2 = 0$ با شرایط فوق $y = 0$ ولت می‌شود.

و اگر $x_1 = x_2 = 0$ ولت باشند.

$$I_{B_1} = I_{B_2} = \frac{V_B}{R_B}$$

با اشباع بودن Q_1 و Q_2 خواهیم داشت ($I_{C_1} = I_{C_2}$)

$$V_{CE_1} = V_{CE_2} = 0 - R_C(I_{C_1} + I_{C_2}) = 0 - I_{C_1} \times R_C = 0/2V$$

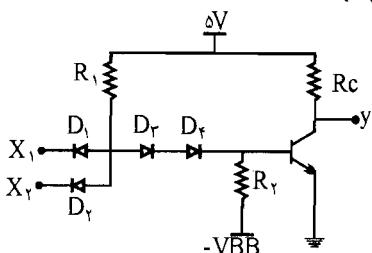
$$\Rightarrow I_{C_1} = \frac{V_B}{2R_C}$$

$$I_{B_2} \geq \frac{I_{C_1}}{\beta_{min}} \Rightarrow \frac{V_B}{R_B} \geq \frac{V_B}{2R_C\beta_{min}}$$

$$\frac{R_B}{R_C} \leq \frac{4/3 \times 2 \times \beta_{min}}{4/8} \Rightarrow \frac{R_B}{R_C} \leq 2 \times 0.896 \beta_{min}$$

لذا با شرط فوق هر دو ترانزیستور در ناحیه اشباع قرار دارند و $y = 0$ ولت می‌باشد.

۲۹- مدار شکل م-۲۹ یک NAND از خانواده DTL است. با فرض اینکه ولتاژ هدایت هر دیود ۰/۷۷V بوده و بروای ترانزیستور، ولتاژهای آستانه هدایت، ناحیه فعل و اشباع بیس-امیتر به ترتیب $0/87V$ و $0/80V$ و $0/77V$ در نظر گرفته شوند، در مورد نحوه عملکرد مدار و مقدار خروجی y به ازای مقادیر جدول داده شده بحث کنید. ($V_{CE(sat)} = 0/2V$)



x_1	x_2	y
۰ V	۰ V	
۰ V	۵ V	
۵ V	۵ V	

x_1	x_2	y
۰ V	۰ V	۵ V
۰ V	۵ V	۵ V
۵ V	۵ V	۰/۲ V

(۱۰) هل:

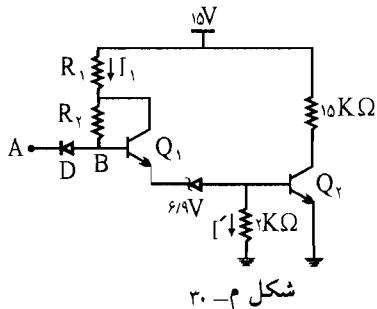
در حالت اول وقتی هر دو ورودی صفر باشند ترانزیستور در حالت قطع قرار دارد و در این حالت ولتاژ خروجی یعنی $y = V_{CE} = 5V$ برابر می‌شود یعنی

در حالت دوم وقتی که یکی صفر و دیگری $5V$ می‌باشد باز هر دو ترانزیستور در حالت قطع قرار دارد و ولتاژ خروجی برابر است با $V_{CE} = 5V$

در حالت سوم وقتی هر دو ورودی $5V$ ولت باشند ترانزیستور در حالت اشباع قرار دارد و ولتاژ خروجی با

$$y = V_{CE}(\text{sat}) = 0/2V$$

۳۰ - مدار شکل م - بخشی از یک دروازه منطقی است که به صورت یک معکوس کننده عمل می‌کند. با فرض ایده‌آل بودن دیود D ، $V_{BE}(\text{sat}) = 0.8V$ و $V_{CE}(\text{sat}) = 0.2V$.
 الف) وضعیت ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 و دیود D را در $Y=0$ تعیین نماید. (منظور $Y=0$ منطقی است).



ب) فرض کنید در ورودی و خروجی، این مدار به دروازه مشابه خود وصل شده باشد. ولتاژ نقاط را برای $Y=0$ تعیین نمایید.

ج) در صورتی که $\beta_1 = \beta_2 = 20$ باشد، $R_1 = R_2 = \beta_1$ را طوری تعیین کنید که در حالت $Y=0$ جریان $I_{C_1}(\text{sat}) / 2$ شود.

(۱۱) هل:

الف) با فرض $Y=0$ ، ترانزیستور Q_2 به اشباع می‌رود و دیود زنر در حالت شکست قرار می‌گیرد پس ولتاژ بیس ترانزیستور Q_1 به صورت زیر می‌شود:

$$\text{KVL: } V_{B_1} = V_{B_{E_1}} + V_Z + V_{B_{E_2}} = 0.7 + 6.9 + 0.7 = 8.3V$$

و وقتی $V_{B_1} = 8.3V$ شود در این صورت $V_A = 15V$ برابر $15V$ خواهد بود یعنی ورودی در سطح (۱) می‌باشد در این صورت دیود D خاموش می‌باشد و ترانزیستور Q_1 روشن می‌باشد.

و اگر $V_A = 0.2V$ باشد که برابر سطح منطقی صفر است در این صورت V_B برابر است با:

$$V_B = 0.2 + 0.7 = 0.9V$$

یعنی $V_B = 0.9V$ می‌شود پس Q_1 و Q_2 هر دو قطع می‌باشد و $Y=0$ می‌شود پس

در سطح منطقی یک باشد پس در حالت ۱ $V_Y = 15V$ هر دو ترانزیستور خاموش و دیود D روشن می‌باشد و دیود زنر در بایاس معکوس می‌باشد و قطع می‌شود.

ب) و V_A در بند الگ محاسبه شده است.

ج) در حالتی که $Y = 0$ می‌باشد، Q_2 به اشباع می‌رود و دیود زنر در حالت شکست می‌باشد و داریم:

$$I_{C_1}(\text{sat}) = \frac{15 - V_Y}{15} = \frac{15 - 0/2}{15} = \frac{15/2}{15} = 0.99 \text{ mA}$$

با توجه به جریان I_1 داریم:

$$I_1 = \frac{I_{C_1}(\text{sat})}{2} = \frac{0.99}{2} = 0.495 \text{ mA}$$

$$I_{E_1} = I'_1 + I_{B_1} \quad I_{E_1} = \frac{V_{BE_1}}{2} + \frac{I_{C_1}}{\beta} = \frac{0/8}{2} + \frac{0.99}{20}$$

$$I_{E_1} = 0/4 + 0/0.49 = 0.449 \text{ mA}$$

$$I_{C_2} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{E_1} = \frac{20}{1+20} \times 0.449 = 0.43 \text{ mA}$$

$$V_B = V_{BE_1} + V_Z + V_{BE_2} = 0/V + 6/9 + 0/8 = 8/4$$

$$V_B = 15 - R_1 I_1 - R_2 (I_1 - I_{C_1}) = 8/4$$

$$15 - R_1 \times 0.495 - R_2 (0.495 - 0.43) = 8/4$$

$$0.65 R_2 = 6/4 - 0.495 R_1 \quad (\text{I})$$

طرف دوم رابطه (I) باید عدد مثبتی باشد پس:

$$6/4 - 0.495 R_1 > 0 \rightarrow R_1 < 13/46 \text{ K}\Omega$$

$$R_1 = 12/25 = R_2 = \frac{6/4 - 0.495 \times 12/25}{0.65} = 8/5 \text{ K}\Omega$$

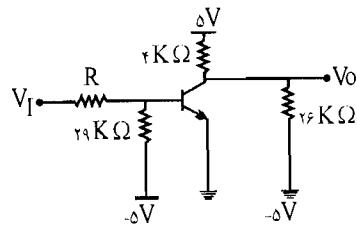
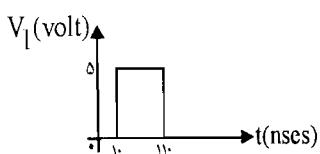
۳۱- در مدار شکل م-۳۱، با فرض $\beta = 100$ و $V_{CE}(\text{sat}) = 0/2V$

الف) حداقل مقادیر R را طوری تعیین کنید که با شکل موج ورودی نشان داده شده تغییر وضعیت ترانزیستور بین حالت‌های قطع و اشباع امکان‌پذیر باشد.

ب) ولتاژ خروجی بین چه مقادیری تغییر می‌کند؟

ج) در صورتی که ترانزیستور مورد نظر $t_s = 60 \text{ nsec}$ و $t_f = 10 \text{ nsec}$ و $t_r = 20 \text{ nsec}$

باشد، شکل موج V را با مقیاس مناسب رسم کنید.



شکل ۳۱ - م

۱۰ حل:

(الف)

$$V_B = \frac{-\Delta \times R}{R + 29 \text{ k}\Omega} + \frac{29 V_I}{R + 29}$$

$$R_B = 29 \parallel R = \frac{29 R}{29 + R}$$

$$V_C = \frac{-\Delta \times 4}{4 + 26} + \frac{\Delta \times 26}{26 + 4} = -\frac{2}{3} + \frac{13}{3} = 3/\sqrt{V}$$

$$R_C = 4 \text{ k}\Omega \parallel 26 \text{ k}\Omega = \frac{4 \times 26}{26 + 4} = 3/5 \text{ k}\Omega$$

$$V_I = 0 \rightarrow V_B = \frac{-\Delta R}{R + 29}$$

به ازای تمام مقادیر R مقادیر V_B منفی است و ترانزیستور در حالت قطع قرار دارد.

در حالت اشباع داریم:

$$V_I = 5 \text{ V}$$

$$V_B = \frac{-\Delta R + 29 V_I}{R + 29} = 0/\Delta$$

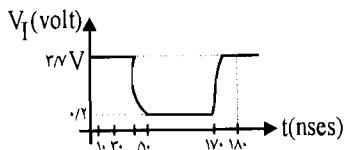
$$\frac{-\Delta R + 29 \times \Delta}{R + 29} = 0/\Delta \rightarrow -\Delta R + 14\Delta = 0/\Delta R + 23/\Delta$$

$$\Delta/\Delta R = 121/\Delta \rightarrow R_{max} = 21 \text{ k}\Omega$$

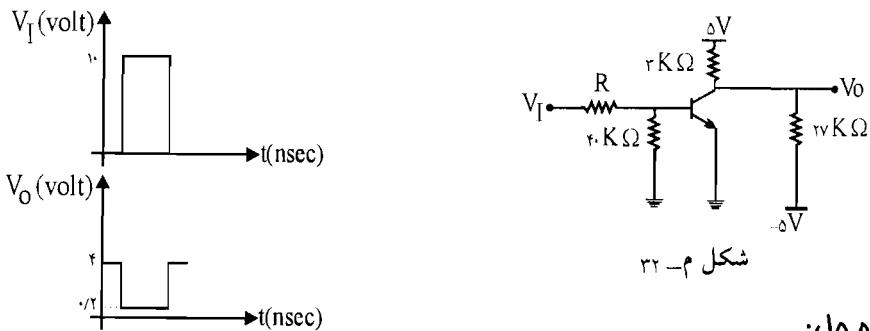
ب) بین $V_{CE(sat)} = 0/2 \text{ V}$ و $V_C = 3/\sqrt{V}$

ج) وقتی $V_I = 5 \text{ V}$ است، ترانزیستور در حالت اشباع قرار دارد و $0/2 \text{ V} = 0 \text{ V}$ می‌باشد، و وقتی

$V_I = 0 \text{ V}$ است، ترانزیستور در حالت قطع قرار دارد و $3/\sqrt{V} = 3.77 \text{ V}$ می‌باشد.



۳۲- در مدار شکل م-۳۲، با فرض $V_{CE}(\text{sat}) = 0/2V$ و $\beta = 100$ ، به ازای شکل موج ورودی V_I ، شکل موج خروجی V_O حاصل شده است. (از زمان‌های قطع و وصل ترانزیستور صرف نظر شده است) مقدار مقاومت R چقدر باید باشد؟ این مقدار حداقل است یا حد اکثر؟



(ا) حل:

مدار معادل تونن را در کلکتور در نظر می‌گیریم:

$$V_C = 5 \times \frac{2V}{2V+3} + \frac{(-\omega) \times 3}{2V+3} = 4V$$

$$R_C = 3K\Omega \parallel 1V K\Omega = \frac{3 \times 2V}{3 + 2V} = 2/V K\Omega$$

همچنین مدار معادل تونن در بیس به صورت زیر است:

$$V_B = \frac{V_I \times 4}{4 + R}$$

$$R_B = R \parallel 4 = \frac{4 \cdot R}{R + 4}$$

و قطبی $V_I = 0V \rightarrow V_B = V_C = 4V$

ترانزیستور در حالت اشباع قرار دارد.

$$\text{و قطبی } V_I = 10V \rightarrow V_B = \frac{10 \times 4}{4 + R} = 8/V$$

$$\frac{400}{40 + R} = 8/V \rightarrow 400 = 32 + 8/V R \rightarrow R = 46 K\Omega$$

این مقدار برای R حد اکثر می‌باشد چون اگر مقدار R از این مقدار بیشتر باشد مقدار V_B از $8/V$ کوچکتر می‌شود و ترانزیستور به حالت قطع پیش می‌رود.

۳۳- در مدار کلید ترانزیستوری شکل م-۳۳، $I_{CBO} = 0/0.1\mu A$ (در دمای 25°C) و $20 \leq \beta \leq 50$ است.

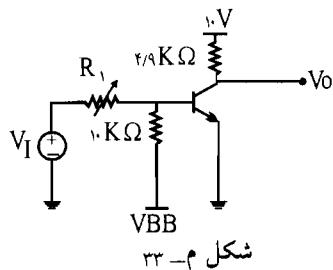
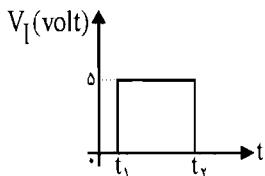
$V_{BE}(\text{cut}) = 0V$ و $V_{CE}(\text{sat}) = 0/2V$ و $0 \leq R_1 \leq 10 K\Omega$ است.

(الف) در صورتی که بخواهیم به ازای $V_I = 0V$ ترانزیستور تا دمای 175°C در حالت قطع باشد،

حداکثر مقدار ولتاژ منبع V_{BB} چقدر باید باشد؟

(ب) به ازای $R_1 = 6\text{ K}\Omega$ و $V_I = -5\text{ V}$ در دمای 25°C شکل موج ولتاژ خروجی را برای شکل موج ورودی V_I نشان داده شده به دست آورید.

(ج) وجود مقاومت متغیر R چه اسکال عملی می‌تواند داشته باشد؟



داه هم:

$$V_B = V_I \times \frac{10}{R_1 + 10} + \frac{V_{BB} \times R_1}{R_1 + 10}$$

الف) مدار معادل تونن ورودی را می‌نویسیم:

$$R_B = R_1 \parallel 10\text{ K}\Omega$$

$$I_{CBO}(175) = I_{CBO}(25) \times 2^{\frac{175-25}{10}} = 0.1\mu\text{A} \times 2^{15} = 327/68\mu\text{A}$$

در حالت قطع باید داشته باشیم $I_B \leq I_{CBO}$

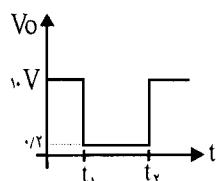
$$I_B = \frac{V_{BB}}{10} \Rightarrow \frac{V_{BB}}{10} \leq -327/68 \times 10^{-3} \Rightarrow V_{BB} \leq 3/28\text{V}$$

(ب)

$$V_B = \frac{10V_I}{10 + R_1} + \frac{V_{BB}R_1}{10 + R_1} \quad \begin{cases} V_{BB} = -5\text{ V} \\ R_1 = 6\text{ K}\Omega \end{cases}$$

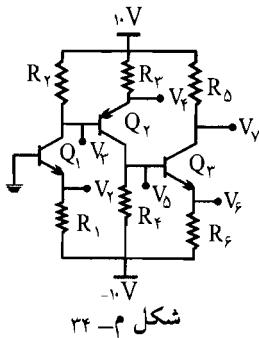
$$V_B = \frac{10V_I}{16} - \frac{30}{16}, \quad R_B = \frac{10 \times 6}{10 + 6} = \frac{60}{16} = 3.75\text{ K}\Omega$$

$$\rightarrow \begin{cases} V_I = 0 \rightarrow V_B = \frac{-30}{16} \rightarrow \text{ترانزیستور قطع} \\ V_I = 5 \rightarrow V_B = \frac{20}{16} = 0.25\text{ V} \rightarrow \text{ترانزیستور اشباع} \end{cases}$$



(ج) اگر R پتانسیومتر باشد، $V_I = 5\text{ V}$ صفر باشد در این صورت، همه ولتاژ ورودی روی پیوند بیس، امیتر می‌افتد که این کار موجب آسیب دیدن ترانزیستور می‌شود.

۳۴- در مدار شکل م- با فرض $\beta = \infty$ ، مقادیر مقاومت‌ها را طوری تعیین کنید که جریان کلکتورهای Q_1 و Q_2 به ترتیب 2 میلی آمپر و Q_3 به ولت $V_V = 2$ ، $V_\delta = -4$ ، $V_\gamma = 0$ باشد. با مقادیر به دست آمده فوق به ازای $\beta = 100$ مقادیر V_γ و V_δ و V_δ را به دست آورید.



راه حل:

$$\beta = \infty \rightarrow I_B = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{Q_1} = 2 = \frac{10 - V_\gamma}{R_\gamma} = \frac{10 - 0}{R_\gamma} \rightarrow R_\gamma = 5\text{K}\Omega \\ I_{Q_2} = 2 = \frac{10 - V_\delta}{R_\delta} = \frac{10 - (V_\gamma + 0/V)}{R_\delta} = \frac{10 - 0/V}{R_\delta} \rightarrow R_\delta = 4/65\text{ K}\Omega \\ I_{Q_3} = 4 = \frac{10 - V_\delta}{R_\delta} = \frac{10 - (2)}{R_\delta} \rightarrow R_\delta = 2\text{K}\Omega \end{array} \right.$$

$$\text{KVL: } V_\gamma - (-10) = R_\gamma \times I_{Q_1} = 2R_\gamma \rightarrow (0 - 0/V) + 10 = 2R_\gamma \rightarrow R_\gamma = 4/65\text{ K}\Omega$$

$$\text{KVL: } V_\delta - (-10) = R_\delta \times I_{Q_2} = 2R_\delta \rightarrow 10 - 4 = 2R_\delta \rightarrow R_\delta = 3\text{K}\Omega$$

$$\text{KVL: } V_\delta - (-10) = R_\delta \times I_{Q_3} = 4R_\delta \rightarrow (V_\delta - 0/V) + 10 = 4R_\delta$$

$$\rightarrow 10 - 4/V = 4R_\delta \rightarrow R_\delta = 1/325\text{ K}\Omega$$

$$V_\gamma = 0 - 0/V = -0/V\text{V}$$

$$\therefore \beta = 100$$

$$I_{E_1} = \frac{10 - 0/V}{4/65} = 2\text{mA} \rightarrow I_{C_1} = 1/9\text{ mA} \rightarrow I_{C_1} = \frac{10 - V_\gamma}{R_\gamma} = \frac{10 - V_\gamma}{5} = 1/9\text{ mA}$$

$$10 - V_\gamma = 9/9 \rightarrow V_\gamma = 0/1\text{V} \rightarrow V_\delta = V_\gamma + 0/V = 0/1 + 0/V = 0/\text{V}$$

$$V_\delta = -10 + R_\delta I_{C_1} \Rightarrow I_{C_1} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{E_1}$$

$$I_{C_1} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{E_1} \rightarrow I_{E_1} = \frac{10 - V_\delta}{R_\delta} = \frac{10 - 0/V}{4/65} = 1/9\text{ mA}$$

$$I_{C_r} = \frac{10}{10} \times 1/9A = 1/96 mA \rightarrow V_o = -10 + 3 \times 1/96 = -4/12V$$

$$V_s = V_o - 0/V = -4/12 - 0/V = -4/12V$$

$$V_v = 10 - R_o I_{C_r}$$

$$I_{C_r} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{E_r} \rightarrow I_{E_r} = \frac{V_s - (-10)}{R_s} = \frac{-4/12 + 10}{1/320} = 3/9 mA$$

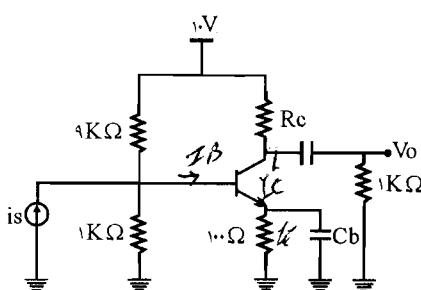
$$\rightarrow I_{C_r} = \frac{10}{10} \times 3/9 mA = 3/18 mA$$

$$\rightarrow V_v = 10 - 2 \times 3/18 mA = 10/12V$$

فصل ۵

طراحی مدارهای بایاس ترانزیستور

۱- در مدار شکل م - ۱ ، با فرض $\beta = 100$ و $V_{CE(sat)} = 0.2V$ ، مقدار R_C را طوری تعیین نمایید که دامنه نوسان متقارن ولتاژ V_O حداقل شود.



شکل م - ۱

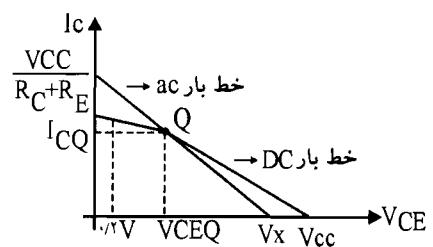
(ا) حل:

مدار معادل ورودی به صورت زیر می باشد:

$$\begin{cases} V_{th} = \frac{10V \times 1K\Omega}{1K\Omega + 9K\Omega} = 1V \\ R_{th} = 1K\Omega \parallel 9K\Omega = 0.1K\Omega \end{cases}$$

$$I_{EQ} \approx I_{CQ}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{th} - 0.1V}{R_E + \frac{R_{th}}{\beta}}$$



$$\rightarrow I_{EQ} = \frac{1 - 0/V}{0/1 + \frac{0/9}{100}} = \frac{0/3}{0/1 + 9 \times 10^{-3}} = 2/75 \text{ mA}$$

$$\rightarrow I_{CQ} = 2/75 \text{ mA}$$

برای اینکه دامنه نوسان متقارن حداکثر شود باید:

$$V_{CEQ} = \frac{V_x - 0/3}{2} \quad (\text{I})$$

$$\text{KVL: } V_{CEQ} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_C = 10 - (0/1 + R_C) \times 2/75 \quad (\text{II})$$

$$ac \text{ معادله خط بار } V_{CE} = V_{CEQ} = -R_{ac} (I_C - I_{CQ})$$

$$V_x = R_{ac} I_{CQ} + V_{CEQ} \quad (\text{III})$$

$$R_{ac} = 1K\Omega \parallel R_C = \frac{R_C}{1 + R_C}$$

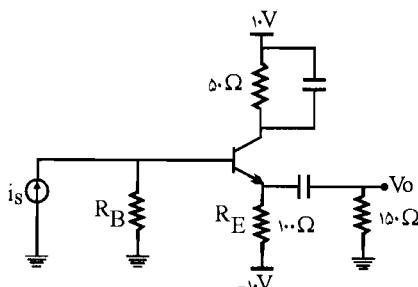
(II) و (III) را در رابطه (I) قرار می‌دهیم:

$$10 - 2/75 (0/1 + R_C) = \frac{\left(\frac{R_C}{1 + R_C} \right) \times 2/75 + 10 - (0/1 + R_C) \times 2/75 - 0/2}{2}$$

این معادله یک معادله درجه (2) می‌باشد که با حل آن مقدار $R_C = 2/83 K\Omega$ به دست می‌آید.

۲- در مدار شکل م-۲، با فرض $R_B \ll R_E \ll R_C$ ، نقطه کار را به دست آورده، خط بارها رارسم نمایید.

حداکثر دامنه نوسان متقارن V_x را مشخص کنید.



شکل ۲-۳

$$\text{KVL: } V_{CEQ} = V_{CC} - V_{EE} - (R_C + R_E) I_{CQ} \quad (\text{I})$$

راه حل:

$I_{CQ} = ? \rightarrow V_{EE}, R_E, V_{BE}$ و R_B در حلقه KVL:

$$\rightarrow \frac{R_B}{\beta} I_{CQ} + 0/V + R_E I_E - 10 = 0 \Rightarrow I_{CQ} = \frac{9/3}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

طبق فرض مسئله $R_B \ll \beta R_E$ یعنی $\frac{R_B}{\beta} \ll R_E$ در برابر R_E صرفنظر می‌کنیم.
 $I_{CQ} = \frac{V_{CEQ}}{R_E} = \frac{9/3}{0/1} = 93 \text{ mA}$

$$(I) \rightarrow V_{CEQ} = 10 - (-10) - (0/0.5 + 0/1) \times 93 = 20 - 0/15 \times 93 = 6/0.5 \text{ V}$$

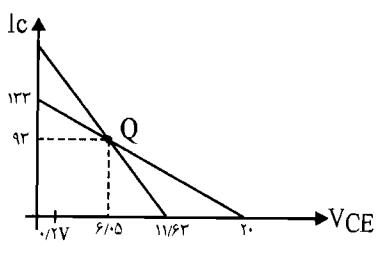
$$CD \text{ خط بار : } 20 - 0/15 I_C = V_{CE}$$

$$\text{ac خط بار } V_{CE} - V_{CEQ} = -R_{ac}(I_C - I_{CQ}) \quad , \quad R_{ac} = 0/1 K\Omega \parallel 0/15 K\Omega = 6.0 \Omega$$

$$I_C = 0 \rightarrow V_{CE} - V_{CEQ} = 6.0 \Omega I_{CQ} \times 10^{-3} = 0/0.6 I_{CQ} \rightarrow \text{ محل تقاطع خط بار ac با ولتاژ}$$

$$\rightarrow V_{CE} = V_x = 0/0.6 I_{CQ} + V_{CEQ} = 11/63$$

حداکثر دامنه نوسان متقارن : V_O^+



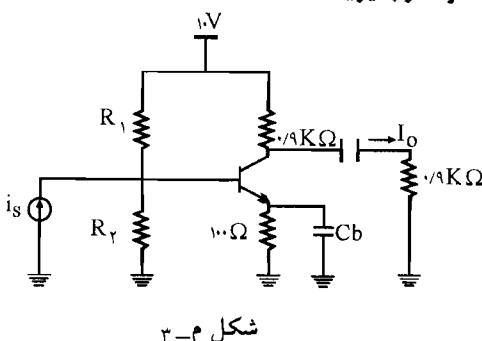
$$V_O^+ = V_x - V_{CEQ} = 11/63 - 7/0.5 = 5/0.85 \text{ V}$$

حداقل دامنه نوسان متقارن : V_O^-

$$V_O^- = V_{CEQ} - V_{CE}(\text{sat})$$

$$\rightarrow V_O^- = 6/0.5 - 0/2 = 5/0.85$$

۳) تقویت کننده شکل ۳ را با فرض $\alpha = 99/0$ در نظر بگیرید.



(الف) R_2 و R_1 را طوری محاسبه کنید که
دامنه نوسان متقارن جریان i_o حداکثر
شود.

(ب) خط بارهای ac و DC رارسم کنید؛
حداکثر دامنه جریان کلکتور چقدر است؟
ج) حداکثر دامنه جریان i_o چقدر
می‌تواند باشد؟

۴۵ هل :

(الف) شرط اینکه دامنه نوسان خروجی حداکثر شود این است که نقطه کار در وسط خط بار ac قرار گیرد.

$$R_{ac} = 0/9 K\Omega \parallel 0/9 K\Omega = \frac{0/9 \times 0/9}{0/9 + 0/9} = 0/45 K\Omega$$



$$R_{DC} = 0.9K\Omega + 0.1K\Omega = 1K\Omega$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{ac} + R_{DC}} = \frac{10V}{1 + 0.1K\Omega} = 6.9mA$$

$$V_{th} = \frac{V_{CC} \times R_Y}{R_1 + R_Y} = \frac{10 \times R_Y}{R_1 + R_Y} \quad (I)$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_Y = \frac{R_1 R_Y}{R_1 + R_Y} \rightarrow \frac{R_Y}{R_1 + R_Y} = \frac{R_{th}}{R_1} \quad (II)$$

$$\text{از طرفی } R_{th} = \frac{\beta R_E}{10} \Rightarrow \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{0.99}{1-0.99} = 99 \rightarrow R_{th} = \frac{99 \times 0.1}{10} = 0.99K\Omega$$

$$(II): \frac{R_Y}{R_1 + R_Y} = \frac{R_{th}}{R_1} = \frac{0.99}{R_1}$$

$$(I): V_{th} = \frac{10 \times 0.99}{R_1} = \frac{9.9}{R_1}$$

$$\begin{aligned} \text{از طرفی } I_{CQ} &= \beta I_B \Rightarrow 6.9mA = 99 \times \frac{V_{th} - 0V}{R_{th} + \beta R_E} = 99 \times \frac{\left(\frac{9.9}{R_1} - 0V\right)}{0.99 + 99 \times 0.1} \\ &\rightarrow 6.9mA = \frac{\frac{9.9}{R_1} - 0V}{0.1 + 0.1} = \frac{\frac{9.9}{R_1} - 0V}{0.2} \rightarrow 0.2 \times 6.9 = \frac{9.9}{R_1} - 0V \end{aligned}$$

$$\rightarrow R_1 = 9.9V \approx 10K\Omega$$

$$\rightarrow \frac{R_Y}{R_1 + R_Y} = \frac{0.99}{10} \rightarrow \frac{R_Y}{9.9V + R_Y} = \frac{0.99}{9.9V} = 0.1$$

$$\rightarrow R_Y = 0.1V + 0.1 \times 9.9V \rightarrow R_Y = 1.09K\Omega$$

$$DC: V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \quad (b)$$

$$ac: V_{CE} - V_{CEO} = -R_{ac}(I_C - I_{CQ})$$

$$\text{از طرفی } V_{CEO} = V_{CC} - (R_C + R_E)I_{CQ} = 10 - (0.1 + 0.9) \times 6.9 = 3.1V$$

محل تقاطع خط بار ac با ولتاژ:

$$i_C = 0 \rightarrow V_{CE} = 3.1V + 0.1 \times 6.9mA = 3.7V$$

محل تقاطع خط بار ac با جریان:

$$V_{CE} = 0 \rightarrow -V_{CEO} = -R_{ac}(i_C - I_{CQ}) \rightarrow$$

$$-\frac{V_{CE}}{R_E} = -0.45(i_C - 6/9) \rightarrow i_C - 6/9 = 6/45 \rightarrow i_C = 13/45 \text{ mA}$$

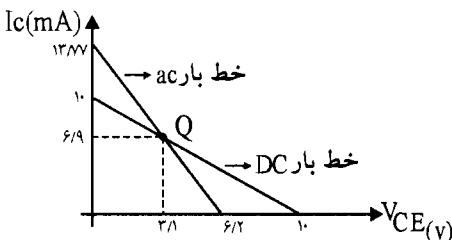
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \rightarrow I_C = 13/45 \text{ mA}$$

محل تقاطع خط بار DC با ولتاژ

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \rightarrow I_C = 0 \rightarrow V_{CE} = V_{CC} = 10 \text{ V}$$

محل تقاطع خط بار DC با جریان

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \rightarrow I_C = 0 \rightarrow V_{CE} = V_{CC} = 10 \text{ V}$$



حداکثر مقدار جریان کلکتور

$$i_{C_{max}} = i_C - I_{CQ} = 13/45 - 6/9 = 6/45 \text{ mA} \approx 6/9 \text{ mA}$$

ج) از قانون تقسیم جریان استفاده می‌کنیم:

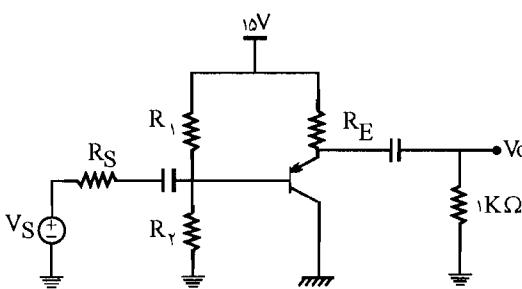
$$i_s = i_C \times \frac{R_L}{R_C + R_L}$$

$$i_{s_{max}} = i_{C_{max}} \times \frac{0.9 \text{ K}\Omega}{0.9 \text{ K}\Omega + 0.9 \text{ K}\Omega} = 6/9 \text{ mA} \times \frac{1}{2} = 3/45 \text{ mA}$$

۴- در مدار شکل ۴، با فرض $\beta < 100$ و $V_{EB} = 0.7 \text{ V}$ و $V_{CE}(\text{sat}) = 0.2 \text{ V}$

الف) معادل خط بارهای DC و ac را

به دست آورید.



شکل ۴

در سیکل فرض تا ۴ ولت نوسان بدون اعوجاج داشته باشد.

(ا) هل:

$$\text{DC: } V_{EC} = V_{CC} - I_C(R_E + R_C) = V_{CC} - I_C R_E = 15 - I_C R_E \quad \text{(الف)}$$

ب) مقادیر مقاومت‌های R_1 ، R_E و R_2 را طوری تعیین کنید که نقطه کار نسبت به تغییرات β پایدار بوده و V_{CE} بتواند در سیکل مثبت تا ۸ ولت و

$$ac: V_{EC} - V_{ECQ} = -R_{ac}(i_C - I_{CQ})$$

$$از طرفی: R_{ac} = R_E \parallel K\Omega = \frac{R_E}{1 + R_E}$$

برای رسم خط بارهای DC و ac ابتدا محل تقاطع این خطوط با V_C را پیدا می کنیم سپس آنها را رسم می کنیم.

محل تلاقی خط بار DC با ولتاژ:



$$I_C = 0 \rightarrow V_{EC} = V_{CC} = 15$$

محل تلاقی خط بار DC با جریان:

$$V_{EC} = 0 \rightarrow V_{CC} - I_C R_E = 0$$

$$\Rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_E} = \frac{15}{R_E}$$

محل تلاقی خط بار ac با ولتاژ:

محل تلاقی خط بار ac با جریان:

$$\begin{cases} V_+ = 4V \\ V_{EC}(\text{sat}) = 0/2 \end{cases} \rightarrow V_{ECQ} = -R_{ac}(i_C - I_{CQ}) \rightarrow V_{ECQ} = 4/2 = 4 \rightarrow V_{ECQ} = 4/2 V \quad (b)$$

$$V_+ = 8V \rightarrow V_x = 8 + 4/2 = 12/2 V$$

$$DC \text{ خط بار } V_{ECQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 15 - R_E I_{CQ} \Rightarrow 15 - 4/2 = I_{CQ} R_E \quad (I)$$

$$ac \text{ خط بار } I_C = 0 \rightarrow V_x = V_{ECQ} + R_{ac} I_{CQ} = 4/2 + \frac{R_E}{1 + R_E} I_{CQ}$$

$$12/2 = 4/2 + \frac{R_E}{1 + R_E} I_{CQ} \rightarrow 8 = \frac{R_E}{1 + R_E} I_{CQ} \quad (II)$$

با استفاده از روابط (I) و (II) داریم:

$$10/8 = 8(1 + R_E) \rightarrow (1 + R_E) = 1/35 \rightarrow R_E = 0/35 K\Omega$$

طبق فرض مسئله نقطه کار نسبت به β پایدار بوده در نتیجه داریم:

$$R_{th} = \frac{\beta_{min} R_E}{1} = \frac{50 \times 0/35}{1} = 1/70 K\Omega$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - 0/V - V_{th}}{R_E + \frac{R_{th}}{\beta_{av}}} = \frac{10 - 0/V - V_{th}}{0/3\Omega + \frac{1/V\Delta}{\beta_{av}}} \quad (\text{III})$$

$$\beta_{av} = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} = \frac{50 + 100}{2} = 75$$

$$V_{ECQ} = V_{CC} - R_E I_{CQ} \rightarrow I_{CQ} = \frac{10 - 4/2}{0/3\Omega} = 3.0/86 \text{ mA}$$

$$\xrightarrow{(\text{III})} 3.0/86 = \frac{14/3 - V_{th}}{0/3\Omega + \frac{1/V\Delta}{75}} \rightarrow 14/3 - V_{th} = 11/52 \rightarrow V_{th} = 2/V\Delta \text{ V}$$

$$V_{th} \text{ از طرفی} = \frac{V_{CC} \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1/V\Delta \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1/V\Delta}{R_1}$$

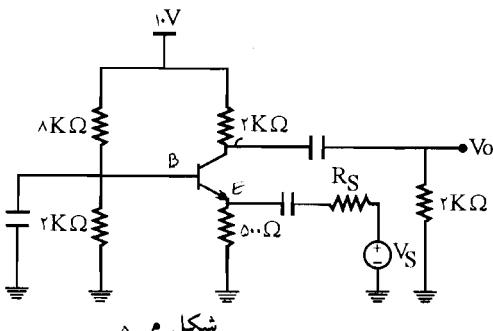
$$\rightarrow V_{th} = \frac{10 \times 1/V\Delta}{R_1} = 2/V\Delta \rightarrow R_1 = 9/54 \text{ K}\Omega$$

$$\frac{R_2}{9/54 + R_2} = \frac{1/V\Delta}{9/54} = 0/18 \rightarrow R_2 = 1/V\Delta + 0/18 R_2 \rightarrow$$

$$\rightarrow R_2 = 2/1 \text{ K}\Omega$$

۵- در تقویت کننده شکل م-۵ با فرض $\beta = 100$ و $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ، مختصات نقطه کار و حد اکثر

دامنه نوسان متقارن V_s را به دست آورید.



شکل م-۵

راه حل:

مدار بیس مشترک است. ابتدا مدار معادل تونن ورودی را می‌یابیم:

$$V_{th} = \frac{10 \times 2K\Omega}{2K\Omega + 1K\Omega} = 2 \text{ V}$$

$$R_{th} = 2K\Omega \parallel 1K\Omega = \frac{2 \times 1}{2+1} = 1/3 K\Omega$$

در معادله خط بار ac داریم:

$$I_{CQ} = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{th}}{\beta}} = \frac{2 - 0.7}{0.5 + \frac{1/3}{100}} = 2/52 mA$$

$$V_{CBQ} = (V_{CC} - V_{BE}) - (R_C + R_E) I_C = (10 - 0.7) - (2 + 0.5)(2/52) = 3V$$

$$\xrightarrow{\text{مختصات نقطه کار}} \begin{cases} I_{CQ} = 2/52 mA \\ V_{CE} = 3V \end{cases}$$

در معادله خط بار ac داریم:

$$V_{CB} - V_{CBQ} = -R_{ac}(i_C - I_{CQ})$$

$$R_{ac} = 2K\Omega \parallel 1K\Omega = 1K\Omega$$

$$i_C = 0 \rightarrow V_{CB} = 3 + 2/52 = 5/52 V = V_x$$

به دست اوردن حداکثر دامنه نوسان متقارن V_x :

$$V_x^- = V_{CBQ} - V_{CBQ}(\text{sat})$$

$$V_{CB}(\text{sat}) = V_{CE}(\text{sat}) - V_{BE}(\text{sat}) = 0/2 - 0/1 = -0/6$$

$$\rightarrow V_x^- = 3V - (-0/6) = 3/6 V$$

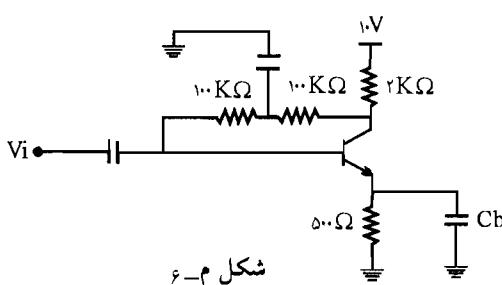
$$V_x^+ = V_x - V_{CBQ} = V_{CB} - V_{CBQ} = 5/52 - 3 = 2/52 V$$

$$\rightarrow V_x^+ = V_x^+ = 2/52 V \quad \text{حداکثر دامنه نوسان متقارن } V_x$$

از دو مقدار به دست آمده کمترین مقدار به عنوان حداکثر دامنه نوسان متقارن V_x می‌باشد.

۶- در مدار شکل م-ع، با فرض $\beta = 400$ و $V_{CE}(\text{sat}) = 0/2 V$ ، مختصات نقطه کار ترانزیستور

را به دست آورید. حداکثر دامنه نوسان متقارن جریان کلکتور چقدر است.



۱۰۵ هل:

معادله خط بار DC:

$$KVL: V_{CEQ} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_C = 10 - (2 + 0.5) I_C \quad (I)$$

$$KVL: 10 - 2(1 + \beta) I_B - 200 I_B - 0.5(1 + \beta) I_B = 0$$

$$\rightarrow I_B = \frac{10 - 0.5V}{(2 + 0.5) \times 4 / 1 + 200} = 5 / 5mA \rightarrow I_{CQ} = \beta I_B = 400 \times 5 / 5\mu A = 4 / 0.8mA$$

$$(I) \rightarrow V_{CEQ} = 10 - 2/0.8 \times 4/0.8 = 2/3V$$

$$R_{ac} = 2K\Omega \parallel 100K\Omega = \frac{2 \times 100}{2 + 100} = 1.96 K\Omega$$

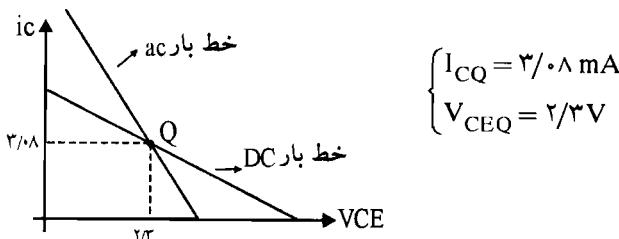
$$ac: V_{CE} - V_{CEQ} = -R_{ac}(i_C - 4/0.8)$$

$$V_{CE} = 0 \rightarrow i_C = 4/26 mA$$

$$i_{Cmax} = i_C - I_{CQ} = 4/26 - 4/0.8 = 1/18 mA$$

حداکثر دامنه نوسان متقارن جریان کلکتور

مختصات نقطه کار:

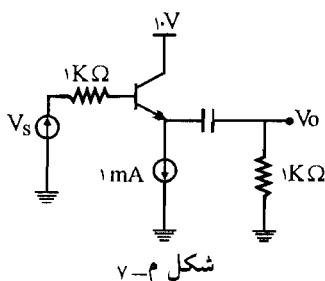


۷- در مدار شکل م-۷، حداکثر دامنه ولتاژ ورودی V_s برای هر یک از حالت‌های زیر با فرض

$\beta = \infty$ و $V_{CE(sat)} = 0/2V$ و $V_{BE} = 0/V$ چقدر می‌تواند باشد؟

الف) در سیکل منفی ولتاژ خروجی برش ایجاد شود.

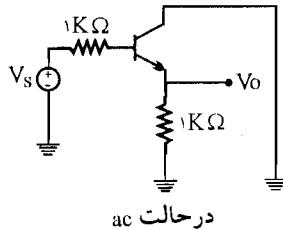
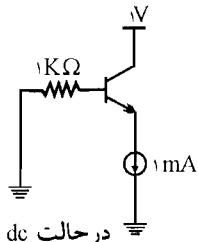
ب) در سیکل مثبت ولتاژ خروجی برش ایجاد شود.



راه حل:

الف) مدار معادل DC و ac را رسم می‌کنیم:

$$I_{CQ} = 1 \text{ mA}$$

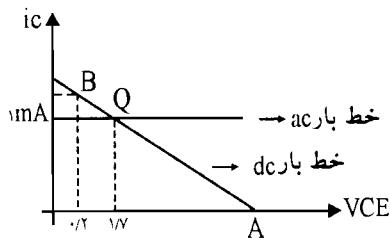


$$\text{DC: معادله خط بار } V_{CE} = V_{CB} + B_{BE}$$

در مدار $V_B = 0$: $I_B = 0$ چون $\beta = \infty$ (پس داریم):

$$V_{CE} = V_C - V_B + V_{BE} = 1 - 0 + 0/V = 1/V \quad , \quad I_{CQ} = 1 \text{ mA} = I_E$$

$$\text{ac: معادله خط بار } V_{Ce} = -1 \times i_C = -i_C$$



برای اینکه سیگنال برش نخورد باید: $V_{CE}(B) \leq V_{CE} \leq V_{CE}(A)$

با $i_C = 0$ و $V_{CE} = 0/2$ می‌باشد:

$$A: نقطه i_C = 0$$

$$B: نقطه V_{CE} = 0/2$$

$$\Rightarrow V_{CE} - V_{CEQ} = -(i_C - I_{CQ})$$

$$\begin{cases} V_{CEQ} = 1/V \\ I_{CQ} = 1 \text{ mA} \end{cases} \quad \begin{cases} V_{CE}(B) = 0/2 \\ V_{CE}(A) = V_{CE}(Q) + I_{CQ} = 1/V + 1 = 2/V \end{cases}$$

$$V_{CE} = V_{ce} + V_{CEQ} \quad \text{از طرفی } 0/2 \leq V_{CE} \leq 2/V$$

$$\Rightarrow 0/2 \leq V_{ce} + V_{CEQ} \leq 2/V \Rightarrow 0/2 \leq V_c - V_e + 1/V \leq 2/V$$

در مدار معادل ac داریم: $V_e = V_s$ و $V_c = 0$

$$\Rightarrow 0/V \leq 0 - V_s + 1/V \leq 2/V \Rightarrow 0/V \leq -V_s + 1/V \leq 2/V$$

پاسخ خواسته شده به صورت زیر می باشد:

$$-V_s + 1/V \leq 2/V \Rightarrow V_s \geq -1$$

$$V_s \geq 1/V$$

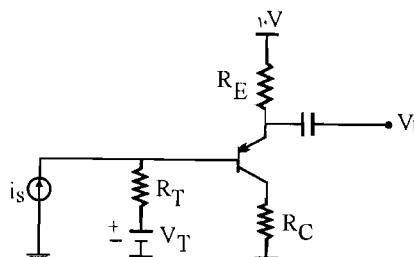
$$-V_s + 1/V \geq 0/V \Rightarrow V_s \leq 1/V$$

$$V_s \leq 1/V$$

- در مدار بیس مشترک شکل م-۸ با شرط پایداری نقطه کار نسبت به تغییرات β و اینکه نقطه کار

وسط خط بار ac قرار داشته باشد، نشان دهید:

$$\frac{R_C}{R_E} = \frac{V_T}{2(9/3 - V_T)}$$



شکل م-۸

(ا) حل:

$$\text{معادله خط بار: } V_{CB} - V_{CB} = +R_{ac}(i_C - I_C)$$

$$i_C = 0 \rightarrow V_{CB} = V_{CB} - R_{ac}I_C$$

$$\text{از طرفی: } R_{ac} = R_C \rightarrow V_{CB} = V_{CB} + R_C I_C$$

وقتی نقطه کار وسط خط بار ac باشد یعنی دامنه متقارن حداقل می باشد.

$$\text{وسط خط بار ac: } V_{CB} = \frac{1}{2}V_{CB} \quad (\text{برای اینکه حداقل دامنه متقارن را داشته باشیم})$$

$$\rightarrow V_{CB} = \frac{1}{2}(V_{CB} - R_C I_C) \rightarrow V_{CB} = -R_C I_C \quad (\text{I})$$

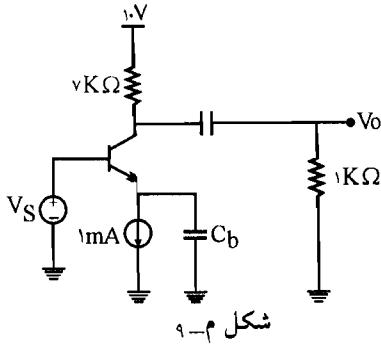
$$\text{معادله خط بار DC: } -V_T - V_{CB} + R_C I_C = 0 \quad (\text{II})$$

$$\text{رابطه (I) را در رابطه (II) قرار می دهیم: } -V_T + R_C I_C + R_C I_C = 0 \rightarrow I_C = \frac{V_T}{2R_C} \quad (\text{III})$$

$$\text{KVL: } -10 + R_E I_C + 0/V + V_T = 0 \rightarrow I_C = \frac{9/3 - V_T}{R_E} \quad (\text{IV})$$

$$(\text{III}), (\text{IV}) \Rightarrow \frac{V_T}{2R_C} = \frac{9/3 - V_T}{R_E} \rightarrow \frac{R_C}{R_E} = \frac{V_T}{2(9/3 - V_T)}$$

۹- برای تقویت کننده شکل م-۹ با فرض $V_{BE} = 0.7V$ و R_E حداقل ولتاژ $V_{CE(sat)} = 0.2V$ مثبت و منفی خروجی چقدر است؟



راه حل:

حداکثر دامنه ولتاژ مثبت و منفی از روابط زیر به دست می‌آید:

$$\begin{cases} V_+^+ = V_{CE \max} - V_{CEO} \\ V_-^- = V_{CEO} - V_{CE(sat)} \end{cases} \quad (I)$$

با توجه به این روابط مشخص می‌شود که باید معادله خط بار DC و ac را مشخص کنیم.
مختصات نقطه کار:

$$\begin{cases} I_{CQ} = 1mA \\ V_C = 10 - R_C I_C = 10 - 1V \times 1 = 9V \\ V_{BE} = V_B - V_E \rightarrow 0.7V = 0 - V_E \rightarrow V_E = -0.7V \end{cases} \rightarrow V_{CEO} = V_C - V_E = 9.7V$$

$$ac: \text{خط بار } V_{Ce} - V_{CEO} = -R_{ac}(i_C - I_{CQ}) \quad (II)$$

$$R_{ac} = 1K\Omega \parallel 1K\Omega = \frac{1K\Omega \times 1K\Omega}{1K\Omega + 1K\Omega} = 0.5K\Omega \quad \text{از طرفی}$$

$$(II) \rightarrow V_{Ce} - 9V = -0.5K\Omega(i_C - 1) \rightarrow V_{Ce \ max} = ?$$

وقتی به دست می‌آید که $i_C = 0$ باشد.

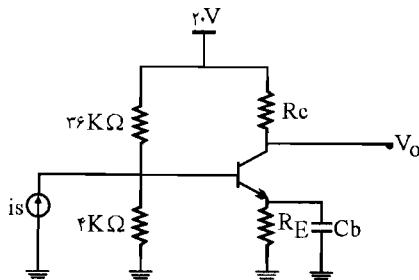
$$\rightarrow V_{Ce \ max} = 9V + 0.5K\Omega V = 9.5V$$

سپس با استفاده از روابط (I) داریم:

$$\begin{cases} V_+^+ = 9.5V - 9V = 0.5V \\ V_-^- = 9V - 0.2V = 8.8V \end{cases}$$

۱۰- در شکل م-۱۰، برای ترانزیستور $\beta > 60$ و $R_C = 40\Omega$ $V_{BE} = 0.7V$ را طوری

تعیین کنید که نقطه کار از پایداری مطلوبی نسبت به تغییرات β برخوردار بوده و خمناً دامنه نوسان مقاین خروجی حداقل شود. حداقل دامنه نوسان خروجی چقدر است؟



شکل ۱۰-۳

۱۰-۴ هل:

مدار معادل تونن ورودی:

$$\begin{cases} V_{th} = \frac{4 \times 20}{4 + 36} = 2V \\ R_{th} = 4K\Omega \parallel 36K\Omega = \frac{4 \times 36}{4 + 36} = 3.6K\Omega \end{cases}$$

طبق فرض مسئله داریم نقطه کار نسبت به تغییرات β پایدار می باشد پس داریم:

$$R_{th} = \frac{\beta_{min} R_E}{10} \rightarrow 3.6K\Omega = \frac{40 R_E}{10} \rightarrow R_E = 0.9K\Omega$$

$$KVL: I_{CQ} = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E} = \frac{2 - 0.7V}{0.9} = \frac{1.3}{0.9} = 1.44mA$$

برای داشتن حداقل دامنه نوسان خروجی:

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{ac} + R_{DC}} \quad \begin{cases} R_{ac} = R_C \\ R_{DC} = R_C + R_E \end{cases}$$

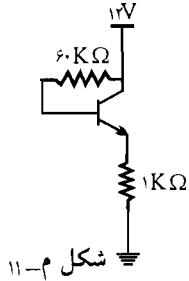
$$\rightarrow I_{CQ} = 1.44mA = \frac{20}{R_C + R_C + 0.9} = \frac{20}{2R_C + 0.9} \rightarrow 20 \times 2R_C + 12/9 = 20$$

$$\rightarrow R_C = 6/4V K\Omega$$

$$V_O^+ = V_{CE} - V_{CEQ} \Rightarrow \begin{cases} ac \text{ خط بار} : V_{CE} - V_{CEQ} = -R_{ac}(I_C - I_{CQ}) \\ I_C = 0 \rightarrow V_{CE} - V_{CEQ} = -6/4V(0 - 1.44) = 9/32 \end{cases}$$

$$\rightarrow V_O^+ = 9/32$$

۱۱- در مدار شکل م - ۱۱، با فرض $V_{BE} = ۰/۷V$ و $\beta = ۵۰$ ، تغییرات جریان کلکتور نقطه کار را محاسبه کنید.



شکل م - ۱۱:

طبق روابط (۵-۵) و (۵-۴۳) کتاب داریم:

$$S_\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta} = \frac{I_{C_1}}{\beta_1} \left[\frac{R_T + R_E}{R_T + (1 + \beta_1)R_E} \right]$$

از طرفی در این مدار (شکل م - ۱۱) داریم:

$$\begin{cases} V_T = 12V \\ R_T = 6K\Omega \end{cases}$$

$$\text{KVL: } I_{C_1} = \frac{12 - 0.7V}{1K\Omega + \frac{6}{50}} = 0/13 \text{ mA}$$

$$\text{داریم: } S_\beta = \frac{0/13}{50} \left[\frac{6 + 1}{6 + (1 + 200) \times 1} \right] = 0/024$$

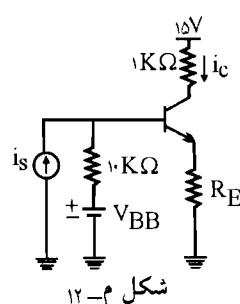
$$\Delta \beta = 200 - 50 = 150 \rightarrow \Delta I_C = S_\beta \times \Delta \beta = 0/024 \times 150 = 3/6 \text{ mA}$$

۱۲- در تقویت کننده شکل م - ۱۲ می خواهیم تقویت کننده را طوری

طراحی نماییم که دامنه نوسان متقارن جریان کلکتور حداقل بشود.

اگر برای توانزیستور به کار رفته β بین 50 تا 150 تغییر کند و

V_{BB} باشد، R_E و $V_{BE} = ۰/۷V$ را محاسبه نمایید. حداقل دامنه نوسان C_A را به دست آورید.



شکل م - ۱۲:

$$R_T = \frac{\beta_{min} R_E}{10} = \frac{50 \times R_E}{10} = 10 \rightarrow R_E = 2K\Omega$$

برای داشتن حداکثر دامنه نوسان متقارن جریان کلکتور:

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{ac} + R_{DC}} \quad \begin{cases} R_{ac} = R_C + R_E \\ R_{DC} = R_C + R_E \end{cases}$$

$$I_{CQ} = \frac{15}{2R_C + 2R_E} = \frac{15}{2+4} = \frac{15}{6} = 2.5 \text{ mA}$$

→ حداکثر دامنه نوسان متقارن جریان کلکتور $\rightarrow 2.5 \text{ mA}$

$$I_C = \frac{V_{BB} - 0/V}{R_E + \frac{R_B}{\beta_{av}}} = \frac{V_{BB} - 0/V}{2 + \frac{10}{100}} = 2.5 \text{ mA}$$

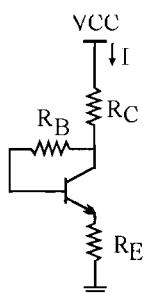
$$\rightarrow 2.5 = \frac{V_{BB} - 0/V}{2/1} \Rightarrow V_{BB} = 5/95 \text{ V}$$

$$\beta_{av} = \frac{50 + 150}{2} = 100$$

۱۳- در مدار شکل م-

الف) ضرایب پایداری جریان نقطه کار را نسبت به تغییرات I_{CBO} و V_{BE} را به دست آورید.

ب) با فرض $R_E = 0$ ، حسابت نقطه کار نسبت به تغییرات دو عامل فوق چگونه است؟ چرا؟



شکل م

راه حل:

$$\text{KVL: } R_C I + R_B I_B + R_E I_E = V_{CC} - V_{BE} \quad (\text{الف})$$

$$\text{از طرفی: } I = I_B + I_C = I_E$$

$$\Rightarrow R_C I_E + R_B I_B + R_E I_E = V_{CC} - V_{BE}$$

$$\Rightarrow I_E (R_C + R_E) + R_B I_B = V_{CC} - V_{BE}$$

$$\Rightarrow (I_B + I_C)(R_C + R_E) + R_B I_B = V_{CC} - V_{BE} \Rightarrow (R_C + R_E) I_C + (R_C + R_B + R_E) I_B = V_{CC} - V_{BE}$$

از طرفی داریم:

$$I_B = \frac{I_C - (1+\beta) I_{CO}}{\beta} \Leftarrow I_C = \beta I_B + (1+\beta) I_{CO}$$

$$\Rightarrow (R_C + R_B) I_C + (R_C + R_E + R_B) \left(\frac{I_C - (1+\beta) I_{CO}}{\beta} \right) = V_{CC} - V_{BE}$$

$$\Rightarrow I_C ((R_C + R_E) \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right) + R_B \times \frac{1}{\beta}) = V_{CC} - V_{BE} + \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right) (R_C + R_E + R_B) I_{CO}(I)$$

حال از رابطه (I) نسبت به V_{BE} مشتق می‌گیریم و بقیه عوامل را ثابت در نظر می‌گیریم:

$$\Rightarrow dI_C ((R_C + R_E) \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right) + \frac{R_B}{\beta}) = -dV_{BE}$$

$$\Rightarrow S_V = \frac{dI_C}{dV_{BE}} = \frac{-\beta}{(R_B + (1+\beta)(R_C + R_E))}$$

حال از رابطه (I) نسبت به I_{CO} مشتق می‌گیریم و بقیه عوامل را ثابت فرض می‌کیم:

$$dI_C ((R_C + R_E) \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right) + \frac{R_B}{\beta}) = \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right) (R_C + R_E + R_B) dI_{CO}$$

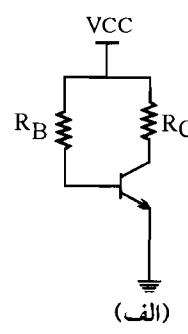
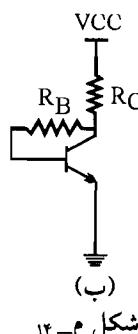
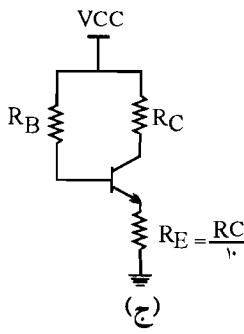
$$S_I = \frac{dI_C}{dI_{CO}} = \frac{(R_C + R_E + R_B)}{R_C + R_E + \frac{R_B}{1+\beta}} = \frac{(1+\beta)(R_C + R_E + R_B)}{(1+\beta)(R_C + R_E) + R_B}$$

با فرض $R_E = 0$

$$S_V = \frac{-\beta}{R_B + (1+\beta)R_C}, \quad S_I = \frac{(R_C + R_B)(1+\beta)}{(1+\beta)R_C + R_B}$$

در این حالت S_I و S_V هر دو بزرگ شدند در نتیجه از پایداری نقطه کار کاسته می‌شود.

۱۴- ضرایب پایداری S_I و S_V و S_β را برای سه مدار شکل م-۱۴ به دست آورده و با هم مقایسه نمایید.



۱۵ حل:

الف) مدار (الف) مدار بایاس امیتر مشترک است:

$$\begin{cases} R_T = R_B \\ V_T = V_{CC} \\ R_E = \infty \end{cases}$$

طبق رابطه (۵۰ - ۵) کتاب داریم:

$$S_I = (1 + \beta) \frac{R_T + R_E}{(1 + \beta) R_E + R_T}$$

$$\rightarrow S_I = (1 + \beta) \frac{R_B + \infty}{(1 + \beta) \times \infty + R_B} = (1 + \beta)$$

$$S_V = \frac{-\beta}{R_E (1 + \beta) + R_T} = \frac{-\beta}{R_B}$$

رابطه (۵۴ - ۵) کتاب:

رابطه (۵۷ - ۵) کتاب:

$$S_B = \frac{I_{C_1}}{\beta_1} \left[\frac{R_T + R_E}{R_T + (1 + \beta_1) R_E} \right] = \frac{I_{C_1}}{\beta_1} \times \left(\frac{R_B}{R_B} \right) = \frac{I_{C_1}}{\beta_1}$$

ب) این مدار، مدار مسئله (۱۳) در قسمت ب میباشد:

$$S_I = \frac{(1 + \beta)(R_B + R_C)}{R_B + (1 + \beta)R_C}$$

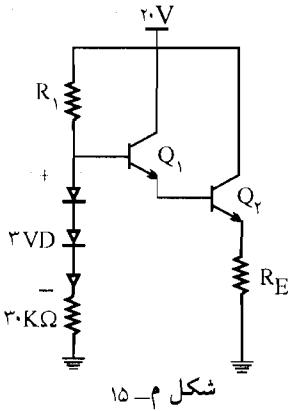
$$S_V = \frac{-\beta}{R_B + (1 + \beta)R_C}, \quad S_B = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta} = \frac{I_{C_1}}{\beta_1} \left(\frac{R_B + R_C}{R_B + (1 + \beta)R_C} \right)$$

ج) مدار (ج) را هم میتوان مدار خود بایاس در نظر گرفت؛ پس روابط (۵ - ۵) و (۵۰ - ۵) و (۵۷ - ۵) در مورد این مدار هم صدق میکند.

$$S_I = \frac{(1 + \beta)(R_B + \frac{R_C}{1})}{(1 + \beta)\frac{R_C}{1} + R_B} = (1 + \beta) \frac{R_B + \infty / 1 R_C}{(1 + \beta) \times \infty / 1 R_C + R_B}$$

$$S_B = \frac{I_{C_1}}{\beta_1} \left[\frac{R_B + \infty / 1 R_C}{R_B + (1 + \beta_1) \times \infty / 1 R_C} \right], \quad S_V = \frac{-\beta}{R_B + \infty / 1 (R_C) (1 + \beta)}$$

مدار (ب) به علت دارا بودن فیدبک در کلکتور و مدار (ج) به علت وجود مقاومت R_E پایداری بهتری نسبت به مدار الف دارند به همین علت ضرایب پایداری آنها کوچکتر است.



شکل م-۱۵

۱۵- در مدار شکل م-۱۵ ترانزیستورها مشابه و دیودها از نظر تغییرات حرارتی مشابه پیوندهای بیس - امپتر ترانزیستورها هستند. آیا می‌توان R_1 را طوری تعیین کرد که تغییرات حرارتی I_E صفر شود؟ (محاسبه کنید) اگر $\beta_1 = \beta_2 = 100$ باشد، R_E را طوری تعیین کنید که نقطه کار پایداری مطلوبی نسبت به تغییرات β داشته باشد ($V_D = V_{BE} = 0.7V$)

راه حل:

مدار معادل ورودی را می‌یابیم:

$$\begin{cases} V_{th} = 20 \times \frac{30}{30 + R_1} + 3V_D \times \frac{R_1}{R_1 + 30} = \frac{600 + 3V_D R_1}{R_1 + 30} \\ R_{th} = R_1 \parallel 30 K\Omega \quad , \quad \beta_{ab} = \frac{50 + 100}{5} = 50 \end{cases}$$

$$I_C = \frac{V_{th} - 2V_{BE}}{\frac{R_{th}}{(\beta_{av})^2} + R_E} = \frac{\frac{600 + 3V_D R_1}{R_1 + 30} - 2 \times V_{BE}}{\frac{R_{th}}{(50)^2} + R_E}$$

$$\frac{\partial I_C}{\partial T} = \frac{2R_1}{R_1 + 30} \times \frac{\partial V_D}{\partial T} - \frac{2\partial V_{BE}}{\partial T} \quad (I)$$

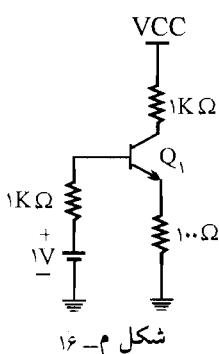
$$V_D = V_{BE} \rightarrow \frac{\partial V_D}{\partial T} = \frac{\partial V_{BE}}{\partial T}$$

$$\text{پس} \quad (I) \rightarrow \frac{2R_1}{R_1 + 30} - 2 = 0 \rightarrow 2R_1 = 2R_1 + 60 \rightarrow R_1 = 60 K\Omega$$

برای اینکه نقطه کار پایداری مطلوبی نسبت به تغییرات β داشته باشد باید داشته باشیم:

$$R_{th} = \frac{(1 + \beta_{min})^2 R_E}{10} = \frac{(1 + 50)^2 \times R_E}{10} = R_{th} = R_1 \parallel 30 = 60 \parallel 30 = 20$$

$$\rightarrow R_E = 100 \Omega$$



شکل م-۱۶

۱۶- در مدار شکل م-۱۶، با فرض $25^{\circ}\text{C} < T < 75^{\circ}\text{C}$ ، $50 < \beta < 200$ ، $V_{BE} = 0.7\text{V}$ در 25°C و $I_{CBO} = 0.1\mu\text{A}$ ، $V_{CC} = 6\pm 0.2\text{V}$ جریان کلکتور، ضرایب پایداری و تغییرات جریان کلکتور را در بدترین حالت محاسبه کنید.

$$I_{CQ} = \frac{V_T - V_{BE}}{R_E + \frac{R_T}{\beta_{av}}}$$

$$\text{از طرفی: } \beta_{av} = \frac{50 + 200}{2} = 125$$

$$\text{پس داریم: } I_{CQ} = \frac{1 - 0.7}{0.1 + \frac{1}{125}} = 2.77\text{mA}$$

ضرایب پایداری: (از روابط صفحه ۱۸۶ استفاده می‌کنیم چون این دو مدار مشابه هستند.)

$$S_I = 1 + \frac{R_T}{R_E} = 1 + \frac{1}{0.1} = 11$$

$$S_V = \frac{-1}{R_E} = \frac{-1}{0.1} = -10$$

$$S_\beta = \frac{I_{CQ_1}}{\beta_1} \left[\frac{R_T + R_E}{R_T + (1 + \beta_2)R_E} \right] = \frac{I_{CQ_1}}{50} \left[\frac{1 + 0.1}{1 + (1 + 200) \times 0.1} \right]$$

$$\text{از طرفی: } I_{CQ_1} = \frac{V_T - V_{BE}}{R_E + \frac{R_T}{\beta_1}} = \frac{1 - 0.7}{0.1 + \frac{1}{50}} = 2/5$$

$$\rightarrow S_\beta = \frac{2/5}{50} \left[\frac{1/1}{1 + 20/1} \right] = \frac{1}{200} \times \frac{11}{201} = 2.77 \times 10^{-3}$$

برای به دست آوردن تغییرات جریان کلکتور از رابطه (۵-۷۱) استفاده می‌کنیم.

$$\Delta I_{CQ} = |S_I \Delta I_{CBO}| + |S_V \Delta V_{BE}| + |S_\beta \Delta \beta| + |S V_{CC} \Delta V_{CC}| + |S R_E \Delta R_E|$$

$$\Delta I_{CBO} = I_{CBO} \times \frac{\Delta T}{2^{\circ}} = 0.1 \mu A \times \frac{5^{\circ}}{2^{\circ}} = 32 \times 0.1 \mu A = 32 \times 10^{-5}$$

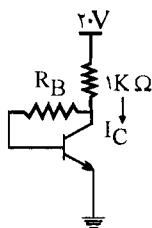
$$\Delta V_{BE} = -2/5 \Delta T = -2/5 \times 50 = -125 \text{ mV} \quad , \quad \Delta \beta = 10^{\circ}$$

$$\Delta V_{CC} = 0.4 \text{ V} \quad \Delta R_E = 0$$

تغییرات V_{CC} در I_C تأثیری ندارد مگر اینکه اثر مدولاسیون عرض بین را در نظر بگیریم که ضرورتی ندارد.

$$\Delta I_{CQ} = 11 \times 32 \times 10^{-5} + |(-10)| \times |(-125)| \times 10^{-3} + 2/\sqrt{5} \times 10^{-3} \times 150 = 1/85 \text{ mA}$$

۱۷- در مدار شکل م-۱۷، R_B را طوری محاسبه کنید که $I_{CQ} = 10 \text{ mA}$ شود. ضرایب پایداری S_I و S_V را به دست آورید. تغییرات نقطه کار را با فرض $I_{CBO} = 1 \mu A$ (در دمای 25°C) برای S_β و $\beta_{av} = 125$ محاسبه نمایید.



شکل م-۱۷

(راه حل:

$$\beta_{av} = \frac{200 + 50}{2} = 125$$

$$\text{KVL: } 10 - 1\text{ K}\Omega (I_B + I_C) - R_B I_B - V_{BE} = 0 \rightarrow$$

$$\begin{cases} 10 - I_B - I_C - R_B I_B - 0/V = 0 & (I) \\ I_{CQ} = 10 \text{ mA} ; I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{10 \text{ mA}}{\beta_{av}} = \frac{10 \text{ mA}}{\left(\frac{50 + 200}{2}\right)} = 8 \times 10^{-4} \text{ mA} \end{cases}$$

$$(I): 10 - 8 \times 10^{-4} - 10 - R_B \times 8 \times 10^{-4} = 0 \rightarrow$$

$$R_B = 115.15 \text{ K}\Omega$$

$$I_{CQ} = \frac{10 - 0/V}{R_C + \frac{R_B}{\beta_1}} = 5/8 \text{ mA}$$

برای به دست آوردن S_I و S_V از روابطی که در مسئله ۱۴ (ب) به دست آوریم، استفاده می‌کنیم:

$$S_I = \frac{(1 + \beta_{av})(R_B + R_C)}{R_B + (1 + \beta_{av})R_C} = \frac{(1 + 120)(110/20 + 1)}{(110/20) + (1 + 120) \times 1} = \frac{1464V/0}{221/20} = 6.0/V$$

$$S_V = \frac{-\beta_{av}}{R_B + (1 + \beta_{av})R_C} = \frac{-120}{110/20 + 126} = -0.052$$

$$S_\beta = \frac{\frac{I_{C1}}{\beta_1}}{R_B + (1 + \beta_1)R_C} = \frac{0.1}{0.1} \left(\frac{110/20 + 1}{110/20 + 2 \times 1 \times 1} \right) = 0.429$$

$$\Delta I_{CBO} = 1\mu A \times 2^{1^\circ} = 0.1mA$$

$$\Delta V_{BE} = -2/5 \times \Delta T = 0.1mV$$

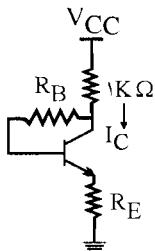
$$\rightarrow \Delta I_C = | S_V \times \Delta V_{BE} | + | S_I \times \Delta I_{CBO} | + | S_\beta \times \Delta \beta |$$

$$\rightarrow \Delta I_C = | (-0.052) | \times | (-0.1mA) | + | 6.0/V \times 0.1mA | + | 0.429 \times 10^\circ |$$

$$= 1V/4 mA$$

۱۸- اگر در مدار شکل ۱۷، مقاومت R_E را به امیتر اضافه کنیم. نشان دهید جریان کلکتور نقطه کار

از رابطه زیر به دست می‌آید:



$$I_{CQ} = \frac{\beta(R_E + R_B + R_C)I_{CBO} + \beta(V_{CC} - V_{BE})}{R_B + (1 + \beta)(R_E + R_C)}$$

همچنین S_I و S_V را محاسبه کنید.

۱۹ حل:

$$KVL: -V_{CC} + R_C(I_B + I_C) + R_B I_B + V_{BE} + R_E(I_C + I_B) = 0$$

$$\rightarrow V_{CC} - V_{BE} = (R_C + R_B + R_E)I_B + (R_C + R_E)I_C \quad (I)$$

$$R_E: I_B = \frac{I_C}{\beta} - I_{CBO} \frac{\beta + 1}{\beta} \quad (II)$$

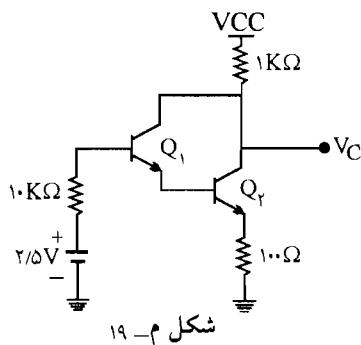
رابطه (II) را در رابطه (I) قرار می‌دهیم.

$$\begin{aligned}
 (I) \rightarrow V_{CC} - V_{BE} &= (R_C + R_B + R_E) \left(\frac{I_C}{\beta} - I_{CBO} \frac{\beta+1}{\beta} \right) + (R_C + R_E) I_C \\
 &= (R_C + R_B + R_E) \left(\frac{I_C}{\beta} \right) - I_{CBO} \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) (R_C + R_B + R_E) + (R_C + R_E) I_C \\
 &= I_C \left(\frac{R_C + R_B + R_E}{\beta} + (R_C + R_E) \right) - I_{CBO} \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) (R_C + R_E + R_B) \\
 \rightarrow I_C \left[\frac{R_C + R_B + R_E}{\beta} + (R_C + R_E) \right] &= (V_{CC} - V_{BE}) + I_{CBO} \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) (R_C + R_E + R_B) \\
 \rightarrow I_C = \frac{(V_{CC} - V_{BE}) + (I_{CBO} \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) (R_C + R_E + R_B))}{\frac{(R_B + R_C + R_E)}{\beta} + (R_C + R_E)} \\
 \rightarrow I_C = (V_{CC} - V_{BE}) \times \frac{\beta}{R_B + (1+\beta)(R_C + R_E)} + \frac{I_{CBO} \times \beta (R_B + R_C + R_E)}{R_B + (1+\beta)(R_C + R_E)} \\
 \rightarrow I_C = \frac{\beta (V_{CC} - V_{BE}) + I_{CBO} \times (R_B + R_C + R_E) \beta}{R_B + (1+\beta)(R_C + R_E)}
 \end{aligned}$$

در مسئله ۱۳ (الف) محاسبه شده‌اند:

$$S_I = \frac{(1+\beta)(R_B + R_C + R_E)}{R_B + (1+\beta)(R_C + R_E)} \quad S_V = \frac{-\beta}{R_B + (1+\beta)(R_C + R_E)}$$

$$S_\beta = \frac{I_{C_1}}{\beta_1} \left[\frac{R_T + R_E}{R_T + (1+\beta_1)R_E} \right]$$



شکل م-۱۹

۱۹- در تقویت کننده مدار شکل م-۱۹، ترانزیستورهای Q_۱ و Q_۲ مشابه و از جنس سیلیکون می‌باشند. برای این ترانزیستورها در دمای ۲۵°C، $I_{CBO} = 0/\mu\text{A}$ ، $V_{BE} = 0.7\text{V}$ ، $\beta = 20$ است. با فرض $\alpha = 0.95$ ، تغییرات ولتاژ V_C را وقتی دما از ۲۵°C تا ۱۰۰°C تغییر نماید. محاسبه کنید.

۱۰ حل: در این مدار دو ترانزیستور به صورت زوج دارلینگتون قرار گرفته‌اند β معادل برابر 2° خواهد شد و ΔV_{BE} نیز دو برابر می‌شود. I_{CBO} مربوط به Q_1 از بیس Q_2 می‌گذرد پس $\frac{1}{\beta}$ برابر I_{CBO} است پس Q_2 اکل به صورت زیر خواهد شد.

$$I_{CBO} = I_{CBO_1} + I_{CBO_2} = (1 + \frac{1}{\beta}) I_{CBO}$$

از روابط $(5-5)$ و $(5-5)$ استفاده می‌کنیم.

$$S_V = \frac{-\beta^2}{(1+\beta^2) R_E + R_B} = \frac{-(20)^2}{(1+(20)^2) \times 0.1 + 1} = -7.98$$

$$S_I = \frac{(1+\beta^2)(R_B + R_E)}{(1+\beta^2) R_E + R_B} = \frac{(1+(20)^2)(10 + 0.1)}{(1+(20)^2) \times 0.1 + 1} = 80.84$$

علت این رابطه در صفحه ۱۷۶ کتاب ذکر شده است.

$$\Delta V_{BE} = 2 \times (-2/5 \times \Delta T) \text{ mV} = -0.375 \text{ V}$$

$$\Delta I_{CBO} = I_{CBO} \times \frac{\Delta T}{10^3} = 1/5 \times 0.1 \mu A \times 10^{-3} \times 27/5 = 0.027 \text{ mA}$$

$$\rightarrow \Delta I_C = S_V \Delta V + S_I \Delta I = 7.98 \times 0.375 + 80.84 \times 0.027 = 0.27 = 0.1 \text{ mA}$$

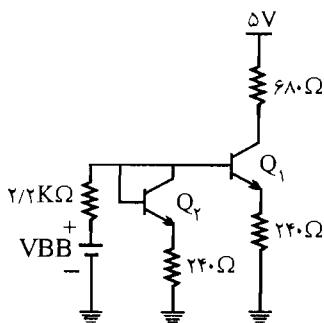
$$\begin{aligned} \Delta V_C &= V_{C_2} - V_{C_1} = (V_{CC} - R_C I_{C_2}) - (V_{CC} - R_C I_{C_1}) = -R_C (I_{C_2} - I_{C_1}) \\ &= -R_C \times \Delta I_C = -1K\Omega \times 0.1 = -0.1 \text{ V} \end{aligned}$$

۲۰- مدارهای شکل م-۲۰ در دمای 25°C تا 25°C کار می‌کنند. در مدار شکل م-۲۰ ب ترانزیستور

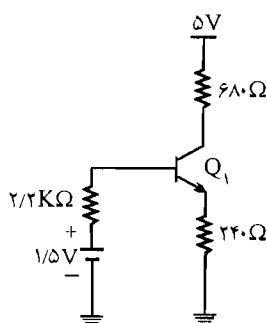
$I_{CBO} = 200 \text{ pA}$ به منظور جبران تغییرات حرارتی V_{BE} قرار داده شده است. با فرض $\beta = 200$.

الف) تغییرات جریان نقطه کار را برای هر دو مدار به دست آورید.

ب) برای مدار شکل (ب)، V_{BB} را محاسبه کنید.



(ب) با مدار جبران کننده



(الف) بدون مدار جبران کننده

راه حل:

(الف) بدون مدار جبران کننده:

$$R_B \ll \beta R_E \rightarrow S_V = \frac{-1}{R_E} = \frac{-1}{0.22} = -4.56$$

$$\Delta V_{BE} = -2/5 \times \Delta T = -2/5 mV \times 65 = -162/5 mV = -32.4 mV$$

$$\Delta I_C = \Delta V_{BE} \times S_V = 4/16 \times 1/625 = 6.7 mA$$

چون I_{CBO} صفر می باشد پس $S_I \times \Delta I_{CBO}$ صفر می شود و β نیز ثابت و برابر ۲۰۰ است پس $\Delta \beta$ صفر می باشد و $S_\beta \Delta \beta$ نیز صفر می باشد یعنی در رابطه (۷۱-۵) کتاب $I_C = \Delta V_{BE} \times S_V$ فقط برابر می شود.
با مدار جبران کننده:

$$R_{th} = 0.22 \parallel 2/2 = 0.22 K\Omega$$

$$R_{th} = 0.22 \parallel 2/2 = 0.22 K\Omega$$

$$V_{th} = \frac{V_B \times 0.22 + V_{BE} \times 2/2}{0.22 \times 2/2}, \quad I_C = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{th}}{\beta}} = \frac{\frac{0.22 V_{BB} + 2/2 V_{BE}}{2.22} - V_{BE}}{\frac{0.22}{2.22} + \frac{0.22}{200}}$$

$$\frac{\partial I_C}{\partial T} = \frac{\partial V_{BE}}{\partial T} \left(\frac{\frac{2/2}{2.22} - 1}{0.22} \right) \rightarrow S_V = \frac{\partial I_C}{\partial V} = -0.409$$

$$\Delta V = -2/5 mV \times 65 = -32.4 mV \rightarrow \Delta I_C = -0.409 \times (-32.4) = 13.2 mA$$

(ب) برای مدار بدون جبران کننده:

$$I_{CQ} = \frac{1/5 - 0/V}{0.22 + \frac{2/2}{200}} = 3/18 mA$$

برای مدار با جبران کننده:

$$I_{CQ} = \frac{V_{th} - V_{BE}}{\frac{R_{th}}{\beta} + 0.22} = \frac{\frac{0.22 V_{BB} + 2/2 \times 0/V}{2.22} - V_{BE}}{0.22/11} = 3/18$$

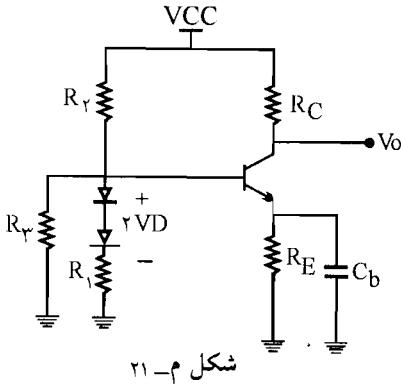
$$\rightarrow V_{BB} = 2/27 V$$

۲۱- مدار شکل م- ۲۱ را در نظر بگیرید.

(الف) چه رابطه ای بین مقاومت های R_1 و R_2 و R_3 برقرار باشد تا تغییرات V_{BE} در اثر تغییر دما به طور کامل جبران شود.

$$(b) اگر \beta = 200 و V_D = V_{BE} = 0/7 V و V_{CC} = 10 V و R_E = 100 \Omega و R_C = 1 K\Omega$$

باشد، مقادیر R_1 و R_2 را چنان تعیین کنید که دامنه نوسان در خروجی حداقل شود.



راه حل:

(الف) مدار معادل تونن ورودی را می‌نویسیم:

$$V_{th} = V_{CC} \times \frac{(R_1 \parallel R_r)}{(R_1 \parallel R_r) + R_2} + V_D \times \frac{(R_2 \parallel R_r)}{R_1 + (R_2 \parallel R_r)} \quad \text{و} \quad R_{th} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_r$$

$$\text{از طرفی: } \frac{\partial V_D}{\partial T} = \frac{\partial V_{BE}}{\partial T}$$

$$I_C = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{th}}{\beta}} = \frac{\left[\frac{V_{CC} \times (R_1 \parallel R_r)}{(R_1 \parallel R_r) + R_2} + \frac{V_D \times (R_2 \parallel R_r)}{R_1 + (R_2 \parallel R_r)} \right] - V_{BE}}{R_E + \frac{(R_1 \parallel R_2 \parallel R_r)}{\beta}}$$

$$\frac{\partial I_C}{\partial T} = \frac{\frac{\partial V_D}{\partial T} \times \left[\frac{V_D \times (R_2 \parallel R_r)}{R_1 + (R_2 \parallel R_r)} \right] - 1}{R_E + \frac{(R_1 \parallel R_2 \parallel R_r)}{\beta}} - 1$$

$$\rightarrow \frac{\partial I_C}{\partial V_D} = \frac{\left[\frac{V_D \times (R_2 \parallel R_r)}{R_1 + (R_2 \parallel R_r)} - 1 \right]}{(R_E + \frac{(R_1 \parallel R_2 \parallel R_r)}{\beta})} = 0$$

برای اینکه رابطه بالا صفر شود باید صورت کسر صفر شود.

$$\rightarrow \frac{V_D \times (R_2 \parallel R_r)}{R_1 + (R_2 \parallel R_r)} - 1 = 0 \rightarrow V_D \times (R_2 \parallel R_r) = R_1 + (R_2 \parallel R_r) \rightarrow R_1 = R_2 \parallel R_r$$

ب) تحلیل ac

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{ac} + R_{DC}} = \frac{10V}{(R_C) + (R_C + R_E)} = \frac{10V}{1 + (1 + \beta/1)} = 4/V \text{ mA}$$

$$V_{th} = \frac{V_{CC} \times (R_1 \| R_T)}{(R_1 \| R_T) + R_T} + \frac{2V_D \times (R_T \| R_T)}{R_1 + (R_T \| R_T)} \quad R_{th} = R_1 \| R_T \| R_T$$

$$\text{KVL: } I_{CQ} = \frac{V_{th} - V_{BE}}{\frac{R_{th}}{\beta} + R_E} = \frac{\left[\frac{10 \times (R_1 \| R_T)}{(R_1 \| R_T) + R_T} + \frac{2 \times 0.7 / V (R_T \| R_T)}{R_1 + (R_T \| R_T)} \right] - 0.7 / V}{\frac{R_1 \| R_T \| R_T}{200} + 0.1} = 4/V \text{ mA}$$

$$\text{از طرفی در قسمت الف به دست آوریم: } R_1 = R_T \| R_T \quad (I)$$

$$R_{th} = \frac{\beta R_E}{10} = \frac{200 \times 0.1}{10} = 2 K\Omega = R_1 \| R_T \| R_T \quad (II)$$

$$I_{CQ} = \frac{10(R_1 \| R_T)}{R_T + (R_1 \| R_T)} + \frac{1/4(R_T \| R_T)}{R_1 + (R_T \| R_T)} = \left(\frac{2}{200} + 0.1 \right) \times 4/V + 0.1/V = 1/22 \quad (III)$$

با توجه به رابطه زیر داریم:

$$R_{th} = 2 K\Omega = R_1 \| R_T \| R_T = R_T \times \frac{(R_1 \| R_T)}{R_T + (R_1 \| R_T)}$$

$$(III): 10 \times \frac{R_{th}}{R_T} + \frac{1/4 \times R_1}{R_1 + R_1} = 1/22 \rightarrow 10 \times \frac{2 K\Omega}{R_T} + \frac{1/4}{2} = 1/22$$

$$\rightarrow R_T = 4 \times 1/4 K\Omega$$

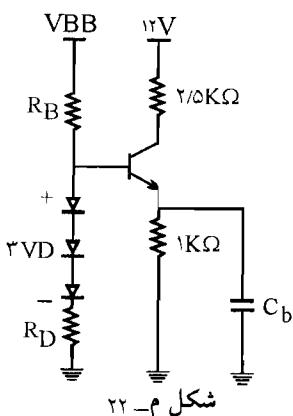
برای به دست آوردن R_1 و R_T

$$\begin{cases} R_1 = R_T \| R_T \\ R_{th} = R_1 \| R_T \| R_T = 2 K\Omega \rightarrow R_1 \| R_1 = 2 K\Omega \rightarrow R_1 = 2 K\Omega \end{cases}$$

$$\rightarrow R_1 = R_T \| R_T \rightarrow R_1 = \frac{R_T R_T}{R_T + R_T} \rightarrow$$

$$4 = \frac{4 \times 4 R_T}{4 + R_T} \rightarrow 4 R_T + 16 = 16 R_T \rightarrow R_T = 4/46 K\Omega$$

۲۲- در مدار شکل م-۲۲، با فرض $V_{BE} = V_D = 0.7V$ و $\beta < 200$



شکل م-۲۲

الف) تحت چه شرایطی مدار از پایداری خوبی نسبت به تغییرات β برخوردار بوده و اثرات حرارتی کاملاً جبران می‌شود (اثبات کنید).

ب) مقادیر V_{BB} و R_D را طوری تعیین کنید که ضمن محقق شدن شرایط بند (الف)، نقطه کار ترانزیستور در وسط خط بار ac آن قرار گیرد.

۱۴ هل:

الف) برای اینکه مدار از پایداری خوبی نسبت به تغییرات β برخوردار باشد باید داشته باشیم:

$$R_{th} = \frac{\beta_{min} R_E}{10} = \frac{100 \times 1}{10} = 10 K\Omega \quad (I)$$

از طرفی مدار معادل تونن به صورت زیر می‌باشد.

$$\begin{cases} R_{th} = R_B \parallel R_D \\ V_{th} = \frac{V_D \times R_B}{R_B + R_D} + \frac{V_{BB} \times R_D}{R_B + R_D} \\ I_C = \frac{V_{th} - V_{BE}}{\frac{R_{th}}{\beta_{av}} + R_E} = \frac{\frac{V_D \times R_B + R_D \times V_{BB}}{R_B + R_D} - V_{BE}}{\frac{R_B \parallel R_D}{\beta_{av}} + R_E} \end{cases}$$

$$\frac{\partial I_C}{\partial T} = \frac{\partial V_D}{\partial T} \left(\frac{\gamma R_B}{R_B + R_D} \right) - \frac{\partial V_{BE}}{\partial T} \text{ از طرفی } \frac{\partial V_D}{\partial T} = \frac{\partial V_{BE}}{\partial T}$$

$$\frac{\partial I_C}{\partial T} = 0 \rightarrow \frac{\gamma R_B}{R_B + R_D} - 10 = 0 \rightarrow \gamma R_B = R_D$$

برای اینکه نقطه کار در وسط خط بار باشد:

(ب)

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{ac} + R_{DC}} = \frac{12}{R_C + (R_E + R_C)} = \frac{12}{10 + (10 + 1)} = 1mA$$

در بند الف به دست آوردهیم :

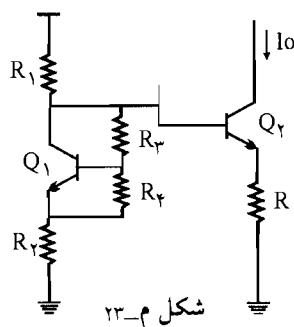
$$R_D = 2R_B \quad , \quad R_{th} = R_B \parallel R_D = \frac{R_B \times R_D}{R_B + R_D} = \frac{R_B \times 2R_B}{R_B + 2R_B} = 1. K\Omega$$

$$\rightarrow \frac{2R_B}{3R_B} = 1. K\Omega \rightarrow R_B = 15 K\Omega$$

$$R_D = 2R_B = 30 K\Omega$$

$$I_C = 2 = \frac{\frac{20 \times 0.7 \times 115 + 30 \times V_{BB}}{20 + 15} - 0.7}{\frac{20 \parallel 15}{15} + 1} \rightarrow V_{BB} = 3/2 V$$

۲۳- در مدار شکل م- ۲۳، ترانزیستور مشابه و دارای β بسیار بزرگ هستند. به منظور افزایش سهم مقاومت بار از منبع تغذیه، R_2 را تا حد نصف R کاهش می‌دهیم. مقاومت‌های R_2 و R_4 را طوری محاسبه‌نمایی کوابستگی β به تغییرات V_{BE} حداقلشود. تبی دهیکم جریان $I_1 = 10 mA$ جریان‌های ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 باشد و $Q_2 = Q_1 = 10 mA$ شود.



راه حل:

$$R_2 = \frac{R_1}{2}$$

$$I_{R_2} = \frac{V_{BE}}{R_2} = 0.1 I_1 = 0.1 \times 10 = 1 mA$$

$$\rightarrow \frac{0.7}{R_2} = 1 mA \rightarrow R_2 = 700 \Omega$$

$$KVL: R_1 IR_1 + R_2 IR_2 + V_{BE1} + R_2 IR_2 + R_4 I_4 = 10$$

$$\rightarrow 10 = R_1 (I_1 + 0.1 I_1) + R_2 \times 0.1 I_1 + 0.7 + 0.7 \times 0.1 I_1$$

$$+ \frac{R_1}{2} R_1 (I_1 + 0.1 I_1)$$

$$\rightarrow \frac{3}{2} R_1 \times 1.1 I_1 = 10 - 0.7 - 0.7 \times 0.1 I_1 - 0.7 R_2 I_1 \quad (I)$$

$$KVL: R_1 IR_1 + RI_1 = 10 - V_{BE} \rightarrow$$

$$R_1 (I_1 + 0.1 I_1) + RI_1 = 10 - 0.7 \quad (II)$$

$$(II) \rightarrow R_1 (1.1) I_1 = 10 - 0.7 - RI_1 \quad (III)$$

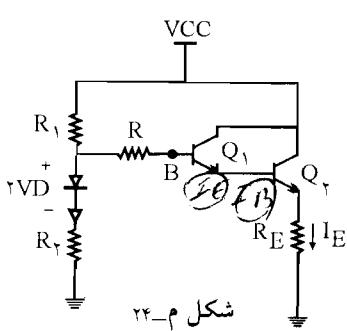
$$(I), (III) \Rightarrow \frac{3}{2} \times [10 - 0/V - RI_0] = 10 - 0/V - 0/VI_0 - 0/IR_3$$

$$I_0 = 10 \text{ mA} \rightarrow \frac{3}{2} \times (9/3 - R \times 10) = 9/3 - 0/V \times 10 - 0/1 \times 10 \times R_3$$

$$\rightarrow 13/90 - 15R = 9/3 - 0/V - R_3 \rightarrow R_3 = 5/30 - 15R$$

۲۴- در مدار دارلینگتون شکل م-۲۴، β معادل برای زوج ترانزیستورها را 2500 در نظر بگیرید.

الف) معادل تونن مدار بایاس بیس از دید نقطه β را به دست آورید.



ب) در مدار حاصل جریان I_E را به دست آورید.

ج) آیا می‌توان مقادیر مقاومت‌های R_1 و R_2 را طوری تعیین نمود که تغییرات حرارتی نقطه کار کاملاً جبران شود؟ (از تغییرات I_{CBO} و β صرفنظر می‌شود) در صورتی که جواب منفی است، در مدار جبران کننده اصلاح لازم را به عمل آورده و شرایط لازم را برای پایداری I_E بیان کنید.

د) در مدار اصلاح با فرض $\Omega = 200 \text{ K}\Omega$ و $R_E = 1 \text{ K}\Omega$ مقادیر R_1 و R_2 را طوری تعیین کنید که مدار از پایداری خوبی نسبت به تغییرات β نیز برخوردار باشد.

راه حل:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{th} = \frac{V_{CC} \times R_2}{R_1 + R_2} + \frac{2V_D R_1}{R_1 + R_2} = \frac{V_{CC} R_2 + 2V_D R_1}{R_1 + R_2} \\ R_{th} = (R_1 \parallel R_2) + R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R \end{array} \right. \quad (\text{الف})$$

پس از اجرای مدار معادل تونن، مدار معادل به صورت زیر می‌باشد:

ب) برای محاسبه I_E ، KVL می‌زنیم:

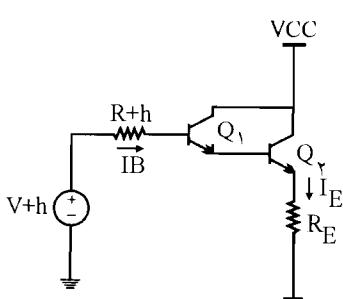
$$\text{KVL: } R_{th} I_B + R_E I_E = V_{th} - 2V_{BE}$$

$$\Rightarrow R_{th} \times \frac{I_E}{1+\beta} + R_E I_E = V_{th} - 2V_{BE}$$

β معادل برای زوج ترانزیستورها طبق فرض مسئله 2500 می‌باشد و در $(1 + \beta)$ از عدد یک در برابر 2500 صرفنظر

می‌کنیم:

$$\Rightarrow I_E \left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) = V_{th} - 2V_{BE}$$



$$I_E \left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) = V_{th} - 2V_{BE}$$

ج) در قسمت ب I_E را به دست آوریم:
به جای V_{th} مقادیر آنها را جایگزین می‌کنیم:

$$I_E \left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) = 2V_D \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} + V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} - 2V_{BE} \quad (I)$$

در نظر می‌گیریم: $V_D = V_{BE}$

$$I_E \left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) = 2V_{BE} \left(\frac{-R_2}{R_1 + R_2} \right) + V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

چون ضریب V_{BE} نمی‌تواند صفر گردد پس تغییرات I_E در رابطه با تغییرات درجه حرارت جبران نمی‌شود و اگر بخواهیم جبران شود باید یک دیود دیگر به مدار اضافه نمائیم در این صورت در رابطه V_{th} به جای $2V_D$ ، $3V_D$ جایگزین می‌شود در این صورت رابطه (I) به صورت زیر در می‌آید.

$$I_E \left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) = 2V_D \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} + V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} - 2V_{BE} \quad (I)$$

در نظر می‌گیریم: $V_D = V_{BE}$

$$I_E \left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) = 2V_{BE} \left(\frac{-R_2}{R_1 + R_2} \right) + V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

چون ضریب V_{BE} نمی‌تواند صفر گردد پس تغییرات I_E در رابطه با تغییرات درجه حرارت جبران نمی‌شود و اگر بخواهیم جبران شود باید یک دیود دیگر به مدار اضافه نمائیم در این صورت در رابطه V_{th} به جای $2V_D$ ، $3V_D$ جایگزین می‌شود در این صورت رابطه (I) به صورت زیر در می‌آید.

$$I_E \left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) = 3V_D \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} + V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} - 2V_{BE}$$

$$\Rightarrow I_E \left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) = V_{BE} \left(\frac{3R_1 - 2R_1 - 2R_2}{R_1 + R_2} \right) + V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow I_E \left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) = V_{BE} \left(\frac{R_1 - 2R_2}{R_1 + R_2} \right) + V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

حال برای جبران کامل تغییرات درجه حرارت ضریب V_{BE} باید صفر شود یعنی:

$$\frac{R_1 - 2R_2}{R_1 + R_2} = 0 \rightarrow R_1 - 2R_2 = 0 \rightarrow R_1 = 2R_2$$

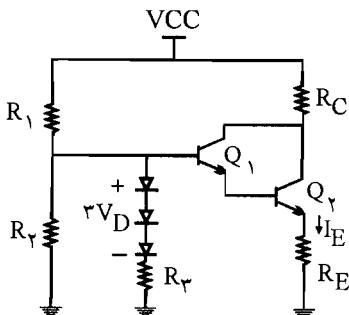
د) برای اینکه مدار از پایداری خوبی نسبت به تغییرات β برخوردار باشد باید داشته باشیم:

$$\frac{R_{th}}{\beta} = 0 / 1 R_E \Rightarrow R_{th} = 0 / 1 R_E \times \beta = 0 / 1 R_E \times 2500 = 250 K\Omega$$

$$\Rightarrow R + \frac{R_1 R_\gamma}{R_1 + R_\gamma} = 250 \quad \text{از طرفی} \quad \begin{cases} R_1 = 2R_\gamma \\ R = 200 \text{ K}\Omega \end{cases}$$

$$\Rightarrow 200 + \frac{2R_\gamma}{2R_\gamma + R_1} = 250 \Rightarrow \frac{2}{3} R_\gamma = 50 \Rightarrow R_\gamma = 75 \text{ K}\Omega$$

$$\Rightarrow R_1 = 2 \times 75 \text{ K}\Omega = 150 \text{ K}\Omega$$



شکل م-۲۵

۲۵- در مدار شکل م-۲۵، با فرض $I_{CBO} = 0$

(الف) I_E را بحسب مقادیر مدار به دست می‌آید.

(ب) با فرض تشابه کامل تغییرات حرارتی ولتاژ پیوند ترانزیستورها و دیودها، شرط لازم برای صفر شدن

$$\frac{\Delta I_E}{\Delta T}$$

$$I_E = (1 + \beta)^r I_B = (1 + \beta)^r \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (1 + \beta)^r R_E}$$

$$\begin{cases} R_{th} = (R_1 \parallel R_\gamma \parallel R_\tau) \\ V_{th} = \frac{V_{CC} \times (R_\gamma \parallel R_\tau)}{R_1 + (R_\gamma \parallel R_\tau)} + V_D \times \frac{(R_1 \parallel R_\gamma)}{(R_1 \parallel R_\gamma) + R_\tau} \end{cases}$$

(راه حل:

(الف)

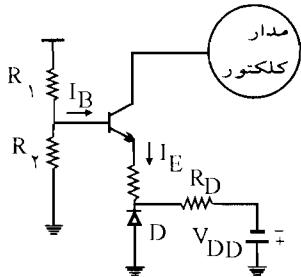
مقادیر به دست آمده برای V_{th} و R_{th} را در رابطه I_E قرار می‌دهیم.

$$\Rightarrow I_E = (1 + \beta)^r = \frac{\frac{V_{CC} \times (R_\gamma \parallel R_\tau)}{R_1 + (R_\gamma \parallel R_\tau)} + V_D \times \left(\frac{R_1 \parallel R_\gamma}{(R_1 \parallel R_\gamma) + R_\tau} \right)}{(R_1 \parallel R_\gamma \parallel R_\tau) + (1 + \beta)^r \times R_E}$$

$$\frac{\partial I_E}{\partial T} = (1 + \beta)^r \frac{\frac{\partial V_D}{\partial T} \times \frac{r(R_1 \parallel R_\gamma)}{(R_1 \parallel R_\gamma) + R_\tau} - r \frac{\partial V_{BE}}{\partial T}}{R_{th} + (1 + \beta)^r R_E} = .$$

$$\rightarrow \frac{r(R_1 \parallel R_\gamma)}{(R_1 \parallel R_\gamma) + R_\tau} - r = 0 \rightarrow (R_1 \parallel R_\gamma) = r R_\gamma$$

۲۶- در مدار شکل ۵-۳۵، نشان دهید که با شرط $\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = \frac{\partial V_D}{\partial T}$ تغییرات حرارتی I_E برابر صفر خواهد بود.



(ا) مل:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\ V_{th} = V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{array} \right.$$

مدار معادل تونن در بیس را می‌نویسیم:

در حلقه V_{th} و R_{th} و V_D و R_E و V_{BE} می‌نویسیم

$$KVL: R_{th} I_B + R_E I_E = V_{th} + V_D - V_{BE}$$

$$R_{th} \times \frac{I_E}{1+\beta} + R_E I_E = V_{th} + V_D - V_{BE}$$

$$I_E \left(\frac{R_{th}}{1+\beta} + R_E \right) = V_{th} + V_D - V_{BE}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta I_E}{\Delta T} \left(\frac{R_{th}}{1+\beta} + R_E \right) = \frac{\Delta V_{th}}{\Delta T} + \frac{\Delta V_D}{\Delta T} - \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T}$$

چون V_{th} عدد ثابتی است پس $\frac{\Delta V_{th}}{\Delta T}$ برابر صفر خواهد بود و طبق فرض فرض مسئله

می‌باشد پس:

$$\frac{\Delta I_E}{\Delta T} \left(\frac{R_{th}}{1+\beta} + R_E \right) = 0 \Rightarrow \frac{\Delta I_E}{\Delta T} = 0$$

چون $\left(\frac{R_{th}}{1+\beta} + R_E \right)$ نمی‌تواند صفر شود پس باید $\frac{\Delta I_E}{\Delta T}$ برابر صفر گردد یعنی تغییرات حرارتی I_E برابر

صفر خواهد بود.

فصل ۶

تقویت‌گنده‌های ترانزیستوری در فرکانس‌های پایین

۱- مشخصات ترانزیستورهای فرکانس بالا غالباً بر حسب پارامتری y داده می‌شود. این پارامترها به صورت زیر تعریف می‌شوند.

$$i_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2$$

$$i_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2$$

الف) یک مدار معادل شبیه ۶-۳ با استفاده از پارامترهای y ترسیم نمایید؟

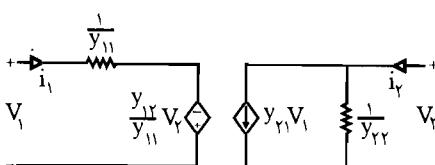
ب) برای هر یک از پارامترهای y یک تعریف مشخص ارائه نمایند؟

راه حل:

الف) اگر معادله فوق به صورت زیر مرتب شود می‌توان یک مدار معادل شبیه هیبرید به دست آورد.

$$V_1 = \frac{1}{y_{11}} i_1 - \frac{y_{12}}{y_{11}} V_2 \quad , \quad i_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2 \quad (1)$$

مدار معادل رابطه (۱) می‌تواند به صورت زیر بیان شود.



(ب)

$$y_{11} = \frac{i_1}{V_1} \quad | \quad V_2 = 0$$

(۱) ادمیتانس ورودی وقتی که خروجی اتصال کوتاه است \longleftrightarrow

$$y_{21} = \frac{i_2}{V_1} \quad \left| \begin{array}{l} V_2 = 0 \end{array} \right. \quad (2) \text{ ادمیتانس انتقالی وقتی خروجی اتصال کوتاه شود} \longrightarrow$$

$$y_{12} = \frac{i_1}{V_2} \quad \left| \begin{array}{l} V_1 = 0 \end{array} \right. \quad (3) \text{ ادمیتانس انتقالی وقتی ورودی اتصال کوتاه است} \longrightarrow$$

$$y_{22} = \frac{i_2}{V_2} \quad \left| \begin{array}{l} V_1 = 0 \end{array} \right. \quad (4) \text{ ادمیتانس خروجی وقتی ورودی اتصال کوتاه است} \longrightarrow$$

۲ - پارامترهای تقویت کننده بیس مشترک را بر حسب پارامترهای h_{re} , h_{oe} , h_{fe} و h_{fe} بدست آورید؟

(۱۵) هل: معادلات مدار معادل ترانزیستور با پارامترهای هیبرید در فرم امیتر مشترک چنین است
که:

$$V_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} V_{ce} \quad (1) \quad , \quad i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \quad (2)$$

اگر در معادله (۲) به جای $V_{ce} = V_{cb} - V_{eb}$ و $i_b = i_e - i_c$ قرار دهیم، خواهیم داشت:

$$i_c = h_{fe} (-i_e - i_c) + h_{oe} (V_{cb} - V_{eb})$$

$$\Rightarrow i_c = \frac{-h_{fe}}{1+h_{fe}} i_e + h_{oe} \frac{V_{cb}}{1+h_{fe}} + \frac{h_{oe}}{1+h_{fe}} V_{be} \quad (3)$$

معادله (۱) نیز با جایگذاری فوق به صورت زیر خواهد شد:

$$V_{be} = h_{ie} (-i_e - i_c) + h_{re} (V_{cb} - V_{eb}) \quad (4)$$

اگر i_c را از معادله (۳) در معادله (۴) قرار دهیم خواهیم داشت:

$$V_{be} = -h_{ie} i_e + \frac{h_{ie} h_{fe}}{1+h_{fe}} i_e - \frac{h_{ie} h_{oe}}{1+h_{fe}} V_{cb} - \frac{h_{ie} h_{oe}}{1+h_{fe}} V_{be} + h_{re} V_{cb} + h_{re} V_{be} \quad (5)$$

از معادله (۵) می‌توان V_{be} را به صورت زیر نوشت:

$$V_{be} = \frac{-h_{ie}}{(1-h_{re})+(1+h_{fe})+h_{ie}h_{oe}} i_e + \frac{h_{re}(1+h_{fe})-h_{ie}h_{oe}}{(1-h_{re})(1+h_{fe})+h_{ie}h_{oe}} V_{eb}$$

$$V_{eb} = -V_{be} = \frac{h_{ie}}{(1-h_{re})(1+h_{fe})+h_{ie}h_{oe}} i_e + \frac{h_{ie}h_{oe}-h_{re}(1+h_{fe})}{(1-h_{re})(1+h_{fe})+h_{ie}h_{oe}} V_{eb}$$

$$V_{eb} = h_{ib} i_e + h_{rb} V_{cb}$$

ضرایب هیبرید در مدل بیس مشترک عبارتست از:

$$h_{ie} = \frac{h_{ie}}{(1 - h_{re})(1 + h_{fe}) + h_{ie}h_{oe}}$$

$$h_{rb} = \frac{h_{ie}h_{oe} - h_{re}(1 + h_{fe})}{(1 - h_{re})(1 + h_{fe}) + h_{ie}h_{oe}}$$

مطابق روش فوق، V_{be} را از معادله (۴) محاسبه می‌کنیم:

$$V_{be} = \frac{-h_{ie}}{1 - h_{re}} i_e - \frac{h_{ie}}{1 - h_{re}} i_e + \frac{h_{re}}{1 - h_{re}} V_{cb} \quad (5)$$

اگر V_{be} ، معادله (۵) را در معادله (۳) قرار دهیم خواهیم داشت:

$$i_c = \frac{-h_{fe}(1 - h_{re}) + h_{oe}h_{ie}}{(1 + h_{fe})(1 - h_{re}) + h_{oe}h_{ie}} i_e + \frac{h_{oe}}{(1 + h_{fe})(1 - h_{re}) + h_{oe}h_{ie}} V_{eb}$$

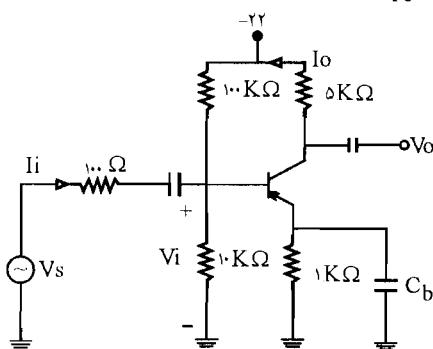
$$i_c = h_{pb} i_c + h_{ob} V_{cb}$$

ضرایب هیبرید در مدل بیس مشترک عبارتست از: ←

$$h_{fb} = \frac{-h_{fe}(1 - h_{re}) + h_{oe}h_{ie}}{(1 + h_{fe})(1 - h_{re}) + h_{oe}h_{ie}} \simeq -1$$

$$h_{ob} = \frac{h_{ee}}{(1 + h_{fe})(1 - h_{re}) + h_{oe} + h_{ie}} \simeq \frac{h_{oe}}{h_{fe} + h_{oe}h_{ie}}$$

۳- در تقویت کننده شکل زیر ترانزیستور دارای $h_{fe} = 100$ است.



شکل ۳-

الف- کمیت‌های A_i ، A_v و R_{rs} را محاسبه کنید؟

ب) اگر فقط نیمی از مقاومت امیتر را با خازن

کنار گذار

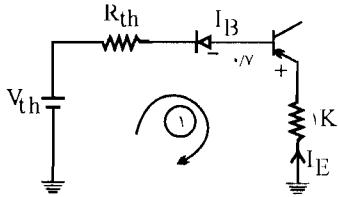
بای پاس نماییم. A_i و A_v و R_{rs} چقدر خواهد

شد؟ این عمل چگونه به خطی تر شدن

تقویت کننده سیگنال بزرگ کمک می‌کند؟

(۱۵ هل: الف) برای محاسبه $I_{EQ} \approx I_{CQ}$ ، ابتدا h_{ie} را محاسبه می‌کنیم. با توجه به مدار، بایاس

از نوع بایاس مقسم ولتاژ است. بنابراین خواهیم داشت:



$$V_{th} = \frac{-22 \times 10}{100 + 10} = -2 \text{ V}$$

$$R_{th} = 10 \text{ k} \parallel 100 \text{ k} = 9.09 \text{ k}\Omega$$

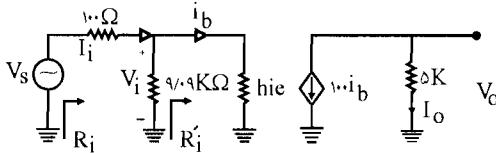
در حلقه ورودی (۱)، با اعمال KVL خواهیم داشت:

$$\text{KVL (۱)}: -V_{th} - 0/V = R_{th} I_B + 10 \text{ k} \times I_E$$

$$\Rightarrow I_{EQ} = 1/19 \text{ mA}$$

$$h_{ie} = \frac{h_{fe} \cdot V_T}{I_{EQ}} = \frac{100 \times 26}{1/19} = 2/18 \text{ k}\Omega$$

حال مدار معادل ac به صورت زیر خواهد شد:



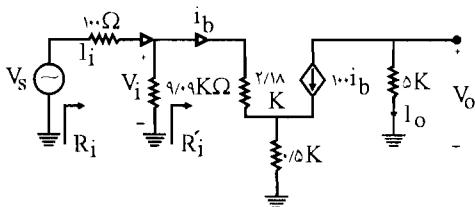
$$R'_i = h_{ie} = 2/18 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_i = 9.09 \text{ k} \parallel 2/18 \text{ k} \cong 1/18 \text{ k}\Omega$$

$$A_I' = \frac{I_o}{i_b} = -h_{fe} = -100, \quad A_I = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{i_b} \cdot \frac{i_b}{I_i} = \frac{1}{1/25} \times A_I' = -\frac{100}{1/25} = -80.$$

$$A_V' = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_L \cdot I_o}{R'_i \cdot i_b} = \frac{R_L}{R'_i} \times A_I' = -100 \times \frac{5}{2/18} = -229$$

$$A_{VS} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \times \frac{V_i}{V_s} = A_V' \times \frac{V_s \times \frac{R_i}{R_i + 0/1}}{V_s} = -216/8$$

ب) اگر فقط نصف C_b با پاس شود مدار معادل به صورت زیر خواهد شد:



$$R'_i = h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_e = 2/18 + (100) \times 0/5 = 52/6 \text{ k}\Omega$$

$$A'_I = \frac{I_o}{I_b} = -100 , \quad A'_v = \frac{R_L}{R_i} \times A'_I = -9/48$$

$$I_b = I_i \times \frac{9/0.9}{9/0.9 + R_i} = 0/147 \times I_i$$

$$A_I = A'_I \times \frac{I_b}{I_i} = A'_I \times 0/147 \cong -15$$

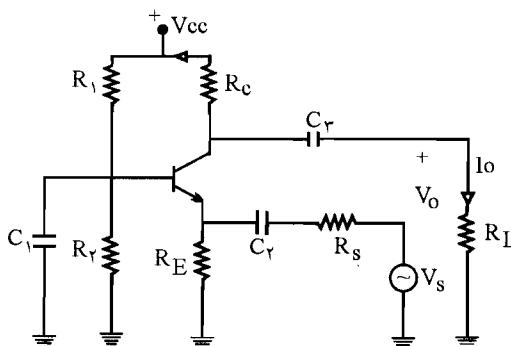
$$R_i = 9/0.9 \text{ K} \parallel R'_i = 9/9 \text{ K}\Omega$$

$$A_{vs} = A'_v \times \frac{R_i}{R_i + 0/1} = -9/4$$

در حالت امیتر، تقویت کاهش می‌یابد و سیگنال‌های با دامنه زیاد بریده نمی‌شوند و بدون برش و اعوجاج عبور خواهد کرد.

۴- یک تقویت‌کننده بیس مشترک با $R_i < 20$ و $A_{V_0} > 50$ و $R_L = \lim A_V$ وقتی که به سمت R_L وقوع کند) طراحی کنید که در آن نوسان متقارن خروجی حداقل بوده و پایداری مطلوبی بینهایت میل می‌کند) در صورتی که β فوق مناسب نباشد به دلخواه از نسبت به تغییرات β داشته باشیم. (۱۵۰ < $\beta < 100$) یک β با میزان تغییرات مناسب استفاده کنید؟

۱۵ حل:



مدار کلی تقویت‌کننده بیس مشترک به صورت مقابله است.

مانند مسئله قبل چون با یاس DC از نوع مقسم ولتاژ است با اعمال KVL در حلقه ورودی خواهیم داشت:

$$V_{th} = V_{CC} \cdot \frac{R_Y}{R_1 + R_Y} , \quad R_{th} = R_1 \parallel R_Y$$

$$R_{th} I_B + R_E I_E = V_{th} - V_{BE}$$

$$\left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) I_E = V_{th} - V_{BE}$$

اگر $I_E \approx I_C$ خواهیم داشت:



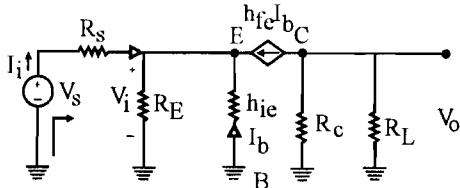
برای داشتن پایداری مناسب نسبت به β باید داشته باشیم:

$$\frac{R_{th}}{\beta_{min}} \leq 1/R_E \quad (1)$$

با در نظر گرفتن حالت مساوی در رابطه (1) خواهیم داشت:

$$R_{th} = 1/R_E \beta_{min} = 10 R_E$$

مدار معادل سیگنال کوچک ac مطابق شکل زیر است.



$$V_i = -h_{ie} I_b \quad , \quad V_o = -h_{fe} i_b \times \frac{R_c \times R_L}{R_c + R_L} \Rightarrow A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{h_{fe}}{h_{ie}} \times \frac{R_c R_L}{R_c + R_L}$$

$$A_{V_o} = A_v \left| R_L \rightarrow \infty \right. = \frac{R_c \cdot h_{fe}}{h_{ie}} \Rightarrow \frac{R_c \times h_{fe}}{h_{ie}} > 50. \quad (2)$$

$$R_i = \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}} \approx \frac{h_{ie}}{h_{fe}} \quad \text{برای امپدانس ورودی به راحتی می‌توان نوشت} \leftarrow$$

$$R_i = \frac{\frac{h_{fe} V_T}{I_C}}{\frac{I_C}{h_{fe}}} \approx \frac{V_T}{I_C} = \frac{26}{10} < 20 \Rightarrow I_C > \frac{26}{20} = 1.3 \text{ mA} \quad (3)$$

از رابطه (2) داریم:

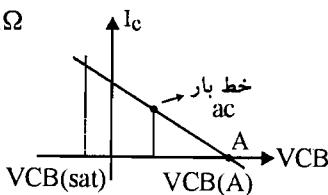
$$\frac{R_C h_{fe}}{h_{ie}} > 50. \quad \text{یا} \quad \frac{R_C \cdot h_{fe}}{h_{ie} V_T} > 50. \Rightarrow \frac{R_C \cdot I_C}{V_T} > 50. \Rightarrow \frac{R_C I_C}{26} > 50.$$

اگر فرض کنیم $I_C = 1.3 \text{ mA}$ خواهیم داشت:

$$R_C \times \frac{1.3}{26} > 50 \Rightarrow R_C \geq 1 \text{ K}\Omega$$

را برابر $1 \text{ K}\Omega$ ، انتخاب می‌کنیم. و اگر فرض کنیم $R_E = 1 \text{ K}\Omega$ خواهیم داشت:

$$R_{th} = 10 R_E = 10 \text{ K}\Omega$$



با توجه به رابطه خط بار ac داریم:

برای داشتن حداکثر انحراف متقارن در خروجی، نقطه کار را وسط خط بار aC در نظر می‌گیریم بنابراین:

$$V_{CBQ} = \frac{V_{CB}(A) + V_{CB}(\text{sat})}{2}, \quad V_{CB}(A) = V_{CBQ} + R_C I_{CQ}$$

$$V_{CBQ} = \frac{V_{CBQ} + R_C I_{CQ} + V_{CB}(\text{sat})}{2} \Rightarrow \boxed{V_{CBQ} = R_C I_{CQ} + V_{CB}(\text{sat})} \quad (4)$$

$$V_{CB}(\text{sat}) = V_{CE}(\text{sat}) - V_{BE}(\text{sat}) = 0/2 - 0/V = -0/5 \text{ Volt}$$

بنابراین از رابطه (4) داریم:

$$V_{CBQ} = 1 \times 1/5 - 0/5 = 1V$$

در حلقه V_E , V_{DE} و زمین داریم:

$$V_{CC} - V_{CBQ} - V_{BE} = R_C I_{CQ} + R_E I_{CQ}$$

$$\Rightarrow V_{CC} = 1 + 0/V + 1 \times 1/5 + 1 \times 1/5 = 4/V V$$

واز آنجا خواهیم داشت:

$$V_{th} = 4/V \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 10 K\Omega$$

در حلقه V_{th} و R_{th} , V_{CB} , V_{CC} داریم:

$$-R_C I_C + R_{th} I_B = -V_{CC} - V_{th} - V_{CB}$$

$$\Rightarrow V_{th} = V_{CC} - R_C I_C + R_{th} \times \frac{I_C}{\beta_{av}} - V_{CB} = 4/V - 1 \times 1/5 + 10 \times \frac{1/5}{125} - 1 = 2/32 V$$

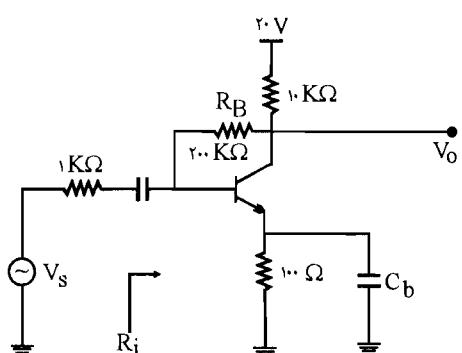
$$B_{av} = \frac{B_{min} + B_{max}}{2}$$

$$\left. \begin{aligned} 2/32 &= 4/V \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} &= 10 K\Omega \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} R_1 &= 20/25 K\Omega \\ R_2 &= 19/75 K\Omega \end{aligned}$$

۵- در تقویت کننده شکل ۵-۵ ترانزیستور دارای 100 و $h_{fe} = h_{re} = h_{oe}$ است.

الف) کمیت های A_{vs} و R_i را محاسبه کنید؟

ب) اگر وسط مقاومت R_B را توسط خازن به زمین وصل کنیم. کمیت‌های مذکور چقدر خواهد شد؟



شکل ۳ - ۵

راه حل:

الف) برای به دست آوردن h_{ie} ابتدا باید I_C را به دست آوریم.

$$\text{KVL: } 10\text{ K}\Omega(I_C + I_B) + 200I_B + 1/(1)(I_E) = 20 - 0/\text{V} \quad , \quad I_E = I_C + I_B$$

$$\Rightarrow 10(I_C + I_B) + 200I_B + 1/(1)(I_C + I_B) = 19/3 \Rightarrow 10/(1)(I_C + I_B) + 200I_B = 19/3$$

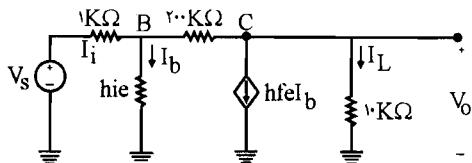
$$\Rightarrow I_C = \beta I_B = 100 I_B$$

$$\Rightarrow 10/(1)(\beta I_B + I_B) + 200I_B = 19/3 \Rightarrow 10/(1)(101I_B) + 200I_B = 19/3 \Rightarrow I_B = 0.0158 \text{ mA}$$

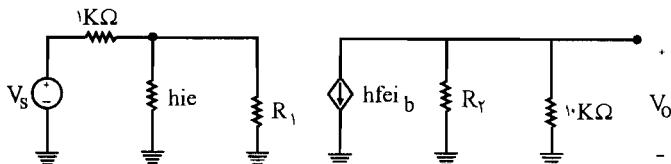
$$\Rightarrow I_C = \beta I_B = 100 \times 0.0158 = 1.58 \text{ mA} \Rightarrow I_C = 1.58 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{100 \times 26}{1.58} = 1654 \Omega \Rightarrow h_{ie} = 1654 \text{ K}\Omega$$

مدار معادل را رسم می‌کنیم:



با استفاده از قضیه میلر مقاومت $200\text{ K}\Omega$ را به دو مقاومت R_1 و R_2 تبدیل می‌کنیم:



$$K = A_V = \frac{V_o}{V_i} \Rightarrow R_\gamma = \frac{200K}{K-1} \simeq 200 \text{ K}\Omega$$

$$R'_L = 10\text{ K}\Omega \parallel 200\text{ K}\Omega$$

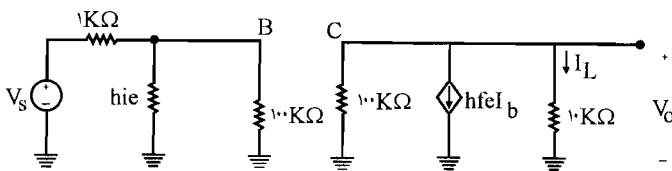
$$AV = \frac{V_O}{V_i} = \frac{-h_{fe}V_b \times (10K\Omega \parallel 20K\Omega)}{h_{ie}V_b} = \frac{-100 \times (\frac{10 \times 20}{10 + 20})}{1/640} = -5V/\text{A}$$

$$\Rightarrow R_i = \frac{20}{1-K} = \frac{20}{1-A_V} = \frac{20}{1+5V/\text{A}} = 0.345 K\Omega$$

$$R_i = R_1 \parallel h_{ie} = 0.345 \parallel 1/640 = 0.285 K\Omega \Rightarrow R_i = 285 \Omega$$

$$A_{VS} = \frac{V_O}{V_s} = \frac{V_O}{V_i} \times \frac{V_i}{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -5V/\text{A} \times \frac{0.285}{0.285 + 1} = -12.8/\text{V}$$

ب) اگر وسط مقاومت R_B را توسط خازن به زمین وصل کنیم مدار معادل به صورت زیر می‌باشد.

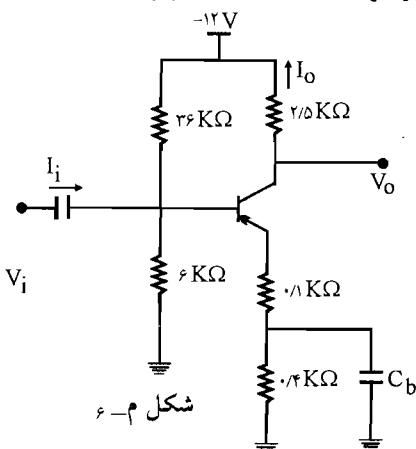


$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{-h_{fe} I_b \times (10K\Omega \parallel 100K\Omega)}{h_{ie} I_b} = \frac{-100 \times (\frac{10 \times 100}{10 + 100})}{1/640} = -552/\text{V}$$

$$R_i = 100 \parallel h_{ie} = \frac{1/640 \times 100}{1/640 + 100} = 1/62 K\Omega$$

$$A_{VS} = -552/\text{V} \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -552/\text{V} \times \frac{1/62}{1/62 + 1} = -34.1/\text{V}$$

در مدار تقویت کننده شکل م-۶، با فرض $h_{re} = h_{oe} = 0$ و $h_{fe} = 100$ ، بهره جریان، بهره ولتاژ و مقاومت ورودی را محاسبه کنید؟



راه حل:

با اجرای تونن در ورودی داریم:

$$\begin{cases} R_{th} = 6 K\Omega \parallel 36 K\Omega = \frac{6 \times 36}{6 + 36} = 5/12 \\ V_{th} = -12 \times \frac{6}{6 + 36} = -1/V \end{cases}$$

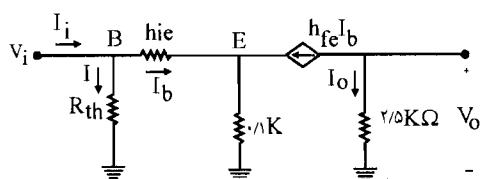
$$KVL: R_{th} I_B + (5/12 + 1/4) I_E = -(V_{th}) - V_{EB}$$

$$5/12 I_B + 1/4(1+\beta) I_B = 1/V - 1/V = 1/0.1 \Rightarrow I_B = \frac{1/0.1}{50/64} = 0.18 mA$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 0.18 = 18 mA$$

$$h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{100 \times 26}{18} = 144 K\Omega$$

مدار معادل به صورت زیر در می آید:



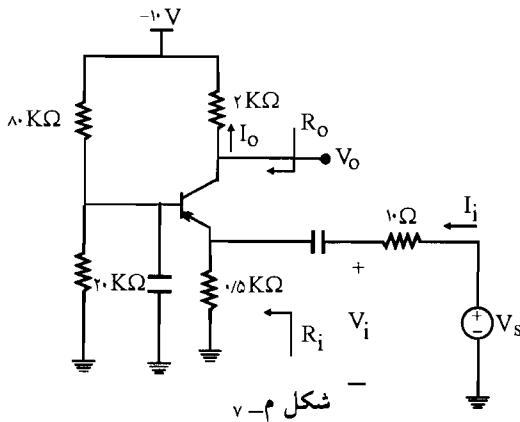
$$I_i = -100 I_B \quad , \quad I_i = I_b + I = I_b + \frac{1/44 I_b + 1/1 (I_b + 100 I_b)}{5/12}$$

$$\Rightarrow I_i = 3/44 I_b \Rightarrow A_I = \frac{I_o}{I_i} = \frac{-100 I_b}{3/44 I_b} = -30/9$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{1/44 I_b + (1/1)(I_b + 100 I_b)}{3/44 I_b} = 3/56 K\Omega$$

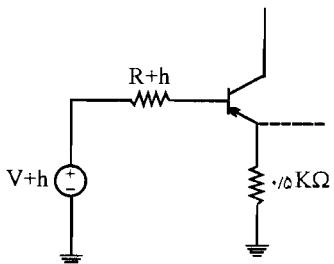
$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -30/9 \times \frac{2/0}{3/56} = -21/V$$

۷- در مدار شکل م-۷ با فرض $R_{Oe} = 100 \Omega$ ، مقادیر A_V و h_{fe} را محاسبه کنید؟



۱۵ حل:

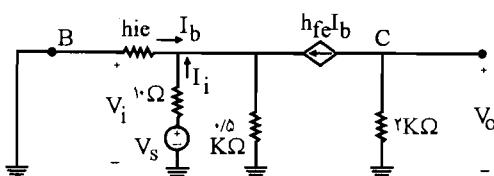
$$\begin{cases} R_{th} = 20 K\Omega \parallel 80 K\Omega = \frac{20 \times 80}{20 + 80} = 16 K\Omega \\ V_{th} = -10 \times \frac{20}{20 + 80} = -2V \end{cases} \quad \text{ابتدا مدار معادل تونن ورودی را می‌یابیم:}$$



$$\begin{aligned} \text{KVL: } & R_{th} I_B + 1/50 I_E = -V_{th} - V_{EB} \\ \Rightarrow & 16 I_B + 1/50(1+\beta) I_B = +2 - 0/V = 1/3 \\ \Rightarrow & I_B (16 + 1/50 + 100) + 1/3 \Rightarrow I_B = 1/195 \text{ mA} \\ \Rightarrow & I_C = \beta I_B = 100 \times I_B = 1/195 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{100 \times 26}{1/195} = 1/33 K\Omega$$

پس مدار معادل به صورت زیر می‌باشد:



$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_{fe} I_b \times 1/5 K\Omega}{-h_{ie} I_b} = \frac{-2 \times 100}{-1/33} = 1500$$

$$KCL: I_i + I_b + h_{fe} I_b + \frac{V_i}{10\Omega} = 0 \quad \text{و}$$

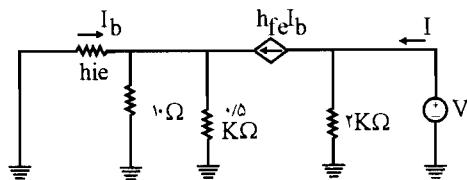
$$\Rightarrow I_i = -(I_b + h_{fe} I_b) - \frac{h_{ie} I_b}{10\Omega}$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{-h_{ie} I_b}{-(I_b + h_{fe} I_b) - \frac{h_{ie} I_b}{10\Omega}} = \frac{h_{ie}}{(1 + h_{fe}) - \frac{h_{ie}}{10\Omega}} = \frac{1/33}{1 + 1 - \frac{1/33}{10}} = 12/\infty \Omega$$

$$A_{VS} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = 150/3 \times \frac{12/\infty}{12/\infty + 10\Omega} = 84/4$$

$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-h_{fe} I_b}{-(I_b + h_{fe} I_b) - \frac{h_{ie} I_b}{10\Omega}} = \frac{+h_{fe}}{(1 + h_{fe}) + 2h_{ie}} = \frac{100}{(1 + 1) + 2 \times 1/33} = 0/96$$

برای به دست آوردن مقاومت خروجی یک منبع ولتاژ V را در دو سر مقاومت $2K\Omega$ در خروجی قرار می‌دهیم و منبع ورودی صفر می‌شود.



$$R_o = \frac{V}{I}$$

$$R_o = \frac{V}{I} : I = \frac{V}{2K\Omega} + h_{fe} I_b \quad (I) \quad \text{و}$$

$$I_b : I_b = \frac{-h_{fe} I_b \times (10\Omega \parallel 10\Omega)}{(10\Omega \parallel 10\Omega) + h_{ie}} = \frac{-h_{fe} I_b \times 10}{10 + 1/33}$$

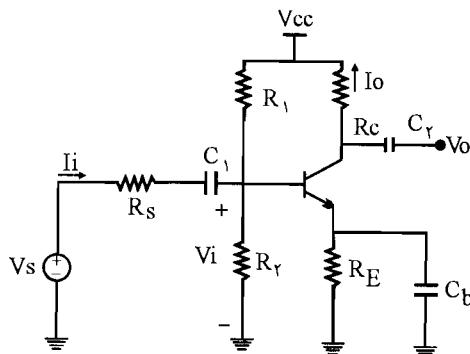
$$\Rightarrow I_b = \left(1 + \frac{h_{fe} \times 10}{11/33}\right) = 0 \Rightarrow I_b = 0$$

$$(I) : I = \frac{V}{2K\Omega} + h_{fe} I_b = \frac{V}{2K\Omega} \Rightarrow R_o = \frac{V}{I} = 2K\Omega$$

- ۸ یک تقویت کننده امپیتر مشترک با $R_i = 1K\Omega$ و $A_V = 200$ را طوری طراحی نمایند که نقطه کار

آن از پایداری خوبی نسبت به تغییرات β برخوردار باشند. $h_{fe} = 100$ و $V_{CC} = 18V$ است.

۱۰۵ مل:



شکل کلی تقویت‌کننده به صورت زیر می‌باشد:

معادل تونن در ورودی را می‌یابیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{th} = \frac{R_1 R_\gamma}{R_1 + R_\gamma} \\ V_{th} = V_{CC} \times \frac{R_\gamma}{R_1 + R_\gamma} \end{array} \right.$$

فرض: $I_C \approx I_E$

$$KVL: R_{th} I_B + R_E I_E = V_{th} - V_{BE} \Rightarrow R_{th} \times \frac{I_C}{\beta} + R_E I_C = V_{th} - V_{BE}$$

$$\Rightarrow I_C \left(R_E + \frac{R_{th}}{\beta} \right) = V_{th} - V_{BE} \quad (I)$$

برای اینکه نقطه کار از پایداری خوبی نسبت به تغییرات β برخوردار باشد باید داشته باشیم:

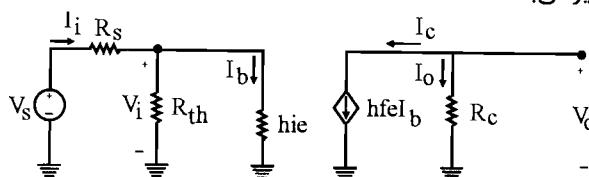
$$\frac{R_{th}}{\beta_{min}} = 0.1 R_E$$

$$\Rightarrow R_{th} = 0.1 \times 100 \times R_E = 10 R_E \quad (II)$$

با جایگذاری (II) در (I) داریم:

$$I_C = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E + 10 R_E} = \frac{V_{th} - V_{BE}}{11 R_E}$$

مدار معادل سیگنال کوچک به صورت زیر می‌باشد:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-h_{fe} I_b}{I_b + \frac{V_i}{R_{th}}} = \frac{-h_{fe} I_b}{I_b + \frac{h_{ie} I_b}{R_{th}}} = \frac{-100 R_{th}}{R_{th} + h_{ie}}$$

$$R_i = \frac{R_{th} h_{ie}}{R_{th} + h_{ie}} = \frac{10 R_E h_{ie}}{10 R_E + h_{ie}}$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_C}{R_i} = \frac{-100 R_{th}}{R_{th} + h_{ie}} \times \frac{R_C (R_{th} + h_{ie})}{R_{th} \times h_{ie}} = \frac{-100 R_C}{h_{ie}}$$

$$A_V = 200 \Rightarrow 200 = \frac{-100 R_C}{h_{ie}} \Rightarrow \frac{R_C}{h_{ie}} = 2 \quad (\text{III})$$

طبق فرض مسئله $R_i = 1K\Omega$ می باشند پس در رابطه R_i داریم:

$$R_i = \frac{10 R_E \times h_{ie}}{10 R_E + h_{ie}} = 1K\Omega \Rightarrow 10 R_E h_{ie} = 10 R_E + h_{ie} \Rightarrow 10 R_E (-1 + h_{ie}) = h_{ie}$$

$$\Rightarrow R_E = \frac{h_{ie}}{10 (h_{ie} - 1)} \quad (\text{IV})$$

و در تقویت کننده بهتر آن می باشد که نقطه کار وسط خط بار ac باشد یعنی باید داشته باشیم:

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE}(\text{sat})}{R_{ac} + R_{dc}} \quad \begin{cases} R_{ac} = R_C \\ R_{dc} = R_C + R_E \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{CQ} = \frac{18}{R_C + R_C + R_E} = \frac{18}{2R_C + R_E} \quad (\text{V})$$

به جای R_C و R_E مقادیر به دست آمده از روابط (III) و (IV) را قرار می دهیم:

$$I_{CQ} = \frac{18}{2 \times 2 h_{ie} + \frac{h_{ie}}{10 (h_{ie} - 1)}} = \frac{18 \times 10 \times (h_{ie} - 1)}{40 h_{ie} (h_{ie} - 1) + h_{ie}}$$

$$\Rightarrow 18 \cdot (h_{ie} - 1) = 2/5 \times 40 \cdot (h_{ie} - 1) + 2/5$$

$$\Rightarrow (h_{ie} - 1) = \frac{2/5}{2/5} = 0.34 \Rightarrow h_{ie} = 1.34 K\Omega$$

$$(\text{III}): R_C = 2 h_{ie} = 2 \times 1.34 = 2.68 K\Omega$$

$$(IV): R_E = \frac{h_{ie}}{1 + (h_{ie} - 1)} = \frac{1/0.34}{1 + (1/0.34 - 1)} = 3/0.4 K\Omega$$

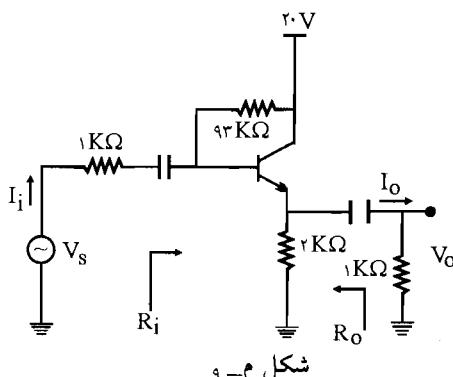
$$(V): I_{CQ} = \frac{18}{2R_C + R_E} = 2/51 mA = \frac{V_{th} - 0/V}{1/1 R_E} \Rightarrow V_{th} = 9/0.9 V$$

$$R_{th} = 1/R_E = 1/0.4 = 3/0.4 K\Omega = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3/0.4}{R_1}$$

$$V_{th} = 9/0.9 = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 18 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 18 \times \frac{3/0.4}{R_1} \Rightarrow R_1 = 59/48 K\Omega$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{9/0.9 \times R_1}{18 - 9/0.9} = 6/0.6 K\Omega$$

۹- در تقویت کننده امپیر فالوور شکل م - که ترانزیستور آن دارای $h_{fe} = 50$ است. مقادیر A_I



شکل م

R_i و A_{VS} را محاسبه کنید. حداقل دامنه ولتاژ ورودی V_s که تقویت کننده در آن خطی می‌ماند، چقدر است؟ در صورت افزایش حداقل ورودی، شکل موج خروجی از بالا زودتر برگش داده می‌شود یا از پایین؟ توضیح دهید؟

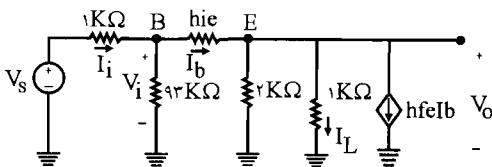
ا) ا) هل:

$$KVL: 93I_B + 2I_E = 20 - V_{BE} = 20 - 0/V = 19/3 \Rightarrow 93I_B + 2(1+\beta)I_B = 19/3$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{19/3}{195} = 0.098 mA \Rightarrow I_C = \beta I_B = 4.95 mA$$

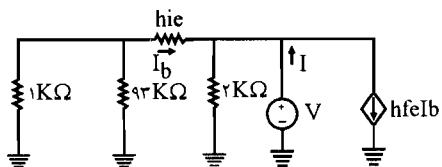
$$h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{50 \times 26}{4.95} = 262/6 \Omega = 0.263 K\Omega$$

مدار معادل به صورت زیر می‌باشد:



$$\begin{aligned}
A_I &= \frac{I_L}{I_i} = \frac{(I_b + h_{fe} I_b) \times \frac{1}{1+1}}{I_b + \frac{V_i}{100}} = \frac{\frac{1}{1+1} I_b (1 + h_{fe})}{I_b + \left(\frac{h_{ie} I_b + 1 \times I_L}{100} \right)} \\
&= \frac{\frac{1}{1+1} I_b (1 + h_{fe})}{I_b + \left(\frac{\frac{h_{ie} I_b + \frac{1}{1+1} I_b (1 + h_{fe})}{100}}{100} \right)} = \frac{\frac{1}{1+1} \times 51}{1 + \left(\frac{0.263 + \frac{1}{1+1} \times 51}{100} \right)} = 24/100 \\
R_i &= \frac{V_i}{I_i} = \frac{h_{ie} I_b + 1 \times I_b}{I_b + \frac{V_i}{100}} = \frac{h_{ie} I_b + \frac{1}{1+1} I_b}{I_b + \frac{h_{ie} I_b + \frac{1}{1+1} \times 51 I_b}{100}} = \frac{0.263 + 24}{1 + \frac{0.263 + 24}{100}} = 25 K\Omega \\
A_V &= A_I \times \frac{R_L}{R_i} = 24/100 \times \frac{1}{25} = 0.994 \\
A_{Vs} &= A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = 0.994 \times \frac{25}{25 + 1} = 0.95
\end{aligned}$$

برای به دست آوردن مقاومت خروجی R_o یک منبع ولتاژ V را در خروجی موازی با مقاومت $2 K\Omega$ (درا نبود مقاومت $2 K\Omega$) قرار می‌دهیم و منبع ورودی را صفر قرار می‌دهیم:



$$I = -h_{fe} I_b - I_b + \frac{V}{100} \quad (I)$$

$$\text{KVL: } (1 K\Omega \parallel 100 K\Omega) I_b + h_{ie} I_b = -V$$

$$\Rightarrow \frac{1 \times 100}{1 + 100} I_b + 0.263 I_b = -V \Rightarrow I_b = \frac{-V}{1/100}$$

$$(I): I = -h_{fe} I_b - I_b + \frac{V}{100} = -50 \times \frac{-V}{1/100} + \frac{V}{1/100} + \frac{V}{100} = V \left[\frac{50}{1/100} + \frac{1}{100} \right] = V \times 41/100$$

$$\Rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{1}{41/100} = 0.24 K\Omega \Rightarrow R = 24 \Omega$$

به دست آوردن حداکثر دامنه ولتاژ ورودی V_s که تقویت کننده در آن خطی می‌ماند:

$$I_{CQ} = 4/95 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - 2K\Omega \times I_E = 20 - 2 \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right) I_C$$

$$\Rightarrow V_{CEQ} = 20 - 2 \times \frac{51}{50} \times 4/95 = 9/9 \text{ V}$$

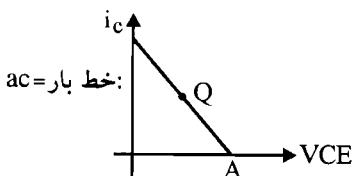
معادله خط بار ac: $V_{ce} = V_c - V_e = 0 - R_{ac} \times i_e$

$$\Rightarrow V_{CE} = -\frac{2}{3} \times \frac{51}{50} i_c \Rightarrow V_{ce} = -0/68 i_c$$

$$\begin{cases} R_{ac} = 2K\Omega \parallel 1K\Omega = \frac{2}{3} \\ i_e = \frac{1+\beta}{\beta} i_c \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{ce} = V_{CE} - V_{CEQ} \\ i_c = i_C - i_{CQ} \end{cases} \Rightarrow V_{CE} - V_{CEQ} = -0/68 (i_C - i_{CQ})$$

نقطه A به ازای $i_c = 0$ از معادله خط بار ac به دست می‌آید.



$$V_{CE}(A) = V_{CEQ} + 0/68 i_{CQ}$$

$$V_{CE}(A) = 9/9 + 0/68 \times 4/95 = 13/27$$

$$\text{قطع} \quad V_{CE} = V_{CE}(A) = 13/27$$

$$\begin{cases} V_{CEQ} = 9/9 \\ V_{CE}(\text{sat}) = 0/2 \text{ V} \end{cases} \quad \text{نقطه کار}$$

$$\Rightarrow V_{ce} = V_{CE}(A) - V_{CEQ} = 13/27 - 9/9 = 3/37 \text{ V} \quad \text{در حالت قطع} \quad V_{ce}$$

$$V_{ce} = 0/2 - 9/9 = -9/7 \text{ V} \quad \text{در حالت اشباع} \quad V_{ce}$$

$$\begin{cases} V_O = -V_{ce} = +9/7 & \text{در حالت اشباع} \\ V_0 = -V_{ce} = -3/37 & \text{در حالت قطع} \end{cases}$$

پس دیده می‌شود حداکثر دامنه خروجی از سمت منفی $3/37$ می‌تواند باشد و سیگنال از این طرف با این

دامنه برش می‌خورد. و از سمت بالا $9/7$ ولت می‌باشد. مقدار متناظر ورودی برای این خروجی عبارت

است از:

$$A_{Vs} = \frac{V_O}{V_s} \Rightarrow V_s = \frac{V_O}{A_{Vs}} = \frac{3/37}{0/954} = 3/53$$

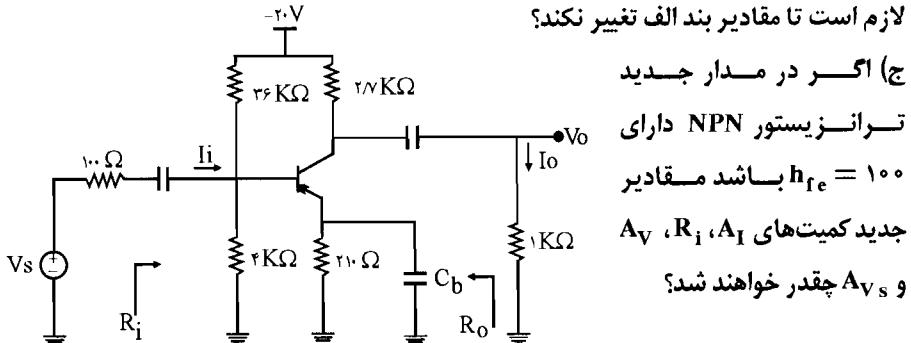
(مقدار ماکریم مجاز بدون برش)

۱۰) در تقویت‌کننده شکل م - ۱۰ ترانزیستور دارای $h_{fe} = ۴۰$ است.

(الف) مقادیر A_I , A_V , R_O و A_{VS} را محاسبه کنید؟

(ب) اگر ترانزیستور را با یک ترانزیستور NPN با همان h_{fe} عوض کنیم، چه تغییراتی در مدار

لازم است تا مقادیر بند الف تغییر نکند؟



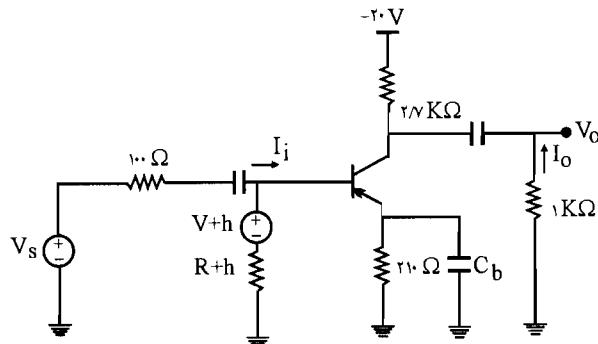
شکل م - ۱۰

ج) اگر در مدار جدید ترانزیستور NPN دارای $h_{fe} = ۱۰۰$ باشد مقادیر A_V , R_I , A_I و A_{VS} چقدر خواهد شد؟

(اه هل):

$$\begin{cases} R_{th} = 4\text{ K}\Omega \parallel 36\text{ K}\Omega = \frac{4 \times 36}{4 + 36} = 3.6\text{ K}\Omega \\ V_{th} = -2.0 \times \frac{4\text{ K}\Omega}{4\text{ K}\Omega + 36\text{ K}\Omega} = -2\text{ V} \end{cases}$$

پس مدار معادل به صورت زیر می‌باشد:

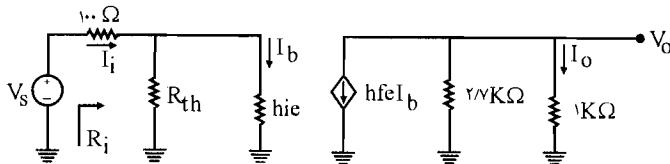


$$KVL: R_{th} I_B + 0.021 I_E = -V_{th} - V_{EB} \Rightarrow 3.6 I_B + 0.021(\beta + 1) I_B = -2 - 0.02 = 1.9$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{1.9}{12/21} = 0.106 \text{ mA} \Rightarrow I_C = 0.106 \times 26 = 2.76 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{40 \times 26}{0.106} = 244 \Omega = 0.244 \text{ K}\Omega$$

پس با h_{ie} مدار معادل ac را رسم می‌کنیم:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-h_{fe} I_b \times \frac{\gamma/\nu}{\gamma/\nu + 1}}{I_b + \frac{0.224 I_b}{\gamma/\nu}} = \frac{-4 \times \frac{\gamma/\nu}{\gamma/\nu}}{1 + \frac{0.224}{\gamma/\nu}} = -\frac{29/2}{1/0.8} = -27/3$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{th} \parallel h_{ie} = 3/6 \parallel 0.224 = 228/5 \Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -27/3 \times \frac{1}{0.228} = -119/5$$

$$A_{Vs} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -119/5 \times \frac{0.228}{0.228 + 0.1} = -8/31$$

$$R_o = \gamma K\Omega$$

ب) برای این منظور باید منبع V_{CC} را از مقدار ۲۰V به مقدار ۲۰V تغییر داد.

$$V_{th} = 20 \times \frac{4}{4+36} = 2V \quad (2)$$

$$\text{KVL: } R_{th} I_B + 0.21 I_E = +V_{th} - V_{BE} \Rightarrow 3/6 I_B + 0.21(1+\beta) I_B = 2 - 0.8 = 1/3$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{1/3}{24/31} = 0.052mA \Rightarrow I_C = \beta I_B = 100 \times 0.052 = 5.2mA$$

$$\Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{100 \times 29}{5.2} = 500 \Omega \Rightarrow h_{ie} = 0.5K\Omega$$

$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-h_{fe} I_b \times \frac{\gamma/\nu}{\gamma/\nu + 1}}{I_b + \frac{0.5 I_b}{3/6}} = \frac{-100 \times \frac{\gamma/\nu}{\gamma/\nu}}{1 + \frac{0.5}{3/6}} = -64$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{th} \parallel h_{ie} = 3/6 \parallel 0.5 = 0.439 K\Omega = 439 \Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -64 \times \frac{1}{0.439} = -145/V$$

$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -145/V + \frac{0.439}{0.439 + 0.1} = -118/V$$

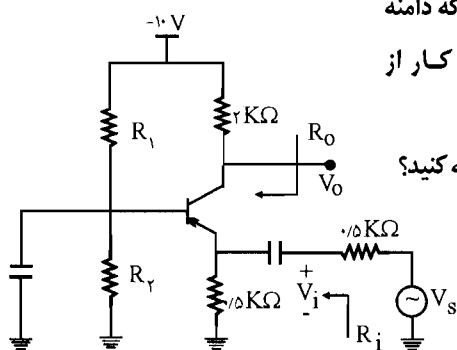
۱۱- تقویت کننده شکل م - ۱۱ را در نظر بگیرید. فرض کنید $\beta < 100$ است.

(الف) مقاومت های R_1 و R_2 را طوری تعیین کنید که دامنه

نوسانات متقارن خروجی حداقل شده و نقطه کار از

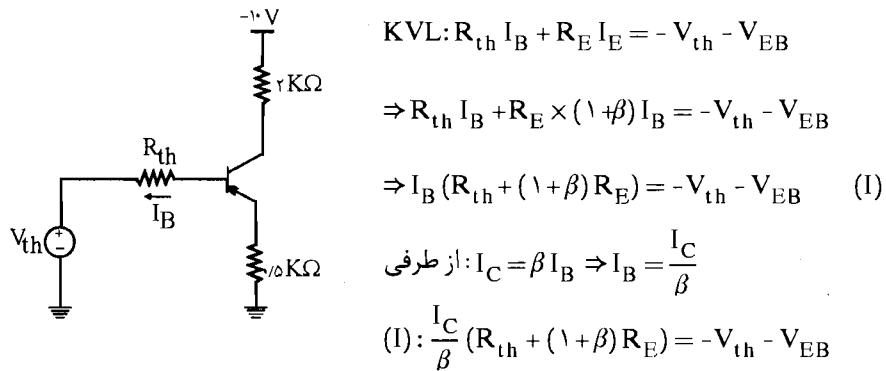
پایداری مطلوبی در برابر β برخوردار باشد.

(ب) مقادیر R_O و A_I ، A_{V_s} ، A_V را محاسبه کنید؟



شکل م - ۱۱

(ا) حل: مدار معادل تونن در ورودی به صورت زیر می باشد:



$$\text{KVL: } R_{th} I_B + R_E I_E = -V_{th} - V_{EB}$$

$$\Rightarrow R_{th} I_B + R_E \times (1 + \beta) I_B = -V_{th} - V_{EB}$$

$$\Rightarrow I_B (R_{th} + (1 + \beta) R_E) = -V_{th} - V_{EB} \quad (I)$$

$$\text{از طرفی: } I_C = \beta I_B \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$(I): \frac{I_C}{\beta} (R_{th} + (1 + \beta) R_E) = -V_{th} - V_{EB}$$

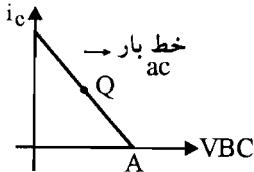
برای اینکه نقطه کار از پایداری خوبی در برابر β برخوردار باشد باید داشته باشیم:

$$\frac{R_{th}}{\beta_{min}} = 0.1 R_E \Rightarrow R_{th} = 0.1 \beta_{min} \times R_E = 0.1 \times 50 \times 0.5 = 2.5 K\Omega$$

برای اینکه در تقویت کننده بیس مشترک حداقل دامنه نوسان متقارن خروجی را داشته باشیم:

$$V_{BCQ} = \frac{V_{BC}(A) + V_{BC}(\text{sat})}{2} \quad (\text{II})$$

نقطه A محل تلاقي خط بار ac با می باشد.



$$ac: V_{BC} - V_{BCQ} = -R_{ac}(i_C - i_{CQ})$$

$$R_{ac} = 2K\Omega$$

$$i_C = 0 \Rightarrow V_{BC}(A) = V_{BCQ} + 2i_{CQ}$$

$$(II): V_{BCQ} = \frac{V_{BC}(A) + V_{BC}(\text{sat})}{2}$$

صرفنظر می کنیم $V_{BC}(\text{sat})$ از

$$(II): V_{BCQ} = \frac{V_{BC}(A)}{2} = \frac{V_{BCQ} + 2i_{CQ}}{2}$$

$$\Rightarrow V_{BCQ} = 2i_{CQ} \quad (\text{III})$$

$$\text{KVL: } 0.5I_E + 2I_C = -V_{CC} - V_{EB} - V_{BC} \Rightarrow 0.5\left(\frac{1+\beta}{\beta}\right)I_C + 2I_C = -(-10) - V_{EB} - 2I_C$$

$$\beta = \beta_{av} = \frac{0.5 + 10}{2} = 5.5$$

$$\Rightarrow 0.5\left(\frac{1+5.5}{5.5}\right)I_C + 2I_C = 10 - 2I_C - 0/V = 10 - 2I_C \Rightarrow I_C = 2/0.6 \text{ mA}$$

در حلقه ورودی KVL را می نویسیم:

$$R_{th}I_B + 0.5(I_B + I_C) = -V_{th} - 0/V = -V_{th} - 0/V$$

$$\beta_{av} = 5.5 \Rightarrow 0.5 \times \frac{2/0.6}{5.5} + 0.5\left(\frac{2/0.6}{5.5} + 2/0.6\right) = -V_{th} - 0/V$$

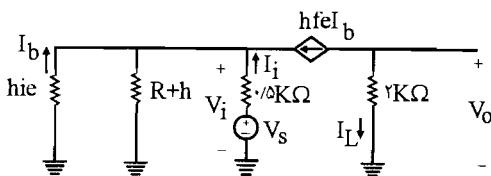
$$\Rightarrow V_{th} = -1/1.2$$

$$\begin{cases} R_{th} = 2/0.5 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\ V_{th} = -1.0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -1/1.2 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0/1.2 \end{cases} \Rightarrow R_1 \times 0/1.2 = 2/0.5 \Rightarrow R_1 = 13/1.2 K\Omega \quad \text{و } R_2 = 3/0.5 K\Omega$$

$$h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{5.5 \times 26}{2/0.6} = 0/94 K\Omega$$

(ب)

مدار معادل به صورت زیر می باشد:



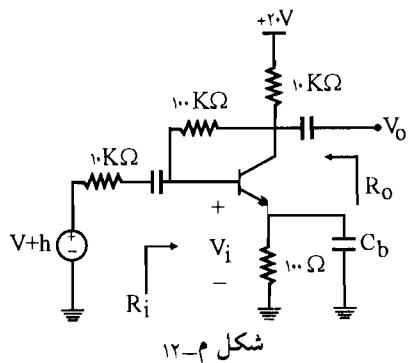
$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-h_{fe} I_B}{-h_{fe} I_b - I_b - \frac{h_{ie} I_b}{10}} = \frac{0.94}{10 + 1 + \frac{0.94}{10}} = 0.9V$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{-h_{ie} I_b}{-h_{fe} I_b - I_b - \frac{h_{ie} I_b}{10}} = \frac{0.94}{10 + 1 + \frac{0.94}{10}} = 12\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = 0.9V \times \frac{10}{12 \times 10^{-3}} = 161/V$$

$$A_{Vs} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = 161/V \times \frac{12 \times 10^{-3}}{12 \times 10^{-3} + 0.9} = 3/A$$

$$R_o = 1K\Omega$$



۱۲ - در تقویت کننده شکل م - ۱۲ با فرض
 $h_{re} = 2 \times 10^{-4}$ و $h_{oe}^{-1} = 30 K\Omega$ و $h_{fe} = 150$
 با استفاده از دل دقيق هيريد h مقادير كميتهای A_I , R_o و A_{Vs} , A_V , R_i را محاسبه کنيد؟

(ا) حل:

$$\text{KVL: } 1.0(I_B + I_C) + 100 I_B + 0.1 I_E = V_{CC} - V_{BE} = 20 - 0.7V = 19.3V$$

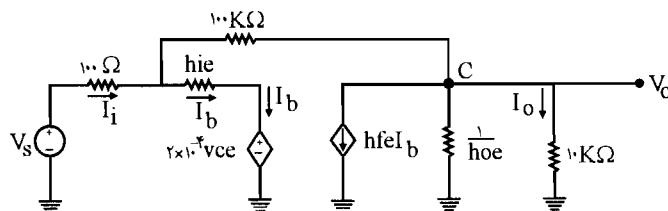
$$\Rightarrow 1.0(I_B + I_C) + 100 I_B + 0.1(I_B + I_C) = 19.3 \Rightarrow 1.1(I_B + I_C) + 100 I_B = 19.3$$

$$\Rightarrow 1.1 \times (I_B + \beta I_B) + 100 I_B = 19.3 \Rightarrow I_B = \frac{19.3}{100 + 1.1 \times 150} = 0.11mA$$

$$I_C = \beta I_B = 1.5mA$$

$$h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{150 \times 26}{1.5mA} = 2191\Omega = 2.191 K\Omega$$

مدار معادل را رسم می کنیم:



در حلقه $10\text{ K}\Omega$ و $100\text{ K}\Omega$ و h_{ie} می‌نویسیم:

$$\text{KVL: } -h_{ie}I_b + (I_i - I_b) \times 100\text{ K}\Omega + 10I_O = 2 \times 10^{-4}V_{ce} = 2 \times 10^{-4}V_O$$

$$\begin{cases} V_O = V_{ce} \\ V_O = 10I_O \end{cases} \Rightarrow -2/19I_b + 100(I_i - I_b) + 10I_O = 2 \times 10^{-4} \times 10V_O \Rightarrow$$

$$100I_i - 102/19I_b + (10 - 2 \times 10^{-4})I_O = 0 \quad (\text{I})$$

$$\text{KCL: } I_i - I_b = I \times 100\text{ K}\Omega = h_{fe}I_b + I_O + \frac{10I_O}{h_{oe}} = 15I_b + I_O + \frac{10I_O}{30}$$

$$\Rightarrow 151I_b = I_i - \frac{4}{3}I_O \Rightarrow I_b = \frac{I_i}{151} - \frac{4}{453}I_O \quad (\text{II})$$

رابطه (II) را در رابطه (I) جایگذاری می‌کنیم:

$$100I_i - 102/19 \times \left(\frac{I_i}{151} - \frac{4}{453}I_O \right) + (10 - 2 \times 10^{-4})I_O = 0$$

$$\Rightarrow A_I = \frac{I_O}{I_i} = -9/1$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{h_{ie}I_b + 2 \times 10^{-4}V_{ce}}{I_i} = \frac{2/19I_b + 2 \times 10^{-4} \times 10I_O}{I_i} = \frac{2/19 \left(\frac{I_i}{151} - \frac{4}{453}I_O \right) + 2 \times 10^{-4}I_O}{I_i}$$

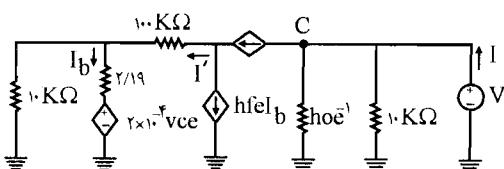
$$= \frac{219}{151} - \frac{4 \times 2/19}{453}A_I + 2 \times 10^{-4}A_I = \frac{2/19}{151} - \frac{4 \times 2/19}{453} \times (-9/1) + 2 \times 10^{-4}(-9/1) = 172\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -9/1 \times \frac{10}{172} = -52.9$$

$$A_{Vs} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -52.9 \times \frac{172}{172 + 10} = -49.5$$

برای به دست آوردن مقاومت خروجی یک منبع ولتاژی V را در خروجی در دو سر مقاومت $10\text{ K}\Omega$ قرار

می‌دهیم و ورودی را صفر می‌کنیم:



$$\text{KCL: } I = \frac{V}{10} + \frac{V}{h_{oe}} + h_{fe}I_b + I' \quad (\text{I})$$

$$I' = I_b + 10\text{ K}\Omega$$

$$\Rightarrow I' = I_b + \frac{2/19I_b + 2 \times 10^{-4}V_{ce}}{10} , \quad V_{ce} = V \Rightarrow I' = I_b + \frac{2/19I_b + 2 \times 10^{-4}V}{10}$$

$$\Rightarrow I' = 1/219 I_b + 2 \times 10^{-5} V \quad (\text{II})$$

$$\text{KVL: } 100 I' + 2/19 I_b = V - 2 \times 10^{-4} V_{ce} = V - 2 \times 10^{-4} V = 0.9998 V$$

$$\Rightarrow 100(1/219 I_b + 2 \times 10^{-5} V) + 2/19 V = 0.9998 V$$

$$\Rightarrow I_b = \frac{0.9998}{124/0.9} V = 0.4 \times 10^{-5} V$$

$$\Rightarrow I' = 1/219 \times 0.4 \times 10^{-5} V + 2 \times 10^{-5} V = 9/82 \times 10^{-5} V$$

$$(\text{I}): \quad I = \frac{V}{10} + \frac{V}{30} + 150 \times 0.4 \times 10^{-5} V + 9/82 \times 10^{-5} V$$

$$\Rightarrow I = V(0/1 + \frac{1}{30} + 150 \times 0.4 \times 10^{-5} + 9/82 \times 10^{-5}) = 1/249$$

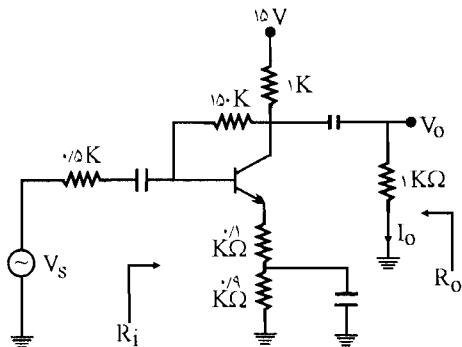
$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1}{1/249} = 241 \Omega$$

۱۳- در مدار شکل م-۱۳ با فرض $V_{CE(sat)} = 0.2 V$ و $h_{fe} \approx 150$ ، $h_{re} \approx 0$ ، $h_{oe} \approx 0$ نقطه کار DC را تعیین کنید؟

ب) معادله خط بار DC و ac را بنویسید؟

ج) حد اکثر دامنه نوسان بدون اعوجاج ولتاژ خروجی از بالا و پایین تقریباً چقدر است؟

د) مقادیر کمیت‌های Λ_V ، Λ_I ، Λ_{Vs} و R_i را محاسبه کنید؟



شکل م-۱۳

۱۴- هل: برای به دست آوردن نقطه کار باید V_{CEQ} و I_{CQ} را به دست آوریم:

در حلقه V_{CC} و V_{BE} و $1K\Omega$ و $150K\Omega$ و $1K\Omega$ و $0.9K\Omega$ و زمین KVL را می‌نویسیم:

$$1K\Omega \times (I_C + I_B) + 150 I_B + 0.9 I_E + 0.9 I_E = V_{CC} - V_{BE} = 15 - 0.9 = 14/3$$

$$1 \times (I_C + I_B) + 150 I_B + (0.1 + 0.9)(I_C + I_B) = 14/3$$

$$\Rightarrow 2 \times (I_C + I_B) + 150 I_B = 14/3 \Rightarrow 2(1 + \beta) I_B + 150 I_B = 14/3$$

$$I_B \times (150 + 2 \times 150) = 14/3 \Rightarrow I_B = \frac{14/3}{150 + 30} = 0.032 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 150 \times 0.032 = 4.8 \text{ mA} \Rightarrow I_{CQ} = 4.8 \text{ mA}$$

$$dc \text{ معادله خط بار } V_{CE} \approx V_{CC} - 1K\Omega (I_C + I_B) - (0.1 + 0.9) (I_B + I_C)$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 15 - 2(I_C + I_B) = 15 - 2(1 + \beta) I_B = 15 - 2 \frac{(1 + \beta)}{\beta} I_C$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 15 - 2 \times \frac{15}{15} I_C = 15 - 2 \times \frac{15}{15} \times 4/74 mA = 5/46 V$$

$$\Rightarrow DC \text{ نقطه کار} : \begin{cases} I_{CQ} = 4/74 mA \\ V_{CEQ} = 5/46 V \end{cases}$$

$$DC \text{ معادله خط بار} : V_{CE} = 15 - 2 \times \frac{(1 + \beta)}{\beta} I_C = 15 - 2/0.13 I_C$$

$$ac \text{ معادله خط بار} : V_{ce} = -R_{ac} i_c$$

$$R_{ac} = (1K\Omega \parallel 1K\Omega) + 0.1 = \frac{1 \times 1}{1+1} + 0.1 = 0.6 K\Omega$$

$$V_{CE} - V_{CEQ} = -R_{ac} (i_C - i_{CQ})$$

$$V_{CE} - 5/46 = -0.6 (i_C - 4/74) \Rightarrow V_{CE} = 8/3 - 0.6 i_C$$

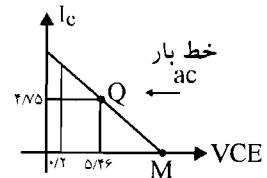
$$ac \text{ معادله خط بار} : V_{CE} = 8/3 - 0.6 i_C$$

(ج)

محل تلاقی خط بار ac را با محور M، V_{CE} می‌نامیم و داریم:

$$V_{CE}(M) = 8/3 - 0.6 \times 0 = 8/3 V$$

$$V_o = V_{ce} + 0.1 I_C = 8/3 + 0.1 \times 0 = 8/3$$



اگر $I_C = I_{CQ}$ باشد. خروجی V_o مقدار dc خواهد شد. و داریم:

$$V_o = 5/46 + 0.1 \times 4/74 = 5/93 V$$

برای محاسبه جریان اشباع به جای V_{CE} مقدار $8/3$ را قرار می‌دهیم:

$$V_{CE} = 8/3 - 0.6 i_C \Rightarrow 8/3 = 8/3 - 0.6 i_C \Rightarrow i_C(\text{sat}) = \frac{8/3}{0.6} = 13/5 mA$$

$$V_o = 0/2 + 0.1 i_C(\text{sat})$$

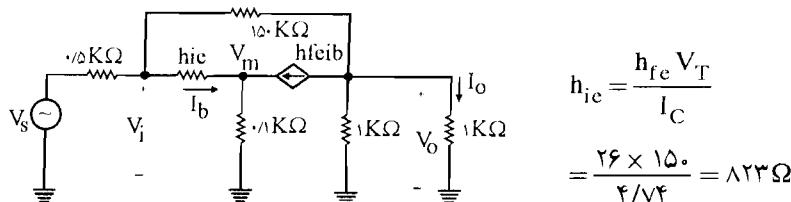
در حالت اشباع خروجی عبارتست از:

$$V_o = 0/2 + 0.1 \times 13/5 = 1/50 V$$

$$= 8/3 - 5/93 = 2/37 V \quad (\text{قطع}) \Rightarrow V_O = V_O - V_O = 8/3 - 5/93 = 2/37 V$$

$$= 1/50 - 5/93 = -4/38 V \quad (\text{اشباع}) \Rightarrow V_O = V_O - V_O = 1/50 - 5/93 = -4/38 V$$

د) مدار معادل ac به صورت زیر خواهد بود.



برای به دست آوردن مقادیر خواسته شده بند (ج) باید مدار معادل ac را تحلیل نمود که با استفاده از قواعد مداری نظری روش تحلیل گره می‌توان ولتاژ‌گرهای را محاسبه نمود و سپس تمامی مقادیر دیگر را به دست آورد.

$$10^{-3} \times \begin{bmatrix} \frac{1}{0.5} + \frac{1}{150} + \frac{1}{0.823} & -\frac{1}{0.823} & -\frac{1}{150} \\ -\frac{1}{0.823} & \frac{1}{0.823} + \frac{1}{0.1} & 0 \\ -\frac{1}{150} & 0 & 2 + \frac{1}{150} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_i \\ V_m \\ V_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_s}{0.5} \\ 0 \\ -150 i_b \end{bmatrix}$$

$$i_b = \frac{V_i - V_m}{0.823}$$

با حل معادله فوق داریم:

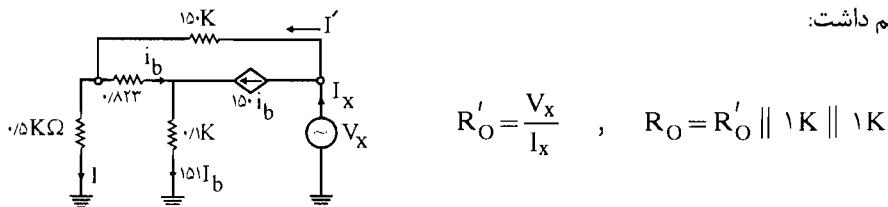
$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -4/V$$

$$I_i = \frac{V_s - V_i}{0.5 K\Omega}, \quad I_O = \frac{V_o}{1 K\Omega}$$

$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = -46/V \quad R_i = \frac{V_i}{I_i} \cong 10 K\Omega$$

$$A_{Vs} = A_V \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -4/V \times \frac{10 K}{10 K + 0.5 K} = -4/4V$$

برای محاسبه R_o یک منبع فرضی V_x در خروجی قرار می‌دهیم و V_s را اتصال کوتاه می‌کنیم بنابراین خواهیم داشت:



ابتدا یک KCL در حلقه، V_x ، 150K و 150K می‌زنیم:

$$\begin{cases} I' = I_x - 150I_b \\ I = I_x - 150I_b - I_b \end{cases}$$

$$-V_x + 150I' + 0.05I = 0 \Rightarrow V_x = 150(I_x - 150I_b) + 0.05(I_x - 150I_b)$$

$$\Rightarrow V_x = 150.0.05I_x - 225.05I_b \quad (1)$$

در حلقه KVL $0.05K + 0.823I_b + 0.1 \times 150I_b = 0$

$$-0.05I + 0.823I_b + 0.1 \times 150I_b = 0$$

$$-0.05(I_x - 150I_b) + 15/92I_b = 0 \Rightarrow I_b = \frac{0.05}{91/42}I_x \quad (2)$$

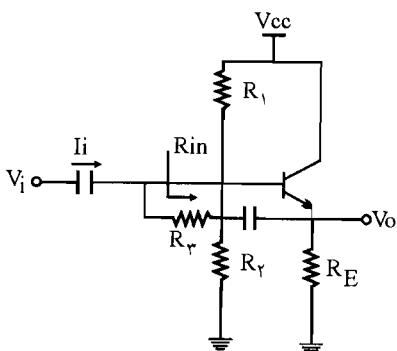
از رابطه (۲) و (۱) خواهیم داشت:

$$V_x = 150/0.05I_x - \frac{225/0.05}{91/42}I_x \Rightarrow \frac{V_x}{I_x} = 149\text{K}\Omega = R'_o$$

$$R_o = R'_o \parallel 1\text{K} \parallel 1\text{K} = 0.498\Omega$$

۱۴- یک مدار بافر با مشخصات $A_V > 99$ و $R_i > 2M\Omega$ ، با استفاده از روش بوت استرپ به نحوی طراحی کنید که مدار دارای پایداری مطلوب نسبت به تغییرات β بوده و دامنه نوسان متقاض خروجی آن حداقل باشد. با فرض $V_{CC} = 15\text{V}$ و $h_{fe} = 100$.

(ا) هل:



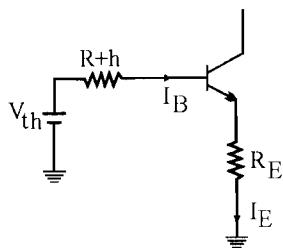
طرح کلی مدار بوت استرپ به صورت مدار مقابل می‌باشد. داریم که:

$$R_{eff} = \frac{V_i}{I_{R_\gamma}} = \frac{V_i}{\frac{V_i - V_o}{R_\gamma}} = \frac{R_\gamma}{1 - A_V}$$

$$R_i = R_{eff} \parallel R_{in} = R_{eff} \parallel (h_{ie} + [1 + h_{fe}] R_E) > 2M\Omega$$

با استفاده از مدار معادل تونن داریم:

$$V_{th} = V_{CC} \cdot \frac{R_\gamma}{R_1 + R_\gamma}, \quad R_{th} = R_\gamma + \frac{R_1 R_\gamma}{R_1 + R_\gamma}$$



$$\Rightarrow R_{th} I_B + R_E I_E = V_{th} - V_{BE}$$

$$\left(\frac{R_{th}}{\beta} + R_E \right) I_C \cong V_{th} - V_{BE}$$

اگر بخواهیم دارای پایداری نسبی نسبت به β وجود داشته باشد باید:

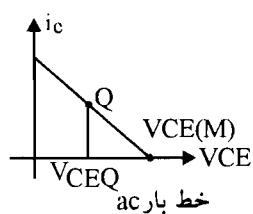
$$\frac{R_{th}}{\beta_{min}} = 0.1 R_E$$

$$R_{th} = 0.1 \times 100 R_E = 10 R_E \quad (1)$$

$$I_C = \frac{V_{th} - V_{BE}}{10 R_E} \quad (2)$$

اگر خط بار ac را بکشیم و با صرف نظر از اشباع نقطه کار و سط خط بار ac باشد داریم:

$$V_{CEQ} = \frac{V_{CE}(M)}{\gamma}$$



$$V_{CE}(M) \cong V_{CC}$$

$$V_{CEQ} = \frac{15}{\gamma} = 1.5 V$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_{CQ}$$

$$I_{CQ} R_E = 1.5 V \quad (3)$$

از رابطه (2) داریم:

$$V_{th} - 0.1 = 0.1 \times 1.5 \Rightarrow V_{th} = 1.95 V$$

در تقویت کننده کلکتور مشترک داریم:

$$A_V = \frac{(1 + h_{fe}) R_E}{h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_E}$$

$$\text{اگر به جای } h_{fe} \text{ مقدار متوسط } \beta \text{ را قرار دهیم } h_{fe} = \frac{125}{\gamma} = 125 \text{ خواهیم داشت:}$$

$$A_V = \frac{125 R_E}{h_{ie} + 125 R_E} , \quad I_C = \frac{h_{fe} V_T}{h_{ie}} = \frac{1.95 - 0.1}{0.1 R_E} \Rightarrow h_{ie} = 0.43 R_E$$

$$A_V = \frac{125 R_E}{0.43 R_E + 125 R_E} = 0.996$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$R_{in} = h_{ie}(\text{min}) + [1 + h_{fe}(\text{min})] R_E > 2 M\Omega$$

$$\frac{h_{fe}(\text{min}) \cdot V_T}{I_{CQ}} + [1 + h_{fe}(\text{min})] R_E > 2 M\Omega \quad (4)$$

از رابطه (۴) و (۳) خواهیم داشت:

$$\frac{100 \times 26 \times 10^{-3}}{I_{CQ}} + \frac{(1 + 100) V_D}{I_{CQ}} > 2000 \times 10^3$$

و خواهیم داشت:

$$I_{CQ} < 0.001 \text{ mA}$$

$$\frac{V_D}{R_E} < 0.001 \text{ mA} \Rightarrow R_E > 1000 / 0.001 \text{ K}\Omega$$

$$I_{CQ} = \frac{V_D}{R_E} = 0.001 \text{ mA} \quad \text{که } R_E = 22 \text{ K}\Omega \text{ باشد.}$$

$$R_{in} = \frac{100 \times 26 \times 10^{-3}}{0.001} + 100 \times 20 = 222 \text{ M}\Omega$$

$$\frac{1}{R_{eff}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{22} = 19 \text{ M}\Omega$$

$$R_{eff} = \frac{R_1}{1 - A_V} \Rightarrow R_1 = (1 - A_V) \times R_{eff} = 100 \text{ K}\Omega$$

$$R_{th} = 100 \text{ K}\Omega = 100 \text{ K}\Omega = R_1 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 142 \text{ K}\Omega \quad (5)$$

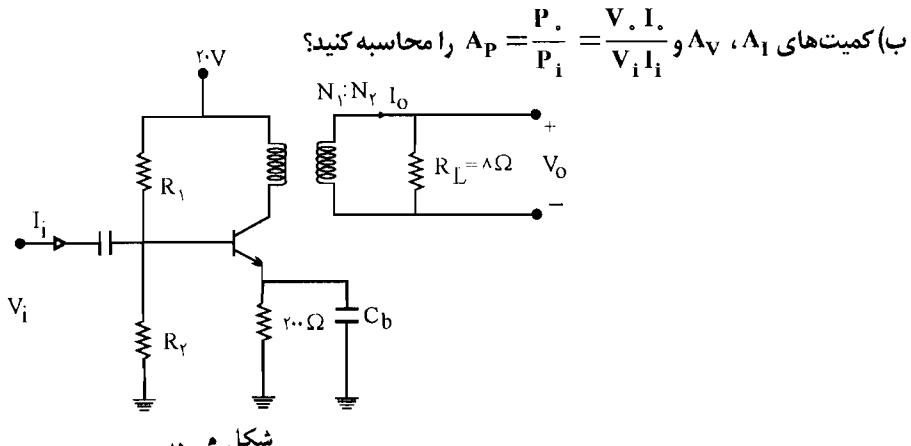
$$V_{th} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{100}{142} = 0.596 \quad (6)$$

$$(5) \text{ و } (6) \Rightarrow R_1 \times 0.596 = 142 \text{ K}\Omega \Rightarrow R_1 = 238 / 25 \text{ K}\Omega$$

$$\frac{R_2}{238 / 25 + R_2} = 0.596 \Rightarrow R_2 = 351 / 5 \text{ K}\Omega$$

۱۵- تقویت کننده شکل م-۱۵ که بنام تقویت کننده کلاس A با کوپلаз ترانسفورماتوری معروف است را در نظر بگیرید. با فرض $h_{fe} = 50$ ، ترانسفورماتور ایده‌آل با مقاومت اهمی صفر و $\frac{N_1}{N_2} = 5$

الف) مقادیر R_2 و R_1 را طوری تعیین کنید که نقطه کار از پایداری خوبی نسبت به تغییرات β برخوردار باشد و در وسط خط بار ac قرار گیرد.



راه حل:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{th} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 20 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \end{array} \right.$$

مدار معادل تونن را در ورودی می‌یابیم:

و برای اینکه نقطه کار از پایداری خوبی نسبت به تغییرات β برخوردار باشد باید رابطه زیر را داشته باشیم:

$$\frac{R_{th}}{\beta} \leq 0.1 R_E \Rightarrow R_{th} = 0.1 \beta R_E = 0.1 \times 50 \times 0.2 = 1 K\Omega$$

$$KVL: R_{th} I_B + R_E I_E = V_{th} - V_{BE} \Rightarrow R_{th} I_B + R_E (1 + \beta) I_B = V_{th} - 0.7V$$

$$\Rightarrow \frac{I_C}{\beta} \left[R_{th} + R_E (1 + \beta) \right] = V_{th} - 0.7V \Rightarrow I_C \left[\frac{R_{th}}{\beta} + \frac{R_E (1 + \beta)}{\beta} \right] = V_{th} - 0.7V \quad (1)$$

و برای اینکه نقطه کار در وسط خط بار ac قرار گیرد باید داشته باشیم:

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_{dc} + R_{ac}} \quad \text{از } V_{CE(sat)} \text{ صرفنظر می‌کنیم:}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{ac} + R_{dc}} \quad \left\{ \begin{array}{l} R_{dc} = 0.2 K\Omega \\ R_{ac} = 1\Omega \times \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 9 \times 25 = 225 \Omega \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow I_{CQ} = \frac{20}{20/2 + 20} = 20 \text{ mA}$$

R_{ac}: مقاومت انتقال یافته $\Delta\Omega$ به اولیه ترانس می‌باشد.
این مقدار به دست آمده را در رابطه (I) قرار می‌دهیم:

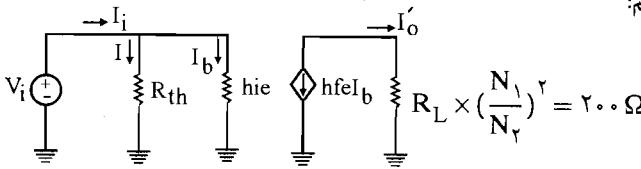
$$20 \text{ mA} \left[\frac{1}{20} + \frac{20}{20} \times \frac{20}{20} \right] = V_{th} - 20/V \Rightarrow V_{th} = 11/9 \text{ V}$$

$$\begin{cases} V_{th} = 20 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 11/9 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{11/9}{2} \\ R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1K\Omega \Rightarrow R_1 \times \frac{11/9}{2} = 1 \Rightarrow R_1 = \frac{20}{11/9} = 18 K\Omega \end{cases}$$

$$R_2 = \frac{R_1 R_{th}}{R_1 - R_{th}} = 2/43 \text{ K}\Omega$$

$$I_{CQ} = 20 \text{ mA} \Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{20 \times 26}{20} = 26 \Omega$$

ب) مدار معادل ac را رسم می‌کنیم:



I_o' : جریان خروجی در اولیه ترانس می‌باشد.

$$A'_I = \frac{I_o'}{I_i} = \frac{-h_{fe} I_b}{I_b + I} = \frac{-h_{fe} I_b}{I_b + \frac{h_{ie} I_b}{R_{th}}} = \frac{-h_{fe}}{1 + \frac{h_{ie}}{R_{th}}} = \frac{-20}{1 + \frac{26}{18 K\Omega}} = \frac{-20}{1 + \frac{26}{18000}} = -4.8/V$$

$$A_I = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_o'} \times \frac{I_o'}{I_i} = \frac{N_1}{N_2} \times A'_I = 20 \times -4.8/V = -243/5$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{h_{ie} I_b}{I_b + \frac{h_{ie} I_b}{R_{th}}} = \frac{h_{ie}}{1 + \frac{h_{ie}}{R_{th}}} = \frac{26 \times 10^{-3}}{1 + \frac{26 \times 10^{-3}}{1}} = 25/3 \Omega$$

$$A'_V = A'_I \times \frac{R_L'}{R_i} = -4.8/V \times \frac{20}{25/3} = -3.80$$

$$A_V = \frac{N_2}{N_1} \times A'_V = \frac{1}{5} \times -3.80 = -0.76$$

$$A_P = A_V \times A_I = (-0.76) \times (-243/5) = 187.56$$

از رابطه به دست آمده برای h_{ie} داريم:

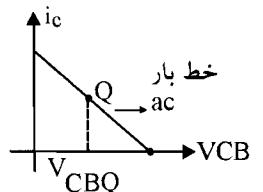
$$h_{ie} = \frac{26 \times 10^{-3} (R_{th} + 0.5\Omega)}{(V_{th} - 0.5V)} \Rightarrow \frac{1}{30} K\Omega = 26 \times 10^{-3} \left(\frac{0.5 \times 10^{-3} + 0.5\Omega}{V_{th} - 0.5V} \right)$$

$$\Rightarrow V_{th} - 0.5V = 30 \times 26 \times 10^{-3} \times (0.5\Omega + 0.5 \times 10^{-3}) \Rightarrow V_{th} = 1/172V$$

يکي ديگر از شرایط مطلوب تقویت کننده وسط بودن نقطه کار در وسط خط بار ac می باشد و اين شرط را نيز بررسی می کنيم:

$$V_{cb} = -R_{ac} i_C \quad R_{ac} = R_L$$

$$\Rightarrow V_{CB} - V_{CBQ} = -R_L (i_C - I_{CQ})$$



$$\Rightarrow V_{CB} (A) = V_{CBQ} + R_L I_{CQ}$$

از $V_{CB} (sat)$ صرفنظر می کنيم و برای اينکه نقطه کار در وسط خط بار ac می باشد باید داشته باشيم:

$$V_{CBQ} = \frac{V_{CB} (A)}{2} = \frac{V_{CBQ} R_L I_{CQ}}{2} \Rightarrow V_{CBQ} = R_L I_{CQ}$$

$$V_{CBQ} = V_{CC} - R_L I_{CQ} - V_{th} - R_{th} I_{BQ} \Rightarrow$$

$$2R_L I_{CQ} + \frac{R_{th}}{\beta} I_{CQ} = V_{CC} - V_{th} \Rightarrow 20 I_{CQ} + \frac{0.5 \times 10^{-3}}{10} I_{CQ} = V_{CC} - 1/172$$

$$\Rightarrow I_{CQ} = \frac{V_{CC} - 1/172}{20/0.5\Omega} \quad (IV)$$

و طبق رابطه به دست آمده برای I_B داريم:

$$I_{BQ} = \frac{V_{th} - 0.5V}{R_{th} + 0.5 \times 10} = \frac{V_{th} - 0.5V}{R_{th} + 0.5\Omega}$$

$$\Rightarrow I_{BQ} = \frac{1/172 - 0.5V}{0.5 \times 10^{-3} + 0.5\Omega} = 0.5mA \Rightarrow I_{CQ} = 10 \times I_{BQ} = 10 \times 0.5mA = 5mA$$

اين مقدار به دست آمده را در رابطه (IV) قرار مي دهيم:

$$5mA = \frac{V_{CC} - 1/172}{20/0.5\Omega} \Rightarrow V_{CC} = 15V/2 V$$

$$\begin{cases} V_{th} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 15V/2 \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 50 \times 10^{-3} \end{cases}$$

$$\frac{50 \times 10^{-3}}{1/172} = \frac{R_2}{15V/2} \Rightarrow R_2 = 7/38 K\Omega \quad \text{این دو رابطه را برابر میکنیم} \Leftrightarrow$$

$$V_O = h_{oe}^{-1} \left(-h_{fe} I_b - \frac{V_o}{10} \right) - h_{ie} I_b \quad \text{رابطه (II) را در رابطه (I) قرار می‌دهیم:}$$

$$\Rightarrow V_O = 10 \left(-h_{fe} I_b - \frac{V_o}{10} \right) - h_{ie} I_b \Rightarrow 2V_O = -10 h_{fe} I_b - h_{ie} I_b$$

$$\Rightarrow 2V_O = -I_b (10 h_{fe} + h_{ie}) \Rightarrow I_b = \frac{-2V_O}{10 h_{fe} + h_{ie}} \quad (\text{III})$$

در حلقه R_s و V_s نیز KVL می‌زنیم:

$$\text{KVL: } V_s = R_s I_b - h_{ie} I_b = 50 \times 10^{-3} (-I_b - h_{fe} I_b) - h_{ie} I_b$$

در این رابطه به جای I مقدار به دست آمده از رابطه (II) را قرار می‌دهیم:

$$= 50 \times 10^{-3} (h_{fe} I_b + \frac{V_o}{10} - I_b - h_{fe} I_b) - h_{ie} I_b$$

$$\Rightarrow V_s = 0.05 \left(\frac{V_o}{10} - I_b \right) - h_{ie} I_b$$

وبه جای I_b مقدار به دست آمده از رابطه (III) را قرار می‌دهیم:

$$V_s = 0.05 \left(\frac{V_o}{10} + \frac{2V_o}{10 h_{fe} + h_{ie}} \right) + h_{ie} \times \frac{2V_o}{(10 h_{fe} + h_{ie})}$$

$$\Rightarrow V_s = V_o \left(0.005 + \frac{2(h_{ie} + 0.05)}{100 + h_{ie}} \right)$$

$$\Rightarrow A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{100 + h_{ie}}{0.05 + 0.005 h_{ie} + 2 h_{ie} + 0.1} = \frac{100 + h_{ie}}{0.05 h_{ie} + 0.6}$$

برای اینکه A_{vs} حداقل شود باید در رابطه بالا h_{ie} مینیمم شود و کمترین مقدار h_{ie} صفر می‌باشد که در

این صورت:

$$h_{ie} = 0 \Rightarrow A_{vs} = \frac{100 + 0}{0.05 \times 0 + 0.6} = \frac{100}{0.6} = 167$$

اما از نظر عملی h_{ie} نمی‌تواند صفر باشد (برای اینکه h_{ie} صفر باشد A باید خیلی بزرگ باشد) بنابراین ماکریم $A_{SV} = 90\%$ این مقدار به دست آمده در نظر گرفته می‌شود در نتیجه داریم:

$$\frac{100 + h_{ie}}{2/0.5 h_{ie} + 0.6} \Rightarrow h_{ie} = \frac{100 - 90}{2/0.5 \times 150 - 1} = \frac{1}{30} K\Omega$$

یکی دیگر از شرایط مورد نیاز پایداری مطلوب نسبت به β می‌باشد:

$$KVL: R_{th} I_B + R_s I_E = V_{th} - V_{BE} \Rightarrow R_{th} \frac{I_C}{\beta} + R_s I_C \left(\frac{1+\beta}{\beta} \right) = V_{th} - V_{BE}$$

$$\Rightarrow \frac{R_{th}}{10} I_C + R_s \times \frac{11}{10} I_C = V_{th} - 0.7V$$

و برای اینکه پایداری نسبت به تغییرات β باید داشته باشیم:

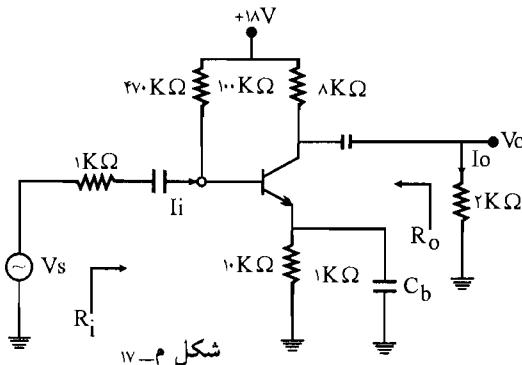
$$\frac{R_{th}}{10} = 0.1 R_s \times \frac{11}{10} \Rightarrow R_{th} = 1/1 R_s = 1/1 \times 50 \Omega = 50 \Omega$$

$$V_{th} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow R_1 = 50/4$$

(۱۷) - در تقویت کننده شکل م-۱۷ ترانزیستور دارای $h_{re} = 20$ و $h_{oe} = 0$ است.

الف) کمیت‌های A_I , A_V , R_O , R_i و R_{re} را محاسبه کنید؟

ب) اگر خازن کنار گذر C_b را برداریم مقادیر جدید R_O و R_i چقدر خواهد بود؟



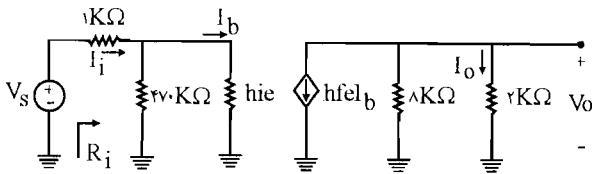
راه حل:

$$KVL: 4V_0 I_B + 1 \times I_E = V_{CC} - V_{BE} = 18 - 0.7V = 17.3V \quad (\text{الف})$$

$$\Rightarrow 4V_0 \times I_B + (1 + \beta) I_B = 17.3V \Rightarrow I_B = \frac{17.3V}{4V_0 + (1 + 20)} = 0.35mA$$

$$\Rightarrow I_C = \beta I_B = 20 \times 0.35mA = 7mA \Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{20 \times 26}{0.7V} = 72.28 K\Omega$$

حال مدار معادل ac را رسم می‌کنیم:



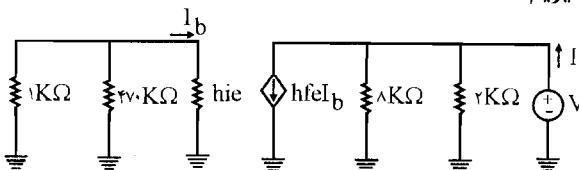
$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-h_{fe} I_b \times \frac{r K\Omega}{r + h_{ie} K\Omega}}{I_b + \frac{h_{ie} I_b}{V_s}} = \frac{-h_{fe} \times -2}{1 + \frac{h_{ie}}{V_s}} = -16$$

$$R_i = V_s K\Omega \parallel h_{ie} = V_s K\Omega \parallel \frac{V_s}{h_{ie}} = \frac{V_s}{h_{ie} + V_s} K\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -16 \times \frac{r}{\frac{V_s}{h_{ie} + V_s}} = -43/5$$

$$A_{Vs} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -43/5 \times \frac{\frac{V_s}{h_{ie} + V_s}}{\frac{V_s}{h_{ie} + V_s} + 1 K\Omega} = -18/43$$

برای به دست آوردن مقاومت خروجی R_O یک منبع ولتاژ را موازی مقاومت $r K\Omega$ در خروجی قرار می‌دهیم و منبع ولتاژ ورودی را صفر می‌گیریم:

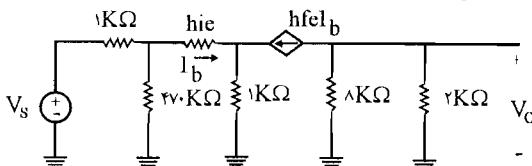


$$I = \frac{V}{r} + \frac{V}{h_{ie} + V_s} + h_{fe} I_b$$

و چون در حلقه ورودی هیچ منبع ولتاژی وجود ندارد پس $I_b = 0$ می‌باشد:

$$\Rightarrow I = \frac{V}{r} + \frac{V}{h_{ie} + V_s} = V \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{h_{ie} + V_s} \right) \Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1}{\frac{1}{r} + \frac{1}{h_{ie} + V_s}} = 1/6 K\Omega$$

ب) در این صورت مدار معادل ac به صورت زیر در می‌آید:

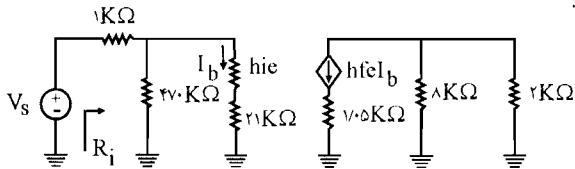


با استفاده از دوگان قضیه میلر داریم:

$$K' = \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_{fe} I_b}{I_b} = h_{fe} = 2.$$

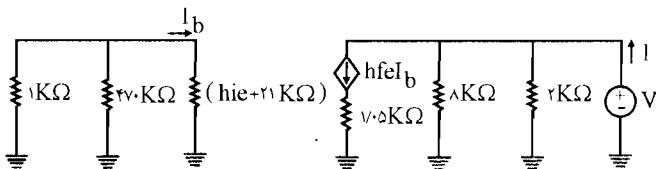
$$\left\{ \begin{array}{l} R'_1 = (1 + K') R' = 21 \times 1 K\Omega = 21 K\Omega \\ R'_2 = \left(\frac{K' + 1}{K'} \right) R' = 0.5 K\Omega \end{array} \right.$$

پس مدار معادل به صورت زیر در می‌آید:



$$R_i = 4V_0 K\Omega \parallel (h_{ie} + R'_1) = 4V_0 \parallel (0.5V_0 + 21) = 20/77 K\Omega$$

و برای به دست آوردن R_O یک منبع ولتاژ V را موازی مقاومت $2 K\Omega$ و قرار می‌دهیم و منبع ولتاژ ورودی را صفر قرار می‌دهیم.

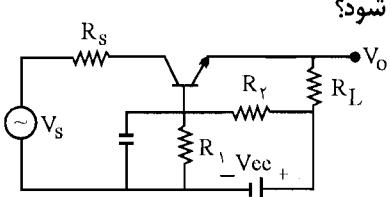


$$I = \frac{V}{1} + 20 I_b + \frac{V}{2}$$

و چون در حلقه ورودی منبع ولتاژ نداریم پس I_b صفر می‌باشد.

$$I = \frac{V}{1} + \frac{V}{2} = V \left(\frac{1}{16} \right) \Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = 1/6 K\Omega$$

۱۶- در مدار شکل م-۱۶، $R_s = 50 \Omega$ و $R_1 = 10 K\Omega$ ، $h_{oe}^{-1} = 10 K\Omega$ ، $h_{re} = 0$ ، $h_{fe} = 10$ V_{CC} و R_2 را چنان تعیین کنید که A_{vs} حداقل شود؟

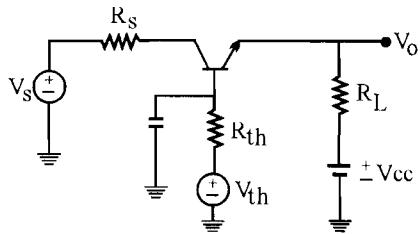


شکل م-۱۶

: راه حل:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\ V_{th} = V_{CC} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} \end{array} \right.$$

مدار معادل تونن بین بیس و زمین را می‌یابیم:



در تحلیل V_s مبنی می‌شود پس در KVL در حلقه V_{BE} و R_{th} و V_{th} داریم:

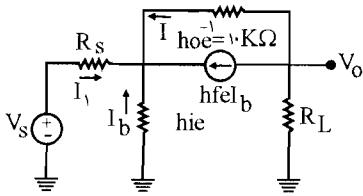
$$\text{KVL: } R_{th} I_B + R_s I_E = V_{th} - V_{BE}$$

$$\Rightarrow R_{th} I_B + 0.01 \times 10^{-3} (1 + \beta) I_B = V_{th} - 0.6 / V \Rightarrow I_B = \frac{V_{th} - 0.6 / V}{R_{th} + 0.01 \times 10^{-3} (1 + 10)} \quad (\text{A})$$

$$\Rightarrow I_C = \beta I_B = \beta \times \left(\frac{V_{th} - 0.6 / V}{R_{th} + (0.01 \times 10^{-3} \times 11)} \right) = 10 \times \left(\frac{V_{th} - 0.6 / V}{R_{th} + (0.01 \times 10^{-3} \times 11)} \right) \quad (\text{B})$$

$$\Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{10 \times V_T}{10 \times \left(\frac{V_{th} - 0.6 / V}{R_{th} + 0.01 \times 10^{-3}} \right)} = \frac{V_T}{\left(\frac{V_{th} - 0.6 / V}{R_{th} + 0.01 \times 10^{-3}} \right)} = \frac{26 \times 10^{-3} \times (R_{th} + 0.01 \times 10^{-3})}{(V_{th} - 0.6 / V)}$$

مدار معادل ac: در حلقه V_{th} , R_L و h_{oe} می‌زنیم:



$$\text{KVL: } V_O = h_{oe} I - h_{ie} I_b \quad (\text{I})$$

$$\text{KCL: } I = -h_{fe} I_b - \frac{V_O}{R_L}$$

$$\Rightarrow I = -h_{fe} I_b - \frac{V_O}{10} \quad (\text{II})$$

با جایگذاری رابطه (II) در رابطه (I) داریم:

$$V_O = 10 \left(-h_{fe} I_b - \frac{V_O}{10} \right) - h_{ie} I_b \Rightarrow 2V_O = - (10 h_{fe} + h_{ie}) I_b$$

$$\Rightarrow I_b = \frac{-2V_O}{10 h_{fe} + h_{ie}} \quad (\text{III})$$

در حلقه V_s , h_{ie} و R_s و V_s می‌زنیم: $V_s = R_s I_b - h_{ie} I_b = R_s (-I - I_b - h_{fe} I_b) - h_{ie} I_b$

در رابطه بالا به جای I مقدار به دست آمده از رابطه (II) را قرار می‌دهیم:

$$\Rightarrow V_s = 0.01 \times 10^{-3} \left(h_{fe} I_b + \frac{V_O}{10} - I_b - h_{fe} I_b \right) - h_{ie} I_b$$

$$\Rightarrow V_s = 0.01 \times 10^{-3} \times \frac{V_O}{10} - I_b (h_{ie} + 0.01 \times 10^{-3})$$

مقدار I_A به دست آمده از رابطه (III) در رابطه بالا قرار می‌دهیم:

$$\Rightarrow V_s = 0 \times 10^{-3} V_o + \frac{2V_o}{10 h_{fe} + h_{ie}} (h_{ie} + 0 \times 10^{-2})$$

$$h_{fe} = 10 \Rightarrow V_s = V_o \left[0 \times 10^{-3} + \frac{2(h_{ie} + 0 \times 10^{-2})}{10 \times 10 + h_{ie}} \right]$$

$$\Rightarrow A_{V_s} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{100 + h_{ie}}{0/0 + 2h_{ie} + 0/000h_{ie} + 0/1} = \frac{100 + h_{ie}}{2/000h_{ie} + 0/6}$$

برای اینکه A_{V_s} ماکزیمم شود، h_{ie} باید مینیمم باشد (مشتق A_{V_s} منفی می‌باشد پس با کاهش می‌یابد)

$$h_{ie} = 0 \Rightarrow A_{V_{s(\max)}} = \frac{100}{0/6} = \frac{500}{3}$$

اما از نظر عملی h_{ie} نمی‌تواند صفر باشند بنابراین $A_{V_s} = 500$. این ماکزیمم مقدار در نظر گرفته می‌شود پس داریم:

$$500 = \frac{100 + h_{ie}}{2/000h_{ie} + 0/6} \Rightarrow h_{ie} = \frac{1}{3} K\Omega$$

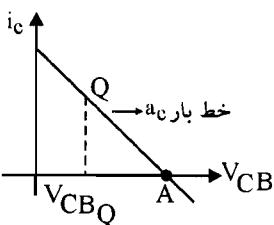
و همچنین پایداری نسبی و مطلوب نسبت به β یکی از شرایط مورد نیاز می‌باشد پس طبق رابطه زیر داریم: $(R_s \text{ و } R_{th} \text{ و } V_{th})$ در حلقه KVL

$$\frac{R_{th}}{\beta} \times I_C + R_s I_C \times \frac{1+\beta}{\beta} = V_{th} - V_{BE} \Rightarrow \frac{R_{th}}{10} I_C + R_C \times \frac{11}{10} I_C = V_{th} - V_{BE}$$

برای اینکه پایداری نسبت به β داشته باشیم:

$$\frac{R_{th}}{10} = 0/1 R_s \times \frac{11}{10} \Rightarrow R_{th} = 0/1 R_s = 0/1 \times 50 = 50 \Omega$$

$$\frac{1}{3} = 26 \times 10^{-3} \left(\frac{50 \times 10^{-3} + 0/50}{V_{th} - 0/V} \right) \Rightarrow V_{th} = 0/172 V$$



وسط بودن نقطه کار در خط بار ac یکی از شرایط مطلوب تقویت کننده است. حال این حالت را بررسی می‌کنیم.

$$V_{cb} = -R_{ac} I_{ac} \quad R_{ac} = R_L$$

$$V_{CB} - V_{CBQ} = -R_L (i_C - I_{CQ})$$

$$V_{CB(A)} = V_{CBQ} + R_L I_{CQ}$$

از $V_{CB}(\text{sat})$ صرف نظر می‌کنیم برای اینکه نقطه کار در وسط خط بار باشد باید داشته باشیم:

$$V_{CBQ} = \frac{V_{CB}(\text{A})}{2} = \frac{V_{CBQ} + R_L I_{CQ}}{2}$$

$$\Rightarrow V_{CBQ} = R_L I_{CQ}$$

$$dc\text{ خط بار}: V_{CBQ} = V_{CC} - R_L I_{CQ} - V_{th} - R_{th} I_{BQ}$$

$$\Rightarrow 2R_L I_{CQ} + \frac{R_{th}}{\beta} I_{CQ} = V_{CC} - V_{th}$$

$$\Rightarrow 2 \cdot I_{CQ} + \frac{50 \times 10^{-3}}{10} I_{CQ} = V_{CC} - 1/172 \Rightarrow I_{CQ} (20/0.050) = V_{CC} - 1/172 (\text{C})$$

طبق رابطه (A) مقدار I_B به دست می‌آید:

$$I_{BQ} = \frac{1/172 - 0/V}{50 \times 10^{-3} + 0/50} = 0/78 \text{ mA}$$

$$(B) \text{ طبق رابطه } I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 78/10 \text{ mA}$$

با جایگذاری این مقدار در رابطه (C) داریم:

$$78/10 \text{ mA} (20/0.050) = V_{CC} - 1/172 \Rightarrow V_{CC} = 15V/2 \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

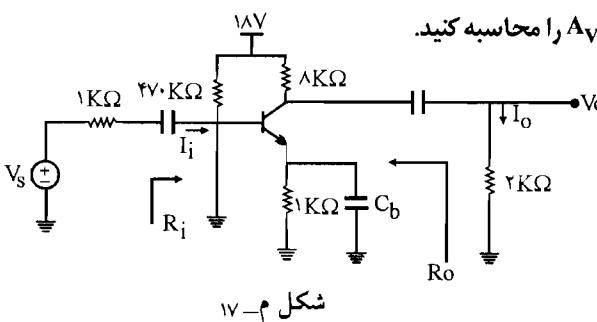
$$V_{th} = V_{CC} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow 1/172 = 15V/2 \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$R_{th} = 50 \times 10^{-3} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{50 \times 10^{-3}}{1/172} = \frac{R_2}{15V/2} \Rightarrow R_2 = 7/38 K\Omega$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{1/172 \times 7/38}{15V/2 - 1/172} = 50/4 \Omega$$

۱۷- در تقویت کننده شکل م- ۱۷ ترانزیستور دارای $h_{oe} = 0$ و $h_{re} = 20$ و $h_{fe} = 20$ است.

است.



الف) کمیت‌های A_V ، R_i و A_I را محاسبه کنید.

ب) اگر خازن کنار گذر C_b را برداریم مقادیر جدید R_i و R_o چقدر خواهد بود؟

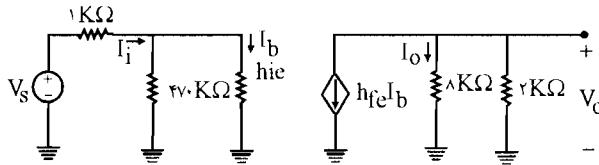
$$KVL: 4V \cdot I_B + 1K\Omega \times I_E = V_{CC} - 0/V = 18 - 0/V = 18/3$$

$$\Rightarrow 4V \cdot I_B + (1 + \beta) \times I_B = 18/3 \Rightarrow I_B = \frac{18/3}{4V + 21} = \frac{18/3}{49}$$

$$\Rightarrow I_C = \beta I_B = \frac{20 \times 18/3}{49} = 0.5mA$$

$$\Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{20 \times 26}{0.5 \times 10^3} = 0.052V/K\Omega$$

مدار معادل ac را رسم می‌کنیم:



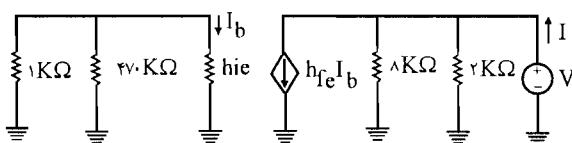
$$A_I = \frac{I_o}{I_i} = \frac{-h_{fe} I_b \times \frac{\lambda}{\lambda + 2}}{I_b + \frac{h_{ie} I_b}{4V}} = \frac{-20 \times 0/\lambda}{1 + 0/48} = -16$$

$$R_i = 4V \cdot K\Omega \parallel h_{ie} = 4V \cdot K\Omega \parallel 0.052V/K\Omega = 0.052V/K\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -16 \times \frac{2}{0.052} = -48/5$$

$$A_{VS} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -48/5 \times \frac{0.052}{1 + 0.052} = -18/48$$

به دست آوردن R_o :



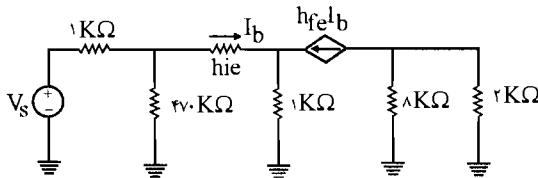
$$KCL: I = \frac{V}{\lambda} + h_{fe} I_b$$

در حلقه h_{ie} و $4V \cdot K\Omega$ و $\lambda K\Omega$ چون منبع وجود ندارد $I_b = 0$ می‌شود پس در رابطه بالا داریم:

$$I = \frac{V}{\lambda} + h_{fe} \times 0 \Rightarrow I = \frac{V}{\lambda} \Rightarrow V_I = \lambda K\Omega = R_o'$$

$$R_o = \frac{V}{I} \parallel \lambda K\Omega = \lambda K\Omega \parallel \lambda K\Omega = \frac{\lambda \times \lambda}{\lambda + \lambda} = 1/2 K\Omega$$

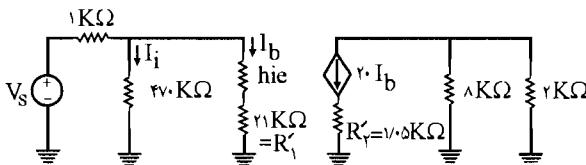
ب) با برداشتن خازن کنار گذر C_b داریم:



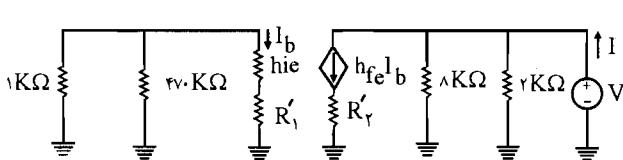
مقاومت $1\text{K}\Omega$ که در امیتر قرار می‌دارد را با قضیه دوگان میلر به شاخه‌های کناری تبدیل می‌کنیم.

$$K' = \frac{I_1}{I_b} = \frac{h_{fe} I_b}{I_b} = h_{fe} = 20. \quad \begin{cases} R'_1 = (1 + K') \times R' = 21 \times 1 = 21\text{K}\Omega \\ R'_r = \frac{1 + K'}{K'} R' = \frac{21}{20} \times 1 = 1.05\text{K}\Omega \end{cases}$$

مدار معادل به صورت زیر درمی‌آید:



$$R_i = (4V * K\Omega) \parallel (R'_1 + h_{ie}) = 4V * K\Omega \parallel (21 + 0.05V) = 20/VV\text{K}\Omega$$



حال محاسبه R_o :

$$I = \frac{V}{\Lambda} + 20 I_b$$

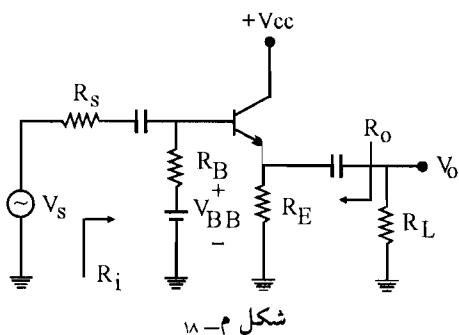
چون در حلقه $V - R_i - h_{ie} - 1\text{K}\Omega$ منبع نداریم پس $I_b = 0$ صفر می‌باشد ($I_b = 0$ پس داریم)

$$I = \frac{V}{\Lambda} + 20 \times 0 = \frac{V}{\Lambda} \Rightarrow I = \frac{V}{\Lambda} = \Lambda$$

$$\text{ز طرفی: } R_o = \frac{V}{I} \parallel 1\text{K}\Omega = \Lambda \text{K}\Omega \parallel 1\text{K}\Omega = \frac{\Lambda \times 1}{\Lambda + 1} = 1/9\text{K}\Omega$$

۱۸- برای مدار شکل م- ۱۸ با فرض $R_B \rightarrow \infty$ و $h_{ie} = 0$ ، $h_{fe} = 160$ ، $R_E = 1\text{K}\Omega$ مطلوب است:

(الف) رسم تغییرات A_V بر حسب R_s و R_L



(ب) رسم تغییرات A_V بر حسب R_s و R_L

$$(R_s = 1\text{K}\Omega \text{ و } R_L < \infty)$$

(ج) رسم تغییرات R_L بر حسب R_s

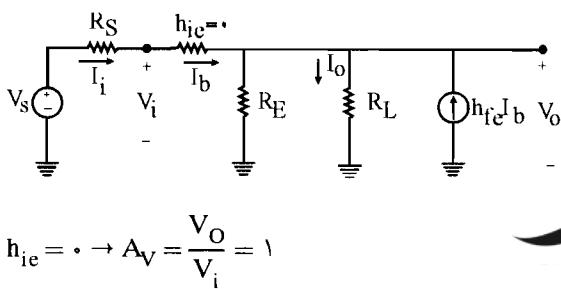
$$(0 < R < \infty)$$

(د) رسم تغییرات R_s بر حسب R_L

$$(0 < R_s < \infty)$$

اوه هل:

مدار معادل ac را رسم می‌کنیم.



(الف) اگر $h_{ie} = 0$ باشد، V_i در دو سر مقاومت R_E قرار می‌گیرد یعنی $V_i = V_O$ می‌باشد. پس A_V تابعی از هیچ تغییری نمی‌باشد. پس تغییرات A_{vs} را بر حسب R_s و R_L رسم می‌کنیم:

$$A_{vs} = \frac{V_O}{V_s} = \frac{V_o}{R_s I_b + V_o} \quad (I)$$

$$V_o = (I_b + h_{fe} I_b)(R_E \parallel R_L) = I_b \times (1 + 160) \times \frac{1\text{K}\Omega \times 1\text{K}\Omega}{1\text{K}\Omega + 1\text{K}\Omega}$$

$$\Rightarrow I_b = \frac{V_o \times 2}{161} \quad (II)$$

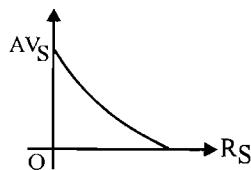
رابطه (II) را در رابطه (I) جایگزین می‌کنیم.

$$A_{VS} = \frac{V_O}{V_s} = \frac{V_O}{R_s \times \frac{V_O}{161} + V_O} = \frac{V_O}{V_O \left(\frac{161}{161} + 1 \right)} = \frac{161}{2R_s + 161}$$

$$\frac{dA_{VS}}{dR_s} = 161 \times \frac{-2}{(2R_s + 161)^2} \Rightarrow$$

مشتق منفی است پس تابع همواره نزولی است.

در رابطه A_{VS} به ازای R_s برابر صفر A_{VS} می‌شود و به ازای R_s برابری نهایت A_{VS} صفر می‌شود پس نمودار به صورت زیر می‌شود.



(ب) رسم تغییرات A_{VS} بر حسب R_L خواسته شده:

$$A_{VS} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_O}{R_s I_b + V_O}$$

$$V_O = (I_b + h_{fe} I_b) (R_E \parallel R_L) = I_b (1 + h_{fe}) \left(\frac{R_E R_L}{R_E + R_L} \right) \Rightarrow I_b = \frac{V_O (R_L + R_E)}{(1 + h_{fe}) R_E R_L}$$

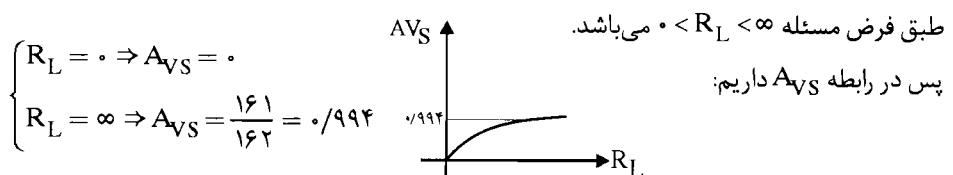
$$\text{با جایگذاری} \Rightarrow A_{VS} = \frac{V_O}{R_s \times \frac{V_O (R_L + R_E)}{(1 + h_{fe}) R_E R_L} + V_O} = \frac{161 R_E R_L}{R_s (R_L + R_E) + 161 R_E R_L}$$

$$\begin{cases} R_s = 1K\Omega \\ R_E = 1K\Omega \end{cases} \Rightarrow A_{VS} = \frac{161 \times R_L}{(R_L + 1) + 161 R_L} = \frac{161 R_L}{162 R_L + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{dA_{VS}}{dR_L} = \frac{161 (162 R_L + 1) - 162 (161) R_L}{(162 R_L + 1)^2} = \frac{161}{(162 R_L + 1)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dA_{VS}}{dR_L} = \frac{161}{(162 R_L + 1)^2} > 0 \Rightarrow$$

مشتق مثبت است پس همواره صعودی است.



ج

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_o}{I_b} = \frac{V_o}{\frac{V_o(R_L + R_E)}{161 R_L R_E}} = \frac{161 R_L \times R_E}{(R_L + R_E)}$$

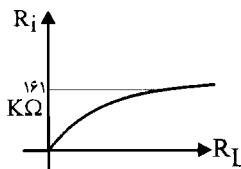
$$R_E = 1K\Omega \Rightarrow R_i = \frac{161 R_L}{R_L + 1} \Rightarrow \frac{dR_i}{dR_L} = 161 \frac{(1)}{(R_L + 1)^2}$$

$$R_E = 1K\Omega \Rightarrow R_i = \frac{161 R_L}{R_L + 1} \Rightarrow \frac{dR_i}{dR_L} = 161 \frac{(1)}{(R_L + 1)^2} > 0$$

مشتق مثبت است

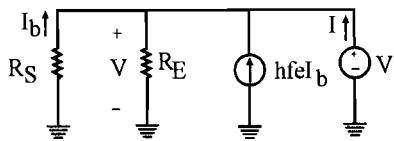
پس تابع همواره صعودی است. و طبق فرض مسئله $R_L < \infty$ می‌باشد پس در رابطه I داریم:

$$\begin{cases} R_L = 0 \Rightarrow R_i = 0 \\ R_L = \infty \Rightarrow R_i = 161 K\Omega \end{cases}$$



د) برای به دست آوردن R_O یک منبع ولتاژ در دو سر R_E موازی با آن قرار می‌دهیم و منبع ولتاژ ورودی را صفر می‌کنیم. جریان عبوری از آن را I در نظر می‌گیریم:

$$I = \frac{V}{R_E} - I_b - h_{fe} I_b = \frac{V}{R_E} - (1 + h_{fe}) I_b$$



$$I_b = \frac{-V}{R_s}$$

$$I = \frac{V}{R_E} - (1 + h_{fe}) \left(\frac{-V}{R_s} \right) = V \times \frac{R_s + (1 + h_{fe}) R_E}{R_E R_s}$$

$$R_O = \frac{V}{I} = \frac{R_s R_E}{R_s + (1 + h_{fe}) R_E}$$

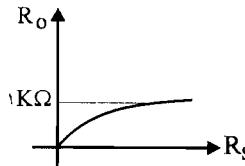
$$R_E = 1K\Omega \Rightarrow R_O = \frac{R_s}{R_s + 161}$$

مشتق مثبت است پس تابع همواره صعودی است

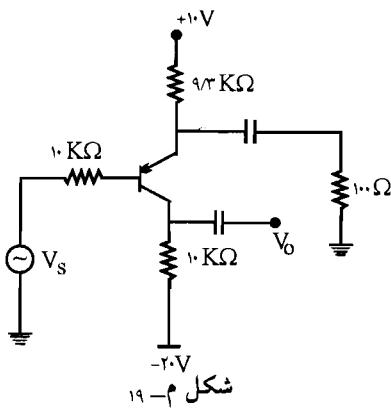
$$\frac{dR_O}{dR_s} = \frac{161}{(R_s + 161)^2} > 0 \Rightarrow$$

طبق فرض مسئله $R_S < \infty$ می‌باشد پس در رابطه R_O داریم:

$$\begin{cases} R_S = 0 \Rightarrow R_O = 0 \\ R_S = \infty \Rightarrow R_O = 1\text{K}\Omega \end{cases}$$



۱۹- در مدار شکل م-۱۹، با فرض $h_{fe} = 100$ ، مقدار A_{VS} را محاسبه کنید.



شکل م-۱۹

۱۹- هم:

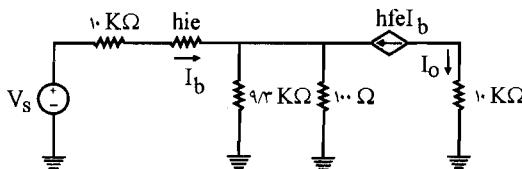
در حلقه V_S و V_{EB} و V_{CC} و V_{EB} و V_{CC} و V_{EB} و V_{CC} می‌زنیم (البته در تحلیل dc منبع ولتاژ V_S بی‌اثر می‌شود).

$$\text{KVL: } \frac{9}{3}I_E + 10I_B = V_{CC} - V_{EB} = 10 - 0/V = 9/3 \Rightarrow \frac{9}{3}I_B(1+\beta) + 10I_B = 9/3$$

$$\Rightarrow R_B = \frac{\frac{9}{3}}{10 + 10 \times 100 \times \frac{9}{3}} = 0.0098 \text{ mA} \Rightarrow I_C = \beta I_B = 0.98 \text{ mA} \Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C}$$

$$\Rightarrow h_{ie} = \frac{100 \times 26 \times 10^{-3}}{0.98} = 2.65 \text{ K}\Omega$$

مدار معادل:



پس باید R_i محاسبه شود:

$$A_{VS} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_S}$$

$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-h_{fe} I_b}{I_b} = -h_{fe} = -100 \Rightarrow R_i = h_{ie} + R'_1$$

$$R'_1 = (1 + K') R' , \quad R' = 9/3 K\Omega \parallel 1 K\Omega = \frac{9/3 \times 1}{9/4} = 0.99 K\Omega$$

$$K' = \frac{h_{fe} I_b}{I_b} = 100 \Rightarrow R'_1 = (1 + 100) \times 0.99 = 999$$

$$\therefore R_i = h_{ie} + 999 = 2/65 + 999 = 12/65 K\Omega$$

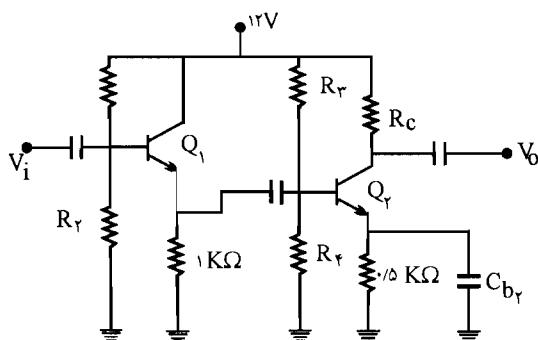
$$\Rightarrow A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -100 \times \frac{10}{12/65} = -79/1$$

$$\Rightarrow A_{VS} = -79/1 \times \frac{12/65}{12/65 + 10} = -44/17$$

۲۰- در تقویت کننده شکل م-۰ برای هر دو ترانزیستور $h_{oe} = h_{re} = 0$ ، $h_{fe} = 100$ و برای

در نقطه کار $h_{ie} = 1 K\Omega$ است.

مقاومت‌های R_1, R_2, R_f, R_c را طوری تعیین کنید که هر دو ترانزیستور پایداری خوبی نسبت به نقطه کار برخوردار بوده و دامنه نوسان خروجی هر یک حداکثر باشد. همچنین می‌خواهیم $|A_V| \geq 100$ باشد.



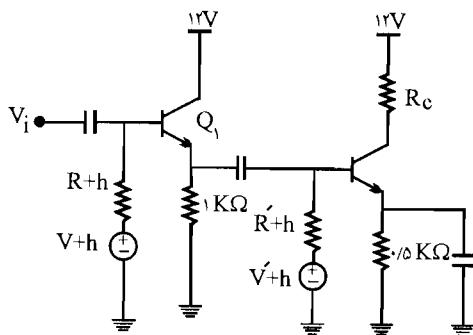
شکل م-۰

$$Q_1: \begin{cases} R_{th} = R_1 \parallel R_f = \frac{R_1 R_f}{R_1 + R_f} \\ V_{th} = V_{CC} \times \frac{R_f}{R_1 + R_f} = 12 \times \frac{R_f}{R_1 + R_f} \end{cases}$$

اول حل:

$$Q_2: \begin{cases} R'_{th} = R_f \parallel R'_1 = \frac{R_f R'_1}{R_f + R'_1} \\ V'_{th} = V_{CC} \times \frac{R'_1}{R_f + R'_1} = 12 \times \frac{R'_1}{R_f + R'_1} \end{cases}$$

با اجرای تونن مدار معادل به صورت زیر می‌شود:



حلقه R_{th} , V_{th} , $1K\Omega$, V_{BE}

$$KVL: R_{th} I_{B1} + R_E I_{C1} = V_{th} - V_{BE}$$

فرض: $I_{C1} = I_{E1}$

$$R_{th} \cdot \frac{I_{C1}}{\beta_1} + R_E I_{C1} = V_{th} - 0/V \Rightarrow I_{C1} \left(\frac{R_{th}}{\beta_1} + R_E \right) = V_{th} - 0/V \quad (I)$$

برای اینکه ترانزیستور پایداری خوبی نسبت به β برخوردار باشد باید داشته باشیم:

$$\frac{R_{th}}{\beta_1} = 0/1 R_{E1} = 0/1 \times 1K\Omega = 0/1 \Rightarrow R_{th} = 0/1 \beta_1 = 0/1 \times 100 = 10K\Omega$$

پس با جایگذاری مقدار R_{th} , در رابطه (I) داریم:

$$I_{C1} \left(\frac{10}{100} + 1 \right) = V_{th} - 0/V \Rightarrow I_{C1} = \frac{V_{th} - 0/V}{1/1} \quad (II)$$

و برای اینکه دامنه نوسان خوبی Q_1 حداکثر شود باید داشته باشیم:

$$I_{CQ1} = \frac{V_{CC} - V_{CE1}(\text{sat})}{R_{ac1} + R_{dc1}} \quad (III)$$

حلقه: R'_{th} , V'_{th} , $0/5K\Omega$, V_{BE_γ}

$$KVL: R'_{th} I_{B_\gamma} + 0/5 I_{E_\gamma} = V'_{th} - V_{BE_\gamma}, \quad \text{فرض: } I_{C_\gamma} = I_{E_\gamma}$$

$$\Rightarrow R'_{th} \frac{I_{C_\gamma}}{\beta_2} + 0/5 I_{C_\gamma} = V'_{th} - 0/V \Rightarrow I_{C_\gamma} \left(\frac{R'_{th}}{\beta_2} + 0/5 \right) = V'_{th} - 0/V \quad (IV)$$

و برای اینکه ترانزیستور از پایداری خوبی نسبت به β_2 برخوردار باشد باید داشته باشیم:

$$R'_{th} = 0/1 R_{E_\gamma} \Rightarrow \frac{R'_{th}}{100} = 0/1 \times 0/5 \Rightarrow R'_{th} = 0/05 \times 100 = 5K\Omega$$

با جایگذاری این مقدار در رابطه (IV) داریم:

$$I_{C_1} \left(\frac{R'_{th}}{\beta_2} + \frac{0.5}{0.5} \right) = V'_{th} - \frac{0.5}{V} \Rightarrow I_{C_1} \left(\frac{0.5}{1.0} + \frac{0.5}{0.5} \right) = V'_{th} - \frac{0.5}{V} \Rightarrow I_{C_1} = \frac{V'_{th} - 0.5/V}{0.55} \quad (V)$$

و برای اینکه دامنه نوسان خروجی Q_2 حداکثر شود باید داشته باشیم:

$$I_{CQ_1} = \frac{V_{CC} - V_{CE_1}(\text{sat})}{R_{ac_1} + R_{dc_1}}$$

$$h_{ie_1} = \frac{h_{fe_1} V_T}{I_{C_1}} = \frac{1.0 \times 26}{I_{C_1}} = 1K\Omega \Rightarrow I_{C_1} = 2/6 \text{ mA}$$

این مقدار را در رابطه (V) قرار می‌دهیم:

$$I_{C_1} = \frac{V'_{th} - 0.5/V}{0.55} = 2/6 \text{ mA} \Rightarrow V'_{th} = 2/6 \times 0.55 + 0.5/V = 2/13 \text{ V}$$

$$\begin{cases} V'_{th} = V_{CC} \times \frac{R_f}{R_f + R_\tau} = 12 \frac{R_f}{R_f + R_\tau} = 2/13 \\ R'_{th} = \frac{R_f R_\tau}{R_f + R_\tau} = 0.5 K\Omega \end{cases} \Rightarrow \frac{12}{R_\tau} = \frac{2/13}{0.5} \Rightarrow R_\tau = \frac{12 \times 0.5}{2/13} = 2.8/13 K\Omega$$

$$R_\tau = \frac{R'_{th} \times R_\tau}{R_\tau - R'_{th}} = \frac{0.5 \times 2.8/13}{2.8/13 - 0.5} = 6/0.5 K\Omega$$

در رابطه I_{CQ_1} از $V_{CE}(\text{sat})$ صرفنظر می‌کنیم و در این رابطه داریم:

$$I_{CQ_1} = \frac{V_{CC} - V_{CE_1}(\text{sat})}{R_{ac_1} + R_{dc_1}} \Rightarrow 2/6 \text{ mA} = \frac{12 - 0}{R_{ac_1} + R_{dc_1}} \quad \begin{cases} R_{ac_1} = R_C \\ R_{dc_1} = R_C + R_E = R_C + 0.5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2/6 = \frac{12}{R_C + (R_C + 0.5)} = \frac{12}{(2R_C + 0.5)} \Rightarrow R_C = 2/0.5 K\Omega$$

و در رابطه I_{CQ_1} از $V_{CE_1}(\text{sat})$ صرفنظر می‌کنیم و داریم:

$$I_{CQ_1} = \frac{V_{CC} - V_{CE_1}(\text{sat})}{R_{ac_1} + R_{dc_1}} = \frac{12}{R_{ac_1} + R_{dc_1}} \quad \begin{cases} R_{dc_1} = R_{E_1} = 1K\Omega \\ R_{ac_1} = 1K\Omega \parallel R_{in} \end{cases}$$

$$R_{in} = R'_{th} \parallel R_{b_1}, \quad R_{b_1} = h_{ie_1} = 1K\Omega$$

$$R_{in} = 0.5 K\Omega \parallel 1 K\Omega = \frac{0.5}{6} K\Omega$$

$$\Rightarrow R_{ac_1} = 1 K\Omega \parallel R_{in} = 1 K\Omega \parallel \frac{5}{6} K\Omega = \frac{\frac{5}{6} \times 1}{\frac{5}{6} + 1} = \frac{5}{11} K\Omega$$

$$\Rightarrow I_{CQ_1} = \frac{12}{\frac{5}{11} + 1} = \frac{12 \times 11}{5 + 11} = 1.25 \text{ mA}$$

$$(II): I_{C_1} = \frac{V_{th} - 0/V}{1/1} = 1.25 = \frac{V_{th} - 0/V}{1/1} \Rightarrow V_{th} = 9.75 V$$

$$\begin{cases} V_{th} = 9.75 = 12 \frac{R_\gamma}{R_1 + R_\gamma} \\ R_{th} = \frac{R_1 R_\gamma}{R_1 + R_\gamma} = 1.0 K\Omega \end{cases} \Rightarrow$$

این دو رابطه را برابر هم تقسیم می کنیم

$$\frac{9.75}{1.0} = \frac{R_1}{12} \Rightarrow R_1 = 12/2.8 K\Omega \quad , \quad R_\gamma = \frac{R_{th} \times R_1}{R_1 - R_{th}} = \frac{1.0 \times 12/2.8}{12/2.8 - 1.0} = 5.3/1.8 K\Omega$$

و همچنانی خواهیم شد: $|A_V| \geq 100$

Q_1 : امیتر مشترک و Q_2 : کلکتور مشترک

$$A_{V_1} = \frac{V_{e_1}}{V_{b_1}} = A_I \times \frac{R_{i_1}}{R_{b_1}} = (1 + h_{fe}) \times \frac{R_{L_1}}{R_{b_1}}$$

$$R_{L_1} = R_{E_1} \parallel R_{in} = \frac{5}{11} K\Omega \quad , \quad R_{b_1} = h_{ie_1} + (1 + h_{fe}) R_{L_1}$$

$$h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{100 \times 26}{1.25} = 312 K\Omega \Rightarrow R_{b_1} = 312 + 1.0 \times \frac{5}{11} = 46/2 K\Omega$$

$$\Rightarrow AV_1 = (1 + 100) \times \frac{11}{46/2} = 0.994$$

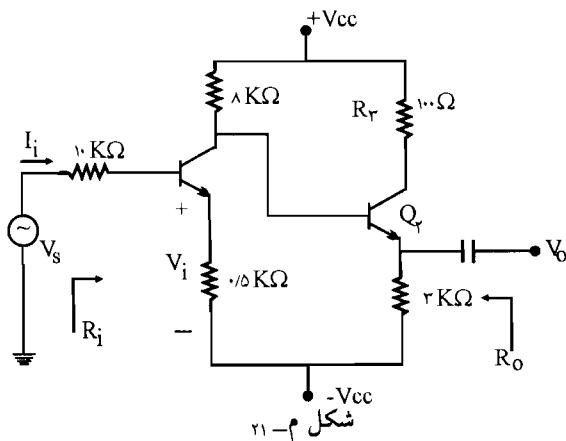
$$A_{V_\gamma} = \frac{V_{C_\gamma}}{V_{b_\gamma}} = -h_{fe} \frac{R_{L_\gamma}}{R_{b_\gamma}} \quad \begin{cases} R_{L_\gamma} = R_C = 2.0 \\ R_{b_\gamma} = h_{ie_\gamma} = 1 K\Omega \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_{V_\gamma} = -100 \times \frac{2.0}{1} = -200$$

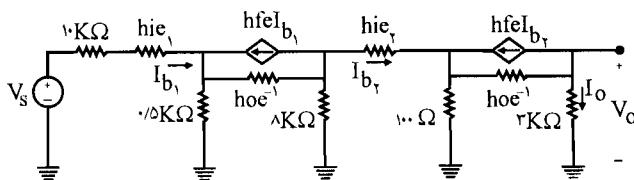
$$A_V = A_{V_1} \times A_{V_\gamma} = 0.994 \times (-200) = -200$$

$$\Rightarrow |A_V| = |-200| = 200 \geq 100$$

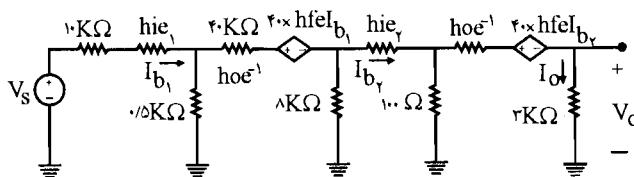
۲۱- در مدار تقویت کننده شکل م-۲۱، با فرض $h_{fe} = h_{fey} = 50$ و $h_{ie} = h_{iex} = 1/1 K\Omega$ و مقادیر کمیت‌های R_i ، A_V ، A_I ، R_o و $h_{oe} = h_{oey} = 40 K\Omega$ را به دست اورید؟



۱۴ هل: مدار معادل ac را رسم می‌کنیم:



با منبع جریان $h_{fe} I_b$ موازی می‌باشد با استفاده از قضیه نورتن داریم:



حلقه: $3K\Omega$ ، 100Ω ، h_{oe} ، $40 \times h_{fe} I_{b_1}$

$$\text{KVL: } 3I_O + h_{oe} I_O + 1/1 (I_O - I_{b_2}) = -40 h_{fe} I_{b_2} = -40 \times 50 I_{b_2} = -2000 I_{b_2}$$

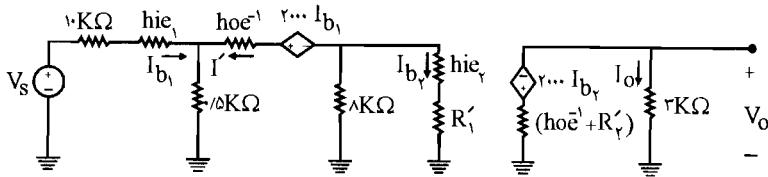
$$\Rightarrow 43/1 I_O = -1999/4 I_{b_2} \Rightarrow I_O = -46/4 I_{b_2}$$

با استفاده از دو گان قضیه میلر در مقاومت $1K\Omega = R_{E_\gamma}$ داریم:

$$\begin{cases} I_1 = I_{b_\gamma} \\ I_\gamma = -I_O \end{cases} \quad K' = \frac{I_\gamma}{I_1} = \frac{+46/4 I_{b_\gamma}}{I_{b_\gamma}} = +46/4$$

$$\begin{cases} R'_1 = R' \times (1 + K') = 0.1 \times (1 + 46/4) = 4.74 K\Omega \\ R'_\gamma = R' \times \left(\frac{1 + K'}{K'} \right) = 0.1 \times \frac{1 + 46/4}{46/4} = 0.102 K\Omega \end{cases}$$

پس مدار معادل به صورت زیر می باشد:



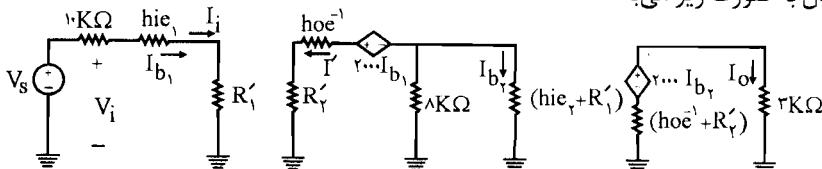
$$KVL: I'(4.74 + (10K\Omega \parallel (h_{ie_\gamma} + R'_1))) + 0.1(I' + I_{b_1}) = 2000 I_{b_1}$$

$$I' \times 4.74/4.74 + 0.1 I_{b_1} + 0.1 I' = 2000 I_{b_1} \Rightarrow I' = 45/58 I_{b_1}$$

حال با استفاده از دو گان قضیه میلر در مقاومت $5K\Omega = R_{E_\gamma}$ یعنی $R_{E_\gamma} = 5K\Omega$ داریم:

$$K' = \frac{I_\gamma}{I_1} = \frac{I'}{I_{b_1}} = \frac{45/58 I_{b_1}}{I_{b_1}} = \frac{45/58}{1} \Rightarrow \begin{cases} R'_1 = R' (1 + K') = 0.1 (1 + 45/58) = 23/29 K\Omega \\ R'_\gamma = R' \left(\frac{1 + K'}{K'} \right) = 0.1 \times \frac{1 + 45/58}{45/58} = 0.51 \end{cases}$$

پس مدار معادل به صورت زیر می باشد:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-46/4 I_{b_\gamma}}{I_{b_1}} \quad , \quad I_{b_\gamma} = -I' \times \frac{1K\Omega}{10K\Omega + (h_{ie_\gamma} + R'_1)} = -I' \times \frac{1}{10 + 5/14} \\ \Rightarrow I_{b_\gamma} = -45/58 I_{b_1} \times \frac{1}{13/14} = -26/35 I_{b_1}$$

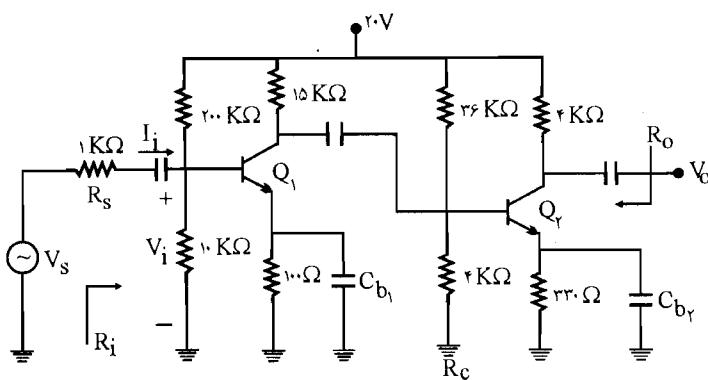
$$\Rightarrow A_I = \frac{-64/4 \times -26/39 I_{b_1}}{I_{b_1}} = 1222/64$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = h_{ie} + R' = 1/1 + 23/29 = 24/39 \text{ K}\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = 1222/64 \times \frac{3\text{K}\Omega}{24/39} = 150/38$$

$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = 150/38 \times \frac{24/39}{24/39 + 10\text{ K}\Omega} = 106/60$$

- در مدار تقویت کننده شکل م- ۲۲ ترانزیستورها مشابه و دارای $h_{re} \cong 40 \text{ K}\Omega$ هستند. مقادیر R_O ، A_I ، R_i ، A_{V_s} ، A_V و $h_{oe} \cong 40 \text{ K}\Omega$ را محاسبه کنید؟



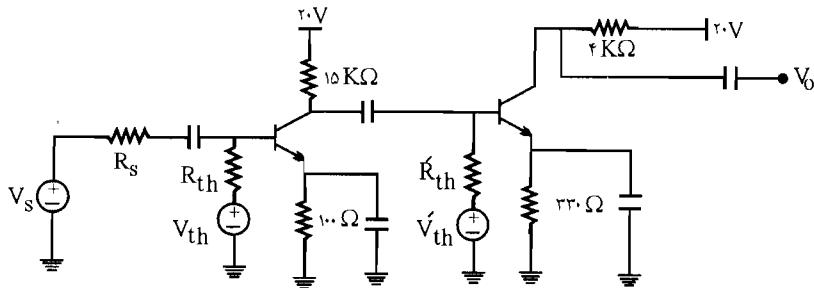
شکل م-۲۲

: این حل:

$$Q_1: \begin{cases} R_{th} = 10\text{ K}\Omega \parallel 100\text{ K}\Omega \parallel \frac{10 \times 100}{10 + 100} = 9/52 \text{ K}\Omega \\ V_{th} = V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 20 \times \frac{10}{10 + 100} = 1.95 \text{ V} \end{cases}$$

$$Q_2: \begin{cases} R'_{th} = 36\text{ }\Omega \parallel 4\text{ K}\Omega = \frac{36 \times 4}{36 + 4} = 3/6 \text{ K}\Omega \\ V'_th = V_{CC} \times \frac{4\text{ K}\Omega}{36\text{ K}\Omega + 4\text{ K}\Omega} = \frac{20 \times 4}{40} = 2 \text{ V} \end{cases}$$

پس مدار معادل به صورت زیر می‌باشد:



$$\text{KVL: } R_{th} I_{B_1} + R_{E_1} I_{E_1} = V_{th} - V_{BE_1}$$

فرض: $I_{C_1} = I_{E_1} \Rightarrow R_{th} = \frac{I_{C_1}}{\beta_1} + R_{E_1} \times I_{C_1} = V_{th} - V_{BE_1}$

$$\Rightarrow \frac{1}{50} \times \frac{I_{C_1}}{50} + 0.1 \times I_{C_1} = 0.95 - 0.7 = 0.25 \Rightarrow I_{C_1} = 0.16 \text{ mA}$$

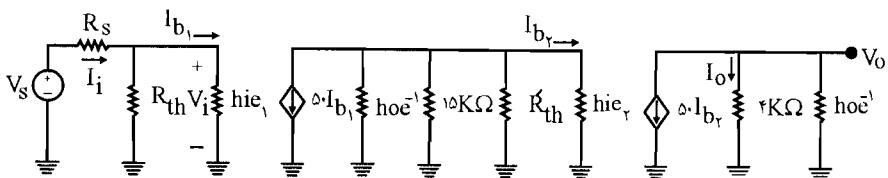
$$\Rightarrow h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{50 \times 26}{0.16} = 15 K\Omega$$

$$\text{KVL: } R'_{th} I_{B_\gamma} + R_{E_\gamma} I_{E_\gamma} = V'_{th} - V_{BE_\gamma} \quad \text{فرض: } I_{C_\gamma} = I_{E_\gamma}$$

$$\frac{I_{C_\gamma}}{\beta_\gamma} + 0.133 I_{C_\gamma} = 2 - 0.7 = 1.3$$

$$\Rightarrow I_{C_\gamma} = \frac{1.3}{0.133} = 10 \text{ mA} \Rightarrow h_{ie_\gamma} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_\gamma}} = \frac{50 \times 26}{10} = 13 K\Omega$$

پس مدار معادل ac به صورت زیر درمی‌آید:



با استفاده از تقسیم جریان:

$$A_i = \frac{I_O}{I_i}, \quad I_O = -50 I_{b_1} \times \frac{10 K\Omega}{10 + 1} = -45/45 I_{b_\gamma}$$

$$I_i = I_{b_1} + \frac{h_{ie_1} I_{b_1}}{R_{th}} = I_{b_1} + \frac{15 I_{b_1}}{50} = 1.16 I_{b_1}$$

$$\Rightarrow A_I = \frac{-40/40 I_{b_1}}{R_{th}} =$$

از طرفی $I_{b_1} = -\Delta \cdot I_{b_1} - \frac{h_{ie_1} I_{b_1}}{h_{oe}^{-1}} - \frac{h_{ie_1} I_{b_1}}{10} - \frac{h_{ie_1} I_{b_1}}{R_{th}'}$

$$\Rightarrow I_{b_1} = -\Delta \cdot I_{b_1} - \frac{0/4 I_{b_1}}{4} - \frac{0/4 I_{b_1}}{10} - \frac{0/4 I_{b_1}}{3/6}$$

$$\Rightarrow -\Delta \cdot I_{b_1} = I_{b_1} + 0/0.1 I_{b_1} + 0/0.2 V I_{b_1} + 0/0.1 I_{b_1} = -\frac{1/10}{\Delta} I_{b_1}$$

$$\Rightarrow A_I = \frac{-40/40 I_{b_1}}{1/16 \times \frac{-1/10}{\Delta} I_{b_1}} = 16.3/\Delta$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{th} \parallel h_{ie_1} = 4/20 K\Omega \parallel 1/0 K\Omega = \frac{4/0.2 \times 1/0}{4/0.2 + 1/0} = 1/3 K\Omega$$

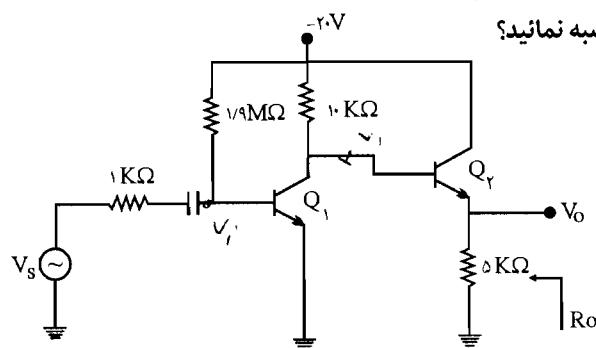
$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = 16.3/\Delta \times \frac{4 K\Omega}{1/3 K\Omega} = 52.41/\Delta K\Omega$$

$$AV_s = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = 52.41/\Delta \times \frac{1/3}{1/3 + 1} = 29.6/20$$

$$R_O = 4 K\Omega \parallel h_{oe}^{-1} = 4 K\Omega \parallel 4 \cdot 0 K\Omega = \frac{4 \times 4}{4 + 4} = 3/64$$

در تقویت کننده در طبقه ۲۳-۲۳ است. جریان نقطه

کار ترانزیستورها، A_V و R_O را محاسبه نمایید؟



شکل ۲۲-۳

راه حل:

KVL در بیس ۱: $1/4 \times 1.0^3 I_{B_1} = -V_{CC} - V_{BE_1} \Rightarrow I_{B_1} = \frac{-V_{CC} - 0.7V}{1/4 \times 1.0^3} = 0.016 mA$

$$\Rightarrow I_{C_1} = \beta_1 I_{B_1} = 10 \times 16 \text{ mA} \Rightarrow h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{100 \times 26}{10 \times 16} = 256 \text{ K}\Omega$$

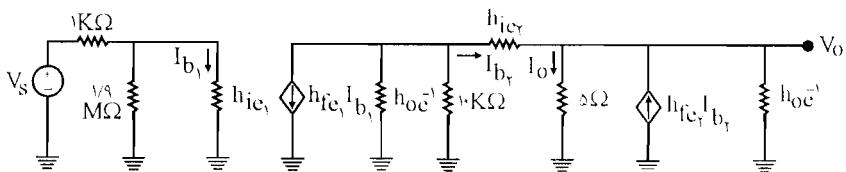
Q2 در بیس KVL: $10 \text{ K}\Omega (I_{C_1} + I_{B_2}) + 5 \text{ K}\Omega I_{B_2} = 20 - 0/V = 10/3$

$$\Rightarrow 10 \text{ K}\Omega \times 10/16 + 10 \times I_{B_2} + 5 \times (1 + \beta_2) I_{B_2} = 10/3$$

$$\Rightarrow 10/16 + 10 I_{B_2} + 5 \times 10/1 I_{B_2} = 10/3 \Rightarrow I_{B_2} = \frac{9/14}{515}$$

$$I_{C_2} = \beta_2 I_{B_2} = 10 \text{ mA} \Rightarrow h_{ie_2} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_2}} = \frac{100 \times 26}{10} = 100 \text{ K}\Omega$$

پس مدار معادل به صورت زیر در می‌آید:



$$h_{oe^{-1}} \parallel 10 \text{ K}\Omega = \Delta \text{ K}\Omega$$

با استفاده از تقسیم جریان داریم:

$$I_O = (I_{B_2} + h_{fe} I_{B_2}) + \frac{h_{oe}^{-1}}{h_{oe}^{-1} + 5 \text{ K}\Omega} = I_{B_2} \times 10 \times \frac{40}{40 + 5} = 80/8 I_{B_2}$$

دو مقاومت $10 \text{ K}\Omega$ و h_{oe}^{-1} موازی هستند پس مقاومت معادل آنها به صورت زیر می‌شود:

$$h_{oe^{-1}} \parallel 10 \text{ K}\Omega = \frac{10 \times 40}{10 + 40} = \Delta \text{ K}\Omega$$

KVL: $\Delta \text{ K}\Omega (h_{fe} I_{B_2} + I_{B_2}) + 10 \text{ V} I_{B_2} + 5 I_O = 0$

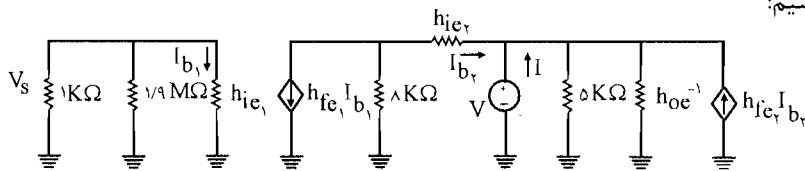
$$\Rightarrow 100 I_{B_2} + 10 \text{ V} I_{B_2} + 5 \times 80/8 I_{B_2} = 0$$

$$\Rightarrow I_{B_2} = -0.573 I_{B_2}$$

$$\Rightarrow A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{5 I_O}{h_{ie_1} \times I_{B_2}} = \frac{5 \times 80/8 I_{B_2}}{256 \times (-0.573) I_{B_2}} = -3.64$$

برای محاسبه R_O یک منبع ولتاژ V را موازی با مقاومت $5 \text{ K}\Omega$ در خروجی قرار می‌دهیم و منبع ولتاژ

V_s را صفر می‌کنیم:



$$I = \frac{V}{h_{oc}} + \frac{V}{5K\Omega} + (-I_{b_r}) - h_{fe} I_{b_r} = V \left(\frac{1}{40} + \frac{1}{5} \right) - I_{b_r} - 100 I_{b_r}$$

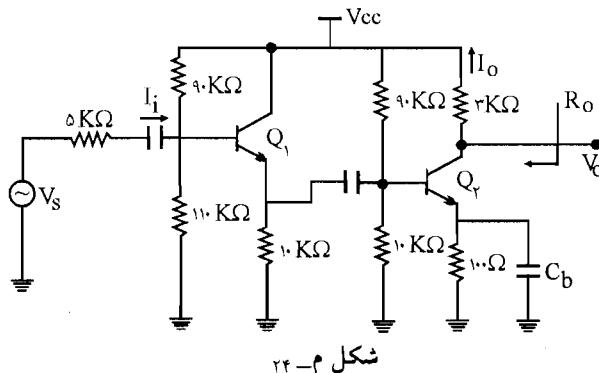
در حلقه KVL: $\Delta I_{b_r} + h_{ie} I_{b_r} = -V$ یک KVL می‌زنیم:

$$\Rightarrow I_{b_r} = \frac{-V}{\Delta + 1/4V} = \frac{-V}{9/4V}$$

$$\Rightarrow I = V \left(\frac{40}{40 \times 5} \right) - \left(\frac{-V}{9/4V} \right) - 100 \times \left(\frac{-V}{9/4V} \right) = V (0.225 + 0.106 + 10/56)$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1}{10/891} = 92\Omega$$

۲۴- در مدار شکل م- ۲۴ برای هر دو ترانزیستور $h_{re} = h_{oe} \approx 0$ و $h_{fe} = 100$ ، $h_{ie} = 3K\Omega$



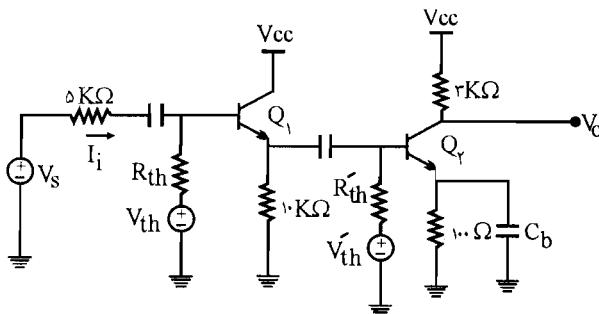
است. مقاومت‌های ورودی و خروجی و بهره‌های جریان و ولتاژ را محاسبه کنید؟

(راه حل:

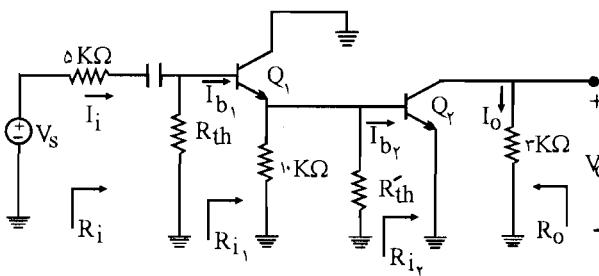
$$Q_1: \begin{cases} R_{th} = 110K\Omega \parallel 90K\Omega = \frac{110 \times 90}{110 + 90} = 49.5K\Omega \\ V_{th} = V_{CC} \times \frac{110K\Omega}{110 + 90} = 0.55V_{CC} \end{cases}$$

$$Q_2: \begin{cases} R'_{th} = 10K\Omega \parallel 90K\Omega = \frac{10 \times 90}{10 + 90} = 9K\Omega \\ V'_th = V_{CC} \times \frac{10}{10 + 90} = 0.1V_{CC} \end{cases}$$

مدار معادل به صورت زیر در می‌آید:



مدار معادل ac به صورت زیر می‌باشد:



$$R_o = R_{L_2} = rK\Omega$$

$$R_i = R_{th} \parallel R_{i_1} \quad (I) \quad R_{i_1} = h_{ie_1} + (1 + h_{fe}) R_{L_1} \quad (II)$$

$$R_{L_1} = R'_{th} \parallel 10K\Omega \parallel R_{i_2}, \quad R_{i_2} = h_{ie_2} = rK\Omega$$

$$\Rightarrow R_{L_1} = 9K\Omega \parallel 10K\Omega \parallel rK\Omega = \left(\frac{9 \times 10}{9 + 10} \right) \parallel rK\Omega = \frac{9}{19} \parallel r = \frac{\frac{9}{19} \times r}{\frac{9}{19} + r} = \frac{270}{118} = 18.4 K\Omega$$

$$(II): R_i = h_{ie_1} + (1 + h_{fe}) R_{L_1} = rK\Omega + (1 + 100) \times 18.4 = 1888.4 K\Omega$$

$$(I): R_{i_1} = R_{th} \parallel R_{i_1} = 9/5 K\Omega \parallel 1888.4 K\Omega = 9/22 K\Omega$$

$$A_I = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_{b_2}} \times \frac{I_{b_2}}{I_{e_1}} \times \frac{I_{e_1}}{I_{b_1}} \times \frac{I_{b_1}}{I_i} = A_{i_2} \times A_{i_1} \times \frac{I_{b_2}}{I_{e_1}} \times \frac{I_{b_1}}{I_i} \quad (III)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{I_1} = \frac{I_O}{I_{b_1}} = -h_{fe} = -100 \\ A_{I_1} = \frac{I_{e_1}}{I_{b_1}} = 1 + h_{fe} = 1 + 100 = 101 \\ \frac{I_{b_1}}{I_{c_1}} = \frac{I_{e_1} \times \frac{1}{R_{i_1}}}{\frac{1}{R_{i_1}} + \frac{1}{10K\Omega} + \frac{1}{90 \parallel 10K\Omega}} \times \frac{1}{I_{e_1}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{10} + \frac{1}{9}} = \frac{3}{49} \\ \frac{I_{b_1}}{I_i} = \frac{I_i \times (90 \parallel 10K\Omega)}{(90 \parallel 10K\Omega) + R_{i_1}} \times \frac{1}{I_i} = \frac{49/10}{49/10 + 188/18} = 0/21 \end{array} \right.$$

$$(III) = AI = -100 \times 101 \times \frac{3}{49} \times 0/21 = -129A/0V$$

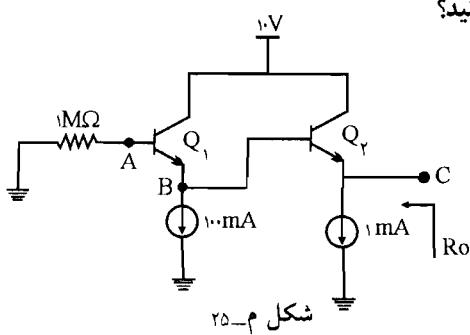
$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_O}{V_{b_1}} \times \frac{V_{b_1}}{V_{b_1}} = \frac{V_O}{V_{b_1}} \times \frac{V_{e_1}}{V_{b_1}} = A_{V_1} \times A_{V_1}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{V_1} = \frac{V_{e_1}}{V_{b_1}} = A_{I_1} \times \frac{R_{L_1}}{R_{i_1}} = 101 \times \frac{1/18}{1888/18} = 0/9A \\ A_{V_1} = A_{I_1} \times \frac{R_{L_1}}{R_{i_1}} = -100 \times \frac{3}{3} = -100 \quad \Rightarrow A_V = A_{V_1} \times A_{V_1} = 0/9A \times (-100) = -9A \end{array} \right.$$

$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -9A \times \frac{39/22}{39/22 + 0} = -86/9$$

۲۵- در مدار شکل م-۲۵، با فرض $V_{BE} = 0/7V$ ، $\beta = 100$ و نقاط DC A، B و C را به

دست آورید. مقاومت خروجی R_o را نیز محاسبه کنید؟



راه حل:

$$I_{E_1} = 100 \mu A + I_{B_1} = 100 \mu A + \frac{I_{E_1}}{1+\beta_1} = 100 \mu A + \frac{100 \mu A}{1+100} = 110 \mu A$$

$$V_A = -1M\Omega \times I_{B_1} = -10^{-3} \times \frac{I_{E_1}}{1+\beta_1} = -10^{-3} \times \frac{110 \mu A}{1+1} \times 10^{-3} = -10.9 V$$

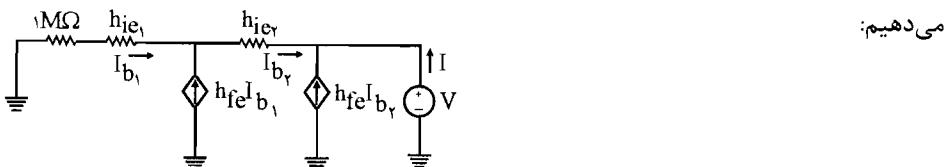
$$V_B = V_A - V_{BE_1} = -10.9 - 0.7V = -10.9 V$$

$$V_C = V_B - V_{BE_1} = -10.9 - 0.7V = -10.2 V$$

$$I_{E_1} = 110 \mu A \Rightarrow h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{100 \times 26}{\frac{I_{E_1}(\beta_1)}{(1+\beta_1)}} = \frac{100 \times 26 \times 100}{110 \times 10^{-3} \times 100} = 23.87 K\Omega$$

$$I_{E_1} = 1mA \Rightarrow h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{100 \times 26}{\frac{1mA \times (100)}{100}} = 2.63 K\Omega$$

مدار معادل ac به صورت زیر می‌شود: برای به دست آوردن R_O یک منبع ولتاژ V را در خروجی قرار



$$I = -h_{fe} I_{b_2} - I_{b_2} = -(1+h_{fe}) I_{b_2} = -10^4 I_{b_2} \quad (I)$$

$$I_{b_2} = I_{b_1} + h_{fe} I_{b_1} = (1+h_{fe}) I_{b_1}$$

$$\text{KVL: } 10^4 K\Omega I_{b_1} + h_{ie_1} I_{b_1} + h_{ie_2} I_{b_2} = -V$$

$$\Rightarrow I_{b_1} (10^4 + h_{ie_1}) + h_{ie_2} (1 + h_{fe}) I_{b_1} = -V$$

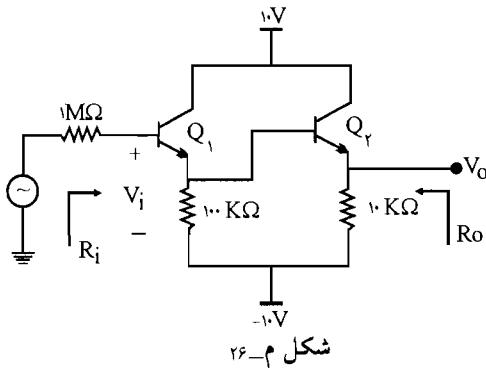
$$\Rightarrow I_{b_1} = \frac{-V}{1289/5}$$

با کمک رابطه (I) داریم:

$$I = -10^4 I_{b_2} = -10^4 \times (1+h_{fe}) I_{b_1} = -10^4 \times 10^4 I_{b_1} = -(10^4)^2 I_{b_1}$$

$$= -(10^4)^2 \times \frac{-V}{1289/5} \Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1289/5}{(10^4)^2} = 126 \Omega$$

۲۶- در مدار شکل م- با فرض $V_{CE(sat)} = 0/2V$ و $B = 100$ ، $V_{BE} = 0/7V$ و $R_i = R_o = 1K\Omega$ را محاسبه نمایند؟ خروجی، حداکثر دامنه بدون اعوجاج خروجی و مقادیر A_V ، R_o را محاسبه نمایند؟



راه حل:

تحلیل dc انجام می‌دهیم و در تحلیل dc V_s صفر می‌شود:

در حلقه $1M\Omega$ و $100K\Omega$ و $10V$ و V_{BE_1} و $10V$ داریم:

$$KVL: 10^3 I_{B_1} + 100(I_{E_1} - I_{B_1}) = 10 - V_{BE_1}$$

$$\Rightarrow 10^3 I_{B_1} + 100(\beta + 1)I_{B_1} - 100I_{B_1} = 10 - 0/V = 9/3$$

$$\Rightarrow 11100I_{B_1} - 100I_{B_1} = 9/3 \quad (I)$$

در حلقه $100K\Omega$ و V_{BE_1} و $10V$ داریم:

$$KVL: 100(I_{E_1} - I_{B_1}) + 10(I_{E_1}) = V_{BE_1} = 0/V$$

$$\Rightarrow 100(1 + \beta)I_{B_1} - 100I_{B_1} - 10(1 + \beta)I_{B_1} = 0/V$$

$$\Rightarrow 10100I_{B_1} - 1110I_{B_1} = 0/V \quad (II)$$

با استفاده از حل این دستگاه I_{B_1} و I_{B_2} محاسبه می‌شوند:

$$\begin{cases} 11100I_{B_1} - 100I_{B_1} = 9/3 \\ 10100I_{B_1} - 1110I_{B_1} = 0/V \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{B_1} = 0.91\mu A \\ I_{B_2} = 0.76\mu A \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{C_1} = \beta I_{B_1} = 0.91mA \\ I_{C_2} = \beta I_{B_2} = 0.76mA \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{100 \times 26}{0.91} = 286 K\Omega \\ h_{ie_2} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_2}} = \frac{100 \times 26}{0.76} = 340 K\Omega \end{cases}$$

$$V_{O_{dc}} = V_{E_r} = 10 I_{E_r} - 10 V = 10 (I_{C_r}) - 10 V = 10 \times 0 / 10 - 10 = -2/4 V$$

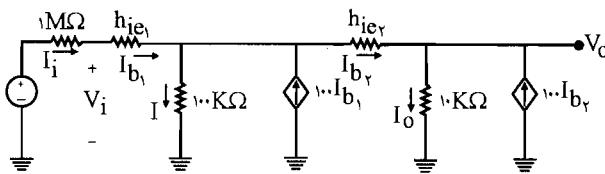
$$V_O(\max) = 10 - 0 / 2 = 9 V$$

$$\begin{cases} V_{O_1} = V_O(\max) - V_O = 9 / 10 - (-2/4) = 12 / 2 \\ V_{O_r} = V_O(\min) - V_O = -10 - (-2/4) = -8 / 2 \end{cases}$$

در حالت اشباع Q_r برابر است با: V_O
در حالت قطع Q_r برابر V میباشد $\Leftrightarrow 10 - 0 / 2 = 9 V$

$$V_O(\max) = 9 / 2$$

برابر کمترین مقدار از نظر قدر مطلق میباشد $\Leftrightarrow V_O(\max)$
مدار معادل ac:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{I_{b_r} + 100 b_r}{I_{b_1}} = \frac{101 b_r}{I_{b_1}} \quad (I)$$

$$I_{b_1} = ? \quad KVL: -100 I + 3/4 I_{b_r} + 10 I_O = 0 \Rightarrow$$

$$-100 (I_{b_1} + 100 I_{b_1} - I_{b_r}) + 3/4 I_{b_r} + 101 I_{b_r} \times 10 = 0$$

$$\Rightarrow -10100 I_{b_1} + 100 I_{b_r} + 3/4 I_{b_r} + 1010 I_{b_r} = 0 \Rightarrow I_{b_1} = 0 / 1102 I_{b_r}$$

$$(I): A_I = \frac{101 I_{b_r}}{0 / 1102 I_{b_r}} = 916 / 0$$

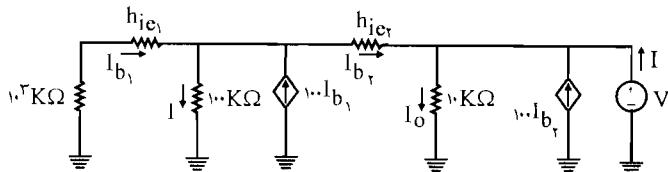
$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{h_{ie1} I_{b_1} + 3/4 I_{b_r} + 10 I_O}{I_{b_1}} = \frac{28/8 \times 0 / 1102 I_{b_r} + 3/4 I_{b_r} + 10 \times 101 I_{b_r}}{0 / 1102 I_{b_r}}$$

$$= 9 / 224 M\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = 916 / 0 \times \frac{10 K\Omega}{9 / 224 \times 10^3} = 0 / 993$$

$$A_{Vs} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = 0 / 993 \times \frac{9 / 224 \times 10^3}{9 / 224 \times 10^3 + 10^3} = 0 / 89$$

برای به دست آوردن R_O یک منبع ولتاژ در خروجی قرار می‌دهیم و منبع ولتاژ ورودی را صفر می‌کنیم.



$$R_O = \frac{V}{I} \quad I = -100 I_{b_1} - I_{b_2} + I_O = -100 I_{b_2} + \frac{V}{10} \quad (I)$$

$$\text{KVL: } I_{b_1} - 100\text{K}\Omega + 100 I_{b_1} = I_{b_2} \Rightarrow I_{b_2} + \frac{(10 + h_{ie_1}) I_{b_1}}{100} + 100 I_{b_1} = I_{b_2}$$

$$\Rightarrow I_{b_2} = 111/29 I_{b_1} \quad (II)$$

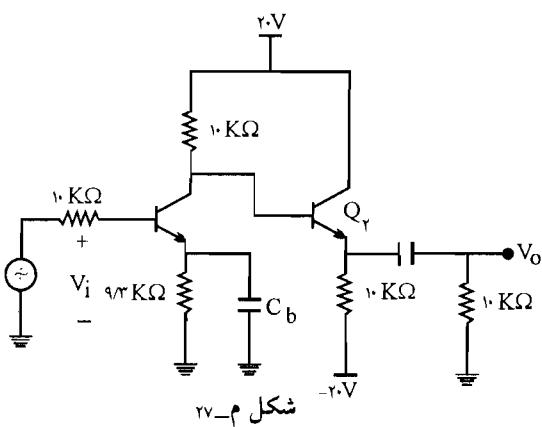
$$\text{KVL: } (h_{ie_1} + 10) I_{b_1} + 3/4 I_{b_2} = -V \Rightarrow$$

$$1028/6 \times \frac{1}{111/29} I_{b_2} + 3/4 I_{b_2} = -V \Rightarrow I_{b_2} = \frac{-V}{12/6}$$

$$\Rightarrow (I) : I = -100 \times \frac{-V}{12/6} + \frac{V}{10} = V(0/1 + 6/10) = 6/10 V$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1}{6/10} = 16.7\Omega$$

- در مدار شکل ۲۷-۲۷ مقادیر A_V ، R_i و R_O را به دست آورید:



ا) اه حل:

در حلقه $10\text{ K}\Omega$ و 20 V و $V_{BE_1} = 0.6\text{ V}$ در Q داریم:

$$\text{KVL: } 10I_{B_1} + 0.6/3I_{E_1} = 20 - 0/V = 19/3 \Rightarrow 10I_{B_1} + 0.6(1+\beta)I_{B_1} = 19/3$$

$$\Rightarrow 48A/3I_{B_1} = 19/3 \Rightarrow I_{B_1} = 0.39 \Rightarrow I_{C_1} = \beta I_{B_1} = 1.99\text{ mA}$$

$$\Rightarrow h_{ie_1} = \frac{h_{fe}V_T}{I_{C_1}} = \frac{0.5 \times 26}{1.99} = 65.3/3\Omega = 0.653\text{ K}\Omega$$

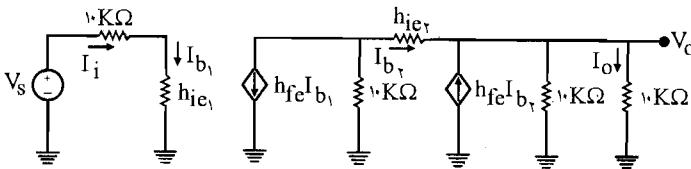
در حلقه $10\text{ K}\Omega$ و 20 V و $20\text{ K}\Omega$ داریم:

$$\text{KVL: } 10K\Omega(I_{C_1} + I_{B_2}) + 10I_{E_2} = 20 - (-20) - 0/V = 39/3$$

$$\Rightarrow 10(1+\beta)I_{B_1} + 10I_{B_2} + 10(1+\beta)I_{B_2} = 39/3 \Rightarrow 520I_{B_2} = 39/3 - 10 \times 1.99$$

$$\Rightarrow I_{B_2} = 0.39V \Rightarrow I_{C_2} = 1.96\text{ mA} \Rightarrow h_{ie_2} = \frac{h_{fe}V_T}{I_{C_2}} = \frac{0.5 \times 26}{1.96} = 0.699\text{ K}\Omega$$

مدار معادل ac به صورت زیر می‌شود:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{(h_{fe}I_{b_2} + I_{b_2}) \times \frac{10\text{ K}\Omega}{10\text{ K}\Omega + 10\text{ K}\Omega}}{I_{b_1}} = \frac{0.1I_{b_2} \times \frac{1}{2}}{I_{b_1}} \quad (I)$$

$$\text{KVL: } 10\text{ K}\Omega(0.1I_{b_2} + I_{b_2}) + h_{ie_2}I_{b_2} + (10\text{ K}\Omega \parallel 10\text{ K}\Omega) \times (I_{b_2} + h_{fe}I_{b_2}) = 0$$

$$\Rightarrow 0.1I_{b_2} + 1.1I_{b_2} + 0.1I_{b_2} + (0.1 \times 0.1)I_{b_2} = 0$$

$$\Rightarrow I_{b_2} = \frac{-0.1}{0.11} I_{b_2} = -0.909 I_{b_2}$$

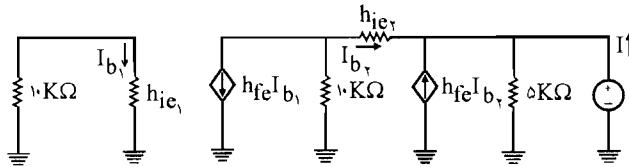
$$(I): A_I = \frac{\frac{0.1}{2} I_{b_2}}{-0.909 I_{b_2}} = -4.545$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = h_{ie_1} = 0.653\text{ K}\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -4V/9V \times \frac{10K\Omega}{0.653} = 735$$

$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = 735 \times \frac{0.653}{0.653 + 10} = -45/0.5$$

برای به دست آوردن R_O یک منبع ولتاژ V در خروجی موازی با مقاومت $10K\Omega$ قرار می‌دهیم و منبع ولتاژ ورودی را بی‌اثر می‌کنیم:



$$R_O = \frac{V}{I} \quad , \quad I = \frac{V}{5} - h_{fe} I_{b_1} - I_{b_2} = \frac{V}{5} - I_{b_1} \quad (\text{II})$$

در حلقه $10K\Omega$ و V و h_{ie} داریم:

$$\text{KVL: } (1 + h_{ie}) I_{b_2} = -V$$

$$\Rightarrow (1 + 0.699) I_{b_2} = -V \Rightarrow I_{b_2} = \frac{-V}{1.699}$$

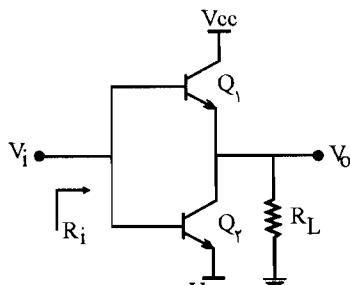
$$\Rightarrow (\text{II}): I = \frac{V}{5} - 0.1 \times \frac{-V}{1.699} = V \left(\frac{1}{5} + \frac{0.1}{1.699} \right) = 4.9V$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1}{4.9V} = 0.201 K\Omega$$

- در تقویت کننده شکل م - ۲۸ پارامترهای هر دو ترانزیستور مشابه‌اند. مقادیر A_V و R_i را برابر

حسب پارامترهای هیبرید h ترانزیستور محاسبه نمایند. ($h_{re} = h_{oe} = 0$)

راه حل:

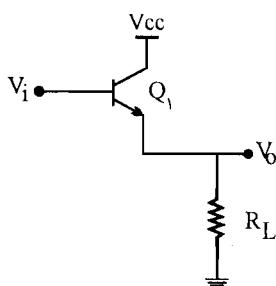


شکل م - ۲۸

در این مدار هر دو ترانزیستور با هم نمی‌توانند روشن باشند اگر Q_1 روشن باشد Q_2 خاموش می‌باشد و اگر Q_2 روشن باشد Q_1 خاموش می‌باشد.

$$\begin{cases} Q_1: \text{ON} \\ Q_2: \text{Off} \end{cases}$$

مدار را وقتی که Q_1 روشن و Q_2 خاموش می‌باشد رسم می‌کنیم:



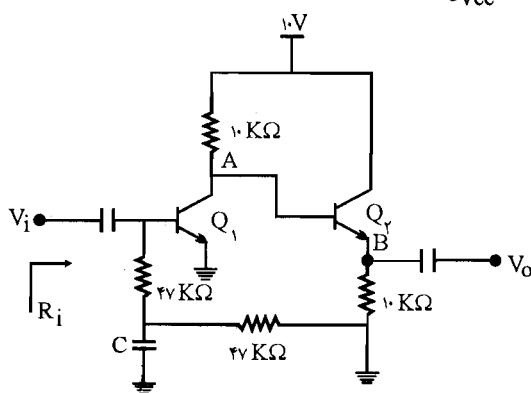
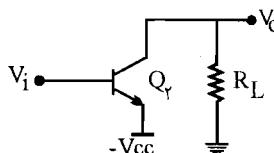
$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} \quad \text{و} \quad \begin{cases} R_i = h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_L \\ A_I = 1 + h_{fe} \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_V = (1 + h_{fe}) \times \frac{R_L}{[h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_L]} = \frac{(1 + h_{fe}) R_L}{[h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_L]}$$

$$\Rightarrow A_V = (1 + h_{fe}) \times \frac{R_L}{[h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_L]} = \frac{(1 + h_{fe}) R_L}{[h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_L]}$$

و وقتی که Q_2 روشن باشد و Q_1 خاموش باشد مدار معادل به صورت زیر می‌باشد ولی روابط هیچ فرقی با روابط بالا نمی‌کند.

$$\begin{cases} Q_1: \text{off} \\ Q_2: \text{ON} \end{cases}$$



شکل م-۲۹

۲۹- برای مقادیر بسیار بزرگ β و B ، ولتاژ DC نقاط A و B

شکل م-۲۹ را به دست اورد. بهره ولتاژ

و مقاومت‌های ورودی و خروجی را برای

حالت‌های زیر محاسبه کنید؟

الف) مدار را مطابق شکل م-۲۹ در

نظر بگیرید.

ب) حافظ C را حذف کنید.

ج) برای بند الی با فرض $V_{CE}(\text{sat}) = 0.2V$, بزرگترین دامنه موج سینوسی خروجی بدون برش و اعوچاچ چقدر است؟

راه حل:

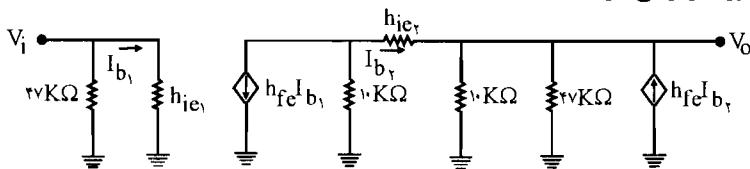
الف) چون طبق صورت مسئله β بسیار بزرگ است پس $I_B = 0$ می‌باشد و همچنین $I_{C_1} = I_{E_1} \leftarrow I_B = 0$. $V_{BE_1} = V_B$

$$V_B = V_{BE_1} = 0/V$$

$$V_A = V_B + V_{BE_2} = 0/V + 0/V = 1/4V$$

$$\begin{cases} I_{C_1} = I_{E_1} = \frac{1 - V_A}{10K\Omega} = \frac{1 - 1/4}{10} = 0.15mA \Rightarrow h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{h_{fe} \times 26}{0.15} = 0.33h_{fe} K\Omega \\ I_{C_2} = I_{E_2} = \frac{V_B}{10K\Omega} = \frac{0/V}{10} = 0/V mA \Rightarrow h_{ie_2} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_2}} = \frac{h_{fe} \times 26}{0/V} = 0.33V h_{fe} K\Omega \end{cases}$$

پس مدار معادل به صورت زیر می‌شود:



$$A_V = \frac{V_o}{V_i} \Rightarrow \begin{cases} V_i = h_{ie_1} I_{b_1} = 0.33h_{fe} I_{b_1} \\ V_o = (4V K\Omega \parallel 10K\Omega) \times (1 + h_{fe}) I_{b_2} \cong 1/24h_{fe} I_{b_2} \end{cases}$$

حلقه: $(4V K\Omega \parallel 10K\Omega), h_{ie_2}, 10K\Omega$

$$\text{KVL: } 10(h_{fe} I_{b_1} + I_{b_2}) + h_{ie_2} I_{b_2} + (4V K\Omega \parallel 10K\Omega) \times (1 + h_{fe}) I_{b_2} = 0$$

$$= 10h_{fe} I_{b_1} + 10I_{b_2} + 0.33V h_{fe} I_{b_2} + 1/24h_{fe} I_{b_2} = 0 \Rightarrow$$

چون h_{fe} خیلی بزرگ است از $10 I_{b_2}$ در مقابل $1/24h_{fe} I_{b_2}$ صرفنظر می‌کنیم.

$$I_{b_1} = \frac{-1/24h_{fe} I_{b_2}}{10h_{fe}} = -0.024h_{fe} I_{b_2} \quad (\text{II})$$

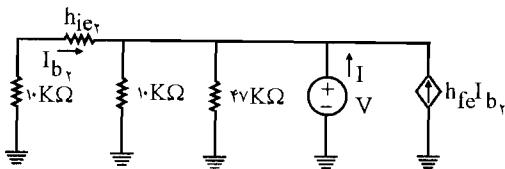
رابطه (II) را در رابطه (I) قرار می‌دهیم:

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1/24h_{fe} I_{b_2}}{0.33h_{fe} I_{b_1}}$$

$$= \frac{\frac{V}{\sqrt{24}} I_{b_\gamma}}{0.3 \times (-0.861) I_{b_\gamma}} = -319$$

$$R_o = \frac{V_i}{I_i} = 4V K\Omega \parallel h_{ie} = 4V K\Omega \parallel 0.3 h_{fe} = 4V K\Omega \parallel \infty = 4V K\Omega$$

برای محاسبه R_o یک منبع ولتاژ V را در دو سر مقاومت $K\Omega$ قرار می‌دهیم و منبع V را اتصال می‌کنیم. چون V صفر در نظر گرفته می‌شود پس I_b صفر می‌شود در نتیجه $h_{fe} I_b$ نیز صفر می‌شود.



$$R_o = \frac{V}{I}$$

$$I = \frac{V}{4V} + \frac{V}{10} - I_{b_\gamma} - h_{fe} I_{b_\gamma} = \frac{V}{\sqrt{24}} - (1 + h_{fe}) I_{b_\gamma} = \frac{V}{\sqrt{24}} - h_{fe} I_{b_\gamma} \quad (\text{III})$$

حلقه $V, h_{ie}\gamma, 10 K\Omega$

$$\text{KVL: } -V = 10 I_{b_\gamma} + h_{ie} I_{b_\gamma} = 10 I_{b_\gamma} + 0.3 h_{fe} I_{b_\gamma}$$

از $10 I_{b_\gamma}$ در مقابل $0.3 h_{fe} I_{b_\gamma}$ صرفنظر می‌کنیم (چون h_{fe} بسیار بزرگ می‌باشد)

$$\Rightarrow -V = 0.3 h_{fe} I_{b_\gamma} \Rightarrow I_{b_\gamma} = \frac{-V}{0.3 h_{fe}} \quad (\text{IV})$$

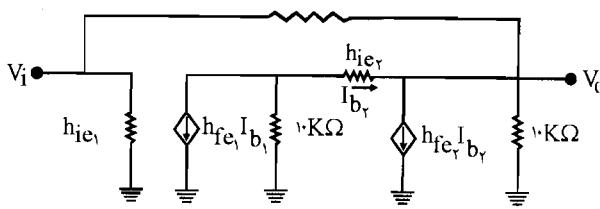
رابطه (IV) را در رابطه (III) قرار می‌دهیم:

$$I = \frac{V}{\sqrt{24}} - h_{fe} \times \frac{-V}{0.3 h_{fe}} = \frac{V}{\sqrt{24}} + \frac{V}{0.3 V} = V \left(\frac{1}{\sqrt{24}} + \frac{1}{0.3 V} \right) = V \times 2/82$$

$$\Rightarrow R_o = \frac{V}{I} = \frac{1}{2/82} = 0.355 K\Omega$$

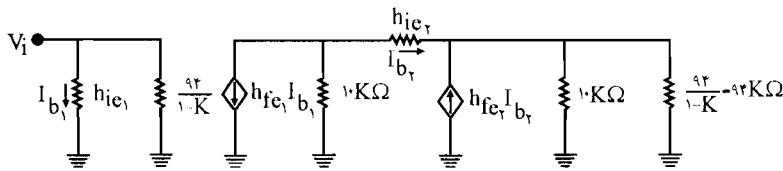
$$4V K\Omega + 4V K\Omega = 94 K\Omega$$

ب) خازن C را حذف می‌کنیم.



شکل (۱)

حال با استفاده از قضیه میلر مدار به صورت زیر درمی‌آید:



$$\frac{94}{K-1} \approx 94 \text{ می باشد پس } \frac{K}{K-1} \approx 1 \text{ عدد نسبت بزرگی می باشد پس } K = \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_O}{V_i}$$

$$A_V = \frac{V_O}{V_i} \Rightarrow \begin{cases} V_O = (1 + h_{fe}) I_{b_2} \times (10 \parallel 94) = h_{fe} I_{b_2} \times 9/0.4 \\ V_i = h_{ie_1} I_{b_2} = 0.03 h_{fe} I_{b_2} \end{cases}$$

حلقه: $h_{ie_1}, 10K\Omega, (10K\Omega \parallel 94K\Omega)$

$$\text{KVL: } 10h_{fe}I_{b_1} + 10I_{b_2} + h_{ie_1}I_{b_2} + h_{fe}I_{b_2} \times 9/0.4 = 0$$

$$\Rightarrow 10h_{fe}I_{b_1} + 10I_{b_2} + 0.03V_{b_2} \times h_{fe} + 9/0.4h_{fe}I_{b_2} = 0$$

از $10I_{b_2}$ صرفنظر می‌کنیم.

$$\Rightarrow 10h_{fe}I_{b_1} = -0.03V_{b_2} \times h_{fe} - 9/0.4I_{b_2} \times h_{fe}$$

$$\Rightarrow I_{b_1} = -\frac{9/0.4}{10} I_{b_2} = -0.941 I_{b_2}$$

با قرار دادن این مقدار در رابطه A_V داریم:

$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{h_{fe}I_{b_2} \times 9/0.4}{0.03h_{fe}I_{b_2}}$$

$$\Rightarrow A_V = \frac{9/0.4I_{b_2}}{0.03 \times (-0.941)I_{b_2}} = -320/2 = K$$

$$R_i = h_{ie_1} \parallel \frac{94}{1-K} = 0.03h_{fe} \parallel \frac{94}{1+320/2} = \frac{94}{321/2} = 0.293 K\Omega$$

حال برای محاسبه R_o باید در شکل (1) یک منبع ولتاژ V را در خروجی قرار داد و منبع ورودی را صفر

در نظر گرفت با صفر شدن منبع ورودی I_b صفر می‌شود پس $h_{fe}I_{b_2}$ نیز صفر می‌شود.

$$R_o = \frac{V}{I}$$

$$I = \frac{V}{10} + \frac{V}{94} - (1 + h_{fe}) I_{b\gamma} \approx \frac{V}{10} + \frac{V}{94} - h_{fe} I_{b\gamma}$$

KVL: $-V = (10 + h_{ie\gamma}) I_{b\gamma}$ در حلقه V و $h_{ie\gamma}$ و 10 داریم:

$$\Rightarrow -V = 10 I_{b\gamma} + h_{ie\gamma} I_{b\gamma} = 10 I_{b\gamma} + 0.73 V h_{fe} I_{b\gamma} \approx 0.73 V h_{fe} I_{b\gamma}$$

$$\Rightarrow I_{b\gamma} = \frac{-V}{0.73 V h_{fe}}$$

با قرار دادن این مقدار $I_{b\gamma}$ در رابطه جریان داریم:

$$I = \frac{V}{10} + \frac{V}{94} - h_{fe} I_{b\gamma}$$

$$= \frac{V}{10} + \frac{V}{94} - h_{fe} \times \frac{-V}{0.73 V h_{fe}} = V \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{94} + \frac{1}{0.73 V} \right)$$

$$\Rightarrow I = V \times 2/81 \Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = 0.3555 K\Omega$$

$I_{C\gamma Q} = 0.73 V mA$ (ج)

$$V_{CE\gamma Q} = V_{C\gamma} - V_{E\gamma} = 10 - V_B = 10 - 0.73 V = 9.27 V$$

با وجود خازن C ، R_L برابر است با:

$$10 K\Omega \parallel 4.73 V K\Omega = 8.24 k\Omega$$

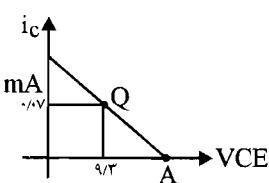
ac معادله خط بار $V_{ce} = -R_{ac} i_c$

$$\Rightarrow V_{ce} = -8.24 i_c \Rightarrow V_{CE} - V_{CEQ} = -8.24 (i_C - I_{CQ})$$

$$V_{CE}(A) = V_{CEQ} + 8.24 I_{CQ} = 9.27 + 8.24 \times 0.73 V = 9.88$$

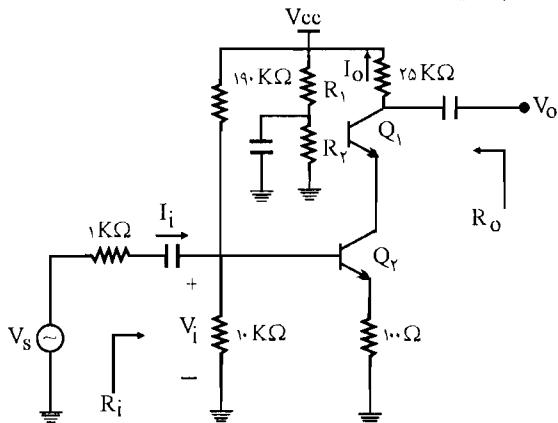
حداکثر دامنه انحراف بدون برش از طرف اشباع $\Rightarrow \begin{cases} V_{ce}(\max) = V_{CEQ} - V_{CE}(\text{sat}) = 9.27 - 0.2 = 9.0 \\ V_O(\max) = V_{CE}(A) - V_{CE}(Q) = 9.88 - 9.27 = 0.61 \end{cases}$

پس حداکثر انحراف بدون برش $V_O(\max) = 0.61$ خواهد بود. (یعنی کمترین مقدار به دست آمده)



۳۰- در تقویت کننده شکل م - ۳۰ ترانزیستورها مشابه و برای آنها $h_{fe} = 50$ و $h_{ie} = 1 K\Omega$ است.

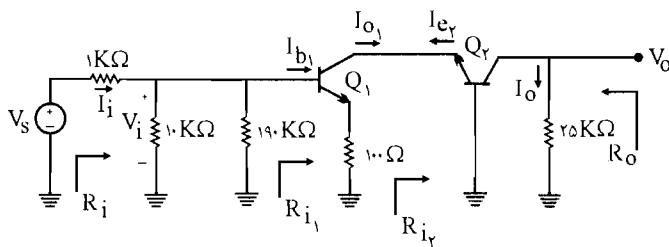
کمیت های A_I ، A_V ، A_{V_s} ، R_O و R_i را محاسبه کنید؟



شکل م

راه حل:

مدار معادل ac به صورت زیر می باشد:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{I_O}{I_{e_r}} \times \frac{I_{e_r}}{I_{b_1}} \times \frac{I_{b_1}}{I_i} \quad (I)$$

$$\begin{cases} \frac{I_O}{I_{e_r}} = \frac{h_{fe}}{1 + h_{fe}} = \frac{50}{51} \\ \frac{I_{e_r}}{I_{b_1}} = -h_{fe} = -50 \\ \frac{I_{b_1}}{I_i} = \frac{I_i \times \frac{1}{R_{i_1}}}{I_i \times \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{50} + \frac{1}{R_{i_1}} \right)} \end{cases}$$

$$R_{i_1} = h_{ie} + (1 + h_{fe}) \times \frac{1}{1} = 1 K\Omega + 50 \times \frac{1}{1} = 51 K\Omega$$



POWEREN.IR

$$\frac{I_{b_1}}{I_i} = \frac{\frac{1}{\delta/1}}{\frac{1}{51} + \frac{1}{190} + \frac{1}{\delta/1}} = \frac{0.164}{0.269} = 0.61 \quad (I) : A_I = \frac{50}{51} \times (-50) \times 0.61 = -29/9$$

$$R_i = R_{i_1} \parallel (10K\Omega \parallel 190K\Omega) = 6/1K\Omega \parallel 9/5K\Omega = 3/5K\Omega$$

$$R_{i_r} = \frac{V_{e_r}}{I_{e_r}} = \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}} = \frac{1}{51} K\Omega$$

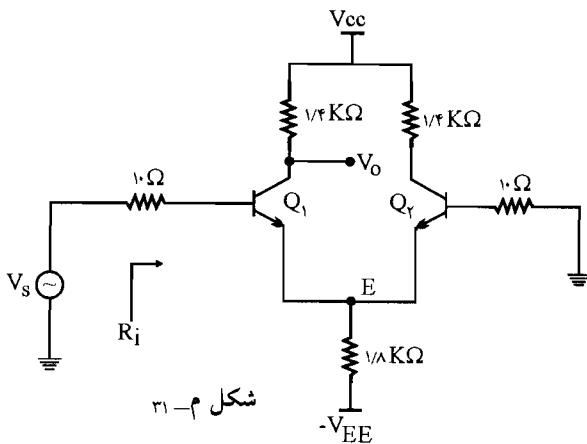
$$R_O = R_L = 25K\Omega$$

$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_O}{V_{e_r}} \times \frac{V_{e_r}}{V_{b_1}} \quad (II)$$

$$(V_i = V_{b_1}) \Rightarrow \begin{cases} \frac{V_O}{V_{e_r}} = A_{I_r} \times \frac{R_{L_r}}{R_{i_r}} = \frac{50}{51} \times \frac{25}{1} = 1250 \\ \frac{V_{e_r}}{V_{b_1}} = A_{I_1} \times \frac{R_{L_1}}{R_{i_1}} = \frac{I_{e_r}}{I_{b_1}} \times \frac{R_{L_1}}{R_{i_1}} \quad (R_{L_1} = R_{i_r}) \\ = -50 \times \frac{1}{6/1} = -0.16 \end{cases}$$

$$(II) : A_V = 1250 \times (-0.16) = -200$$

$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -200 \times \frac{3/5}{3/5 + 1} = -200 \times \frac{3/5}{4/5} = -15V/4V$$



۳۱- شکل ۳۱-۲ یک

تقویت کننده تفاضلی است. در

این تقویت کننده Q_1 و Q_2 کاملاً

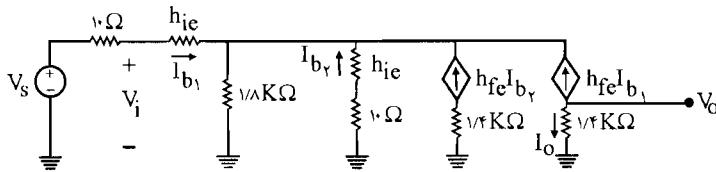
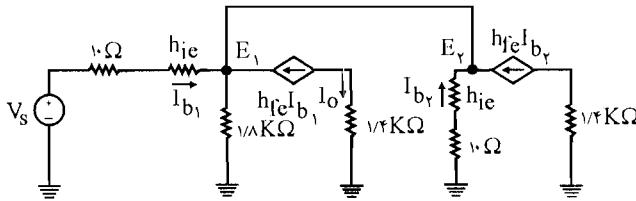
مشابه‌اند و Ω و $h_{ie} = 700$

و مطلوب است. $h_{fe} = 200$

است حسابه R_i و

A_{V_s}

راه حل: مدار معادل ac را رسم می کنیم:



حلقه $1/\Delta K\Omega$ و 10Ω و h_{ie}

$$\text{KVL: } 1/\Delta(I_{b_1} + I_{b_2} + h_{fe}I_{b_1} + h_{fe}I_{b_2}) + \left(\frac{10\Omega + V_{o}\Omega}{10^3}\right)I_{b_2} = 0$$

$$\Rightarrow 1/\Delta(I_{b_1} + 1000I_{b_1}) + 1/\Delta(I_{b_2} + 1000I_{b_2}) + 0/V1I_{b_2} = 0$$

$$\Rightarrow 201 \times 1/\Delta I_{b_1} = -39 1/\Delta I_{b_2} - 0/V1I_{b_2} = -392/51 I_{b_2}$$

$$\Rightarrow I_{b_1} = -1000 I_{b_2}$$

$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-h_{fe}I_{b_1}}{I_{b_1}} = -h_{fe} = -100$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{h_{ie}I_{b_1} - 0/V1I_{b_2}}{I_{b_1}} = \frac{0/V \times (-100 I_{b_2}) - 0/V1I_{b_2}}{-100 I_{b_2}}$$

$$\Rightarrow R_i = \frac{-0/V14 I_{b_2} - 0/V1I_{b_2}}{-100 I_{b_2}} = 1/41 K\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -100 \times \frac{1/4}{1/41} = -198/51$$

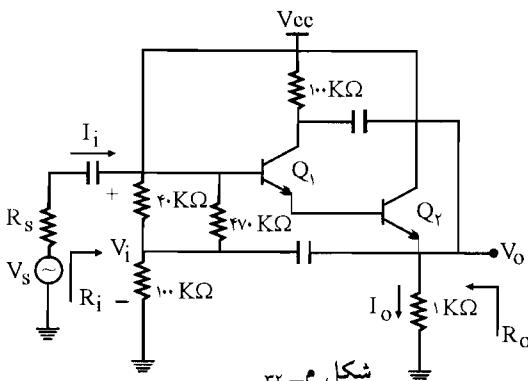
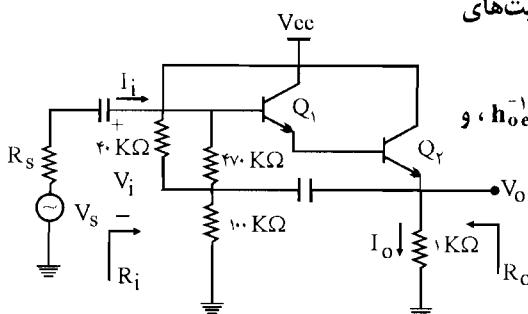
$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -198/51 \times \frac{1/41}{1/41 + 1/1} = -198/11$$

۳۲- در تقویتکننده‌های شکل م-۳۲ کمیت‌های

R_O و R_i ، A_v ، A_I را محاسبه نماید.

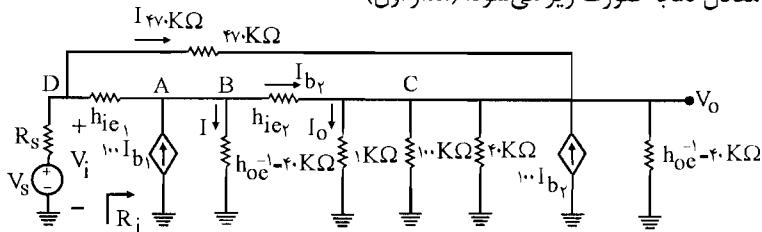
ترانزیستورها مشابه، $h_{oe} = 40 \text{ K}\Omega$ ، و

$h_{fe} = 100$ و $h_{ie} = 1 \text{ K}\Omega$ است.



شکل م-۳۲

۱۵-۱: مدار معادل ac به صورت زیر می‌شود: (مدار اول)



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} \quad (A)$$

با استفاده از تقسیم جریان

$$I_O = (I_{b_2} + 100 I_{b_2} + 1 \cdot 10^4 \text{ K}\Omega) \times \frac{1}{\frac{1}{1 \text{ K}\Omega} + \frac{1}{4 \cdot 10^3 \text{ K}\Omega} + \frac{1}{4 \cdot 10^3 \text{ K}\Omega} + \frac{1}{1 \text{ K}\beta}}$$

$$= \frac{10^4}{53} (101 I_{b_2} + 1 \cdot 10^4 \text{ K}\Omega) \quad (I)$$

$$(A \text{ گو}) \text{ KCL: } I_{b_2} = I_{b_1} + 100 I_{b_1} - I_{10 \text{ K}\Omega} = 101 I_{b_1} - \frac{h_{ie} I_{b_2} + I_O}{4 \cdot 10^3 \text{ K}\Omega}$$

$$\Rightarrow 41I_{b_1} = 4040I_{b_1} - I_O \quad (\text{II})$$

حلقه: $4V \cdot K\Omega$, h_{ie_1} , h_{ie_2}

$$\text{KVL: } 4V \cdot K\Omega - 1 \times I_{b_1} - 1 \times I_{b_2} = 0$$

$$\Rightarrow I_{4V \cdot K\Omega} = \frac{I_{b_1} + I_{b_2}}{4V} = 2/13 \times 10^{-3}(I_{b_1} + I_{b_2}) \quad (\text{III})$$

رابطه (III) را در رابطه (I) جایگزین می‌کنیم:

$$\Rightarrow I_O = \frac{0}{53} (101I_{b_2} + 2/13 \times 10^{-3}(I_{b_1} + I_{b_2}))$$

با جایگذاری این رابطه به دست آمده در رابطه (II) داریم:

$$41I_{b_2} = 4040I_{b_1} - \frac{0}{53} (101I_{b_2} + 2/13 \times 10^{-3}(I_{b_1} + I_{b_2}))$$

$$\Rightarrow 41I_{b_2} = 4040I_{b_1} - \frac{0}{53} \times 2/13 \times 10^{-3}I_{b_1} - \frac{0}{53} \times 101I_{b_2} - \frac{0}{53} \times 2/13 \times 10^{-3}I_{b_2}$$

$$\text{از } \frac{0}{53} \times 2/13 \times 10^{-3}I_{b_2} \text{ در مقابل } \frac{0}{53} \times 101I_{b_2} \text{ و } \frac{0}{53} \times 2/13 \times 10^{-3}I_{b_2}$$

مقابل $4040I_{b_1}$ نیز قابل صرفنظر کردن می‌باشد.

$$\Rightarrow 41I_{b_2} = 4040I_{b_1} - \frac{0}{53} \times 101I_{b_2} \Rightarrow 136/3I_{b_2} = 4040I_{b_1}$$

$$\Rightarrow I_{b_2} = 29/6 I_{b_1}$$

با جایگذاری این رابطه در رابطه (III) داریم:

$$I_{4V \cdot K\Omega} = 2/13 \times 10^{-3}(I_{b_1} + 29/6I_{b_1}) = 2/13 \times 10^{-3} \times 35/6I_{b_1}$$

$$= 65 \times 10^{-3}I_{b_1}$$

$$\stackrel{(I)}{\Rightarrow} I_O = \frac{0}{53} (101 \times 29/6I_{b_1} + 65 \times 10^{-3}I_{b_1}) = 2820I_{b_1}$$

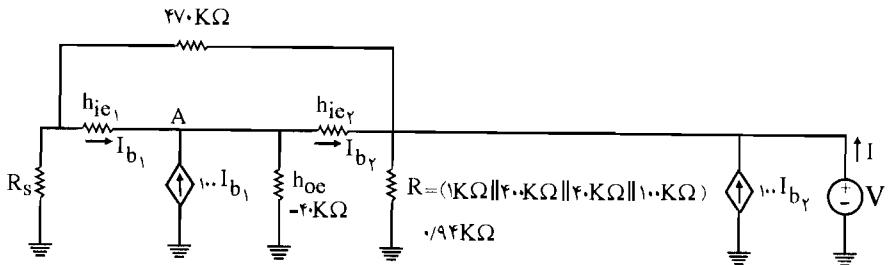
$$\stackrel{(A)}{\Rightarrow} A_I = \frac{I_o}{I_i} = \frac{2820I_{b_1}}{I_{4V \cdot K\Omega} + I_{b_1}} = \frac{2820I_{b_1}}{65 \times 10^{-3}I_{b_1} + I_{b_1}} = 2648$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{4V \times I_{4V \cdot K\Omega} + I_O \times 1}{I_i} = 4V \cdot \frac{I_{4V \cdot K\Omega}}{I_i} + A_I$$

$$\Rightarrow R_i = 4V \times \frac{0/65I_{b_1}}{1/65I_{b_1}} + 2648 = 2676/V K\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = 2648 \times \frac{1}{2676/V} = 0.989$$

برای محاسبه R_O یک منبع ولتاژ V را در خروجی قرار می‌دهیم و منبع ولتاژ ورودی را بی‌اثر می‌کنیم.



$$R_o = \frac{V}{I}$$

$$I = \frac{V}{94} - I_{b2} - 100I_{b1} - I_{9V \cdot K\Omega} \quad (I)$$

$$(A\text{-گره}) \text{ KCL: } I_{b2} = 100I_{b1} + I_{b1} - I_{9V \cdot K\Omega}$$

$$\Rightarrow I_{b2} = 101I_{b1} - \frac{1 \times I_{b1} + V}{9 \cdot K\Omega} \quad (II)$$

حلقه: $V, 9V \cdot K\Omega, R_s$

$$\text{KVL: } 9V \cdot I_{9V \cdot K\Omega} + R_s I_{R_s} + V = 0$$

$$\Rightarrow 9V \cdot I_{9V \cdot K\Omega} - R_s(I_{b1} + I_{9V \cdot K\Omega}) = -V \Rightarrow -V = I_{9V \cdot K\Omega}(9V \cdot K\Omega + R_s) + R_s I_{b1} \quad (III)$$

حلقه: $9V \cdot K\Omega, 1K\Omega, 1K\Omega$

$$\text{KVL: } 9V \cdot I_{9V \cdot K\Omega} - 1 \times I_{b1} - 1 \times I_{b2} = 0 \Rightarrow I_{9V \cdot K\Omega} = \frac{I_{b1} + I_{b2}}{9V \cdot K\Omega}$$

$$-V = \left(\frac{I_{b1} + I_{b2}}{9V \cdot K\Omega} \right) (9V \cdot K\Omega + R_s) + R_s I_{b1}$$

این رابطه را در رابطه (III) قرار می‌دهیم:

$$\Rightarrow I_{b1} + I_{b2} + \frac{R_s}{9V} (I_{b1} + I_{b2}) + R_s I_{b1} = -V$$

$$(1 + R_s) I_{b1} + \left(1 + \frac{R_s}{9V}\right) I_{b2} = -V$$

از $\frac{R_s I_{b1}}{9V}$ در مقابل $R_s I_{b2}$ صرفنظر می‌کنیم.

طبق رابطه (II) داریم:

$$101I_{b1} - 1/0.25 I_{b2} = 0/0.25 V$$

با استفاده از دو معادله بالا I_{b_1} و I_{b_2} رابه دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} I_{b_1} = -\frac{(1 - 0.1 \times 10^{-3} R_s) V}{10.2 + 1/24 R_s} \\ I_{b_2} = -\frac{(1.01 + 20 \times 10^{-3} R_s) V}{10.2 + 1/24 R_s} \end{cases}$$

با جایگذاری این دو مقدار در رابطه (III) داریم:

$$I_{4V \cdot K\Omega} = -\frac{1}{4V_0} \left(\frac{10.2 + 20 \times 10^{-3}}{10.2 + 1/24 R_s} \right) V$$

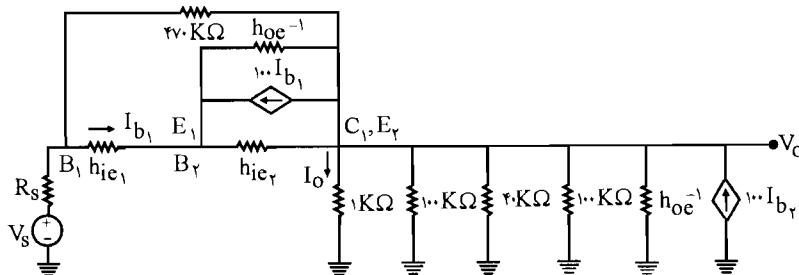
با جایگذاری مقادیر $I_{4V \cdot K\Omega}$ و I_{b_2} در رابطه (I) داریم:

$$I = \frac{V}{0.94} + 1.01 \times \frac{(1.01 + 20 \times 10^{-3} R_s) V}{10.2 + 1/24 R_s} + \frac{1}{4V_0} \times \frac{(10.2 + 20 \times 10^{-3} R_s) V}{10.2 + 1/24 R_s}$$

$$\Rightarrow I = \left(\frac{10.2 + 1/24 R_s + 9.01 \times 10^{-3} R_s + 2/4 R_s}{0.94(10.2 + 1/24 R_s)} \right) V$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{9.01 \times 10^{-3} R_s}{9.691 + 2/64 R_s}$$

مدار دوم، مدار معادل ac این مدار را رسم می‌کنیم:



$$E_1 \text{ گردد: } KCL: I_{b_1} + 100 I_{b_1} = I_{b_2} + \frac{1 \times I_{b_2}}{4V_0} \Rightarrow I_{b_2} = 9.8 / 5 I_{b_1}$$

حلقه $4V_0 \cdot k\Omega$, h_{ie_1} , h_{oe_1}

$$KVL: 4V_0 \cdot I_{4V \cdot K\Omega} = 1 \times I_{b_1} + 1 \times I_{b_2} \Rightarrow 4V_0 \cdot I_{4V \cdot K\Omega} = I_{b_1} + 9.8 / 5 I_{b_1}$$

$$\Rightarrow I_{4V \cdot K\Omega} = 0.21 I_{b_1}$$

$$(C_1 \text{ گردد}) I_O = (I_{b_2} + 100 I_{b_2} - 100 I_{b_1} + \frac{1 \times I_{b_2}}{4V_0} I_{4V \cdot K\Omega}) \times \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{4V_0} + \frac{1}{4V_0} + \frac{1}{100}}$$

$$\Rightarrow I_O = (1.01 / 0.21 I_{b_1} - 100 I_{b_1} + 0.21 I_{b_1}) \times \frac{200}{214}$$

$$\Rightarrow I_O = (10V / 0.25 \times 98/5 I_{b_1} - 99/79 I_{b_1}) \times \frac{100}{10V} = 920V I_{b_1}$$

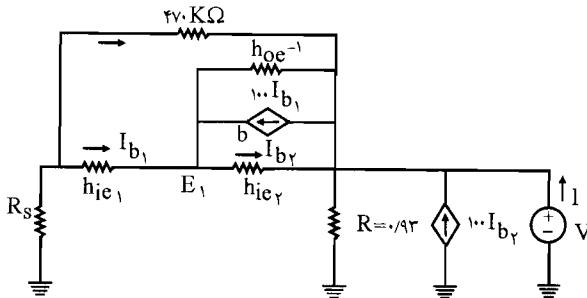
$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{920V I_{b_1}}{I_{b_1} + 14V \cdot K\Omega} = \frac{920V I_{b_1}}{I_{b_1} + 0.14V I_{b_1}} = 76.9$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{4V \cdot I_{fV} \cdot K\Omega + 1 \times I_O}{I_i} = 4V \cdot \frac{I_{fV} \cdot K\Omega}{I_i} + A_I = 4V \times \frac{0.14V I_{b_1}}{0.14V I_{b_1}} + 76.9$$

$$\Rightarrow R_i = 7691 K\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = 76.9 \times \frac{1}{7691} = 0.0104$$

برای محاسبه R_O یک منبع ولتاژ V را در خروجی قرار می‌دهیم و منبع ولتاژ ورودی را بی‌اثر می‌کنیم



$$(گروه E_1) KCL: I_{b_2} = 98/5 I_{b_1}$$

حلقه V , $4V \cdot K\Omega$, R_s

$$KVL: R_s (I_{b_1} + I_{fV} \cdot K\Omega) + 4V \cdot I_{fV} \cdot K\Omega = -V$$

$$\Rightarrow (1/21 R_s + 99/5) I_{b_1} = -V \Rightarrow I_{b_1} = \frac{-V}{99/5 + 1/21 R_s}$$

$$I_{fV} \cdot K\Omega = 0.14V I_{b_1} = \frac{0.14V}{99/5 + 1/21 R_s}$$

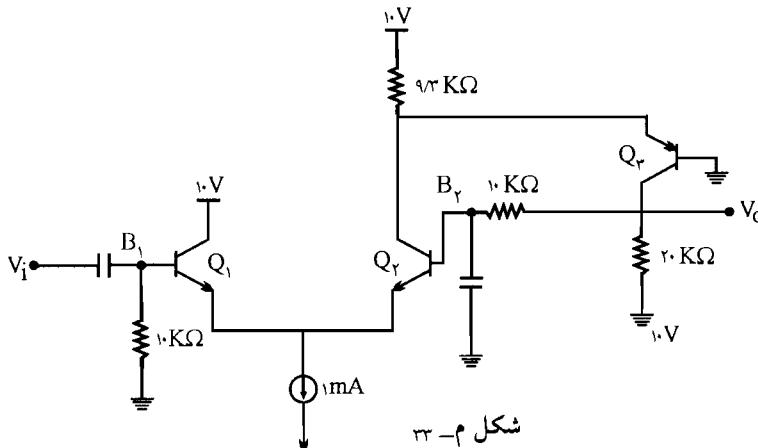
$$I_{b_2} = 98/5 I_{b_1} = - \frac{98/5 V}{99/5 + 1/21 R_s}$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{0.99} + 100 I_{b_1} - \frac{1 \times I_{b_2}}{4} - 100 I_{b_2} - I_{fV} \cdot K\Omega$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{0.92} - \frac{100V}{99/5 + 1/21R_s} - 10/25 \left(\frac{-98/5V}{99/5 + 1/21R_s} \right) - \left(\frac{-0/21V}{99/5 + 1/21R_s} \right)$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{92/5 + 1/12R_s}{9261 + 1/21R_s}$$

۳۳- با فرض $h_{fe} = 100$ و $V_{BE} = 0.7V$ برای همه ترانزیستورها، ولتاژهای DC نقاط B_1 ، B_2 ، A_V را در شکل م-۳۳ به دست آورید. همچنین ولتاژ DC خروجی و بسره ولتاژ A_V را محاسبه نمائید؟



(راه حل:

$$I_{E_1} + I_{E_2} = 1 \text{ mA} \quad (I)$$

$$\text{KVL: } 9/3(I_{C_2} + I_{E_2}) = 10 - V_{BE_2} = 10 - 0.7V = 9.3V$$

$$\Rightarrow I_{C_2} + I_{E_2} = \frac{9.3}{9/3} = 1 \Rightarrow \frac{\beta_2}{1+\beta_2} I_{E_2} + I_{E_2} = 1 \Rightarrow \frac{100}{101} I_{E_2} + I_{E_2} = 1$$

$$\Rightarrow 100 I_{E_2} + 101 I_{E_2} = 101 \quad (II)$$

در حلقه V_{BE_1} و V_{BE_2} و $10k\Omega$ و $20k\Omega$ و $10V$ داریم:

$$\text{KVL: } 10I_{B_1} - 10I_{B_2} + 20(I_{C_2} - I_{B_2}) = 10 - 0.7V + 0.7V = 10$$

$$\Rightarrow 10I_{B_1} - 20I_{B_2} + 20I_{C_2} = 10 \Rightarrow I_{B_1} - 2I_{B_2} + 2I_{C_2} = 1 \Rightarrow \frac{I_{E_1}}{1+\beta_2} - \frac{2I_{E_2}}{1+\beta_2} + 2 \frac{\beta_2}{1+\beta_2} I_{E_2} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{I_{E_1}}{101} - \frac{2I_{E_2}}{101} + \frac{200}{101} I_{E_2} = 1 \Rightarrow I_{E_1} - 2I_{E_2} + 200 I_{E_2} = 101 \quad (III)$$

$$(I), (II), (III): \begin{cases} I_{E_1} + I_{E_2} = 1 \text{ mA} \\ 100 I_{E_2} + 101 I_{E_2} = 101 \\ I_{E_1} - 2I_{E_2} + 200 I_{E_2} = 101 \end{cases}$$

در دو رابطه (II) و (III) را حذف می‌کنیم.

$$\begin{cases} 100 \times 200 I_{E_1} + 101 \times 200 I_{E_2} = 101 \times 200 \\ -101 I_{E_1} + 203 \times 101 I_{E_2} - 200 \times 101 I_{E_1} = -101 \times 101 \end{cases} \xrightarrow{\oplus} 203 \cdot 3 I_{E_2} - 101 I_{E_1} = 9999 \quad (IV)$$

$$(I), (IV): \begin{cases} I_{E_1} + I_{E_2} = 1 \\ 203 \cdot 3 I_{E_2} - 101 I_{E_1} = 9999 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{E_1} = 0.050 \text{ mA} \\ I_{E_2} = 0.459 \text{ mA} \end{cases}$$

$$(III) \Rightarrow I_{E_2} = 0.459 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow V_{B_1} = -10 I_{B_1} = -10 \times \frac{I_{E_1}}{1+\beta} = -10 \times \frac{0.050}{1.1} = -0.45 \text{ V}$$

$$V_{B_2} = V_{BE_2} - V_{BE_1} + V_{B_1} = 0.7 - 0.7 - 0.45 = -0.45 \text{ V}$$

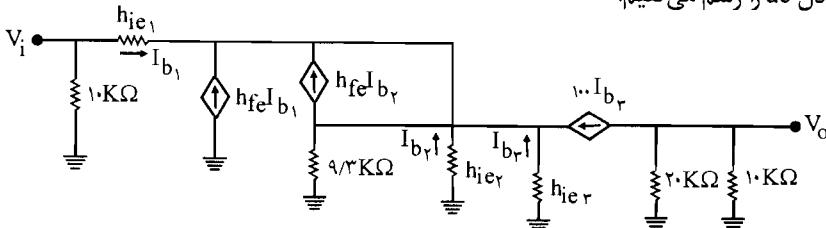
$$\begin{aligned} V_o &= 20 I_{C_2 K} - 10 = 20 (I_{C_2} - I_{B_2}) - 10 = 20 \left(\frac{I_{E_2} \times \beta}{1+\beta} - \frac{I_{E_2}}{1+\beta} \right) - 10 \\ &= 20 \left(\frac{0.459 \times 1.0}{1.1} - \frac{0.459}{1.1} \right) - 10 \approx 0 \end{aligned}$$

$$I_{C_1} = \frac{I_{E_1} \times \beta}{1+\beta} = \frac{0.050 \times 1.0}{1.1} \Rightarrow h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{100 \times 26}{I_{C_1}} = \frac{2600}{0.05} = 52 \text{ K}\Omega$$

$$I_{C_2} = \frac{I_{E_2} \times \beta}{1+\beta} = \frac{0.459 \times 1.0}{1.1} \Rightarrow h_{ie_2} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_2}} = \frac{26 \times 1.0}{I_{C_2}} = 0.26 \text{ K}\Omega$$

$$I_{C_1} = \frac{I_{E_1} \times \beta}{1+\beta} = \frac{0.050 \times 1.0}{1.1} \Rightarrow h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{100 \times 26}{I_{C_1}} = 0.15 \text{ K}\Omega$$

حال مدار معادل ac را رسم می‌کنیم:



$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-100 I_{b_2} \times (20 \text{ K}\Omega \parallel 10 \text{ K}\Omega)}{h_{ie_1} I_{b_1} - h_{ie_2} I_{b_2}} = \frac{-100 I_{b_2} \times \frac{20}{20+10}}{0.26 I_{b_1} - 0.15 I_{b_2}} \quad (I')$$

$$\begin{aligned} \text{KCL: } I_{b_1} + h_{fe} I_{b_1} + h_{fe} I_{b_2} + I_{b_2} &= 0 \Rightarrow (1 + 100) I_{b_1} = -(100 + 1) I_{b_2} \\ \Rightarrow I_{b_1} &= -I_{b_2} \quad (II') \end{aligned}$$

حلقه ۹/۳KΩ ، h_{ie}

$$\text{KVL: } 9/3I_9/3KΩ - h_{ie}I_{bγ} = 0 \quad (\text{III})' \quad \text{و} \quad I_9/3KΩ = -100I_{bγ} - I_{bγ} + 100I_{bγ} - I_{bγ}$$

$$\Rightarrow I_9/3KΩ = -100I_{bγ} + 99I_{bγ}$$

$$(\text{II})' = 9/3(-100I_{bγ} + 99I_{bγ}) - 5/15I_{bγ} = 0 \Rightarrow 920/75I_{bγ} = 944/45I_{bγ}$$

$$\Rightarrow I_{bγ} = 1/0.26I_{bγ} \quad (\text{IV})'$$

$$(\text{I}') : A_V = \frac{-100 \times \frac{7}{3} \times I_{bγ}}{5/2 \times (-1/0.26I_{bγ}) - 5/7 \times 1/0.26I_{bγ}} = 59/61$$

۳۴ - در مدار شکل م - ۳۴ مقاومت‌های R_1 و R_2

R_3 را طوری محاسبه کنید که شرایط زیر به طور همزمان برقرار باشد.

(الف) $V_{CEQ} = 5V$ باشد.

(ب) به ازای $h_{fe} = 300$ مقاومت ورودی حداقل شود.

(ج) مدار از پایداری مطلوبی نسبت به تغییرات β بخوردار باشد.

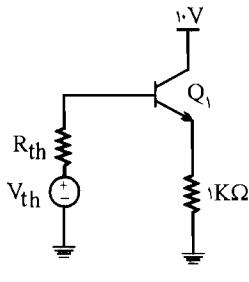
راه حل:

با اجرای تونن در بیس داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{th} = R_\gamma + (R_1 \parallel R_\gamma) = R_\gamma + \frac{R_1 R_\gamma}{R_1 + R_\gamma} \\ V_{th} = V_{CC} \times \frac{R_\gamma}{R_1 + R_\gamma} = 10 \times \frac{R_\gamma}{R_1 + R_\gamma} \end{array} \right.$$

و مدار در حالت dc به صورت مقابل در می‌آید:

فرض: $I_C \approx I_E$



$$\text{KVL: } R_{th} I_B + 1KΩ I_E = V_{th} - V_{BE}$$

$$\Rightarrow R_{th} \times \frac{I_C}{\beta} + I_C = V_{th} - V_{BE} \Rightarrow$$

$$I_C \left(\frac{R_{th}}{\beta} + 1 \right) = V_{th} - V_{BE} \quad (\text{I})$$

و با توجه به فرض آخر مسئله یعنی پایداری مطلوب نسبت به تغییرات β داریم:

$$\frac{R_{th}}{\beta} = \frac{1}{1} R_E = \frac{1}{1} \times 1 K\Omega = \frac{1}{1} \Rightarrow R_{th} = \frac{1}{1} \beta \quad (II)$$

(II) در (I) جایگزین می‌کنیم:

$$I_C \left(\frac{\frac{1}{1} \beta}{\beta} + 1 \right) = V_{th} - V_{BE} \Rightarrow I_C \left(\frac{1}{1} \right) = V_{th} - \frac{1}{1} V$$

$$\Rightarrow I_C = \frac{V_{th} - \frac{1}{1} V}{\frac{1}{1}}$$

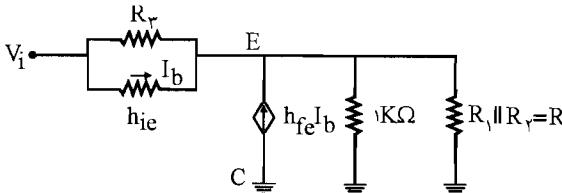
$$KVL: V_{CEQ} = V_{CC} - R_E I_E = 10 - 1 K\Omega \times I_E \quad , \quad I_C \approx I_E$$

$$\Rightarrow V_{CEQ} = 10 - I_C = 10 - \frac{V_{th} - \frac{1}{1} V}{\frac{1}{1}} = 5 V \quad (\text{فرض مسئله } V_{CEQ} = 5 V)$$

$$\Rightarrow V_{th} = -5/5 + 11 + \frac{1}{1} V = 6/2 V \Rightarrow I_{CQ} = \frac{V_{th} - \frac{1}{1} V}{\frac{1}{1}} = \frac{6/2 - \frac{1}{1} V}{\frac{1}{1}} = 5 mA$$

$$\Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{CQ}} = \frac{300 \times 26}{5} = 1/6 K\Omega$$

مدار معادل ac به صورت زیر درمی‌آید.



$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{h_{ie} I_b + (1 + h_{fe}) I_b (1 K\Omega \parallel R) + \frac{h_{ie} I_b}{R_r} \times (R \parallel 1 K\Omega)}{I_b + \frac{h_{ie} I_b}{R_r}}$$

$$= \frac{h_{ie} I_b + (1 + h_{fe} + \frac{h_{ie}}{R_r}) I_b \times \frac{R \times 1}{R + 1}}{I_b + \frac{h_{ie} I_b}{R_r}} = \frac{h_{ie} + (1 + h_{fe} + \frac{h_{ie}}{R_r}) \times \frac{R}{R + 1}}{1 + \frac{h_{ie}}{R_r}}$$

$$= \frac{R_r (R + 1) h_{ie} + R R_r (1 + h_{fe}) + R h_{ie}}{(R_r + h_{ie})(1 + R)}$$

$$h_{fe} = 300 \Rightarrow R_{th} = \frac{1}{1} \beta \quad (II) \Rightarrow R_{th} = \frac{1}{1} \times 300 = 30 K\Omega$$

$$R_{th} = R_r + \frac{R_r R_f}{R_1 + R_r} = R_r + R = 30 \Rightarrow R = 30 - R_r$$

با جایگذاری این مقادیر در R_i داریم:

$$R_i = \frac{R_2(30 - R_2 + 1) \times 1/6 + (30 - R_2)R_2(1 + 300) + (30 - R_2) \times 1/6}{(R_2 + 1/6)(1 + 30 - R_2)}$$

$$\Rightarrow R_i = \frac{30 \cdot 2/6 R_2^2 - 90 \cdot 78 R_2 - 48}{R_2^2 - 29/4 R_2 - 49/6}$$

طبق فرض ب مسئله مقاومت ورودی باید حداکثر شود پس از رابطه R_i نسبت به R_2 مشتق می‌گیریم و برابر صفر قرار می‌دهیم:

$$\Rightarrow \frac{dR_i}{dR_2} = \frac{(30 \cdot 2/6 \times 2R_2 - 90 \cdot 78)(R_2^2 - 29/4 R_2 - 49/6) - (2R_2 - 29/4)(30 \cdot 2/6 R_2^2 - 90 \cdot 78 \times R_2 - 48)}{(R_2^2 - 29/4 R_2 - 49/6)^2}$$

$$\frac{dR_i}{dR_2} = 0 \Rightarrow \text{صورت برابر صفر باید باشد} \Rightarrow 181/56 R_2^2 - 29921/92 R_2 + 448807/6 = 0$$

$$\Rightarrow R_2^2 - 164/8 R_2 + 2472/2 = 0$$

با حل این معادله درجه ۲ مقادیر R_2 به دست می‌آید:

$$\begin{cases} R_2 = 16/69 K\Omega \\ R_2 = 148 K\Omega \end{cases}$$

طبق رابطه R_{th} داریم: $R_{th} = R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 30 K\Omega$ نمی‌تواند از $30 K\Omega$ بیشتر باشد

پس $R_2 = 148 K\Omega$ قابل قبول نمی‌باشد ولی $R_2 = 16/69 K\Omega$ قابل قبول است.

$$\Rightarrow R_{th} = R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 30 K\Omega \Rightarrow \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 30 - 16/69 = 13/31 \quad (A)$$

$$\Rightarrow V_{th} = \frac{1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 6/2 V \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0/62$$

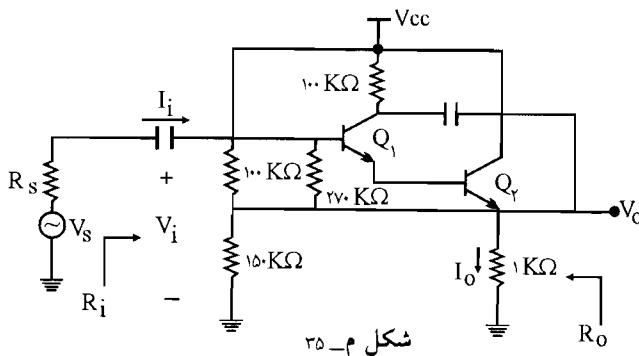
$$\Rightarrow A: R_1 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 13/31 \Rightarrow R_1 \times 0/62 = 13/31 \Rightarrow R_1 = 21/4 V K\Omega$$

$$\Rightarrow \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 13/31 \Rightarrow \frac{21/4 V R_2}{21/4 V + R_2} = 13/31 \Rightarrow 21/4 V R_2 = 285/76 + 13/31 R_2$$

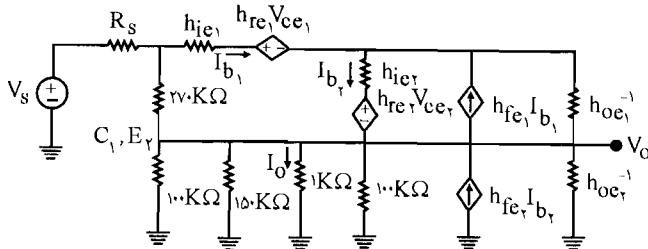
$$\Rightarrow R_2 = 30 K\Omega$$

۳۵- در مدار تقویت کننده کلکتور مشترک شکل م-۳۵ با فرض $h_{oe} = 40 \text{ K}\Omega$, $h_{ie} = 1 \text{ K}\Omega$, $V_{ce1} = V_{ce2} = 0.98 \text{ V}$ و $A_{V1} = A_{V2} = 0.96$, $R_1 = R_2 = 100 \text{ K}\Omega$

مقدار دقیق R_1 را محاسبه کنید و توضیح دهید از چه روشی و چگونه مقاومت ورودی تقویت کننده افزایش یافته است؟



(راه حل:



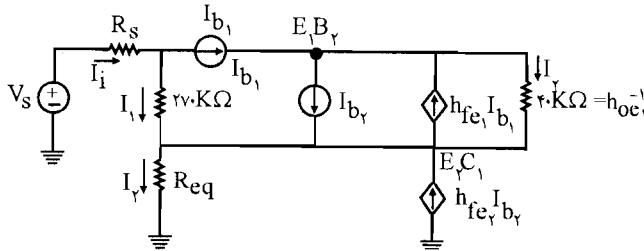
مدار معادل ac را رسم می کنیم:

مقاومت معادل مقاومت های موازی h_{oe}^{-1} و $100 \text{ K}\Omega$ و $150 \text{ K}\Omega$ و $100 \text{ K}\Omega$ را می بابیم:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{150} + \frac{1}{1} + \frac{1}{100} + \frac{1}{4}} = 0.95 \text{ K}\Omega$$

و به جای شاخه Ib_1 منبع جریان Ib_1 و به جای شاخه Ib_2 منبع جریان Ib_2 را جایگزین می کنیم و مدار

معادل را رسم می کنیم:



با توجه به فرض مسئله داریم:

$$A_{V_1} = \frac{V_{e_1}}{V_{b_1}} = 0/96$$

با توجه به مدار معادل V_{b_1} را می‌بابیم:

$$\begin{cases} V_{e_1} = 40I_2 + 0/95I_3 \\ V_{b_1} = 270I_1 + 0/95I_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_{V_1} = \frac{40I_2 + 0/95I_3}{270I_1 + 0/95I_3} = 0/96 \Rightarrow 40I_2 + 0/95I_3 = 259/2I_1 + 0/912I_3$$

$$40I_2 = 0/0.38I_3 = 259/2I_1 \quad (I)$$

$$A_{V_2} = \frac{V_{e_2}}{V_{b_2}} = 0/98 \Rightarrow \begin{cases} V_{e_2} = 0/95I_3 \\ V_{b_2} = 40I_2 + 0/95I_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_{V_2} = \frac{0/95I_3}{40I_2 + 0/95I_3} = 0/98 \Rightarrow 0/95I_3 = 39/2I_2 + 0/931I_3$$

$$\Rightarrow 39/2I_2 = 0/0.19I_3 \Rightarrow I_3 = 20.63I_2 \quad (II)$$

با جایگذاری (II) در (I) داریم:

$$40I_2 + 0/0.38 \times 20.63I_2 = 259/2I_1 \Rightarrow I_1 = 0/456I_2$$

$$E_2 \text{ در گره KCL: } 100I_{b_2} + I_{b_2} - 100I_{b_1} + I_2 + I_1 - I_3 = 0$$

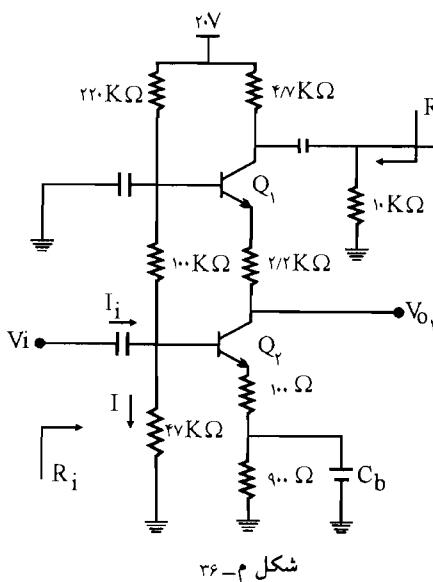
$$\Rightarrow 101I_{b_2} - 100I_{b_1} = 20.63I_2 - 0/456I_2 - I_2 = 20.61I_2 \quad (A)$$

$$E_1 \text{ در گره KCL: } I_{b_1} + 100I_{b_1} = I_2 + I_{b_2} \Rightarrow 101I_{b_1} - I_{b_2} = I_2 \quad (B)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 101I_{b_2} - 100I_{b_1} = 20.61I_2 \\ -I_{b_2} + 101I_{b_1} = I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{b_1} = 0/214I_2 \\ I_{b_2} = 20/81I_2 \end{cases}$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_{b_1}}{I_1 + I_{b_1}} = \frac{270I_1 + 0/95I_3}{0/456I_2 + 0/214I_2} = \frac{270 \times 0/456I_2 + 0/95 \times 20.63I_2}{0/465I_2 + 0/214I_2}$$

$$R_i = \frac{20.82/9V}{0/6V} = 31.08 \text{ K}\Omega$$



شکل م - ۳۶

۳۶ - در مدار تقویت کننده شکل م - ترانزیستورها مشابه و β آنها بزرگ فرض می‌شود. با فرض $V_{CE(sat)} = 0/2V$ ، $h_{re} = h_{oe} \cong 0$ و $V_{BE(ON)} = 0/7V$

الف) مقادیر جریان I_{CQ} و ولتاژ V_{CEQ} را برای هر یک از ترانزیستورها به دست می‌آید.

ب) مقادیر کمیت‌های A_V ، $A_V = \frac{V_{O_1}}{V_i}$ R_O و R_i را محاسبه کنید؟

(ا) هل:

الف) چون β بسیار بزرگ فرض شده است پس جریان بیس ترانزیستورها صفر می‌شود پس $I_E = I_C$ خواهد شد.

در شاخه مقاومت‌های $220\text{ K}\Omega$ و $100\text{ K}\Omega$ و $47\text{ K}\Omega$ جریان I را به دست می‌آوریم:

$$I = \frac{20\text{ V}}{220 + 100 + 47} = \frac{20}{367} \text{ mA}$$

: حلقه $47\text{ K}\Omega$ ، V_{BE_1} ، 100Ω ، 900Ω

$$\text{KVL: } 4V - (0/1 + 0/9) I_{E_1} = V_{BE_1} \Rightarrow 4V - I_{C_1} = 0/V \Rightarrow$$

$$I_{C_1} = 4V - 0/V = 4V \times \frac{20}{367} - 0/V = 1/86 \text{ mA}$$

از طرفی با توجه به مدار $I_{C_1} = I_{C_2}$

$$\Rightarrow I_{C_1} = I_{C_2} = 1/86 \text{ mA}$$

: $V_{BE} = 100\text{ K}\Omega$ و $47\text{ K}\Omega$

$$Q_1: \begin{cases} \text{KVL: } V_{E_1} = (4V + 100)I - V_{BE_1} \\ \Rightarrow 14V \times \frac{20}{367} - 0/V = 7/3V \\ \text{KVL: } V_{C_1} = 20 - 4/V I_{C_1} = 20 - 4/V \times 1/86 = 11/26V \end{cases}$$

$$V_{CE_1} = V_{C_1} - V_{E_1} = 11/26 - 7/23 = 3/96 \text{ V}$$

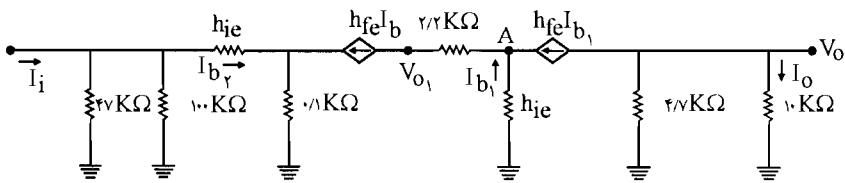
$$Q_1: \begin{cases} V_{C_1} = V_{E_1} - 2/2 I_{C_1} = 7/23 - 2/2 \times 1/86 = 3/21 \text{ V} \\ V_{E_1} = (100 + 90) \times 10^{-3} I_{C_1} = 1 \times 1/86 = 1/86 \text{ V} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_{CE_1} = V_{C_1} - V_{E_1} = 3/21 - 1/86 = 1/35 \text{ V}$$

$$I_{C_1} = I_{C_1} \quad (b)$$

$$h_{ie_1} = h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = h_{fe} \times \frac{26}{1/86} = 14 \times 10^{-3} h_{fe} \text{ K}\Omega$$

و چون h_{fe} بسیار بزرگ می‌باشد پس $\rightarrow h_{ie}$ ، مدار معادل به صورت زیر می‌باشد:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} (I) \begin{cases} I_O = -h_{fe} I_{b_1} \frac{1/V}{1/V + 10} = \frac{-1/V h_{fe} I_{b_1}}{14/V} \\ I_i = I_{b_1} + \frac{h_{ie} I_{b_1} + (1 + h_{fe}) I_{b_1} \times 1/V}{14/V K \parallel 100 \text{ K}\Omega} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_i = I_{b_1} + \frac{(14 \times 10^{-3} h_{fe} + h_{fe} \times 1/V) I_{b_1}}{14/V K \parallel 100 \text{ K}\Omega} \quad \text{به جای } 1 + h_{fe} \text{ را قرار می‌دهیم.}$$

چون h_{fe} خیلی بزرگ می‌باشد از I_{b_1} در مقابل کسر بعدی صرفنظر می‌کنیم \Leftarrow

$$I_i = \frac{1/V h_{fe}}{14/V K \parallel 100 \text{ K}\Omega}$$

$$A_I = \frac{(1 + h_{fe}) I_{b_1}}{I_i} = \frac{h_{fe} I_{b_1}}{I_i} \Rightarrow I_{b_1} \approx I_i$$

$$\Rightarrow A_I = \frac{I_O}{I_i} (I) \Rightarrow A_I = \frac{\frac{-1/V h_{fe} I_{b_1}}{14/V}}{\frac{1/V h_{fe}}{14/V K \parallel 100 \text{ K}\Omega}} = \frac{-1/V I_{b_1} \times h_{fe}}{14/V} \frac{14/V K \parallel 100 \text{ K}\Omega}{14/V}$$

$$\Rightarrow A_I = -89/75$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{h_{ie} I_{b_1} + (1+h_{fe}) \times 10^{-3} I_{b_1}}{\frac{0.114 I_{b_1} h_{fe}}{75}} = \frac{14 \times 10^{-3} h_{fe} + 0.1 h_{fe}}{\frac{0.114 h_{fe}}{75}} = 37 K\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -89/75 \times \frac{10}{37} = -2.4/0.75$$

$$V_{O_1} = -2/2 I_1 / 75 K\Omega - h_{ie} I_{b_1} = -2/2 \times (1+h_{fe}) I_{b_1} - h_{ie} I_{b_1}$$

$$= -(2/2 h_{fe} + h_{ie}) I_{b_1} = -(2/2 h_{fe} + 14 \times 10^{-3} h_{fe}) I_{b_1}$$

$$= -(2/2 + 14 + 10^{-3}) h_{fe} I_{b_1} = -2/2 14 h_{fe} I_{b_1}$$

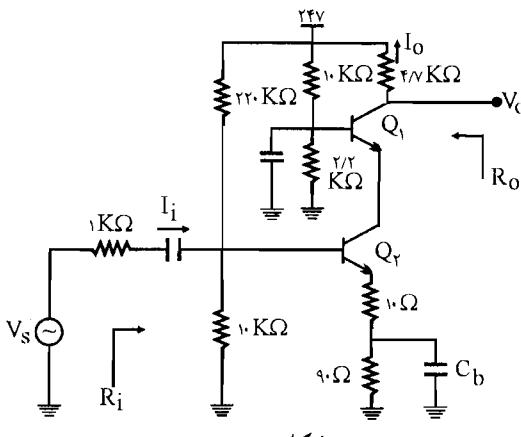
$$A_{V_1} = \frac{V_{O_1}}{V_i} = \frac{-2/2 14 h_{fe} I_{b_1}}{\frac{0.114 h_{fe} I_{b_1}}{75}} = -19/42$$

$$R_O = 4/V \parallel 10 = \frac{4/V \times 10}{4/V + 10} = 3/2 K\Omega$$

۳۷- در مدار تقویت کننده شکل م-۳۷، β ترانزیستورها بسیار بزرگ است.

(الف) مختصات نقطه کار DC هر یک از ترانزیستورها را به دست آورید.

(ب) مقادیر A_V ، R_O ، R_i ، A_I و V_o را محاسبه کنید؟



شکل م-۳۷

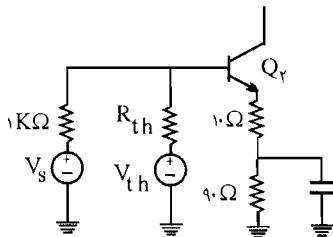
راه حل:

$$Q_1: \begin{cases} R_{th} = 220 \text{ K}\Omega \parallel 10 \text{ K}\Omega = \frac{220 \times 10}{220 + 10} = 9.56 \text{ K}\Omega \\ V_{th} = V_{CC} \times \frac{10 \text{ K}\Omega}{220 + 10} = 24 \times \frac{10}{230} = 1.043 \text{ V} \end{cases}$$

پس ورودی Q_2 به صورت زیر در می‌آید:

$$\text{KVL: } V_{th} - V_{BE_1} = R_{th} I_{B_1} + \frac{(10 + 90)}{10} I_{E_1} \Rightarrow$$

چون β ترانزیستور بسیار بزرگ است پس $I_{B_1} = 0$ می‌باشد و



$$\Rightarrow V_{th} - V_{BE_1} = 0 / 1 I_{C_1} \Rightarrow I_{C_1} = \frac{1.043 - 0}{1} = 1.043 \text{ mA}$$

$$\text{از طرفی: } I_{C_1} = I_{C_2} \Rightarrow I_{C_2} = 1.043 \text{ mA}$$

در حلقه V_{CC} و $10 \text{ K}\Omega$ و $2/2 \text{ K}\Omega$ داریم:

$$I = \frac{24 \text{ V}}{2/2 + 10} = 1.96 \text{ V mA}$$

در حلقه V_{BE_1} و V_{CE_1} و $4/4 \text{ K}\Omega$ داریم:

$$\text{KVL: } 10 \times I - 4/4 I_{C_1} = V_{CE_1} - V_{BE_1} \Rightarrow 10 \times 1.96 - 4/4 \times 1.043 + 0 = V_{CE_1},$$

$$\Rightarrow V_{CE_1} = 4.25 \text{ V}$$

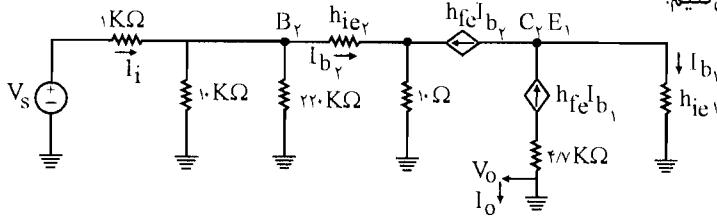
در حلقه V_{CC} و V_{CE_1} و $4/4 \text{ K}\Omega$ و 10Ω و 90Ω داریم:

$$\text{KVL: } 4/4 I_{C_1} + \frac{(10 + 90)}{10} I_{E_1} = -V_{CE_1} - V_{CE_2} + 24$$

$$\Rightarrow V_{CE_2} = 24 - 4/4 - 4/4 \times 1.043 - 0/1 \times 1.043 = 3.29 \text{ V}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{h_{fe} \times 24}{1.043} = 1.5 h_{fe} \Omega = 1.5 \times 10^{-3} h_{fe} \text{ K}\Omega \\ h_{ie_2} = 1.5 h_{fe} \end{array} \right. \quad (b)$$

مدار معادل ac را رسم می‌کنیم:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-h_{fe} I_{b1}}{V_{B2} + \frac{10K\Omega \parallel 22K\Omega}{10K\Omega}} = \frac{-h_{fe} I_{b1}}{I_{b2} + \frac{9/56}{10/56}} \quad (I)$$

$$V_{B2} = (1 + h_{fe}) I_{b2} \times 10 \times 10^{-3} + h_{ie2} I_{b2}$$

$$h_{fe} I_{b2} = (1 + h_{fe}) I_{b2} \Leftarrow h_{fe} I_{b2} + I_{b2} = h_{fe} I_{b2} \quad \text{در گره } C_2 \text{ و } E_1 \text{ داریم:}$$

$$\Rightarrow h_{fe} I_{b2} \cong h_{fe} I_{b1} \Rightarrow I_{b2} \cong I_{b1}$$

$$(I) : A_I = \frac{-h_{fe} I_{b1}}{I_{b1} + \frac{h_{fe} I_{b1} \times 10^{-3} + h_{fe} \times 9/56 \times 10^{-3}}{9/56}}$$

و چون h_{fe} بسیار بزرگ است در مخرج A_I از I_{b1} در مقابل کسر بعدی صرف نظر می‌کنیم:

$$\Rightarrow A_I = \frac{-h_{fe} I_{b1}}{\frac{h_{fe} I_{b1} \times 10^{-3} + h_{fe} I_{b1} \times 9/56 \times 10^{-3}}{9/56}} = \frac{-9/56}{9/56 \times 10^{-3} + 10^{-3}} = -0.44$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i}{\frac{V_i}{9/56} + I_{b2}} = \frac{V_i}{\frac{V_i}{9/56} + I_{b1}} = \frac{1}{\frac{1}{9/56} + \frac{I_{b1}}{V_i}}$$

$$\Rightarrow R_i = \frac{\frac{1}{9/56} + \frac{I_{b1}}{h_{ie2} I_{b2} + (1 + h_{fe}) I_{b2} \times 0.1}}{I_{b1}} = \frac{\frac{1}{9/56} + \frac{I_{b1}}{h_{ie2} I_{b1} + h_{fe} I_{b1} \times 0.1}}{I_{b1}}$$

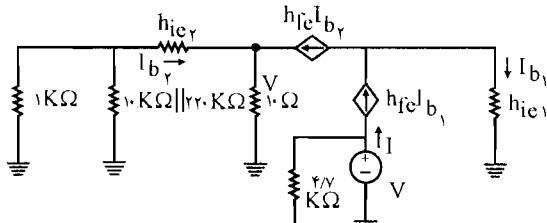
چون h_{fe} خیلی بزرگ است در مخرج R_i کسر دوم یعنی $\frac{1}{h_{fe} I_{b1} + h_{fe} I_{b1} \times 0.1}$ برابر صفر می‌شود

$$\Rightarrow R_i = \frac{1}{\frac{1}{9/56}} = 9/56 K\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -0.44 \times \frac{4/7}{9/56} = -2.67$$

$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -2.67 \times \frac{9/56}{9/56 + 1} = -2.42$$

برای به دست آوردن R_O یک منبع ولتاژ V در خروجی قرار می‌دهیم و منبع ولتاژ ورودی را صفر قرار می‌دهیم.

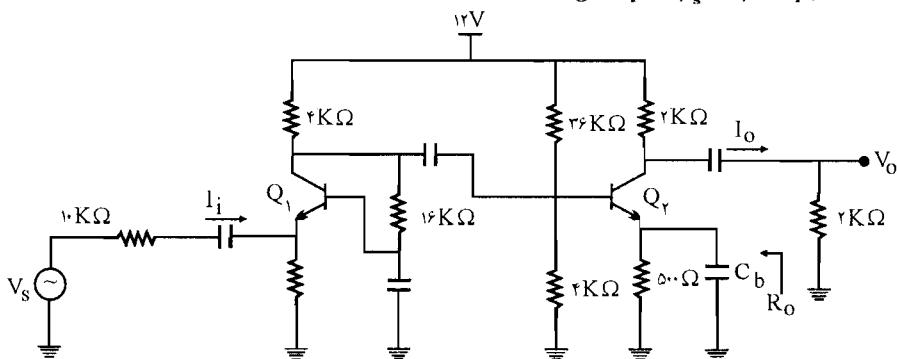


$$R_O = \frac{V}{I} = 4/V K\Omega$$

۳۸- در مدار تقویت کننده شکل م-۳۸ با فرض $h_{re} = h_{oe} \approx ۰$ و $h_{fe} = ۵۰$ برای هر دو ترانزیستور

(الف) نقطه کار هر یک از ترانزیستورها را تعیین کنید؟

(ب) مقادیر i ، R_O و A_V را محاسبه کنید؟



شکل م-۳۸

(ا) حل:

حلقه: $V_{CC} = 12V$ ، $4K\Omega$ ، $16K\Omega$ ، $V_{BE1} = 0.7V$ ، 80Ω

$$\text{KVL: } 4(I_{C1} + I_{B1}) + 16I_{B1} + 80 \times 10^{-3}I_{B1} = 12 - V_{BE1} = 12 - 0.7V = 11.3V$$

$$\Rightarrow 4I_{E1} + \frac{16 \times I_{E1}}{1+\beta_1} + 80 \times 10^{-3}I_{E1} = 11.3V \Rightarrow I_{E1} = \frac{11.3V}{4/39}$$

$$\Rightarrow I_{C1} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{E1} = \frac{50}{51} \times \frac{11.3V}{4/39} = 2.52mA$$

$$\Rightarrow V_{CE1} = V_{CC} - (4 + 80 \times 10^{-3}) I_{E1} = 12 - 4 \times 80 \times 10^{-3} \times \frac{11.3V}{4/39} = 1.5V$$

$$Q_1: \begin{cases} R_{th} = 4K\Omega \parallel 36K\Omega = 4/36 K\Omega \\ V_{th} = V_{CC} \times \frac{4K\Omega}{4+36} = 12 \times \frac{4}{40} = 1.2V \end{cases}$$

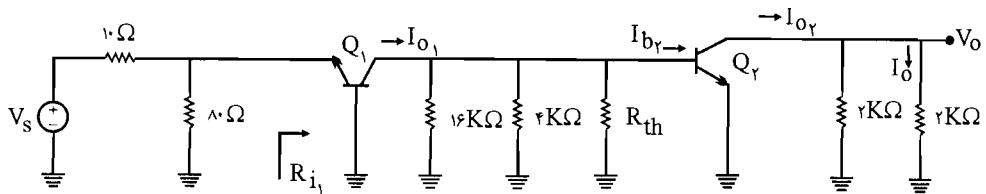
$$\text{KVL: } R_{th} I_{B_1} + 0.0 \times 10^{-3} I_{B_1} = V_{th} - V_{BE_1} = 1.2 = 0/V = 0/0$$

$$\Rightarrow 36I_{B_1} + 0/0 \times 0.1I_{B_1} = 0/0 \Rightarrow I_{B_1} = \frac{0}{36} mA \Rightarrow I_{C_1} = 0.1I_{B_1} = 0/10 mA$$

$$\Rightarrow V_{CE_1} = V_{CC} - 2I_{C_1} - 0/0 I_{E_1} = 12 - 2/0 I_{C_1} = 12 - 2/0 I_{C_1} = 12 - 2/0 \times 0/10 = 9/10 V$$

$$\begin{cases} h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{0.1 \times 26}{2/02} = 0/02 K\Omega \\ h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{0.1 \times 26}{0/10} = 1/0 K\Omega \end{cases} \quad (b)$$

مدار معادل ac به صورت زیر می‌باشد:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{I_O}{I_{O_1}} \times \frac{I_{O_1}}{I_{b_1}} \times \frac{I_{b_1}}{I_{O_1}} \times \frac{I_{e_1}}{I_i} \quad (I)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{I_{O_1}}{I_{b_1}} = -h_{fe} = -0.1 & , \quad \frac{I_{O_1}}{I_{e_1}} = \frac{h_{fe}}{1+h_{fe}} = \frac{0.1}{0.1} \\ \frac{I_O}{I_{O_1}} = ? & \text{با استفاده از تقسیم جریان} : I_O = \frac{I_{O_1} \times 2K\Omega}{2+2} = \frac{I_{O_1}}{2} \Rightarrow \frac{I_O}{I_{O_1}} = \frac{1}{2} \\ \frac{I_{b_1}}{I_{O_1}} = ? & I_{b_1} = I_{O_1} \times \frac{(16K\Omega \parallel 4K\Omega \parallel R_{th})}{(16K\Omega \parallel 4K\Omega \parallel R_{th}) + h_{ie_1}} = \frac{I_{O_1} \times 1/64}{1/64 + 1/0} = 0/03 I_{O_1} \\ \frac{I_{e_1}}{I_i} = ? & \Rightarrow I_{e_1} = \frac{I_i \times (1.0 \parallel 1.0)}{(1.0 \parallel 1.0) + h_{ie_1}} = I_i \times \frac{1}{1 + 0/02} = 0/99 I_i \end{cases}$$

$$\Rightarrow (I): A_I = \frac{1}{\gamma} \times (-50) \times 0.02 \times \frac{50}{51} \times 0.94 = -12/2$$

$$R_{i_\gamma} = h_{ie_\gamma} = 1/5 K\Omega$$

$$R_{L_\gamma} = 2K\Omega \parallel 2K\Omega = 1K\Omega = R_O$$

$$R_{L_1} = 16K\Omega \parallel 4K\Omega \parallel R_{th} \parallel R_{i_\gamma} = 16K\Omega \parallel 4K\Omega \parallel 3/8K\Omega \parallel 1/5K\Omega = 0.8K\Omega$$

$$R_{i_1} = \frac{h_{ie_1}}{1+h_{fe}} = \frac{0.02}{51} = 1.0 \Omega$$

$$R_i = 8.0 \Omega \parallel R_{i_1} = 8.0 \Omega \parallel 1.0 \Omega = \frac{8.0 \times 1.0}{8.0 + 1.0} = 0.89 K\Omega$$

$$A_V = \frac{V_O}{V_{e_1}} = \frac{V_O}{V_{b_\gamma}} \times \frac{V_{b_\gamma}}{V_{e_1}} \Rightarrow \begin{cases} \frac{V_O}{V_{b_\gamma}} = \frac{I_{O_\gamma} \times R_{L_\gamma}}{I_{b_\gamma} \times R_{i_\gamma}} = \frac{I_{O_\gamma}}{I_{b_\gamma}} \times \frac{R_{L_\gamma}}{R_{i_\gamma}} = -50 \times \frac{1K\Omega}{1/5} = \frac{-50}{1/5} \\ \frac{V_{b_\gamma}}{V_{e_1}} = \frac{I_{O_1} \times (R_{L_1})}{I_{e_1} \times R_{i_1}} = \frac{I_{O_1}}{I_{e_1}} \times \frac{R_{L_1}}{R_{i_1}} = \frac{50}{51} \times \frac{0.8}{1.0 \times 1.0} = 0.8/4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_V = \frac{V_O}{V_{e_1}} = \frac{-50}{1/5} \times 0.8/4 = -2613$$

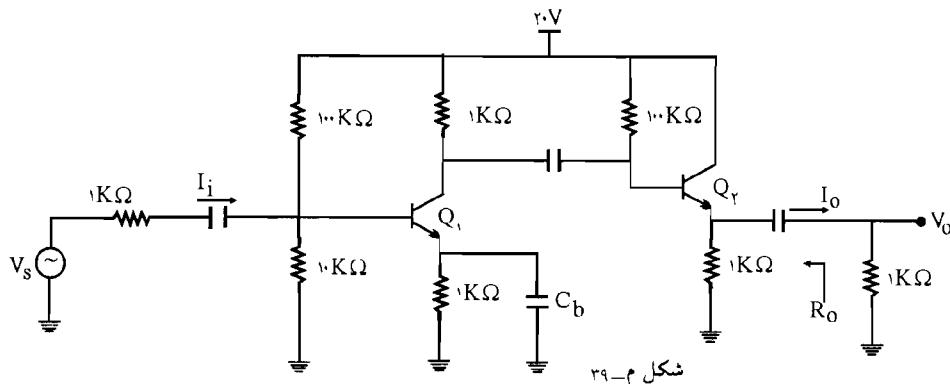
$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -2613 \times \frac{0.89}{0.89 + 1.0} = -122.0$$

۳۹- در تقویت کننده شکل م-۳۹ ترانزیستورها مشابه‌اند. با فرض $100 h_{fe}$

الف) مختصات نقطه کار DC ترانزیستورها را تعیین کنید؟ ب) A_V ، A_I و R_O را به دست

آورید؟ ج) حداقل دامنه نوسان متقارن برای V_{ce_1} و V_{ce_2} را به دست آورد و از آنجا حداقل دامنه

نوسان متقارن ولتاژ ورودی V_s را محاسبه کنید؟



راه حل:

الف) در بیس Q₁ تونن را اجرامی کنیم:

$$Q_1: \begin{cases} R_{th} = 10 K\Omega \parallel 100 K\Omega = \frac{10 \times 100}{10 + 100} = 9/1 K\Omega \\ V_{th} = 20 \times \frac{10}{10 + 100} = 1.82 V \end{cases}$$

حلقه: $R_{th}, V_{BE_1}, 1 K\Omega, V_{th}$

$$\text{KVL: } R_{th} I_{B_1} + 1 K\Omega \times I_{E_1} = V_{th} - V_{BE_1} \Rightarrow 9/1 I_{B_1} + (1 + \beta) = 1.82 - 0/V = 1.82$$

$$\Rightarrow I_{B_1} = \frac{1.82}{9/1 + 10} = 0.182 \text{ mA} \Rightarrow I_{C_1} = \beta I_{B_1} = 100 \times 0.182 = 18.2 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{100 \times 26}{18.2} = 550 \text{ K}\Omega$$

حلقه: $20 V, 1 K\Omega, V_{CE_1}, 1 K\Omega$

$$\text{KVL: } V_{CE_1} = 20 - 1 \times I_{C_1} - 1 \times I_{E_1} = 20 - 18.2 \times 1 - 1 \times \frac{1 + 100}{100} \times 1.82 = 17.95 \text{ V}$$

$$Q_1: \begin{cases} I_{C_1} = 18.2 \text{ mA} \\ V_{CE_1} = 17.95 \text{ V} \end{cases}$$

حلقه: $20 V, 100 K\Omega, V_{BE_1}, 1 K\Omega$

$$Q_2: 100 I_{B_2} + 1 \times I_{E_2} = 20 - V_{BE_2} = 20 - 0/V = 20 \Rightarrow$$

$$100 I_{B_2} + (1 + 100) I_{B_2} = 20 \Rightarrow I_{B_2} = 0.196 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_{C_2} = \beta I_{B_2} = 100 \times 0.196 = 19.6 \text{ mA}$$

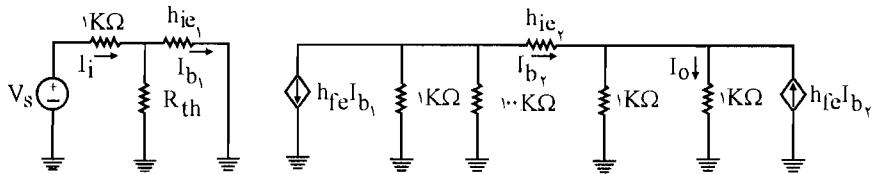
$$h_{ie_2} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_2}} = \frac{100 \times 26}{19.6} = 260 \text{ K}\Omega = 260 \text{ mV/K}\Omega \quad \text{(الف)}$$

حلقه: $20 V, V_{CE_2}, 1 K\Omega$

$$V_{CE_2} = 20 - 1 \times I_{E_2} = 20 - 1 \times \frac{1 + \beta}{\beta} I_{C_2} = 20 - \frac{1 + 100}{100} \times 19.6 = 10.304 \text{ V}$$

$$Q_2: \begin{cases} I_{C_2} = 19.6 \text{ mA} \\ V_{CE_2} = 10.304 \text{ V} \end{cases}$$

ب) مدار معادل ac را رسم می‌کنیم:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} \quad (I)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_O = \frac{(h_{fe} I_{b2} + I_{b2}) \times 1K\Omega}{1K\Omega + 1K\Omega} \\ = 50/5 I_{b2} \\ I_i = I_{b1} + \frac{h_{ie} I_{b1}}{R_{th}} = I_{b1} + \frac{2/50 I_{b1}}{9/1} \end{array} \right.$$

با استفاده از تقسیم جریان

(حلقه) $(1K\Omega \parallel 100K\Omega), (1K\Omega \parallel 1K\Omega), h_{ie2}$

$$\text{KVL: } h_{ie2} I_{b2} + (I_{b2} + 100 I_{b1}) \times (1K\Omega \parallel 100K\Omega) + (I_{b2} + 100 I_{b1}) \times (1K\Omega \parallel 1K\Omega) = 0$$

$$\Rightarrow 0/28 I_{b2} + 0/99 I_{b2} + 99 I_{b1} + 50/5 I_{b1} = 0 \Rightarrow$$

$$99 I_{b1} + 50/5 I_{b2} = 0 \Rightarrow I_{b2} = -1/99 I_{b1}$$

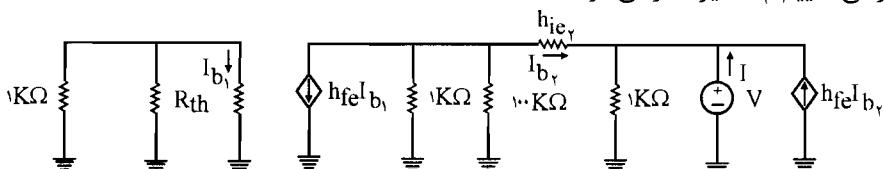
$$(I) : A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{50/5 I_{b2}}{I_{b1} + 0/28 I_{b1}} = \frac{50/5 \times (-1/99) I_{b1}}{1/28 I_{b1}} = -50/35$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = 9/1 K\Omega \parallel h_{ie1} = \frac{9/1 \times 2/50}{9/1 + 2/50} = 1/99 K\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = (-50/35) \times \frac{1}{1/99} = -357/35$$

برای محاسبه R_O یک منبع ولتاژ V را در خروجی در دو سر مقاومت $1K\Omega$ قرار می‌دهیم و منبع ورودی

را بی‌اثر می‌نماییم، I_{b2} نیز صفر می‌شود.



$$R_O = \frac{V}{I}, \quad I = \frac{V}{1K\Omega} + \frac{V}{1K\Omega} - (1 + h_{fe}) I_{b2} = 2V - 101 I_{b2} \quad (I)$$

حلقه (1KΩ || 100KΩ), h_{ie}, V

$$\text{KVL: } (1KΩ || 100KΩ) \times (I_{b_r} + 100 I_{b_r}) + h_{ie} I_{b_r} = -V$$

$$\Rightarrow 0.01 I_{b_r} + 0.02V I_{b_r} = -V \Rightarrow I_{b_r} = \frac{-V}{0.02} \quad (\text{II})$$

$$I = 2V - 100 \times \frac{-V}{0.02} = 2V + (V \times 100/2) \\ = 102V$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1}{100/102} = 12Ω$$

را در (I) جایگذاری می‌کنیم.

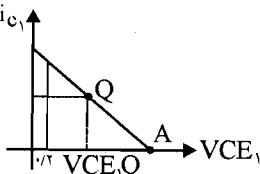
$$Q_1 \text{ ac: معادله خط بار } V_{ce_1} = -R_{ac} i_{c_1} = -(1KΩ || 100KΩ || R_{i_r}) i_{c_1} \quad (\text{ج})$$

$$\text{و } R_{i_r} = h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_{L_r} = 0.02V + 100 \times (1KΩ || 1KΩ) = 50/V$$

$$\Rightarrow V_{ce_1} = -(1KΩ || 100KΩ || 50/V) i_{c_1} = -0.05V i_{c_1}$$

$$\Rightarrow V_{CE_1} - V_{CE_1} Q = -0.05V(i_C - I_{C,Q})$$

$$\text{به دست آوریم } \Rightarrow V_{CE_1} = 17/95V \quad \text{و } I_{C,Q} = 1/02$$



$$V_{CE_1}(B) \left| \begin{array}{l} = -0.05V(0 - I_{C,Q}) + V_{CE_1} Q \\ i_{C_1} = 0 \quad = +0.05V \times 1/02 + 17/95 = 17/94V \end{array} \right.$$

حداکثر انحراف از سمت ناحیه اشباع

$$V_{ce_1}(\max) = V_{CE_1} Q - V_{CE}(\text{sat}) = 17/95 - 0.02 = 17/75V$$

حداکثر انحراف از سمت ناحیه قطع

$$V_{ce_1}(\max) = V_{CE_1}(A) - V_{CE_1} Q = 17/94 - 17/95 = 0.01V$$

پس کمترین مقدار مورد قبول می‌باشد یعنی حداکثر انحراف برابر است با:

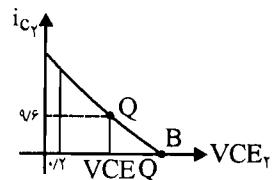
معادله خط بار

$$V_{ce_r} = -R_{ac} i_{c_r} = -(1KΩ || KΩ) i_{c_r} = -0.05 i_{c_r}$$

$$\Rightarrow V_{CE_r} - V_{CE_r} Q = -0.05(i_c - I_{CQ_r})$$

$$\text{به دست آوردهیم: } \left\{ \begin{array}{l} V_{CE_r} Q = 10/30.4V \\ I_{C_r} Q = 9/6V \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow V_{CE_r}(B) \left| \begin{array}{l} i_{c_r} = 0 \\ = 0.05 \times 9/6 + 10/30.4 = 15/10.4 \end{array} \right.$$



حداکثر انحراف از سمت ناحیه اشباع:

$$V_{ce_1}(\max) = V_{CE_1Q} - V_{CE_1}(\text{sat}) = 10/30\text{V} - 0/2 = 10/10\text{V}$$

حداکثر انحراف از سمت ناحیه قطع:

$$V_{ce_1}(\max) = V_{CE_1}(B) - V_{CE_1}Q = 10/10\text{V} - 10/30\text{V} = 4/8\text{V}$$

پس کمترین مقدار قابل قبول می باشد یعنی حداکثر انحراف Q_2 برابر است با

حداکثر دامنه نوسان متقارن ولتاژ ورودی:

$$A_{Vs} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -37/86 \times \frac{1/99}{1/99 + 1} = -25/2$$

از طرفی: $A_{Vs} = A_{V_1} \times A_{V_2}$

$$A_{Vs} = A_{V_2} \text{ می باشد پس } 1 = A_{V_2} \text{ می باشد پس } 1$$

$$\Rightarrow A_{V_2} = -25/2 \Rightarrow A_{V_1} = \frac{V_{ce_1}}{V_s} = -25/2 \Rightarrow$$

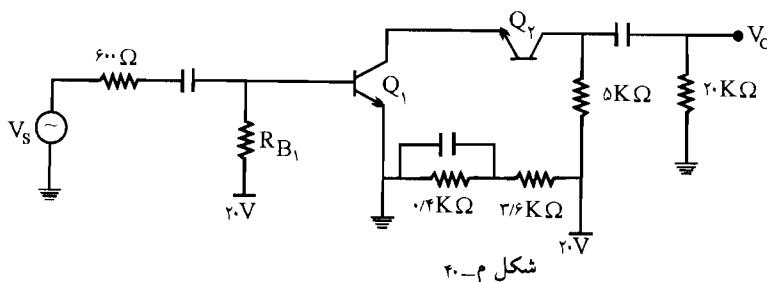
$$-25/2 = \frac{0/99}{V_s} \Rightarrow V_s = -\frac{0/99}{25/2} = -0/0\text{V} = 0/0\text{V}$$

$$\Rightarrow |V_s| = |-0/0\text{V}| = 0/0\text{V} = 0\text{mV}$$

- در تقویت کننده شکل م-۴۰ ترانزیستورها مشابه، $V_{CE}(\text{sat}) = 0/2\text{V}$ ، $h_{fe} = 100$ است.

(الف) R_{B_1} را طوری تعیین کنید که دامنه نوسان متقارن ولتاژ خروجی Q_2 حداکثر شود.

(ب) با فرض $A_{Vs} = 0$ و $h_{oe}^{-1} = 40\text{K}\Omega$ A_{Vs} را محاسبه کنید؟



شکل م-۴۰

راه حل:

(الف) حلقه R_{B_1} و V_{BE_1}

معادله خط بار ac و dc را می یابیم:

$$\text{KVL: } R_{B_1} I_{B_1} = 20 - V_{BE_1} - 20 - 0/7V = 19/3$$

$$\Rightarrow I_{B_1} = \frac{19/3}{R_{B_1}} \Rightarrow I_{C_1} = \frac{19/3}{R_{B_1}} \times \beta = \frac{19/3 \times 100}{R_{B_1}} = \frac{1930}{R_{B_1}}$$

$$Q_2: \begin{cases} R_{th} = 3/6 \text{ K}\Omega \parallel 0/4 \text{ K}\Omega = \frac{3/6 \times 0/4}{3/6 + 0/4} = 0/36 \text{ K}\Omega \\ V_{B_2} = 20 \times \frac{0/4}{0/4 + 3/6} = 2V = V_{th} \end{cases}$$

حلقه: $20V, 5\text{K}\Omega, V_{CB_2}, V_{th}, R_{th}$

$$\text{KVL: } V_{CBQ_2} = 20 - V_{th} - 5I_{CQ_2} + R_{th}I_{B_2} \Rightarrow V_{CBQ_2} = 20 - 2 - 5I_{CQ_2} + R_{th} \times \frac{I_{CQ_2}}{\beta}$$

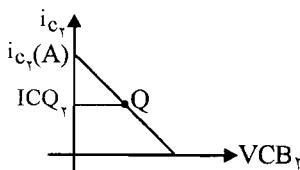
$$dc \text{ معادله خط بار} \Rightarrow V_{CBQ_2} = 18 - 5I_{CQ_2} + 0/36 \times \frac{I_{CQ_2}}{100} = 18 - 5I_{CQ_2}$$

$$ac \text{ معادله خط بار: } V_{cb_2} = -R_{ac}i_{c_2} = -(5\text{K}\Omega \parallel 20\text{K}\Omega) i_{c_2} = -4i_{c_2}$$

$$\Rightarrow V_{CB_2} - V_{CBQ_2} = -4(i_{c_2} - I_{CQ_2})$$

و برای اینکه دامنه نوسان متقارن ولتاژ خروجی Q_2 حداقل شود نقطه کار باید در وسط خط بار قرار

داشته باشد:



$$i_{c_2}(A) = 2I_{CQ_2}$$

$i_{c_2}(A)$ شدت جریان نقطه تلاقی خط بار ac با محور

می باشد که با قراردادن 0 در معادله خط بار ac به دست

می آید.

$$0 - V_{CBQ_2} = -4i_{c_2}(A) + 4I_{CQ_2} \Rightarrow i_{c_2}(A) = \frac{V_{CBQ_2} + 4I_{CQ_2}}{4}$$

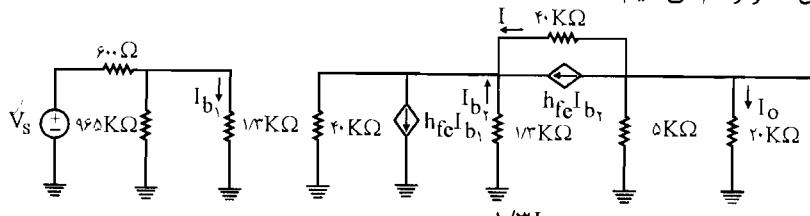
$$\Rightarrow 2I_{CQ_2} = \frac{V_{CBQ_2} + 4I_{CQ_2}}{4} \Rightarrow V_{CBQ_2} = 4I_{CQ_2}$$

$$dc \text{ معادله خط بار: } V_{CBQ_2} = 18 - 5I_{CQ_2} \Rightarrow 4I_{CQ_2} = 18 - 5I_{CQ_2} \Rightarrow I_{CQ_2} = 2mA$$

$$\Rightarrow I_{CQ_1} \approx I_{CQ_2} = \frac{1930}{R_{B_1}} = 2mA \Rightarrow R_{B_1} = \frac{1930}{2} = 965 \text{ K}\Omega$$

$$h_{ie_1} = h_{ie_2} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{100 \times 26}{2} = 1300 \Omega = 1/3 \text{ K}\Omega \quad (b)$$

حال مدار معادل ac را رسم می‌کنیم:



$$A) KCL: I = -I_{b_1} + h_{fe}I_{b_1} - h_{fe}I_{b_1} - \frac{1}{10}I_{b_1} = -10/0.325I_{b_1} + 100I_{b_1} \quad (I)$$

حلقه: $40K\Omega$, $1/3K\Omega$, $(20K\Omega \parallel 5K\Omega)$

$$(KVL): 40I - 1/3I_{b_1} + (I + 100I_{b_1}) \times \left(\frac{10 \times 5}{20 + 5} \right) = 0 \Rightarrow 40I - 1/3I_{b_1} + 40I_{b_1} = 0$$

$$\Rightarrow 40I = -39I/10 \Rightarrow I = -9/0.9I_{b_1}$$

$$(I): -9/0.9I_{b_1} = -10/0.325I_{b_1} + 100I_{b_1} \Rightarrow I_{b_1} = 0.92I_{b_1}$$

$$V_O = -(20K\Omega \parallel 5K\Omega) \times (I + 100I_{b_1}) = -4 \times \frac{90/94}{1/3I_{b_1}} = -363/76I_{b_1}$$

$$V_s = 0/6(I_{b_1} + I_{965K\Omega}) + 1/3I_{b_1} = 0/6(I_{b_1} + \frac{1}{965}) + 1/3I_{b_1}$$

$$= 0/6I_{b_1} + 1/3I_{b_1} \cong 1/9I_{b_1}$$

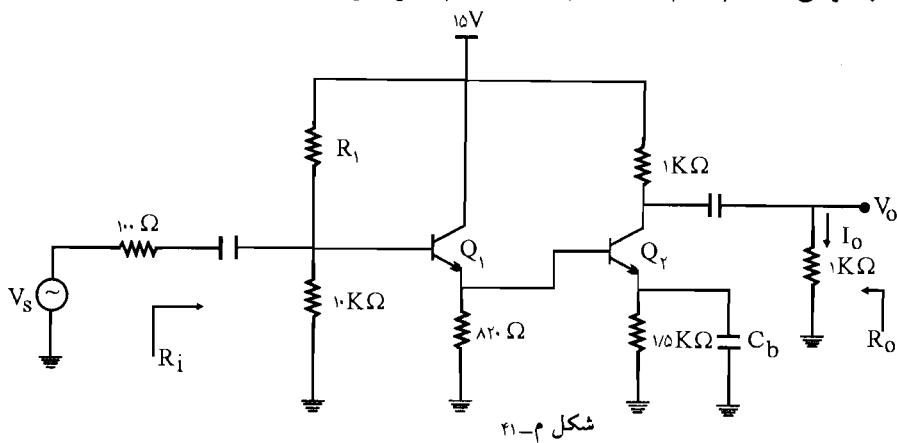
$$\Rightarrow V_s = 1/9 \times 0.92I_{b_1} = 1/84.8I_{b_1}$$

$$\Rightarrow A_{V_s} = \frac{V_O}{V_s} = \frac{-363/76I_{b_1}}{1/84.8I_{b_1}} = -20.8/1$$

. در مدار شکل م-۴۱ با فرض $V_{CE(sat)} = 0.2V$ و $h_{fe} = 50$ ، $h_{re}^{-1} = 40K\Omega$ ، $h_{oe}^{-1} = 40K\Omega$

الف) مقاومت R_i را طوری تعیین کنید که دامنه توسان متقارن و لتاژ خروجی حداقل شود.

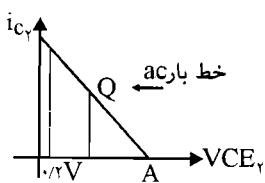
ب) با فرض $R_i = 5/6k\Omega$ ، مقادیر کمیت‌های A_V ، A_I ، R_O و R_i را به دست آورید؟



اہ مل:

الف) معادله خط بار ac در Q_2 :

$$\begin{cases} V_{CEr} = -R_{ac} i_{Cr} = -(1K\Omega \parallel 1K\Omega) i_{Cr} = -0.5 i_{Cr} \\ V_{CEr} - V_{CErQ} = 0.5(i_{Cr} - I_{CrQ}) \end{cases}$$



نقطه محل تلاقي خط بار ac با محور V_{CEr} وقتی $i_{Cr} = 0$

است میباشد

$$V_{CEr}(A) = V_{CErQ} + 0.5 I_{CrQ}$$

اگر انحراف متقارن باشد:

$$V_{CErQ} = \frac{V_{CEr}(A) + V_{CE}(sat)}{2}$$

$$\Rightarrow V_{CErQ} = \frac{V_{CErQ} + 0.5 I_{CrQ} + 0.5 V}{2} \Rightarrow V_{CErQ} = 0.5 I_{CrQ} + 0.5 V \quad (I)$$

$$\text{با توجه به شکل مدار: KVL: } V_{CErQ} = V_{CC} - 1K\Omega \times I_{CrQ} = 0.5 I_{ErQ} \quad (II)$$

(I) را در (II) جایگذاری میکنیم:

$$(II) \Rightarrow 0.5 I_{CrQ} + 0.5 V = 0.5 I_{CrQ} - 0.5 I_{ErQ}$$

$$\Rightarrow 0.5 V = 0.5 I_{CrQ} + 0.5 \times \frac{(1+0.5)}{0.5} I_{CrQ} \Rightarrow \begin{cases} I_{CrQ} = 4/88 mA \\ I_{ErQ} = -0.5 \times 4/88 = 4/98 mA \end{cases}$$

حلقه: 1.2Ω , V_{BEr} , $0.5 K\Omega$

$$\text{KVL: } 0.5 (I_{E1} - I_{Br}) - 0.5 I_{Er} = 0.5 \Rightarrow 0.5 I_{E1} = 0.5 I_{Er} + 0.5 \frac{I_{Cr}}{\beta} + 0.5$$

$$\Rightarrow 0.5 I_{E1} = 0.5 \times 4/98 + 0.5 \times \frac{4/88}{0.5} + 0.5 = 4/25 \Rightarrow I_{E1} = 1.0 mA$$

$$\Rightarrow I_{Br} = \frac{I_{E1}}{1+\beta} = \frac{1.0}{51} = 0.19 mA, I_{Cr} = 0.5 I_{Br} = 0.98 mA$$

$$Q_3: \begin{cases} R_{th} = R_1 \parallel 1.0 K\Omega = \frac{1.0 R_1}{R_1 + 1.0} \\ V_{th} = 0.5 \times \frac{1.0}{1.0 + R_1} = \frac{0.5}{1.0 + R_1} \end{cases}$$

حلقه: $V_{BE_1}, V_{BE_2}, V_{th}, R_{th}, 1/2 K\Omega$

$$\text{KVL: } R_{th} I_B + 1/2 I_E = V_{th} - V_{BE_1} - V_{BE_2} = V_{th} - 1/4$$

$$\Rightarrow \frac{10}{10+R_1} \times 0.19V + 1/2 \times 4/9A = V_{th} - 1/4 = 10 \times \frac{10}{10+R_1} - 1/4$$

$$\Rightarrow 1/9V R_1 + V/4/V + V/4 R_1 = 10 - 1/4 - 1/4 R_1$$

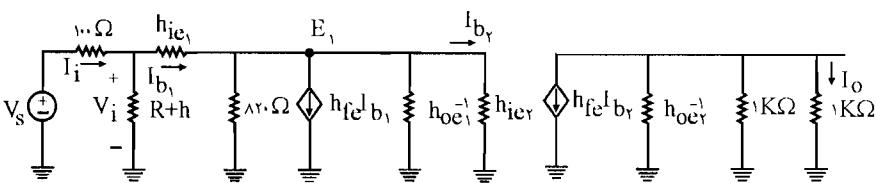
$$\Rightarrow 6/10 = 10/84 R_1 \Rightarrow R_1 = 6/60 K\Omega$$

(ب)

$$\begin{cases} h_{ie_1} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_1}} = \frac{50 \times 26}{9/8} = 133 \Omega = 0.133 K\Omega \\ h_{ie_2} = \frac{h_{fe} V_T}{I_{C_2}} = \frac{50 \times 26}{4/88} = 266 \Omega = 0.266 K\Omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_{th} = \frac{10 \times 5/6}{10 + 5/6} = 3/6 K\Omega \\ V_{th} = \frac{10}{10 + 5/6} = 9/62 V \end{cases}$$

مدار معادل ac را با فرض $R_1 = 5/6$ رسم می‌کنیم.



$$I_O = -h_{fe} I_{b_2} \times \frac{\frac{1}{1}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}} = -\frac{1000}{11} I_{b_2}$$

$$E_1 \text{ و } I_{b_2} = (1 + h_{fe}) I_{b_2} \times \frac{V_i}{3/6} \quad (I)$$

$$E_1 \text{ و } I_{b_2} = (1 + h_{fe}) I_{b_2} \times \frac{\frac{1}{266}}{\frac{1}{10 \times 1.0} + \frac{1}{1020} + \frac{1}{266}} = 38/32 I_{b_2}$$

$$V_i = h_{ie_1} I_{b_1} + h_{ie_2} I_{b_2} = 0.133 I_{b_1} + 0.266 \times 38/32 I_{b_1} = 1.0/33 I_{b_1}$$

$$(I): \quad I_i = I_{b_1} + \frac{V_i}{R_{th}} = I_{b_1} + \frac{1.0/33 I_{b_1}}{3/6} = 3/8 V I_{b_1}$$

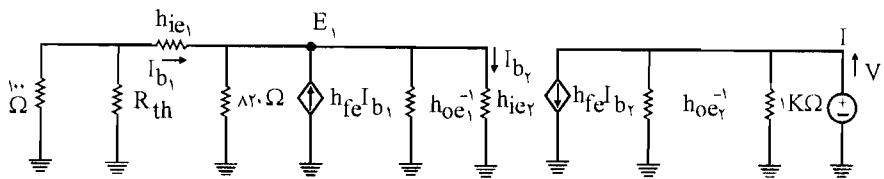
$$\Rightarrow R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{10/33 I_{b_1}}{3/8 V I_{b_1}} = 2/6 V K\Omega$$

$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-\frac{100}{81} \times 3/32 I_{b_1}}{3/8 V I_{b_1}} = -244/5$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -244/5 \times \frac{1 K\Omega}{2/6 V} = -91/6$$

$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -91/6 \times \frac{2/6 V}{2/6 V + 0/1} = -88/3$$

برای محاسبه R_o یک منبع ولتاژ V را در خروجی قرار می‌دهیم و منبع ولتاژ V_s را بی‌اثر می‌کنیم.



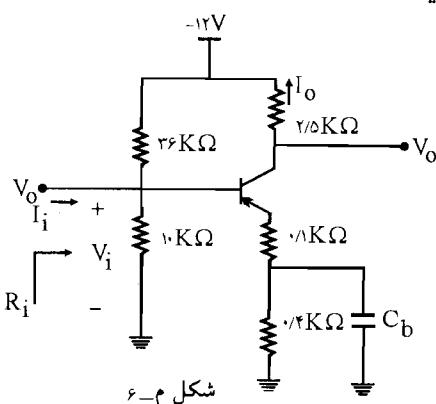
$$R_o = \frac{V}{I} \quad \text{و} \quad I = h_{fe} I_{b_2} + \frac{V}{40} + \frac{V}{1} + \frac{V}{1} = 50 I_{b_2} + \frac{V}{40} + 2V$$

I_{b_2} چون مدار سمت چپ منبع مستقل نداشته و نیز منبع واپسی به سمت راست ندارد.

$$\Rightarrow I = 50 \times 0 + \frac{V}{40} + 2V = V \left(\frac{1}{40} + 2 \right) \Rightarrow R_o = \frac{V}{I} = \frac{1}{\frac{1}{40} + 2} = \frac{40}{1 + 80}$$

$$\Rightarrow R_o = 0.494 K\Omega$$

۴۲- مسائل ۶ و ۷ را با استفاده از مدل هیبرید π حل کنید؟



راه حل:

$$R_i, A_i, A_V = ?$$

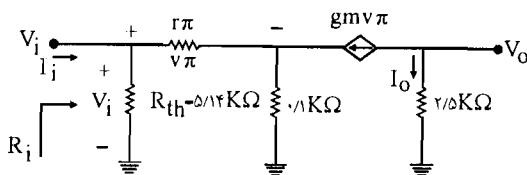
$$\begin{cases} h_{fe} = 100 \\ h_{re} = h_{oe} = 0 \end{cases}$$

در مسئله ۶ IC را به دست آور دیم:

$$I_{CQ} = 1/\lambda mA$$

$$\begin{cases} g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1/\lambda}{26} = 89/2 \frac{mA}{V} \\ r_\pi = \frac{h_{fe}}{g_m} = \frac{100}{89/2} = 1/44 K\Omega \end{cases}$$

مدار معادل به صورت زیر می شود:



$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{-g_m V_\pi}{I_{R_{th}} + I_{r\pi}} = \frac{-89/2 V_\pi}{\frac{V_\pi}{1/44} + \frac{V_\pi + 0/1(89/2 V_\pi + \frac{V_\pi}{1/44})}{89/2}} \Rightarrow$$

$$A_i = \frac{-89/2 V_\pi}{89/2 V_\pi + \frac{V_\pi}{1/44}} = -30/\lambda$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_\pi + 0/1(g_m V_\pi + \frac{V_\pi}{V_\pi})}{I_i}$$

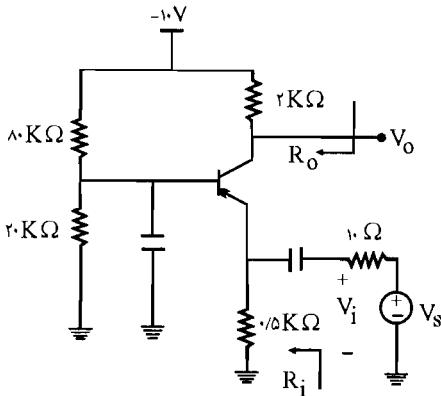
$$\Rightarrow R_i = \frac{V_\pi + 0/1(89/2 V_\pi + \frac{V_\pi}{1/44})}{2/20 V_\pi} = \frac{V_\pi}{2/20 V_\pi} = 3/50 K\Omega$$

$$A_V = A_i \times \frac{R_L}{R_i} = -30/\lambda \times \frac{1/50}{3/50} = -20/V$$

مسئله (۷)

$$h_{fe} = 100$$

$$A_V, A_{V_s}, R_i, A_i, R_o = ?$$

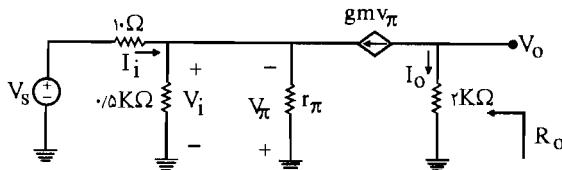


در مسئله (۷)، A_{CQ} را به دست آوردیم:

$$\begin{cases} R_{th} = \frac{\gamma_0 \times \lambda_0}{\gamma_0 + \lambda_0} = 16 \\ V_{th} = -V_0 \times \frac{\gamma_0}{\gamma_0 + \lambda_0} = -2V \end{cases}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1/96}{2} = 50 \text{ mA/V} \quad , \quad r_\pi = \frac{h_{fe}}{g_m} = \frac{100}{50} = 2 \text{ K}\Omega$$

مدار معادل به صورت زیر در می‌آید:



$$A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{-g_m V_\pi}{\frac{V_i}{r_\pi} - \frac{V_\pi}{r_\pi} - g_m V_\pi} = \frac{-50 V_\pi}{\frac{-V_\pi}{2} - \frac{V_\pi}{2} - 50 V_\pi} = \frac{50}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 50} = 0.96$$

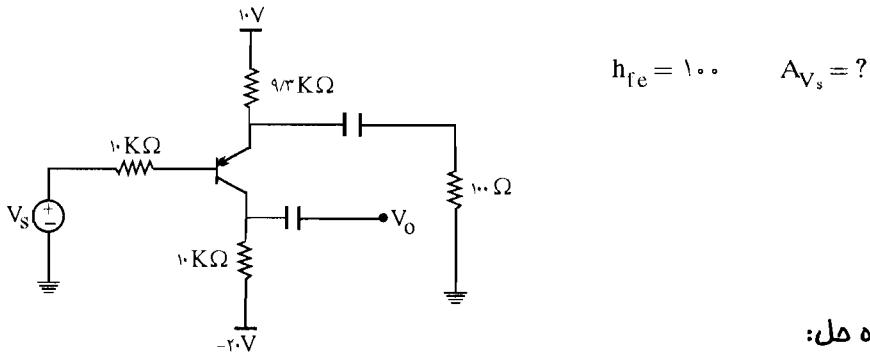
$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{-V_\pi}{\frac{-V_\pi}{r_\pi} - \frac{V_\pi}{r_\pi} - g_m V_\pi} = \frac{+1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 50} = 12 \Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = 0.96 \times \frac{2}{0.12} = 14 \text{ V/V}$$

$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = 14 \text{ V/V} \times \frac{0.12}{0.12 + 1} = 1.2 \text{ V/V}$$

$$R_o = R_L = 2 \text{ K}\Omega$$

۴۳- مسئله ۱۹ را با فرض $V_A = 100$ و با استفاده از مدل هیبرید π حل کنید؟



راه حل:

در مسئله ۱۹ I_{CQ} را به دست آوردیم:

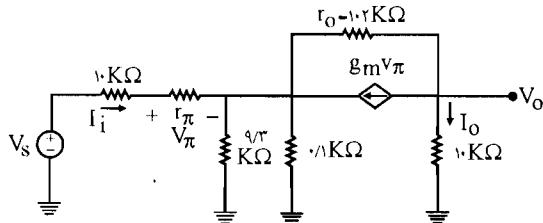
$$I_{CQ} = 0.01 \text{ mA}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.01}{26} = 3.81 \times 10^{-5} \text{ A/V}$$

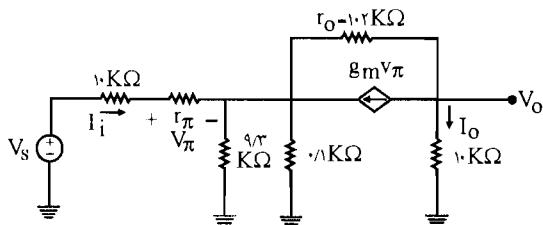
$$r_\pi = \frac{h_{fe}}{g_m} = \frac{100 \Omega}{3.81 \times 10^{-5} \text{ A/V}} = 2652 \Omega = 2.652 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C} = \frac{100}{0.01} = 10 \text{ k}\Omega \quad \text{رابطه (۶-۹)}$$

مدار معادل ac به صورت زیر می‌باشد:



با تبدیل منبع جریان $V\pi$ به منبع ولتاژ داریم:



$$V_\pi = r_\pi \times I_i = 7/652 I_i$$

$$A_I = \frac{I_O}{I_i}$$

حلقه: $10\text{ K}\Omega$, $0.989\text{ K}\Omega$, r_O , $g_m V_\pi r_O$

$$\text{KVL: } 0.989(I_i - I_O) - (10 + 10)I_O = g_m V_\pi \times r_O$$

$$0.989(I_i - I_O) - 112I_O = 7/652 \times 10^{-3} \times 10 \times 2/652 I_i \times 10^3$$

$$0.989I_i - 0.989I_O - 112I_O = 10/2 \times 10^3 I_i$$

$$\Rightarrow 10/2 \times 10^3 I_i = 112/0.989 I_O \Rightarrow A_I = \frac{I_O}{I_i} = -91$$

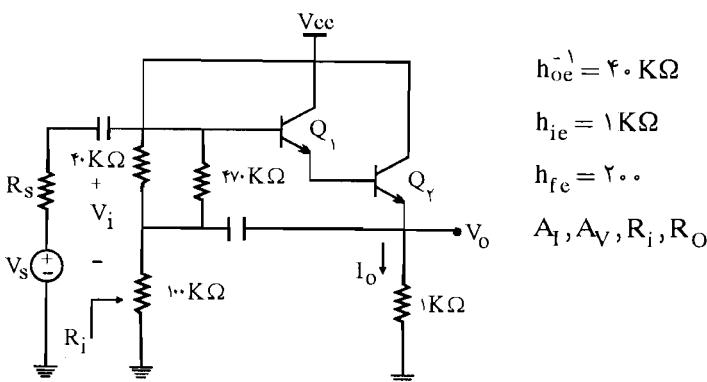
$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{0.989(I_i - I_O)}{I_i} = 0.989 - 0.989 A_I = 0.989 - 0.989 \times (-91)$$

$$= 9.99 \text{ K}\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = -91 \times \frac{10\text{ K}\Omega}{9.99\text{ K}\Omega} = -100$$

$$A_{V_s} = A_V \times \frac{R_i}{R_i + R_s} = -100 \times \frac{9.99}{9.99 + 10} = -49.5$$

مسأله ۳۲ را با فرض $\beta = 200$ و $V_\pi = 7/5\text{ mA}$ حل کنید.

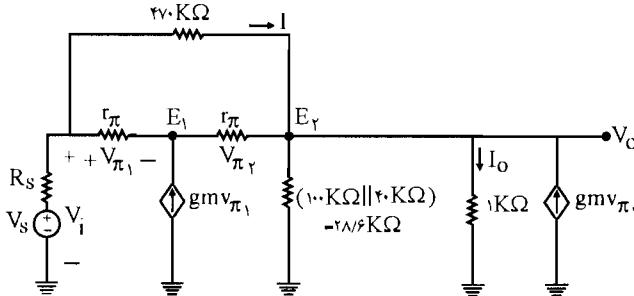


راه حل:

$$I_{C_1} = I_{C_2} \Rightarrow g_{m_1} = g_{m_2} = g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{7/5\text{ mA}}{26} = 288/5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$r_{\pi_1} = r_{\pi_2} = r_\pi = \frac{h_{fe}}{g_m} = \frac{200}{288/5} = 0.91 \text{ K}\Omega$$

مدار معادل را رسم می‌کنیم:



با استفاده از تقسیم جریان

$$A_I = \frac{I_O}{I_i} \Rightarrow \begin{cases} \left(I + g_m V_{\pi_1} + \frac{V_{\pi_1}}{r_\pi} \right) \times \frac{28/6}{28/6 + 1} = I_O \\ I + \frac{V_{\pi_1}}{r_\pi} = I_i \end{cases} \quad (I)$$

$$\text{حلقه: } V_{\pi_1}, V_{\pi_2}, 4V \cdot K\Omega \Rightarrow \text{KVL: } V_{\pi_1} + V_{\pi_2} = 4V \cdot I \quad (II)$$

$$(KCL) \text{KCL: } \frac{V_{\pi_1}}{r_\pi} + g_m V_{\pi_1} = \frac{V_{\pi_2}}{r_\pi} \Rightarrow \frac{V_{\pi_1}}{0.69} + 288/5 V_{\pi_1} = \frac{V_{\pi_2}}{0.69}$$

$$\Rightarrow V_{\pi_2} = 20.0/1 V_{\pi_1} \quad (III)$$

با جایگذاری (III) در رابطه (II) داریم:

$$V_{\pi_1} + 20.0/1 V_{\pi_1} = 4V \cdot I \Rightarrow I = \frac{20.0/1}{4V} V_{\pi_1} = 0.43 V_{\pi_1}$$

این رابطه به دست آمده را در رابطه (I) قرار می‌دهیم:

$$(I): A_I = \frac{\left(I + 288/5 V_{\pi_1} + \frac{V_{\pi_1}}{0.69} \right) \times \frac{28/6}{28/6 + 1}}{\left(I + \frac{V_{\pi_1}}{0.69} \right)}$$

$$A_I = \frac{\left(0.43 V_{\pi_1} + 288/5 \times 20.0/1 V_{\pi_1} + \frac{20.0/1}{0.69} V_{\pi_1} \right) \times 0.43}{\left(0.43 V_{\pi_1} + \frac{V_{\pi_1}}{0.69} \right)} = 1/88 V_{\pi_1}$$

$$\Rightarrow A_I = 2994V$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{4V \cdot I + 1 \times I_O}{I_i} = 4V \cdot \frac{I}{I_i} + A_I = 4V \cdot \frac{0.43 V_{\pi_1}}{1/88 V_{\pi_1}} = 2994V + 10V/5 =$$

$$= 300.04 / 5 K\Omega \approx 3 M\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = 29947 \times \frac{1}{300.04 / 5} = 0.996$$

برای محاسبه R_O منبع ورودی را صفر می کنیم و یک منبع ولتاژ V را در خروجی قرار می دهیم:

$$R_O = \frac{V}{I}$$

$$I = \frac{V}{1 K\Omega} + \frac{V}{28.6 K\Omega} - 288/5 V_{\pi_1} - I_{47.0 K\Omega} - \frac{V_{\pi_1}}{r_{\pi}}$$

قبل‌آ به دست آورده بودیم: $V_{\pi_1} = 200/1 V_{\pi_1}$ و $I = 0/437 V_{\pi_1}$ با جایگذاری این روابط در رابطه

بالا داریم:

$$I = 1/0.35 V - 288/5 \times 200/1 V_{\pi_1} - 0/43 V_{\pi_1} - \frac{200/1 V_{\pi_1}}{0/69}$$

$$\Rightarrow I = 1/0.35 V - 58.019/37 V_{\pi_1} \quad (A)$$

حلقه: $V_{\pi_1}, V_{\pi_2}, R_s, V$

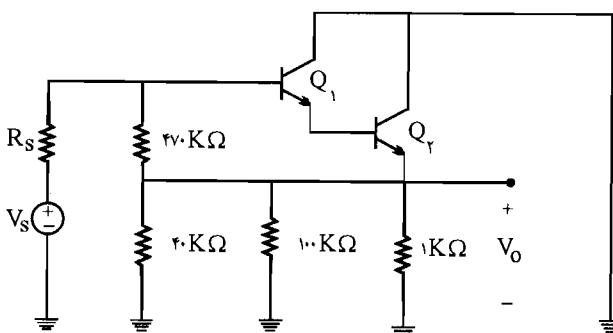
$$\text{KVL: } V = -V_{\pi_1} - V_{\pi_2} - R_s(I + \frac{V_{\pi_1}}{0/69}) = -V_{\pi_1} - 200/1 V_{\pi_1} - R_s(0/43 V_{\pi_1} + \frac{V_{\pi_1}}{0/69})$$

$$\Rightarrow V = -V_{\pi_1}(20/1/1 + 1/88 R_s) \Rightarrow V_{\pi_1} = \frac{-V}{20/1/1 + 1/88 R_s}$$

$$\stackrel{(A)}{\Rightarrow} I = 1/0.35 V - 58.019/3 \times \frac{-V}{20/1/1 + 1/88 R_s}$$

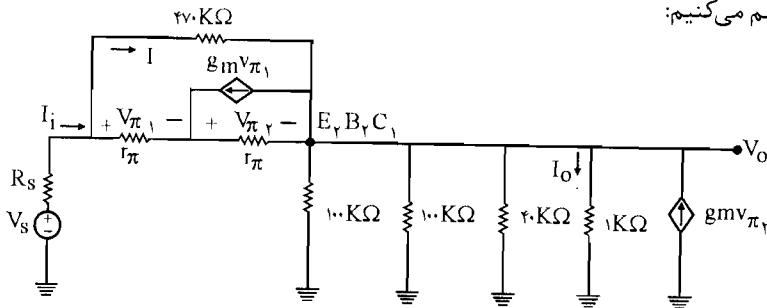
$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{20/1/1 + 1/88 R_s}{58.229/3 + 1/94 R_s}$$

مدار دوم:



$$g_m = 288/5 \quad , \quad r_{\pi} = 0.69 K\Omega$$

مدار معادل ac را رسم می‌کنیم:



با استفاده از تقسیم جریان:

$$A_I = \frac{I_O}{I_i} \Rightarrow \begin{cases} I_O = (\gamma - 1) V_{\pi_1} + V_{\pi_2} \\ I_i = I + \frac{V_{\pi_1}}{r_{\pi_1}} \end{cases}$$

حلقه: $V_{\pi_1}, V_{\pi_2}, 4V \cdot K\Omega$

$$\text{KVL: } 4V \cdot I = V_{\pi_1} + V_{\pi_2} \quad (I)$$

$$(E_1 \text{ گرد}) \text{ KCL: } \frac{V_{\pi_1}}{r_{\pi_1}} + \gamma V_{\pi_1} = \frac{V_{\pi_2}}{r_{\pi_2}} \Rightarrow V_{\pi_2} = 20.0 / 1 V_{\pi_1} \quad (II)$$

با جایگذاری رابطه (II) در رابطه (I) داریم:

$$4V \cdot I = V_{\pi_1} + 20.0 / 1 V_{\pi_1} \Rightarrow I = 0.43 V_{\pi_1}$$

با جایگذاری در رابطه I_O داریم:

$$I_O = (\gamma V_{\pi_1} - 20.0 / 1 V_{\pi_1} + 0.43 V_{\pi_1} + \frac{20.0 / 1 V_{\pi_1}}{0.43}) \times \frac{22/22}{22/22+1} \Rightarrow I_O = 0.0244 / \Delta V_{\pi_1}$$

$$I_i = 0.43 V_{\pi_1} + \frac{V_{\pi_1}}{0.43} = 1.88 V_{\pi_1}$$

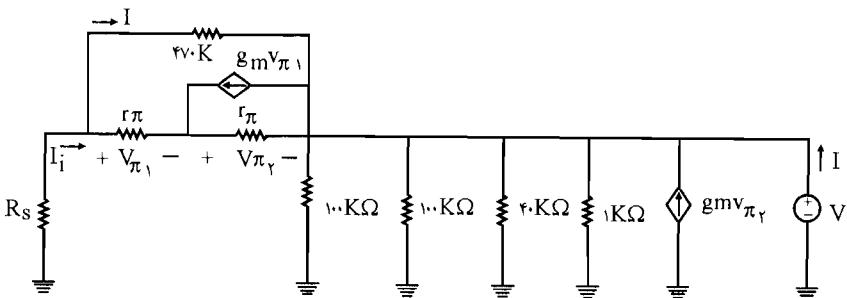
$$\Rightarrow A_I = \frac{I_O}{I_i} = \frac{0.0244 / \Delta V_{\pi_1}}{1.88 V_{\pi_1}} = 29380 / 4$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{4V \cdot I + 1 \times I_o}{I_i} = 4V \cdot \frac{I}{I_i} + A_I = 4V \cdot \frac{0.43 V_{\pi_1}}{1.88 V_{\pi_1}} + 29380 / 4$$

$$\Rightarrow R_i = 29492 / 9 K\Omega$$

$$A_V = A_I \times \frac{R_L}{R_i} = 29380 / 4 \times \frac{1}{29492 / 9} = 0.996$$

برای به دست آوردن R_O یک منبع ولتاژ V را در خروجی قرار می‌دهیم و منبع ورودی را بی‌اثر می‌کنیم.



$$R_O = \frac{V}{I} \quad , \quad I = \frac{V}{1 + \frac{V}{40}} + \frac{V}{100} + \frac{V}{100} - g_m V_{\pi_2} + g_m V_{\pi_1} - I_{4V_0 K\Omega} - \frac{V_{\pi_2}}{r_\pi}$$

$$\Rightarrow I = 1/40 V - 288/5 \times 200/1 V_{\pi_1} + 288/5 V_{\pi_2} - 0/43 V_{\pi_1} - 1/40 \times 200/1 \times V_{\pi_2}$$

$$\Rightarrow I = 1/40 - 57731 V_{\pi_1}$$

حلقه: V , $4V_0 K\Omega$, R_s

$$V = -4V_0 I - R_s (I_{4V_0} + \frac{V_{\pi_1}}{r_\pi}) = -4V_0 \times 0/43 V_{\pi_1} - R_s (0/43 V_{\pi_1} + \frac{1}{0.69} V_{\pi_1})$$

$$\Rightarrow V = -(202/1 + 1/\lambda R_s) V_{\pi_1}$$

$$\Rightarrow V_{\pi_1} = -\frac{V}{202/1 + 1/\lambda R_s}$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{V}{1/40 V - 57731 V_{\pi_1}} = \frac{V}{1/40 V - 57731 \times \frac{-V}{202/1 + 1/\lambda R_s}}$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{202/1 + 1/\lambda R_s}{57731/2 + 1/46 R_s}$$

فصل

ترانزیستورهای اثر میدان

- ۱- برای یک JFET با $V_{DS} = -2V$ و $I_{DSS} = 10mA$ کوچک اعمال شده است.
مقدار r_{DS} را به ازای مقادیر $V_{GS} = 0V$ و $V_{GS} = -1V$ را به دست آورید.
طبق رابطه (۷-۳) کتاب داریم:

(۱۵) هل:

$$r_{DS} = \left[\frac{2 \times 10}{-2} \left(\frac{0}{-2} - 1 \right) \right]^{-1}$$

$$V_{GS} = 0 \Rightarrow r_{DS} = \left[\frac{2 \times 10}{-2} \left(\frac{0}{-2} - 1 \right) \right]^{-1} = \frac{1}{10} K\Omega \Rightarrow r_{DS} = 100 \Omega$$

$$V_{GS} = -1V \Rightarrow r_{DS} = \left[\frac{2 \times 10}{-2} \left(\frac{-1}{-2} - 1 \right) \right]^{-1} = \frac{1}{5} K\Omega \Rightarrow r_{DS} = 200 \Omega$$

- ۲- یک JFET را با $V_{DS} = -1/5V$ و $I_{DSS} = 10mA$ در نظر بگیرید. به ازای $V_{GS} = -2V$ حداقل مقدار V_{DS} که به ازای آن JFET در ناحیه اشباع کار می‌کند چقدر است؟

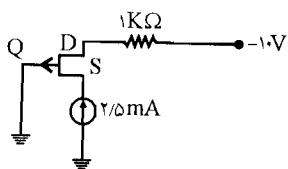
(۱۶) هل:

$$V_{GD} \leq -|V_P| \Rightarrow V_{GS} - V_{DS} \leq -|V_P|$$

$$\Rightarrow -1/5 - V_{DS} \leq -2 \Rightarrow V_{DS} \geq 0/5$$

پس حداقل مقدار V_{DS} برابر $0/5V$ می‌باشد.

۳- یک JFET کانال P با $V_P = -3V$ و $I_{DSS} = 10mA$ باگیت زمین شده در حال کار است. درین با یک مقاومت $1K\Omega$ به ولتاژ $V = 10V$ - وصل شده و سورس توسط یک منبع جریان ثابت $2/5mA$ تعذیه میشود. ولتاژهای V_{GD} و V_{DS} و V_{GS} را به دست آورید.



راه حل:

$$I_S = I_D - 2/5mA$$

$$\text{KVL: } -(-10) - 1K\Omega \times I_D - V_{GD} = 0 \rightarrow V_{GD} = 10 - 1 \times 2/5 = 7/5V$$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{|V_{GS}|}{|V_P|} \right)^2 \Rightarrow 2/5 = 10 \left(1 - \frac{|V_{GS}|}{3} \right)^2 \Rightarrow \frac{1}{4} = \left(1 - \frac{|V_{GS}|}{3} \right)^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 - \frac{V_{GS}}{3} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{V_{GS}}{3} = \frac{1}{4} \Rightarrow V_{GS} = 1/5V \\ 1 - \frac{V_{GS}}{3} = -\frac{1}{4} \Rightarrow \frac{V_{GS}}{3} = \frac{3}{4} \Rightarrow V_{GS} = 4/5V \end{cases}$$

$V_{GS} = 4/5V$ قابل قبول نمیباشد چون در این صورت $V_{GS} > V_P$ میشود که شرط نادرستی میباشد

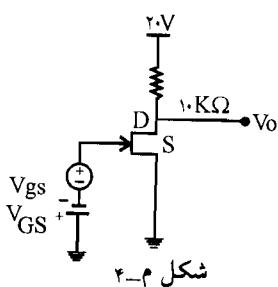
ولی $V_{GS} = 1/5V$ برابر $1/5V$ قابل قبول است.

$$V_{GS} = V_{GD} + V_{DS} \Rightarrow$$

$$1/5V = V_{DS} + (+7/5) \Rightarrow V_{DS} = 1/5 - 7/5 = -6V$$

۴- در مدار شکل ۴، JFET دارای $V_P = -4V$ و $I_{DSS} = 16mA$ است. برای

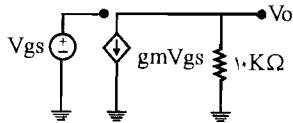
مقدار g_m و A_V را به دست آورید. برای یک سیگنال ورودی $1V$ (موج مربعی) دامنه سیگنال خروجی در درین چقدر است؟ کمترین ولتاژ درین سورس ممکن چقدر است؟



۱۵ حل:

$$g_m = \frac{-2 I_{DSS}}{V_P} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{-2 \times 16}{-4} \left(1 - \frac{-2}{-4} \right) = 8 \left(\frac{1}{4} \right) = 2 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

مدار معادل:



$$A_V = \frac{V_O}{V_i}$$

$$V_O = -g_m V_{GS} \times 10 \text{ k}\Omega = -2 \times V_{GS} \times 10 = -20 V_{GS}$$

$$V_i = V_{GS}$$

$$\Rightarrow A_V = \frac{-20 V_{GS}}{V_{GS}} = -20.$$

$$\text{به ازای } V_{GS} = 0 \text{ V} \Rightarrow V_O = -20 V_{GS} = -20 \times 0 / 1 = -20 \text{ V}$$

کمترین ولتاژ درین - سورس:

$$N: \text{کانال - } V_{GS} < - |V_P| \Rightarrow V_{GD} < -4 \Rightarrow V_{GS} - V_{DS} < -4 \Rightarrow$$

$$V_{DS} > V_{GS} + 4 \Rightarrow V_{DS} > V_{GS} + V_{GS} + 4 \Rightarrow V_{DS} > V_{GS} + (-3) + 4$$

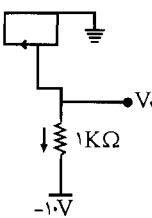
$$\Rightarrow V_{DS} > V_{GS} + 1$$

کمترین مقدار ولتاژ V_{DS} به ازای V_{GS} برابر صفر ولت به دست می‌آید.

$$V_{DS(\min)} = 0 + 1 = 1 \text{ V}$$

۵- در مدارهای شکل م-۵ مقادیر ولتاژها و جریان‌های نشان داده شده را به دست آورید. برای کلیه

$$|V_P| = 2V \text{ و } I_{DSS} = 4 \text{ mA} \text{ JFET است.}$$



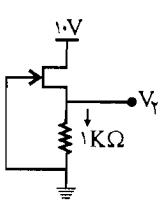
در این مدار گیت و سورس به هم متصل می‌باشند پس $V_{GS} = 0$ می‌باشد در نتیجه طبق رابطه $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$ داریم:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = I_{DSS} = 4 \text{ mA}$$

۱۵ حل:

و چون JFET از نوع کانال P می‌باشد پس جهت جریان در جهت نشان داده شده می‌باشد. (از سورس به سمت درین)

$$\text{KVL: } V_1 - 1 \times I_D - (-10) = 0 \Rightarrow V_1 - 4 + 10 = 0 \Rightarrow V_1 = -6V$$



$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - V_2 = -V_2$$

چون JFET از نوع کانال N می‌باشد پس $V_p < 0$ می‌باشد یعنی $V_p = -2V$ و جهت جریان در جهت نشان داده شده می‌باشد.

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 4 \left(1 - \frac{(-V_2)}{-2}\right)^2 \simeq 4 \left(1 - \frac{V_2}{2}\right)^2 \quad (\text{I})$$

$$\text{KVL: } V_2 = 1 \times I_D = I_D \quad (\text{II})$$

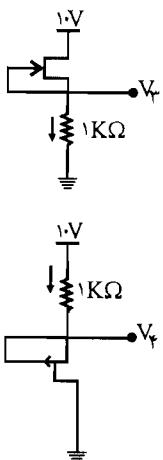
با جایگذاری (II) در (I) داریم:

$$V_2 = 4 \left(1 - \frac{V_2}{2}\right)^2 \Rightarrow V_2 = (2 - V_2)^2 = 4 + V_2^2 - 4V_2 \Rightarrow V_2^2 - 5V_2 + 4 = 0$$

با حل این معادله درجه ۲ داریم:

$$\begin{cases} V_2 = 1V \\ V_2 = 4V \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_2 = 1V \Rightarrow V_{GS} = -V_2 = -1 > V_p \Rightarrow \\ V_2 = 4V \Rightarrow V_{GS} = -V_2 = -4 < V_p \Rightarrow \end{cases} \begin{matrix} \text{قابل قبول} \\ \text{قابل قبول نمی‌باشد} \end{matrix} \Rightarrow V_2 = 1V$$



$$V_2 = 1 \times I_D = I_D$$

از طرفی در این مدار گیت و سورس به هم متصل می‌باشند \Leftrightarrow

$$V_{GS} = 0 \Rightarrow$$

$$I_D = I_{DSS} = 4 \text{ mA} \Rightarrow V_2 = I_D = 4V$$

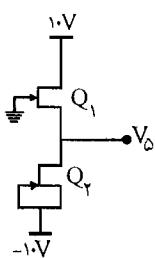
در این مدار نیز گیت و سورس به هم متصل می‌باشند پس:

$$V_{GS} = 0$$

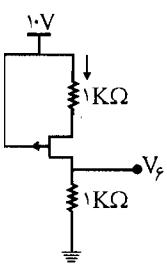
$$\Rightarrow I_D = I_{DSS} = 4 \text{ mA}$$

$$\text{از طرفی: } V_2 = 10 - 1 \times I_D = 10 - 1 \times 4 = 6V$$

در مدار مقابل: در Q2 گیت و سورس به هم متصل می‌باشند پس: $V_{GS2} = 0$ می‌باشد پس:

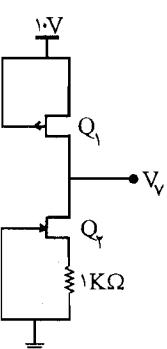


از طرفی این جریان $I_{D_1} = I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ همان جریان Q_1 می‌باشد
یعنی $I_{D_1} = I_{DSS}$ یعنی در نیز $V_{GS_1} = 0$ می‌باشد
 $V_{GS_1} = 0 \Rightarrow V_{G_1} - V_{S_1} = 0 \Rightarrow 0 - V_{S_1} = 0 \Rightarrow$
 $-V_{S_1} = 0 \Rightarrow V_{S_1} = V_d = 0 \Rightarrow V_d = 0 \text{ V}$



در این مدار: چون از نوع کanal P می‌باشد پس $V_p > 0$ می‌باشد یعنی
 $V_p = 2 \text{ V}$
 $V_{GS} = 1 \times I_D = I_D$ از طرفی
در نتیجه در رابطه I_D داریم:
 $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$
 $\Rightarrow I_D = 4 \left(1 - \frac{I_D}{2} \right)^2 = (2 - I_D)^2 = 4 + I_D^2 - 4 I_D \Rightarrow$
 $I_D^2 - 5 I_D + 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} I_D = 4 \\ I_D = 1 \end{cases}$

قابل قبول نمی‌باشد چون در این صورت $I_D = I_{DSS}$ می‌شود که در این حالت باید
 $I_D = 4 \text{ mA}$ قابل قبول نمی‌باشد پس $I_D = 1 \text{ mA}$ می‌باشد
 $V_d = 1 \times I_D = 1 \times 1 \text{ mA} = 1 \text{ V}$



در Q_1 داریم: $I_{D_1} = I_{DSS} \Leftarrow V_{GS_1} = 0$ از طرفی این جریان همان جریان
 Q_2 می‌باشد پس $I_{D_1} = I_{DSS}$ باید $V_{GS_2} = 0$ شود: $V_{GS_2} = 0 \Rightarrow V_{G_2} - V_{S_2} = 0 \Rightarrow 0 - V_{S_2} = 0 \Rightarrow V_{S_2} = 0$
که این حالت امکان ندارد چون در این صورت $I_{D_2} = 0$ می‌شود در صورتی که
 $I_{D_1} = I_{DSS}$ می‌باشد در این صورت در Q_2 می‌دانیم $V_{GS_2} \neq 0$ می‌باشد (کanal n)
خواهیم داشت: $I_{D_2} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS_2}}{V_p} \right)^2 = 4 \left(1 - \frac{V_{G_2} - V_{S_2}}{2} \right)^2$

$$\Rightarrow I_{D_2} = 4 \left(1 - \frac{0 - 1 \times I_{D_2}}{2} \right)^2 \Rightarrow \begin{cases} I_{D_2} = 4 \\ I_{D_2} = 1 \end{cases}$$

قابل قبول نمی‌باشد چون در این صورت $V_{GS_1} = I_{DSS_1} = I_{DS_1}$ یعنی $V_{GS_1} = 4 \text{ mA}$

$$I_V = I_{D_1} = 1 \text{ mA} \Leftrightarrow I_{D_1} = 1 \text{ mA}$$

KVL: $V_V = 10 + V_{DS_1}$

از طرفی Q_1 در حالت اشباع نمی‌باشد چون $V_{GS_1} = I_{D_1} = I_{DS_1}$ جریان 4 mA

قابل قبول نیست و $I_{D_1} = 1 \text{ mA}$ نمی‌باشد پس Q_1 در حالت تریود کار می‌کند و در این حالت داریم: رابطه (۲-۷)

کتاب

$$I_{D_1} = I_{DS_1} \left[2 \left(\frac{V_{GS_1}}{V_P} - 1 \right) \frac{V_{DS_1}}{V_P} - \left(\frac{V_{DS_1}}{V_P} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow I_{D_1} = 4 \left[2 \left(\frac{0}{2} - 1 \right) \frac{V_{DS_1}}{2} - \left(\frac{V_{DS_1}}{2} \right)^2 \right] \Rightarrow V_{DS_1}^2 + 4V_{DS_1} + 1 = 0$$

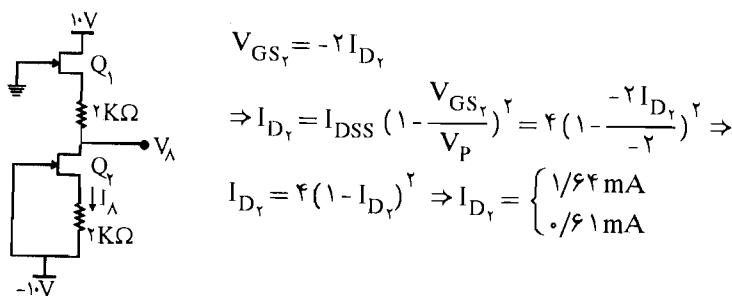
$$\Rightarrow \begin{cases} V_{DS_1} = -0.2V \\ V_{DS_1} = -3.8V \end{cases}$$

در ناحیه تریود باید: $V_{GS_1} < V_P$ یعنی $V_{GS_1} < V_P$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{DS_1} = -3.8V \Rightarrow 0 - (-3.8) < V_P \Rightarrow \text{قابل قبول نمی‌باشد} \\ V_{DS_1} = -0.2V \Rightarrow 0 - (-0.2) < V_P \Rightarrow \text{قابل قبول می‌باشد} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_V = 10 + V_{DS_1} = 10 - 0.2 = 9.8V$$

در Q_2 داریم:



$$V_{GS_1} = -2I_{D_1}$$

$$\Rightarrow I_{D_1} = I_{DS_1} \left(1 - \frac{V_{GS_1}}{V_P} \right)^2 = 4 \left(1 - \frac{-2I_{D_1}}{2} \right)^2 \Rightarrow$$

$$I_{D_1} = 4(1 - I_{D_1})^2 \Rightarrow I_{D_1} = \begin{cases} 1/64 \text{ mA} \\ 0/61 \text{ mA} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{D_1} = 1/64 \Rightarrow V_{GS_1} = -2I_{D_1} = -3/28 < V_P \Rightarrow \text{قابل قبول نمی‌باشد} \\ I_{D_1} = 0/61 \Rightarrow V_{GS_1} = -2 \times 0/61 = -1/32 > V_P \Rightarrow \text{قابل قبول می‌باشد} \end{cases}$$

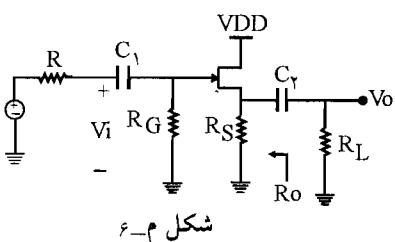
$$\Rightarrow I_A = I_{D_1} = 0/61 \text{ mA} \Rightarrow I_{D_1} = I_{D_1} = 0/61$$

$$\Rightarrow I_{D_1} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS_1}}{V_P} \right)^2 \Rightarrow 0.61 = 4 \left(1 - \frac{V_{GS_1}}{-2} \right)^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS_1} = -2/78 \\ V_{GS_1} = -1/22 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{GS_1} = -2/78 < V_P \Rightarrow \text{قابل قبول نمی باشد} \\ V_{GS_1} = -1/22 > V_P \Rightarrow \text{قابل قبول می باشد} \end{cases} \Rightarrow V_{G_1} - V_{S_1} = -1/22 \Rightarrow -V_{S_1} = -1/22$$

$$\Rightarrow V_{S_1} = 1/22 \Rightarrow V_A = V_{S_1} - 2I_{D_1} = 1/22 - 2 \times 0.61 = -V \Rightarrow V_A = 0 \text{ V}$$

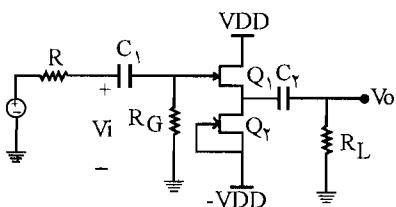
۶- در یک مدار سورس فالوئر شکل م-۶ به جای مقاومت R_S می توان از یک JFET دیگر (مشابه



اولی) استفاده نمود. گیت و سورس این JFET به $-V_{DD}$ وصل شده و درین آن به سورس اول متصل می شود. V_S مدار سورس فالوئر چقدر است؟ مقاومت خروجی سورس فالوئر را به دست آورید. با توجه به مقدار ولتاژ DC در سورس آیا در این حالت C_2 مورد نیاز است؟

۱۵ هل:

وقتی به جای R_S یک JFET با شرایط گفته شده در صورت مسأله قرار گیرد مدار به صورت شکل زیر در می آید.



$$Q_2: V_{GS_2} = 0 \Rightarrow I_{D_2} = I_{DSS}$$

$$I_{D_1} = I_{DSS} \Rightarrow I_{D_2} = I_{DSS}$$

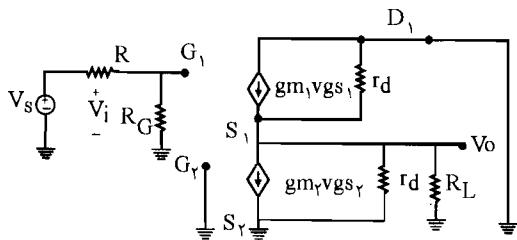
$$\Rightarrow I_{D_1} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS_1}}{V_P} \right)^2 \Rightarrow I_{DSS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS_1}}{V_P} \right)^2 \Rightarrow V_{GS_1} = 0$$

$$\Rightarrow V_{G_1} - V_{S_1} = 0 \Rightarrow V_{G_1} = 0$$

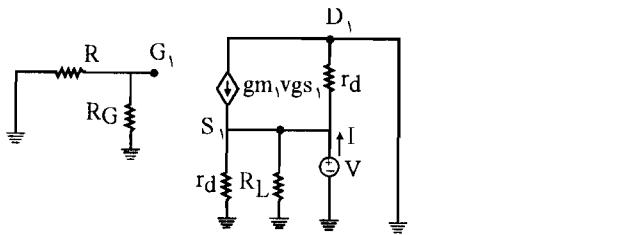
$$\Rightarrow \cdot - V_{S_1} = \cdot \Rightarrow V_{S_1} = V_S = \cdot$$

$$g_{m_1} = g_{m_\gamma} = \frac{-\gamma I_{DSS}}{V_P} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) \quad \boxed{V_{GS} = \cdot} \Rightarrow g_{m_1} = g_{m_\gamma} = \frac{-\gamma I_{DSS}}{V_P}$$

مدار معادل به صورت زیر در می‌آید:



برای اینکه مقاومت خروجی سورس فالوثر را به دست آوریم مدار معادل تون در دو سر R_L اجرا می‌کنیم.

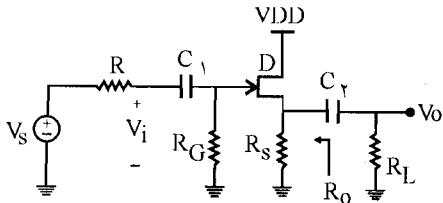


$$V_{g_1} = \cdot \quad \text{و} \quad V_{S_1} = V \Rightarrow V_{g_{S_1}} = V_{g_1} - V_{S_1} = \cdot - V = -V$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{V}{R_L} + \frac{V}{r_d} - g_m V_{g_{S_1}} + \frac{V}{r_d} = V \left(\frac{1}{R_L} + \frac{\gamma}{r_d} \right) - (g_m V_{g_{S_1}}) \\ &= V \left(\frac{1}{R_L} + \frac{\gamma}{r_d} \right) - g_m (-V) = V \left(\frac{1}{R_L} + \frac{\gamma}{r_d} + g_m \right) \\ \rightarrow R'_O &= R_{th} = \frac{V}{I} = \frac{1}{\frac{1}{R_L} + \frac{\gamma}{r_d} + g_m} = \frac{R_L \times r_d}{r_d + \gamma R_L + g_m r_d R_L} \end{aligned}$$

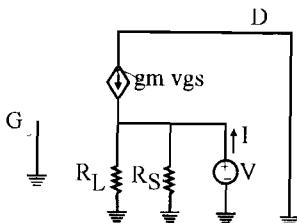
مقداری که برای V_S به دست آمده برابر صفر می‌باشد که مشخص می‌شود که وجود خازن C_2 دیگر نیاز نمی‌باشد چراکه خروجی V_O مؤلفه DC ندارد لذا می‌توانیم کوپلر مستقیم داشته باشیم.

۷- در مدار شکل م- عبا فرض A_V و R_O ، مقاومت $R_L = 10\text{ K}\Omega$ و $R_S = 10\text{ K}\Omega$ و $g_m = 2 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$ را به دست آورید.



راه حل:

برای به دست آوردن R_O ، در دو سر R_L تونن را اجرا می کنیم. V_S را برابر صفر قرار می دهیم. (از r_d به دلیل بزرگ بودن صرف نظر شده است).



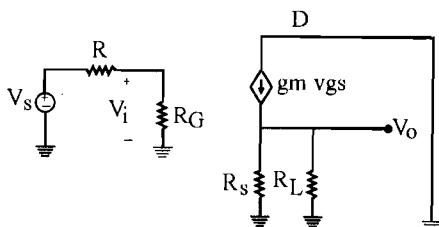
$$\text{KCL: } \frac{V}{R_L} + \frac{V}{R_S} = g_m V_{GS} + I \Rightarrow V \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_S} \right) = g_m V_{GS} + I \quad (I)$$

$$\begin{cases} V_g = 0 \\ V_S = V \end{cases} \Rightarrow V_{GS} = V_g - V_s = 0 - V = -V$$

$$(I) \Rightarrow V \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) = g_m (-V) + I \Rightarrow V (0.2 + 2) = I$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ K}\Omega = 500 \Omega$$

به دست آوردن A_V

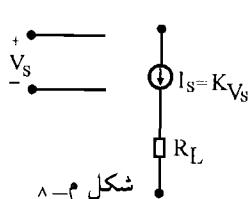


$$\text{KCL: } V_O \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_S} \right) = g_m V_{GS} \Rightarrow V_O = g_m V_{GS} \times \frac{R_L R_S}{R_L + R_S}$$

$$= 2V_{gs} \times \frac{10 \times 10}{10 + 10} = 10V_{gs}$$

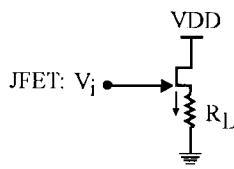
از طرفی: $V_i = V_o + V_{gs} = 10V_{gs} + V_{gs} = 11V_{gs}$

$$\Rightarrow A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{10V_{gs}}{11V_{gs}} = 0.91$$



۸- با کمک B_jT ، JFET و دیود به تعداد دلخواه یک منبع جریان I_S مطابق شکل م-۸، که تابعی خطی از یک ولتاژ V_S باشد را طوری طراحی کنید که بار متغیر ($R_L < 1K\Omega$) را تغذیه کند. V_S بین صفر تا ۵ ولت تغییر می‌کند (K نباید خیلی کوچک انتخاب شود).

راه حل:



$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{|V_{GS}|}{|V_P|} \right)^{\gamma} \Rightarrow V_p \Leftrightarrow 0 \text{ کانال N}$$

$$\Rightarrow I_D = I_{DSS} \left(1 + \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^{\gamma} = I_{DSS} \left(\frac{V_P + V_{GS}}{V_P} \right)^{\gamma}$$

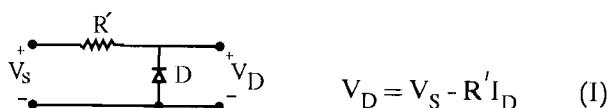
$$\text{اگر } V_{GS} = -V_P + K' \sqrt{|V_S|} \text{ باشد در این صورت داریم:}$$

(باید باشد)

$$I_D = I_{DSS} \left(\frac{K' \sqrt{|V_S|}}{V_P} \right)^{\gamma} \Rightarrow I_D = \frac{I_{DSS}}{(V_P)^{\gamma}} \times K'^{\gamma} \times V_S$$

$$K'^{\gamma} \times \frac{I_{DSS}}{(V_P)^{\gamma}} = K \Rightarrow I_D = K \times V_S \Rightarrow \text{این همان فرم } I_S \text{ می‌باشد.}$$

بنابراین باید $V_{GS} = -V_P + K' \sqrt{|V_S|}$ به صورت اگر V_S به دیودی اعمال می‌شود در دو سر دیود چنین ولتاژی را خواهیم داشت:



رابطه I_D در دیود به صورت مقابل می‌باشد:

$$I_D = I_O (e^{\frac{-V_D}{nV_T}} - 1) \quad \text{فرض} \eta = 1 \Rightarrow I_D = I_O (e^{\frac{-V_D}{V_T}} - 1)$$

اگر $\frac{V_D}{V_T}$ کوچک باشد با بسط $e^{-\frac{V_D}{V_T}}$ خواهیم داشت:

$$I_D = I_O \left[1 - \frac{V_D}{V_T} + \frac{1}{2} \left(\frac{V_D}{V_T} \right)^2 + \dots - 1 \right] \Rightarrow I_D = -I_O \times \frac{V_D}{V_T} + \frac{1}{2} I_O \left(\frac{V_D}{V_T} \right)^2$$

این رابطه را در رابطه (۱) قرار می‌دهیم:

$$V_D = V_S - R' \left[-I_O \times \frac{V_D}{V_T} + \frac{1}{2} I_O \times \left(\frac{V_D}{V_T} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow V_D = V_S + \frac{R' I_O}{V_T} V_D - \frac{R'}{2} I_O \left(\frac{V_D}{V_T} \right)^2$$

$\frac{R' I_O}{V_T}$ را برابر یک در نظر می‌گیریم یعنی $\frac{V_T}{I_O} = R'$ در نظر گرفته می‌شود در این صورت خواهیم داشت:

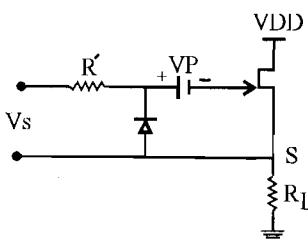
$$V_S = \frac{R'}{2} I_O \left(\frac{V_D}{V_T} \right)^2 \Rightarrow V_D = V_T \times \sqrt{\frac{2}{R' I_O}} \times \sqrt{V_S}$$

رابطه V_{GS} را ملاحظه می‌کنیم $\sqrt{V_S} K' \sqrt{V_D}$ نیاز بود که ولتاژ دو سر V_D چنین فرمی داشته باشد بنابراین:

$$K' = V_T \sqrt{\frac{2}{R' I_O}} = \sqrt{2 V_T}$$

خواهد شد و این ولتاژ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

اما در رابطه V_p ، V_{GS} - نیز است که به صورت یک باطری اضافه می‌شود و مدار شکل زیر پاسخگوی منبع جریان I خواهد شد.



در این مدار $V_{GS} = -V_p + V_D$ می‌باشد که به صورت $I_D = K \sqrt{V_S} K' \sqrt{V_D}$ می‌باشد بنابراین: $K' \sqrt{V_S}$ شده و K عبارت است از:

$$K = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} \times K'^2$$

$$K = \frac{I_{DSS}}{V_p^2} \times V_T$$

و با جایگزینی $K' = \sqrt{2 V_T}$ داریم:

شرط اینکه مدار درست کار کند این است که شرایط ناحیه اشباع برقرار باشد یعنی باید داشته باشیم:

$$-V_P < V_{GS} < 0 \quad , \quad V_{GD} < -V_P$$

$$-V_P < -V_P + K' \sqrt{V_S} < 0 \Rightarrow K' \sqrt{V_S} > 0 \quad , \quad K' \sqrt{V_S} < -V_P \quad \text{با جایگزینی } V_{GS} \text{ داریم:}$$

چون V_S مثبت و K' نیز مثبت است لذا شرط اول همواره برقرار می‌باشد و برای اینکه شرط دوم برقرار باشد باید داشته باشیم:

$$K' \sqrt{V_S} < -V_P \Rightarrow \sqrt{2V_T} \times \sqrt{V_S} < -V_P$$

چون V_S ماکزیمم ۵ است پس V_S را ۵ در نظر می‌گیریم.

$$\Rightarrow \sqrt{2 \times 26 \times 10^{-3}} \times \sqrt{5} < -V_P \Rightarrow \sqrt{26 \times 10^{-2}} < -V_P \Rightarrow -V_P > 0.51V$$

و همچنین برای اینکه در حالت اشباع باشیم باید $-V_{GD} < -V_P$ باشد.

$$V_{GS} - V_{DS} < -V_P \Rightarrow -V_P + K' \sqrt{V_S} - (V_D - V_S) < -V_P \Rightarrow$$

$$K' \sqrt{V_S} < V_D - V_S \Rightarrow K' \sqrt{V_S} < V_{DD} - R_L I_D$$

$$\Rightarrow \sqrt{2V_T} \times \sqrt{V_S} < V_{DD} - KV_S \times R_L \Rightarrow V_{DD} > \sqrt{2V_T} \times \sqrt{V_S} + KV_S \times R_L$$

$$\Rightarrow V_{DD} > \sqrt{2 \times 26 \times 10^{-3} \times V_S} + \frac{2 I_{DSS} \times V_T^2}{V_P^2} \times V_S \times R_L$$

کمترین مقدار V_{DD} به ازای R_L و V_S ماکزیمم به دست می‌آید و همچنین باید V_P مینیمم باشد.
($V_P(\min) = 0.51$)

$$\Rightarrow V_{DD} > 0.51 + \frac{2 I_{DSS} \times 26 \times 10^{-3}}{(0.51)^2} \times 5 \times 1 \Rightarrow V_{DD} > 0.51 + I_{DSS}$$

با این شرط و شرط $V_P > 0.51$ مدار فوق پاسخگوی منبع جریان خواسته شده می‌باشد.

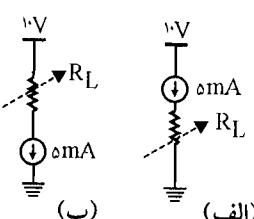
۹- با یک JFET با پارامترهای $V_P = 2/5V$ و $I_{DSS} = 8mA$ ، $|V_P| = 250K\Omega$ و $r_d = 250m\Omega$ یا با یک

BJT با پارامترهای $h_{FE} = 300$ و $h_{oe}^{-1} = 100$ می‌خواهیم

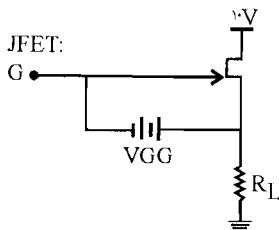
منابع جریان $-9mA$ را برای $R_L < 1/4K\Omega$ طراحی کنیم. برای هر یک

از مدارهای شکل ۹- یک بار با JFET و بار دیگر با BJT مدار

خود را طراحی کنید.



۱۵ حل:



ابتدا مدار مقابل را در نظر می‌گیریم اگر JFET در ناحیه اشباع کار کند در این صورت JFET ($I_D = 5\text{mA}$) از نوع کanal N انتخاب شده است.

$$\Rightarrow V_P = -2/5 \text{ V}$$

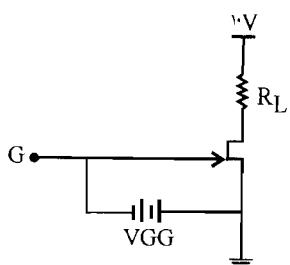
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \Rightarrow 5 = 8 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-2/5} \right)^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = -4/475 \\ V_{GS} = -0/525 \end{cases}$$

$V_{GS} = -4/475 < V_P$ می‌باشد در نتیجه قابل قبول نمی‌باشد پس $V_{GS} = -0/525$ می‌باشد پس قابل قبول می‌باشد یعنی $V_{GS} = -0/525 \text{ V}$ می‌باشد. حال باید ببینیم به ازای مقادیر آنها JFET در ناحیه اشباع کار می‌کند یا خیر؟

$$V_{GD} = V_G - V_D = (V_{GS} + V_S) - V_D = -0/525 + 5R_L - 10$$

رابطه بالا به ازای ماکریم مقادیر $R_L = 1/4 \text{ K}\Omega$ یعنی V_P کوچکتر از $V_{GS} = -0/525 \text{ V}$ پس مدار فوق با JFET با $R_L = 1/4 \text{ K}\Omega$ در این رابطه صدق می‌کند و $V_{GG} = -V_{GS} = -0/525 \text{ V}$ پارامترهای داده شده پاسخگوی طرح خواسته شده در شکل (الف) می‌باشد.

شکل (ب) با JFET:



با $V_{GS} = -0/525 \text{ V}$ مانند مدار قبلی $I_D = 5\text{mA}$ شده و باید

ببینیم به ازای مقادیر داده شده برای R_L ، JFET در ناحیه اشباع می‌باشد یا نه؟

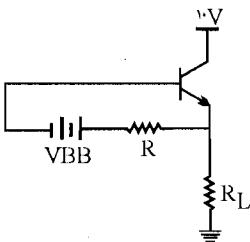
$$V_{GD} = V_G - V_D = -0/525 - (10 - 5R_L) < V_P = -2/5$$

رابطه بالا به ازای ماکریم مقادیر $R_L = 1/4 \text{ K}\Omega$ یعنی $R_L = 1/4 \text{ K}\Omega$ باید

$$V_{GD} = -0/525 - 10 + 5 \times 1/4 = -3/525 < -2/5 \Rightarrow \text{صادر باشد رابطه فوق صادق است.}$$

پس مدار فوق با $V_{GG} = -V_{GS} = 0/525 \text{ V}$ با JFET به کار می‌رود. (مقادیر مقدار مقاومت خروجی به کار می‌رود.)

خواسته شده در شکل (ب) می‌باشد.



مدار شکل الف با BJT :

اگر BJT در ناحیه فعال باشد و $I_C = 5 \text{ mA}$ در این صورت مدار پاسخگوی طرح خواسته شده در شکل الف خواهد بود (BJT از نوع npn انتخاب شده است).

$$\begin{aligned} \text{فرض: } R &= 15 \text{ K}\Omega : V_{BB} - V_{BE} = RI_B \Rightarrow V_{BB} = V_{BE} + R \times \frac{I_C}{h_{fe}} \\ \Rightarrow V_{BB} &= 0.7V + 15 \times \frac{0.005}{100} = 0.95V \end{aligned}$$

حال باید بینیم BJT به ازای مقادیر داده شده برای R_L در ناحیه فعال می‌باشد یا نه؛ یعنی باید داشته باشیم:

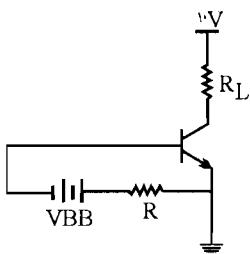
$$V_{CE} = V_C - V_E = 10 - R_L I_C = 10 - 5R_L > 0.2V$$

این رابطه باید به ازای ماکزیمم مقدار R_L صادق باشد یعنی به ازای $R_L = 1/4 \text{ K}\Omega$

$$V_{CE} = 10 - 5 \times 1/4 = 3 > 0.2V$$

می‌بینیم که رابطه صادق بوده و مدار فوق با $V_{BB} = 0.95V$ با پارامترهای داده شده پاسخگوی طرح خواسته شده در شکل (الف) می‌باشد.

مدار شکل (ب) با BJT :



با $V_{BB} = 0.95V$ مانند مدار قبلی $I_C = 5 \text{ mA}$ می‌باشد و باید بینیم به ازای مقادیر داده شده برای R_L ، R در ناحیه فعال می‌باشد یا نه؟ باید داشته باشیم:

$$V_{CE} = V_C - V_E = 10 - I_C \times R_L - 0 = 10 - 5R_L > 0.2V$$

رابطه بالا به ازای ماکزیمم مقدار R_L در ناحیه فعال می‌باشد یا نه؟ باید داشته باشیم:

$$V_{CE} = V_C - V_E = 10 - I_C \times R_L - 0 = 10 - 5R_L > 0.2V$$

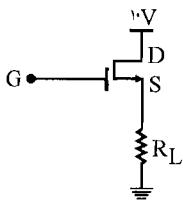
رابطه بالا به ازای ماکزیمم مقدار R_L یعنی $R_L = 1/4 \text{ K}\Omega$ باید صادق باشد:

$$V_{CE} = 10 - 5 \times 1/4 = 3 > 0.2V$$

می‌بینیم که رابطه صادق بوده و مدار فوق با $V_{BB} = 0.95V$ با BJT با پارامترهای داده شده پاسخگوی طرح خواسته شده در شکل ب می‌باشد. (مقاآمت h_{oe} در تعیین مقدار مقاومت خروجی به کار می‌رود).

۱۰ - مسئله ۹ را با $V_T = 2V$ و $K = \frac{mA}{V^2}$ هستند، تکرار کنید.

(۱۵ مل):



شکل الف: MOS را از نوع N انتخاب می‌کنیم:

$$I_D = I_S = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

MOS از نوع N می‌باشد در نتیجه $V_T > 0$ می‌باشد.

$$\Rightarrow 5 = \frac{1}{2} (V_{GS} - 2)^2$$

$$\Rightarrow 10 = (V_{GS} - 2)^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 5/16 V \\ V_{GS} = -1/16 V \end{cases}$$

در MOSFET نوع ارتقایی از نوع N باید: $V_{GS} < V_T$ باشد پس $V_{GS} = -1/16 V$ قابل قبول نمی‌باشد

$V_{GS} = 5/16 V$ پس قابل قبول می‌باشد:

پس در مدار بالا باید بین G و S یک منبع ولتاژ به اندازه $V_{GS} = 5/16 V$ قرار داده شود شرط اینکه مدار

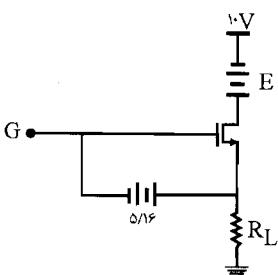
در حالت اشباع باشد به صورت زیر است:

$$V_{GD} < V_T \Rightarrow V_G - V_D < V_T \Rightarrow (V_{GS} + V_S) - V_{DD} < V_T$$

$$\Rightarrow (5/16 + R_L \times I_D) - 10 < 2 \Rightarrow R_L < \frac{2 + 4/16}{I_D}$$

$$\Rightarrow R_L < \frac{6/16}{5} = 1/33 K\Omega$$

چون در صورت مسئله $R_L < 1/4 K\Omega$ می‌باشد پس باید در مدار فوق یک منبع ولتاژی مانند E اضافه شود.



شرط اشباع: $V_{GD} < V_T \Rightarrow (V_G - V_D) < V_T$

$$\Rightarrow (V_{GS} + V_S) - (V_{DD} + E) < V_T$$

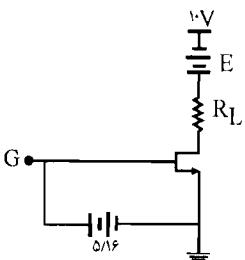
$$\Rightarrow (5/16 + I_D \times R_L) - (10 + E) < 2$$

$$\Rightarrow E > -6/16 + R_L I_D = -6/16 + 5R_L$$

رابطه بالا باید به ازای مأکریم مقدار $R_L = 1/4 \text{ K}\Omega$ یعنی $R_L = 1/4 \text{ K}\Omega$ صادق باشد پس:

$$E > -6/84 + 5 \times 1/4 = 0/16 \text{ V}$$

شکل (ب) با NMOS به صورت زیر می‌باشد:



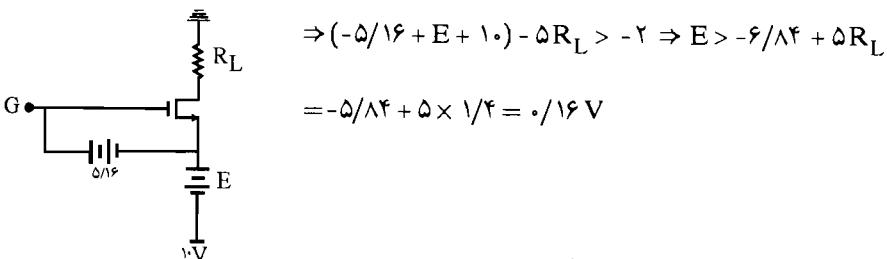
شکل (الف) با PMOS به صورت زیر می‌باشد:

$$I_D = I_S = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \quad \text{در } V_T = -2 \text{ V . PMOS} \text{ منفی می‌باشد یعنی } V_T < 0$$

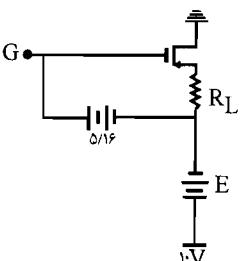
$$\Rightarrow I_D = I_S = \frac{1}{2} (-5/16 + 2)^2 \simeq 5 \text{ mA}$$

شرط اینکه مدار در حالت اشباع باشد:

$$V_{GD} > V_T \Rightarrow V_G - V_D > V_T \Rightarrow (V_{GS} + E + 10) - I_D \times R_L > V_T$$

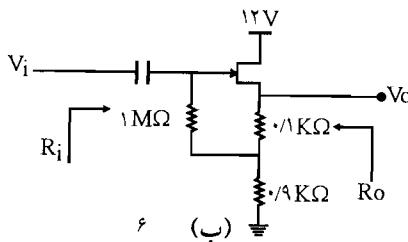


شکل (ب) با PMOS به صورت زیر می‌باشد:

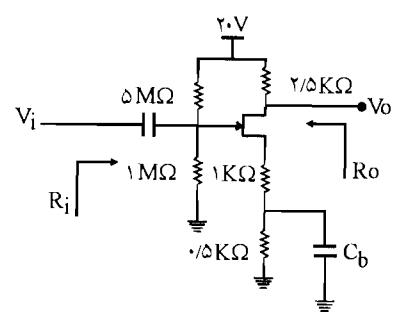


11- در هر یک از تقویت‌کننده‌های شکل م- ۱۱ مقادیر R_O ، A_V ، R_i وحدات دامنه نوسان متقارن

برای آنکه تقویت کننده در ناحیه اشباع باقی بماند را به دست اورید. JFET دارای پارامترهای $r_d = 200 \text{ K}\Omega$ و $|V_p| = 2V$ و $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ هستند.



(ب)



(الف)

شکل م-۱۱

اده حل:

$$\begin{cases} V_G = \frac{20 \times 1M\Omega}{1+5} = \frac{10}{3} \text{ V} \\ V_S = (1K\Omega + 1/5K\Omega) \times I_D = 1/5 I_D \end{cases} \Rightarrow V_{GS} = \frac{10}{3} - 1/5 I_D \Rightarrow I_D = \frac{20 - 6V_{GS}}{9} \quad (\text{I})$$

از طرفی طبق رابطه I_D داریم:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

$(V_p = -2V$ می باشد یعنی $V_p < 0$ می باشند پس $V_{GS} = -6V$ است)

$$\Rightarrow I_D = 10 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-2} \right)^2 \quad (\text{II})$$

به جای I_D در رابطه (II)، I_D به دست آمده از رابطه (I) را قرار می دهیم:

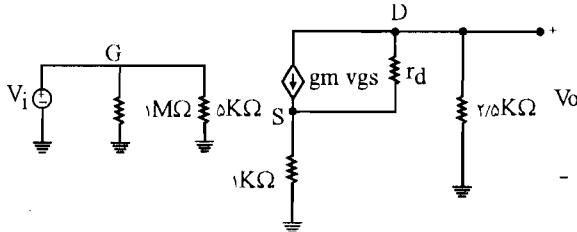
$$\frac{20 - 6V_{GS}}{9} = 10 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-2} \right)^2 \Rightarrow 45V_{GS}^2 + 192V_{GS} + 140 = 0$$

با حل این معادله درجه (2) داریم:

$$\begin{cases} V_{GS} = -0.93 > V_p \Rightarrow \text{قابل قبول می باشد} \\ V_{GS} = -3.13 \Rightarrow V_{GS} < V_p \Rightarrow \text{قابل قبول نمی باشد} \end{cases} \quad V_{GS} = -0.93$$

$$\Rightarrow g_m = \frac{-2I_{DSS}}{V_p} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right) = \frac{-2 \times 10}{-2} \left(1 - \frac{-0.93}{-2} \right) = 0.535 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

حال مدار معادل را رسم می‌کنیم:



حال به جای منبع جریان $g_m V_{GS}$ از منبع ولتاژ $g_m V_{GS} r_d$ استفاده می‌کنیم. (تبدیل منبع جریان به منبع ولتاژ)

$$I = \frac{V}{2/5} + \frac{V - 0/84 V}{201} = V \left(\frac{1}{2/5} + \frac{0/16}{201} \right) = V \times 0/400 \text{ A}$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1}{0/400} = 2/495 \text{ K}\Omega$$

برای به دست آوردن حداکثر دامنه نوسان متقارن:
با توجه به مدار معادل داریم:

$$V_{ds} = V_d - V_s = V_o - \left(i_d - \frac{V_{ds}}{r_d} \right) \times 1 \text{ K}\Omega$$

$$\Rightarrow V_{ds} = -2/5 i_d - \left(i_d - \frac{V_{ds}}{r_d} \right) \times 1 \text{ K}\Omega \Rightarrow V_{ds} \left(1 - \frac{1}{200} \right) = -3/5 i_d$$

$$\Rightarrow V_{ds} = \frac{-3/5 i_d}{0/995} = -3/5 18 i_d \quad \text{معادله خط بار ac:}$$

$$\text{DC: معادله خط بار } V_{DS} - V_{DSQ} = -3/5 18 (i_D - i_{DQ}) \quad (1)$$

$$i_{DQ} = \frac{-6 V_{GSQ} + 20}{9} = \frac{-6 \times (-0/93) + 20}{9} = 2/842 \text{ mA}$$

$$V_{DSQ} = 20 - (2/5 + 1 + 0/5) \times I_{DQ} = 20 - 4 \times 2/842 = 8/632 \text{ V}$$

$$V_{ODS} = 20 - 2/5 I_{DQ} = 20 - 2/5 \times 2/842 = 12/9 \text{ V}$$

در نقطه قطع که $i_D = 0$ می‌باشد خروجی ماکریم می‌باشد یعنی $V_O(\max) = 20 \text{ V}$
مرز اشباع و تریود چنین می‌شود: V_{DS}

$$V_{GD} \leq V_P \Rightarrow V_{GS} - V_{DS} \leq V_P \Rightarrow V_{DS} \geq -V_P + V_{GS}$$

رابطه فوق به ازای جمع مقادیر V_{GS} باید صادق باشد تا از ناحیه اشباع خارج نشویم و $V_{DS} = 0$ بزرگترین مقدار ممکن سمت راست رابطه فوق می‌باشد که باید V_{DS} از این مقدار نیز بزرگتر باشد لذا

$$V_{DS} \geq -V_P \Rightarrow V_{DS} \geq -V_P \Rightarrow V_{DS} \geq -(-2) = 2 \quad \text{داریم:}$$

بنابراین $V_{DS} = 2V$ می‌تواند ماکریم مقدار جریان i_D را مشخص کند. با توجه به رابطه (۱) داریم:

$$V_{DS} - V_{DSQ} = -\frac{2}{5}18(i_D - i_{DQ}) \Rightarrow 2 - \frac{2}{5}18 = -\frac{2}{5}15i_D + \frac{2}{5}18 \times \frac{2}{842}$$

$$\Rightarrow i_D(\max) = 4/73$$

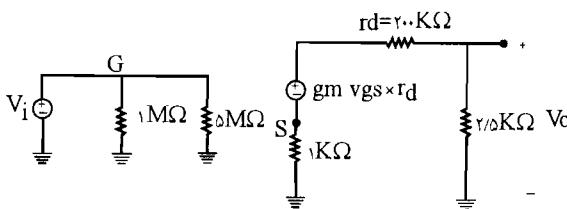
و کمترین مقدار V_O چنین می‌شود:

$$V_O(\min) = 2 - \frac{2}{5}i_D(\max) = 2 - \frac{2}{5} \times \frac{4}{73} = 175V$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{O_1} = V_O(\max) - V_O = 2 = 12/9 = 4/1 \\ V_{O_2} = V_O - V_O(\min) = 12/9 - 175 = 4/73 \end{array} \right.$$

حداکثر انحراف متقارن خروجی بدون اعوجاج $V_O(\max) = 4/73$ حداکثر دامنه نوسان متقارن را

کمترین مقدار به دست آمده از دو مقدار بالا مشخص می‌کند.



$$V_O = -\frac{\frac{2}{5} \times g_m v_{gs} r_d}{\frac{2}{5} + 200 K\Omega + 1 K\Omega} = \frac{-\frac{2}{5} \times 5/35 \times 200}{202/5} V_{gs} \quad \text{با استفاده از تقسیم ولتاژ}$$

$$\Rightarrow V_O = -131/V_{gs}$$

$$V_S = \frac{1 K\Omega \times g_m v_{gs} r_d}{\frac{2}{5} + 200 + 1 K\Omega} = \frac{5/35 \times 200}{202/5} v_{gs} = 5/26 v_{gs} \quad \text{(از طرفی با استفاده از تقسیم ولتاژ)}$$

از طرفی طبق مدار داریم:

$$V_i = V_g \quad , \quad V_{gs} = V_g - V_s = V_i - V_s$$

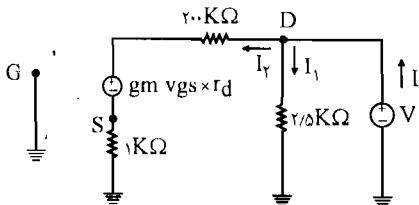
$$\Rightarrow V_{gs} + V_s = V_i \Rightarrow V_i = V_{gs} + 5/26 V_{gs} = 6/26 V_{gs}$$

$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{-131/V_{gs}}{6/26 V_{gs}} = -2/1$$

$$R_i = 1M\Omega \parallel 5M\Omega = \frac{5}{6} M\Omega = 833 K\Omega$$

به دست آوردن مقاومت R_j :

به دست آوردن مقاومت R_O : برای به دست آوردن مقاومت خروجی، یک منبع ولتاژ V را در دو سر مقاومت $2/5 K\Omega$ قرار می‌دهیم و منبع ورودی i را صفر در نظر می‌گیریم.



$$\text{طبق مدار: } V_g = 0, \quad I = I_1 + I_2 = \frac{V}{2/5} + \frac{V + g_m V_{gsrd}}{200 + 1} \quad (\text{A})$$

$$\text{از طرفی: } V_{gs} = V_g - V_s = 0 - 1 \times I_2 = -I_2, \quad I_2 = + \frac{V + g_m V_{gs} r_d}{200 + 1}$$

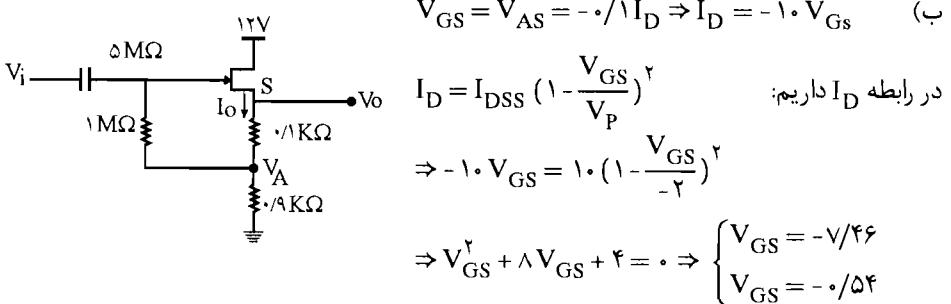
$$\Rightarrow V_{gs} = -I_2 = - \frac{V + g_m V_{gs} r_d}{201} = - \frac{V + 0/30 \times 200 V_{gs}}{201} \Rightarrow$$

$$201 V_{gs} + 0/30 \times 200 V_{gs} = -V \Rightarrow V_{gs} = \frac{-V}{1271} \quad (\text{B})$$

با جایگذاری (B) در (A) داریم:

$$(\text{A}) : I = \frac{V}{2/5} + \left[\frac{0/30 \times 200 \times \frac{-V}{1271}}{201} + \frac{V}{201} \right] \Rightarrow$$

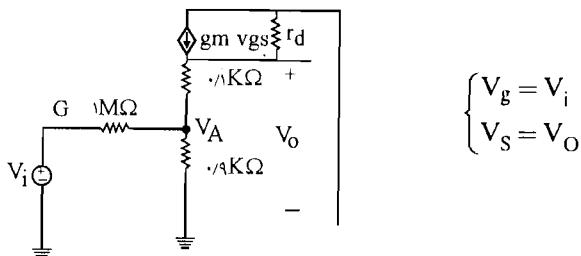
$$V_{GS} = V_{AS} = -0/1 I_D \Rightarrow I_D = -10 V_{GS} \quad (\text{B})$$



قابل قبول نمی‌باشد چون از V_P کوچکتر است ولی $V_{GS} = -0/5$ چون از V_P بزرگتر می‌باشد قابل قبول است.

$$g_m = \frac{-2 I_{DSS}}{V_P} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{-2 \times 10}{-2} \left(1 - \frac{(-0/5)}{2} \right) = 5 \frac{mA}{V}$$

مدار معادل به صورت زیر می‌باشد:



$$\begin{cases} V_g = V_i \\ V_s = V_o \end{cases}$$

$$V_A \left(\frac{1}{0.9} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{0.1} \right) - \frac{1}{1000} V_i - \frac{1}{0.1} V_o = 0 \quad (I)$$

$$V_o \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{0.1} \right) - V_A \times \frac{1}{0.1} = g_m v_{gs} \quad (II) \quad , \quad v_{gs} = v_g - v_s = v_i - v_o$$

$$(I) : V_A \left(11/112 \right) - 10 V_o = 0.001 V_i$$

$$(II) : V_o \left(10 + 0.005 \right) - 10 V_A = 1/3 (V_i - V_o) \Rightarrow -10 V_A + 17/30 V_o = 1/3 V_i$$

$$V_A = 0.79 V_i \quad , \quad V_o = 0.88 V_i$$

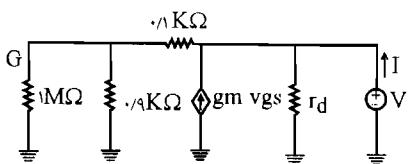
با استفاده از این دو رابطه داریم:

$$\Rightarrow A_V = \frac{V_o}{V_i} = 0.88$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i}{\left(\frac{V_g - V_A}{1000} \right)} = \frac{1000 V_i}{V_i - 0.79 V_i} = \frac{1000}{0.21} = 4760 \Omega$$

به دست آوردن R_o :

برای به دست آوردن R_o یک منبع ولتاژ V در خروجی گذاشته و منبع V_i را صفر می‌کنیم.



$$I = \frac{V}{r_d} - g_m v_{gs} + \frac{V}{0.1 + (0.9 \parallel 1000)} \quad \text{از طرفی: } V_{gs} = V_g - V_s = 0 - V = -V$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{200} - 1/3 \times (-V) + \frac{V}{0.1 + 0.899} \Rightarrow I = 1/3.6 \Rightarrow R_o = \frac{V}{I} = \frac{1}{1/3.6} = 120 \Omega$$

به دست آوردن حداکثر دامنه نوسان متقارن:

$$I_{DQ} = -10 \text{ V}_{GSQ} = -10 \left(-0.5/4 \right) = 5/4 \text{ mA}$$

$$V_{DSQ} = 12 - (0.9 + 0.1) I_{DQ} = 12 - 1 \times 5/4 = 6/4 \text{ V}$$

$$\text{مُؤلفه خروجی: } V_O = 12 - V_{DSQ} = 12 - 6/4 = 5/4 \text{ V}$$

در نقطه قطع که $i_D = 0$ می‌باشد خروجی مینیمم مقدار خود یعنی صفر را دارد.

V_{DS} مرز ناحیه اشباع و تریود به صورت زیر می‌باشد:

$$V_{GD} \leq V_P \Rightarrow V_{GS} - V_{DS} \leq V_P \Rightarrow V_{DS} \geq -V_P + V_{GS}$$

رابطه بالا به ازای تمام مقادیر V_{GS} باید صادق باشد تا از مرز ناحیه اشباع خارج نشویم و $V_O = 0$

بزرگترین مقدار ممکن سمت راست رابطه فوق را مشخص می‌کند که باید V_{DS} از این مقدار نیز بزرگتر باشد پس داریم:

$$V_{DS} \geq -V_P + 0 \Rightarrow V_{DS} \geq -V_P \geq -(-2) = 2$$

بنابراین $V_{DS} = 2 \text{ V}$ می‌تواند ماکزیمم جریان I_D و نیز ماکزیمم مقدار خروجی را مشخص کند.

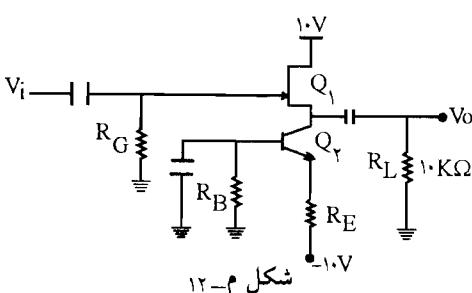
$$V_{DS} = 2 \text{ V} \Rightarrow V_O(\max) = 12 - V_{DS}(\min) = 12 - 2 = 10 \text{ V}$$

$$\begin{cases} V_{O_1} = V_O(\max) - V_O = 10 - 5/4 = 4/6 \\ V_{O_2} = V_O - V_O(\min) = 5/4 - 0 = 5/4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_O(\max) = 4/6$$

حداکثر انحراف متقارن خروجی بدون اعوجاج برای کمترین مقدار در رابطه بالا است.

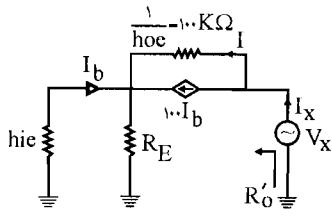
در تقویت‌کننده شکل ۱۲ می‌خواهیم $A_V = 12/0.97$ باشد و برای خروجی یک نوسان متقارن با



دامنه ۴ ولت حول صفر ممکن باشد. همه مقادیر مجھول را محاسبه کنید. با فرض $V_P = -2/7 \text{ V}$ و $I_{DSS} = 7/6 \text{ mA}$ و $r_d = 100 \text{ K}\Omega$ و $h_{fe} = 100$ و $r_o = 100 \text{ K}\Omega$ ، اگر در این طرف مقاومت $h_{oe}^{-1} = 100 \text{ K}\Omega$ مستقیماً به S وصل می‌شود چه می‌شود؟

۱۵ مل:

مقاومت خروجی دیده شده از کلکتور Q_2 به صورت زیر محاسبه می شود.



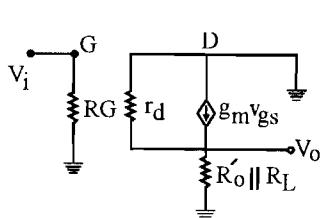
$$I_x = I + 100 I_b$$

$$I_b = -\frac{R_E}{R_E + h_{ie}} I_x \Rightarrow I = I_x - 100 I_b = \frac{h_{ie} + 100 R_E}{R_E + h_{ie}}$$

با اعمال KVL در حلقه بیرونی (شامل V_x ، R_o و $\frac{1}{h_{oe}}$) خواهیم داشت:

$$V_x = 100 I - h_{ie} I_b \Rightarrow \frac{V_x}{I_x} = R'_o = \frac{100 h_{ie} + 100 R_E + h_{ie} R_E}{R_E + h_{ie}}$$

اگر به جای طبقه Q_2 ، مقاومت خروجی R'_o را قرار دهیم و مدار معادل Q_1 را بکشیم مدار زیر حاصل می شود.



$$R \triangleq R'_o \parallel R_L$$

$$V_o = \frac{g_m V_{gs} \times R \cdot r_d}{R + r_d} \quad (1)$$

می دانیم که:

$$\begin{cases} V_g = V_i \\ V_s = V_o \end{cases} \text{ از طرفی پس خواهیم داشت:}$$

$$V_{gs} - V_i - V_o \quad (2)$$

با جایگذاری رابطه (2) در (1) خواهیم داشت:

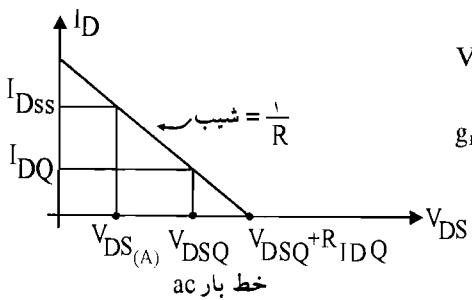
$$V_o = \frac{g_m (V_i - V_o) \cdot R \cdot r_d}{R + r_d}$$

$$g_m r_d = \mu \Rightarrow A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\mu R}{R(1+\mu) + r_d} \geq 0.9V \Rightarrow 3g_m \times 100 R - 9V(R + 100) \geq 0$$

خط بار ac، JFET به صورت زیر به دست می آید:

$$V_{ds} = -R \cdot i_d$$

$$V_{DS} - V_{DSQ} = -R(i_D - I_{DQ})$$



$$V_{DS}(A) = V_{DSQ} - R(I_{DSS} - I_{DQ})$$

$$g_m = 2I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) \left(-\frac{1}{V_p}\right)$$

$$g_m = 2I_{DSS} \times \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}} \left(-\frac{1}{V_p}\right) = 2/04 \sqrt{I_{DQ}} \quad (4)$$

با جایگزینی رابطه (۲) در (۳) خواهیم داشت:

$$2 \times 2/04 \sqrt{I_{DQ}} \times 100R - 9V(R + 100) \geq 0 \Rightarrow \sqrt{I_{DQ}} \geq \frac{9V(R + 100)}{612R}$$

اگر $I_{DQ} < \frac{I_{DSS}}{2}$ شود در اینجا $R I_{DQ}$ حداکثر انحراف بوده و باید $4V$ باشد یعنی داریم:

$$R I_{DQ} = 4 \Rightarrow I_{DQ} = \frac{4}{R} \Rightarrow \frac{4}{R} \geq \frac{(9V)^2 (R + 100)}{(612R)^2}$$

$$251/26 \times \left(\frac{1}{R}\right)^2 + 1/025 \left(\frac{1}{R}\right) + 0/025 \leq 0 \quad (5)$$

چند جمله‌ای عبارت (۵) همواره مثبت است ولذا این حالت به جواب نمی‌رسد.

اگر $I_{DQ} > \frac{I_{DSS}}{2} = 3/8$ باشد. داریم:

$$R(I_{DSS} - I_{DQ}) = 4$$

$$I_{DQ} = \frac{V/6R - 4}{R} \quad (6)$$

با جایگزینی (۶) در معادله (۳) خواهیم داشت:

$$\frac{V/6R - 4}{R} \geq \frac{(9V)^2 (R + 100)}{(612R)^2}$$

$$251/26 \left(\frac{1}{R}\right)^2 + 6/025 \left(\frac{1}{R}\right) - V/5V \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{R} = 0/186, -0/162$$

$$\frac{1}{R} < 0/186 \Rightarrow R > 5/38 \text{ K}\Omega$$

با محاسبه R ، I_{DQ} از رابطه (۶) محاسبه می‌شود با داشتن h_{ie} ، I_{DQ} محاسبه خواهد شد:

$$h_{ie} = \frac{h_{fe} V_T}{I_C} = \frac{h_{fe} \cdot V_T}{I_{DQ}}$$

با جایگزینی h_{ie} در رابطه R'_O خواهیم داشت:

$$R'_O \parallel 10K = R \Rightarrow R'_O = \frac{10R}{100 - R} \quad (V)$$

از روی معادله (V)، R_E محاسبه خواهد شد. (R_E باید مثبت باشد)

$$R_E \approx 165\Omega$$

مثلاً اگر $R = 10K$ بگیریم خواهیم داشت:

$$I_{DQ} = \frac{V/2 R - 4}{R} = V/2 \text{ mA}$$

$$g_m = \sqrt{I_{DSS} \cdot I_{DQ}} \left(-\frac{1}{V_p} \right) = 0.4 \times \left(\frac{mA}{V} \right) \text{ یا } s$$

$$A_V = \frac{\mu R}{R(1+\mu) + r_d} \approx 1$$

واز حلقه R_E ، R_B و V_{BE} ولت خواهیم داشت:

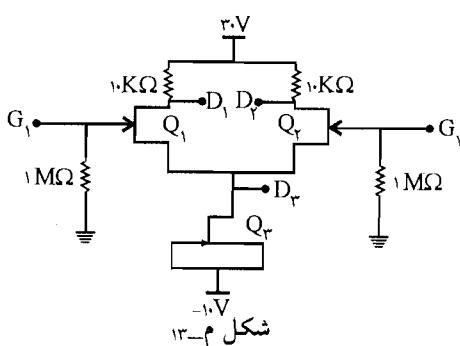
$$R_E I_C + R_B I_B = 10 - V_{BE}$$

$$0/165 \times V/2 + R_B \times \frac{V/2}{100} = 10 - 0/V \Rightarrow R_B = 112/5 K\Omega$$

ب) اگر R_L مستقیماً به سورس (s) متصل شود. جریان DC مربوط به کلکتور یعنی I_C با جریان I_{DQ} برابر نخواهد شد و بخشی از I_{DQ} عبور خواهد کرد و در ضمن خروجی دارای مؤلفه dc می‌شود. ۱۳- در مدار شکل ۱۳-۱، همه JFET‌ها مشابه و برای آنها $V_p = -2V$ و $I_{DSS} = 4mA$ است.

الف) ولتاژ‌های DC نقاط D_1 و D_2 را به

دست آورید.



ب) در صورتی که یک سیگنال کوچک با کوپلار خازنی بین G_2 و G_1 اعمال شده و خروجی از بین نقاط D_1 و D_2 گرفته شود بهره ولتاژ چقدر خواهد بود؟

(اهمیاتی): Q_2 به صورت یک منبع جریان ثابت عمل می‌کند. از دید سیگنال به جای آن مقاومت r_o را جایگزین نمایید.

راه حل:

الف) در Q_1 چون گیت و سورس به هم متصل می‌باشند پس $V_{GS_1} = V$ می‌باشد لذا: $I_{D_1} = I_{D_\gamma} = I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ و این جریان بین Q_1 و Q_2 تقسیم می‌شود (چون دو ترانزیستور Q_1 و Q_2 کاملاً مشابه می‌باشند). پس:

$$I_{D_1} = I_{D_\gamma} = \frac{V}{R} = 2 \text{ mA} \Rightarrow V_{D_1} = 30 - 10 I_{D_1} = 30 - 10 \times 2 = 10 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{D_\gamma} = 30 - 10 \times I_{D_\gamma} = 10 \text{ V} \Rightarrow V_{D_1} = V_{D_\gamma} = 10 \text{ V}$$

$$I_{D_1} : I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS_1}}{V_p}\right)^2 \Rightarrow 2 = 4 \left(1 - \frac{V_{GS_1}}{-2}\right)^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS_1} = -3/4 \\ V_{GS_1} = -0.59 \end{cases}$$

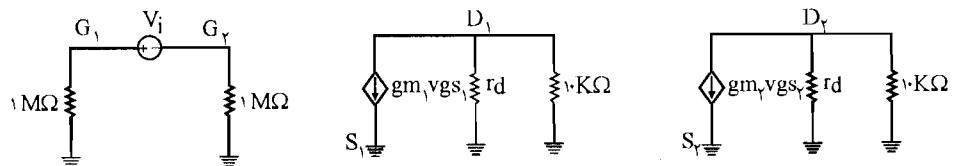
$$\Rightarrow \begin{cases} V_{GS_1} = -3/4 < V_p \Rightarrow \text{قابل قبول نمی‌باشد} \\ V_{GS_1} = -0.59 > V_p \Rightarrow \text{قابل قبول می‌باشد} \end{cases}$$

($V_{GS_1} = -0.59 < V_p$) می‌باشد چون توسط یک مقاومت $1 M\Omega$ به زمین وصل شده‌اند).

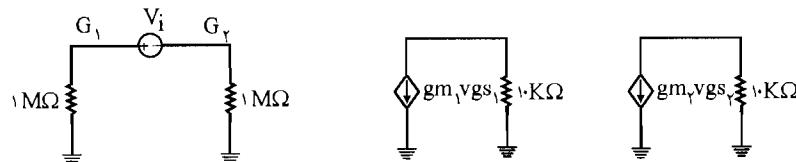
$$\Rightarrow V_{G_1} - V_{S_1} = -0.59$$

$$\Rightarrow 0 - V_{S_1} = -0.59 \Rightarrow V_{G_1} = 0.59 \Rightarrow V_{D_\gamma} = V_{S_1} = 0.59$$

(ب) مدار معادل Q_2 یک منبع جریان ثابت با مقدار 4 mA و یک مقاومت r_d در دو سر آن می‌باشد. مدار معادل کل به صورت شکل صفحه بعد می‌باشد:



اگر r_d را بزرگ در نظر بگیریم r_d در مقابل مقاومت 10 KΩ حذف می‌شود:



$$g_m = \frac{-\gamma I_{DSS}}{V_p} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) = \frac{-\gamma \times 4}{-\gamma} \left(1 - \frac{-2}{-\gamma}\right) = 2/82$$

$$\begin{cases} V_{g_1} = V_i \times \frac{1}{1+1} = \frac{V_i}{2} \\ V_{g_2} = -V_i \times \frac{1}{1+1} = -\frac{V_i}{2} \end{cases}$$

$$\text{از طرفی: } g_m V_{gs_1} = -g_m V_{gs_2} \Rightarrow (V_{g_1} - V_{s_1}) = -(V_{g_2} - V_{s_2})$$

$$\Rightarrow V_{g_1} = V_{g_2}$$

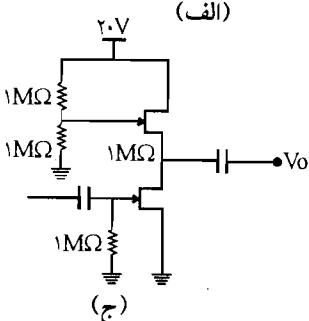
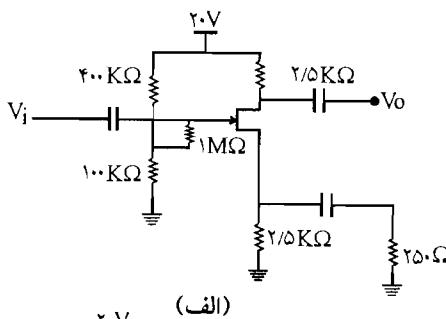
$$V_{D_2} = -g_m V_{gs_2} \times 10 = -2/82 \times \left(\frac{V_i}{2}\right) \times 10 = -14/17V$$

$$V_{D_1} = -g_m V_{gs_1} \times 10 = -2/82 \times \left(\frac{V_i}{2}\right) \times 10 = -14/17V$$

$$V_O = V_{D_1} - V_{D_2} = -14/17V_i - (+14/17V_i)$$

$$\Rightarrow A_V = \frac{V_O}{V_i} = -28/2$$

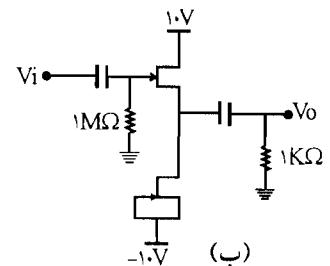
(خروجی از بین نقاط D_1 و D_2 گرفته می‌شود).



۱۴- در مدارهای شکل م-۱۴ فرض کنید برای

$$|V_p| = 2V \text{ و } I_{DSS} = 8mA, \text{ ها، JFET مه}$$

است. A_V را محاسبه کنید.

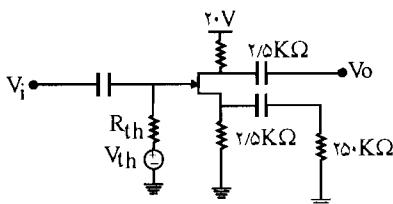


۱۵)

الف) مدار معادل تونن را در گیت اجرا می کنیم:

$$\begin{cases} R_{th} = 1M\Omega + \frac{100 \times 400}{100 + 400} = 1.8K\Omega \\ V_{th} = 20 \times \frac{100}{400 + 100} = 4V \end{cases}$$

پس مدار معادل به صورت زیر می باشد:



چون از نوع N کاتال می باشد V_p منفی می باشد.

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_{th} - 2/5 I_D = 4 - 2/5 I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2 = 8 \left(1 - \frac{4 - 2/5 I_D}{-2} \right)^2$$

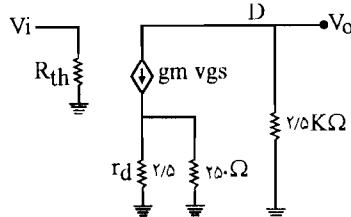
$$\Rightarrow 25 I_D^2 - 122 I_D + 144 = 0$$

با حل این معادله درجه (۲) مقادیر زیر برای I_D به دست می آید:

$$\begin{cases} I_D = 2 \Rightarrow V_{GS} = 4 - 2/5 \times 2 = -1 > V_p \Rightarrow \text{قابل قبول می باشد} \\ I_D = 2/88 \Rightarrow V_{GS} = 4 - 2/5 \times 2/88 = -3/2 < V_p \Rightarrow \text{قابل قبول نمی باشد} \end{cases}$$

$$g_m = \frac{-2 I_{DSS}}{V_p} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right) = \frac{-2 \times 8}{-2} \left(1 - \frac{-1}{-2} \right) = 4 \frac{mA}{V}$$

مدار معادل به صورت زیر می باشد:



$$V_o = -g_m V_{gs} \times 2/5 = -4 \times 2/5 \times V_{gs} = -10 V_{gs} (I)$$

$$V_{gs} = V_g - V_s = V_i - (2/5 K\Omega \parallel 24 K\Omega) \times g_m V_{gs}$$

$$\Rightarrow V_i = V_{gs} + 0.32 \times 4 V_{gs} = V_{gs} (1 + 0.92) = 1.92 V_{gs} \quad (II)$$

رابطه (II) را در رابطه (I) قرار می‌دهیم:

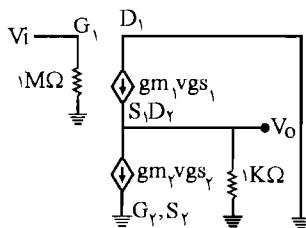
$$(I) \Rightarrow V_O = -10 \times \frac{V_i}{1.92} \Rightarrow A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{-10}{1.92} = -5/2$$

(ب) در مدار شکل ب چون گیت و سورس Q_2 به هم وصل می‌باشد پس $V_{GS_2} = 0$ می‌باشد بنابراین:

$$I_{D_1} = I_{D_2} = I_{DSS}$$

$$g_{m_1} = g_{m_2} = \frac{-2 I_{DSS}}{V_P} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{-2 \times \lambda}{-2} (1 - 0) = \lambda \frac{mA}{V}$$

پس مدار معادل مطابق شکل زیر می‌باشد:



$$V_{gs_2} = 0 \Rightarrow g_{m_2} V_{gs_2} = 0 \Rightarrow V_O = g_{m_1} V_{gs_1} \times 1 = \lambda V_{gs_1}$$

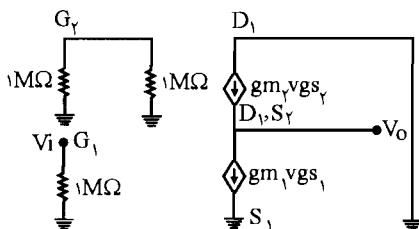
$$V_{gs_1} = V_{g_1} - V_{s_1} = V_i - V_O = V_i - \lambda V_{gs_1} \Rightarrow V_i = 4 V_{gs_1}$$

$$\Rightarrow V_{AV} = \frac{V_O}{V_i} = \frac{\lambda V_{gs_1}}{4 V_{gs_1}} = 0.89$$

ج) در مدار شکل ج داریم؛ (در JFET پایینی Q_1)

$$V_{GS_1} = V_{G_1} - V_{S_1} = 0 - 0 = 0 \Rightarrow I_{D_1} = I_{DSS}$$

$$\text{از طرفی: } I_{D_1} = I_{D_2} = I_{DSS} = \lambda mA \Rightarrow g_{m_1} = g_{m_2} = \frac{-2 I_{DSS}}{V_P} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \lambda \frac{mA}{V}$$



مدار معادل به صورت زیر می‌باشد:

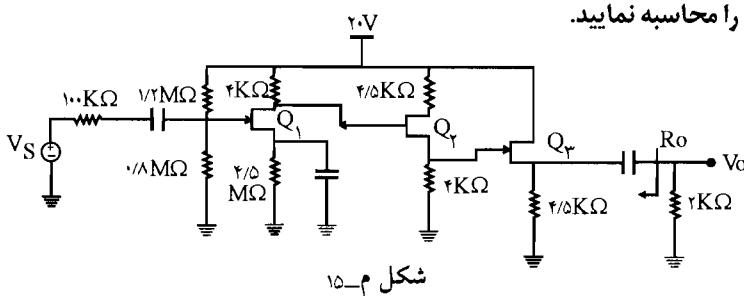
$$g_m, V_{gs_1} = \lambda(V_{g_1} - V_{s_1}) = \lambda(V_i - 0) = \lambda V_i \Leftrightarrow \begin{cases} V_{g_1} = V_i \\ V_{s_1} = 0 \end{cases}$$

$$g_m, V_{gs_2} = \lambda(V_{g_2} - V_{s_2}) = \lambda(0 - V_O) = -\lambda V_O \Leftrightarrow \begin{cases} V_{g_2} = 0 \\ V_{s_2} = V_O \end{cases}$$

از طرفی دو منبع جریان g_m, V_{gs_1} و g_m, V_{gs_2} برابر می‌باشند پس:

$$g_m, V_{gs_1} = g_m, V_{gs_2} \Rightarrow \lambda V_i = -\lambda V_O \Rightarrow A_V = \frac{V_O}{V_i} = -1$$

۱۵- برای همه JFET‌های مدار شکل م-۱۵-۱۵ است. برای این مدار R_O, R_i, A_{V_s} را محاسبه نمایید.

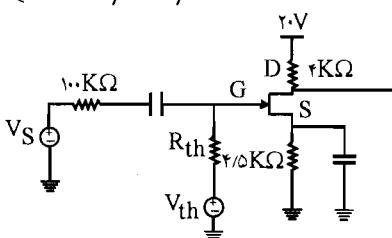


: (اه حل)

مدار معادل تونن در ورودی Q_1 اول را می‌نویسیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{th} = 1/2M\Omega \parallel 1/\lambda m\Omega = \frac{1/2 \times \lambda / \lambda}{1/2 + \lambda / \lambda} = 1/4 \lambda M\Omega \\ V_{th} = \frac{\lambda \cdot \times \lambda / \lambda}{1/2 + \lambda / \lambda} = \lambda V \end{array} \right.$$

پس مدار معادل تا قبل از Q_2 به شکل زیر در می‌آید:



می‌باشد و چون در کanal JFET $V_P < 0$ ، N می‌باشد پس $V_P = -2V$ در نظر

$V_{GS_1} = V_{G_1} - V_{S_1}$ گرفته می‌شود).

$$KVL: V_{GS_1} = \Delta - \frac{4}{5} I_{D_1}$$

$$I_{D_1} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS_1}}{V_P} \right)^2 = 4 \left(1 - \frac{\Delta - \frac{4}{5} I_{D_1}}{-2} \right)^2 \Rightarrow$$

$$I_{D_1} = \left(2 + \Delta - \frac{4}{5} I_{D_1} \right)^2 = \left(10 - \frac{4}{5} I_{D_1} \right)^2$$

با حل این معادله درجه (۲) مقادیر زیر برای I_{D_1} به دست می‌آید:

$$\begin{cases} I_{D_1} = 2/5 \Delta mA \Rightarrow V_{GS_1} = \Delta - \frac{4}{5} \times 2/5 \Delta = -3/61 V < V_P \Rightarrow \\ I_{D_1} = 1/915 mA \Rightarrow V_{GS_1} = \Delta - \frac{4}{5} \times 1/915 = -0/62 V > V_P \Rightarrow \end{cases}$$

$$\Rightarrow g_m = \frac{-2 I_{DSS}}{V_P} \left(1 - \frac{V_{GS_1}}{V_P} \right) = \frac{-2 \times 4}{-2} \left(1 - \frac{(-0/62)}{-2} \right) = 2/76 \frac{mA}{V}$$

حال در Q_2 داریم:

$$V_{GS_2} = V_{G_2} - V_{S_2}$$

$$\begin{cases} V_{S_2} = 20 - \frac{4}{5} I_{D_2} \\ V_{G_2} = 20 - 4 I_{D_1} = 20 - 4 \cdot 1/915 = 12/34 V \end{cases}$$

$$V_{GS_2} = 12/34 - (20 - \frac{4}{5} I_{D_2}) = \frac{4}{5} I_{D_2} - 7/66$$

$$I_{D_2} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS_2}}{V_P} \right)^2 = 4 \left(1 - \frac{\frac{4}{5} I_{D_2} - 7/66}{+2} \right)^2$$

چون Q_2 از نوع کانال P می‌باشد پس $V_P = 2V$ عدد مثبت می‌باشد.

$$\Rightarrow I_{D_2} = \left(2 + \frac{7}{66} - \frac{4}{5} I_{D_2} \right)^2 \Rightarrow 20/25 I_{D_2}^2 - 8V/94 I_{D_2} + 93/32 = 0$$

با حل این معادله درجه (۲)، مقادیر زیر برای I_{D_2} به دست می‌آید:

$$\begin{cases} I_{D_2} = 2/49V mA \\ I_{D_2} = 1/845 mA \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{GS_2} = \frac{4}{5} \times 2/49V - 7/66 = 3/58 > V_P \Rightarrow \\ V_{GS_2} = \frac{4}{5} \times 1/845 - 7/66 = -0/643 < V_P \Rightarrow \end{cases}$$

$$g_{m_r} = \frac{V_{DSS}}{V_p} \left(1 - \frac{V_{GS_r}}{V_p}\right) = \frac{2}{2} \times \frac{4}{2} \left(1 - \frac{-0.643}{2}\right) = 2/714 \frac{mA}{V}$$

در Q_2 داریم:

$$V_{GS_r} = V_{G_r} - V_{S_r}$$

$$\begin{cases} V_{G_r} = 4I_{D_r} = 4 \times 1/840 = 7/38 V \\ V_{S_r} = 4/5 I_{D_r} \end{cases} \Rightarrow V_{GS_r} = 7/38 - 4/5 I_{D_r}$$

از نوع کاتال N می‌باشد پس $V_p = -2V$ می‌باشد.

$$I_{D_r} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS_r}}{V_p}\right)^2 = 4 \left(1 - \frac{7/38 - 4/5 I_{D_r}}{-2}\right)^2$$

$$\Rightarrow 20/25 I_{D_r}^2 - 80/42 I_{D_r} + 87/98 = 0$$

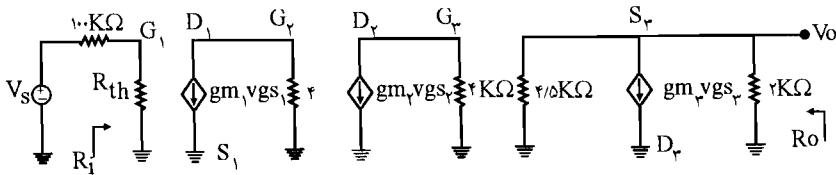
با حل این معادله درجه (۲) مقادیر زیر برای I_{D_r} به دست می‌آید:

قابل قبول نمی‌باشد

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{D_r} = 2/43 \Rightarrow V_{GS_r} = 7/38 - 4/5 I_{D_r} = 7/38 - 4/5 \times 2/43 = -3/555 < V_p \Rightarrow \uparrow \\ I_{D_r} = 1/787 \Rightarrow V_{GS_r} = 7/38 - 4/5 \times 1/787 = -0/66 > V_p \Rightarrow \text{قابل قبول نمی‌باشد} \end{cases}$$

$$\Rightarrow g_{m_r} = \frac{-2I_{DSS}}{V_p} \left(1 - \frac{V_{GS_r}}{V_p}\right)^2 = \frac{-2 \times 4}{-2} \left(1 - \frac{-0/66}{-2}\right) = 2/68 \frac{mA}{V}$$

حال مدار معادل شکل م-۱۵ را رسم می‌کنیم:



$$V_O = V_{S_r} \quad (I)$$

طبق مدار معادل داریم:

$$V_{S_r} = g_{m_r} V_{g_r} \times (2K\Omega \parallel 4/5K\Omega) = 2/68 \times (V_{g_r} - V_{S_r}) \times \left(\frac{2 \times 4/5}{2 + 4/5}\right)$$

$$\Rightarrow V_{S_r} = 3/71 (V_{g_r} - V_{S_r}) \Rightarrow 4/71 V_{S_r} = 3/71 V_{g_r} \Rightarrow V_{S_r} = \frac{3/71}{4/71} V_{g_r} \quad (II)$$

$$\text{از طرفی: } V_{g_T} = -g_m V_{gs_T} \times 4K\Omega = -2/V_1 \times 4 \times (V_{g_1} - V_{s_T}) = -10/84 \times V_{g_1} \quad (\text{III})$$

$$\text{از طرفی: } V_{g_T} = -g_m V_{gs_1} \times 4K\Omega = -2/V_2 \times 4 \times (V_{g_1} - V_{s_1}) = -11/04 \times V_{g_1} \quad (\text{IV})$$

$$\text{از طرفی: } V_{gs_1} = V_{g_1} - V_{s_1} = V_{g_1} - 0 = V_{g_1}$$

$$V_{g_1} = V_s \times \frac{R_{th}}{R_{th} + 100} = V_s \times \frac{0.48 \times 10^3}{0.48 \times 10^3 + 100} = 0.83 V_s \quad (\text{V})$$

با جایگذاری روابط (V) و (IV) و (III) و (II) در رابطه (I) داریم:

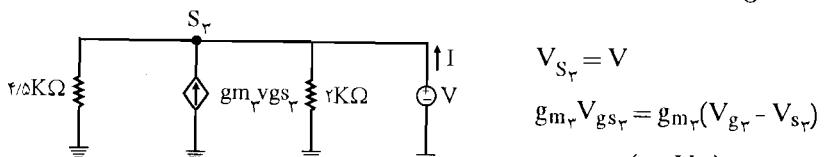
$$\begin{aligned} V_O = V_{s_T} &= \frac{2/V_1}{4/V_1} V_{g_T} = \frac{2/V_1}{4/V_1} \times (-10/84) V_{g_1} = \frac{2/V_1}{4/V_1} \times (-10/84) \times (-11/04) V_{g_1} \\ &= \frac{2/V_1}{4/V_1} \times (-10/84) \times (-11/04) \times 0.83 V_s \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_O}{V_s} = \frac{2/V_1}{4/V_1} \times 10/84 \times 11/04 \times 0.83 = 78/24$$

$$R_i = 0.48 M\Omega = 480 K\Omega$$

با توجه به مدار معادل داریم:

برای به دست آوردن R_O یک منبع ولتاژ V را در خروجی قرار می‌دهیم.



$$V_{s_T} = V$$

$$g_{m_T} V_{gs_T} = g_{m_T} (V_{g_T} - V_{s_T})$$

$$= g_{m_T} \times (0 - V_{s_T}) = -g_{m_T} V$$

$$I = -g_{m_T} V_{gs_T} + \frac{V}{4/5} + \frac{V}{2} = -(-g_{m_T} V) + V \left(\frac{1}{4/5} + \frac{1}{2} \right)$$

$$= V \left(g_{m_T} + \frac{1}{4/5} + \frac{1}{2} \right) = (2/68 + \frac{1}{4/5} + \frac{1}{2})$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1}{(2/68 + \frac{1}{4/5} + \frac{1}{2})} = 0.294 K\Omega \Rightarrow R_O = 294 \Omega$$

۱۶- یک سورس فالوئر مکمل از به هم پیوستن

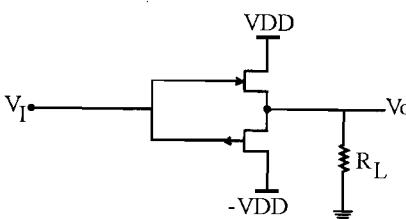
کانال N و یک JFET کانال P مطابق شکل

م- ۱۶ حاصل می‌شود (JFET‌ها مشابه هستند).

به ازای $V_I = 0$ چه جریان ثابتی از JFET‌ها

عبور می‌کند؟ مقاومت خروجی سورس فالوئر

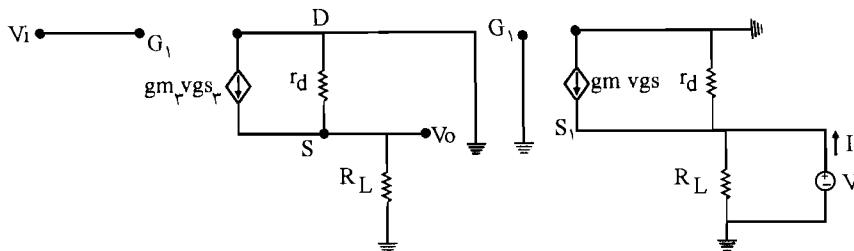
چقدر است؟



شکل ۱۶

راه حل:

- به ازای $V_i = 0$ ، به دلیل متقارن بودن مدار و مشابه بودن JFET‌ها، V_O برای هر دو ترانزیستور صفر می‌باشد.
- $V_O = 0 \Rightarrow V_{GS_1} = V_{GS_2} = 0 \Rightarrow I_{D_1} = I_{D_2}$
- مدار معادل:



برای محاسبه مقاومت خروجی یک منبع ولتاژ در خروجی در دو سر R_L قرار می‌دهیم و V_i را صفر می‌کنیم.

$$V_{gs_1} = V_{g_1} - V_{s_1} = 0 - V = -V$$

$$\text{فرض } g_{m_1} = g_{m_2} = g_m \Rightarrow I = \frac{V}{R_L} + \frac{V}{r_d} - g_m V_{gs} = \frac{V}{R_L} + \frac{V}{r_d} - g_m (-V)$$

$$= \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{r_d} + g_m \right) \times V \Rightarrow R_O = \frac{V}{I} = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{r_d} + g_m \right)}$$

- ۱۷- یک ترانزیستور NMOS نوع تهی با $I_{DSS} = 1\text{ mA}$ و $V_P = -1\text{ V}$ و $V_{GS} = 1\text{ V}$ و $V_D = -1\text{ V}$ چقدر مقدار V_{DS} برای اینکه این ترانزیستور در ناحیه اشباع کار کند چقدر است؟ مقدار I_D چقدر می‌شود؟

راه حل:

$$\text{در ناحیه اشباع: } V_{GD} \leq -|V_P| \Rightarrow V_{GD} \leq -1 \Rightarrow V_{GS} - V_{DS} \leq -1$$

$$\Rightarrow -V_{DS} \leq -1 \Rightarrow V_{DS} \geq 2\text{ V}$$

حداقل مقدار V_{DS} برابر 2 V به دست آمد.

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 1 \times \left(1 - \frac{1}{-1} \right)^2 = 4\text{ mA}$$

- ۱۸- یک ترانزیستور PMOS نوع تهی با $I_{DSS} = 8\text{ mA}$ و $V_P = 2\text{ V}$ و $V_{GS} = -1\text{ V}$ در کار می‌کند.

حداقل مقدار V_{DS} برای اینکه ترانزیستور در ناحیه اشباع کار کند چقدر است؟ مقدار I_D چقدر می شود؟

$$\text{PMOS : } \begin{aligned} V_{DG} &< - |V_P| \\ V_{GD} &\geq V_P \Rightarrow V_{GD} \geq 2 \Rightarrow V_{GS} - V_{DS} \geq 2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow -1 - V_{DS} \geq 2 \Rightarrow V_{DS} \leq -3V$$

حداقل مقدار $-3V$ می باشد (حداقل قدر مطلق V_{DS})

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 18 \left(1 - \frac{-1}{2}\right)^2 = 18 \text{ mA}$$

۱۹- یک ترانزیستور NMOS نوع تهی با $V_{GS} = 10V$, $V_P = -0.5V$, $I_{DSS} = 0.5mA$ در کار می کند. جریان درین در ناحیه اشباع چقدر خواهد بود؟ چه ولتاژ درین - سورس مورد نیاز است؟

۱۹ حل:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 0.5 \left(1 - \frac{10}{-0.5}\right)^2 = 22.05 \text{ mA}$$

به دست آوردن ولتاژ V_{DS}

$$\text{NOMS } V_{GD} \leq - |V_P| \Rightarrow V_{GD} \leq -0.5 \Rightarrow V_{GS} - V_{DS} \leq -0.5$$

$$\Rightarrow 10 - V_{DS} \leq -0.5 \Rightarrow V_{DS} \geq 10.5V$$

۲۰- یک ترانزیستور NMOS نوع ارتقایی با $V_T = 2V$, $V_{GS} = 4V$ در ناحیه اشباع کار کند. به ازای چه حداقلی این حالت امکان دارد؟

$$\text{نوع ارتقایی در ناحیه اشباع NMOS : } V_{GD} \leq V_T \Rightarrow V_{GD} \leq 2V \Rightarrow V_{GS} - V_{DS} \leq 2V$$

$$\Rightarrow 4 - V_{DS} \leq 2V \Rightarrow V_{DS} \geq 2V$$

حداقل مقدار V_{DS} برابر $2V$ می باشد.

۲۱- یک ترانزیستور PMOS نوع ارتقایی با $V_T = -1V$ به عنوان یک دیود مورد استفاده قرار می گیرد (گیت درین آن به هم وصل شده است). به ازای ولتاژ $2V$ این دیود جریان $10mA$ را از خود عبور می دهد. افت ولتاژ دیود در جریان های $1mA$ و $1mA/0$ چقدر است؟

۱۹ حل:

طبق فرض مسئله گیت و درین به هم متصل می باشند پس $V_{GD} = 0$ و در نتیجه

می‌باشد و چون $V_{GD} > V_T = -1V$ است و PMOS ترانزیستور در ناحیه اشباع کار می‌کند و در ناحیه اشباع رابطه I_D به صورت زیر می‌باشد:

$$I_D = \frac{K}{\gamma} (V_{GS} - V_T)^\gamma$$

$$\begin{cases} V_{GS} = V_{DS} = V_D - V_S = V_D = -2V \\ I_D = 10mA \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_D = \frac{K}{\gamma} (V_{GS} - V_T) \Rightarrow 10mA = \frac{K}{\gamma} (-2 + 1)^\gamma \Rightarrow K = 2 \cdot \frac{mA}{V^\gamma}$$

افت ولتاژ دیود:

$$V_{GS} = V_{DS}$$

$$I_D = 1mA$$

$$I_D = \frac{K}{\gamma} (V_{GS} - V_T)^\gamma \Rightarrow 1 = \frac{2}{\gamma} (V_{DS} - (-1))^\gamma$$

$$\Rightarrow (V_{DS} + 1)^\gamma = 1/1 \Rightarrow V_{DS} + 1 = \pm 1/32$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{DS} = -1/32V \\ V_{DS} = -0/68V \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = -1/32V \\ V_{GS} = -0/68V \end{cases}$$

به ازای $V_{GS} = -0/68V$ می‌باشد که قابل قبول نمی‌باشد چون در حالت اشباع باید $V_{GS} < V_T = -1/32V$ قابل قبول می‌شود. پس ولتاژ دو سر دیود $V_{GS} = 1/32V$ می‌باشد.

$$I_D = 0/1mA \Rightarrow 0/1 = \frac{2}{\gamma} (V_{DS} + 1)^\gamma \Rightarrow (V_{DS} + 1)^\gamma = 0/0.1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{DS} = -1/1V \\ V_{DS} = -0/9V \end{cases}$$

مانند دلایل حالت قبل $V_{DS} = -0/9V$ قابل قبول نمی‌باشد و $V_{DS} = -1/1V$ قابل قبول می‌باشد. پس ولتاژ دو سر دیود $1/1V$ می‌باشد.

۲۲- دیود مسأله ۷- ۲۱ به صورت سری با یک مقاومت $5K\Omega$ به یک منبع ولتاژ $10V$ متصل شده

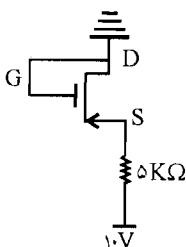
است. ولتاژ دو سر دیود چند ولت است؟

(ا) ۵ ولت

در صورت مسئله ۲۱ داشتیم گیت و درین PMOS به هم وصل شده است و به ازای ولتاژ ۲ ولت دیود شدت جریان 10 mA را از خود عبور می‌دهد و چون گیت و درین به هم متصل می‌باشند $V_{GS} = V_{DS}$

می‌شود پس؛ $V_{GS} = V_{DS}$

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow 10\text{ mA} = \frac{K}{2} (-2 + 1)^2 \Rightarrow K = 2 \cdot \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$



با توجه به صورت این مسئله شکل مدار به صورت زیر می‌باشد:

$$V_{DS} = ? \quad \text{به دست آوردن ولتاژ دو سر دیود: ?}$$

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{2}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = 10 (V_{DS} + 1)^2 \quad (\text{I})$$

$$\text{KVL: } V_{DS} = -10 + 5I_D \Rightarrow I_D = \frac{V_{DS} + 10}{5} \quad (\text{II})$$

در رابطه (I) به جای I_D مقدار (II) به دست آمده از رابطه (II) را قرار می‌دهیم:

$$\frac{V_{DS} + 10}{5} = 10 (V_{DS} + 1)^2 \Rightarrow V_{DS} + 10 = 50 (V_{DS} + 1)^2$$

$$\Rightarrow 50 V_{DS}^2 + 99 V_{DS} + 40 = 0 \Rightarrow$$

با حل این معادله مقادیر زیر برای V_{DS} به دست می‌آید:

$$\begin{cases} V_{DS} = -0.56 \\ V_{DS} = -1.41 \end{cases}$$

$V_{DS} = -0.56$ قابل قبول نمی‌باشد چون در این صورت $V_{GS} > V_T$ می‌شود در حالی که در PMOS

در حالت اشباع باید $V_{DS} = -1.41$ قابل قبول می‌باشد چون در این صورت

$$V_{DS} = 1.41\text{ V} \quad \text{می‌باشد پس مقدار ولتاژ دو سر دیود برابر است با:}$$

۲۳- دیود طراحی شده در مسئله ۷-۲۱ قرار است به صورت یک تنظیم کننده ولتاژ موازی که توسط

یک جریان 10 mA تقدیمه می‌شود به کار رود. ولتاژ خروجی تنظیم کننده چقدر است؟ مقاومت خروجی

تنظیم کننده چقدر است در صورتی که یک جریان بار 1 mA از تنظیم کننده کشیده شود (توسط یک

موازی) افت ولتاژ دو سر آن چقدر خواهد بود؟

راه حل:

در مسئله ۲۱ به دست آوردهایم:

$$V_{GS} = V_{DS} \quad , \quad I_D = \frac{k}{\gamma} (V_{GS} - V_T)^{\gamma} = \frac{20}{\gamma} (V_{DS} - V_T)^{\gamma}$$

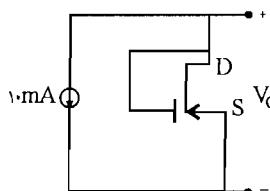
$$I_D = 10(1 - V_O)^{\gamma} \quad \leftarrow \quad V_{DS} = -V_D = -V_O \quad , \quad V_T = -1 \quad \text{از طرفی}$$

$$I_D = 10 \text{ mA} \Rightarrow I_D = 10(1 - V_O)^{\gamma} \Rightarrow 10 = 10(1 - V_O)^{\gamma}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_O = 0 \text{ V} \\ V_O = 2 \text{ V} \end{cases}$$

قابل قبول نمی‌باشد چون در این صورت: $V_O = 0 \text{ V}$

$$V_O = -V_{DS} = -V_{GS} = 0 \text{ V} > V_T$$



در حالی که در PMOS در حالت اشباع باید $V_{GS} < V_T$ شود.

ولی $V_O = 2 \text{ V}$ قابل قبول نمی‌باشد چون:

$$V_O = -V_{DS} = -V_{GS} = +2 \text{ V} \Rightarrow V_{GS} = -2 \text{ V} < V_T$$

برای به دست آوردن مقاومت خروجی:

برای محاسبه مقاومت خروجی یک منبع ولتاژ V در خروجی گذاشته و I آن محاسبه می‌شود:

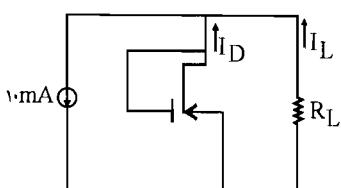
$$I = 10(1 - V)^{\gamma}$$

$$R_O = \frac{dV}{dI} \quad \text{چون رابطه بین } I \text{ و } V \text{ خطی نمی‌باشد پس داریم:}$$

$$\Rightarrow R_O = \frac{dV}{10 \times 2 \times (1 - V) \times (-dV)} = \frac{1}{-20(1 - V)}$$

$$(V = 2 \text{ V} \Rightarrow R_O = \frac{1}{-20(1 - 2)} = \frac{1}{20} \text{ K}\Omega = 50 \Omega) \quad \text{در حالت قبل به دست آمده}$$

حال اگر یک جریان بار 1 mA از تنظیم کننده توسط یک مقاومت R_L موازی کشیده شود:



$$I = I_D + I_L \Rightarrow 10 \text{ mA} = I_D + 1 \Rightarrow I_D = 9 \text{ mA}$$

$$I_D = 10(1 - V_O)^\gamma \Rightarrow 9 = 10(1 - V_O)^\gamma \Rightarrow \begin{cases} V_O = 0.05 \text{ V} \\ V_O = 1.95 \text{ V} \end{cases}$$

$V_O = 0.05 \text{ V}$ قابل قبول نمی‌باشد چون در این صورت:

$$V_{GS} = -V_O = -0.05 \Rightarrow V_{GS} > V_T$$

در حالی که در حالت اشباع باید $V_{GS} < V_T$ شود $V_O = 1.95 \text{ V}$ قابل قبول می‌باشد چون:

$$V_{GS} = -V_O = -1.95 \text{ V} < V_T = -1 \text{ V}$$

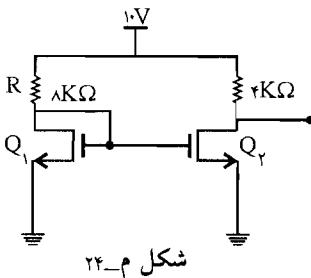
$$\text{پس } V_O = 1.95 \text{ V}$$

$$(افت ولتاژ دوسر دیود) \Delta V_O = 2 - 1.95 = 0.05 \text{ V} \Rightarrow \Delta V_O = 50 \text{ mV}$$

دو NMOS مشابه، با $K = \frac{1 \text{ mA}}{V^2}$ به صورت شکل ۲۴-۲ به هم وصل شده‌اند. ولتاژ $V_T = 1 \text{ V}$

خروجی V_O چند ولت است؟ اگر مقاومت R به $4 \text{ k}\Omega$ کاهش یابد ولتاژ V_O چقدر خواهد شد؟

راه حل:



$$V_O = 10 - 4 I_{D_2} \quad (\text{I})$$

$$Q_1: V_{GS_1} = V_{G_1} - V_{S_1} = 10 - 4 I_{D_1} - 0 = 10 - 4 I_{D_1}$$

$$I_{D_1} = \frac{K}{\gamma} (V_{GS_1} - V_T)^\gamma = \frac{1}{\gamma} (10 - 4 I_{D_1} - 1)^\gamma \Rightarrow$$

$$4 I_{D_1} = (9 - 4 I_{D_1})^\gamma \Rightarrow I_{D_1} = \begin{cases} 1/33 \text{ mA} \\ 0.95 \text{ mA} \end{cases}$$

$I_{D_1} = 0.95 \text{ mA}$ قابل قبول نمی‌باشد چون در این حالت $V_{GS_1} = 10 - 4 I_{D_1} = -0.64 \text{ V}$ می‌شود که

از $V_T = 1 \text{ V}$ کوچکتر می‌باشد در حالی که در حالت اشباع باید $V_{GS} > V_T$ باشد پس $I_{D_1} = 1/33 \text{ mA}$ قابل قبول

نمی باشد ولی با $V_{GS_1} > V_T$, $I_D = 0/95 \text{ mA}$ قابل قبول می باشد.

$$I_{D_1} = I_{D_T} = 0/95 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} V_O = 10 - 4 \times 0/95 = 6.2 \text{ V}$$

حال اگر $R = 4 \text{ k}\Omega$ باشد:

$$V_{GS_1} = V_{G_1} - V_{S_1} = 10 - 4I_{D_1}$$

$$I_{D_1} = \frac{K}{\gamma} (V_{GS_1} - V_T)^{\gamma} = \frac{1}{\gamma} (10 - 4I_{D_1} - 1)^{\gamma} \Rightarrow$$

$$4I_{D_1} = (9 - 4I_{D_1})^{\gamma} \Rightarrow I_{D_1} = \begin{cases} 2/85 \text{ mA} \\ 1/88 \text{ mA} \end{cases}$$

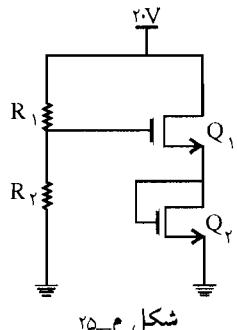
با $V_T = 2/85 \text{ V}$ داریم: $V_{GS_1} < V_T$ می بینیم که $V_{GS_1} = 10 - 4I_{D_1} = -1/4 \text{ V}$ می باشد که از

کوچکتر است پس $V_{GS_1} = 2/85 \text{ V}$ قابل قبول نمی باشد ولی با $V_T = 1/88 \text{ V}$ داریم $I_D = 1/88 \text{ mA}$ که از $V_{GS_1} = 2/88 \text{ V}$ بزرگتر است پس قابل قبول می باشد.

$$I_{D_1} = I_{D_T} = 1/88 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow V_O = 10 - 4I_{D_T} = 10 - 4 \times 1/88 = 2/88 \text{ V}$$

دو - ۲۵ - MOS مشابه به صورت شکل م - ۲۵ به هم متصل شده‌اند. در صورتی که $V_T = 2 \text{ V}$ و $K = 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$ باشد مقاومت‌های R_1 و R_2 را طوری به دست آورید که جریان $I_D = 1 \text{ mA}$ از ترانزیستورها عبور کرده و در گیت Q_1 حداقل مقاومت ممکن را داشته باشیم. بزرگترین مقاومت در دسترس $10 \text{ M}\Omega$ است. در صورتی که در اثر تغییر فرآیند ساخت مقدار $V_T = 1/5 \text{ V}$ کاهش یابد، جریان I_D چه مقدار خواهد شد؟ (در صورتی که به جای Q_2 از یک مقاومت ($R_S = 1 \text{ k}\Omega$) استفاده می‌کردیم جریان I_D هنگامی که V_T ترانزیستور Q_2 از $2/5$ ولت تغییر می‌کرد چه مقدار می باشد؟



شکل م - ۲۵

در MOS (Q₂) چون گیت و درین به هم متصل می باشند $V_{DS} = V_{GD} = 0 \text{ V}$ می باشد پس $V_{GS} = V_{DS} = 0 \text{ V}$ می باشد پس ترانزیستور در ناحیه اشباع می باشد پس داریم: $V_{GD} = 2 \text{ V} < V_T = 0 \text{ V}$

$$I_{D_T} = \frac{K}{\gamma} (V_{GS_T} - V_{T_T})^{\gamma} \Rightarrow 1 = \frac{0.5}{\gamma} (V_{GS_T} - 2)^{\gamma} \Rightarrow \begin{cases} V_{GS_T} = 4 \text{ V} \\ V_{GS_T} = 0 \text{ V} \end{cases}$$

قابل قبول نمی باشد

راه حل:

اگر $V_{GS} = 0$ V باشد در این صورت $V_{GS} < V_T$ می‌باشد پس قابل قبول نمی‌باشد چون در NMOS $V_{GS} > V_T$ شود پس $V_{GS} = 4$ V قابل قبول می‌باشد.

$$V_{GS_1} = 4 \text{ V} \Rightarrow V_{G_1} - V_{S_1} = 4 \text{ V} \Rightarrow V_{G_1} - 0 = 4 \Rightarrow V_{G_1} = 4 \text{ V}$$

از طرفی داریم: Q_1 MOS پس برای $V_{G_1} = V_{D_1} = V_{S_1}$ داریم

$$V_{DS_1} = 20 - V_{S_1} = 20 - 4 = 16 \text{ V}$$

$$I_{D_1} = \frac{k_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^\gamma \Rightarrow I = \frac{1/5}{2} (V_{GS_1} - 2)^\gamma \Rightarrow \begin{cases} V_{GS_1} = 4 \text{ V} \\ V_{GS_1} = 0 \text{ V} \end{cases} \quad \text{قابل قبول نمی‌باشد}$$

مثل حالت قبل $V_{GS_1} = 0$ V قابل قبول نمی‌باشد و $V_{GS_1} = 4$ V قابل قبول می‌باشد.

$$V_{GS_1} = 4 \text{ V} \Rightarrow V_{G_1} - V_{S_1} = 4 \text{ V} \Rightarrow V_{G_1} - 4 = 4 \Rightarrow V_{G_1} = 8 \text{ V}$$

$$V_A = 8 \text{ V}$$

با استفاده از قانون تونن در این مدار داریم:

$$\begin{aligned} R_1 &\parallel V \\ R_2 &\parallel A \\ \therefore R_{th} &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1/5 R_2 \times R_2}{1/5 R_2 + R_2} = \frac{3}{5} R_2 \end{aligned}$$

چون طبق فرض مسئله می‌خواهیم در گیت Q_1 حداکثر مقاومت ممکن را داشته باشیم پس باید R_1 و یا

R_2 ماکریزیم باشند و چون گفته حداکثر مقاومت ممکن $10 \text{ M}\Omega$ باشد پس داریم:

$$R_1 = 20 \text{ M}\Omega \Rightarrow R_1 = 1/5 R_2 \Rightarrow R_2 = 6/6 \text{ M}\Omega$$

$$\begin{cases} I_{D_1} = \frac{k}{\gamma} (V_{GS_1} - V_T)^\gamma \\ I_{D_1} = \frac{k}{\gamma} (V_{GS_1} - V_T)^\gamma \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{اگر } V_T = 1/5 \text{ V} \text{ باشد:} \\ \text{از طرفی: } I_{D_1} = I_{D_1} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{K}{\gamma} (V_{GS_1} - V_T)^\gamma &= \frac{K}{\gamma} (V_{G_1} - V_T)^\gamma \Rightarrow V_{GS_1} = V_{GS_1} \Rightarrow \\ V_{G_1} - V_{S_1} &= V_{G_1} - V_{S_1} \Rightarrow V_{S_1} - 0 = V_{th} - V_{S_1} \Rightarrow V_{S_1} = \frac{V_{th}}{\gamma} = \frac{\Delta}{\gamma} = 4 \text{ V} \end{aligned}$$

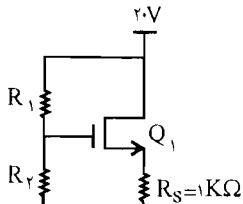


$$\Rightarrow V_{G_1} = V_{S_1} = 4V \Rightarrow V_{GS_1} = 4 - 0 = 4V$$

$$\Rightarrow I_D = \frac{1}{2} (4 - 1/5)^2 = 1/56 \text{ mA}$$

$$\Delta I_D = 1/56 - 1 \text{ mA} = -1/56 \text{ mA}$$

حال اگر به جای Q_1 MOS مقاومت $1K\Omega$ قرار دهیم طبق شکل مقابل داریم:



$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS_1} - V_T)^2 = \frac{1}{2} (V_{GS_1} - 1/5)^2$$

$$= \frac{1}{4} (V_{G_1} - V_{S_1} - 1/5)^2$$

از طرفی $\begin{cases} V_{S_1} = R_S \times I_D \\ V_{G_1} = V_{th} = 4V \end{cases}$

$$\Rightarrow I_D = \frac{1}{4} (4 - 1 \times I_D - 1/5)^2 \Rightarrow$$

با حل این معادله مقادیر زیر برای I_D به دست می‌آید:

$$I_D = \begin{cases} 3/0.2 \text{ mA} \\ 13/97 \text{ mA} \end{cases}$$

$$I_D = 13/97 \Rightarrow V_{GS} = 4 - 1 \times 13/97 < 0$$

$I_D = 13/97$ قابل قبول نمی‌باشد.

چون در این حالت V_{GS} یک عدد منفی به دست می‌آید که از V_T کوچکتر می‌باشد پس این مقدار I_D قابل قبول نمی‌باشد.

$$I_D = 3/0.2 \Rightarrow V_{GS} = 4 - 1 \times 3/0.2$$

با $I_D = 3/0.2$ مقداری که برای V_{GS} به دست می‌آید عددی است که از V_T بزرگ‌تر است پس این مقدار I_D قابل قبول می‌باشد.

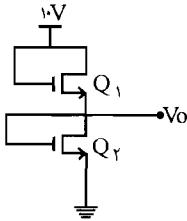
حال اگر $V_T = 2V$ شود داریم:

$$I_D = \frac{1}{4} (4 - I_D - 2) \Rightarrow I_D = \begin{cases} 2/71 \\ 13/29 \end{cases}$$

مانند دلایل حالت قبل $I_D = 13/29$ قابل قبول نمی‌باشد و $I_D = 2/71$ قابل قبول است پس

$$I_D = 2/71 \Rightarrow \Delta I_D = 3/0.2 - 2/71 = 0.31 \text{ mA}$$

۲۶- در مدار شکل م-۲۶، در حالت‌های زیر V_O را محاسبه نمایید.



شکل م-۲۶

$$(الف) \quad V_{T_1} = V_{T_2} \text{ و } K_1 = K_2$$

$$(ب) \quad V_{T_1} = V_{T_2} \text{ و } K_1 = \frac{K_2}{4}$$

$$(ج) \quad V_{T_1} = 4V_{T_2} \text{ و } K_1 = K_2$$

(ا) حل:

$$I_{D_1} = I_{D_2} \Rightarrow \frac{K_1}{2} (V_{GS_1} - V_{T_1})^2 = \frac{K_2}{2} (V_{GS_2} - V_{T_2})^2 \quad (الف)$$

$$\begin{cases} K_1 = K_2 \\ V_{T_1} = V_{T_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{K_1}{2} (V_{GS_1} - V_{T_1})^2 = \frac{K_1}{2} (V_{GS_2} - V_{T_2})^2$$

$$\Rightarrow (V_{GS_1} - V_{T_1})^2 = (V_{GS_2} - V_{T_2})^2 \Rightarrow V_{GS_1} = V_{GS_2}$$

$$I_{D_1} = I_{D_2} \Rightarrow \frac{K_1}{2} (V_{GS_1} - V_{T_1})^2 = \frac{K_2}{2} (V_{GS_2} - V_{T_2})^2$$

$$\begin{cases} V_{G_1} = 10V \\ V_{S_1} = V_O \end{cases} \text{ از طرفی } , \quad \begin{cases} V_{G_2} = V_O \\ V_{S_2} = 0V \end{cases} \Rightarrow (10 - V_O) = (V_O - 0) \Rightarrow V_O = 5V \quad (ب)$$

$$I_{D_1} = I_{D_2} \Rightarrow \frac{k_1}{2} (V_{GS_1} - V_{T_1})^2 = \frac{k_2}{2} (V_{GS_2} - V_{T_2})^2$$

$$\begin{cases} K_1 = \frac{K_2}{4} \\ V_{T_1} = V_{T_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{K_2}{2} (V_{GS_1} - V_{T_1})^2 = \frac{K_2}{2} (V_{GS_2} - V_{T_2})^2$$

$$\Rightarrow V_{GS_1} - V_{T_1} = 2(V_{GS_2} - V_{T_2}) \quad , \quad \begin{cases} V_{G_1} = 10 \\ V_{S_1} = V_O \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} V_{G_2} = V_O \\ V_{S_2} = 0V \end{cases}$$

$$\Rightarrow (10 - V_O - V_{T_1}) = 2(V_O - 0 - V_{T_2}) \Rightarrow 2V_O = 10 + V_{T_1} \Rightarrow V_O = \frac{10 + V_{T_1}}{3}$$

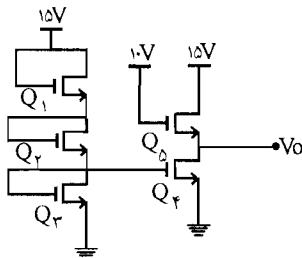
$$I_{D_1} = I_{D_2} \Rightarrow \frac{K_1}{2} (V_{GS_1} - V_{T_1})^2 = \frac{K_2}{2} (V_{GS_2} - V_{T_2})^2 \quad , \quad \begin{cases} K_1 = K_2 \\ V_{T_1} = 4V_{T_2} \end{cases} \quad (ج)$$

$$\Rightarrow (V_{GS_1} - V_{T_1})^+ = (V_{GS_1} - V_{T_1})^- \Rightarrow V_{GS_1} - V_{T_1} = V_{GS_1} - V_{T_1}$$

$$\begin{cases} V_{G_1} = 10 \\ V_{S_1} = V_O \end{cases}, \quad \begin{cases} V_{G_1} = V_O \\ V_{S_1} = 0 \end{cases} \Rightarrow (10 - V_O - V_{T_1})^+ = (V_O - 0 - V_{T_1})^- \Rightarrow V_O = 10 - V_{T_1}$$

$$\Rightarrow V_O = \frac{10 - V_{T_1}}{2}$$

۲۷- در مدار شکل م- ۲۷ همه MOS ها مشابه‌اند. ولتاژ V_O چقدر است؟



شکل م

راه حل:

سه ترانزیستور Q_1 و Q_2 و Q_3 مشابه هستند پس داریم:

$$V_{DS} = \frac{10}{3} = 5V$$

$$V_{DS_1} = V_{D_1} - V_{S_1} = V_{G_1} - 0 = V_{G_1} = 5V$$

$$Q_1: I_{D_1} = \frac{K}{2} (V_{GS_1} - V_{T_1})^+ \Rightarrow I_{D_1} = \frac{K}{2} (V_{G_1} - V_{S_1} - V_{T_1})^+$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{G_1} = V_{G_1} = 5V \\ V_{S_1} = 0V \end{cases} \quad \text{گیت } Q_1 \text{ و } Q_4 \text{ به هم متصل می‌باشد سورس } Q_4 \text{ زمین شده است.}$$

$$\Rightarrow I_{D_1} = \frac{K}{2} (5 - V_{T_1})^+$$

$$Q_4: V_{GD_4} = -5V < V_T \Rightarrow Q_5 \text{ در اشباع است.}$$

$$I_{D_4} = \frac{k}{2} (V_{GS_4} - V_{T_4})^+ = \frac{K}{2} (V_{G_4} - V_{S_4} - V_{T_4})^+$$

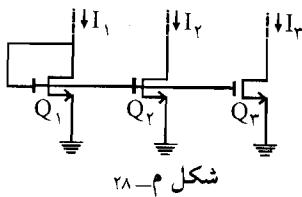
$$\Rightarrow \begin{cases} V_{G_4} = 10V \\ V_{S_4} = V_O \end{cases} \Rightarrow I_{D_4} = \frac{K}{2} (10 - V_O - V_{T_4})^+$$

$$I_{D_1} = I_{D_2} \Rightarrow \frac{K_1}{\gamma} (\phi - V_T)^{\gamma} = \frac{K_2}{\gamma} (10 - V_O - V_T)^{\gamma} \Rightarrow$$

$$(\phi - V_T)^{\gamma} = (10 - V_O - V_T)^{\gamma} \Rightarrow \phi - V_T = 10 - V_O - V_T \Rightarrow$$

$$V_O = \phi V$$

۲۸- در مدار شکل م-۲۸، با فرض مقادیر $I_1 = 1 \text{ mA}$ و $K_1 = K_2 = \frac{K_r}{\gamma}$ و $V_{T_1} = V_{T_2} = V_{T_r}$ و I_r را محاسبه نماید.



شکل م-۲۸

می باشد پس $V_{GD_1} < V_{T_1}$ در حالت اشباع است:

$$Q_1: I_1 = I_{D_1} = \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma} \Rightarrow 1 \text{ mA} = \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma}$$

$$\Rightarrow K_1 (V_{GS_1} - V_{T_1})^{\gamma} = 2 \quad (\text{I})$$

$$Q_2: I_{D_2} = I_2 = \frac{K_2}{\gamma} (V_{GS_2} - V_{T_2})^{\gamma}$$

گیت دو ترانزیستور Q_1 و Q_2 به هم وصل و سورس هر دوی آنها زمین می باشد پس

$$K_1 = K_2 \quad , \quad V_{T_1} = V_{T_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_2} - V_{T_2}) \quad (\text{II})$$

رابطه (I) را در رابطه (II) قرار می دهیم:

$$\Rightarrow I_2 = \frac{\gamma}{\gamma} = 1 \text{ mA}$$

$$Q_r: I_r = I_{D_r} = \frac{K_r}{\gamma} (V_{G_r} - V_{T_r})^{\gamma}$$

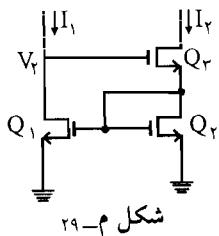
$$K_1 = K_2 = K_r = \frac{K_r}{\gamma} \quad , \quad V_{T_1} = V_{T_2} = V_{T_r}$$

و چون گیت سه ترازیستور به هم متصل می‌باشد و سورس هر سه آنها زمین شده است پس داریم:

$$V_{GS_1} = V_{GS_2} = V_{GS_3}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{K_1}{2} (V_{GS_1} - V_{T_1})^2 = \frac{2 \times 2}{2} = 2 \text{ mA}$$

- مدار شکل ۲۹ را در نظر بگیرید. با فرض $I_1 = 1 \text{ mA}$ و $V_{T_1} = V_{T_2} = V_{T_3}$ ، مقادیر I_2 و V_{S_1} را به دست آورید.



راه حل:

$$I_1 = \frac{K_1}{2} (V_{GS_1} - V_{T_1})^2 \Rightarrow 1 \text{ mA} = \frac{2}{2} (V_{GS_1} - 2)^2 \Rightarrow 1 = (V_{G_1} - V_{S_1} - 2)^2$$

$$V_{S_1} = 0 \text{ V} \Rightarrow 1 = (V_{G_1} - 2)^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{G_1} - 2 = 1 \Rightarrow V_{G_1} = 3 \text{ V} \\ V_{G_1} - 2 = -1 \Rightarrow V_{G_1} = 1 \text{ V} \end{cases}$$

قابل قبول نمی‌باشد چون $V_{GS} = 1 \text{ V} > V_T$. $V_{G_1} = 1 \text{ V}$ نمی‌باشد.

$$V_{G_1} = 3 \text{ V} \text{ قابل قبول} \Rightarrow V_1 = V_{G_1} = 3 \text{ V}$$

$$I_2 = I_{D_2} = I_{D_3} = \frac{K_2}{2} (V_{GS_2} - V_{T_2})^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{S_2} = 0 \\ V_{G_2} = V_{G_1} = 3 \text{ V} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{2}{2} (3 - 2)^2 = 1 \text{ mA}$$

$$I_{D_2} = I_{D_3} = 1 \text{ mA} \Rightarrow 1 \text{ mA} = \frac{K_2}{2} (V_{GS_2} - V_{T_2})^2 \Rightarrow$$

$$1 \text{ mA} = \frac{2}{2} (V_{G_2} - V_{S_2} - 2)^2$$

$$V_{S_2} = V_1 = 3 \text{ V} \Rightarrow 1 = (V_{G_2} - 3 - 2)^2 \Rightarrow$$

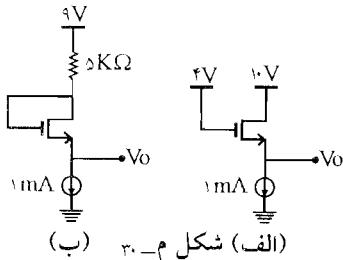
از طرفی

$$V_{G_T} - 5 = \pm 1 \Rightarrow \begin{cases} V_{G_T} = 6 \text{ V} \\ V_{G_T} = 4 \text{ V} \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{قابل قبول نمیباشد} \\ \text{قابل قبول نمیباشد} \end{array}$$

$V_{G_T} = 4 \text{ V}$ باشد در این صورت $V_{GS_T} = 4 - 3 = 1 \text{ V}$ کمتر میباشد پس $V_{G_T} = 6 \text{ V}$ قابل قبول نمیباشد پس داریم:

$$V_{G_T} = 6 \text{ V} \Rightarrow V_2 = V_{G_T} = 6 \text{ V}$$

۳۰- در مدارهای شکل م-۳۰، مقادیر $V_O = 0 / 5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$ و مقاومت دیده شده از سر سورس را به دست آورید.



۱۰ هل:

شکل (الف)

$$V_{GD} = -10 + 4 = -6 \text{ V} < V_T$$

پس در ناحیه اشباع میباشد.

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow 1 \text{ mA} = \frac{0.5}{2} (V_{GS} - 2)^2 \Rightarrow$$

$$(V_{GS} - 2)^2 = 4 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} - 2 = 2 \Rightarrow V_{GS} = 4 \text{ V} \\ V_{GS} - 2 = -2 \Rightarrow V_{GS} = 0 \text{ V} \end{cases}$$

از طرفی برای اینکه ترانزیستور در اشباع باشد باید $V_{GS} > V_T$ باشد پس $V_{GS} = 0 \text{ V}$ قابل قبول نمیباشد.

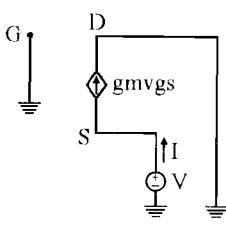
$$V_{GS} = 4 \text{ V} \Rightarrow V_G - V_S = 4 \text{ V} \Rightarrow 4 - V_O = 4 \Rightarrow V_O = 0 \text{ V}$$

به دست آوردن مقاومت دیده شده از سر سورس:

$$g_m = K (V_{GS} - V_T) = 0.5 (4 - 2) = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$I = -g_m V_{GS} = -1 \times V_{GS} = -V_{GS} = -(0 - 4) = 4 \text{ V}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{V}{\frac{V}{V}} = 1 \text{ K}\Omega$$



شکل (ب)

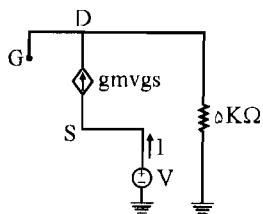
$$I_D = \frac{K}{\gamma} (V_{GS} - V_T)^{\gamma} \Rightarrow I = \frac{\partial I}{\partial (V_{GS} - V_T)} (V_{GS} - V_T)^{\gamma} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} V_{GS} = 4V \\ V_{GS} = 0V \end{cases} \Rightarrow \text{قابل قبول نمیباشد} \Rightarrow V_{GS} = 4V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 4V \Rightarrow V_G = 9 - 5I_D \quad V_s = V_O, \quad I_D = I_S$$

$$\Rightarrow 9 - 5I_D - V_O = 4 \Rightarrow 9 - 5 \times 1 - V_O = 4 \Rightarrow V_O = 0.$$

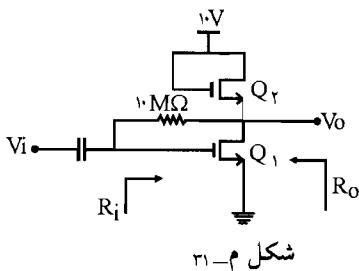
مقاومت دیده شده از سر سورس



$$g_m = K(V_{GS} - V_T) = 0.5(4 - 2) = 1 \frac{mA}{V}$$

$$I = -g_m V_{GS} = -1 \times V_{GS} = -V_{GS} \quad \begin{cases} V_g = V_d = 5I_d = 5I \\ V_S = V \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = -(5I - V) \Rightarrow 6I = V \rightarrow R = \frac{V}{I} = 6 \text{ k}\Omega$$



۳۱- در مدار شکل ۳۱، $V_{T_1} = V_{T_2} = 2V$ و $V_{T_1} = V_{T_2} = 2V$

$K_1 = 0.5 \frac{mA}{V}$ و $K_2 = 36 \frac{mA}{V}$ است. مقدار ولتاژ

خروجی (V_O) را به دست آورید. A_V و R_i و R_o را محاسبه نمایید.

(راه حل:

در دو MOSFET (Q_2, Q_1) در $V_{GD} = 0$ ، $V_{GS} < V_T$ است پس دو NMOS ناحیه اشباع میباشد چون شرط اینکه $V_{GD} < V_T$ در ناحیه اشباع باشد و $V_{GS} > V_T$ میباشد. و چون جریان مقاومت $10 M\Omega$ بسیار کم میباشد پس داریم:

$$I_{D_1} = I_{D_\gamma}$$

$$\Rightarrow \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^\gamma = \frac{K_\gamma}{\gamma} (V_{GS_\gamma} - V_{T_\gamma})^\gamma \Rightarrow \frac{36}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^\gamma = \frac{0.5}{\gamma} (V_{GS_\gamma} - V_{T_\gamma})^\gamma$$

$$\Rightarrow \sqrt[12]{(V_{GS_1} - V_{T_1})^\gamma} = (V_{GS_\gamma} - V_{T_\gamma})^\gamma \Rightarrow \pm \sqrt[12]{2} (V_{GS_1} - V_{T_1}) = (V_{GS_\gamma} - V_{T_\gamma}) \quad (A)$$

از طرفی:

$$\begin{cases} \text{KVL: } V_{DS_1} + V_{DS_\gamma} = 10 \text{ V} \\ V_{GS_\gamma} = V_{DS_\gamma} \quad (\text{II}) \\ V_{GS_1} \approx V_{DS_1} \quad (\text{III}) \end{cases}$$

چون G_2 مستقیماً به D_γ متصل شده است:

$$(\text{II}), (\text{III}) \Rightarrow (\text{I}): V_{GS_1} + V_{GS_\gamma} = 10 \Rightarrow V_{GS_\gamma} = 10 - V_{GS_1} \quad (\text{B})$$

رابطه (B) را در رابطه (A) قرار می‌دهیم:

$$V_{T_1} = V_{T_\gamma} = 2 \text{ V}$$

$$\pm \sqrt[12]{2} (V_{GS_1} - 2) = (10 - V_{GS_1} - 2) = 8 - V_{GS_1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (6\sqrt[12]{2} + 1) V_{GS_1} = 8 + 12\sqrt[12]{2} \Rightarrow V_{GS_1} = 2/63 \text{ V} \\ (+6\sqrt[12]{2} - 1) V_{GS_1} = 12\sqrt[12]{2} - 8 \Rightarrow V_{GS_1} = 1/2 \text{ V} \Rightarrow V_{GS_1} < V_{T_1} \end{cases}$$

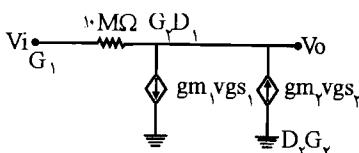
قابل قبول نمی‌باشد

$$V_{GS_\gamma} = 10 - V_{GS_1} = 10 - 2/63 = 5/37 \text{ V} \quad \text{قابل قبول می‌باشد: } V_{GS_1} = 2/63 \text{ V}$$

$$V_O = V_{DS_1} \approx V_{GS_1} = 2/63 \text{ V}$$

$$\begin{cases} g_{m_1} = \gamma \times \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1}) = 36 (2/63 - 2) = 22/6 \lambda \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ g_{m_\gamma} = \gamma \times \frac{0.5}{\gamma} (5/37 - 2) = 1/5 \lambda \frac{\text{mA}}{\text{V}} \end{cases}$$

مدار معادل به صورت زیر می‌باشد



$$\begin{cases} V_{gs_1} = V_i \\ V_{gs_\gamma} = -V_O \end{cases}$$

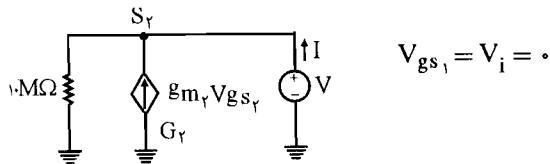
$$\frac{V_O - V_i}{10 \times 10} = g_{m_\gamma} V_{gs_\gamma} - g_{m_1} V_{gs_1}$$

$$\frac{V_O - V_i}{10^4} = (2/V \times (-V_O) - 22/6 \times V_i) \Rightarrow (V_O - V_i) = 10^4 (-2/V V_O - 22/6 V_i)$$

$$(2V + 1)V_O = -226799 V_i \Rightarrow A_V = \frac{V_O}{V_i} = -8/39$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i}{\frac{V_i - V_O}{10^4 M\Omega}} = \frac{10^4 V_i}{V_i - V_O} = \frac{10}{1 - A_V} = \frac{10}{1 + 8/39} = 1/0.6 M\Omega$$

محاسبه R_o : برای محاسبه R_o در خروجی منبع V می‌گذاریم و منبع ورودی را صفر قرار می‌دهیم.



با توجه به مدار مقابل داریم:

$$V_{g_s} = -V$$

$$I = -g_m V_{g_s} + \frac{V}{10000} \Rightarrow I = -g_m (-V) + \frac{V}{10000}$$

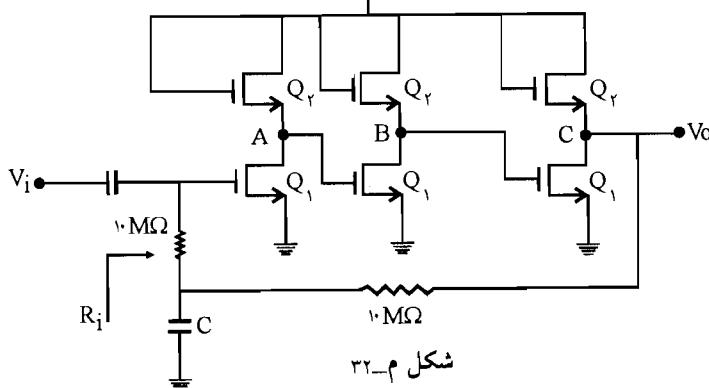
از $\frac{1}{10000}$ در مقابل $2/7$ (g_m) صرفنظر می‌کنیم پس داریم:

$$I \approx 2/V V \Rightarrow R_o = \frac{V}{I} = \frac{1}{2/V K\Omega}$$

۳۲- در مدار شکل م-۳۲، با فرض $K_1 = 4 \frac{mA}{V}$ و $K_2 = 0.5 \frac{mA}{V}$ و $V_{T_1} = V_{T_2} = 2V$ و بزرگ $C = 0$ در مدار شکل م-۳۲، با فرض $K_1 = 4 \frac{mA}{V}$ و $K_2 = 0.5 \frac{mA}{V}$ و $V_{T_1} = V_{T_2} = 2V$ و بزرگ

بودن خازن‌ها، ولتاژ DC خروجی و A_V را محاسبه نمایید. برای $C = 0$ مقاومت

ورودی مدار چقدر است؟



شکل م-۳۲

۱۵ حل:

ابتدا و MOSFET (Q₁ و Q₂) سمت چپ را در نظر می‌گیریم. داریم:

$$\begin{cases} I_{D_1} = I_{D_2}, \\ I_D = \frac{K}{\gamma} (V_{GS} - V_T)^\gamma \Rightarrow \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^\gamma = \frac{K_2}{\gamma} (V_{GS_2} - V_{T_2})^\gamma \end{cases} \quad (I)$$

جریان دو MOSFET سمت چپ می‌باشد.) (I_{D₁} و I_{D₂})

$$\begin{cases} V_{G_1} = V_O \\ V_{S_1} = 0 \end{cases} \rightarrow V_{GS_1} = V_O \quad (II) \quad , \quad \begin{cases} V_{G_2} = 10V \\ V_{S_2} = V_A \end{cases} \rightarrow V_{GS_2} = 10 - V_A \quad (III)$$

روابط (II) و (III) را در رابطه (I) قرار می‌دهیم:

$$\begin{aligned} \frac{4}{\gamma} (V_O - 2)^\gamma &= \frac{0.5}{\gamma} (10 - V_A - 2)^\gamma \Rightarrow 2(V_O - 2)^\gamma = 0.25(8 - V_A)^\gamma \\ \Rightarrow 8(V_O - 2)^\gamma &= (8 - V_A)^\gamma \end{aligned} \quad (x)$$

حال دو ستون وسط را در نظر می‌گیریم. در این دو MOSFET هم داریم:

$$\begin{cases} I_{D_1} = I_{D_2}, \\ I_D = \frac{K}{\gamma} (V_{GS} - V_T)^\gamma \Rightarrow \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^\gamma = \frac{K_2}{\gamma} (V_{GS_2} - V_{T_2})^\gamma \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{G_1} = V_A \\ V_{S_1} = 0 \end{cases} \rightarrow V_{GS_1} = V_A \quad , \quad \begin{cases} V_{G_2} = 10V \\ V_{S_2} = V_B \end{cases} \rightarrow V_{GS_2} = 10 - V_B$$

$$\frac{4}{\gamma} (V_A - 2)^\gamma = \frac{0.5}{\gamma} (10 - V_B - 2)^\gamma \Rightarrow$$

$$8(V_A - 2)^\gamma = (8 - V_B)^\gamma \quad (y)$$

حال دو سمت راست را در نظر می‌گیریم:

$$\begin{cases} I_{D_1} = I_{D_2}, \\ I_D = \frac{K}{\gamma} (V_{GS} - V_T)^\gamma \Rightarrow \frac{K_1}{\gamma} (V_{GS_1} - V_{T_1})^\gamma = \frac{K_2}{\gamma} (V_{GS_2} - V_{T_2})^\gamma \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{G_1} = V_B \\ V_{S_1} = 0 \end{cases} \rightarrow V_{GS_1} = V_B , \quad \begin{cases} V_{G_T} = 10V \\ V_{S_T} = V_C = V_O \end{cases} \rightarrow V_{GS_T} = 10 - V_C$$

با جایگذاری داریم $\frac{4}{2}(V_B - 2) = \frac{10}{2}(10 - V_O - 2) \Rightarrow$

$$4(V_B - 2) = (10 - V_O - 2) \quad (z)$$

$$(x), (y), (z) \Rightarrow \begin{cases} 4(V_O - 2) = (10 - V_A) \\ 4(V_A - 2) = (10 - V_B) \\ 4(V_B - 2) = (10 - V_O) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\sqrt{2}(V_O - 2) = (10 - V_A) & (A) \\ 2\sqrt{2}(V_A - 2) = (10 - V_B) & (B) \\ 2\sqrt{2}(V_B - 2) = (10 - V_O) & (C) \end{cases}$$

$$(B) \begin{cases} 2\sqrt{2}(V_A - 2) = (10 - V_B) \\ (C) \begin{cases} 2\sqrt{2}(V_B - 2) = (10 - V_O) \end{cases} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\sqrt{2}V_A - 4\sqrt{2} - 10 + V_B = 0 \\ 2\sqrt{2}V_B - 4\sqrt{2} - 10 + V_O = 0 \end{cases}$$

در این دو رابطه V_B را حذف می‌کنیم:

$$\begin{cases} -8V_A + 16 + 16 + 16\sqrt{2} - 2\sqrt{2}V_B = 0 \\ 2\sqrt{2}V_B - 4\sqrt{2} - 10 + V_O = 0 \end{cases} \xrightarrow{\oplus} -8V_A + 16 + 12\sqrt{2} + V_O = 0 \quad (D)$$

$$(D) \begin{cases} -8V_A + 16 + 12\sqrt{2} + V_O = 0 \\ 2\sqrt{2}V_O - 4\sqrt{2} - 10 + V_A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -8V_A + 16 + 12\sqrt{2} + V_O = 0 \\ 16\sqrt{2}V_O - 32\sqrt{2} - 64 + 8V_A = 0 \end{cases}$$

$$16\sqrt{2} + 1)(V_O - 20\sqrt{2} - 56 = 0 \Rightarrow V_O = 3/6 V$$

$$(A); V_A = 3/6 V$$

$$(B); 2\sqrt{2}(3/6 - 2) = (10 - V_B) \Rightarrow V_B = 3/6 V$$

با اعداد به دست آمده مشخص می‌شود که Q_1 و Q_2 ها در حالت اشباع قرار دارند و در همه آنها از V_{GS}

بزرگتر می‌باشد.

در دو سمت MOSFET:

$$\begin{cases} g_{m_1} = \frac{K}{V} (V_{GS_1} - V_{T_1}) \Rightarrow g_{m_1} = \frac{4}{4} (V_O - 2) = \frac{4}{4} (\frac{3}{6} - 2) = 6/4 \frac{mA}{V} \\ g_{m_r} = \frac{0.5}{V} (10 - V_A - 2) = 0.5 (8 - \frac{3}{6}) = 2/2 \frac{mA}{V} \end{cases}$$

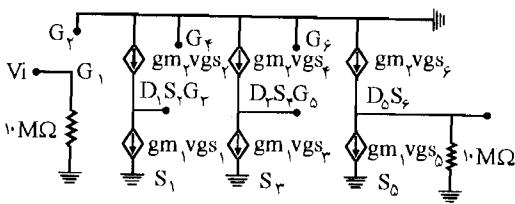
در دو ستون وسط:

$$\begin{cases} g_{m_1} = \frac{4}{4} (V_A - 2) = \frac{4}{4} (\frac{3}{6} - 2) = 6/4 \frac{mA}{V} \\ g_{m_r} = 0.5 (10 - V_B - 2) = 0.5 (8 - \frac{3}{6}) = 2/2 \frac{mA}{V} \end{cases}$$

در دو سمت راست:

$$\begin{cases} g_{m_1} = \frac{4}{4} (V_B - 2) = \frac{4}{4} (\frac{3}{6} - 2) = 6/4 \frac{mA}{V} \\ g_{m_r} = 0.5 (10 - V_C - 2) = 0.5 (8 - \frac{3}{6}) = 2/2 \frac{mA}{V} \end{cases}$$

مدار معادل:



در این مدار داریم:

$$V_O = (g_{m_r} V_{gs_r} - g_{m_1} V_{gs_1}) \times 10 M\Omega \times 10^{-3}$$

با توجه به مدار داریم:

$$g_{m_r} V_{gs_r} = g_{m_1} V_{gs_1}$$

$$\Rightarrow 2/2 (0 - V_{S_r}) = 6/4 (V_i - 0) \Rightarrow V_{S_r} = -\frac{6/4 V_i}{2/2} = -\frac{32}{11} V_i$$

با توجه به مدار داریم:

$$g_{m_r} V_{gs_r} = g_{m_1} V_{gs_1} \Rightarrow 2/2 (0 - V_{S_r}) = 6/4 (V_{G_r} - 0)$$

$$V_{G_r} = V_{S_r}$$

$$\Rightarrow 2/2 (0 - V_{S_r}) = 6/4 (V_{S_r} - 0) \Rightarrow V_{S_r} = \frac{-6/4}{2/2} V_{S_r} = \left(\frac{32}{11}\right)^2 V_i$$

در رابطه V_O داريم:

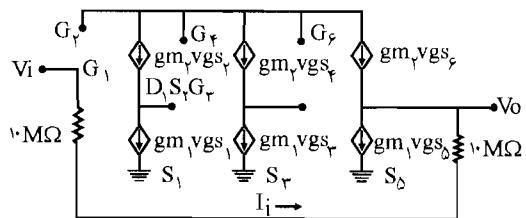
$$V_O = (\frac{1}{2}(0 - V_O) - \frac{6}{4}(V_{S_T} - 0)) \times 10^4$$

$$\Rightarrow V_O = -\frac{1}{2}V_O \times 10^4 - \frac{6}{4}V_{S_T} \times 10^4 = -\frac{1}{2} \times 10^4 V_O - \frac{6}{4} \times 10^4 \times \left(\frac{32}{11}\right)^2 V_i$$

$$\Rightarrow A_V = \frac{V_O}{V_i} = -24/6$$

$$R_i = 10 M\Omega$$

$$C = 0 \Rightarrow$$



در اين مدار معادل داريم:

$$I_i = g_{m_1} V_{gs_3} - g_{m_2} V_{gs_4} \quad (I)$$

$$V_{gs_3} = V_{S_T} = \left(\frac{32}{11}\right)^2 V_i \quad , \quad V_{S_T} = \frac{-32}{11} V_i$$

$$\text{KVL: } I_i = \frac{V_i - V_{S_T}}{(10 + 10) \times 10^4} \Rightarrow V_{S_T} = -2 \times 10^4 I_i + V_i$$

اين رابطه را در رابطه (I) قرار مى دهيم:

$$I_i = g_{m_1} V_{gs_3} - g_{m_2} V_{gs_4} = \frac{6}{4} (V_{gs_3} - V_{S_T}) - \frac{1}{2} (V_{gs_3} - V_{gs_4})$$

$$\Rightarrow I_i = \frac{6}{4} \left(\left(\frac{32}{11}\right)^2 V_i - 0 \right) - \frac{1}{2} (0 + 2 \times 10^4 I_i - V_i)$$

$$\Rightarrow I_i = \frac{6}{4} \times \frac{1}{4} \times 6 V_i - \frac{1}{4} \times 10^4 I_i + \frac{1}{2} V_i$$

$$\Rightarrow R_i = \frac{V_i}{I_i} = 1000/4 K\Omega$$

